上海市锦天城律师事务所

关于

Semiconductor Manufacturing International Corporation

（中芯国际集成电路制造有限公司）

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的

律师工作报告

锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000　　传真：021-20511999　　邮编：200120

目录

声明事项 2

引 言 5

一、 律师事务所简介 5
二、 签字律师简介 5
三、 律师工作报告、法律意见书的制作过程 6

释 义 9

正 文 15

一、 本次发行上市的批准和授权 15
二、 发行人本次发行上市的主体资格 19
三、 发行人本次发行上市的实质条件 20
四、 发行人的设立 25
五、 发行人的独立性 25
六、 股东及实际控制人 27
七、 发行人的股本（份）及其演变 30
八、 发行人的业务 36
九、 关联（连）交易及同业竞争 41
十、 发行人的主要财产 61
十一、 发行人的重大债权债务 79
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 81
十三、 发行人公司章程的制定与修改 82
十四、 发行人公司治理制度的建立健全及规范运作 83
十五、 发行人董事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 85
十六、 发行人及其境内子公司的税务 88
十七、 发行人及其境内子公司的环境保护和产品质量、技术等标准 92
十八、 发行人募集资金的运用 95
十九、 发行人的业务发展目标 97
二十、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 98
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 100
二十二、 结论意见 100

附表一： 主要专利权 ..... 错误!未定义书签。

附表二： 主要商标权 ..... 错误!未定义书签。

附表三： 集成电路布图设计专有权 ..... 错误!未定义书签。

附表四： 发行人的其他子公司及参股公司 965

上海市锦天城律师事务所
关于
Semiconductor Manufacturing International Corporation
（中芯国际集成电路制造有限公司）
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的
律师工作报告

案号：01F20183054

致：Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受 Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）（以下简称“发行人”或“公司”或“中芯国际”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务委托协议》，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国务院办公厅转发证监会<关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见>的通知》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》等有关中国法律法规的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本律师工作报告。

声明事项

一、 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则 12 号》”）等规定及本律师工作报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本律师工

作报告所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、 本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关的中国境内法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项和境外法律事项发表专业意见。在本律师工作报告和为本次发行上市出具的《上海市锦天城律师事务所关于 Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、内部控制报告及境外法律意见书或报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。本所律师并不具备核查和评价该等非中国境内法律专业的事项的适当资格。

三、 本律师工作报告中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的中国法律法规为依据。

四、 本律师工作报告的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本律师工作报告和《法律意见书》所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。

五、 对于本律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、 本所同意将本律师工作报告和《法律意见书》作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、 本所同意发行人在《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按上海证券交易所审核要求引用本律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、 本律师工作报告仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关中国法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

引 言

一、 律师事务所简介

上海市锦天城律师事务所于 1999 年 4 月设立，总部位于上海，注册地为上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，目前在中国大陆二十一个城市（北京、深圳、杭州、苏州、南京、成都、重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春、武汉、乌鲁木齐）及中国香港、英国伦敦开设分所，并与香港史蒂文生黄律师事务所联营，与英国鸿鹄律师事务所（Bird&Brid LLP）建立战略合作关系。

本所主要提供直接投资、证券期货、金融银行、公司并购重组、知识产权及技术转让、房地产、税收及劳动关系相关的诉讼及非诉讼业务，具有中国司法部、上海市司法局等政府机关颁发的专业资质证书，是一家能够为广大客户提供全方位法律服务的综合性律师事务所。

二、 签字律师简介

本所指派鲍方舟律师、王立律师、沈诚律师、杨继伟律师担任本次发行上市《法律意见书》和本律师工作报告的签字律师。

鲍方舟律师为本所高级合伙人，目前为本所证券业务内核委员，主要执业领域为证券业务，包括首次公开发行上市、上市公司重大资产重组和再融资、国企混改等业务。鲍方舟律师曾为上海国际机场股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、万达信息股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、曲美家居集团股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司等企业提供过证券法律服务，最近 3 年连续从事证券法律业务。

王立律师为本所高级合伙人，目前为本所证券业务内核委员，主要执业领域为证券业务，包括首次公开发行上市、上市公司重大资产重组和再融资、资产证券化等业务。王立律师近期曾为京东数字科技控股有限公司、中国投融资担保股份有限公司、湖北楚天交通智能股份有限公司、重庆新大正物业集团股份有限公

司、江苏润邦重工股份有限公司、格尔软件股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司等企业的证券项目提供过法律服务，最近 3 年连续从事证券法律业务。

沈诚律师为本所合伙人，目前为本所证券业务内核委员，主要执业领域为证券业务，包括首次公开发行上市、上市公司重大资产重组和再融资等业务。沈诚律师近期曾为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、建科机械（天津）股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、复星旅游文化集团、曲美家居集团股份有限公司、上海电气集团股份有限公司等企业的证券项目提供过法律服务，最近 3 年连续从事证券法律业务。

杨继伟律师为本所合伙人，目前为本所证券业务内核委员，主要执业领域为证券、私募等投融资法律业务，包括首次公开发行上市、上市公司重大资产重组和再融资、公司债和资产证券化等业务。杨继伟律师近期曾为京东数字科技控股有限公司、中国投融资担保股份有限公司、湖北楚天交通智能股份有限公司、重庆新大正物业集团股份有限公司等企业的证券项目提供过法律服务，最近 3 年连续从事证券法律业务。

签字律师的联系方式为：

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层，邮政编码：200120，电话：021-20511000，传真：021-20511999。

三、 律师工作报告、法律意见书的制作过程

接受发行人委托后，由签字律师及本所其他若干律师、律师助理组成的项目工作组即全程参与了本次发行上市的各项法律工作。本所律师制作《法律意见书》和本律师工作报告的工作过程主要如下：

1、 初步沟通及编制查验计划。本所律师首先与发行人本次发行上市工作组成员进行沟通，全面了解发行人的基本情况、股权关系、组织架构、主要资产、重大债权债务、诉讼仲裁等。在此基础上，本所依据《证券法律业务执业规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验工作程序和查验方法，查验事项涵盖了出具《法律意见书》和本律师工作报告所需调查的各方面情况，并就需书面审查的事项向发行人提交了法律

尽职调查文件清单。在法律尽职调查文件清单提交后，本所律师向发行人对接人员说明了法律尽职调查的要求和责任，并就其在资料搜集过程中提出的相关问题进行了答复。

2、 落实查验计划。为全面落实查验计划，本所项目工作组成员分工收集相关支持性文件和资料，遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了书面审查、实地调查、与有关人员面谈、向国家机关查证、查询公开信息等方式进行查验，对发行人提供的文件材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。在查验过程中，项目工作组成员不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向发行人提交补充尽职调查文件清单。针对尽职调查工作中发现的问题，本所通过邮件和其他形式，及时向发行人提出了相应的建议和要求，督促与协助发行人依法予以解决。

3、 指导发行人规范运作。在落实查验计划过程中，本所律师对发行人是否依法经营和规范运作进行了全面核实，并参照上市公司相关治理标准，对发行人进一步完善公司治理，加强规范运营提出相关建议，参与了发行人规范运作的辅导工作。

4、 制作工作底稿。本所已经将《法律服务委托协议》、查验计划、实施查验计划中收集到的重要文件资料（包括工商档案文件、公司存档文件、国家机关出具的批文、证照、证明文件、其他中介机构出具的专业报告、有关方出具的说明函和确认函等）、拍摄的实地照片、制作的会议纪要、访谈笔录、网上查询结果截屏、《法律意见书》和本律师工作报告草稿等归类成册，制作成工作底稿。

5、 律师工作报告和法律意见书的起草、内核与出具。本所律师按照《证券法》《科创板首发管理办法》和《编报规则 12 号》等有关中国法律法规的规定要求，根据发行人的情况，对完成的查验工作进行归纳总结，拟定《法律意见书》和本律师工作报告。此后，本所律师将本律师工作报告和《法律意见书》提交本所证券业务内核委员会进行审核，并对内核委员提出的问题进行了回复并相应更新了本律师工作报告和《法律意见书》。本所证券业务内核委员审核通过后，本所向发行人正式提交了本律师工作报告和《法律意见书》。截至本律师工作报告出具之日，本所律师就本次发行上市项目投入的工作时间已累计超过 288 个工作日。

释 义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

中芯国际、发行人、公司	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）
大唐香港	指	Datang Holdings (Hongkong) Investment Company Limited （大唐控股〔香港〕投资有限公司）
鑫芯香港	指	Xinxin (Hongkong) Capital Company Limited （鑫芯〔香港〕投资有限公司）
Lightmane Holdings	指	Lightmane Holdings Company Limited
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
大基金一期	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
紫光集团附属公司	指	为本律师工作报告之目的，特指紫光集团国际有限公司、紫光科技战略投资有限公司、紫光科技投资（香港）有限公司
中芯集电	指	中芯集电投资（上海）有限公司
中芯控股	指	中芯国际控股有限公司
中芯上海	指	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
中芯天津	指	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司
中芯北京	指	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司
中芯深圳	指	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司
中芯长电	指	中芯长电半导体（江阴）有限公司
中芯南方	指	中芯南方集成电路制造有限公司
中芯北方	指	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司
中芯新技术	指	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司
上海合芯	指	上海合芯投资管理合伙企业（有限合伙）
成都开发	指	中芯国际开发管理（成都）有限公司
北京创新	指	北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司
中芯晶圆	指	中芯晶圆股权投资（上海）有限公司
中芯晶圆宁波	指	中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司
宁波设计	指	芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司，曾用名中芯国际创新设计服务中心（宁波）有限公司
芯电上海	指	芯电半导体（上海）有限公司
中芯能源	指	中芯能源科技（上海）有限公司
中芯聚源	指	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司
中芯宁波	指	中芯集成电路（宁波）有限公司
中芯绍兴	指	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
中芯协成	指	中芯协成投资（北京）有限责任公司
灿芯半导体	指	灿芯半导体（上海）有限公司

华芯创投	指	上海华芯创业投资企业
上海创新	指	上海集成电路制造创新中心有限公司
盛吉盛	指	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司
凸版彩晶	指	凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司
芯鑫租赁	指	芯鑫融资租赁有限责任公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
Better Way	指	Better Way Enterprises Limited（柏途企业有限公司）
SMIC Europe	指	SMIC EUROPE S.r.l.
SMIC Japan	指	SMIC Japan Company limited
SMIC Americas	指	SMIC, Americas
LFoundry	指	LFoundry S.r.l.
Solar Cell HK	指	SMIC Solar Cell (HK) Company Limited（中芯国际太阳能光伏〔香港〕有限公司）
SJ CA	指	SJ Semiconductor Corporation
SJ USA	指	Sj Semiconductor (USA) Co.
SJ HK	指	SJ Semiconductor (HK) Limited（中芯长电半导体〔香港〕有限公司）
BJ HK	指	SMIC Beijing (HK) Company Limited（中芯国际北京〔香港〕有限公司）
SZ HK	指	SMIC Shenzhen (HK) Company Limited（中芯国际深圳〔香港〕有限公司）
TJ HK	指	SMIC Tianjin (HK) Company Limited（中芯国际天津〔香港〕有限公司）
Solar Cell	指	Semiconductor Manufacturing International (Solar Cell) Corporation
BJ Cayman	指	SMIC Beijing (Cayman) Corporation
SZ Cayman	指	SMIC Shenzhen (Cayman) Corporation
TJ Cayman	指	SMIC Tianjin (Cayman) Corporation
SilTech Cayman	指	SilTech Semiconductor Corporation
SilTech HK	指	SilTech Semiconductor (Hong Kong) Corporation Limited（芯电半导体〔香港〕有限公司）
SH Cayman	指	SMIC Shanghai (Cayman) Corporation
SMIC BVI	指	Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation
Magnificent	指	Magnificent Tower Limited
CFT Nordic	指	CFT Nordic Investment Center Limited
SMIC HK	指	SMIC Hong Kong International Limited（中芯国际香港〔国际〕有限公司）
深圳深超	指	深圳市深超科技投资有限公司
沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司
子公司	指	发行人合并财务报表范围内的全资、控股子公司，为本律师工作

		报告之目的，此处包括发行人合并财务报表范围内的合伙企业
关联（连）方	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《国际财务报告准则》中定义的关联方及关连方
关联（连）关系	指	《科创板上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《香港上市规则》中定义的关联关系及关连关系
关连方	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中定义的关连方
保荐人、保荐机构、联席保荐人、联席保荐机构	指	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
承销商	指	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
审计机构、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
本所/锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
本所律师	指	本所为发行人本次发行上市指派的经办律师
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
《公司章程》	指	发行人制定及不时修订的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》
《公司章程（A 股上市后适用稿）》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》
《股东大会议事规则》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事会议事规则》
《审计委员会章程》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）审计委员会章程》
《提名委员会章程》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）提名委员会章程》
《薪酬委员会章程》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）薪酬

		委员会章程》
《战略委员会章程》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）战略委员会章程》
《对外投资管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）对外担保管理制度》
《关联（连）交易管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关联（连）交易管理制度》
《信息披露境内代表工作细则》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）信息披露境内代表工作细则》
《投资者关系管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）投资者关系管理制度》
《信息披露事务管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）信息披露事务管理制度》
《募集资金管理制度》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）募集资金管理制度》
《内部审计章程》	指	发行人本次发行上市后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）内部审计章程》
《审计报告》	指	审计机构出具的普华永道中天审字[2020]第 11026 号《中芯国际集成电路制造有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表及审计报告》
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度
A 股、人民币股份	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股
港股	指	在香港联交所上市的以港币认购和进行交易的普通股股票
特别授权	指	发行人于股东特别大会上寻求股东授出的特别授权，以根据本次发行配发及发行人民币股份
《内部控制报告》	指	审计机构出具的普华永道中天特审字[2020]第 2456 号《中芯国际集成电路制造有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》
《招股说明书（申报	指	发行人向上海证券交易所申报的首次公开发行人民币普通股（A

稿）》		股）股票申请文件中所纳入的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《开曼群岛法律意见书》	指	开曼群岛律师事务所Conyers Dill & Pearman为发行人本次发行上市事宜于 2020 年 6 月 1 日出具的法律意见书
《香港法律意见书》	指	Slaughter and May（香港司力达律师楼）为发行人本次发行上市事宜于 2020 年 6 月 1 日出具的法律意见书及 DLA Piper Hong Kong（香港欧华律师事务所）就发行人遵守《香港上市规则》事宜于 2020 年 6 月 1 日出具的法律意见书
《美国 ADS 法律意见书》	指	美国律师就发行人 ADS 从美国纽交所退市事宜出具的法律意见书
《大唐香港法律意见书》	指	香港秦觉忠律师行出具的《关于大唐控股（香港）投资有限公司的香港法律意见书》
《鑫芯香港法律意见书》	指	方达（香港）律师事务所出具的《Hong Kong legal opinion on Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited》
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
商标局	指	中华人民共和国国家知识产权局商标局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
上交所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
美国纽交所	指	New York Stock Exchange, Inc.（纽约证券交易所有限公司）
ADS	指	American Depositary Shares（美国预托证券股份）
美国证交会	指	The U.S. Securities and Exchange Commission（美国证券交易委员会）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《若干意见》	指	《国务院办公厅转发证监会<关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见>的通知》
《实施办法》	指	《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》
《外汇管理条例》	指	《中华人民共和国外汇管理条例》

《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号，自 2008 年 1 月 1 日起生效）
财税[2008]第 1 号通知	指	《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]第 1 号）
财税[2016]49 号通知	指	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号)
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，包括其附录
《1934 年证券交易法》	指	《Securities Exchange Act of 1934》
《开曼群岛公司法》	指	《Cayman Islands Companies Law》
BVI	指	British Virgin Islands
开曼群岛	指	Cayman Islands
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
美国	指	United States of America
中国	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）；为本律师工作报告之目的，特指中国大陆地区
境内	指	中国大陆地区
境外	指	中国大陆地区以外的国家及地区
中国法律法规	指	提及当时公布并生效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性法律文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 http://www.gsxt.gov.cn/
元	指	人民币元，上下文另有说明的除外
本律师工作报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成		

正 文

一、 本次发行上市的批准和授权

（一） 发行人董事会、股东大会对本次发行上市的批准情况

经本所律师查验发行人董事会会议、二零二零年第二次股东特别大会会议文件资料，发行人为本次发行上市所取得的批准如下：

1、 2020 年 4 月 30 日，发行人召开董事会会议，形成了包括但不限于批准发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上交所科创板上市、批准授权董事会全权办理发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上交所科创板上市相关事宜、批准首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市募集资金用途等与本次发行上市有关的决议案，并同意将与本次发行上市相关的议案提交股东大会批准。

2、 发行人于 2020 年 6 月 1 日召开了二零二零年第二次股东特别大会，审议批准了与本次发行上市有关的议案，本次发行方案主要内容如下：

（1） 人民币股份的性质：由目标认购人（如下文所述）以人民币认购并将于科创板上市及以人民币进行买卖的普通股份，属与港股相同的普通股类别。

（2） 人民币股份的面值：每股 0.004 美元（与港股的面值相同）。

（3） 将予发行的人民币股份数目：建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过 1,685,620,000 股股份，占不超过二零一九年十二月三十一日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的 25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目 15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份，并不涉及现有股份的转换。

（4） 目标认购人：符合资格的网下投资者及已于上交所开立账户的自然人、法人、其他机构投资者（中国法律、法规及监管文件禁止购买者除外）或符合中国证监会相关资格规定的其他目标认购人。

倘任何上述本次发行的目标认购人为发行人的关连人士，发行人将采取合理措施以遵守相关监管部门的要求。

（5） 发行方式：发行人将采取网下配售及网上认购结合的方式，或中国相关证券监管机构批准的其他发行方式。

（6） 定价方式：股东于股东特别大会将授权董事会与发行人的承销商通过(i)向潜在投资者推广及初步询价确定价格区间；及(ii)按照中国相关法律法规以及相关证券监管机构的规定确定发售价。

为确保发售价符合发行人及股东的整体利益，董事会及发行人承销商于确定发售价时会参考以下因素：(i)发行人的运营及财务状况；(ii)半导体行业于二级市场的平均市盈率；(iii)港股于香港联交所的买卖价；(iv)中国股市的市况，及；(v)适用的法律及法规。

倘发售价低于港股的买卖价，董事会于考虑市况、发行人届时的实际资金需要及发展策略、可比公司于二级市场的买卖价以及其他相关因素后决定是否继续进行本次发行。

（7） 联席保荐人及承销商：海通证券及中金公司。

（8） 承销主要条款：承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

（9） 募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行的募集资金计划用于“12英寸芯片 SN1 项目”、发行人先进及成熟工艺研发项目储备资金，以及补充流动资金。

倘本次发行募集的实际资金超过上述项目所需的投资总额，发行人将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于发行人主营业务。倘本次发行募集的资金不足，发行人将通过自筹资金解决资金缺口。

因承销商行使超额配股权而发行的人民币股份所筹集得的任何募集资金将用于发行人附属公司的集成电路生产线建设及适用法律、法规及证券监管部门允许的其他用途。

本次发行的募集资金到位前，发行人可以根据有关项目的进展情况使用自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后，发行人将使用有关募集资金置换前期投入的资金，然后用于支付项目的剩余投资款项。

（10） 发行前的滚存利润分配计划：于本次发行完成后，发行人于本次发行前形成的滚存未分配利润将按全体股东（包括人民币股份持有人及港股持有人）的各自持股比例分派予彼等。

（11） 人民币股份上市地点：科创板。

（12） 决议案的有效期：自本次发行的特别授权于发行人二零二零年第二次股东特别大会获批准之日起十二个月内有效。

根据《开曼群岛法律意见书》《香港法律意见书》，发行人上述董事会、股东大会的决议已根据《公司章程》得到有效通过，未违反开曼群岛法律的规定；发行人的上述董事会、股东大会会议召集召开的程序、应受《香港上市规则》监管的相关事项的决议内容及相关授权未违反《香港上市规则》有关董事会日期的通知要求以及附录十四《企业管治守则》的守则条文要求。

（二） 发行人就本次发行上市事宜对董事会的授权情况

根据发行人二零二零年第二次股东特别大会审议通过的《有关授权董事会全权办理与人民币股份发行有关的事宜之决议案》，发行人股东特别大会授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜，授权范围包括但不限于以下事项：

1、 根据发行人二零二零年第二次股东特别大会批准的原则及按照证券监管部门的相关要求，并依据发行人的实际情况，与承销商协商确定并实施本次发行的有关具体方案，包括但不限于：发行规模、超额配股权的具体实施方案、可能涉及的战略配售（包括配售比例及配售对象）、定价方式、发行方式、承销方式、发行时间、目标认购人及发行人的重大承诺事项等；除依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定必须于股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整（包括暂停及终止发行方案的实施）；

2、 办理与本次发行相关的申请事宜，包括但不限于办理登记、备案或取得有关政府部门、本地及海外监管机构、上交所及中国证券登记结算有限公司之批准或同意；

3、 草拟、修改、补充、签署、递交、刊发、披露、执行、暂停及终止与本次发行有关的协议、合同、公告、通函或其他文件（包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议及中介组织的服务合同等）；委聘及变更保荐人、

承销商、律师事务所、会计师事务所及其他参与本次发行的中介机构等；以及厘定及支付本次发行相关的费用等；

4、 根据与本次发行的申请及审批过程中相关境内外监管机构的意见以及发行人的实际情况，对募集资金将予投资的项目及募集资金用途进行调整，包括但不限于行使超额配股权的募集资金的具体用途、募集资金投资相关项目的进度及比例的调整，以及签署有关该等项目的重大协议或合同等；

5、 根据相关法律及法规以及监管部门的要求，分析、研究、论证本次发行对发行人即期财务指标及股东即期回报等影响；修改、完善并落实相关的措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

6、 根据需要于本次发行前确定募集资金专用账户，并签立相关文件；

7、 根据本次发行情况相应修改或修订《公司章程》及其他内部管理政策的相关条款（如涉及）；

8、 于本次发行后，根据股东的承诺在中国证券登记结算有限公司办理股份登记及结算相关事宜，包括但不限于股票托管登记等事宜；

9、 倘相关证券监管部门就与本次发行相关的法规或政策颁布新规定，则根据该等新规定对本次发行与相关事项做出相应调整；及

10、 办理与本次发行相关的其他事宜，并授权再转授权力予董事长、联合首席执行官之一或联席公司秘书之一单独或共同处理与本次发行有关的事项。

本项授权自发行人二零二零年第二次股东特别大会审议通过之日起生效，有效期为十二个月。

根据《开曼群岛法律意见书》《香港法律意见书》，发行人上述股东大会的决议已根据《公司章程》得到有效通过，未违反开曼群岛法律的规定；发行人的上述股东大会会议召集召开的程序、应受《香港上市规则》监管的相关事项的决议内容及相关授权未违反《香港上市规则》有关董事会日期的通知要求以及附录十四《企业管治守则》的守则条文要求。

（三） 发行人就本次发行上市向香港联交所申请豁免的情况

香港联交所于 2020 年 4 月 29 日就发行人本次发行上市出具了一份豁免函。根据前述豁免函，香港联交所对发行人本次发行上市无异议，针对本次发行上市，香港联交所同意豁免发行人根据《香港上市规则》相关规定申请本次拟发行的 A 股在香港联交所上市，此外，香港联交所明确了发行人在完成本次发行上市后《香港上市规则》有关条款的适用性。

根据《香港法律意见书》，发行人向香港联交所提交的与本次发行上市有关的豁免申请已得到香港联交所的批准。

（四） 发行人本次发行上市尚待上交所审核，发行人本次发行注册尚待中国证监会同意

综上所述，本所律师认为，发行人就本次发行上市已获得发行人董事会及股东大会的有效批准与授权；香港联交所已豁免发行人本次发行的 A 股股票在香港联交所上市；发行人本次发行上市尚待上交所审核及中国证监会同意注册。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据《开曼群岛法律意见书》及发行人提供的主体资格资料，并经本所律师查验，发行人为依据《开曼群岛公司法》适当设立且存续的有限公司，截至报告期末，其基本情况如下：

英文名称	Semiconductor Manufacturing International Corporation
中文名称	中芯国际集成电路制造有限公司
法定股本总额	42,000,000.00 美元
法定股份总数	10,500,000,000 股（包括：10,000,000,000 股普通股、500,000,000 股优先股）
已发行股份总数	5,056,868,912 股（普通股）
成立日期	2000 年 04 月 03 日
注册地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
主要生产经营地址	中国上海市浦东新区张江路 18 号
目前在其他交易场所上市的情况	981（香港联交所）

如本律师工作报告正文第三部分“发行人本次发行上市的实质条件”所述，本所律师认为，发行人具备《若干意见》《科创板首发管理办法》《科创板上市规则》中有关发行人本次发行上市的主体资格。

综上所述，本所律师认为，发行人为依据《开曼群岛公司法》适当设立且存续的有限公司，其发行的普通股股票目前在香港联交所上市，其主要经营活动在境内，属于《若干意见》《科创板上市规则》和《实施办法》项下已境外上市的红筹企业，具备本次发行上市的主体资格。

三、 发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《证券法》《科创板首发管理办法》《若干意见》《实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》《科创板上市规则》等中国法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的相关实质条件：

（一） 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的公开发行股票的条件

1、 根据发行人提供的资料并经本所律师查验，发行人已经根据《开曼群岛公司法》《香港上市规则》等适用法律法规建立了股东大会、董事会、董事会下属专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会）、内部审计部门等内部机构，选举了董事（包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事）、各董事会下属专门委员会委员，并聘请了联合首席执行官、首席财务官、执行副总裁等高级管理人员，并制定了相关内部控制制度。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、 根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人的确认并经本所律师查验，发行人具有持续经营能力。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、 根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、 经本所律师查验，发行人无控股股东及实际控制人；发行人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、 经本所律师查验，发行人已经聘请海通证券、中金公司担任本次发行上市的联席保荐机构。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十条第一款的规定。

（二） 发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、 根据发行人提供的资料以及《开曼群岛法律意见书》并经本所律师查验，发行人为依据《开曼群岛公司法》适当设立且存续的有限公司，发行人自成立至今持续经营时间在三年以上；发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十条的规定。

2、 根据《审计报告》、发行人的说明并经本所律师查验，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由审计机构出具了无保留意见的审计报告。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款的规定。

3、 根据《内部控制报告》、发行人的说明并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由审计机构出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款的规定。

4、 经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立（详见本律师工作报告正文第五部分“发行人的独立性”），发行人无控股股东及实际控制人，主要股东及其控制的企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联（连）交易（详见本律师工作报告正文第九部分“关联（连）交易及同业竞争”之“（二）关联（连）交易”）。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款的规定。

5、 经本所律师查验，发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大变化（详见本律师工作报告正文第八部分“发行人的业务”之“（三）发行人主营业务的变更情况”、本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”之“（二）发行人最近两年董事和高级管理人员的变化”和“（四）发行人的核心技术人员”）。经本所律师查验，发行人无控股股东及实际控制人，该等情况最近 2 年内没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷（详见本律师工作报告正文第六部分“股东及实际控制人”之“（二）发行人的实际控制人”）。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第二款的规定。

6、 经本所律师查验，发行人不存在可能对本次发行上市构成实质性法律障碍的主要资产、核心技术、商标权等的重大权属纠纷（详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”），发行人不存在重大偿债风险、重大担保等或有事项、可能对本次发行上市构成实质性法律障碍的诉讼、仲裁（详见本律师工作报告正文第十一部分“发行人的重大债权债务”、本律师工作报告正文第二十部分“重大诉讼、仲裁或行政处罚”）。根据《招股说明书（申报稿）》并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响的情形，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》中披露了相关风险因素。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第三款的规定。

7、 根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务系为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务，发行人主营业务属于《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》规定的鼓励类产业范围，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》给予特别管理措施的行业，因此发行人符合国家有关外商投资企业产业政策的规定。经本所律师比对中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布之《产业

结构调整指导目录（2019 年本）》及原中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2017 年版）》，发行人现有经营业务不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款的规定。

8、 经本所律师查验，发行人无控股股东及实际控制人；最近 3 年内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款的规定。

9、 经本所律师查验，发行人作为依据《开曼群岛公司法》设立的有限公司，未设置监事；发行人董事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款的规定。

（三） 发行人本次发行上市符合《若干意见》《实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》以及《科创板上市规则》规定的条件

1、 如本律师工作报告前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件。

本所律师认为，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、 根据《公司章程》《开曼群岛法律意见书》以及《审计报告》并经本所律师查验，本次发行后发行人的股本总额不低于人民币 3,000 万元。

本所律师认为，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、 根据发行人本次发行上市的相关方案并经本所律师查验，发行人本次初始发行的 A 股数量不超过 168,562.00 万股，不超过初始发行后股份总数的 25.00%

（行使超额配售选择权之前），此外发行人已公开发行的普通股股票目前均在香港联交所上市。

本所律师认为，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、 根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》并经本所律师查验，发行人是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于软件和集成电路行业的高新技术产业和战略性新兴产业，达到相当规模，社会形象良好，具有稳定的商业模式和盈利模式，对经济社会发展有突出贡献，能够引领实体经济转型升级的创新企业。

本所律师认为，发行人符合《若干意见》关于试点企业的市场定位、所属行业、业务规模等条件以及《实施办法》第六条的规定。

5、 本次发行上市选择的市值指标为“市值 200 亿元以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。”根据《招股说明书（申报稿）》，发行人属于拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位且已在香港联交所上市的红筹企业，发行人市值超过 200 亿元。

本所律师认为，发行人符合《若干意见》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》关于已境外上市红筹企业在境内发行股票涉及的市值要求以及《科创板上市规则》第 2.1.3 条第一款的规定。

6、 如本律师工作报告正文第十四部分“发行人公司治理制度的建立健全及规范运作”之“（四）发行人本次发行上市对境内投资者权益保护水平总体上不低于中国境内法律法规规定的要求”所述，发行人关于境内投资者权益保护的总体安排不低于中国法律法规及中国证监会的要求。

本所律师认为，发行人符合《若干意见》关于试点红筹企业关于投资者权益保护的要求、《实施办法》第十三条以及《科创板上市规则》第 13.1.3 款的规定。

7、 如本律师工作报告前文所述，发行人符合《证券法》《若干意见》《科创板上市规则》规定的在境内首次公开发行 A 股股票的条件。

本所律师认为，发行人符合《实施办法》第十条第一款的规定。

综上所述，本所律师认为，本次发行上市符合《证券法》《科创板首发管理办法》《若干意见》《实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》《科创板上市规则》等中国法律法规规定的实质条件。

四、 发行人的设立

根据 Registrar of Companies（开曼群岛公司注册处）签发的 Certificate of Incorporation（《设立证书》）及《开曼群岛法律意见书》，发行人是根据《开曼群岛公司法》于 2000 年 4 月 3 日在开曼群岛注册成立的有限公司。

发行人于 2000 年 5 月通过董事决议，对外发行 10,000 股普通股，由 RU-GIN RICHARD CHANG（张汝京）持有。

据此，根据《开曼群岛法律意见书》，发行人系依照《开曼群岛公司法》适当设立且存续的有限公司。

五、 发行人的独立性

发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

（一） 发行人的资产完整情况

根据发行人提供的组织架构图、不动产权证、商标注册证、专利证书、集成电路布图设计登记证书等材料及发行人的确认，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人拥有开展业务所需的完整的资质、资产和配套设施，合法拥有经营所需的土地、房产、设备、商标权、专利权、集成电路布图设计专有权等的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。发行人资产完整，具备与经营有关的业务体系及相关资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害发行人利益的情况。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人的资产完整。

（二） 发行人的人员独立情况

根据发行人的确认及发行人高级管理人员的任职文件、所填写的调查表等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人建立了健全的法人治理结构，董事、高级管理人员严格按照《公司章程》等的相关规章制度选举产生。发行人不存在其高级管理人员在发行人第一大股东及其控制的企业处担任除董事、监事以外的其他职务并领取薪酬的情形，且不存在发行人的财务人员在发行人第一大股东及其控制的企业中兼职的情形。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人在人员方面具有独立性。

（三） 发行人的财务独立情况

根据《审计报告》《内部控制报告》等材料，并经发行人的确认及经本所律师查验，截至报告期末，发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系，制订了内部财务管理制度并建立了对下属公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。发行人及其子公司拥有独立的银行账户，发行人作为独立纳税人，履行独立纳税义务。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人在财务方面具有独立性。

（四） 发行人的机构独立情况

经发行人的确认及经本所律师查验，截至报告期末，发行人根据实际情况和生产需要，建立了健全且适应自身发展需要的内部组织机构，建立了相应的内部管理制度，拥有独立的职能部门并独立行使经营管理职权，发行人不存在各职能机构在经营场所、办公场所和管理制度等各方面与第一大股东及其控制的企业混同的情形。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人在机构方面具有独立性。

（五） 发行人的业务独立情况

根据《招股说明书（申报稿）》、发行人的确认并经本所律师查验，截至报告期末，发行人的主营业务系为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。发行人拥有完整、独立的研发、采购、生产和销售的运营管理体系，发行人的业务独立于其第一大股东。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人在业务方面具有独立性。

综上，本所律师认为，截至报告期末，发行人资产完整，在人员、财务、机构、业务方面具有独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、 股东及实际控制人

（一） 发行人的股东

1、 发行人的股权结构

发行人为香港联交所上市公司。根据发行人提供的资料及截至报告期末持有发行人 5%以上股份股东提供的股东调查表等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例(%)
1	大唐香港	859,522,595	17.00
2	鑫芯香港	797,054,901	15.76
3	其他股东	3,400,291,416	67.24
合计		**5,056,868,912**	**100.00**

2、 直接持有发行人 5%以上股份的股东

根据发行人的确认并经本所律师查验，截至报告期末，直接持有发行人 5%以上股份的股东为大唐香港、鑫芯香港。其基本情况如下：

（1） 大唐香港

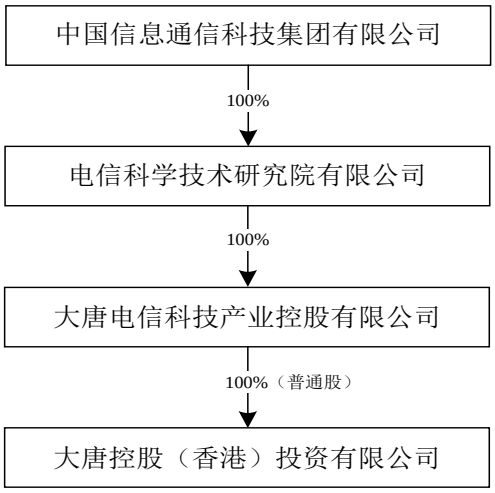
1） 大唐香港的基本情况

根据大唐香港的 Certificate of Incorporation（《设立证书》）、周年申报表、《大唐香港法律意见书》等资料，截至报告期末，大唐香港的基本情况如下：

企业名称	大唐控股（香港）投资有限公司
注册编号	1291749
注册地址	香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 26 楼
成立日期	2008 年 12 月 03 日
股东	大唐控股
已发行股份	1,000 股普通股由大唐控股持有；284,000,000 股可转换优先股由 Lightmane Holdings 持有

2） 大唐香港的股权结构

根据大唐香港的周年申报表、Register of Members（《股东名册》）、股东调查表等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，大唐香港的股权结构如下：



根据《大唐香港法律意见书》，Lightmane Holdings 作为持有大唐香港 284,000,000 股可转换优先股的股东享有获取分红的优先权但没有投票权。只要可转换优先股转换成普通股后大唐控股仍为大唐香港的控股股东及电信科学技术研究院有限公司仍为大唐控股的实际控制人，Lightmane Holdings 作为可转换优先股股东有权依据其自行判断将所持有的该可转换优先股转换为大唐香港的普通股，前述权利仅能行使一次。根据大唐香港与 Lightmane Holdings 于 2018 年 6 月 5 日签署的《股份认购协议》及《大唐香港法律意见书》，在该可转换优先股转换为大唐香港普通股的情况下，Lightmane Holdings 所持大唐香港股份比例约为 19.36%，且不得高于大唐控股及其关联方在大唐香港中的联合持股比例。

3） 大唐香港的设立、存续情况

根据《大唐香港法律意见书》，截至 2020 年 4 月 27 日，大唐香港是符合香港法律有效设立及合法存续的有限公司。

4） 大唐香港优先认购权的情况

2008 年 11 月 6 日，发行人与大唐香港的全资股东大唐控股签订《股权购买协议》，双方约定，如发行人发行新的普通股、任何可转换为或可交换为普通股的证券，或任何可认购普通股的认股证或其他权利，除若干例外情况，大唐控股或其附属公司拥有优先认购权。

根据发行人与大唐香港于 2020 年 5 月 6 日签署的《人民币普通股发行通知》，大唐香港同意就本次发行上市放弃该优先认购权。

（2） 鑫芯香港

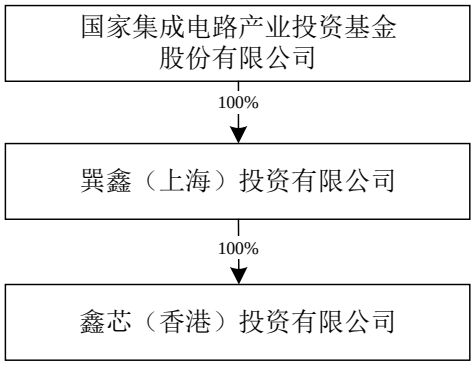
1） 鑫芯香港的基本情况

根据鑫芯香港的 Certificate of Incorporation（《设立证书》）、周年申报表、《鑫芯香港法律意见书》等资料，截至报告期末，鑫芯香港的基本情况如下：

企业名称	鑫芯（香港）投资有限公司
注册编号	2196863
注册地址	31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
成立日期	2015 年 01 月 27 日
股东	巽鑫（上海）投资有限公司
已发行股份	11,712,823,204 股普通股由巽鑫（上海）投资有限公司持有

2） 鑫芯香港的股权结构

根据鑫芯香港的周年申报表、股东调查表等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，鑫芯香港的股权结构如下：



3） 鑫芯香港的设立、存续情况

根据《鑫芯香港法律意见书》，截至 2020 年 4 月 28 日，鑫芯香港为一家根据香港法律依法成立并有效存续的有限公司。

4） 鑫芯香港优先认购权的情况

2015 年 2 月 12 日，发行人与鑫芯香港的间接全资股东大基金一期签订《股权购买协议》，双方约定，如发行人发行新的普通股、任何可转换为或可交换为普通股的证券，或任何可认购普通股的认股证或其他权利，除若干例外情况外，大基金一期或其附属公司拥有优先认购权。

根据发行人与大基金一期于 2020 年 5 月 6 日签署的《人民币普通股发行通知》，大基金一期同意就本次发行上市放弃该优先认购权。

（二） 发行人的实际控制人

报告期内，发行人股权结构相对分散，任何单一股东持股比例均未超过 30%。截至报告期末，大唐香港作为第一大股东持股比例为 17.00%，鑫芯香港作为第二大股东持股比例为 15.76%，第一大股东与第二大股东股权比例较为接近。

根据发行人的确认，并经本所律师查验发行人董事会决议及香港联交所公告等资料，发行人现任董事合计 14 名（其中独立非执行董事 5 名），各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配发行人股份表决权能够决定发行人董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形。

据此，本所律师认为，发行人的股权结构较为分散，截至报告期末，任何单一股东持股比例均低于 30%，且所委派或提名的董事人数低于董事会成员的二分之一，无法对发行人董事会或股东大会构成控制，发行人无控股股东和实际控制人。

七、 发行人的股本（份）及其演变

（一） 发行人的设立

根据 Registrar of Companies（开曼群岛公司注册处）签发的 Certificate of Incorporation（《设立证书》）及开曼群岛律师出具的《开曼群岛法律意见书》，发行人是根据《开曼群岛公司法》于 2000 年 4 月 3 日在开曼群岛注册成立的有限公司。

发行人于 2000 年 5 月通过董事决议，对外发行 10,000 股普通股，由 RU-GIN RICHARD CHANG（张汝京）持有。

（二） 发行人报告期内股本（份）变动

根据发行人报告期内历年年度报告以及发行人提供的相关文件，报告期内，发行人的股本（份）变动分为法定股本变动及已发行股份（普通股）变动，具体变动情况如下：

1、 法定股本变动

2016 年 12 月 20 日，发行人召开董事会，审议并同意增加 5,000,000,000 股普通股，法定股本总额由 2,200.00 万美元增加至 4,200.00 万美元（包括每股面值为 0.004 美元的 10,000,000,000 股普通股及每股面值为 0.004 美元的 500,000,000 股优先股）。

2017 年 6 月 23 日，发行人召开股东周年大会，审议通过上述法定股本增加事项。

2、 已发行普通股变动

依据发行人年度报告以及提供的相关文件，报告期内，发行人已发行普通股变动的具体情况如下：

（1） 2017 年普通股变动

2017 年度已发行普通股变动概述如下：

事项	普通股数量（股）
2016 年 12 月 31 日普通股结余数	**4,252,922,259**
年内可换股债券换股	389,042,383
2017 年 12 月发行普通股	241,418,625
股权激励计划项下的普通股发行	32,723,622
2017 年 12 月 31 日普通股结余数	**4,916,106,889**

2017 年度已发行普通股变动具体如下：

1） 可换股债券换股

序号	发行日期	到期日	债券品种	本金金额（美元）
1	2013-11-07	2018-11-07	零息可换股债券	200,000,000
2	2014-06-24	2018-11-07	零息可换股债券	95,000,000
3	2014-05-29	2018-11-07	零息可换股债券	86,800,000

4	2014-12-04	2018-11-07	零息可换股债券	22,200,000
5	2016-07-07	2022-07-07	零息可换股债券	450,000,000

2017 年度，上述可换股债券发生换股，兑换为 389,042,383 股普通股。

2） 增发普通股

2017 年 11 月 14 日，发行人召开董事会，审议并同意授权公司与联席配售代理 JP Morgan Securities PLC、Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 订立配售协议，发行人通过联席配售代理按每股配售股份 10.65 港元的价格向不少于 6 名承配人发行 241,418,625 股普通股。

3） 股权激励计划项下的普通股发行

根据发行人 2004 年购股权计划和 2004 年以股支薪奖励计划，发行人分别发行 18,138,095 股普通股及 3,102,735 股普通股；根据发行人 2014 年购股权计划和 2014 年以股支薪奖励计划，发行人分别发行 3,692,407 股普通股及 7,790,385 股普通股。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人依据上述股权激励计划合计发行 32,723,622 股普通股。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已累计发行 4,916,106,889 股普通股，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	大唐香港	797,996,122	16.23
2	鑫芯香港	740,000,000	15.05
3	紫光集团附属公司[1]	363,345,100	7.39
4	其他股东	3,014,765,667	61.33
合计		**4,916,106,889**	**100.00**

（2） 2018 年普通股变动

2018 年度已发行普通股变动概述如下：

事项	普通股数量（股）
2017 年 12 月 31 日普通股结余数	**4,916,106,889**

[1]经本所律师查询披露易网站，上表中“紫光集团附属公司”持股情况系指截至 2017 年 12 月 31 日，紫光集团有限公司通过其附属公司紫光集团国际有限公司、紫光科技战略投资有限公司、紫光科技投资（香港）有限公司共同持有发行人 363,345,100 股普通股。

2018 年 06 月发行普通股	61,526,473
2018 年 08 月发行普通股	57,054,901
购回普通股及注销	-18,941,000
股权激励计划项下的普通股发行	24,071,936
2018 年 12 月 31 日普通股结余数	**5,039,819,199**

2018 年度已发行普通股变动具体如下：

1） 增发普通股

2018 年 6 月 22 日，发行人召开股东特别大会，批准发行人分别与大唐控股、大唐香港签署的优先股份认购协议及发行人与大基金一期、鑫芯香港签署的优先股份认购协议，并同意向大唐香港及鑫芯香港发行普通股。

2018 年 6 月 29 日，发行人以每股 10.65 港元的价格向大唐香港发行 61,526,473 股普通股。2018 年 8 月 29 日，发行人以每股 10.65 港元的价格向鑫芯香港发行 57,054,901 股普通股。

2） 回购普通股及注销

经发行人 2018 年 6 月 22 日召开的股东周年大会批准，发行人分别于 2018 年 9 月 27 日及 2018 年 10 月 4 日于香港联交所回购 7,291,000 股普通股及 11,650,000 股普通股。

2018 年 10 月 25 日，发行人注销上述已回购的普通股。

3） 股权激励计划项下的普通股发行

根据发行人 2004 年购股权计划、2014 年购股权计划和 2014 年以股支薪奖励计划，发行人分别发行 9,876,536 股普通股、1,861,780 股普通股及 12,333,620 股普通股。

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人根据上述股权激励计划合计发行 24,071,936 股普通股。

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人已累计发行 5,039,819,199 股普通股，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	大唐香港	859,522,595	17.05

2	鑫芯香港	797,054,901	15.82
3	紫光集团附属公司[1]	374,665,110	7.43
4	其他股东	3,008,576,593	59.70
合计		**5,039,819,199**	**100.00**

（3） 2019 年普通股变动

2019 年度已发行普通股变动概述如下：

事项	普通股数量（股）
2018 年 12 月 31 日普通股结余数	**5,039,819,199**
股权激励计划项下的普通股发行	17,049,713
2019 年 12 月 31 日普通股结余数	**5,056,868,912**

2019 年度已发行普通股变动具体如下：

根据发行人 2004 年购股权计划、2014 年购股权计划和 2014 年以股支薪奖励计划，公司分别发行 7,196,560 股普通股、1,544,113 股普通股及 8,309,040 股普通股。

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人根据上述股权激励计划合计发行 17,049,713 股普通股。

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人已累计发行 5,056,868,912 股普通股，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	大唐香港	859,522,595	17.00
2	鑫芯香港	797,054,901	15.76
3	其他股东	3,400,291,416	67.24
合计		**5,056,868,912**	**100.00**

依据发行人提供的材料以及《开曼群岛法律意见书》《香港法律意见书》，发行人报告期内的股份发行及股份回购已获得《公司章程》的适当授权且并未违反开曼群岛法律法规，涉及的董事会会议、股东大会会议召集召开的程序、应受《香港上市规则》监管的相关事项的决议内容及相关授权不存在违反《香港上市

[1]经本所律师查询披露易网站，上表中“紫光集团附属公司”持股情况系指截至 2018 年 12 月 31 日，紫光集团有限公司通过其附属公司紫光集团国际有限公司、紫光科技战略投资有限公司、紫光科技投资（香港）有限公司共同持有发行人 374,665,110 股普通股。

规则》有关董事会日期的通知要求、股东大会通知、公告及通函披露的要求以及附录十四《企业管治守则》的守则条文要求的情况。

（三） 发行人在香港联交所上市、在美国纽交所发行 ADS 及退市情况

1、 发行人在香港联交所上市、在美国纽交所发行 ADS 的情况

2004 年 1 月 28 日，发行人董事会审议并同意发行人公开发行股份并上市。2004年2月16日，发行人股东特别大会审议并同意发行人公开发行股份并上市。

2004 年 3 月 5 日，发行人与 Credit Suisse First Boston (HongKong) Limited 和 Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 签订承销协议，拟全球发售 5,151,515,000 股普通股。2004 年 3 月 18 日，发行人的普通股在香港联交所上市，股票代码：981；证券简称：中芯国际。发行人的 ADS 于美国纽交所上市，股票代码：SMI。

依据发行人于 2004 年于香港联交所上市的招股说明书等公开信息披露情况以及发行人的说明，本次拟全球发售 5,151,515,000 股普通股，包括发行人股东公开发售和新增发售，其中股东公开发售 2,121,212,000 股普通股，新增发售 3,030,303,000 股普通股。

2、 发行人在美国纽交所退市情况

2019 年 2 月 14 日，发行人董事会通过决议，授权发行人在合适的时机取消 ADS 在美国证交会的注册，并根据《1934 年证券交易法》（经修订）终止发行人向美国证交会的报告义务。

2019 年 5 月 24 日，发行人发出《关于拟将美国预托证券股份从纽约证券交易所退市和撤销根据美国证券交易法之注册及终止申报责任之公告》，发行人通知美国纽交所，根据《1934 年证券交易法》（经修订）申请自愿将其 ADS 从美国纽交所退市，并撤销该等 ADS 和相关普通股的注册。

2019 年 6 月 3 日，发行人向美国证交会申请 ADS 的退市。2019 年 6 月 14 日，发行人的 ADS 从美国纽交所退市并进入美国场外交易市场交易，发行人向美国证交会申请撤销注册及终止其在美国证券交易法下的申报责任。截至报告期末，发行人的 ADS 注册已成功撤销并终止在美国证券交易法下的申报责任。

根据《美国 ADS 法律意见书》并经本所律师查验，发行人已完成了其 ADS 在美国纽交所的退市手续，并终止了其在美国证券交易法下关于 ADS 的申报责任。

根据《开曼群岛法律意见书》并经本所律师查验，准予发行人从美国纽交所退市的董事会决议已被有效且适当的通过且相关董事会决议的通过不违反开曼群岛的法律法规。

（四） 主要股东所持发行人股份受限情况

根据大唐香港股东调查表以及《大唐香港法律意见书》，截至 2020 年 5 月 18 日，大唐香港所持发行人的股份不存在委托持股或信托持股的情形，亦不存在冻结、质押等权利限制的情形。

根据鑫芯香港股东调查表以及《鑫芯香港法律意见书》，截至 2020 年 5 月 7 日，鑫芯香港所持发行人的股份不存在担保权利限制的情形。

八、 发行人的业务

（一） 发行人及其子公司的经营范围与经营方式

1、 发行人的经营范围和经营方式

根据发行人说明以及发行人提供的相关材料并经本所律师查验，发行人的主营业务系为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。根据《公司章程》及《开曼群岛法律意见书》，发行人成立的宗旨不受限制，发行人拥有完全的权力及权限实施《开曼群岛公司法》或开曼群岛任何其他法律并无禁止的任何宗旨。

2、 发行人境内子公司的经营范围

根据发行人境内主要子公司的营业执照及工商档案，经本所律师查验，截至报告期末，发行人境内主要子公司的经营范围如下：

序号	名称	经营范围
1	中芯控股	1.在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2.受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所提供企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器

		设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；3.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；4.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；5.承接其母公司和关联公司的服务外包业务；6.集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；7.自有物业出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	中芯集电	1.在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2.集成电路相关电子产品的研发、生产（由分支机构经营）；3.受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。4.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；5.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；6.承接其母公司和关联公司的服务外包业务；7.集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	中芯上海	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	中芯北京	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	中芯天津	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测

		试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	中芯北方	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造（含线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造）、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7	中芯深圳	半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、销售自产产品。
8	中芯新技术	集成电路的制造、技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让、销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9	中芯长电	集成电路设计，线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS 和化合物半导体集成电路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	中芯南方	集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11	芯电上海	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12	中芯晶圆	股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13	中芯晶圆宁波	股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	宁波设计[1]	集成电路及微电子系统相关软、硬件的技术研发、设计、测试、技术咨询、技术转让、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	北京创新	与集成电路、半导体技术有关的开发、设计服务、技术服务、技术

[1]中芯上海所持宁波设计全部股权已于 2020 年 4 月 1 日转让予芯创智（北京）微电子有限公司，并变更公司名称为“芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司”。

		转让、技术咨询；半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；销售自产产品。（该企业 2019 年 12 月 24 日前为内资企业，于 2019 年 12 月 24 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
16	成都开发	中芯国际配套项目设施（宿舍、学校、超市等）的建设、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	上海合芯	投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师查验，发行人境内子公司的经营范围均已在工商登记机关办理登记手续，发行人境内子公司当前实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，且符合《指导外商投资方向规定》《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》等外商投资产业政策，其经营范围和经营方式符合中国法律法规的规定。

3、 发行人境内主要子公司取得的资质或备案

根据发行人提供的生产经营环节的相关主要资质、备案等资料，截至本律师工作报告出具之日，发行人境内主要子公司取得的与主营业务相关的主要资质或备案情况如下：

（1） 高新技术企业证书

资质或证书名称	公司名称	资质或证书编号	有效期	发证机关
高新技术企业证书	中芯北京	GR201811007829	2018-11-30/ 2021-11-29	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
高新技术企业证书	中芯上海	GR201731003213	2017-11-23/ 2020-11-22	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
高新技术企业证书	中芯天津	GR201912001080	2019-11-28/ 2022-11-27	天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局
高新技术企业证书	中芯北方	GR201911006793	2019-12-02/ 2022-12-01	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
高新技术企	中芯长电	GR201932004450	2019-11-22/ 2022-11-21	江苏省财政厅、江苏省科学

业证书				技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局

（2） 进出口相关证书

资质或证书名称	公司名称	资质或证书编号	注册登记日期/备案日期	发证机关
报关单位注册登记证	中芯北京	1113240108	2003-09-11	北京海关
报关单位注册登记证	中芯北方	1113230225	2013-10-16	北京海关
报关单位注册登记证	中芯深圳	4403540047	2008-05-29	深圳海关
报关单位注册登记证	中芯天津	1211940356	2003-11-12	天津海关
报关单位注册登记证	中芯上海	3122240755	2001-01-21	浦东海关
报关单位注册登记证	中芯南方	3122233105	2018-05-14	上海海关
报关单位注册登记证	中芯新技术	3122232946	2015-03-12	浦东海关
报关单位注册登记证	中芯长电	3216945844	2014-12-25	江阴海关
报关单位注册登记证	芯电上海	3122245975	2009-05-19	浦东海关
报关单位注册登记证	中芯集电	3122245901	2009-03-02	浦东海关
对外贸易经营者备案登记表	中芯北方	02132108	2018-01-23	---
对外贸易经营者备案登记表	中芯深圳	01592470	2017-07-17	---
对外贸易经营者备案登记表	中芯天津	02564320	2018-03-09	---
对外贸易经营者备案登记表	中芯新技术	02695734	2018-06-27	---

（二） 发行人在中国大陆之外从事经营的情况

根据发行人提供的对外投资资料及《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人设立在开曼群岛，并在境外拥有 20 家子公司、1 家参股公司（详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（五）发行人的对外投资”）。除此以外，发行人没有在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

（三） 发行人主营业务的变更情况

根据发行人的确认、发行人境内子公司的工商登记档案、发行人报告期内历年年度报告及《审计报告》，并经本所律师查验，发行人近两年主营业务没有发生过重大变更，持续为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

（四） 发行人的主营业务突出

根据《审计报告》，报告期内发行人主营业务收入情况如下：

年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	2,201,788.29	2,301,670.68	2,138,982.24
主营业务收入（万元）	2,146,997.70	2,254,069.90	2,098,164.91
主营业务收入占比(%)	97.51	97.93	98.09

据此，本所律师认为，报告期内发行人的营业收入以主营业务收入为主，发行人的主营业务突出。

（五） 发行人的持续经营能力

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常；发行人境内子公司依照中国法律法规的规定在其经营范围内开展经营活动，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，在合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》中披露了相关风险因素。

九、 关联（连）交易及同业竞争

（一） 发行人的主要关联（连）方

参照《科创板上市规则》《香港上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《国际财务报告准则》等法律法规的规定，根据持有发行人 5%以上股份的直接股东、董事及高级管理人员填写的调查表及《审计报告》、发行人的确认，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统的公开查询，发行人主要关联（连）方如下：

1、 直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至报告期末，直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织情况如下：

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
1	大唐香港	直接持有发行人 17.00%的股份
2	鑫芯香港	直接持有发行人 15.76%的股份

2、 发行人子公司

发行人的子公司均为发行人的关联（连）方，该等关联（连）方截至报告期末的基本情况，详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（五）发行人的对外投资”之“一、发行人子公司”。

3、 发行人的联营企业和合营企业

截至报告期末，发行人的主要联营企业和合营企业情况如下：

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
1	凸版彩晶	发行人持有 30.00%股权
2	芯鑫租赁	发行人持有 7.44%股权
3	长电科技	发行人三级全资子公司芯电上海持有 14.28%股权
4	中芯协成	发行人二级全资子公司中芯上海持有 49.00%股权
5	中芯聚源	发行人二级全资子公司中芯上海持有 19.51%股权
6	灿芯半导体	发行人一级全资子公司中芯控股持有 34.75%股权
7	中芯宁波	发行人一级全资子公司中芯控股持有 38.57%股权
8	中芯绍兴	发行人一级全资子公司中芯控股持有 23.47%股份
9	上海创新	发行人二级全资子公司中芯上海持有 33.33%股权
10	盛吉盛	发行人一级全资子公司中芯控股持有 27.27%股权
11	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	发行人三级全资子公司中芯晶圆持有 31.63%合伙财产份额
12	北京吾金创业投资中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 32.61%合伙财产份额
13	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 66.23%合伙财产份额
14	上海信芯投资中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 49.00%合伙财产份额
15	上海聚源启泰投资中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 33.00%合伙财产份额
16	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 44.83%合伙财产份额
17	上海诚芯投资中心（有限合伙）	发行人四级全资子公司中芯晶圆宁波持有 31.50%合伙财产份额

4、 发行人董事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

截至报告期末，发行人董事、高级管理人员均为发行人的关联（连）方（该等关联（连）方的基本情况，详见本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、

高级管理人员和核心技术人员及其变化”之“（一）发行人董事和高级管理人员的任职”）。

与上述人士关系密切的家庭成员亦为发行人的关联（连）方，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

5、 发行人董事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者前述人员（独立非执行董事及其关系密切的家庭成员除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织

截至报告期末，发行人董事、高级管理人员直接或间接控制的，或者前述人员（独立非执行董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织[1]如下：

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	董事长、执行董事周子学担任独立董事
2	海信视像科技股份有限公司	董事长、执行董事周子学担任独立董事
3	宁波市集成电路产业基金管理有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书高永岗担任董事长
4	中芯聚源股权投资管理（北京）有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书高永岗担任执行董事
5	浙江巨化股份有限公司	执行董事、联合首席执行官 ZHAO HAIJUN（赵海军）担任董事
6	沪硅产业	非执行董事任凯担任副董事长
7	上海芯铖投资管理有限公司	非执行董事任凯担任董事长
8	湖北紫光国器科技控股有限公司	非执行董事任凯担任董事
9	湖北紫芯科技投资有限公司	非执行董事任凯担任董事
10	福建省安芯投资管理有限责任公司	非执行董事任凯担任董事长
11	三安光电股份有限公司	非执行董事任凯担任董事
12	上海万业企业股份有限公司	非执行董事任凯担任副董事长
13	长江存储科技控股有限责任公司	非执行董事任凯担任董事

[1]发行人董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，如为发行人的联营或合营企业、直接或间接持发行人 5%以上股份的法人，则不在此处赘述。

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
		非执行董事路军担任董事
14	长江存储科技有限责任公司	非执行董事任凯担任董事 非执行董事路军担任董事
15	武汉新芯集成电路制造有限公司	非执行董事任凯担任董事 非执行董事路军担任董事
16	华芯投资管理有限责任公司	非执行董事任凯担任董事兼副总裁 非执行董事路军担任董事兼总裁
17	国开金融有限责任公司	非执行董事路军担任副总裁
18	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	非执行董事路军担任执行董事
19	国开熔华产业投资基金管理有限责任公司	非执行董事路军担任董事长兼经理
20	中国—比利时直接股权投资基金	非执行董事路军担任董事
21	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	非执行董事路军担任董事
22	海通证券	非执行董事周杰担任董事长
23	烽火通信科技股份有限公司	非执行董事陈山枝担任董事
24	AsiaLink Capital Limited	独立非执行董事范仁达持股100%并担任主席兼董事总经理

与发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员在报告期内直接或间接控制的，或者前述人员（与独立非执行董事关系密切的家庭成员除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联（连）方。

6、 间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至报告期末，间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织如下：

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
1	大唐控股	持有大唐香港100%股权
2	电信科学技术研究院有限公司	持有大唐控股100%股权
3	中国信息通信科技集团有限公司	持有电信科学技术研究院有限公司100%股权
4	巽鑫（上海）投资有限公司	持有鑫芯香港100%股权
5	大基金一期	持有巽鑫（上海）投资有限公司100%股权

7、 其他关联（连）方

报告期末，发行人其他主要关联（连）方主要包括：

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
控股子公司的持股比例超过 10%的少数股东		
1	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	持有发行人二级控股子公司中芯南方 22.86%股权[1]
2	上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司	于 2020 年 05 月 15 日持有发行人二级控股子公司中芯南方 11.53%股权
发行人控制的其他机构		
3	北京市中芯学校	发行人通过二级全资子公司中芯北京出资设立的民办非营利学校
4	上海市民办中芯学校	发行人通过二级全资子公司中芯上海出资设立的民办非营利学校
报告期内曾为发行人的子公司		
5	SMIC (Sofia) EOOD	发行人二级全资子公司 SMIC HK 持有 100%股权，于 2019 年 07 月 29 日随 SMIC HK 一并转让
6	LFoundry	发行人二级全资子公司 SMIC HK 持有 70%股权，于 2019 年 07 月 29 日随 SMIC HK 一并转让
7	LFoundry Sofia EOOD	发行人三级控股子公司 LFoundry 持有 100%股权，于 2019 年 07 月 29 日随 SMIC HK 一并转让
8	SMIC HK	发行人一级全资子公司 SH Cayman 持有 100%股权，于 2019 年 07 月 29 日转让
9	中芯能源科技（上海）有限公司	发行人二级全资子公司 Solar Cell HK 持股 100%，于 2018 年 08 月 08 日注销
10	Admiral Investment Holdings Limited	发行人持有 100%股权，于 2019 年 10 月 29 日注销
11	上海荣芯投资管理合伙企业（有限合伙）	发行人三级全资子公司中芯晶圆曾系有限合伙人，持有其 99%的出资份额，通过《委托管理协议》实际控制，于 2017 年 04 月 20 日转让
报告期内曾为发行人的联营或合营企业		
12	宁波微电子创新产业园有限公司	发行人二级全资子公司中芯上海持有 20.00%股权，于 2019 年 12 月 25 日转让；执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书高永

[1]2020 年 5 月 15 日，中芯控股与大基金一期、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司、中芯南方签订《增资扩股协议》，本次增资完成后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股 12.31%。

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
		岗曾任董事长，2019 年 12 月 25 日退任
报告期内发行人子公司曾出资的其他机构		
13	北京市中芯幼儿园	发行人二级全资子公司中芯北京作为举办人出资设立的民办非营利学校，已于2019年09月25日捐赠
14	北京市大兴区中芯南海子幼儿园	发行人二级全资子公司中芯北京作为举办人出资设立的民办非营利学校，已于2019年09月25日捐赠
15	上海市民办中芯幼儿园	发行人二级全资子公司中芯上海作为举办人出资设立的民办非营利学校，已于2019年09月25日捐赠
报告期内曾间接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织		
16	北京紫光资本管理有限公司	曾间接持有发行人 5%以上股份
17	紫光集团有限公司	持有北京紫光资本管理有限公司 100%股份，曾间接持有发行人 5%以上股份
发行人董事、高级管理人员报告期内曾直接或间接控制的，或者前述人员（独立非执行董事除外）曾担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织[1]		
18	大唐电信集团财务有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书高永岗曾担任董事长，2019年01月29日退任
19	有研新材料股份有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书高永岗曾任独立董事，2018年04月16日退任
20	国开新能源科技有限公司	非执行董事路军曾任董事长，2018年07月20日退任
21	国开投资基金管理有限责任公司	非执行董事路军曾任董事，2018年07月10日退任
22	开信创业投资有限公司	非执行董事路军曾任董事长，2018年06月28日退任
23	开信创业投资管理（北京）有限公司	非执行董事路军曾任副董事长，2018年06月29日退任
24	辰芯科技有限公司	非执行董事陈山枝曾任董事，2018年07月19日退任
25	烽火科技集团有限公司	非执行董事童国华曾任董事，2017年01月13

[1]发行人董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员曾担任董事、高级管理人员的，发行人报告期内曾经的董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员担任或曾担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，如为发行人的联营或合营企业、直接或间接持发行人 5%以上股份的法人、其他发行人董事（独立非执行董事除外）或高级管理人员截至报告期末仍担任董事或高级管理人员的法人或其他组织，则不在此处赘述。

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
		日退任
26	武汉烽火移动通信有限公司	非执行董事童国华曾任董事长，2019年06月04日注销
27	上海医药（集团）有限公司	非执行董事周杰曾任董事，2017年02月21日退任
28	上海上实（集团）有限公司	非执行董事周杰曾任董事兼总经理，2017年05月23日退任
29	上海海外联合投资股份有限公司	非执行董事周杰曾任董事，2018年03月30日退任
30	新华半导体控股（上海）有限公司	非执行董事任凯曾任董事，2019年09月11日注销
报告期内曾担任发行人董事、高级管理人员的自然人		
31	蒋尚义	报告期内曾任发行人的独立非执行董事，2019年 06 月 21 日不再担任独立非执行董事
32	邱慈云	报告期内曾任发行人执行董事、首席执行官、非执行董事，2017 年 05 月 10 日不再担任首席执行官和执行董事，2018 年 06 月 30 日不再担任非执行董事
33	李永华	报告期内曾任发行人非执行董事陈山枝之替任董事，2017 年 02 月 24 日不再担任替任董事
34	龚志伟	报告期内曾任发行人投资及战略业务发展及财务执行副总裁兼公司秘书，2017 年 07 月 03 日不再担任执行副总裁兼公司秘书
35	JYISHYANG JOHN LIU（刘吉祥）	报告期内曾任工程及服务执行副总裁，2017 年 12 月 31 日不再担任执行副总裁
36	MIKE REKUC	报告期内曾任全球销售及市场执行副总裁，2017 年 12 月 31 日不再担任执行副总裁
37	李智	报告期内曾任法务/公共和政府关系/行政事务执行副总裁，由于职级调整于 2018 年 12 月 04 日不再担任高级管理人员
38	TIAN-SHEN TANG（汤天申）	报告期内曾任设计服务执行副总裁，2018 年 02 月 01 日不再担任执行副总裁
39	I-HUA CARMEN CHANG（周一华）	报告期内曾任发行人独立非执行董事，2018 年 06 月 22 日不再担任独立非执行董事
40	LIP-BU TAN（陈立武）	报告期内曾任发行人的独立非执行董事，2018 年 06 月 22 日不再担任独立非执行董事
报告期内发行人曾经的董事、高级管理人员直接或间接控制或曾直接或间接控制的，或者前述人员（独立非执行董事除外）担任或曾担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公		

序号	关联（连）方名称	主要关联（连）关系
司以外的法人或其他组织[1]		
41	上海新昇半导体科技有限公司	报告期内曾任执行董事、首席执行官、非执行董事邱慈云担任董事兼总经理
42	Axcelis Technologies	报告期内曾任执行董事、首席执行官、非执行董事邱慈云担任独立董事
43	国新健康保障服务集团股份有限公司	报告期内曾任非执行董事李永华担任董事兼总裁
44	Solantro Semiconductor Corp.	报告期内曾任设计服务执行副总裁 TIAN-SHEN TANG（汤天申）担任首席执行官兼总裁
45	摩尔精英集成电路产业发展（合肥）有限公司	报告期内曾任设计服务执行副总裁 TIAN-SHEN TANG（汤天申）担任独立董事
46	VXI Global Solutions LLC	报告期内曾任投资及战略业务发展及财务执行副总裁兼公司秘书龚志伟担任首席财务官
47	大唐恩智浦半导体有限公司	报告期内曾任非执行董事李永华曾任董事长，2019 年 11 月 11 日退任
48	大唐电信科技股份有限公司	报告期内曾任非执行董事李永华曾任总经理兼董事，2019 年 08 月 22 日退任
49	上海华虹ＮＥＣ电子有限公司	报告期内曾任执行副总裁李智曾任董事，于 2018 年 08 月 03 日注销
50	大唐移动通信设备有限公司	报告期内曾任非执行董事李永华曾担任董事长，2017 年 05 月 26 日退任

以下自然人或法人或其他组织亦为发行人的关联（连）方：

（1） 与发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员报告期内曾经直接或间接控制的，或者前述人员（与独立非执行董事关系密切的家庭成员除外）在报告期内曾担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织；

（2） 与发行人报告期内曾经的董事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（3） 与发行人报告期内曾经的董事、高级管理人员关系密切的家庭成员报告期内直接或间接控制，或曾经直接或间接控制的，或者前述人员（与独立非执

行董事关系密切的家庭成员除外）在报告期内担任或曾担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织。

8、 根据《香港上市规则》所界定的关连方

根据《香港上市规则》所界定的关连方亦属于发行人的关联（连）方。

（二） 关联（连）交易

根据发行人提供的关联（连）交易资料及《审计报告》、发行人的确认，并经本所律师查验，报告期内发行人发生的关联（连）交易如下：

1、 经常性关联（连）交易

（1） 销售商品、提供劳务的关联（连）交易

关联（连）方	交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额（万元）	占营业收入比例(%)	金额（万元）	占营业收入比例(%)	金额（万元）	占营业收入比例(%)
灿芯半导体及其子公司	销售货物	28,772.60	1.31	22,329.00	0.97	29,875.37	1.40
	提供劳务	255.88	0.01	-	-	-	-
紫光集团有限公司子公司	销售货物	27,808.52	1.26	49,004.28	2.13	51,382.85	2.40
	提供劳务	10.00	0.00	-	-	-	-
中芯绍兴	销售货物	25,028.43	1.14	6,162.79	0.27	-	-
	提供劳务	5,390.38	0.24	4,833.54	0.21	-	-
长电科技及其子公司	提供劳务	19,293.01	0.88	82.49	0.00	43.51	0.00
大唐控股子公司	销售货物	6,805.15	0.31	7,875.60	0.34	13,697.31	0.64
中芯宁波	销售货物	3,356.29	0.15	593.92	0.03	-	-
	提供劳务	544.28	0.02	1,009.73	0.04	-	-
武汉新芯集成电路制造有限公司	销售货物	0.66	0.00	410.75	0.02	-	-
	提供劳务	3.56	0.00	-	-	20.06	0.00

关联（连）方	交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额（万元）	占营业收入比例(%)	金额（万元）	占营业收入比例(%)	金额（万元）	占营业收入比例(%)
盛吉盛	提供劳务	7.78	0.00	-	-	-	-
上海市民办中芯幼儿园	提供劳务	50.61	0.00	-	-	-	-
北京中芯幼儿园	提供劳务	7.14	0.00	-	-	-	-
合计		**117,334.28**	**5.33**	**92,302.10**	**4.01**	**95,019.11**	**4.44**

根据发行人的确认，报告期内，发行人及其境内子公司向灿芯半导体及其子公司、紫光集团有限公司的子公司、中芯绍兴、长电科技及其子公司等关联（连）方提供集成电路晶圆代工、芯片流片、凸块加工及测试等服务。

（2） 采购商品、接受劳务的关联（连）交易

关联（连）方	交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额（万元）	占营业成本比例(%)	金额（万元）	占营业成本比例(%)	金额（万元）	占营业成本比例(%)
沪硅产业子公司	采购货物	5,719.64	0.33	4,403.43	0.25	2,838.12	0.18
长电科技及其子公司	接受劳务	5,214.17	0.30	6,990.73	0.39	10,908.79	0.68
凸版彩晶	采购货物	4,196.01	0.24	4,755.36	0.27	7,637.41	0.47
	接受劳务	68.61	0.00	21.03	0.00	39.70	0.00
有研新材料股份有限公司子公司	采购货物	1,385.20	0.08	839.06	0.05	155.48	0.01
中芯绍兴	采购货物	104.79	0.01	-	-	-	-

	接受劳务	340.18	0.02	-	-	-	-
中芯聚源	接受劳务	207.54	0.01	241.42	0.01	626.67	0.04
灿芯半导体及其子公司	接受劳务	-	-	60.74	0.00	1,362.26	0.08
合计		**17,236.15**	**0.99**	**17,311.78**	**0.98**	**23,568.43**	**1.46**

根据发行人的确认，报告期内，发行人及其境内子公司向沪硅产业子公司、长电科技及其子公司、凸版彩晶等关联（连）方采购原材料及封装测试服务。

（3） 关联（连）方提供租赁

单位：万元

关联（连）方	租赁资产种类	项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
芯鑫租赁及其子公司	机器设备	使用权资产	38,177.69	-	-
		租赁负债利息支出	7,118.96	-	-
		租赁费用[1]	-	58,696.34	34,715.14
长电科技	厂房	使用权资产	1,555.69	-	-
		租赁负债利息支出	78.11	-	-
		租赁费用[1]	-	306.94	277.96

根据发行人的确认，报告期内，发行人境内子公司接受芯鑫租赁及其子公司提供的机器设备租赁服务。此外，发行人境内子公司向长电科技租赁厂房用于生产经营。

（4） 确认的租赁收入

单位：万元

关联（连）方	出租资产种类	2019 年度	2018 年度	2017 年度
中芯绍兴	厂房及房屋	5,091.67	28.07	-
凸版彩晶	厂房	2,705.78	2,754.10	2,638.15
上海市民办中芯幼儿园	房屋	136.32	-	-
北京中芯幼儿园	房屋	38.26	-	-
长电科技	设备	-	19.35	12.90

根据发行人的确认，报告期内，发行人境内子公司主要向中芯绍兴、凸版彩晶出租厂房，供其生产经营。

（5） 向关联（连）方授权知识产权

单位：万元

关联（连）方	2019 年度	2018 年度	2017 年度
中芯绍兴	-	134,790.56	-
中芯宁波	-	1,400.00	-

2018 年度发行人向中芯绍兴授权知识产权实现收入 134,790.56 万元，主要为开展微机电系统及功率半导体器件业务相关的知识产权。

[1]新租赁准则对 2019 年租赁相关的财务报表列报方式进行了调整。

（6） 关键管理人员薪酬

报告期各期，发行人向关键管理人员（含董事、高级管理人员）支付薪酬，关联（连）交易金额（包括工资、奖金及股权激励费用）分别为 9,619.79 万元、4,215.95 万元和 2,711.63 万元。

2、 偶发性关联（连）交易

（1） 转让资产

单位：万元

关联（连）方	交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
中芯绍兴	卖出机器设备[1]	2,173.78	47,788.78	-
芯鑫租赁及其子公司	卖出机器设备[1]	-	205,927.99	449,150.85
合计		**2,173.78**	**253,716.76**	**449,150.85**
盛吉盛	买入机器设备[1]	518.52	-	-
长电科技及其子公司	买入机器设备[1]	15.71	8.14	9.26
合计		**534.23**	**8.14**	**9.26**

根据发行人的确认，报告期内，发行人境内子公司向中芯绍兴转让部分机器设备，包括 2018 年度转让的微机电及功率器件业务相关的机器设备；并接受芯鑫租赁及其子公司提供的机器设备售后回租服务。

（2） 向董事、高级管理人员售房

2017 年度、2018 年度及 2019 年度，发行人向董事、高级管理人员（含报告期内已离任高管）出售房屋金额分别为 2,212.03 万元、821.65 万元及 1,409.26 万元。

（3） 接受财务顾问服务

2017 年度及 2018 年度，发行人接受海通证券提供的财务顾问服务，分别发生财务顾问费 100.00 万元、50.00 万元。

（4） 收回委托贷款

中芯北京于 2015 年向北京中芯幼儿园提供委托贷款 1,200.00 万元，其中 600.00 万元于 2019 年收回。

（5） 关联（连）方认购发行人发行的普通股及永久次级可换股证券

[1]新租赁准则对 2019 年租赁相关的财务报表列报方式进行了调整。

2018 年 6 月 29 日，发行人向大唐香港配发 61,526,473 股普通股，发行价格为 10.65 港元/股。同日，发行人向大唐香港发行本金为 2.00 亿美元的永久次级可换股证券。

2018 年 8 月 29 日，发行人向鑫芯香港配发 57,054,901 股普通股，发行价格为 10.65 港元/股。同日，发行人向鑫芯香港发行本金为 3.00 亿美元的永久次级可换股证券。

（6） 认购关联（连）方债务投资工具

2018 年 5 月 18 日，中芯北京与上海国泰君安证券资产管理有限公司订立资产管理协议，上海国泰君安证券资产管理有限公司向中芯北京提供资产管理及投资服务，包括投资于定向债务融资工具。

2018 年 7 月 6 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司以其受托的中芯北京的资产认购芯鑫租赁发行的本金总额为人民币 5.00 亿元的定向债务融资工具中的 2.00 亿元。

2018 年 8 月 10 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司以其受托的中芯北京的资产认购芯鑫租赁发行的本金总额为人民币 5.00 亿元的定向债务融资工具中的 1.00 亿元。

（7） 认购关联（连）方非公开发行的股份

2016 年 4 月 27 日，芯电上海和长电科技订立协议，芯电上海向长电科技出售苏州长电新科投资有限公司 19.61%股权，作价 6.64 亿元，由长电科技向芯电上海按 15.36 元/股发行 43,229,166 股 A 股支付。同日，芯电上海和长电科技订立认购协议，长电科技同意向芯电上海按 17.62 元/股非公开发行 150,681,044 股 A 股，总认购价 26.55 亿元。2017 年 5 月 10 日，中国证监会出具《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663 号）文件核准了该次交易。2017 年 6 月 19 日，上述股份完成发行及登记程序。

2017 年 9 月 28 日，长电科技召开董事会审议通过了非公开发行有关议案。拟向大基金一期、芯电上海等对象非公开发行股票。2018 年 8 月 15 日，中国证监会出具《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2018]1085 号）文件核准了该次交易。2018 年 8 月 30 日，芯电上海认购长电科技非公开发行的 34,696,198 股股份，认购价格为 14.89 元/股，总认购价为 516,626,388.22 元，上述股份于当日完成发行及登记程序。

（8） 向关联（连）方转让股权及共同增资

2018 年 3 月 22 日，中芯控股、中芯宁波及大基金一期订立股权转让协议，中芯控股出售中芯宁波的 28.17%股权给大基金一期。

2018 年 3 月 23 日，中芯控股与中芯宁波各股东订立增资协议，中芯控股增资 5.65 亿元，大基金一期增资 5.00 亿元，宁波胜芯电子科技有限公司增资 2.00 亿元，宁波市集成电路产业基金管理有限公司增资 1.00 亿元，盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金增资 1.00 亿元，北京集成电路设计与封测股权投资中心不增资。

（9） 与关联（连）方共同对外投资

2016 年 6 月 23 日，中芯晶圆与上海肇芯投资管理中心（有限合伙）及大基金一期就成立上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心订立合伙协议。根据合伙协议，大基金一期认缴出资 9.98 亿元，中芯晶圆认缴出资 7.00 亿元，上海肇芯投资管理中心（有限合伙）认缴出资 1,500 万元。

2017 年 7 月 20 日，发行人和大基金一期等各方修改芯鑫租赁的合资经营协议，发行人向芯鑫租赁增资 2.00 亿元，大基金一期增资 15.00 亿元。

2017 年 8 月 10 日，发行人与大基金一期等中芯北方的股东订立增资协议，发行人、中芯北京、中芯控股向中芯北方增资 12.24 亿美元，大基金一期增资 9.00 亿美元。

2018 年 1 月 30 日，中芯控股、中芯上海与大基金一期及上海集成电路产业投资基金股份有限公司订立合资合同和增资扩股协议，中芯控股、大基金一期及上海集成电路产业投资基金股份有限公司分别向中芯南方出资 15.435 亿美元、9.47 亿美元及 8.00 亿美元。

2018 年 5 月 2 日，中芯晶圆、上海尧芯商务信息咨询有限公司及大基金一期等订立基金合伙协议，成立盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业

（有限合伙），大基金一期出资 8.00 亿元，中芯晶圆出资 1.65 亿元，由盈富泰克创业投资有限公司担任基金管理人。

2018 年 8 月 10 日，中芯控股、Triplecores Korea Co., Ltd.、芯空间控股有限公司及芯鑫租赁修订对盛吉盛的合资合同：Triplecores Korea Co., Ltd.增资 200.00 万美元，芯空间控股有限公司增资 300.00 万美元，芯鑫租赁增资 500.00 万美元，中芯控股不增资。

3、 关联（连）方往来余额

（1） 应收关联（连）方款项

单位：万元

项目	关联（连）方	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	中芯绍兴	18,746.87	10,809.78	-
	灿芯半导体及其子公司	10,898.63	7,395.06	8,462.39
	长电科技及其子公司	9,482.41	31.95	13.68
	紫光集团有限公司的子公司	5,876.02	3,824.06	5,882.64
	中芯宁波	2,324.80	686.38	-
	大唐控股子公司	413.75	2,312.37	1,497.12
	武汉新芯集成电路制造有限公司	-	380.47	-
合计		**47,742.47**	**25,440.07**	**15,855.82**
其他应收款	中芯绍兴	7,263.23	72,262.24	-
	中芯宁波	1,870.22	1,319.30	-
	凸版彩晶	494.76	1,623.29	437.57
	上海市民办中芯幼儿园	354.69		
	北京中芯幼儿园	109.00		
	盛吉盛	2.74	-	-
合计		**10,094.64**	**75,204.84**	**437.57**
其他流动资产—债券投资	芯鑫租赁	-	30,679.78	-
一年内到期的非流动资产—委托贷款	北京中芯幼儿园	1,000.46	-	-

根据发行人的确认，报告期内，发行人向关联（连）方应收账款主要为应收中芯绍兴、灿芯半导体及其子公司、长电科技及其子公司等关联（连）方的集成电路晶圆代工服务应收款；其他应收款主要为应收中芯宁波、中芯绍兴的设备转让款及服务费等；其他流动资产—债券投资为持有的芯鑫租赁发行的定向债务融资工具；一年内到期的非流动资产—委托贷款为中芯北京及北京市中芯学校向北京中芯幼儿园提供的尚未收回的委托贷款。

（2） 应付关联（连）方款项

单位：万元

项目	关联（连）方	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付账款	长电科技及其子公司	1,745.08	650.36	12.47
	沪硅产业子公司	975.26	223.88	664.93
	凸版彩晶	345.34	506.03	580.44
	中芯绍兴	48.75	-	-
合计		**3,114.43**	**1,380.27**	**1,257.83**
其他应付款	盛吉盛	31.88	-	-
	长电科技及其子公司	3.20	-	-
	海通证券	-	-	106.00
合计		**35.07**	**-**	**106.00**
租赁负债	芯鑫租赁及其子公司	171,558.00	-	-
	长电科技	1,371.10	-	-
合计		**172,929.10**	**-**	**-**

根据发行人的确认，报告期内，发行人及其境内子公司向关联（连）方应付账款主要为应付长电科技及其子公司的封装测试服务费及应付沪硅产业子公司的原材料采购费；租赁负债主要为未来应付芯鑫租赁的设备租赁费。

根据《审计报告》、发行人提供的资料以及发行人及其独立非执行董事的确认，并经本所律师查验，报告期内发行人与关联（连）方之间的关联（连）交易定价公允，不存在损害发行人及股东利益的情形。

（三） 关联（连）交易承诺

经本所律师查验，为有效规范与减少关联（连）交易，持有发行人5%以上股份的股东大唐香港及其股东大唐控股、鑫芯香港及其股东巽鑫（上海）投资有限公司分别出具了书面承诺，主要内容如下：

“1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、对于正常经营范围内所需的关联交易，本公司将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次 A 股发行后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》等发行人内控制度的规定履行或配合发行人履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于公平公正公开等关联交易基本原则实施。

3、保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

（四） 发行人的关联（连）交易决策程序

经本所律师查验，发行人根据有关法律法规的规定，已在其《公司章程（A 股上市后适用稿）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联（连）交易管理制度》规定了股东大会、董事会在审议有关关联（连）交易事项时关联（连）股东、关联（连）董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会、董事会审议通过。此外，根据《关联（连）交易管理制度》规定，如某项交易既属于《科创板上市规则》下的“关联交易”，也属于《香港上市规则》14A 章下的“关连交易”，发行人应该确保该项交易在内部决策程序、信息披露等方面均符合《科创板上市规则》和《香港上市规则》中更严格的要求。

据此，本所律师认为，发行人已在其《公司章程（A 股上市后适用稿）》及其他本次上市后适用的内部控制制度中明确了关联（连）交易公允决策的程序。

（五） 同业竞争

报告期内，发行人不存在控股股东和实际控制人（详见本律师工作报告正文第六部分“股东及实际控制人”）。

此外，为进一步保障发行人的利益，持有发行人 5%以上股份的股东大唐香港及其股东大唐控股、鑫芯香港及其股东巽鑫（上海）投资有限公司分别出具了避免同业竞争的书面承诺，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人或其下属企业主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。发行人及其下属企业现有主营业务为：提供 0.35 微米至 14 纳米等不同技术节点的晶圆制造（代工）服务以及辅助设计服务、IP 支持、光掩模制造、凸块加工、一站式封装测试等配套技术服务（以本次 A 股发行披露内容为准）。

2、自本承诺函出具之日起，本企业承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与发行人或其下属企业主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如本企业及本企业直接或间接控制的下属企业获得以任何方式拥有与发行人及其下属企业主营业务竞争的企业的控制性股份、股权或权益的新投资机会，本企业将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该新投资机会的书面答复，本企业或本企业直接或间接控制的下属企业（发行人及其下属企业除外）在合法框架下尽力促使该等新投资机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属企业。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业及一致行动人（如有）直接或间接持有发行人股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）发行人的股票终止在上海证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

4、‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。”

十、 发行人的主要财产

（一） 发行人拥有的不动产权

根据发行人及其境内子公司提供的国有土地使用证书/房屋所有权证书/不动产权证、不动产登记部门出具的权属状况登记信息查询单，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人及其境内子公司拥有的与生产经营相关且已取得产证的主要不动产权情况如下：

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积/ 宗地面积（㎡）	土地性质	用途	终止日期	他项权利
1	中芯上海	沪房地浦字（2015）第 104816 号	张江路 18 号	201,772.00/ 361,805.00	出让	工业用地	2052-08-29	正在办理抵押登记（注[1]）
2	中芯北京	京房权证开外字第 00059 号/京技国用（2015 出）第 00022 号	北京经济技术开发区文昌大道 18 号	143,017.34/ 126,465.90	出让	工业用地	2052-12-30	无
3		京（2019）开不动产权第 0007981 号	北京经济技术开发区文昌大道 18 号院 8 号-1 至 1 层 101	1,623.84/ 126,465.90	出让	工业用地/仓库	2052-12-30	无
4	中芯北方	京（2019）开不动产权第 0003580 号	北京经济技术开发区文昌大道 18 号院 11 号楼 1 至 4 层 101 等[7]套	192,677.79/ 113,673.70	出让	工业用地/厂房及配套	2052-12-30	无
5		京（2019）开不动产权第 0006024 号	北京经济技术开发区文昌大道 18 号院 12 号楼 1 至 4 层 101	89,793.44/ 113,673.70	出让	工业用地/厂房	2052-12-30	无
6	中芯天津	津（2020）西青区	西青区西青开发区兴	109,755.01/	出让	工业用地/非	2047-07-28	无

[1]中芯上海与中国进出口银行上海分行于 2019 年 8 月 29 日签署了三份《借款合同（进口信贷固定资产类贷款）》，贷款金额分别为 7,000 万美元、6,800 万美元、6,200 万美元，贷款期限 60 个月，自“贷款”项下首次放款日起至最后还款日止。中芯上海与中国进出口银行上海分行签署《房地产最高额抵押合同》，以“沪房地浦字（2015）第 104816 号”不动产为抵押物之一，为上述借款合同项下贷款的偿还提供抵押担保。

		不动产权第1002387号	华道与兴华五支路交口西南侧兴华道19号	215,731.70		居住		
7	中芯长电	苏（2017）江阴市不动产权第0011034号	城东街道红岩村	宗地面积：182,082.00	出让	工业用地	2066-05-29	无[1]

[1]根据江阴市不动产登记中心于2020年5月13日出具的《江阴市不动产登记簿证明》，本地块存在抵押情况，已办理抵押登记，不动产登记证明号为“苏（2020）江阴市不动产证明第0018089号”，抵押方式为最高额抵押，债权金额为102,239,000元，设定日期为2020年5月7日，债权履行期限为2020-03-09至2021-03-09，抵押权人为中国建设银行股份有限公司江阴支行。

此外，根据发行人的说明及提供的无证房产相关建设工程资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人境内子公司拥有的主要不动产权中部分尚未取得产证，具体情况如下：

序号	权利人	座落位置	建筑面积（M^2）	用途	办理进度
1	中芯上海	上海市浦东新区张江路18号	78,650.94	综合办公楼和部分生产厂房及配套	部分完成竣工验收备案，部分正在办理竣工验收及备案
2			17,276.00	综合办公楼	详见下述第 1/B 部分
3	中芯深圳	深圳市坪山区龙田街道出口加工区高芯路18号	宗地面积为200,060.32 建筑面积为226,894.5	工业用地/集成电路芯片生产线厂房及配套	详见下述第 2 部分
4	中芯北京	北京经济技术开发区文昌大道18号	35,162.31	厂房及配套建筑物	详见下述第 3 部分
5	成都开发	高新区西部园区III号园区	41,944.62	生活区配套工程	详见下述第 4 部分

1、 中芯上海未办理产证事项

中芯上海未办理产证房产主要为综合办公楼和部分生产厂房及配套等，主要如下：

A、前述序号 1 未办理产证的上述生产厂房及配套，已取得建设工程规划许可证，其中部分已完成竣工验收备案，部分正在办理竣工验收，根据中芯上海确认，其后续办理上述房产的产证不存在法律障碍。

B、前述序号 2 未办理产证的综合办公楼，经本所律师查验，该处无证房产已取得了消防验收批文，发行人确认该房产未办理产证系历史客观原因形成，用途为综合办公用途，不涉及厂房研发等生产经营核心场所，建筑面积占发行人生产经营相关自有房产总面积的比例较低，且发行人周边类似可替代性办公房产较多，如此房产被房产主管部门责令拆除或要求整改，发行人寻找类似办公场所不存在障碍。此外，上海市浦东新区建设和交通委员会于 2020 年 5 月 9 日出具告

知书，确认“中芯上海报告期内不存在因违反房屋管理法律、法规、规章和规范性文件的规定而遭受处罚判决书的情形。”

据此，本所律师认为，中芯上海上述已建建筑物虽未取得相应产证，但大部分正在办理竣工验收或产证登记等事宜；部分综合办公用途房产虽未取得产证，但建筑面积占发行人生产经营自有房产总面积很低，且此类办公场所替代性强，中芯上海现阶段部分建筑物未取得相应产证事宜，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

2、 中芯深圳未办理产证事项

A、中芯深圳土地：2008 年 9 月 19 日，中芯深圳与深圳市国土资源和房产管理局签署《深圳市土地使用权出让合同书》（合同编号为“深地合字（2008）5059 号”），中芯深圳通过招拍挂方式出让取得宗地编号为 G12205-0002，宗地面积为 200,060.32 平方米，用途为工业用地的项目地块之国有建设用地使用权。中芯深圳已缴纳了相应的土地出让金。经发行人确认，中芯深圳未取得该地块产证的主要原因是房产相关代建费未支付完毕，未来拟和房产权证一并办理。

B、中芯深圳房产：经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，中芯深圳就上述房产已取得了《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》，尚未办理竣工验收备案手续。

经本所律师查验，2008 年 6 月 12 日，深圳深超与中芯深圳签署《关于在深圳合作建设集成电路芯片生产线厂房的合作协议》，约定由深圳深超出资 6.75 亿元为中芯深圳代建项目厂房的土建部分（含 8 英寸芯片生产线厂房、12 英寸芯片生产线厂房、动力厂房及研发办公大楼）。

2016 年 11 月 3 日，深圳市发展和改革委员会与发行人签署《关于建设集成电路芯片生产线项目投资合作协议》，约定在中芯深圳按照协议约定向深圳深超支付完毕 6.75 亿元厂房建设资金后，深圳市发展和改革委员会将协助中芯深圳尽快办理厂房产权登记手续。

2017 年 12 月，深圳深超与中芯深圳签署《关于在深圳合作建设集成电路芯片生产线厂房协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定中芯深圳应分五年向深圳深超归还其垫付的中芯深圳项目厂房建设资金 6.75 亿元，每年

1.35 亿元，其中第一期为 2017 年 12 月 30 日前，全部代建费用应于 2021 年 9 月 30 日前支付完毕。前述《补充协议》还约定，在中芯深圳按照约定支付完毕 6.75 亿元厂房建设资金之日起，深圳深超应于中芯深圳备齐相关资料后 30 个工作日内协助向深圳市规划国土、住建部门提交办理厂房产权登记手续的申请及相关附件材料，直至中芯深圳获得该厂房产权为止，并承诺于 2021 年 12 月底前完成上述义务。

深圳市坪山区住房和建设局于 2020 年 5 月 7 日出具证明，确认“自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，中芯深圳在该局职责范围内不存在违反国家和地方住房建设领域相关的法律、法规、规章及其他规范性文件规定的记录。”

深圳市规划和自然资源局于 2020 年 5 月 9 日出具证明，确认“自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，未发现中芯深圳因违反规划土地管理方面的法律、法规等相关规定而被调查或行政处罚的记录。”

据此，本所律师认为，中芯深圳已合法拥有上述土地的国有建设用地使用权，未取得土地及房屋产权证系因尚未支付完毕代建机构全部代建费，在中芯深圳向代建机构按照前述约定支付完毕代建费用后，深圳市发展和改革委员会与代建机构承诺将及时协助办理厂房权证，根据中芯深圳确认，上述房产及土地正常办理验收后办理产证不存在法律障碍。据此，本所律师认为，中芯深圳已合法拥有上述土地国有建设用地使用权，未取得土地及房屋产权证系因尚未支付完毕代建机构全部代建费，在中芯深圳向代建机构按照前述约定支付完毕代建费用后，深圳市发展和改革委员会和代建机构承诺将及时协助办理厂房权证，根据中芯深圳确认，上述房产及土地正常办理验收后办理产证不存在法律障碍。

3、 中芯北京未办理产证事项

经本所律师查验，上述序号 4 所述房产之中芯北京位于北京经济技术开发区文昌大道 18 号一宗房产尚未取得产证，该房产目前已竣工且已经取得了《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》及消防验收批复，并取得了《建设工程竣工档案预验收意见》。经发行人确认，该房产未办理产证系历史客观原因形成，建筑面积占发行人生产经营相关自有房产总面积比例较低。根据北京经济技

术开发区开发建设局出具的证明，“中芯北京自 2017 年 1 月至今不存在因违反相关法律法规规定而受到行政处罚的情况。”

4、 成都开发未办理产证事项

经本所律师查验，成都开发在成都高新区西部园区III号园区有一处建筑面积为 41,944.62 平方米的生活配套住宅，不涉及生产经营用房，因历史客观原因未办理产证。目前该房产主要用于对外出租使用，未用于发行人主营业务。根据发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，成都开发未因上述房产事宜受到过房产主管政府部门的行政处罚。

经发行人确认，除上述列示无证不动产外，截至报告期末，中芯天津拥有的集成电路生产线项目工程除 PMD 厂房以外的部分及中芯上海部分厂房、变电站，由在建工程转为固定资产，正在正常办理竣工验收及备案等手续过程中。

据此，本所律师认为，虽然发行人境内子公司拥有的主要不动产权存在个别未办理产证的情形，但发行人境内子公司占有、使用该等房产不存在限制或障碍，前述情形不会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

（二） 租赁房产

根据发行人境内子公司的房屋租赁合同及相关租赁房产的权属证书等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人境内子公司承租的主要经营性房产情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	面积（㎡）	用途
1	长电科技	中芯长电	江阴市东定西路 1 号	2014-12-01/ 2024-11-30	14,193.75	生产、办公
2	江阴扬子江创智投资发展有限公司	中芯长电	江阴市东盛西路 6 号的扬子江生物医药加速器 A8 楼 4 单元	2019-11-20/ 2024-11-19	1,760.00	办公
3	上海裕龙润泰石化有限公司	中芯上海	苏州工业园区苏雅路 158 号 1 幢 602 室	2019-05-05/ 2021-05-04	306.96	办公

本所律师注意到，上述房屋租赁合同所对应的租赁房屋未向住房和城乡建设部地方主管部门进行登记备案。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11 号）第四条的规定，“若合同当事人并未将登记备案作为房屋租赁合同生效要件的，房屋租赁合同不以办理登记备案手续作为生效要件，未办理登记备案的房屋租赁合同，不存在《中华人民共和国合同法》规定的无效或可撤销的情形时，应认定合法有效，合同签订双方应按约履行合同约定义务”。经本所律师查验，发行人境内子公司与出租方签署的上述房屋租赁合同均未约定以合同登记备案作为合同的生效要件。

综上，本所律师认为，发行人境内子公司所承租的生产办公用房存在未办理房屋租赁备案手续的情形，但不影响租赁关系的法律效力。截至本律师工作报告出具之日，发行人境内子公司占有、使用该房产不存在限制或障碍。

（三） 发行人拥有的主要知识产权

1、 专利权

（1） 境内专利权

根据发行人提供的境内专利证书、专利统计汇总表及国家知识产权局出具的批量专利法律状态证明，并经本所律师查验，截至报告期末，登记在发行人及其子公司名下的与其生产经营相关的主要境内专利权共有 6,527 项，其中：5,965 项为发明专利权、562 项为实用新型专利权，目前均在专利权保护期内（详见本律师工作报告附表一）。

（2） 境外专利权

根据 Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP 出具的境外专利尽调报告，并经本所律师查验，截至报告期末，登记在发行人及其子公司名下的与其生产经营相关的主要境外专利权共有 1,595 项（详见本律师工作报告附表一）。

据此，根据发行人提供的专利证书、专利统计汇总表、国家知识产权局出具的批量专利法律状态证明以及 Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP 出具的境外专利尽调报告，本所律师认为，截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有上述境内和境外专利权。

除此之外，根据发行人所处半导体行业惯例，发行人及其子公司存在获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权的情形。

2、 商标权

（1） 境内商标权

根据发行人提供的境内注册商标证书、汇总统计表以及国家商标局出具的商标档案，并经本所律师查验，截至报告期末，登记在发行人及其子公司名下与其生产经营相关的主要境内注册商标权共有 59 项（详见本律师工作报告附表二）。

（2） 境外商标权

根据 Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP 出具的境外商标尽调报告，并经本所律师查验，截至报告期末，登记在发行人及其子公司名下与其生产经营相关的主要境外注册商标权共有 11 项（详见本律师工作报告附表二）。

据此，依据发行人提供的注册商标证书、汇总统计表、国家商标局出具的商标档案以及 Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP 出具的境外商标尽调报告，本所律师认为，截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有上述境内和境外商标权。

3、 集成电路布图设计专有权

根据发行人提供的集成电路布图设计登记证书、汇总统计表，国家知识产权局出具的集成电路布图设计登记簿副本，并经本所律师查验，截至报告期末，登记在发行人及其子公司名下的集成电路布图设计专有权共有 94 项（详见本律师工作报告附表三）。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有上述集成电路布图设计专有权。

（四） 发行人拥有的主要生产经营设备

根据《审计报告》、发行人及其子公司的主要固定资产清单及本所律师抽查的重大设备采购合同、发票等相关资料，截至报告期末，发行人及其子公司的主要生产经营设备为机器设备，该等设备均由发行人及其子公司实际占有和使用，不存在与权属相关的诉讼和仲裁。

（五） 发行人的对外投资

根据发行人子公司、参股公司的工商登记档案、注册文件等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人共拥有 37 家子公司、26 家参股公司，发行人对外投资的主要情况如下：

序号	名称	统一社会信用代码/注册号	成立日期	注册资本/法定股本	持股比例/持有财产份额
一、发行人子公司					
1	中芯上海	91310115710939629R	2000-12-21	219,000.00 万美元	中芯集电持股 100%
2	中芯北京	911103027404017237	2002-07-25	100,000.00 万美元	中芯集电持股 100%
3	中芯天津	91120111717869977N	2003-11-03	129,000.00 万美元	中芯集电持股 100%
4	中芯深圳	914403006729728144	2008-03-20	70,000.00 万美元	中芯控股持股 81.86% 中芯集电持股 18.14%
5	中芯北方	91110302071737747W	2013-07-12	480,000.00 万美元	中芯控股持股 25.50% 中芯集电持股 13.00% 中芯北京持股 12.50%
6	中芯南方	91310115MA1K3K5P44	2016-12-01	350,000.00 万美元	中芯控股持股 45.67% 中芯上海持股 4.43%
7	中芯控股	913100003221774669	2015-07-28	5,000.00 万美元	中芯国际持股 100%
8	中芯集电	91310115754792112E	2003-09-30	46,580.00 万美元	中芯国际持股 100%
9	中芯新技术	913100003105758 2XG	2014-10-28	40,000.00 万美元	中芯集电持股 24.75% 中芯控股持股 75.25%
10	北京创新	91110302MA017TPY2A	2017-09-25	15,000.00 万元	中芯控股持股 66.00% 中芯北方持股 0.67%
11	成都开发	915101007801211363	2005-12-29	500.00 万美元	中芯国际持股 100%
12	芯电上海	913101156840682323	2009-03-03	1,200.00 万美元	SilTech HK 持股 100%
13	中芯晶圆	91310000087838761E	2014-02-27	145,800.00 万元	中芯上海持股 100%
14	中芯晶圆宁波	91330206MA2AHAE84E	2018-02-28	120,000.00 万元	中芯晶圆持股 100%
15	上海合芯	91310109312231932K	2014-08-01	5,000.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 99%财产份额

16	中芯长电	91320281321666575D	2014-11-25	39,950.00 万美元	SJ HK 持股 100%
17	宁波设计[1]	91330212MA2AETTY8P	2017-10-13	2,000.00 万元	中芯上海持股 100%
18	SMIC Japan	0100-01-136671	2002-10-08	1,000.00 万日元	中芯国际持股 100%
19	SMIC Americas	C2246481	2001-06-22	500,000.00 美元	中芯国际持股 100%
20	Better Way	6481	2000-04-05	1,000,000.00 美元	中芯国际持股 100%
21	Magnificent	1003599	2006-01-05	50,000.00 美元	Better Way 持股 100%
22	SMIC Europe	2112053	2003-07-03	100,000.00 欧元	中芯国际持股 100%
23	Solar Cell	151181	2005-06-30	11,000.00 美元	中芯国际持股 100%
24	Solar Cell HK [2]	1177680	2007-10-23	10,000.00 港元	Solar Cell 持股 100%
25	SH Cayman	198722	2007-11-08	50,000.00 美元	中芯国际持股 100%
26	BJ Cayman	198720	2007-11-08	50,000.00 美元	中芯国际持股 100%
27	BJ HK[2]	1181320	2007-11-02	1,000.00 港元	BJ Cayman 持股 100%
28	TJ Cayman	198710	2007-11-08	50,000.00 美元	中芯国际持股 100%
29	TJ HK[2]	1181334	2007-11-02	1,000.00 港元	TJ Cayman 持股 100%
30	SMIC BVI	1400826	2007-04-26	10.00 美元	中芯国际持股 100%
31	SZ Cayman	203473	2008-01-21	50,000.00 美元	中芯国际持股 100%
32	SZ HK[2]	1207964	2008-01-29	1,000.00 港元	SZ Cayman 持股 100%
33	SilTech Cayman	204815	2008-02-13	10,000.00 美元	中芯国际持股 100%
34	SilTech HK	1219618	2008-03-20	1,000.00 港元	SilTech Cayman 持股 100%
35	SJ CA	290967	2014-08-19	15,000.00 美元	中芯国际持股 55.97%

[1]中芯上海所持宁波设计全部股权已于 2020 年 4 月 1 日转让予芯创智（北京）微电子有限公司，并变更公司名称为“芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司”。

[2]Solar Cell HK、BJ HK、TJ HK、SZ HK 于 2020 年 1 月 17 日已注销。

36	SJ HK	2140216	2014-09-02	1,000.00 港元	SJ CA 持股 100%
37	SJ USA	C3892839	2016-04-04	2,000,000.00 美元	SJ CA 持股 100%
二、发行人参股公司					
1	凸版彩晶	913101157683915471	2004-11-24	6,400.00 万美元	中芯国际持股 30.00%
2	芯鑫租赁	91310115350670 83X5	2015-08-27	1,064,994.00 万元	中芯国际持股 7.44%
3	长电科技	91320200142248 781B	1998-11-06	160,287.4555 万元	芯电上海持股 14.28%
4	中芯协成	91110228592355 189F	2012-01-09	5,000.00 万元	中芯上海持股 49.00%
5	中芯聚源	91310000087837 486P	2014-02-27	3,000.00 万元	中芯上海持股 19.51%
6	灿芯半导体	91310115677813 273L	2008-07-17	536.439 万美元	中芯控股持股 34.75%
7	中芯宁波	91330206MA282 QRM1W	2016-10-14	182,000.00 万元	中芯控股持股 38.57%
8	中芯绍兴	91330600MA2B DY6H13	2018-03-09	588,000.00 万元	中芯控股持股 23.47%
9	上海创新	91310115MA1K 40GC95	2018-01-16	15,000.00 万元	中芯上海持股 33.33%
10	盛吉盛	91330200MA2A HN2244	2018-03-22	2,200.00 万美元	中芯控股持股 27.27%
11	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	91310000MA1FL 2G39Y	2016-06-27	221,275.00 万元	中芯晶圆作为有限合伙人持有 31.63%财产份额
12	北京吾金创业投资中心（有限合伙）	91110114318103 480R	2014-10-27	9,200.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 32.61%财产份额
13	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	91310115350747 163X	2015-08-25	15,100.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 66.23%财产份额
14	上海诚芯投资中心（有	91310115312208 652M	2014-08-05	3,673.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合

	限合伙）				伙人持有 31.50%财产份额
15	上海信芯投资中心（有限合伙）	91310115312237 7606	2014-08-05	168,860,99 3.77 元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 49.00%财产份额
16	上海聚源启泰投资中心（有限合伙）	91310115324709 77XK	2015-02-05	3,030.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 33.00%财产份额
17	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	91320500346175 158R	2015-07-07	11,152.76 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人持有 44.83%财产份额
18	上海华芯创业投资企业	91310000570811 198E	2011-03-31	78,790,772 美元	中芯国际持股 1.27%
19	上海新储集成电路有限公司	91310000682206 013P	2008-12-04	1,000.00 万元	中芯上海持股 19.00%
20	CFT Nordic	2436478	2016-10-07	204.00 万欧元	TJ Cayman 持股 49.00%
21	青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	91370211MA3C D1P303	2016-05-30	100,000.00 万元	中芯晶圆作为有限合伙人，持有 3.00%财产份额
22	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	91110108317922 88XB	2014-09-25	112,110.00 万元	中芯晶圆作为有限合伙人，持有 8.92%财产份额[1]
23	中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）	91120111MA06 AUN56D	2018-03-27	110,500.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人，持有 9.05%财产份额
24	上海物联网二期创业投资基金合伙	91310114MA1G T59D9N	2016-01-14	36,000.00 万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人，持有 3.61%财产份额

[1]根据发行人提供的《北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（2019 年签署），持股情况变更为中芯晶圆宁波持有 8.92%的财产份额，截至报告期末，尚未办理工商登记变更手续。2020 年 1 月 22 日，该次变更办理完毕工商登记手续。

	企业（有限合伙）				
25	盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91440300MA5F47LD0P	2018-05-07	161,616.00万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人，持有 10.21%财产份额
26	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	91320214MA1WCXRQ83	2018-04-16	30,250.00万元	中芯晶圆宁波作为有限合伙人，持有 16.53%财产份额

根据《招股说明书（申报稿）》，截至报告期末，中芯上海、中芯北京、中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方系发行人集成电路晶圆代工业务重要的经营主体，形成一定的生产销售规模或承担核心技术研发，于 2019 年末总资产规模占发行人合并财务报表总资产规模比例均超过 5%，属于重要子公司。上述重要子公司的基本情况如下：

1、 中芯上海

截至报告期末，中芯上海持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 2 月 9 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯上海的基本情况如下：

公司名称	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
注册资本	219,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91310115710939629R
法定代表人	ZHAO HAIJUN（赵海军）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号
成立日期	2000 年 12 月 21 日
营业期限	2000 年 12 月 21 日至 2050 年 12 月 20 日
经营范围	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师查验，截至报告期末，中芯上海的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯集电	219,000.00	100.00
合计		**219,000.00**	**100.00**

2、 中芯北京

截至报告期末，中芯北京持有北京市工商行政管理局于 2018 年 2 月 9 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯北京的基本情况如下：

公司名称	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司
注册资本	100,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	911103027404017237
法定代表人	ZHAO HAIJUN（赵海军）
住所	北京市北京经济技术开发区文昌大道 18 号
成立日期	2002 年 07 月 25 日
经营期限	2018 年 02 月 09 日至 2052 年 07 月 24 日
经营范围	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经本所律师查验，截至报告期末，中芯北京的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯集电	100,000.00	100.00
合计		**100,000.00**	**100.00**

3、 中芯天津

截至报告期末，中芯天津持有天津市市场和质量监督管理委员会于 2018 年 3 月 2 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯天津的基本情况如下：

公司名称	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司
注册资本	129,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91120111717869977N
法定代表人	ZHAO HAIJUN（赵海军）

住所	天津市西青经济开发区兴华道 19 号
成立日期	2003 年 11 月 03 日
经营期限	2003 年 11 月 03 日至 2053 年 11 月 02 日
经营范围	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师查验，截至报告期末，中芯天津的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯集电	129,000.00	100.00
合计		**129,000.00**	**100.00**

4、 中芯深圳

截至报告期末，中芯深圳持有深圳市市场监督管理局于 2019 年 3 月 4 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯深圳的基本情况如下：

公司名称	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司
注册资本	70,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外商合资）
统一社会信用代码	914403006729728144
法定代表人	ZHAO HAIJUN（赵海军）
住所	深圳市坪山区龙田街道出口加工区高芯路 18 号
成立日期	2008 年 03 月 20 日
经营期限	2008 年 03 月 20 日至 2058 年 03 月 20 日
经营范围	半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、销售自产产品。

经本所律师查验，截至报告期末，中芯深圳的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯控股	57,300.00	81.86
2	中芯集电	12,700.00	18.14
合计		**70,000.00**	**100.00**

5、 中芯北方

截至报告期末，中芯北方持有北京市工商行政管理局经济技术开发区分局于2019 年 7 月 8 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯北方的基本情况如下：

公司名称	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司
注册资本	480,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91110302071737747W
法定代表人	周子学
住所	北京市北京经济技术开发区文昌大道 18 号 9 幢
成立日期	2013 年 07 月 12 日
经营期限	2013 年 07 月 12 日至 2038 年 07 月 11 日
经营范围	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造（含线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造）、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经本所律师查验，截至报告期末，中芯北方的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	大基金一期	153,600.00	32.00
2	中芯控股	122,400.00	25.50
3	中芯集电	62,400.00	13.00
4	中芯北京	60,000.00	12.50
5	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	43,200.00	9.00
6	北京亦庄国际投资发展有限公司	27,600.00	5.75
7	中关村发展集团股份有限公司	5,400.00	1.125
8	北京工业发展投资管理有限公司	5,400.00	1.125
合计		**480,000.00**	**100.00**

6、 中芯南方[1]

[1]注：2020 年 5 月 15 日，中芯上海与中芯控股签订《股权转让协议》，将其所持中芯南方的全部股权转让予中芯控股，本次转让完成后，中芯控股持有中芯南方 50.10%股权。同日，中芯控股与大基金一期、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司、中芯南方签订《增资扩股协议》，本次增资完成后，中芯南方注册资本由 350,000 万美元增加至 650,000 万美元，中芯控股持股 38.52%，为第一大股东。

截至报告期末，中芯南方持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2019 年 10 月 21 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中芯南方的基本情况如下：

公司名称	中芯南方集成电路制造有限公司
注册资本	350,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91310115MA1K3K5P44
法定代表人	周子学
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 3 号楼 5 楼
成立日期	2016 年 12 月 01 日
经营期限	2016 年 12 月 01 日至 2066 年 11 月 30 日
经营范围	集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师查验，截至报告期末，中芯南方的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯控股	159,850.00	45.67
2	大基金一期	94,650.00	27.04
3	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	80,000.00	22.86
4	中芯上海	15,500.00	4.43
合计		**350,000.00**	**100.00**

7、 经本所律师查验，截至报告期末，发行人的其他子公司及参股公司的基本情况详见本律师工作报告附表四。

（六） 主要财产权利受到限制情形

根据发行人的说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至报告期末，发行人及其子公司的上述主要财产均通过合法途径取得，除将部分财产用于担保银行借款外，不存在其他设定抵押、质押及查封、冻结等权利限制的情形。

十一、 发行人的重大债权债务

（一） 重大合同

根据发行人提供的重大合同、订单等材料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人及其子公司正在履行以及在报告期内履行完毕的，且对其主要财产、生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的重大合同、订单如下：

1、 重大材料采购订单

发行人及其子公司截至报告期末正在履行的或报告期内已履行完毕的金额在 400.00 万美元以上的材料采购订单如下：

序号	供应商	采购产品	金额（美元）	签订日期
1	材料供应商一	硅片	6,500,000.00	2019-05-17
2		硅片	5,005,000.00	2019-05-17
3		硅片	4,884,000.00	2018-02-02
4		硅片	4,381,000.00	2019-02-25
5		硅片	4,130,000.00	2019-12-10
6	材料供应商二	硅片	5,820,800.00	2017-05-04
7		硅片	4,280,000.00	2017-01-17
8	材料供应商三	硅片	4,920,000.00	2019-06-25
9		硅片	4,312,500.00	2018-02-11
10		硅片	4,200,000.00	2018-08-02
11		光阻	4,022,650.00	2018-06-29
12	材料供应商四	研磨垫及研磨盘	4,539,761.25	2018-06-26
13		研磨垫及研磨盘	4,149,649.30	2017-12-29
14	材料供应商五	研磨液	4,324,400.20	2017-12-27
15	材料供应商六	硅片	4,181,000.00	2019-05-17
16		硅片	4,147,500.00	2017-11-08
17		硅片	4,070,000.00	2019-05-15
18	材料供应商七	研磨液	4,023,813.00	2017-12-27

2、 重大设备采购合同

发行人及其子公司与报告期内累计采购额前三的设备供应商签订的重大设备采购框架协议或单笔金额最大的订单如下：

序号	供应商	合同性质	采购产品	签订/更新日期	有效期至
1	Applied Materials Asia-Pacific., Ltd.,	框架协议	集成电路晶圆代工设备	2001-04-16 于 2019-04-30 修订	2022-04-30
2	ASML Hong Kong Ltd.,	框架协议	集成电路晶圆代工设备	2018-01-01	2020-12-31
3	Lam Research International Sarl	订单	集成电路晶圆代工设备	2019-12-25	-

3、 重大销售合同

发行人及其子公司与报告期各期前五大客户签订的销售框架协议如下：

序号	客户名称	销售内容	签订/更新日期	合同期限
1	客户一	集成电路晶圆代工	2012-09-03 修订于 2019-03-25	初始有效期 1 年，除约定情形外，到期后自动延长 1 年
2	客户二	集成电路晶圆代工	2006-09-22 修订于 2014-11-17	初始有效期 5 年，除约定情形外，到期后自动延长 2 年
3	客户三	集成电路晶圆代工	2016-12-22 修订于 2019-12-20	6 年
4	客户四	集成电路晶圆代工	2017-10-01	3 年
5	客户五	集成电路晶圆代工	2011-06-17	初始有效期 1 年，除约定情形外，到期后自动延长 1 年

4、 重大借款合同

截至报告期末发行人及其子公司正在履行的余额在 100,000.00 万元以上的借款合同如下：

序号	借款方	借款余额（万元）	贷款期限
1	国家开发银行	129,500.00	2016-05-26/2031-05-25
2	国家开发银行	215,572.50	2017-12-22/2024-12-21
3	中国进出口银行	139,610.00	2019-08-30/2024-08-30
4	中国工商银行（亚洲）	138,958.49	2019-08-21/2024-08-21
5	中国进出口银行	120,064.60	2016-03-23/2021-03-22

经本所律师查验，截至报告期末，上述发行人及其子公司正在履行的或在报告期内履行完毕的适用中国法律的重大合同、订单合法有效。截至本律师工作报告出具之日，未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

（二） 侵权之债

根据发行人的确认及《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三） 发行人与关联（连）方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

除已披露的关联(连)交易外(详见本律师工作报告正文第九部分“关联(连)交易及同业竞争”之“（二）关联（连）交易”），根据发行人的确认及《审计报告》，并经本所律师查验，发行人及其子公司与其他的关联（连）方之间不存在其他重大债权债务关系。

根据发行人的确认及《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人与除发行人子公司以外的关联（连）方之间不存在相互提供担保的情形。

（四） 发行人金额较大的其他应收款及其他应付款

根据《审计报告》及发行人的确认，发行人及其子公司报告期末其他应收款主要由应收押金及保证金等构成；发行人及其子公司报告期末其他应付款主要由应付资产采购款等构成。发行人及其子公司截至报告期末存在的其他应收款及其他应付款均因正常的经营活动产生。

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并

（一） 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的确认并经本所律师查验，报告期内发行人历次股本（份）变动已履行必要的内部决策程序（如涉及）（详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本（份）及其演变”之“（二）发行人报告期内股本（份）变动”）。经本所律师查验，发行人在报告期内未进行合并、分立或构成中国证监会相关规定界定之重大资产重组的收购、出售资产。

（二） 发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在拟进行的可能构成中国证监会相关规定所界定之重大资产重组的资产置换、资产剥离、资产出售或收购。

十三、 发行人公司章程的制定与修改

（一） 发行人在报告期内的章程修订情况

根据《开曼群岛法律意见书》，发行人现行有效的《公司章程》系由公司股东经适当程序审议通过并具有完全效力，内容符合开曼群岛法律的规定，不与开曼群岛现行的任何其他适用法律、法规、命令或法令相冲突或违反。根据《香港法律意见书》，发行人现行有效的《公司章程》未违反《香港上市规则》附录三及附录十三 B 部相关要求。

经本所律师查阅发行人于香港联交所的公告文件，发行人在报告期内就 2017 年法定股份增加（详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本（份）及其演变”之“（二）发行人报告期内股本及股份变动”之“1、法定股本变动”）及 2018 年注册办事处变更（经发行人董事会决议通过）在香港联交所公告了增加附注的《公司章程》，前述内容均已经包含在《公司章程（A 股上市后适用稿）》内并经发行人二零二零年第二次股东特别大会审议通过。

（二） 本次发行上市后适用的章程修改

经本所律师查验，《公司章程（A 股上市后适用稿）》已分别经发行人董事会及二零二零年第二次股东特别大会审议通过。根据发行人于 2020 年 5 月 8 日公告的《建议根据特别授权进行人民币股份发行建议修订组织章程大纲及章程细则及股东特别大会通告》，本次对《公司章程》进行修订主要涉及：（1）为满足本次发行上市的要求，加入有关 A 股发行、上市、存管、转让及其他事宜之条文；（2）为满足《科创板上市规则》的相关要求，使发行人对于境内投资者权益保护的安排总体不低于中国法律法规的规定，加入或修订有关董事会以及股东大会各自的权力和职责、股东召开股东大会及提名董事人选的权利、股东大会

以特别决议案批准之事项及其他条款；及（3）为反映发行人最新的公司资料（即本部分（一）中提及的法定股本变更和注册办事处变更），更新有关条款。

根据《开曼群岛法律意见书》，《公司章程（A 股上市后适用稿）》已由公司股东经适当程序审议通过并具有完全效力，《公司章程（A 股上市后适用稿）》的内容符合开曼群岛法律的规定，不与开曼群岛现行的任何其他适用法律、法规、命令或法令相冲突或违反。根据《香港法律意见书》，《公司章程（A 股上市后适用稿）》的内容符合《香港上市规则》附录三及附录十三 B 部相关要求。

综上，《公司章程（A 股上市后适用稿）》的内容符合适用法律法规的规定，《公司章程（A 股上市后适用稿）》已经由发行人股东大会审议通过，并将在本次发行上市完成后生效，发行人将在本次发行上市完成后向开曼群岛公司登记机关办理《公司章程（A 股上市后适用稿）》的备案。

十四、 发行人公司治理制度的建立健全及规范运作

（一） 发行人的组织机构

根据发行人现行有效的《公司章程》、有关内部决议等资料，发行人已建立了股东大会、董事会及董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，选举了董事（包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事）、各董事会下属专门委员会委员，并聘请了联合首席执行官、首席财务官、执行副总裁等高级管理人员。

根据《香港法律意见书》《开曼群岛法律意见书》，发行人现行有效的《公司章程》中关于发行人组织机构的相关规定符合香港联交所及开曼群岛相关法律法规的要求。

据此，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人具有完善的公司治理结构。

（二） 发行人的公司治理制度

经本所律师查验发行人现行有效的《公司章程》、有关内部决议等资料，发行人现行有效的《公司章程》规定了股东大会和董事会的职权，并针对股东大会和董事会的召开程序制定了相关规则。此外，发行人已经制定了《股东大会议事

规则》和《董事会议事规则》，前述议事规则已分别经发行人董事会及二零二零年第二次股东特别大会审议通过，并将在本次发行上市完成后生效。

此外，发行人已就董事会成员的委任与董事会下属专门委员会的运作制定或修改了《提名委员会章程》《审计委员会章程》《薪酬委员会章程》《战略委员会章程》，并就公司治理制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联（连）交易管理制度》《信息披露境内代表工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计章程》等内部控制制度文件。

根据《开曼群岛法律意见书》，上述内部控制制度已由公司董事会经适当程序审议通过并具有完全效力，不与开曼群岛现行的任何其他适用法律、法规、命令或法令相冲突或违反。

（三） 发行人的董事会、股东大会会议召开及授权

根据《香港法律意见书》，发行人报告期内历次股东大会、董事会的召集召开程序、关于应受《香港上市规则》监管的事项的决议内容及相关授权不存在违反《香港上市规则》有关股东大会通知、公告及通函披露的相关要求、董事会日期的通知要求以及附录十四《企业管治守则》要求的情形。

（四） 发行人本次发行上市对境内投资者权益保护水平总体上不低于中国境内法律法规规定的要求

发行人是一家根据开曼群岛法律设立的公司，其发行的普通股股票目前在香港联交所上市交易，其主要经营活动在境内，属于《若干意见》《科创板上市规则》和《实施办法》项下的红筹企业。本次发行上市完成后，发行人股票将同时在香港联交所和上交所科创板上市交易。根据《若干意见》和《科创板上市规则》和《实施办法》，红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规，但关于投资者权益保护的安排总体上应不低于中国法律法规规定的要求。经本所律师查验，发行人关于境内投资者权益保护的总体安排不低于中国法律法规及中国证监会的要求，详见本所律师出具的《上海市锦天城律师事务所关于 Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际

集成电路制造有限公司）对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律、行政法规及中国证监会要求的结论性意见》。

十五、 发行人董事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一） 发行人董事和高级管理人员的任职

根据发行人聘任董事和高级管理人员的会议文件及香港联交所报告期内董事及高级管理人员选举/聘任的公告文件，并经本所律师查验，发行人现任董事合计 14 名（其中独立非执行董事 5 名）、联合首席执行官 2 名、执行副总裁 2 名、首席财务官 1 名，发行人的董事每届任期为 3 年。截至本律师工作报告出具之日，前述人员在发行人处担任董事、高级管理人员的具体任职情况如下：

姓名	任职情况	选举/聘任程序
周子学	执行董事兼董事长	于 2015 年 06 月 26 日股东周年大会获任执行董事兼董事长 于 2017 年 06 月 23 日股东周年大会获任执行董事兼董事长
ZHAO HAIJUN（赵海军）	联合首席执行官	于 2013 年 04 月 24 日董事会获任执行副总裁及首席运营官 于 2017 年 05 月 10 日董事会获任首席执行官 于 2017 年 10 月 16 日该职务更名为联合首席执行官
	执行董事	于 2017 年 10 月 16 日董事会获任执行董事 于 2018 年 06 月 22 日股东周年大会获任执行董事
梁孟松	联合首席执行官	于 2017 年 10 月 16 日董事会获任联合首席执行官
	执行董事	于 2017 年 10 月 16 日董事会获任执行董事 于 2018 年 06 月 22 日股东周年大会获任执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会获任执行董事
高永岗	执行副总裁	于 2013 年 06 月 15 日董事会获任执行副总裁
	首席财务官	于 2014 年 02 月 17 日董事会获任首席财务官
	执行董事	于 2014 年 06 月 27 日股东周年大会获任执行董事 于 2017 年 06 月 23 日股东周年大会获任执行董事
陈山枝	非执行董事	于 2015 年 06 月 26 日股东周年大会获任非执行董事 于 2018 年 06 月 22 日股东周年大会获任非执行董事
周杰	非执行董事	于 2016 年 06 月 24 日股东周年大会获任非执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会获任非执行董事
任凯	非执行董事	于 2016 年 06 月 24 日股东周年大会获任非执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会获任非执行董事
路军	非执行董事	于 2016 年 06 月 24 日股东周年大会获任非执行董事 于 2018 年 06 月 22 日股东周年大会获任非执行董事

姓名	任职情况	选举/聘任程序
童国华	非执行董事	于 2017 年 02 月 14 日董事会获任非执行董事 于 2017 年 06 月 23 日股东周年大会获任非执行董事
WILLIAM TUDOR BROWN	独立非执行董事	于 2014 年 06 月 27 日股东周年大会获任独立非执行董事 于 2017 年 06 月 23 日股东周年大会获任独立非执行董事
JINGSHENG JASON CONG（丛京生）	独立非执行董事	于 2017 年 02 月 14 日董事会获任独立非执行董事 于 2017 年 06 月 23 日股东周年大会获任独立非执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会获任独立非执行董事
刘遵义	独立非执行董事	于 2018 年 06 月 22 日董事会获任独立非执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会任独立非执行董事
范仁达	独立非执行董事	于 2018 年 06 月 22 日董事会获任独立非执行董事 于 2019 年 06 月 21 日股东周年大会获任独立非执行董事
KWANG-LEEI YOUNG（杨光磊）	独立非执行董事	于 2019 年 08 月 07 日董事会获任独立非执行董事
ZHOU MEISHENG（周梅生）	技术研发执行副总裁	于 2017 年 10 月 16 日董事会获任技术研发执行副总裁

根据《开曼群岛法律意见书》《香港法律意见书》和发行人的确认，发行人董事、高级管理人员的委任未违反开曼群岛及香港联交所相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定。

根据发行人的确认和发行人董事、高级管理人员填写的调查表、《香港法律意见书》等文件，并经本所律师查询香港证监会、香港联交所网站公开信息，发行人现任董事、高级管理人员最近三年内不存在因违反香港联交所规范性法律文件而受到香港联交所纪律行动公开处罚（包括谴责、批评、市场禁入等）的情况，亦不存在因违反《证券及期货条例》及其他应受香港证监会监管的事宜而受到香港证监会执法行动处理的情况。

根据发行人的确认和发行人董事、高级管理人员取得的无违法犯罪证明、出具的承诺及调查表等文件，并经本所律师查询中国证监会、证券交易所网站公开信息，发行人现任董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，其任职资格符合中国证监会、上交所相关规范性法律文件的规定。

（二） 发行人最近两年董事和高级管理人员的变化

根据发行人聘任董事和高级管理人员的会议文件及报告期内发行人董事及高级管理人员选举/聘任的公告文件，并经本所律师查验，发行人最近两年内的董事、高级管理人员的任职变动情况如下：

1、 董事的变化

发行人最近两年内的董事的任职变动情况具体如下表所示：

时间	董事
2018-06-22	LIP-BU TAN（陈立武）、I-HUA CARMEN CHANG（周一华）不再担任独立非执行董事
	刘遵义、范仁达获任独立非执行董事
2018-06-30	邱慈云不再担任非执行董事兼副董事长
2019-06-14	蒋尚义不再担任独立非执行董事
2019-08-07	KWANG-LEEI YOUNG（杨光磊）获任独立非执行董事

2、 高级管理人员的变化

发行人最近两年内的高级管理人员的任职变动情况具体如下表所示：

时间	高级管理人员
2018-02-01	TIAN-SHEN TANG（汤天申）不再担任设计服务执行副总裁
2018-12-04	因职级调整，李智不再担任高级管理人员

根据发行人提供的资料并经本所律师查验，发行人的董事、高级管理人员在最近两年内的变动主要系发行人根据业务发展和完善公司治理结构的需要进行合理调整等原因所致，没有发生重大变化。

（三） 发行人的独立非执行董事

根据发行人选举/聘任的决议及公告文件，并经本所律师查验，发行人根据《公司章程》的规定聘任 WILLIAM TUDOR BROWN、JINGSHENG JASON CONG（丛京生）、刘遵义、范仁达、KWANG-LEEI YOUNG（杨光磊）为独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事总数三分之一以上。

根据《香港法律意见书》及发行人的确认，报告期内，发行人独立非执行董事不存在任职资格违反《香港上市规则》第 3.10 条有关专业资格及第 3.13 条有关独立性的相关要求的情形。

（四） 发行人的核心技术人员

根据发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人共有核心技术人员五名，该等人员最近两年均在发行人任职，具体任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	ZHAO HAIJUN（赵海军）	执行董事、联合首席执行官
2	梁孟松	执行董事、联合首席执行官
3	ZHOU MEISHENG（周梅生）	技术研发执行副总裁
4	ZHANG XIN（张昕）	运营与工程资深副总裁
5	吴金刚	技术研发副总裁

根据发行人核心技术人员签署的调查表，截至报告期末，除在发行人及其子公司、参股公司任职以外，前述核心技术人员未在其他经营同类业务的公司兼职。

根据发行人的确认，并经本所律师查验，最近两年发行人的核心技术人员未发生变动。

十六、 发行人及其境内子公司的税务

（一） 发行人及其境内子公司执行的主要税种、税率

根据《审计报告》及报告期内纳税申报表，并经本所律师查验，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

税种	税基	税率
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%及 25%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）；或应税销售额（应纳税额按当期应纳税销售额乘以征收率计算）	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%及 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%及 7%

1、 企业所得税

根据《开曼群岛法律意见书》及《审计报告》，发行人于报告期间在开曼群岛无须纳税。

根据《企业所得税法》，于 2008 年或其后外资企业分派其利润于直接控股公司（非中国居民企业）须按 10%税率代扣代缴预提所得税。如果中国内地与外商控股公司所在地区有优惠税率协议，则可采用较低的代扣代缴所得税率。

根据《企业所得税法》的规定，外商投资企业和国内企业的企业所得税的税率为 25%，除非适用特殊的优惠税率。

2、 增值税

一般计税方法下，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 17%、16%、13%、11%、10%、9%和 6%分别计算。简易计税方法下，应纳增值税额根据特定应税行为销售额的 5%、3%分别计算。

发行人自营产品，增值税实行免抵退的税收政策。根据财政部、国家税务总局于 2004 年 12 月 10 日颁布的《关于提高部分信息技术（IT）产品出口退税率的通知》（财税[2004]第 200 号），发行人代工晶圆的出口退税率为 17%；根据财政部、国家税务总局于 2018 年 4 月 4 日颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]第 32 号）及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，发行人代工晶圆的出口退税率为 16%。根据财政部、国家税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，发行人代工晶圆的出口退税率为 13%。

3、 其他税项

根据国务院于 2010 年 10 月 18 日颁布的《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号），从 2010 年 12 月 1 日起发行人按增值税、消费税、营业税之和的 1%（或 7%）及 3%缴纳城市维护建设税及教育费附加。从 2011 年 1 月 1 日起发行人按增值税、消费税、营业税之和的 2%缴纳地方教育费附加，其中，注册于上海的公司从 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间按增值税的 1%缴纳地方教育费附加。

经本所律师查验，发行人境内子公司报告期内执行的主要税种、税率符合中国法律法规的规定。

（二） 发行人境内子公司享受的税收优惠

根据《企业所得税法》及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠。

根据财政部、国家税务总局于 2008 年 2 月 22 日颁布的财税[2008]第 1 号通知，投资总额超过人民币 80 亿元或集成电路线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业，可按 15%的优惠税率纳税。如果企业经营期超过 15 年，则企业自过往年度税务亏损全数弥补后的首个获利年度起计五年豁免缴纳所得税，其后五年的所得税减半。根据《国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69 号），各类情形的定期减免税，均应按照企业所得税 25%的法定税率计算的应纳税额减半征税。

根据国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），重新执行财税[2008]第 1 号通知给予软件和集成电路企业的企业所得税优惠。

财政部、国家税务总局于 2012 年 4 月 20 日颁布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税的通知》（财税[2012]27 号），规定了集成电路产业发展的所得税政策。

国家税务总局、财政部及其他联合部委于 2016 年 5 月 4 日公布的财税[2016]49 号通知，强调落实备案制度、澄清税收优惠的若干准则建立备案后核查机制及加强监督管理。

国家税务总局、财政部及其他联合部委于 2018 年 3 月 28 日公布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2018]27 号），进一步公布对在 2018 年 1 月 1 日之前及之后成立的集成电路生产企业提供税收优惠，以及更新税收优惠的若干准则。财税[2008]第 1 号通知部分由该通知废除，财税[2008]第 1 号通知规定的优惠税率政策由该通知取代。财税[2016]49 号通知已部分被该通知废除。

根据发行人提供的税收优惠方面的资料，并经本所律师查验，发行人境内子公司于报告期内所享受的主要税收优惠政策如下：

1、 中芯上海

中芯上海取得发证时间为 2017 年 11 月 23 日的高新技术企业证书，自 2017 年度至 2019 年度的企业所得税税率为 15%。

2、 中芯北京

中芯北京作为集成电路生产企业，在完全弥补过往年度税务亏损后，自 2015 年起享有十年的企业所得税减免期（首五年全免，其后五年减半），2017 年至 2019 年享受企业所得税免税优惠。同时，中芯北京取得发证时间为 2015 年 12 月 30 日和 2018 年 11 月 30 日的高新技术企业证书。

3、 中芯天津

中芯天津作为集成电路生产企业，在完全弥补过往年度税务亏损后，自 2013 年起享有十年的企业所得税减免期（首五年全免，其后五年减半），2017 年享受企业所得税免税优惠，2018 年及 2019 年的企业所得税税率为 12.5%。同时，中芯天津取得发证时间为 2019 年 11 月 28 日的高新技术企业证书。

4、 中芯北方

中芯北方取得发证时间为 2019 年 12 月 2 日的高新技术企业证书。中芯北方于 2019 年适用 15%的企业所得税税率。于报告期内，中芯北方处于亏损阶段。

5、 中芯长电

中芯长电取得发证时间为 2016 年 11 月 30 日和 2019 年 11 月 22 日的高新技术企业证书，2017 年至 2019 年适用 15%的企业所得税税率。于报告期内，中芯长电处于亏损阶段[1]。

经本所律师查验，发行人境内子公司报告期内享受的上述税收优惠符合中国法律法规的规定。

（三） 发行人境内子公司享受的财政补贴

[1]中芯长电 2019 年度会计利润为盈利状态，但经纳税调节后仍呈税务亏损状态。

根据《审计报告》及发行人提供的报告期内主要财政补贴依据文件，发行人境内子公司在报告期内取得的主要财政补贴如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	计入非经常性损益金额	金额	计入非经常性损益金额	金额	计入非经常性损益金额
与资产相关	72,219.25	72,219.25	45,456.63	45,456.63	38,935.36	38,935.36
与收益相关	131,707.65	131,707.65	65,208.11	65,208.11	63,434.83	63,434.83
合计	**203,926.91**	**203,926.91**	**110,664.73**	**110,664.73**	**102,370.18**	**102,370.18**

（四） 发行人及其境内子公司的税务合规情况

根据发行人的确认、发行人境内子公司所在地税务主管部门出具的证明，并经本所律师查询相关公开信息，本所律师认为，发行人及其境内子公司在报告期内不存在因违反税务方面的中国法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十七、 发行人及其境内子公司的环境保护和产品质量、技术等标准

（一） 环境保护

1、 发行人所处行业不属于重污染行业

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)、《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

根据原国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105 号）的规定，重污染行业暂定为：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、酿造、造纸、发酵、纺织、制革。发行人所处行业不属于前述重污染行业。

2、 发行人境内子公司建设项目环境影响评价批复及验收文件情况

根据发行人提供的建设项目环境影响评价批复、环境保护竣工验收批复、专家组验收意见、环境保护竣工验收监测报告等资料及发行人的确认，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人境内子公司的建设项目均已根据环境保护相关法律法规的规定由有资质的环评机构出具了环境影响评价报告、取得了主管部门的环境影响批复文件；已经竣工验收的建设项目均已按照相关法律法规的规定取得了主管部门的环境影响竣工验收批复，或已组织自主验收。

3、 发行人境内子公司取得的《排污许可证》

根据发行人的确认，并经本所律师查验发行人境内子公司报告期内的《审计报告》、建设项目环境影响评价文件等资料，发行人境内实际从事生产且涉及污染物排放的子公司均已按照相关法律法规的规定取得了《排污许可证》。

根据发行人提供的《排污许可证》及本所律师对全国排污许可证管理信息平台(http://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/xkgg/xkgg!xkgg_cxggList.action)的查询结果，并经发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人境内子公司取得的《排污许可证》如下所列：

序号	单位名称	证书编号	生产经营场所地址	行业类别	有效期限	发证机关
1	中芯天津	91120111717869977N001R	天津市西青经济开发区兴华道 19 号	集成电路制造，锅炉	2019-12-31/ 2022-12-30	天津市西青区行政审批局
2	中芯北方	91110302071737747W001Q	北京市北京经济技术开发区文昌大道 18 号 9 幢	集成电路制造	2019-12-24/ 2022-12-23	北京经济技术开发区行政审批局
3	中芯北京	91110302740401723700 1Q	北京市北京经济技术开发区文昌大道 18 号	集成电路制造	2019-12-24/ 2022-12-23	北京经济技术开发区行政审批局
4	中芯上海	91310115710939629R001V	上海浦东新区张江路 18 号	集成电路制造，热力生产和供应	2019-12-25/ 2022-12-24	上海市浦东新区生态环境局
5	中芯南方	91310115MA1K3K5P44001Q	上海市浦东新区张江路 18 号中芯上海现有厂区内	集成电路制造	2019-12-20/ 2022-12-19	上海市浦东新区生态环境局

			西侧			
6	中芯深圳	91440300672972814400 1U	深圳市坪山区龙田街道出口加工区高芯路 18 号	集成电路制造	2019-12-06/ 2022-12-05	深圳市生态环境局坪山管理局
7	中芯长电	91320281321666575D001Z	江苏省江阴市长山大道 78 号	集成电路制造	2020-04-16/ 2023-04-15	无锡市生态环境局

4、 发行人境内子公司报告期内受到的环境保护行政处罚

根据深圳市坪山区环境保护和水务局于 2018 年 3 月 21 日出具的《深圳市坪山区环境保护和水务局行政处罚告知书》（深坪环罚告字[2018]108 号），坪山区环境监测站经监测认定中芯深圳 1#污水排放口化学需氧量浓度超标，属于超标排放废水，深圳市坪山区环境保护和水务局依据《深圳经济特区环境保护条例》第六十九条第一款的规定，对中芯深圳处以 13 万元罚款的行政处罚。

根据深圳市生态环境局于 2019 年 9 月 26 日出具的《关于中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司无重大环境违法违规证明的函》，中芯深圳因未按照《排污许可证》的规定排放水污染物，被深圳市生态环境局坪山管理局（原坪山区环境保护和水务局）处以罚款壹拾叁万元。该违法行为按照《深证市环境行政处罚裁量权实施标准》（第四版）适用较低档处罚，不属于重大环境违法违规行为。

据此，本所律师认为，中芯深圳前述违法违规行为不属于情节严重的重大违法违规行为。

根据发行人提供的银行电子回执，中芯深圳已于 2018 年 4 月 27 日向深圳市坪山区财政局缴纳了前述罚款。根据发行人的确认，中芯深圳受到该次处罚后积极采取了相应整改措施，确保废水达标排放。

根据深圳市生态环境局于 2020 年 4 月 30 日出具的《市生态环境局关于中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司环保守法情况的函》，中芯深圳自 2017 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日无其他环保行政处罚记录。

根据发行人及其子公司的确认、环境保护主管部门出具的证明、本所律师对相关环境保护主管部门网站的查询结果，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因违反环境保护方面法律法规而受到环境保护主管部门重大行政处罚的情形。

5、 发行人募集资金投资项目的环境保护情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，发行人本次发行上市募集资金投资项目之“12 英寸芯片 SN1 项目”的环境影响报告表已于 2017 年 8 月 24 日经上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局审批同意建设（沪浦环保许评[2017]1205 号），该项目之项目调整环境影响报告表已于 2019 年 6 月 19 日经上海市浦东新区生态环境局审批同意修改（沪浦环保许评[2019]292 号）。

发行人本次发行上市募集资金投资项目之“先进及成熟工艺研发项目储备资金”项目及“补充流动资金”项目不直接涉及环保投入，亦不涉及需要履行环境影响评价义务的情形。

综上，本所律师认为，报告期内，发行人及其境内子公司的生产经营活动符合国家和地方环境保护法律法规的要求，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情形，发行人的募集资金投资项目符合国家有关环境保护的要求。

（二） 产品质量、技术标准

根据发行人境内子公司所在地市场监督管理部门出具的证明，以及本所律师对国家企业信用信息公示系统、相关市场监督管理部门网站的查询结果及发行人的确认，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因违反产品质量与技术标准监督管理方面法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

十八、 发行人募集资金的运用

（一） 募集资金投资项目

根据发行人于 2020 年 6 月 1 日召开的二零二零年第二次股东特别大会审议通过的《有关人民币股份发行及特别授权之决议案》及《有关人民币股份发行募集资金的用途之决议案》，发行人本次发行上市的募集资金使用项目如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	拟投入资金比例
1	12 英寸芯片 SN1 项目	800,000.00	40.00%
2	先进及成熟工艺研发项目储备资金	400,000.00	20.00%
3	补充流动资金	800,000.00	40.00%

合计	**2,000,000.00**	**100.00%**

根据发行人于 2020 年 6 月 1 日召开的二零二零年第二次股东特别大会审议通过的《有关人民币股份发行募集资金的用途之决议案》，发行人本次募集资金运用已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与发行人的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。

如果募集资金超过上述投资项目的总额，发行人将按照有关规定履行必要的程序后把超募资金用于发行人主营业务。如果本次发行募集资金不足，发行人将通过自筹资金解决资金缺口。

本次发行上市发行人可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于发行人各子公司集成电路生产线建设及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

本次募集资金到位之前，发行人可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，募集资金到位后，发行人将首先置换前期投入的自筹资金，剩余款项按照募集资金使用的相关规定用于募集资金投资项目的后续建设。

本次募集资金投资项目中，“12 英寸芯片 SN1 项目”已于 2018 年 7 月 5 日在上海市张江高科技园区管委会备案并取得了《上海市外商投资项目备案证明》；“先进及成熟工艺研发项目储备资金”项目及“补充流动资金”项目不涉及需要在主管部门备案的情形。

（二） 募集资金投资项目的建设厂房及用地情况

1、 12 英寸芯片 SN1 项目

“12 英寸芯片 SN1 项目”为中芯南方“12 英寸芯片生产线 SN1 和 SN2 项目”的第一阶段。根据“12 英寸芯片 SN1 项目”的《上海市外商投资项目备案证明》，为加快项目进度，本项目分为厂房土建和生产线建设两个阶段进行；厂房土建以中芯上海为主体，已完成项目备案并取得了《上海市外商投资项目备案证明》；生产线建设以中芯南方为主体。中芯南方已租赁中芯上海厂房用于完成本项目的建设。

（1） “12 英寸芯片 SN1 项目”的建设厂房

根据上海达恩贝拉环境科技发展有限公司（建设项目环境影响评价资质证书编号：国环评证甲字第 1816 号）于 2017 年 8 月编制的《中芯南方集成电路制造有限公司 12 英寸芯片生产线 SN1 和 SN2 项目建设项目环境影响报告表》，该项目不新建厂房，由中芯南方租赁中芯上海的厂房、配套构建筑物及其他公建配套设施。

（2） “12 英寸芯片 SN1 项目”的用地情况

中芯南方租赁中芯上海的建设厂房建设“12 英寸芯片 SN1 项目”，该项目的建设用地权属情况详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（一）发行人拥有的不动产权”，中芯上海第 1 项不动产。

2、“先进及成熟工艺研发项目储备资金”项目及“补充流动资金”项目

经发行人的确认并经本所律师查验并经，本次募集资金投资项目中的“先进及成熟工艺研发项目储备资金”项目及“补充流动资金”项目均不涉及建设厂房及用地事项。

（三） 募集资金投资项目是否涉及与他人合作

根据募集资金投资项目的相关资料及发行人的确认，并经本所律师查验，本次募集资金投资项目中，中芯南方为“12 英寸芯片 SN1 项目”的实施主体（中芯南方的基本情况详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（五）发行人的对外投资”）。发行人本次募集资金投资项目不涉及与其他第三方新设主体使用募集资金的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市的募集资金投资项目已经得到了发行人有效的内部批准，并已按照规定履行了现阶段需要取得的政府相关部门备案手续，符合相关法律法规的规定，募集资金投资项目的实施不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

十九、 发行人的业务发展目标

（一） 根据发行人的确认并经本所律师查验，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标与主营业务一致。

（二） 根据发行人的确认并经本所律师查验，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合中国法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、 重大诉讼、仲裁或行政处罚

（一） 发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁情况

根据发行人提供的相关案件材料及本所律师对发行人法务部门相关负责人员的访谈，截至本律师工作报告出具之日，发行人尚未了结的主要诉讼、仲裁案件具体情况如下：

1、 与 Innovative Foundry Technologies LLC 的专利诉讼

原告 Innovative Foundry Technologies LLC（以下简称“IFT”）于 2019 年 12 月 20 日在美国德克萨斯州西区联邦地区法院针对发行人及相关子公司的下游客户提起了专利诉讼，诉讼请求主要为经济赔偿。

2020 年 4 月 2 日，发行人的相关子公司作为原告，主动在美国加利福尼亚州北区联邦地区法院针对 IFT 提起了确认不侵权之反诉，陈述并诉请法院判决确认发行人及相关子公司并未侵犯涉案专利权。此外，发行人的相关子公司也同时在美国专利及商标局，针对本案所涉及的相关专利权，提起了专利复审程序的申请（即 Inter Parte Review）。

根据发行人的确认，本案中，IFT 系一家 Non-Practicing Entity（以下简称“NPE”），该类型诉讼在美国科技类企业中较为常见，NPE 主要利用美国民事诉讼程序复杂、费用高昂等特点，通过提起诉讼或威胁提起诉讼的方式迫使案件相对方支付专利许可费用。

结合 NPE 诉讼的性质，以及发行人历史上曾处理过的类似 NPE 诉讼和争议的结果及经验，并经发行人确认，本案不会对发行人持续经营构成实质影响。据此，本所律师认为，本案不会构成发行人本次发行的实质性法律障碍。

2、 与 PDF SOLUTIONS, INC.的合同纠纷仲裁

原告 PDF SOLUTIONS, INC.（以下简称“PDF”）就其与中芯新技术签署的《Project Agreement》等一系列技术服务协议（以下简称“《技术服务协议》”）项下双方权利义务的履行情况存在争议，向香港国际仲裁中心提起了仲裁。中芯新技术于 2020 年 5 月 7 日收到香港国际仲裁中心出具的仲裁通知书。

PDF 要求中芯新技术支付《技术服务协议》项下的固定费用、奖励费用及逾期费用（结算至 2020 年 4 月 30 日）共计约 2,072 万美元。此外，PDF 还提出按照《技术服务协议》约定的最高标准收取后续的浮动费用，并由中芯新技术承担本案相关的仲裁费用、利息费用等要求。截至本律师工作报告出具之日，该案件尚在审理过程中。

经发行人确认，本案不会对发行人持续经营构成实质影响。据此，本所律师认为，本案不会构成发行人本次发行的实质性法律障碍。

根据相关境外法律意见书、发行人的确认及本所律师对发行人法务部门相关负责人员的访谈，并经本所律师通过“裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)”、“全国法院被执行人信息查询系统(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)”、“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”、“信用中国(https://creditcity.creditchina.gov.cn/)”等公示系统进行查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司不存在未决的重大诉讼、仲裁案件。

（二） 发行人的重大行政处罚情况

根据发行人提供的行政处罚相关材料、发行人的确认及主管部门出具的证明文件等，并经本所律师查验，发行人及其境内子公司报告期内不存在受到重大行政处罚的情形；本律师工作报告中披露的行政处罚均不构成重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

（三） 发行人主要股东诉讼、仲裁及司法程序等情况

根据《大唐香港法律意见书》，依据香港诉讼查册并经大唐香港的确认，截至 2020 年 5 月 18 日，大唐香港不存在重大诉讼、仲裁案件或受到重大行政处罚的情况。

根据《鑫芯香港法律意见书》，依据 2020 年 4 月 28 日香港诉讼查册情况并经鑫芯香港的确认，鑫芯香港在香港地区不存在正在进行的重大诉讼或司法程序

（包括由政府发起的诉讼或司法程序），在任何法庭或仲裁庭不存在针对或涉及鑫芯香港的诉讼、仲裁或其他程序，不存在针对鑫芯香港的未决或可预见的重大行政处罚情况。

（四） 发行人董事、高级管理人员及核心技术人员诉讼、仲裁及行政处罚等情况

根据《香港法律意见书》及《开曼群岛法律意见书》、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员填写的调查问卷、书面声明、有关部门出具的证明文件等相关材料，并经本所律师通过“裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)”、“全国法院被执行人信息查询系统(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)”、“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”、“信用中国(https://creditcity.creditchina.gov.cn/)”等公示系统进行的查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人的现任董事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》的讨论，已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别审阅了其中引用本律师工作报告及《法律意见书》的相关内容，《招股说明书（申报稿）》不存在因引用本律师工作报告及《法律意见书》相关内容产生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人符合《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板上市规则》《若干意见》《实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》等中国法律法规规定的已境外上市的红筹企业首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的主体资格和实质条件；发行人本次发行上市已取得了现阶段必要的批准与授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于 Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的律师工作报告》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：_____
顾功耘

经办律师：_____
鲍方舟

经办律师：_____
王　立

经办律师：_____
沈　诚

经办律师：_____
杨继伟

2020 年 6 月 1 日

附表一：主要专利权[1]

（一） 主要境内发明专利权[2]

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1	低压低功耗双栅金属氧化物半导体场效应晶体管混频器	ZL200510011928.0	中芯北京、北京大学	2005-06-14	2008-11-26	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
2	利用深亚微米 CMOS 标准工艺实现的 EEPROM 电平转换电路及方法	ZL200610089593.9	中芯北京、北京大学	2006-07-05	2008-08-20	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
3	一种横向双扩散场效应晶体管的制备方法	ZL200810103871.0	中芯北京、北京大学	2008-04-11	2010-06-23	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
4	电阻存储器、含有电阻存储器的集成电路的制作方法	ZL200810105304.9	中芯北京	2008-04-28	2011-11-30	原始取得	无
5	基于模型的校验光学邻近修	ZL200810105305.3	中芯北京	2008-04-28	2012-12-12	原始取得	无

[1] 本附表一系截至报告期末登记在发行人及其子公司名下的与其生产经营相关的主要专利权。此外，根据国家知识产权局专利局于 2020 年 4 月 23 日及 2020 年 4 月 24 日出具的《批量专利法律状态证明》，部分专利于 2020 年 4 月 24 日前失效或未按期缴纳专利相关费用且经发行人确认不再缴纳，对于该部分专利本表中未予列示。

[2] 本表所列第 5504 条至第 5965 条取得方式为继受取得的发明专利权属于由发行人及其子公司自主研发、自主向国家知识产权局申请相应专利并于获得相关专利权后将相关专利权转让给本表所列的当前专利权人的情形。

[3] 本表中取得方式为继受取得系指在专利权授权后发生专利权人著录信息变更的情况，本表中取得方式为原始取得系指在专利权授权后未发生专利权人著录信息变更的情况。

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	正的方法						
6	含有电阻存储器的集成电路的层间连接方法	ZL200810105306.8	中芯北京	2008-04-28	2010-11-10	原始取得	无
7	刻蚀后的灰化方法及刻蚀结构的形成方法	ZL200810105308.7	中芯北京	2008-04-28	2011-01-12	原始取得	无
8	半导体器件及栅极的形成方法	ZL200810105309.1	中芯北京	2008-04-28	2011-03-23	原始取得	无
9	电阻存储器、含有电阻存储器的集成电路的制作方法	ZL200810105310.4	中芯北京	2008-04-28	2011-07-06	原始取得	无
10	刻蚀停止层、具有通孔的半导体器件及其形成方法	ZL200810105311.9	中芯北京	2008-04-28	2011-01-12	原始取得	无
11	半导体器件、n 型 MOS 晶体管及其制作方法	ZL200810105617.4	中芯北京	2008-04-30	2011-08-24	原始取得	无
12	半导体器件、p 型 MOS 晶体管及其制作方法	ZL200810105618.9	中芯北京	2008-04-30	2011-07-06	原始取得	无
13	时间数字转换器及方法	ZL200810105620.6	中芯北京	2008-04-30	2012-08-22	原始取得	无
14	N 型轻掺杂区域的形成方法及半导体器件的制造方法	ZL200810105624.4	中芯北京	2008-04-30	2011-11-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
15	互补金属氧化物半导体器件及其制作方法	ZL200810105625.9	中芯北京	2008-04-30	2012-01-18	原始取得	无
16	锁相环频率合成器及调整调制信号频率的方法	ZL200810105626.3	中芯北京	2008-04-30	2012-08-22	原始取得	无
17	半导体器件的制造方法	ZL200810105900.7	中芯北京	2008-05-05	2011-10-05	原始取得	无
18	半导体器件的形成方法	ZL200810105902.6	中芯北京	2008-05-05	2010-09-22	原始取得	无
19	电阻存储器的存储单元及其制作方法	ZL200810105904.5	中芯北京	2008-05-05	2011-11-30	原始取得	无
20	氮化硅薄膜及 MIM 电容的形成方法	ZL200810105905.X	中芯北京	2008-05-05	2010-07-06	原始取得	无
21	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL200810105906.4	中芯北京	2008-05-05	2011-03-23	原始取得	无
22	层间介质层化学机械研磨方法	ZL200810105922.3	中芯北京	2008-05-05	2012-02-29	原始取得	无
23	栅极、半导体器件及栅极、掺杂区、含氮侧墙基层形成方法	ZL200810105923.8	中芯北京	2008-05-05	2011-03-23	原始取得	无
24	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL200810105933.1	中芯北京	2008-05-05	2011-10-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
25	静电放电保护结构的布图方法	ZL200810112507.0	中芯北京	2008-05-23	2011-05-04	原始取得	无
26	形成半导体互联结构的方法	ZL200810112509.X	中芯北京	2008-05-23	2011-03-23	原始取得	无
27	在电介质层上形成孔的方法	ZL200810112513.6	中芯北京	2008-05-23	2011-03-23	原始取得	无
28	去除光刻胶残留的方法	ZL200810112515.5	中芯北京	2008-05-23	2010-11-10	原始取得	无
29	随机存取存储器及其存储单元	ZL200810112775.2	中芯北京	2008-05-26	2011-07-06	原始取得	无
30	只读存储器单元阵列及其制作方法	ZL200810112776.7	中芯北京	2008-05-26	2011-03-23	原始取得	无
31	提高在不同基底上沉积的介质层厚度一致性的方法	ZL200810112777.1	中芯北京	2008-05-26	2011-03-23	原始取得	无
32	减小 NMOS 器件栅极诱导漏极漏电流的方法	ZL200810112801.1	中芯北京	2008-05-26	2011-07-06	原始取得	无
33	沟槽的刻蚀方法	ZL200810112807.9	中芯北京	2008-05-26	2011-11-30	原始取得	无
34	栅极及其形成方法	ZL200810113660.5	中芯北京	2008-05-29	2011-03-23	原始取得	无
35	锁相环电路	ZL200810113662.4	中芯北京	2008-05-29	2011-08-24	原始取得	无
36	静电放电保护电路	ZL200810113666.2	中芯北京	2008-05-29	2011-07-06	原始取得	无
37	多晶硅栅极、半导体器件及其	ZL200810113689.3	中芯北京	2008-05-29	2011-10-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	形成方法						
38	锁相环电路	ZL200810113690.6	中芯北京	2008-05-29	2011-08-24	原始取得	无
39	栅极形成方法	ZL200810113694.4	中芯北京	2008-05-29	2011-05-04	原始取得	无
40	修正光刻胶图形误差的方法	ZL200810113982.X	中芯北京	2008-05-30	2011-05-04	原始取得	无
41	掺杂区、阱区形成方法和基底图形化方法	ZL200810113985.3	中芯北京	2008-05-30	2012-01-18	原始取得	无
42	掺杂区形成方法	ZL200810113987.2	中芯北京	2008-05-30	2012-05-16	原始取得	无
43	MOS 晶体管及其形成方法	ZL200810113988.7	中芯北京	2008-05-30	2011-05-04	原始取得	无
44	通孔形成方法	ZL200810113993.8	中芯北京	2008-05-30	2010-09-22	原始取得	无
45	多晶硅栅极、侧墙、半导体器件及其形成方法	ZL200810113994.2	中芯北京	2008-05-30	2011-11-30	原始取得	无
46	应变 NMOS 器件以及应变 CMOS 器件的制造方法	ZL200810113997.6	中芯北京	2008-05-30	2011-05-04	原始取得	无
47	等离子体处理腔室中原位紫外线处理方法及应力氮化硅膜的形成方法	ZL200810113999.5	中芯北京	2008-05-30	2011-07-06	原始取得	无
48	应变金属氧化物半导体器件的制造方法	ZL200810114000.9	中芯北京	2008-05-30	2010-12-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
49	凸点下金属层和连接垫层的形成方法	ZL200810114066.8	中芯北京	2008-05-30	2011-07-06	原始取得	无
50	数据序列的检测方法及从数据序列中恢复信息的方法	ZL200810114068.7	中芯北京	2008-05-30	2013-01-30	原始取得	无
51	沟槽的形成方法	ZL200810114312.X	中芯北京	2008-06-03	2011-10-05	原始取得	无
52	用于保护芯片的半导体结构	ZL200810114313.4	中芯北京	2008-06-03	2012-06-20	原始取得	无
53	半导体刻蚀方法及刻蚀系统	ZL200810114316.8	中芯北京	2008-06-03	2012-05-23	原始取得	无
54	半导体器件栅极的形成方法和栅极刻蚀的控制系统	ZL200810114317.2	中芯北京	2008-06-03	2010-11-10	原始取得	无
55	一种实现多系统间互连的三维互连系统	ZL200810114485.1	中芯北京、北京大学	2008-06-03	2011-04-20	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
56	半导体制程中无机膜层刻蚀方法及浅沟槽隔离区形成方法	ZL200810115959.4	中芯北京	2008-06-30	2011-07-06	原始取得	无
57	晶圆清洗方法和清洗装置	ZL200810116051.5	中芯北京	2008-07-02	2011-07-06	原始取得	无
58	熔丝感应电路	ZL200810116052.X	中芯北京	2008-07-02	2011-11-30	原始取得	无
59	栅极结构的制造方法	ZL200810118403.0	中芯北京	2008-08-14	2012-10-31	原始取得	无
60	栅层的制造方法	ZL200810118404.5	中芯北京	2008-08-14	2011-05-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
61	半导体器件的制造方法	ZL200810118407.9	中芯北京	2008-08-14	2012-05-16	原始取得	无
62	去除光刻胶层的方法	ZL200810118408.3	中芯北京	2008-08-14	2011-10-05	原始取得	无
63	接触孔的形成方法	ZL200810118409.8	中芯北京	2008-08-14	2011-10-05	原始取得	无
64	电荷泵电路	ZL200810172764.3	中芯北京	2008-12-12	2012-10-31	原始取得	无
65	一种形成焊盘的两步刻蚀方法	ZL200810222112.6	中芯北京	2008-09-09	2012-04-25	原始取得	无
66	铝层的生长方法及金属-绝缘体-金属板	ZL200810222115.X	中芯北京	2008-09-09	2010-03-16	原始取得	无
67	一种光刻后注入离子的方法	ZL200810222119.8	中芯北京	2008-09-09	2011-10-05	原始取得	无
68	通孔刻蚀方法	ZL200810224596.8	中芯北京	2008-10-21	2011-04-20	原始取得	无
69	在晶圆上制造栅极的方法	ZL200810224597.2	中芯北京	2008-10-21	2011-07-20	原始取得	无
70	一种半导体器件栅极的制作方法	ZL200810224598.7	中芯北京	2008-10-21	2014-10-22	原始取得	无
71	PMOS 晶体管的制造方法及 PMOS 晶体管	ZL200810224805.9	中芯北京	2008-10-21	2012-08-22	原始取得	无
72	具有双镶嵌结构的半导体器件及其形成方法	ZL200810225758.X	中芯北京	2008-11-11	2012-04-18	原始取得	无
73	双镶嵌结构的形成方法	ZL200810225759.4	中芯北京	2008-11-11	2012-05-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
74	通孔及双镶嵌结构的形成方法	ZL200810225760.7	中芯北京	2008-11-11	2012-02-29	原始取得	无
75	氧化硅薄膜及金属-绝缘体-金属型电容的形成方法	ZL200810225923.1	中芯北京	2008-11-06	2012-07-18	原始取得	无
76	灰化处理方法	ZL200810226329.4	中芯北京	2008-11-13	2011-10-05	原始取得	无
77	浅沟槽形成方法	ZL200810226381.X	中芯北京	2008-11-14	2011-11-30	原始取得	无
78	半导体制造设备和半导体结构的刻蚀方法	ZL200810226383.9	中芯北京	2008-11-14	2011-05-04	原始取得	无
79	具有栅极侧壁层的半导体器件及其形成方法	ZL200810227174.6	中芯北京	2008-11-24	2012-05-16	原始取得	无
80	电镀方法	ZL200810227176.5	中芯北京	2008-11-24	2012-05-23	原始取得	无
81	等离子体气相沉积方法	ZL200810227177.X	中芯北京	2008-11-24	2012-01-18	原始取得	无
82	刻蚀方法	ZL200810227178.4	中芯北京	2008-11-24	2012-08-22	原始取得	无
83	半导体器件的制造方法	ZL200810227179.9	中芯北京	2008-11-24	2012-01-18	原始取得	无
84	调整间隙壁宽度的方法以及构造间隙壁的蚀刻方法	ZL200810227404.9	中芯北京	2008-11-25	2012-06-13	原始取得	无
85	非易失性存储器控制栅极字线的加工方法	ZL200910082356.3	中芯北京	2009-04-14	2012-04-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
86	实现打线封装的结构及其制作方法	ZL200910083426.7	中芯北京	2009-05-04	2012-03-28	原始取得	无
87	提高浮栅檫除效率的方法	ZL200910083467.6	中芯北京	2009-05-06	2012-03-14	原始取得	无
88	半导体制造工艺流程中掺杂栅极和漏、源极的方法	ZL200910083470.8	中芯北京	2009-05-06	2011-10-26	原始取得	无
89	沟槽刻蚀的方法及量测沟槽深度的装置	ZL200910084125.6	中芯北京	2009-05-20	2012-11-14	原始取得	无
90	构造晶片浅沟道隔离槽的方法	ZL200910084126.0	中芯北京	2009-05-20	2012-03-28	原始取得	无
91	半导体器件的栅极掺杂方法	ZL200910084127.5	中芯北京	2009-05-20	2013-03-20	原始取得	无
92	接触孔的形成方法	ZL200910084636.8	中芯北京	2009-05-18	2014-03-12	原始取得	无
93	一种无电容式 DRAM 单元及其制备方法	ZL200910085131.3	中芯北京、北京大学	2009-06-02	2011-06-15	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
94	一种阻变存储器	ZL200910085134.7	中芯北京、北京大学	2009-06-02	2011-01-26	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
95	碰撞电离金属氧化物半导体晶体管及制造方法	ZL200910085336.1	中芯北京	2009-05-21	2012-09-12	原始取得	无
96	提高 NMOS 晶体管电子迁移	ZL200910085435.X	中芯北京	2009-05-22	2012-12-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	率的方法						
97	形成沟槽的方法、形成金属连线的方法、光刻方法及设备	ZL200910085436.4	中芯北京	2009-05-22	2012-09-28	原始取得	无
98	光学邻近修正的方法	ZL200910085446.8	中芯北京	2009-05-22	2012-06-27	原始取得	无
99	对数据库进行光学邻近修正的方法	ZL200910085447.2	中芯北京	2009-05-22	2012-05-23	原始取得	无
100	离子注入的方法	ZL200910085448.7	中芯北京	2009-05-22	2011-11-23	原始取得	无
101	对晶片浅沟道隔离槽加工过程进行控制的方法	ZL200910085735.8	中芯北京	2009-05-27	2012-07-25	原始取得	无
102	制造太阳能电池的方法	ZL200910085996.X	中芯北京	2009-06-03	2012-07-25	原始取得	无
103	在晶圆上制造栅极的方法	ZL200910085997.4	中芯北京	2009-06-03	2012-02-01	原始取得	无
104	一种抗辐照的多叉指 CMOS 器件	ZL200910087223.5	中芯北京、北京大学	2009-06-19	2011-11-09	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
105	一种阻变存储器及其制备方法	ZL200910089611.7	中芯北京、北京大学	2009-07-24	2012-01-18	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
106	一种阻变存储器及其制备方法	ZL200910089612.1	中芯北京、北京大学	2009-07-24	2011-01-26	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
107	一种锗基肖特基晶体管的制	ZL200910090737.6	中芯北京、北京大学	2009-08-07	2012-05-30	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	备方法					北京：继受取得	
108	一种新型的抗总剂量辐照的 CMOS 集成电路	ZL200910092744.X	中芯北京、北京大学	2009-09-22	2011-01-19	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
109	一种抗总剂量辐照的 CMOS 集成电路	ZL200910093413.8	中芯北京、北京大学	2009-09-30	2012-05-30	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
110	具有 NMOS 器件抗总剂量辐照的新型集成电路	ZL200910093415.7	中芯北京、北京大学	2009-09-30	2011-05-04	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
111	一种去除芯片陶瓷封装体的方法	ZL200910195572.9	中芯北京、中芯上海	2009-09-11	2014-03-19	原始取得	无
112	光刻方法	ZL200910195831.8	中芯北京、中芯上海	2009-09-17	2013-06-19	原始取得	无
113	一种微机电装置及其制造方法	ZL200910196113.2	中芯北京、中芯上海	2009-09-22	2015-05-20	原始取得	无
114	存储器的电性地址与拓扑地址的转换方法	ZL200910197117.2	中芯北京、中芯上海	2009-10-13	2013-07-31	原始取得	无
115	CMOS 图像传感器的制作方法	ZL200910198351.7	中芯上海	2009-11-05	2013-05-29	原始取得	无
116	用于制造半导体器件的方法	ZL200910199444.1	中芯上海	2009-11-26	2013-06-19	原始取得	无
117	半导体电容装置	ZL200910200705.7	中芯北京、中芯上海	2009-12-24	2014-03-12	原始取得	无
118	一种基于平面工艺自对准制	ZL201010100144.6	中芯北京、北京大学	2010-01-22	2011-08-24	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	备隧穿场效应晶体管的方法					北京：继受取得	
119	一种自对准制备平面碰撞电离场效应晶体管的方法	ZL201010100174.7	中芯北京、北京大学	2010-01-22	2011-07-27	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
120	一种可在 BJT 和 MOSFET 之间相互转变的器件	ZL201010103868.6	中芯北京、北京大学	2010-01-29	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
121	一种基于氧化和化学机械抛光工艺制备超细线条的方法	ZL201010128839.5	中芯北京、北京大学	2010-03-22	2011-10-26	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
122	PMOS 器件源漏泄漏缺陷的检测方法	ZL201010128882.1	中芯北京、中芯上海	2010-03-19	2013-07-31	原始取得	无
123	磁性隧道结结构的制作方法	ZL201010130889.7	中芯上海	2010-03-24	2013-05-29	原始取得	无
124	一种制备超窄槽的方法	ZL201010153583.3	中芯北京、北京大学	2010-04-23	2012-01-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
125	一种低电压阻变存储器及其制备方法	ZL201010158789.5	中芯北京、北京大学	2010-04-28	2012-06-13	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
126	一种有机阻变存储器及制备方法	ZL201010161422.9	中芯北京、北京大学	2010-05-04	2012-08-29	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
127	一种多态有机阻变存储器及制备方法	ZL201010162689.X	中芯北京、北京大学	2010-05-05	2011-06-22	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
128	一种静电保护器件及其制备方法	ZL201010163416.7	中芯北京、北京大学	2010-05-05	2011-10-26	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
129	一种实时监测晶体管温度的热表征方法及结构	ZL201010163419.0	中芯北京、北京大学	2010-05-06	2012-07-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
130	抗总剂量辐照的 SOI 器件及其制造方法	ZL201010164465.2	中芯北京、北京大学	2010-04-30	2012-05-30	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
131	一种抗总剂量辐照的 SOI 器件及其制造方法	ZL201010164471.8	中芯北京、北京大学	2010-04-30	2012-05-30	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
132	通孔的形成方法	ZL201010192346.8	中芯北京、中芯上海	2010-06-04	2013-09-25	原始取得	无
133	一种离子注入机机械臂装卸托盘	ZL201010192482.7	中芯北京、中芯上海	2010-06-04	2013-08-14	原始取得	无
134	一种等离子体刻蚀机反应腔均匀环倾斜警报装置	ZL201010216455.9	中芯北京、中芯上海	2010-06-30	2013-12-18	原始取得	无
135	一种提高机械手臂运动准确性的装置及其使用方法	ZL201010216469.0	中芯北京、中芯上海	2010-06-30	2013-09-25	原始取得	无
136	一种沟道应力引入方法及采用该方法制备的场效应晶体管	ZL201010219177.2	中芯北京、北京大学	2010-07-07	2012-07-04	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
137	一种应变沟道场效应晶体管及其制备方法	ZL201010219179.1	中芯北京、北京大学	2010-06-25	2012-05-30	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
138	基于非化学剂量比的氮氧硅的双极阻变存储器及制备方法	ZL201010223393.4	中芯北京、北京大学	2010-07-12	2012-02-22	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
139	控制不平坦硅片表面上的图形的关键尺寸的方法	ZL201010229224.1	中芯北京、中芯上海	2010-07-16	2013-09-04	原始取得	无
140	一种 SOI 场效应晶体管的散热结构	ZL201010259659.0	中芯北京、北京大学	2010-08-23	2012-02-15	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
141	提高 MRAM 中的 MTJ 金属间电介质的填充能力的方法	ZL201010261517.8	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-04-16	原始取得	无
142	嵌入 MRAM 的集成电路及该集成电路的制备方法	ZL201010261538.X	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-03-19	原始取得	无
143	减小写入干扰的分离栅闪存制作方法	ZL201010261549.8	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-01-08	原始取得	无
144	化学机械研磨工艺的返工方法	ZL201010261562.3	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2013-12-18	原始取得	无
145	LDMOSESD 结构	ZL201010261575.0	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-02-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
146	一种离子注入工艺中防止栅极损坏的方法	ZL201010261589.2	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-03-12	原始取得	无
147	嵌入衰减式相位移光罩及其制作方法	ZL201010261599.6	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2014-08-13	原始取得	无
148	校验 DUT 板质量的方法	ZL201010261633.X	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2013-12-04	原始取得	无
149	制备双大马士革结构的方法	ZL201010262784.7	中芯北京、中芯上海	2010-08-24	2013-08-14	原始取得	无
150	电压转换速率控制电路	ZL201010267080.9	中芯北京、中芯上海	2010-08-27	2014-04-09	原始取得	无
151	相变存储器件及其制造方法	ZL201010285160.7	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2014-02-19	原始取得	无
152	制备金属硅化物的方法	ZL201010285178.7	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2015-05-20	原始取得	无
153	一种用于检测光刻过程中照明条件的结构及其检测方法	ZL201010285285.X	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2014-07-16	原始取得	无
154	台阶状硅锗源/漏结构的制造方法	ZL201010285697.3	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2013-10-23	原始取得	无
155	一种磁性随机存取存储器磁性隧道结层制造方法	ZL201010285719.6	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2014-11-26	原始取得	无
156	双大马士革结构中的沟槽刻蚀方法	ZL201010285788.7	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2014-06-04	原始取得	无
157	金属栅 MOS 器件的接触孔刻	ZL201010285797.6	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2014-03-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	蚀方法						
158	台阶状硅锗源/漏结构的制造方法	ZL201010285821.6	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2013-11-13	原始取得	无
159	一种半导体纳米圆环的制备方法	ZL201010506128.7	中芯北京、北京大学	2010-10-09	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
160	湿法处理方法及回蚀方法	ZL201010508098.3	中芯北京、中芯上海	2010-10-15	2014-03-19	原始取得	无
161	MOS 器件的 SPICE 测试结构	ZL201010508099.8	中芯北京、中芯上海	2010-10-15	2014-02-12	原始取得	无
162	MOSFET 形成方法	ZL201010511963.X	中芯北京	2010-10-12	2014-03-12	原始取得	无
163	NMOS 晶体管的制造方法	ZL201010511973.3	中芯北京	2010-10-12	2013-09-04	原始取得	无
164	CMOS 晶体管的制作方法	ZL201010511991.1	中芯北京	2010-10-12	2014-06-04	原始取得	无
165	栅极结构及其制造方法	ZL201010517824.8	中芯北京	2010-10-15	2014-11-05	原始取得	无
166	一种 T 型栅结构的低功耗隧穿场效应晶体管	ZL201010530475.3	中芯北京、北京大学	2010-11-03	2011-12-28	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
167	形成双镶嵌结构的方法、半导体器件	ZL201010532035.1	中芯北京	2010-10-29	2014-07-02	原始取得	无
168	NMOS 晶体管的制作方法	ZL201010532046.X	中芯北京	2010-10-29	2014-03-12	原始取得	无
169	NMOS 晶体管的制造方法	ZL201010532047.4	中芯北京	2010-10-29	2014-09-03	原始取得	无
170	半导体器件的制造方法	ZL201010532048.9	中芯北京	2010-10-29	2014-03-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
171	一种检测掩膜版雾状缺陷的方法	ZL201010534162.5	中芯北京、中芯上海	2010-11-05	2015-04-29	原始取得	无
172	相变随机存储器的制造方法	ZL201010534177.1	中芯北京、中芯上海	2010-11-05	2014-02-12	原始取得	无
173	提高相变材料粘附性的实现方法	ZL201010534179.0	中芯北京、中芯上海	2010-11-05	2015-06-10	原始取得	无
174	消除相变随机存储器下电极损伤的实现方法	ZL201010534186.0	中芯北京、中芯上海	2010-11-05	2014-06-04	原始取得	无
175	半导体器件制造方法	ZL201010543458.3	中芯北京、中芯上海	2010-11-12	2015-05-20	原始取得	无
176	薄膜厚度的监控方法	ZL201010551355.1	中芯北京	2010-11-19	2014-03-12	原始取得	无
177	相变存储器的制作方法	ZL201010552266.9	中芯北京	2010-11-19	2013-09-04	原始取得	无
178	晶体管及其制作方法	ZL201010558393.X	中芯北京	2010-11-24	2014-07-02	原始取得	无
179	晶体管及其制作方法	ZL201010559188.5	中芯北京	2010-11-24	2014-04-02	原始取得	无
180	晶体管及其制作方法	ZL201010559189.X	中芯北京	2010-11-24	2014-01-08	原始取得	无
181	MOS 晶体管的形成方法	ZL201010559824.4	中芯北京	2010-11-25	2015-06-03	原始取得	无
182	晶体管及其制作方法	ZL201010560075.7	中芯北京	2010-11-24	2015-03-11	原始取得	无
183	相变存储器深沟槽隔离结构及制作方法	ZL201010560166.0	中芯北京	2010-11-25	2014-03-12	原始取得	无
184	一种低功耗复合源结构 MOS	ZL201010560176.4	中芯北京、北京大学	2010-11-25	2012-03-07	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	晶体管及其制备方法					北京：继受取得	
185	双重图形化的方法、形成互连结构的方法	ZL201010560208.0	中芯北京	2010-11-25	2015-04-29	原始取得	无
186	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201010560217.X	中芯北京	2010-11-25	2014-09-03	原始取得	无
187	相变存储器制造方法	ZL201010560261.0	中芯北京	2010-11-25	2013-12-04	原始取得	无
188	掺杂外延层的掺杂杂质浓度的监控方法	ZL201010565093.4	中芯北京	2010-11-29	2014-04-02	原始取得	无
189	半导体器件的形成方法	ZL201010565095.3	中芯北京	2010-11-29	2014-04-02	原始取得	无
190	晶体管的制作方法	ZL201010565896.X	中芯北京	2010-11-29	2015-03-11	原始取得	无
191	硅锗外延层的形成方法	ZL201010566044.2	中芯北京	2010-11-29	2015-07-08	原始取得	无
192	晶圆表面光阻去边的方法	ZL201010566050.8	中芯北京	2010-11-29	2013-12-04	原始取得	无
193	一种半导体器件的形成方法	ZL201010566057.X	中芯北京	2010-11-29	2013-12-04	原始取得	无
194	应变记忆作用的半导体器件的制造方法及应力层结构	ZL201010567123.5	中芯北京	2010-11-30	2014-09-03	原始取得	无
195	双重图形化方法	ZL201010568205.1	中芯北京	2010-11-30	2013-08-07	原始取得	无
196	晶体管及其形成方法	ZL201010568261.5	中芯北京	2010-11-30	2014-05-07	原始取得	无
197	光学平台的形成方法	ZL201010568274.2	中芯北京	2010-11-30	2014-07-02	原始取得	无
198	一种半导体装置及使用方法	ZL201010568293.5	中芯北京	2010-11-30	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
199	形成栅极的方法	ZL201010568295.4	中芯北京	2010-11-30	2014-06-04	原始取得	无
200	形成栅极的方法	ZL201010568297.3	中芯北京	2010-11-30	2013-11-06	原始取得	无
201	一种金属栅极及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201010568376.4	中芯北京	2010-11-30	2013-09-04	原始取得	无
202	晶体管的制作方法	ZL201010568378.3	中芯北京	2010-11-30	2014-03-12	原始取得	无
203	相变存储器的制作方法	ZL201010568380.0	中芯北京	2010-11-30	2014-04-02	原始取得	无
204	相变存储器的制作方法	ZL201010568382.X	中芯北京	2010-11-30	2014-01-01	原始取得	无
205	半导体器件及其形成方法	ZL201010569390.6	中芯北京	2010-12-01	2014-05-07	原始取得	无
206	互连结构的制造方法	ZL201010569402.5	中芯北京	2010-12-01	2014-09-03	原始取得	无
207	检测通孔缺陷的方法	ZL201010571132.1	中芯北京	2010-12-02	2014-12-03	原始取得	无
208	晶圆表面光阻去边的方法	ZL201010571138.9	中芯北京	2010-12-02	2014-06-04	原始取得	无
209	一种金属栅极及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201010571163.7	中芯北京	2010-12-02	2013-11-06	原始取得	无
210	晶体管的制作方法	ZL201010571330.8	中芯北京	2010-12-02	2014-03-12	原始取得	无
211	形成栅极的方法	ZL201010571419.4	中芯北京	2010-12-02	2014-07-02	原始取得	无
212	相变存储器制造方法	ZL201010571432.X	中芯北京	2010-12-02	2015-09-02	原始取得	无
213	一种细线条的制备方法	ZL201010572032.0	中芯北京、北京大学	2010-12-03	2012-07-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
214	形成准 SOI 结构的方法	ZL201010573114.7	中芯北京	2010-12-03	2014-04-02	原始取得	无
215	抛光装置及其异常处理方法	ZL201010573122.1	中芯北京	2010-12-03	2015-01-21	原始取得	无
216	相变存储器的形成方法	ZL201010573140.X	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
217	晶体管制作方法	ZL201010573149.0	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
218	等离子清洁装置	ZL201010573196.5	中芯北京	2010-12-03	2015-06-03	原始取得	无
219	连接件的制造方法	ZL201010573199.9	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
220	铜互连结构及其形成方法	ZL201010573225.8	中芯北京	2010-12-03	2013-12-04	原始取得	无
221	相位移掩模版及其制造方法、雾状缺陷检测方法	ZL201010573244.0	中芯北京	2010-12-03	2014-06-04	原始取得	无
222	应变 CMOS 器件的制作方法	ZL201010573256.3	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
223	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201010573301.5	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
224	金属前介质层及其制造方法	ZL201010573303.4	中芯北京	2010-12-03	2014-03-12	原始取得	无
225	双重图形化方法	ZL201010573305.3	中芯北京	2010-12-03	2014-11-05	原始取得	无
226	一种去除工艺腔内静电吸盘上污染颗粒的方法	ZL201010573587.7	中芯北京、中芯上海	2010-12-03	2015-12-16	原始取得	无
227	测温装置及扩散炉	ZL201010592886.5	中芯北京	2010-12-16	2016-05-25	原始取得	无
228	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL201010592926.6	中芯北京	2010-12-16	2014-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
229	静态随机存储器的制造方法	ZL201010593192.3	中芯北京	2010-12-16	2014-07-30	原始取得	无
230	LED 封装结构	ZL201010593195.7	中芯北京	2010-12-16	2014-05-07	原始取得	无
231	一种闪存单元形成方法	ZL201010593211.2	中芯北京	2010-12-16	2015-04-29	原始取得	无
232	相变存储器的加热层制备方法	ZL201010594920.2	中芯北京	2010-12-17	2013-10-09	原始取得	无
233	芯片尺寸封装方法及封装结构	ZL201010599212.8	中芯北京	2010-12-21	2015-04-29	原始取得	无
234	MIM 电容器及其制备方法	ZL201010599891.9	中芯北京、中芯上海	2010-12-20	2015-06-10	原始取得	无
235	抛光方法	ZL201010603419.8	中芯北京	2010-12-23	2014-11-05	原始取得	无
236	相变存储器及其制备方法	ZL201010607709.X	中芯北京	2010-12-27	2014-09-03	原始取得	无
237	相变存储器及其制备方法	ZL201010608394.0	中芯北京	2010-12-27	2014-02-05	原始取得	无
238	LDMOS 晶体管,布局方法和制作方法	ZL201010608460.4	中芯北京	2010-12-27	2014-07-02	原始取得	无
239	一种抛光垫修整方法	ZL201010610236.9	中芯北京、中芯上海	2010-12-23	2015-01-07	原始取得	无
240	非易失性存储器及其数据读取方法	ZL201010612649.0	中芯北京	2010-12-29	2015-10-14	原始取得	无
241	晶体管及其制作方法	ZL201010612652.2	中芯北京	2010-12-29	2014-12-03	原始取得	无
242	金属氧化物半导体器件及其	ZL201010612921.5	中芯北京	2010-12-29	2014-09-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	形成方法						
243	晶体管及其制作方法	ZL201010613284.3	中芯北京	2010-12-29	2014-12-24	原始取得	无
244	半导体器件的形成方法	ZL201010616772.X	中芯北京	2010-12-30	2014-12-03	原始取得	无
245	应变记忆作用的半导体器件的制造方法	ZL201010617131.6	中芯北京	2010-12-30	2014-12-24	原始取得	无
246	检测 MOCVD 反应系统情况的方法	ZL201010619752.8	中芯北京、中芯上海	2010-12-29	2014-08-27	原始取得	无
247	一种闪存的测试方法	ZL201010619789.0	中芯北京、中芯上海	2010-12-29	2015-07-29	原始取得	无
248	一种晶圆测试方法	ZL201010620289.9	中芯北京、中芯上海	2010-12-29	2015-11-25	原始取得	无
249	半导体器件及其制作方法	ZL201010620300.1	中芯北京、中芯上海	2010-12-29	2014-10-22	原始取得	无
250	纳米晶快闪存储器栅极的制造方法	ZL201010620308.8	中芯北京、中芯上海	2010-12-29	2014-11-26	原始取得	无
251	MOS 晶体管的制造方法	ZL201010620464.4	中芯北京	2010-12-31	2015-04-29	原始取得	无
252	NMOS 晶体管的形成方法	ZL201010620564.7	中芯北京	2010-12-31	2014-09-24	原始取得	无
253	一种梳状栅复合源 MOS 晶体管及其制作方法	ZL201110021444.X	中芯北京、北京大学	2011-01-19	2012-07-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
254	一种带杂质分凝的复合源 MOS 晶体管及其制备方法	ZL201110021486.3	中芯北京、北京大学	2011-01-19	2012-12-19	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
255	一种锗基肖特基 N 型场效应晶体管的制备方法	ZL201110026949.5	中芯北京、北京大学	2011-01-25	2012-07-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
256	基于氧化分凝的埋沟结构硅基围栅晶体管及其制备方法	ZL201110029601.1	中芯北京、北京大学	2011-01-27	2012-12-19	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
257	一种基于纳米线器件的耐高压横向双向扩散晶体管	ZL201110029706.7	中芯北京、北京大学	2011-01-27	2012-07-25	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
258	晶体管及其制作方法	ZL201110031951.1	中芯北京	2011-01-30	2014-12-03	原始取得	无
259	一种叉指型栅结构的低功耗隧穿场效应晶体管	ZL201110048595.4	中芯北京、北京大学	2011-03-01	2012-05-02	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
260	一种提取 MOS 管沿沟道电荷分布的方法	ZL201110053772.8	中芯北京、北京大学	2011-03-07	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
261	一种阻变存储器及其制备方法	ZL201110070280.X	中芯北京、北京大学	2011-03-23	2012-07-18	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
262	一种抑制闪存编程干扰的工艺方法	ZL201110084807.4	中芯北京、北京大学	2011-04-06	2012-08-29	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
263	无衬底引出半导体器件的栅介质层陷阱密度的测试方法	ZL201110087463.2	中芯北京、北京大学	2011-04-08	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
264	硅纳米线晶体管器件可编程	ZL201110089699.X	中芯北京、北京大学	2011-04-11	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	阵列的制备方法					北京：继受取得	
265	一种锗基 MOS 器件衬底的表面钝化方法	ZL201110098970.6	中芯北京、北京大学	2011-04-20	2012-12-19	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
266	COMS 器件辐照位移损伤区在沟道相对位置的估算方法	ZL201110103196.3	中芯北京、北京大学	2011-04-25	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
267	半导体器件及其制造方法	ZL201110121749.8	中芯北京	2011-05-12	2015-04-08	原始取得	无
268	在半导体制造工艺中形成硬掩模的方法	ZL201110131583.8	中芯北京	2011-05-20	2015-06-17	原始取得	无
269	一种空气为侧墙的围栅硅纳米线晶体管的制备方法	ZL201110139058.0	中芯北京、北京大学	2011-05-26	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
270	以空气为侧墙的围栅硅纳米线晶体管的制备方法	ZL201110139305.7	中芯北京、北京大学	2011-05-27	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
271	空气侧墙围栅硅纳米线晶体管的制备方法	ZL201110139383.7	中芯北京、北京大学	2011-05-27	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
272	一种以空气为侧墙的围栅硅纳米线晶体管的制备方法	ZL201110139453.9	中芯北京、北京大学	2011-05-26	2012-08-29	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
273	一种隧穿场效应晶体管及其制备方法	ZL201110144333.8	中芯北京、北京大学	2011-05-31	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
274	半导体器件的制造方法	ZL201110147173.2	中芯北京	2011-06-02	2016-01-06	原始取得	无
275	半导体器件的制造方法	ZL201110147175.1	中芯北京	2011-06-02	2016-03-30	原始取得	无
276	半导体器件的制造方法	ZL201110147455.2	中芯北京	2011-06-02	2015-05-13	原始取得	无
277	半导体器件的制备方法	ZL201110152847.8	中芯北京	2011-06-09	2015-08-12	原始取得	无
278	半导体器件及其制造方法	ZL201110152931.X	中芯北京	2011-06-09	2016-04-13	原始取得	无
279	半绝缘体上硅半导体器件及其制造方法	ZL201110153290.X	中芯北京	2011-06-09	2015-03-04	原始取得	无
280	半导体器件的制造方法	ZL201110164683.0	中芯北京	2011-06-20	2015-04-01	原始取得	无
281	半导体器件及其制造方法	ZL201110164686.4	中芯北京	2011-06-20	2016-11-30	原始取得	无
282	一种锗基 NMOS 器件及其制备方法	ZL201110171004.2	中芯北京、北京大学	2011-06-23	2012-12-19	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
283	半导体器件和用于制造半导体器件的方法	ZL201110173872.4	中芯北京	2011-06-27	2015-01-28	原始取得	无
284	制造半导体器件的方法和半导体器件	ZL201110173874.3	中芯北京	2011-06-27	2014-10-29	原始取得	无
285	半导体器件及其制造方法	ZL201110197676.0	中芯北京	2011-07-15	2015-06-17	原始取得	无
286	半导体器件的制造方法	ZL201110197909.7	中芯北京	2011-07-15	2015-12-16	原始取得	无
287	半导体器件的制造方法	ZL201110197911.4	中芯北京	2011-07-15	2015-08-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
288	半导体器件及其制造方法	ZL201110201271.X	中芯北京	2011-07-19	2016-03-16	原始取得	无
289	半导体器件及其制造方法	ZL201110201273.9	中芯北京	2011-07-19	2016-06-01	原始取得	无
290	半导体器件及其制造方法	ZL201110201413.2	中芯北京	2011-07-19	2016-03-02	原始取得	无
291	一种双围栅结构的隧穿场效应晶体管及其制备方法	ZL201110217282.7	中芯北京、北京大学	2011-07-29	2012-10-10	北京大学：原始取得；中芯北京：继受取得	无
292	一种半导体器件制作方法	ZL201110218931.5	中芯北京	2011-08-02	2015-05-13	原始取得	无
293	半导体器件及其制造方法	ZL201110220340.1	中芯北京	2011-08-03	2015-07-22	原始取得	无
294	一种制作半导体器件的方法	ZL201110220347.3	中芯北京	2011-08-03	2015-04-22	原始取得	无
295	半导体器件及其制造方法	ZL201110227476.5	中芯北京	2011-08-10	2015-04-22	原始取得	无
296	半导体器件及其制造方法	ZL201110227479.9	中芯北京	2011-08-10	2015-07-29	原始取得	无
297	半导体器件的制造方法	ZL201110227768.9	中芯北京	2011-08-10	2015-03-04	原始取得	无
298	半导体器件制造方法	ZL201110233890.7	中芯北京	2011-08-16	2015-06-17	原始取得	无
299	电控操作器	ZL201110234386.9	中芯北京	2011-08-16	2015-03-04	原始取得	无
300	一种制作半导体器件的方法	ZL201110235045.3	中芯北京	2011-08-16	2015-03-11	原始取得	无
301	半导体器件及其制造方法	ZL201110243428.5	中芯北京	2011-08-24	2015-05-13	原始取得	无
302	半导体器件及其制造方法	ZL201110246794.6	中芯北京	2011-08-26	2016-04-13	原始取得	无
303	半导体装置及其制造方法	ZL201110248458.5	中芯北京	2011-08-26	2016-03-30	原始取得	无
304	一种锗基 MOS 器件衬底的表	ZL201110259567.7	中芯北京、北京大学	2011-09-05	2012-12-19	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	面钝化方法					北京：继受取得	
305	图案,掩模图案形成方法和半导体器件制造方法	ZL201110261499.8	中芯北京	2011-09-06	2015-12-16	原始取得	无
306	半导体器件及其制造方法	ZL201110266369.3	中芯北京	2011-09-09	2016-02-10	原始取得	无
307	半导体器件制造方法	ZL201110268485.9	中芯北京	2011-09-13	2015-07-22	原始取得	无
308	半导体器件及其制造方法	ZL201110270585.5	中芯北京	2011-09-14	2015-07-08	原始取得	无
309	半导体晶片及其处理方法	ZL201110278871.6	中芯北京	2011-09-20	2015-07-22	原始取得	无
310	静电放电保护电路和静电放电保护方法	ZL201110281322.4	中芯北京	2011-09-21	2015-02-11	原始取得	无
311	双栅晶体管及其制造方法	ZL201110282916.7	中芯北京	2011-09-22	2015-08-19	原始取得	无
312	光刻对准标记以及包含其的掩模板和半导体晶片	ZL201110285659.2	中芯北京	2011-09-23	2015-10-21	原始取得	无
313	半导体器件及其制造方法	ZL201110295406.3	中芯北京	2011-09-27	2016-03-09	原始取得	无
314	用于晶片边缘曝光的方法、光学模块和自动聚焦系统	ZL201110295452.3	中芯北京	2011-09-29	2014-11-26	原始取得	无
315	光刻设备	ZL201110295458.0	中芯北京	2011-09-29	2015-03-04	原始取得	无
316	光致抗蚀剂和光刻的方法	ZL201110295647.8	中芯北京	2011-09-29	2015-02-04	原始取得	无
317	光刻方法	ZL201110300889.1	中芯北京	2011-09-29	2015-04-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
318	检测标记的设备和方法以及半导体器件加工系统	ZL201110300891.9	中芯北京	2011-09-29	2015-04-01	原始取得	无
319	弹性固定轮及包含其的晶圆适配器	ZL201110301433.7	中芯北京	2011-09-29	2015-04-22	原始取得	无
320	化学机械抛光方法和化学机械抛光设备	ZL201110302495.X	中芯北京	2011-10-09	2016-07-06	原始取得	无
321	蚀刻后的处理方法	ZL201110313586.3	中芯北京	2011-10-17	2015-11-25	原始取得	无
322	一种新型的磁隧穿结器件及其制造方法	ZL201110317543.2	中芯北京	2011-10-19	2015-06-03	原始取得	无
323	一种新型的磁隧穿结器件及其制造方法	ZL201110318281.1	中芯北京	2011-10-19	2016-03-30	原始取得	无
324	相变存储器及其制造方法	ZL201110322547.X	中芯北京	2011-10-21	2015-03-04	原始取得	无
325	掩模板及其制造方法、以及监测掩模板雾状污染的方法	ZL201110330676.3	中芯北京	2011-10-27	2014-07-23	原始取得	无
326	制造半导体器件的方法	ZL201110332325.6	中芯北京	2011-10-28	2015-10-21	原始取得	无
327	一种半导体器件制作方法	ZL201110335055.4	中芯北京	2011-10-28	2015-06-17	原始取得	无
328	半导体器件及其制造方法	ZL201110340752.9	中芯北京	2011-11-02	2016-08-10	原始取得	无
329	半导体装置的制造方法	ZL201110354553.3	中芯北京	2011-11-10	2016-04-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
330	半导体装置及其制造方法	ZL201110354571.1	中芯北京	2011-11-10	2016-05-18	原始取得	无
331	半导体器件及其制造方法	ZL201110360297.9	中芯北京	2011-11-15	2015-04-08	原始取得	无
332	半导体器件及其制造方法	ZL201110376996.2	中芯北京	2011-11-24	2015-09-30	原始取得	无
333	半导体器件及其制造方法	ZL201110377035.3	中芯北京	2011-11-24	2016-01-06	原始取得	无
334	半导体器件及其制造方法	ZL201110379131.1	中芯北京	2011-11-25	2015-09-16	原始取得	无
335	用于处理晶圆的反应装置、静电吸盘和晶圆温度控制方法	ZL201110379158.0	中芯北京	2011-11-25	2016-08-03	原始取得	无
336	半导体器件及其制造方法	ZL201110398750.5	中芯北京	2011-12-05	2016-02-03	原始取得	无
337	芯片与晶片的接合方法以及三维集成半导体器件	ZL201110410223.1	中芯北京	2011-12-12	2016-05-04	原始取得	无
338	集成半导体器件及其制造方法	ZL201110410241.X	中芯北京	2011-12-12	2015-12-09	原始取得	无
339	半导体器件及其制造方法	ZL201110412676.8	中芯北京	2011-12-12	2016-08-17	原始取得	无
340	半导体器件和半导体器件制造方法	ZL201110412974.7	中芯北京	2011-12-13	2016-08-24	原始取得	无
341	用于处理晶圆的反应装置、静电吸盘和晶圆温度控制方法	ZL201110434746.X	中芯北京	2011-12-22	2016-08-31	原始取得	无
342	注入装置及处理设备	ZL201110452845.0	中芯北京	2011-12-30	2016-01-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
343	半导体器件制造方法	ZL201110453192.8	中芯北京	2011-12-30	2015-04-08	原始取得	无
344	喷淋头以及半导体处理设备	ZL201110453494.5	中芯北京	2011-12-30	2015-11-25	原始取得	无
345	鳍片式场效应晶体管及其制造方法	ZL201110458242.1	中芯北京	2011-12-31	2015-10-21	原始取得	无
346	一种互补结型场效应晶体管 c-JFET 器件及其后栅极的制造方法	ZL201110458243.6	中芯北京	2011-12-31	2016-04-13	原始取得	无
347	具有改进排布方式的通孔阵列和具有该阵列的半导体器件	ZL201110458372.5	中芯北京	2011-12-23	2016-04-13	原始取得	无
348	半导体器件的制作方法	ZL201110459120.4	中芯北京	2011-12-31	2015-10-14	原始取得	无
349	半导体器件及其制造方法	ZL201110459129.5	中芯北京	2011-12-31	2015-04-08	原始取得	无
350	半导体器件的制造方法	ZL201110459144.X	中芯北京	2011-12-31	2016-03-02	原始取得	无
351	半导体器件及其制造方法	ZL201110459160.9	中芯北京	2011-12-31	2016-06-22	原始取得	无
352	结型场效应晶体管及其制造方法	ZL201110459177.4	中芯北京	2011-12-31	2016-08-17	原始取得	无
353	半导体器件及其制造方法	ZL201110459310.6	中芯北京	2011-12-31	2016-01-06	原始取得	无
354	LDMOS 器件及其形成方法	ZL201310341827.4	中芯北京、中芯上海	2013-08-07	2018-06-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
355	晶体管的形成方法	ZL201310378974.9	中芯北京、中芯上海	2013-08-27	2017-07-14	原始取得	无
356	一种 FinFET 器件及其制造方法	ZL201310379313.8	中芯北京、中芯上海	2013-08-27	2017-08-01	原始取得	无
357	电容式压力传感器及其形成方法	ZL201310381786.1	中芯北京、中芯上海	2013-08-28	2016-12-28	原始取得	无
358	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310398091.4	中芯北京、中芯上海	2013-09-04	2017-07-14	原始取得	无
359	一种半导体器件的制造方法	ZL201310459968.6	中芯北京、中芯上海	2013-09-27	2017-06-16	原始取得	无
360	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310474009.1	中芯北京、中芯上海	2013-10-11	2017-06-13	原始取得	无
361	光学邻近修正模型的获取方法	ZL201310505289.8	中芯北京、中芯上海	2013-12-23	2019-03-29	原始取得	无
362	金属栅极 CMP 工艺及半导体器件的制造方法	ZL201310562536.8	中芯北京、中芯上海	2013-11-13	2018-07-24	原始取得	无
363	鳍式场效应管的形成方法	ZL201310698046.0	中芯北京、中芯上海	2013-12-18	2017-11-03	原始取得	无
364	可穿戴智能设备及可穿戴智能设备的互动方法	ZL201310741185.7	中芯北京、中芯上海	2013-12-27	2018-12-21	原始取得	无
365	一种形成 FinFET 器件的鳍片的方法	ZL201410045930.9	中芯北京、中芯上海	2014-02-08	2018-08-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
366	一种晶圆选择性键合方法	ZL201410089051.6	中芯北京	2014-03-12	2016-08-17	原始取得	无
367	一种键合结构的制造方法	ZL201410108911.6	中芯北京	2014-03-21	2017-12-29	原始取得	无
368	一种 MEMS 器件的制作方法	ZL201410114224.5	中芯北京	2014-03-25	2016-05-18	原始取得	无
369	MEMS 压力传感器及其制作方法	ZL201410117606.3	中芯北京	2014-03-27	2017-09-29	原始取得	无
370	一种半导体器件的制造方法	ZL201410160807.1	中芯北京、中芯上海	2014-04-21	2018-03-30	原始取得	无
371	一种集成电路的设计方法和集成电路	ZL201410163001.8	中芯北京、中芯上海	2014-04-22	2018-03-16	原始取得	无
372	一种半导体器件的制造方法、半导体器件和电子装置	ZL201410166586.9	中芯北京、中芯上海	2014-04-24	2019-09-03	原始取得	无
373	芯片中静态电流失效器件的检测方法和装置	ZL201410182150.9	中芯北京、中芯上海	2014-04-30	2017-11-14	原始取得	无
374	半导体检测结构及形成方法、检测方法	ZL201410185201.3	中芯北京、中芯上海	2014-05-04	2018-03-09	原始取得	无
375	一种用于 HTOL 测试的闪存设置方法	ZL201410195902.5	中芯北京、中芯上海	2014-05-09	2019-04-09	原始取得	无
376	一种半导体结构失效分析方法	ZL201410195953.8	中芯北京	2014-05-09	2018-02-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
377	互连结构及其形成方法	ZL201410229127.0	中芯北京、中芯上海	2014-05-27	2019-01-25	原始取得	无
378	半导体结构的形成方法	ZL201410234152.8	中芯北京、中芯上海	2014-05-29	2019-01-22	原始取得	无
379	半导体器件及其制造方法	ZL201410268654.2	中芯北京、中芯上海	2014-06-17	2018-05-15	原始取得	无
380	一种半导体器件的制造方法	ZL201410281295.4	中芯北京、中芯上海	2014-06-20	2018-10-23	原始取得	无
381	热处理腔室和热处理方法、涂布设备	ZL201410350605.3	中芯北京、中芯上海	2014-07-22	2018-03-09	原始取得	无
382	半导体装置及其制造方法	ZL201410500240.8	中芯北京、中芯上海	2014-09-26	2018-11-13	原始取得	无
383	制造半导体装置的方法	ZL201410500255.4	中芯北京、中芯上海	2014-09-26	2019-02-26	原始取得	无
384	半导体器件及其形成方法	ZL201510456885.0	中芯北京、中芯上海	2015-07-29	2019-09-27	原始取得	无
385	层叠 MIM 电容检测结构及其检测方法	ZL201510492691.6	中芯北京、中芯上海	2015-08-12	2019-01-04	原始取得	无
386	三维晶体管的形成方法	ZL201510526717.4	中芯北京、中芯上海	2015-08-25	2019-11-01	原始取得	无
387	减薄磷化铟层的方法	ZL201510531734.7	中芯北京、中芯上海	2015-08-26	2019-09-27	原始取得	无
388	晶圆结构及其形成方法和喷淋装置	ZL201510547844.2	中芯北京、中芯上海	2015-08-31	2019-08-27	原始取得	无
389	测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201510612745.8	中芯北京、中芯上海	2015-09-23	2019-04-26	原始取得	无
390	静电放电保护结构及其形成	ZL201510654344.9	中芯北京、中芯上海	2015-10-10	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
391	一种半导体测试结构及测试方法	ZL201510666862.2	中芯北京、中芯上海	2015-10-15	2019-03-29	原始取得	无
392	半导体器件的形成方法	ZL201510691122.4	中芯北京、中芯上海	2015-10-22	2019-09-27	原始取得	无
393	半导体器件及其制造方法	ZL201510742087.4	中芯北京、中芯上海	2015-11-04	2019-12-03	原始取得	无
394	互连结构的形成方法和曝光对准系统	ZL201510746891.X	中芯北京、中芯上海	2015-11-05	2019-07-02	原始取得	无
395	纳米线半导体器件及其形成方法	ZL201510897267.X	中芯北京、中芯上海	2015-12-08	2019-09-27	原始取得	无
396	抛光垫及其监测方法和监测系统	ZL201510898297.2	中芯北京、中芯上海	2015-12-08	2019-11-01	原始取得	无
397	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201610343965.X	中芯北京、中芯上海	2016-05-23	2019-06-28	原始取得	无
398	一种 MEMS 麦克风及其制作方法	ZL201610498069.0	中芯北京、中芯上海	2016-06-29	2019-12-03	原始取得	无
399	半导体测试单元及半导体测试结构	ZL201610620291.3	中芯北京、中芯上海	2016-08-01	2019-12-10	原始取得	无
400	静电放电 ESD 保护器件以及	ZL201610626293.3	中芯北京、中芯上海	2016-08-02	2019-12-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	保护电路的方法						
401	多晶硅质量检测样品的制备方法及质量检测方法	ZL201610639191.5	中芯北京、中芯上海	2016-08-05	2019-08-27	原始取得	无
402	芯片应力测试组件及其制备方法	ZL201710186774.1	中芯北京、中芯上海	2017-03-27	2019-12-10	原始取得	无
403	70 纳米多晶硅栅刻蚀－氟化+反应离子刻蚀方法	ZL00135749.2	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2000-12-19	2005-03-02	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
404	采用锗或锑预无定形注入及清洗的钛硅化物方法	ZL00135750.6	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2000-12-19	2004-03-31	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
405	锗预无定形注入结合低能注入形成超浅源漏延伸区的方法	ZL00135751.4	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2000-12-19	2004-01-07	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
406	一种钴－自对准硅化物的方法	ZL00135752.2	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2000-12-19	2004-01-07	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
407	一种场效应晶体管	ZL03105084.0	北京大学、中芯上海	2003-03-06	2007-02-28	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						上海：继受取得	
408	一种组合栅场效应晶体管	ZL03105085.9	中芯上海、北京大学	2003-03-06	2006-09-06	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
409	一种适用于超深亚微米领域的场效应晶体管及其制备方法	ZL03131044.3	中芯上海、北京大学	2003-05-16	2004-12-29	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
410	双沟道积累型变容管及其制造方法	ZL03137436.0	中芯上海、北京大学	2003-06-20	2007-05-02	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
411	一种双栅金属氧化物半导体晶体管及其制备方法	ZL03137771.8	北京大学、中芯上海	2003-06-24	2007-06-20	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
412	一种制备空洞层上的硅场效应晶体管的方法	ZL03149753.5	北京大学、中芯上海	2003-08-05	2005-07-06	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
413	一种源漏下陷型超薄体 SOIMOS 晶体管及其制作方法	ZL200310103424.2	北京大学、中芯上海	2003-10-31	2007-07-25	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
414	一种位于 SOI 衬底上的 CMOS 电路结构及其制作方法	ZL200410009317.8	中芯上海、北京大学	2004-07-09	2007-01-31	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
415	一种体硅 MOS 晶体管的制作方法	ZL200410009320.X	北京大学、中芯上海	2004-07-09	2009-04-15	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
416	可减小增益波动的压控振荡器	ZL200410009955.X	北京大学、中芯上海	2004-12-03	2008-07-30	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
417	可减小增益波动的压控振荡器	ZL200410009956.4	北京大学、中芯上海	2004-12-03	2008-04-23	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
418	宽频带的压控振荡器	ZL200410009957.9	北京大学、中芯上海	2004-12-03	2008-07-30	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
419	用于低非线性度模-数转换器的器件与方法	ZL200410017099.2	中芯上海	2004-03-15	2010-04-07	原始取得	无
420	场效应晶体管的制备方法	ZL200410101391.2	北京大学、中芯上海	2004-12-21	2007-05-02	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
421	用于应变硅 MOS 晶体管的金属硬掩模方法和结构	ZL200510023524.3	中芯上海	2005-01-18	2010-10-06	原始取得	无
422	形成存储结接触孔的方法	ZL200510027615.4	中芯上海	2005-07-07	2011-04-20	原始取得	无
423	用于存储器系统的高性能读出放大器及相应的方法	ZL200510030004.5	中芯上海	2005-09-22	2010-10-13	原始取得	无
424	用于选择性光学图形补偿的方法与系统	ZL200510030306.2	中芯上海	2005-09-28	2010-12-15	原始取得	无
425	超大规模集成电路设计中保	ZL200510052691.0	中芯上海、中国科学	2005-03-03	2008-06-11	中国科学院微电子研究所：	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	持时间快速收敛的方法		院微电子研究所			原始取得；中芯上海：继受取得	
426	锁相环指示器	ZL200510110860.1	中芯上海	2005-11-29	2010-10-06	原始取得	无
427	一种快闪存储器结构及其制备方法	ZL200510127626.X	北京大学、中芯上海	2005-12-06	2008-01-30	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
428	一种肖特基势垒 MOS 晶体管及其制作方法	ZL200510130001.9	中芯上海、北京大学	2005-12-08	2008-05-21	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
429	采用电感实现的射频信号集成静电释放保护电路	ZL200610001709.9	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2006-01-23	2008-12-17	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
430	一种闪存存储单元的制备方法	ZL200610012185.3	北京大学、中芯上海	2006-06-09	2009-03-11	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
431	单端单位延迟元件	ZL200610023744.0	中芯上海	2006-01-28	2011-05-11	原始取得	无
432	制造分离的双栅场效应晶体管的方法	ZL200610023749.3	中芯上海、中芯北京	2006-02-06	2013-06-19	原始取得	无
433	修正光学近距效应的图形分割方法	ZL200610024872.7	中芯上海	2006-03-20	2012-05-23	原始取得	无
434	一种消防恒压供水系统	ZL200610025837.7	中芯上海	2006-04-19	2010-09-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
435	宽输入共模电压比较器及低共模电压比较器	ZL200610026321.4	中芯上海	2006-04-30	2010-05-12	原始取得	无
436	半导体器件的制造方法	ZL200610026761.X	中芯上海	2006-05-22	2010-05-12	原始取得	无
437	使基于模型的光学近似修正更精确的方法	ZL200610027446.9	中芯上海	2006-06-08	2011-06-08	原始取得	无
438	光刻胶残留物的清洗方法	ZL200610027584.7	中芯上海	2006-06-12	2011-12-07	原始取得	无
439	TEM 样品最小有效厚度的检测方法	ZL200610028786.3	中芯上海	2006-07-10	2010-12-22	原始取得	无
440	一种有效降低高压 LDNMOS 截止电流并避免双峰特性的 IMP 方法及其应用	ZL200610028923.3	中芯上海	2006-07-13	2011-06-22	原始取得	无
441	接触孔形成方法	ZL200610029917.X	中芯上海	2006-08-10	2011-05-11	原始取得	无
442	半导体器件中金属硅化物接触的制造方法	ZL200610030799.4	中芯上海	2006-09-04	2010-11-10	原始取得	无
443	一种制备低栅扩展电容绝缘体上硅体接触器件的方法	ZL200610112701.X	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2006-08-30	2009-04-22	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
444	一种硼磷硅玻璃膜回流方法	ZL200610116167.X	中芯上海	2006-09-18	2011-07-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
445	一种防止晶圆表面氧化膜破坏的晶圆清洗方法	ZL200610117987.0	中芯上海	2006-11-03	2010-12-15	原始取得	无
446	信用处理装置和流控制传输装置及其方法	ZL200610118298.1	中芯上海	2006-11-13	2011-10-05	原始取得	无
447	建立光学近接修正模型的方法	ZL200610118821.0	中芯上海	2006-11-28	2011-07-06	原始取得	无
448	用于自对准蚀刻的系统和方法	ZL200610119024.4	中芯上海	2006-11-30	2011-03-23	原始取得	无
449	金属前介质层形成方法及其结构	ZL200610119164.1	中芯上海	2006-12-05	2010-09-29	原始取得	无
450	继电器控制电路的控制方法	ZL200610147396.8	中芯上海	2006-12-15	2010-11-24	原始取得	无
451	高速外设部件互连接口及信号处理方法	ZL200610147794.X	中芯上海	2006-12-22	2010-09-29	原始取得	无
452	多芯片半导体封装结构及封装方法	ZL200610148239.9	中芯上海	2006-12-28	2011-12-07	原始取得	无
453	半导体器件及其制作方法	ZL200610148248.8	中芯上海	2006-12-28	2012-01-25	原始取得	无
454	扫描曝光机校准度检测方法	ZL200710036530.1	中芯上海	2007-01-17	2010-09-29	原始取得	无
455	改善掩膜关键尺寸趋势的制	ZL200710037153.3	中芯上海	2007-02-06	2011-03-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	造方法						
456	浅沟槽隔离区、浅沟槽隔离区掩膜版及浅沟槽隔离区制造方法	ZL200710037439.1	中芯上海	2007-02-12	2010-04-21	原始取得	无
457	光学邻近修正方法	ZL200710037441.9	中芯上海	2007-02-12	2010-09-29	原始取得	无
458	紫外线处理装置及形成应力膜的方法	ZL200710037670.0	中芯上海	2007-02-13	2012-07-11	原始取得	无
459	数据检测电路	ZL200710037684.2	中芯上海	2007-02-14	2012-06-20	原始取得	无
460	一种可提高药液配制效率的药液配制装置以及配制方法	ZL200710037832.0	中芯上海	2007-03-06	2011-06-01	原始取得	无
461	互补性金属氧化物半导体场效应晶体管的制造方法	ZL200710037833.5	中芯上海	2007-03-06	2010-06-16	原始取得	无
462	一种提高 MOS 器件阈值电压稳定性的方法	ZL200710038221.8	中芯上海	2007-03-20	2010-04-21	原始取得	无
463	引线框架	ZL200710038446.3	中芯上海	2007-03-22	2010-06-09	原始取得	无
464	半导体器件的制造方法及半导体器件	ZL200710038447.8	中芯上海	2007-03-22	2011-10-05	原始取得	无
465	确定最佳高频偏压值的方法	ZL200710039183.8	中芯上海	2007-04-06	2010-06-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
466	栅介质层完整性的测试结构的测试方法	ZL200710039252.5	中芯上海	2007-04-03	2010-05-19	原始取得	无
467	多晶硅薄膜的制备方法	ZL200710039785.3	中芯上海	2007-04-20	2011-03-23	原始取得	无
468	再分布结构及其制作方法和再分布凸点及其制作方法	ZL200710040237.2	中芯上海	2007-04-24	2011-05-11	原始取得	无
469	半导体器件及半导体器件的栅极制作方法	ZL200710040239.1	中芯上海	2007-04-24	2010-05-19	原始取得	无
470	CMOS 驱动电路	ZL200710040244.2	中芯上海	2007-04-24	2010-05-19	原始取得	无
471	光学近距修正的方法	ZL200710040245.7	中芯上海	2007-04-24	2011-10-05	原始取得	无
472	弹性缓冲装置	ZL200710040246.1	中芯上海	2007-04-24	2011-07-06	原始取得	无
473	半导体器件的制作方法	ZL200710040247.6	中芯上海	2007-04-24	2010-04-21	原始取得	无
474	半导体器件及其制造方法	ZL200710040249.5	中芯上海	2007-04-24	2010-09-29	原始取得	无
475	直流/直流转换系统	ZL200710040260.1	中芯上海	2007-04-24	2011-10-05	原始取得	无
476	静电放电保护器件的布图设计方法及 MOS 器件	ZL200710040263.5	中芯上海	2007-04-24	2011-07-06	原始取得	无
477	改善 MIM 电容容量的方法及装置	ZL200710040297.4	中芯上海	2007-04-29	2010-05-19	原始取得	无
478	一种芯片的蚀刻方法	ZL200710040531.3	中芯上海	2007-05-11	2010-05-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
479	一种改善集成电路制程中硅位错的方法	ZL200710040533.2	中芯上海	2007-05-11	2010-07-07	原始取得	无
480	栅介质层测试控片及其形成方法	ZL200710040598.7	中芯上海	2007-05-10	2010-08-11	原始取得	无
481	重传缓冲装置及传输数据的方法	ZL200710040627.X	中芯上海	2007-05-11	2011-05-11	原始取得	无
482	晶片清洗回收方法	ZL200710040971.9	中芯上海	2007-05-21	2010-06-09	原始取得	无
483	半导体器件逻辑电路	ZL200710040972.3	中芯上海	2007-05-21	2011-07-13	原始取得	无
484	半导体器件逻辑电路	ZL200710040984.6	中芯上海	2007-05-21	2011-07-13	原始取得	无
485	多晶硅膜阻值的测试方法	ZL200710041039.8	中芯上海	2007-05-22	2011-04-20	原始取得	无
486	晶圆质量控制方法	ZL200710041092.8	中芯上海	2007-05-23	2010-11-10	原始取得	无
487	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL200710041107.0	中芯上海	2007-05-23	2010-09-29	原始取得	无
488	光学近距修正的方法	ZL200710041108.5	中芯上海	2007-05-23	2011-03-23	原始取得	无
489	掩模版及使用掩模版调式光刻机套刻精度的匹配方法	ZL200710041576.2	中芯上海	2007-06-01	2011-03-23	原始取得	无
490	晶片的干燥方法	ZL200710042136.9	中芯上海	2007-06-18	2012-05-23	原始取得	无
491	自对准浅沟槽隔离结构、存储器单元及其形成方法	ZL200710042137.3	中芯上海	2007-06-18	2010-08-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
492	半导体器件互连层顶层布线层及其形成方法	ZL200710042150.9	中芯上海	2007-06-18	2011-03-23	原始取得	无
493	导电插塞及其制作方法	ZL200710042162.1	中芯上海	2007-06-18	2010-11-10	原始取得	无
494	用于在存储器结构中形成自对准共源极的方法和装置	ZL200710042205.6	中芯上海	2007-06-19	2010-05-19	原始取得	无
495	具有嵌入式 EEPROM 的电可编程器件及其制作方法	ZL200710042341.5	中芯上海	2007-06-21	2010-10-06	原始取得	无
496	刻蚀方法	ZL200710042343.4	中芯上海	2007-06-21	2011-08-17	原始取得	无
497	静电放电保护电路	ZL200710042349.1	中芯上海	2007-06-21	2010-10-13	原始取得	无
498	隧穿氧化层的制作方法及快闪存储器的制作方法	ZL200710042350.4	中芯上海	2007-06-21	2010-08-11	原始取得	无
499	焊接金球的去除方法	ZL200710042409.X	中芯上海	2007-06-22	2010-05-19	原始取得	无
500	一种废水的氨氮成分处理装置	ZL200710043278.7	中芯上海	2007-06-29	2010-06-16	原始取得	无
501	一种静电吸盘的清洗方法	ZL200710043323.9	中芯上海	2007-06-29	2011-06-01	原始取得	无
502	一种可避免产生包状缺陷的等离子化学气相沉积方法	ZL200710043405.3	中芯上海	2007-06-29	2010-05-19	原始取得	无
503	炉管保养测试程式控制系统	ZL200710043868.X	中芯上海	2007-07-17	2010-06-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	及控制方法						
504	一种减小阈值电压标准方差的方法	ZL200710044057.1	中芯上海	2007-07-20	2010-08-11	原始取得	无
505	一种改善晶片研磨不足厚度偏厚的方法及装置	ZL200710044058.6	中芯上海	2007-07-20	2010-11-17	原始取得	无
506	防止非挥发性存储器阵列产生位线干扰的方法	ZL200710044091.9	中芯上海	2007-07-20	2010-12-15	原始取得	无
507	掩膜图案校正方法	ZL200710044546.7	中芯上海	2007-08-03	2010-12-22	原始取得	无
508	光学邻近校正的方法	ZL200710044547.1	中芯上海	2007-08-03	2011-06-01	原始取得	无
509	通孔填充方法、通孔填充结构及通孔制作方法	ZL200710044634.7	中芯上海	2007-08-05	2011-12-07	原始取得	无
510	栅层形成方法	ZL200710044811.1	中芯上海	2007-08-09	2010-08-11	原始取得	无
511	栅层的制造方法、半导体器件的制造方法和半导体结构	ZL200710044813.0	中芯上海、中芯北京	2007-08-09	2013-05-29	原始取得	无
512	数据恢复电路和方法	ZL200710045030.4	中芯上海	2007-08-17	2011-07-20	原始取得	无
513	半导体器件、晶圆粗对准标记和粗对准方法	ZL200710045032.3	中芯上海	2007-08-17	2010-06-09	原始取得	无
514	一种优化曝光装置监控的方	ZL200710045042.7	中芯上海	2007-08-20	2011-02-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
515	防止存储器阵列产生位线干扰的方法	ZL200710045043.1	中芯上海	2007-08-20	2010-12-22	原始取得	无
516	金属制程工艺中凹陷现象的测试结构及方法	ZL200710045075.1	中芯上海	2007-08-21	2010-09-29	原始取得	无
517	集成电路器件结构形成方法及相应结构	ZL200710045103.X	中芯上海	2007-08-21	2011-11-30	原始取得	无
518	晶圆缺陷的检测方法	ZL200710045485.6	中芯上海	2007-08-31	2010-07-21	原始取得	无
519	涂底的方法及光刻胶的涂布方法	ZL200710046207.2	中芯上海	2007-09-20	2010-08-11	原始取得	无
520	具有不同侧壁层宽度的CMOS器件及其制造方法	ZL200710046212.3	中芯上海	2007-09-17	2011-07-06	原始取得	无
521	建立测量程式的方法及系统、测量方法	ZL200710046304.1	中芯上海	2007-09-20	2010-09-29	原始取得	无
522	离子注入后的清洗方法	ZL200710046311.1	中芯上海	2007-09-20	2010-06-09	原始取得	无
523	半导体器件的制造方法	ZL200710046314.5	中芯上海	2007-09-20	2010-06-09	原始取得	无
524	CMOS图像传感器及其形成方法	ZL200710046483.9	中芯上海	2007-09-26	2010-09-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
525	数模转换单元和电路	ZL200710046487.7	中芯上海	2007-09-26	2010-11-10	原始取得	无
526	熔丝修整电路	ZL200710046490.9	中芯上海	2007-09-26	2011-08-17	原始取得	无
527	形成膜层的方法	ZL200710046495.1	中芯上海	2007-09-26	2010-11-10	原始取得	无
528	缺陷分析方法和系统	ZL200710046496.6	中芯上海	2007-09-26	2010-09-29	原始取得	无
529	一种可提高平整度的像素电极制造方法	ZL200710046689.1	中芯上海	2007-09-29	2010-08-25	原始取得	无
530	栅层的制造方法及半导体器件的制造方法	ZL200710046795.X	中芯上海	2007-09-27	2011-10-05	原始取得	无
531	曝光修正方法	ZL200710046798.3	中芯上海	2007-09-30	2010-11-10	原始取得	无
532	一种可提高成品率的光罩	ZL200710046838.4	中芯上海	2007-10-09	2011-03-23	原始取得	无
533	一种可增大工艺窗口的金属层版图布图方法	ZL200710047359.4	中芯上海	2007-10-24	2010-10-20	原始取得	无
534	一种可避免产生突起的保护层制作方法	ZL200710047363.0	中芯上海	2007-10-24	2010-12-15	原始取得	无
535	化学机械研磨方法	ZL200710047515.7	中芯上海	2007-10-25	2011-10-05	原始取得	无
536	一种修正光刻胶图形的方法	ZL200710047859.8	中芯上海、中芯北京	2007-11-06	2015-04-01	原始取得	无
537	一种三角波发生器	ZL200710047992.3	中芯上海	2007-11-08	2011-06-01	原始取得	无
538	闪存中过擦除存储单元的检	ZL200710047995.7	中芯上海	2007-11-08	2011-03-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	测方法						
539	一种高稳定性 D 触发器结构	ZL200710047996.1	中芯上海	2007-11-08	2010-12-15	原始取得	无
540	一种锁相环的自校准方法及电路	ZL200710047997.6	中芯上海	2007-11-08	2011-03-23	原始取得	无
541	改善 SRAM 匹配度的方法	ZL200710094402.2	中芯上海	2007-12-07	2011-10-05	原始取得	无
542	光刻胶掩膜图形的显影方法	ZL200710094405.6	中芯上海	2007-12-07	2011-12-07	原始取得	无
543	MOS 晶体管的形成方法	ZL200710094406.0	中芯上海	2007-12-07	2010-09-29	原始取得	无
544	微机电系统压力传感器及其制作方法	ZL200710094407.5	中芯上海	2007-12-07	2011-01-12	原始取得	无
545	半导体器件及其形成方法	ZL200710094409.4	中芯上海	2007-12-07	2011-05-11	原始取得	无
546	布局、光掩模版的制作及图形化方法	ZL200710094457.3	中芯上海	2007-12-13	2011-05-11	原始取得	无
547	制作光掩模版及图形化的方法	ZL200710094459.2	中芯上海	2007-12-13	2010-11-10	原始取得	无
548	光学临近修正、光掩模版制作及图形化方法	ZL200710094461.X	中芯上海	2007-12-13	2012-04-18	原始取得	无
549	形成浅沟槽隔离结构的方法和形成浅沟槽的刻蚀方法	ZL200710094466.2	中芯上海	2007-12-13	2011-08-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
550	半导体器件及其制作方法	ZL200710094474.7	中芯上海	2007-12-13	2010-11-24	原始取得	无
551	MOS 晶体管及其形成方法	ZL200710094476.6	中芯上海	2007-12-13	2011-03-23	原始取得	无
552	基片架控制装置、基片架移动控制方法及沉积装置	ZL200710094478.5	中芯上海	2007-12-13	2011-10-05	原始取得	无
553	环形半导体器件及其制作方法	ZL200710094480.2	中芯上海	2007-12-13	2011-01-12	原始取得	无
554	叠加容量存储器及控制方法	ZL200710094482.1	中芯上海	2007-12-13	2011-12-07	原始取得	无
555	减小 SRAM 阱邻近效应的方法	ZL200710094484.0	中芯上海	2007-12-13	2010-09-29	原始取得	无
556	用于闪存的数据存储方法及装置	ZL200710094486.X	中芯上海	2007-12-13	2011-07-06	原始取得	无
557	通孔形成方法	ZL200710094499.7	中芯上海	2007-12-13	2011-05-11	原始取得	无
558	浅沟槽隔离区形成方法	ZL200710094519.0	中芯上海	2007-12-13	2010-12-22	原始取得	无
559	套刻精度的控制方法和装置	ZL200710094528.X	中芯上海	2007-12-13	2011-12-07	原始取得	无
560	通孔及双镶嵌结构的形成方法	ZL200710094539.8	中芯上海	2007-12-13	2011-08-17	原始取得	无
561	刻蚀方法和双镶嵌结构的形成方法	ZL200710094541.5	中芯上海	2007-12-13	2011-01-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
562	刻蚀停止层、具有通孔的半导体器件及其形成方法	ZL200710094544.9	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2013-08-14	原始取得	无
563	化学机械研磨方法及晶片清洗方法	ZL200710094545.3	中芯上海	2007-12-13	2011-03-23	原始取得	无
564	在 CMOS 上感测图像的系统和方法	ZL200710094550.4	中芯上海	2007-12-13	2011-03-23	原始取得	无
565	DRAM 单元晶体管器件和方法	ZL200710094551.9	中芯上海	2007-12-13	2011-03-23	原始取得	无
566	获取非挥发存储器中失效二进制位分布信息的方法与装置	ZL200710094553.8	中芯上海	2007-12-13	2010-11-10	原始取得	无
567	测试结构版图的形成方法及系统、测试结构的形成方法	ZL200710094556.1	中芯上海	2007-12-13	2011-05-11	原始取得	无
568	连接孔的形成方法	ZL200710094562.7	中芯上海	2007-12-13	2011-08-17	原始取得	无
569	一种体硅纳米线晶体管器件的制备方法	ZL200710098812.4	北京大学、中芯上海	2007-04-27	2009-09-02	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
570	一种双鳍型沟道双栅多功能场效应晶体管及其制备方法	ZL200710105963.8	中芯上海、北京大学	2007-06-05	2009-08-12	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
571	鳍型沟道双栅多功能场效应晶体管的制备方法	ZL200710111248.5	北京大学、中芯上海	2007-06-19	2009-05-20	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
572	一种部分耗尽的 SOIMOS 晶体管的制备方法	ZL200710121802.8	北京大学、中芯上海	2007-09-14	2009-08-12	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
573	静态随机存取存储器电路稳定性的仿真方法	ZL200710126501.4	中芯上海	2007-06-22	2010-08-11	原始取得	无
574	高压晶体管和存储器的形成方法	ZL200710126599.3	中芯上海	2007-06-22	2010-06-09	原始取得	无
575	根据氮化硅薄膜应力校准薄膜沉积机台中机械手位置的方法	ZL200710170549.5	中芯上海	2007-11-16	2011-05-11	原始取得	无
576	一种去除金属绝缘层金属结构的侧壁聚合物的方法	ZL200710170620.X	中芯上海	2007-11-19	2011-11-09	原始取得	无
577	一种可提高抛光性能的多晶硅抛光方法	ZL200710170744.8	中芯上海	2007-11-21	2011-10-05	原始取得	无
578	淀积含碳的薄膜用于形成掺杂区域间隔层的方法	ZL200710170911.9	中芯上海	2007-11-23	2011-01-12	原始取得	无
579	硬掩膜层的形成方法及蚀刻	ZL200710170950.9	中芯上海	2007-11-21	2012-01-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
580	制作光掩模版的方法及图案化的方法	ZL200710171088.3	中芯上海	2007-11-27	2011-05-11	原始取得	无
581	一种制作 MOS 器件的方法	ZL200710171574.5	中芯上海	2007-11-30	2011-10-05	原始取得	无
582	一种可减小器件漏电流的金属电极制造方法	ZL200710171607.6	中芯上海	2007-11-30	2010-10-20	原始取得	无
583	一种解决上电过快的方法及其电路	ZL200710171609.5	中芯上海	2007-11-30	2010-12-22	原始取得	无
584	蚀刻停止层、双镶嵌结构及其形成方式	ZL200710171664.4	中芯上海	2007-11-27	2012-03-07	原始取得	无
585	半导体器件及其形成方法	ZL200710171665.9	中芯上海	2007-11-27	2010-12-22	原始取得	无
586	一种 CMOS 到 MCML 的转换电路	ZL200710172417.6	中芯上海	2007-12-17	2011-04-20	原始取得	无
587	一种非挥发性阻抗存储器制造方法	ZL200710172419.5	中芯上海	2007-12-17	2011-06-01	原始取得	无
588	用于减少晶片表面缺陷的湿式蚀刻方法及其装置	ZL200710172511.1	中芯上海	2007-12-18	2011-04-20	原始取得	无
589	半导体衬底、半导体衬底的制	ZL200710173095.7	上海新傲科技股份有	2007-12-26	2012-02-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	备方法及三维封装方法		限公司、中芯上海				
590	一种制作准双栅 MOSFET 晶体管的方法	ZL200710176292.4	北京大学、中芯上海	2007-10-24	2009-09-09	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
591	一种制备金属栅电极的方法	ZL200710178281.X	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2007-11-28	2010-09-22	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
592	一种双输入路径的超宽带低噪声放大器	ZL200710179862.5	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2007-12-19	2010-12-08	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
593	二元过渡族金属氧化物非挥发电阻转变型存储器	ZL200710304220.3	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2007-12-26	2010-06-16	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
594	一种可优化工艺的半导体器件制造方法	ZL200810032344.5	中芯上海	2008-01-07	2012-05-09	原始取得	无
595	一种电源开/关自动控制装置	ZL200810033042.X	中芯上海	2008-01-24	2011-06-15	原始取得	无
596	一种双镶嵌结构的制造方法	ZL200810033043.4	中芯上海	2008-01-24	2011-03-23	原始取得	无
597	用于对集成电路内层电介质进行可靠性分析的测试用结	ZL200810033131.4	中芯上海	2008-01-25	2011-02-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	构						
598	一种防止静电放电的输入电阻及制造方法	ZL200810033257.1	中芯上海	2008-01-29	2012-06-06	原始取得	无
599	一种可提高两相邻 N 阱间击穿电压的方法	ZL200810033362.5	中芯上海	2008-01-31	2011-10-05	原始取得	无
600	一种在半导体制程中制备掩膜过程中的 OPC 方法	ZL200810033366.3	中芯上海	2008-01-31	2012-05-23	原始取得	无
601	一种更替掩模版的方法	ZL200810035089.X	中芯上海	2008-03-25	2011-04-20	原始取得	无
602	一种可提高切割成品率的切割道	ZL200810035897.6	中芯上海	2008-04-10	2011-12-28	原始取得	无
603	一种可减小等离子体损伤效应的 MOS 管	ZL200810035898.0	中芯上海	2008-04-10	2010-12-15	原始取得	无
604	一种可减小等离子损伤效应的 MOS 电容	ZL200810035899.5	中芯上海	2008-04-10	2011-02-02	原始取得	无
605	一种锁相环自校准系统以及方法	ZL200810035901.9	中芯上海	2008-04-10	2011-07-20	原始取得	无
606	一种芯片制造工艺中的挡片回收的检测方法	ZL200810035902.3	中芯上海	2008-04-10	2011-12-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
607	一种制作 STI 的衬氧化层的方法	ZL200810036583.8	中芯上海	2008-04-24	2010-12-22	原始取得	无
608	一种金属槽的制作方法	ZL200810036584.2	中芯上海	2008-04-24	2010-12-22	原始取得	无
609	残留物的去除方法	ZL200810036585.7	中芯上海	2008-04-24	2011-04-20	原始取得	无
610	自偏置锁相环和锁相方法	ZL200810037055.4	中芯上海	2008-05-04	2011-12-07	原始取得	无
611	一种优化金属沟槽制作的方法	ZL200810037679.6	中芯上海	2008-05-20	2011-04-20	原始取得	无
612	一种过孔和金属沟槽的制作方法	ZL200810037682.8	中芯上海	2008-05-20	2010-12-22	原始取得	无
613	自偏置锁相环	ZL200810038056.0	中芯上海	2008-05-23	2011-08-17	原始取得	无
614	用于基于 SONOS 的快闪存储的多晶硅栅极蚀刻方法和器件	ZL200810038057.5	中芯上海	2008-05-23	2011-03-23	原始取得	无
615	减少芯片焊盘区晶格缺陷形成的方法及相应焊盘形成方法	ZL200810038383.6	中芯上海	2008-05-30	2012-05-09	原始取得	无
616	拉西环的清洗装置	ZL200810038389.3	中芯上海	2008-05-30	2011-06-15	原始取得	无
617	降低天线效应的光刻方法	ZL200810038390.6	中芯上海	2008-05-30	2011-11-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
618	刻蚀闪存中介电存储层的方法	ZL200810040226.9	中芯上海	2008-07-04	2011-06-15	原始取得	无
619	金属氧化物半导体器件及其制造方法	ZL200810040232.4	中芯上海	2008-07-04	2011-04-20	原始取得	无
620	具有 OTP 功能的非晶硅 MONOS 或 MAS 存储单元结构	ZL200810040284.1	中芯上海	2008-07-02	2011-08-17	原始取得	无
621	用于闪存器件的字线增压器	ZL200810040285.6	中芯上海	2008-07-02	2012-01-25	原始取得	无
622	降低存储单元电容器的缺陷的方法	ZL200810040286.0	中芯上海	2008-07-02	2011-07-06	原始取得	无
623	具有非晶硅 MAS 存储单元结构的半导体器件及其制造方法	ZL200810040287.5	中芯上海	2008-07-02	2011-08-17	原始取得	无
624	TFT 快闪存储单元的原子层沉积外延硅生长	ZL200810040288.X	中芯上海	2008-07-02	2011-08-17	原始取得	无
625	具有多晶硅接触的自对准 MOS 结构	ZL200810040290.7	中芯上海	2008-07-02	2011-01-12	原始取得	无
626	用于进行加速软错误率测试	ZL200810040292.6	中芯上海	2008-07-03	2011-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的系统和方法						
627	TFT SAS 存储单元结构	ZL200810040293.0	中芯上海	2008-07-03	2011-10-05	原始取得	无
628	硅基液晶器件及其制造方法	ZL200810040294.5	中芯上海	2008-07-03	2011-08-17	原始取得	无
629	有选择的反窄宽度效应的 DRAM 单元结构及其生成方法	ZL200810040296.4	中芯上海	2008-07-03	2011-01-12	原始取得	无
630	采用高能电磁辐射的快速热处理半导体衬底形成介电层的方法	ZL200810040368.5	中芯上海	2008-07-08	2011-10-05	原始取得	无
631	制备透射电子显微镜样品的方法	ZL200810040369.X	中芯上海	2008-07-08	2011-05-11	原始取得	无
632	双镶嵌结构及其制作方法	ZL200810040373.6	中芯上海	2008-07-08	2011-05-11	原始取得	无
633	形成接触孔及双镶嵌结构的方法	ZL200810040566.1	中芯上海	2008-07-15	2012-01-25	原始取得	无
634	集成静电放电器件	ZL200810040570.8	中芯上海	2008-07-15	2011-03-23	原始取得	无
635	图像传感器的互连方法	ZL200810040740.2	中芯上海	2008-07-15	2011-05-11	原始取得	无
636	非易失性存储器可靠性的测试方法和装置	ZL200810040767.1	中芯上海、中芯北京	2008-07-18	2013-03-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
637	DRAM 中存储单元的离子掺杂方法	ZL200810040858.5	中芯上海	2008-07-22	2011-11-30	原始取得	无
638	用于制造半导体晶片的外围遮光型掩膜结构及其制造方法	ZL200810041066.x	中芯上海	2008-07-25	2012-01-25	原始取得	无
639	闪存中源极和漏极的制作方法	ZL200810041290.9	中芯上海	2008-08-01	2011-07-13	原始取得	无
640	生产流程控制方法及系统	ZL200810041367.2	中芯上海	2008-08-04	2012-05-23	原始取得	无
641	光刻工艺的监控方法及系统	ZL200810041567.8	中芯上海	2008-08-11	2013-04-17	原始取得	无
642	静态随机存储器上拉晶体管阈值电压调整方法	ZL200810041569.7	中芯上海	2008-08-11	2011-06-15	原始取得	无
643	NAND 闪存及其制作方法	ZL200810041826.7	中芯上海	2008-08-18	2011-12-07	原始取得	无
644	化学机器研磨的方法	ZL200810041827.1	中芯上海	2008-08-18	2012-03-07	原始取得	无
645	锁相环及其锁定检测装置和方法	ZL200810041829.0	中芯上海	2008-08-18	2012-06-20	原始取得	无
646	光刻方法及系统	ZL200810041879.9	中芯上海	2008-08-19	2011-07-20	原始取得	无
647	抑制金属焊盘腐蚀的方法	ZL200810041881.6	中芯上海	2008-08-19	2011-09-07	原始取得	无
648	有源区结构	ZL200810041882.0	中芯上海	2008-08-19	2011-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
649	一种绝缘体上硅电路 ESD 全局保护结构	ZL200810104230.7	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2008-04-16	2010-09-08	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
650	浅沟槽内绝缘材料高度的确定方法	ZL200810201172.X	中芯上海	2008-10-14	2012-03-28	原始取得	无
651	浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL200810201776.4	中芯上海	2008-10-24	2011-07-20	原始取得	无
652	控制源/漏结电容的方法和 PMOS 晶体管的形成方法	ZL200810201780.0	中芯上海	2008-10-24	2011-07-06	原始取得	无
653	控制源/漏结电容的方法和 PMOS 晶体管的形成方法	ZL200810201781.5	中芯上海	2008-10-24	2011-10-05	原始取得	无
654	USB 存储设备及其接口电路	ZL200810201783.4	中芯上海	2008-10-24	2011-12-07	原始取得	无
655	形成快闪存储器栅极的方法以及快闪存储器	ZL200810201785.3	中芯上海	2008-10-24	2011-10-05	原始取得	无
656	相变半导体器件的制造方法及相变半导体器件	ZL200810201787.2	中芯上海	2008-10-24	2012-05-16	原始取得	无
657	相变半导体器件的制造方法及相变半导体器件	ZL200810201788.7	中芯上海	2008-10-24	2011-12-07	原始取得	无
658	防止位线之间穿通电压降低	ZL200810201792.3	中芯上海	2008-10-24	2011-08-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的方法及半导体存储器						
659	去除晶圆正面胶粘残渣的方法	ZL200810201822.0	中芯上海	2008-10-27	2011-04-20	原始取得	无
660	照明灯节能控制系统	ZL200810202032.4	中芯上海	2008-10-31	2013-01-02	原始取得	无
661	具有低翘曲度的半导体晶片的制作方法	ZL200810202116.8	中芯上海	2008-10-31	2012-03-07	原始取得	无
662	铜支柱制作工艺	ZL200810202279.6	中芯上海	2008-11-05	2011-11-09	原始取得	无
663	金属半导体场效应晶体管	ZL200810202458.X	中芯上海	2008-11-10	2012-01-25	原始取得	无
664	减少应力的芯片制造方法	ZL200810202702.2	中芯上海	2008-11-13	2011-06-15	原始取得	无
665	对产品进行在线检测的方法以及装置	ZL200810202776.6	中芯上海	2008-11-14	2012-05-16	原始取得	无
666	铝布线制作方法	ZL200810202827.5	中芯上海	2008-11-17	2012-05-16	原始取得	无
667	并行输入串行输出的转换电路	ZL200810202829.4	中芯上海	2008-11-17	2011-12-07	原始取得	无
668	浅沟槽结构制造方法及快闪存储器	ZL200810202830.7	中芯上海	2008-11-17	2011-12-07	原始取得	无
669	NMOS 晶体管的制作方法	ZL200810202835.x	中芯上海	2008-11-17	2011-08-17	原始取得	无
670	只读存储器及其制作方法	ZL200810202837.9	中芯上海	2008-11-17	2011-08-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
671	晶圆及制作方法、系统级封装结构及封装方法	ZL200810202838.3	中芯上海	2008-11-17	2011-08-17	原始取得	无
672	MOS 晶体管及其制作方法	ZL200810202960.0	中芯上海	2008-11-18	2011-03-23	原始取得	无
673	MOS 晶体管及其制作方法	ZL200810202962.x	中芯上海	2008-11-18	2011-03-23	原始取得	无
674	LDMOS 晶体管、半导体器件及其制造方法	ZL200810203538.7	中芯上海	2008-11-27	2012-01-25	原始取得	无
675	消除半导体器件表面缺陷的方法及半导体器件	ZL200810203540.4	中芯上海	2008-11-27	2012-06-06	原始取得	无
676	阶梯式栅氧化层的制造方法及半导体器件	ZL200810203542.3	中芯上海	2008-11-27	2012-07-11	原始取得	无
677	可承受高电压的输出缓冲器	ZL200810203803.1	中芯上海	2008-12-01	2011-11-30	原始取得	无
678	双极晶体管及其制造方法	ZL200810203811.6	中芯上海	2008-12-01	2012-03-07	原始取得	无
679	双极晶体管及其制造方法	ZL200810203812.0	中芯上海、中芯北京	2008-12-01	2013-09-11	原始取得	无
680	消除干法刻蚀中溴化氢浓缩残留方法	ZL200810203860.X	中芯上海	2008-12-02	2011-11-09	原始取得	无
681	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL200810204153.2	中芯上海	2008-12-03	2011-08-17	原始取得	无
682	袋形注入区的离子注入方法及 MOS 晶体管的制造方法	ZL200810204179.7	中芯上海	2008-12-08	2011-05-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
683	MOS 晶体管的制造方法	ZL200810204182.9	中芯上海	2008-12-08	2011-12-07	原始取得	无
684	半导体器件制作方法	ZL200810204360.8	中芯上海	2008-12-10	2012-07-04	原始取得	无
685	光刻方法	ZL200810204617.x	中芯上海、中芯北京	2008-12-15	2013-01-02	原始取得	无
686	袋形注入区的离子注入方法及 MOS 晶体管的制造方法	ZL200810204618.4	中芯上海	2008-12-15	2011-12-07	原始取得	无
687	数据存取控制装置及数据存取方法	ZL200810204620.1	中芯上海	2008-12-15	2012-03-07	原始取得	无
688	光学临近效应修正方法	ZL200810204777.4	中芯上海	2008-12-17	2012-07-04	原始取得	无
689	聚对苯撑苯并双恶唑纤维表面处理方法	ZL200810204962.3	中芯上海	2008-12-30	2011-10-05	原始取得	无
690	静态随机存储器中晶体管的测试结构	ZL200810205261.1	中芯上海	2008-12-31	2012-05-23	原始取得	无
691	模数/数模转换器	ZL200810205384.5	中芯上海	2008-12-31	2012-06-06	原始取得	无
692	浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL200810205387.9	中芯上海	2008-12-31	2012-06-06	原始取得	无
693	PMOS 器件的 LDD 的形成方法及 PMOS 器件的制造方法	ZL200810205395.3	中芯上海	2008-12-31	2012-07-11	原始取得	无
694	晶圆承载装置	ZL200810205396.8	中芯上海	2008-12-31	2012-06-20	原始取得	无
695	CMOS 图像传感器的芯片级封	ZL200810207513.4	中芯上海	2008-12-22	2011-10-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	装结构及封装方法						
696	形成离子注入区的方法、MOS晶体管及其制造方法	ZL200810207515.3	中芯上海、中芯北京	2008-12-22	2012-12-19	原始取得	无
697	CMOS图像传感器的芯片级封装结构及封装方法	ZL200810207526.1	中芯上海	2008-12-22	2011-10-05	原始取得	无
698	双大马士革工艺中的灰化处理方法	ZL200810207675.8	中芯上海	2008-12-24	2011-12-21	原始取得	无
699	连接孔的制造方法	ZL200810208047.1	中芯上海	2008-12-25	2011-12-07	原始取得	无
700	双镶嵌结构的形成方法及沟槽形成方法	ZL200810208065.X	中芯上海	2008-12-25	2012-05-23	原始取得	无
701	工艺盘	ZL200810208081.9	中芯上海	2008-12-29	2012-05-30	原始取得	无
702	非挥发存储器的制备方法	ZL200810223341.X	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2008-09-26	2010-01-20	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
703	非挥发存储器的制备方法	ZL200810223345.8	中芯上海、中国科学院微电子研究所	2008-09-26	2010-11-10	中国科学院微电子研究所：原始取得；中芯上海：继受取得	无
704	半导体器件的制作方法	ZL200910045143.3	中芯上海	2009-01-09	2012-05-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
705	存储器制造方法	ZL200910045245.5	中芯上海	2009-01-13	2012-01-25	原始取得	无
706	改善栅氧化层整合性参数的方法	ZL200910045248.9	中芯上海	2009-01-13	2012-06-27	原始取得	无
707	一种高压 LDMOS 器件及其制造方法	ZL200910045293.4	中芯上海	2009-01-19	2011-11-09	原始取得	无
708	空调箱及空气清洗装置	ZL200910045597.0	中芯上海	2009-01-20	2012-05-30	原始取得	无
709	传输线驱动电路	ZL200910045702.0	中芯上海	2009-01-23	2012-06-06	原始取得	无
710	一种 VDMOS 制造方法	ZL200910045704.X	中芯上海	2009-01-23	2011-10-05	原始取得	无
711	次分辨率辅助图形校正方法	ZL200910045706.9	中芯上海	2009-01-23	2012-01-25	原始取得	无
712	增大引入沟道中的应力的方法和半导体器件	ZL200910045823.5	中芯上海	2009-01-23	2012-07-25	原始取得	无
713	半导体元器件的清洗方法	ZL200910045825.4	中芯上海	2009-01-23	2011-10-05	原始取得	无
714	半导体元器件的离子注入方法	ZL200910045826.9	中芯上海	2009-01-23	2012-05-30	原始取得	无
715	光学邻近校正规则的优化方法	ZL200910045895.X	中芯上海	2009-01-23	2012-07-11	原始取得	无
716	电压转换电路	ZL200910045896.4	中芯上海、中芯北京	2009-01-23	2013-01-23	原始取得	无
717	数字延迟锁相环	ZL200910045944.x	中芯上海	2009-01-22	2013-05-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
718	全数字脉宽控制电路	ZL200910045945.4	中芯上海	2009-01-22	2011-11-30	原始取得	无
719	浅沟槽及其制造方法和浅沟槽隔离结构	ZL200910045977.4	中芯上海	2009-01-19	2012-04-18	原始取得	无
720	铜互连层上的熔丝制程方法及其半导体器件	ZL200910046707.5	中芯上海	2009-02-26	2012-05-30	原始取得	无
721	制造分离栅级存储器浮栅的方法	ZL200910046775.1	中芯上海	2009-02-27	2012-03-21	原始取得	无
722	半导体元器件的干蚀刻方法	ZL200910046887.7	中芯上海	2009-03-02	2012-03-21	原始取得	无
723	浅沟道隔离结构的制造方法	ZL200910046888.1	中芯上海	2009-03-02	2011-12-21	原始取得	无
724	改善栅极特征线宽均匀性的方法	ZL200910046889.6	中芯上海	2009-03-02	2012-05-30	原始取得	无
725	净化管路及炉管杂质的装置和方法	ZL200910046890.9	中芯上海	2009-03-02	2012-07-18	原始取得	无
726	半导体器件制造方法	ZL200910046896.6	中芯上海	2009-03-02	2012-06-20	原始取得	无
727	半导体装置的制造方法及系统	ZL200910046900.9	中芯上海	2009-02-27	2012-04-18	原始取得	无
728	带有内嵌电容的电阻串分压装置	ZL200910047007.8	中芯上海	2009-03-04	2012-02-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
729	源漏极离子注入的方法	ZL200910047440.1	中芯上海	2009-03-12	2012-02-08	原始取得	无
730	半导体的掺杂方法	ZL200910047633.7	中芯上海	2009-03-16	2011-12-21	原始取得	无
731	浅槽隔离的方法	ZL200910047948.1	中芯上海	2009-03-20	2012-05-09	原始取得	无
732	闪存中制作外围电路器件栅极的方法	ZL200910048617.X	中芯上海	2009-03-31	2012-07-25	原始取得	无
733	形成沟槽及双镶嵌结构的方法	ZL200910049282.3	中芯上海	2009-04-14	2012-10-03	原始取得	无
734	微反射镜层、硅基液晶显示装置及其制作方法	ZL200910049283.8	中芯上海	2009-04-14	2012-05-23	原始取得	无
735	离子源装卸装置	ZL200910049285.7	中芯上海	2009-04-14	2012-06-20	原始取得	无
736	离子扩散及半导体器件形成的方法	ZL200910049561.x	中芯上海	2009-04-17	2012-05-23	原始取得	无
737	CMOS 图像传感器的制造方法	ZL200910049562.4	中芯上海	2009-04-17	2012-03-07	原始取得	无
738	半导体工艺的监控方法	ZL200910049564.3	中芯上海	2009-04-17	2011-10-05	原始取得	无
739	晶圆在线检测方法及系统	ZL200910049991.1	中芯上海	2009-04-24	2012-06-20	原始取得	无
740	电镀铜方法	ZL200910049992.6	中芯上海	2009-04-24	2011-11-30	原始取得	无
741	形成焊接凸块的方法	ZL200910049994.5	中芯上海	2009-04-24	2013-02-27	原始取得	无
742	用于制造金属互连线的掩模	ZL200910049996.4	中芯上海	2009-04-24	2012-03-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	板版图						
743	一种精密离子研磨机台及其样片夹	ZL200910050249.2	中芯上海	2009-04-29	2012-07-25	原始取得	无
744	连接孔测试结构及其透射电镜制样方法	ZL200910050408.9	中芯上海	2009-04-30	2012-05-09	原始取得	无
745	掩膜版设计方法	ZL200910050692.X	中芯上海	2009-05-06	2012-05-09	原始取得	无
746	提高 N-阱到 N-阱击穿电压的方法	ZL200910050693.4	中芯上海	2009-05-06	2012-01-25	原始取得	无
747	ONO 介电层切断方法	ZL200910050694.9	中芯上海	2009-05-06	2011-11-30	原始取得	无
748	金属层的刻蚀方法	ZL200910050989.6	中芯上海	2009-05-08	2012-06-06	原始取得	无
749	浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL200910051060.5	中芯上海	2009-05-12	2012-07-18	原始取得	无
750	尖峰热处理设备稳定性的检测方法	ZL200910051549.2	中芯上海	2009-05-19	2012-07-04	原始取得	无
751	一种芯片装配方法	ZL200910051553.9	中芯上海	2009-05-19	2011-09-07	原始取得	无
752	一种用于涂胶及洗边检测的测试晶圆	ZL200910051554.3	中芯上海	2009-05-19	2013-02-27	原始取得	无
753	涂胶显影机	ZL200910051561.3	中芯上海	2009-05-19	2011-10-05	原始取得	无
754	测量电阻变化检测氮掺杂浓	ZL200910051701.7	中芯上海	2009-05-21	2012-01-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	度的方法						
755	焊料凸块制作方法	ZL200910051849.0	中芯上海	2009-05-22	2012-05-23	原始取得	无
756	NROM 的制造方法及其器件	ZL200910051851.8	中芯上海	2009-05-22	2012-10-03	原始取得	无
757	双栅极场效应晶体管	ZL200910051866.4	中芯上海	2009-05-22	2011-12-07	原始取得	无
758	相变随机存取存储器及制造方法	ZL200910051867.9	中芯上海	2009-05-22	2012-03-07	原始取得	无
759	减少晶片处理过程中电弧产生的方法	ZL200910052188.3	中芯上海	2009-05-27	2012-08-08	原始取得	无
760	叠对误差补偿方法	ZL200910052189.8	中芯上海	2009-05-27	2012-05-23	原始取得	无
761	零标记曝光的检测方法及系统	ZL200910052191.5	中芯上海	2009-05-27	2012-05-23	原始取得	无
762	倒装芯片锡银凸块结构及其制造方法	ZL200910052539.0	中芯上海	2009-06-04	2011-12-28	原始取得	无
763	芯片失效的数据分类分析方法及其装置	ZL200910052548.x	中芯上海	2009-06-04	2012-12-12	原始取得	无
764	键合垫及其制造方法以及键合方法	ZL200910052644.4	中芯上海、矽成积体电路股份有限公司	2009-06-05	2013-06-19	原始取得	无
765	袋形注入区的离子注入方法	ZL200910052645.9	中芯上海	2009-06-05	2012-07-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	及 MOS 晶体管的制作方法						
766	NROM 器件的制作方法	ZL200910052646.3	中芯上海、中芯北京	2009-06-05	2013-05-29	原始取得	无
767	半导体存储器的制造方法	ZL200910052647.8	中芯上海、中芯北京	2009-06-05	2013-05-29	原始取得	无
768	快闪存储器制造方法	ZL200910052805.x	中芯上海	2009-06-09	2012-06-27	原始取得	无
769	一种倒装芯片凸块结构及其制作工艺	ZL200910052807.9	中芯上海	2009-06-09	2012-01-25	原始取得	无
770	蚀刻装置及方法	ZL200910052944.2	中芯上海	2009-06-11	2012-01-25	原始取得	无
771	气体输送装置以及干法刻蚀装置	ZL200910053152.7	中芯上海、中芯北京	2009-06-16	2013-01-30	原始取得	无
772	双向阀及使用工业气体的半导体加工系统	ZL200910053373.4	中芯上海	2009-06-18	2012-05-30	原始取得	无
773	检测曝光机台焦平面变化的方法及装置	ZL200910053374.9	中芯上海、中芯北京	2009-06-18	2013-01-23	原始取得	无
774	扫描晶圆表面图像的方法	ZL200910053375.3	中芯上海	2009-06-18	2012-05-30	原始取得	无
775	MOS 晶体管及其制作方法	ZL200910053494.9	中芯上海	2009-06-19	2012-01-25	原始取得	无
776	半导体结构和侧墙间隔方法	ZL200910053495.3	中芯上海	2009-06-19	2012-05-23	原始取得	无
777	优化 CMOS 图像传感器版图的方法	ZL200910053496.8	中芯上海	2009-06-19	2012-03-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
778	氮化物只读存储器的制造方法	ZL200910053525.0	中芯上海	2009-06-19	2012-05-09	原始取得	无
779	CMOS 晶体管及其制作方法	ZL200910053526.5	中芯上海	2009-06-19	2012-03-28	原始取得	无
780	提高栅极尺寸均匀性的方法	ZL200910053813.6	中芯上海	2009-06-25	2012-09-26	原始取得	无
781	改善快闪存储器制作工艺中光刻胶涂布缺陷的方法	ZL200910054019.3	中芯上海	2009-06-26	2012-06-20	原始取得	无
782	MOS 晶体管的制作方法	ZL200910054094.x	中芯上海	2009-06-26	2011-12-07	原始取得	无
783	MOS 晶体管的制作方法	ZL200910054099.2	中芯上海、中芯北京	2009-06-26	2012-12-05	原始取得	无
784	MOS 晶体管的制作方法	ZL200910054100.1	中芯上海、中芯北京	2009-06-26	2013-01-23	原始取得	无
785	金属栅电极形成方法	ZL200910054101.6	中芯上海	2009-06-26	2012-05-23	原始取得	无
786	一种化学机械研磨方法	ZL200910054375.5	中芯上海	2009-07-03	2012-03-28	原始取得	无
787	金属布线的制作方法	ZL200910054396.7	中芯上海	2009-07-03	2012-01-25	原始取得	无
788	接触孔填充方法	ZL200910054397.1	中芯上海	2009-07-03	2012-03-07	原始取得	无
789	沟槽的形成方法	ZL200910054403.3	中芯上海	2009-07-03	2012-01-25	原始取得	无
790	金属布线的制作方法	ZL200910054404.8	中芯上海	2009-07-03	2012-07-11	原始取得	无
791	半导体器件的制造方法	ZL200910054406.7	中芯上海、中芯北京	2009-07-03	2012-12-05	原始取得	无
792	建立光学邻近校正模型方法和光学邻近校正方法	ZL200910054409.0	中芯上海、中芯北京	2009-07-03	2013-01-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
793	离子注入方法、设备及形成轻掺杂结构的方法	ZL200910054410.3	中芯上海、中芯北京	2009-07-03	2013-03-06	原始取得	无
794	MOS 晶体管及其制作方法	ZL200910054411.8	中芯上海	2009-07-03	2012-06-06	原始取得	无
795	掩膜制作方法	ZL200910054504.0	中芯上海	2009-07-07	2012-03-28	原始取得	无
796	提高非易失性存储器性能的方法	ZL200910054545.X	中芯上海、中芯北京	2009-07-09	2013-03-13	原始取得	无
797	存储单元区制作的方法	ZL200910054546.4	中芯上海	2009-07-09	2012-07-25	原始取得	无
798	铝线形成方法	ZL200910054798.7	中芯上海	2009-07-14	2012-07-25	原始取得	无
799	石英改板清洗方法	ZL200910054800.0	中芯上海	2009-07-14	2012-07-25	原始取得	无
800	晶背蚀刻方法及系统	ZL200910054927.2	中芯上海、成都成芯半导体制造有限公司	2009-07-16	2012-07-18	原始取得	无
801	接触孔形成方法	ZL200910054929.1	中芯上海、成都成芯半导体制造有限公司	2009-07-16	2012-11-14	原始取得	无
802	化学机械研磨制程的研磨终点判断方法	ZL200910054931.9	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
803	一种晶片的干燥方法	ZL200910054932.3	中芯上海、成都成芯半导体制造有限公司	2009-07-16	2012-08-08	原始取得	无
804	在晶圆上形成互连通孔失败	ZL200910054933.8	中芯上海、成都成芯	2009-07-16	2012-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的补救方法		半导体制造有限公司				
805	检测半导体器件的静电放电性能的方法	ZL200910054940.8	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2014-06-04	原始取得	无
806	物理气相沉积线圈的处理方法及物理气相沉积线圈结构	ZL200910054945.0	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-04-17	原始取得	无
807	相变随机存取存储器及制造方法、编程方法	ZL200910054947.X	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-05-29	原始取得	无
808	提高 MOS 晶体管载流子迁移率的方法	ZL200910054948.4	中芯上海	2009-07-16	2012-05-16	原始取得	无
809	绿色场效应晶体管及其制造方法	ZL200910054949.9	中芯上海	2009-07-16	2012-03-07	原始取得	无
810	金属布线沟槽的形成方法	ZL200910054950.1	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-01-23	原始取得	无
811	单级 CMOS 器件及其制造方法	ZL200910054953.5	中芯上海	2009-07-16	2012-01-25	原始取得	无
812	横向双扩散金属氧化物半导体场效应管及其制作方法	ZL200910054955.4	中芯上海	2009-07-16	2012-07-11	原始取得	无
813	可用作半导体封装材料的环氧树脂组合物	ZL200910054956.9	中芯上海、义典科技股份有限公司	2009-07-16	2011-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
814	相变存储器及其制造方法	ZL200910054957.3	中芯上海	2009-07-16	2012-06-20	原始取得	无
815	PN 结二极管、相变随机存储器及其制作方法	ZL200910054959.2	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
816	半导体器件及半导体器件的形成方法	ZL200910054960.5	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
817	CMOS 器件及其制造方法	ZL200910054961.x	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
818	半导体器件的制造方法	ZL200910054971.3	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-12-12	原始取得	无
819	SONOS 快闪存储器单元及其形成方法	ZL200910054973.2	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-09-11	原始取得	无
820	掩模版图修正方法、掩模版制作方法和光学邻近校正方法	ZL200910054974.7	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
821	LDMOS 的制造方法	ZL200910054975.1	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-07-17	原始取得	无
822	SONOS 快闪存储器单元及其形成方法	ZL200910054976.6	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2013-09-11	原始取得	无
823	浅沟槽填充方法	ZL200910054980.2	中芯上海	2009-07-16	2012-05-23	原始取得	无
824	氧-氮-氧叠层结构及栅极制造方法	ZL200910054981.7	中芯上海	2009-07-16	2012-03-07	原始取得	无
825	制作栅氧化层和栅极多晶硅	ZL200910055154.X	中芯上海	2009-07-21	2012-02-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	层的方法						
826	提高沟槽宽度均匀性的方法	ZL200910055167.7	中芯上海、中芯北京	2009-07-21	2013-01-16	原始取得	无
827	隔离结构的制作方法	ZL200910055168.1	中芯上海	2009-07-21	2012-05-30	原始取得	无
828	形成焊接凸块的方法	ZL200910055365.3	中芯上海	2009-07-24	2012-12-26	原始取得	无
829	晶圆测试方法	ZL200910055366.8	中芯上海	2009-07-24	2012-05-23	原始取得	无
830	半导体器件的制作方法	ZL200910055378.0	中芯上海	2009-07-24	2012-12-12	原始取得	无
831	芯片测试板及芯片测试系统	ZL200910055379.5	中芯上海	2009-07-24	2012-12-12	原始取得	无
832	一种制作相变存储单元相变单元的方法	ZL200910055386.5	中芯上海、中国科学院上海微系统与信息技术研究所	2009-07-24	2012-10-17	原始取得	无
833	存储单元失效分析的测试方法	ZL200910055387.x	中芯上海	2009-07-24	2013-01-02	原始取得	无
834	层间介质层的化学机械研磨方法	ZL200910055391.6	中芯上海	2009-07-24	2012-06-27	原始取得	无
835	双极晶体管及其形成方法、虚拟接地电路	ZL200910055408.8	中芯上海、中芯北京	2009-07-24	2013-06-19	原始取得	无
836	双极晶体管、双极晶体管的形成方法及带隙基准电路	ZL200910055410.5	中芯上海、中芯北京	2009-07-24	2012-12-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
837	形成自对准硅化物区域阻挡膜图案的方法	ZL200910055435.5	中芯上海、中芯北京	2009-07-27	2013-07-24	原始取得	无
838	存储器件的制作方法	ZL200910055436.X	中芯上海	2009-07-27	2012-07-25	原始取得	无
839	提高经过多次擦写周期后电荷保持能力的存储单元结构	ZL200910055762.0	中芯上海	2009-07-31	2012-05-30	原始取得	无
840	改善有源区边缘缺陷的方法	ZL200910055776.2	中芯上海	2009-07-31	2012-08-29	原始取得	无
841	具有浅沟槽隔离结构的半导体器件及其制造工艺	ZL200910055805.5	中芯上海	2009-08-03	2012-06-20	原始取得	无
842	光掩膜的铬金属膜去除方法	ZL200910055834.1	中芯上海	2009-08-03	2012-02-08	原始取得	无
843	金属接线端及其构造方法	ZL200910055835.6	中芯上海	2009-08-03	2012-03-21	原始取得	无
844	俄歇电子能谱仪检测样品的表面处理方法	ZL200910055898.1	中芯上海	2009-08-04	2012-11-21	原始取得	无
845	芯片级互连线缺陷分析方法	ZL200910055899.6	中芯上海	2009-08-04	2012-05-09	原始取得	无
846	MIM 电容器及其制造方法	ZL200910055902.4	中芯上海	2009-08-04	2011-11-30	原始取得	无
847	电容器制作方法	ZL200910055903.9	中芯上海	2009-08-04	2012-03-28	原始取得	无
848	避免光刻胶层图形损伤的方法	ZL200910055937.8	中芯上海	2009-08-05	2012-05-09	原始取得	无
849	铜互连方法	ZL200910055938.2	中芯上海、中芯北京	2009-08-05	2013-01-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
850	多晶硅层掺杂的方法	ZL200910055939.7	中芯上海	2009-08-05	2012-07-25	原始取得	无
851	机台进行产品处理的方法	ZL200910055940.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-05	2013-01-30	原始取得	无
852	改进的氮化硅非易失存储器及其实现方法	ZL200910055942.9	中芯上海、中芯北京	2009-08-05	2014-02-12	原始取得	无
853	光掩膜的制作方法	ZL200910055943.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-05	2013-06-19	原始取得	无
854	低 K 介电材料的失效分析方法	ZL200910056016.3	中芯上海	2009-08-06	2012-03-07	原始取得	无
855	芯片封装块解封装的方法及装置	ZL200910056017.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2013-01-02	原始取得	无
856	半导体 NROM 存储装置	ZL200910056018.2	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2014-04-02	原始取得	无
857	掩模版图校正方法、掩模版图和掩模版制造方法	ZL200910056019.7	中芯上海	2009-08-06	2012-03-07	原始取得	无
858	NMOS 晶体管的制造方法	ZL200910056024.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2013-01-02	原始取得	无
859	图形转移方法和掩模版制作方法	ZL200910056026.7	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2013-05-29	原始取得	无
860	MIM 电容器及其制造方法	ZL200910056027.1	中芯上海	2009-08-06	2012-03-07	原始取得	无
861	比较半导体器件的静电放电性能的方法	ZL200910056030.3	中芯上海	2009-08-06	2012-07-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
862	颗粒自动控制方法及系统	ZL200910056031.8	中芯上海	2009-08-06	2012-05-16	原始取得	无
863	不对称晶体管的形成方法	ZL200910056032.2	中芯上海	2009-08-06	2012-01-25	原始取得	无
864	电容器制作方法	ZL200910056280.7	中芯上海	2009-08-11	2012-08-08	原始取得	无
865	容器	ZL200910056281.1	中芯上海	2009-08-11	2013-02-27	原始取得	无
866	晶圆切割工具及使用该工具切割晶圆的方法	ZL200910056372.5	中芯上海、中芯北京	2009-08-13	2013-06-12	原始取得	无
867	刻蚀方法以及形成浅沟槽隔离结构的方法	ZL200910056453.5	中芯上海	2009-08-14	2012-07-04	原始取得	无
868	一种用于集成电路的自对准接触的方法和结构	ZL200910056517.1	中芯上海、中芯北京	2009-08-13	2013-05-08	原始取得	无
869	晶片的检测方法	ZL200910056520.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2013-03-27	原始取得	无
870	半导体器件的制造方法	ZL200910056521.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2014-01-08	原始取得	无
871	暴露半导体衬底的方法和失效分析方法	ZL200910056522.2	中芯上海	2009-08-14	2012-03-07	原始取得	无
872	CMOS 图像传感器及其制造方法	ZL200910056523.7	中芯上海	2009-08-14	2012-06-20	原始取得	无
873	半导体器件灰化制程的检测方法和电特性的检测方法	ZL200910056617.4	中芯上海	2009-08-18	2012-12-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
874	半导体器件的形成方法	ZL200910056625.9	中芯上海	2009-08-18	2012-12-12	原始取得	无
875	去除阻挡层和金属层中污染物颗粒的方法	ZL200910056664.9	中芯上海、中芯北京	2009-08-19	2015-01-28	原始取得	无
876	双镶嵌结构的形成方法及半导体结构	ZL200910056704.x	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-03-06	原始取得	无
877	制造接触接合垫的方法及半导体器件	ZL200910056718.1	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-11-06	原始取得	无
878	半导体器件的形成方法	ZL200910056725.1	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-04-17	原始取得	无
879	凸点的形成方法	ZL200910056726.6	中芯上海	2009-08-20	2012-03-07	原始取得	无
880	颗粒自动控制方法及系统	ZL200910056727.0	中芯上海	2009-08-20	2012-07-11	原始取得	无
881	非易失性存储器结构及其形成方法	ZL200910056728.5	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-09-11	原始取得	无
882	优化 CMOS 图像传感器版图的方法及刻蚀方法	ZL200910056729.x	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2012-12-05	原始取得	无
883	颗粒控制的方法	ZL200910056734.0	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-03-06	原始取得	无
884	形成互连结构的方法	ZL200910056735.5	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-03-06	原始取得	无
885	凸点的形成方法	ZL200910056737.4	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-01-23	原始取得	无
886	监测 DMR 性能的方法	ZL200910056767.5	中芯上海	2009-08-20	2012-05-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
887	顶层铜互连层的制作方法	ZL200910056768.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2013-07-31	原始取得	无
888	半导体器件的制作方法	ZL200910056769.4	中芯上海	2009-08-20	2012-07-18	原始取得	无
889	半导体器件的制作方法	ZL200910140304.7	中芯上海	2009-07-15	2012-03-21	原始取得	无
890	MOS 晶体管的形成方法及其阈值电压调节方法	ZL200910143705.8	中芯上海	2009-05-22	2011-07-20	原始取得	无
891	在边缘去除过程中减少晶圆缺陷的方法及晶圆结构	ZL200910146319.4	中芯上海	2009-06-19	2012-02-08	原始取得	无
892	一种晶圆缺陷分析方法	ZL200910194434.9	中芯上海	2009-08-21	2012-10-03	原始取得	无
893	氧化物层及包含其的闪存的栅极的制作方法	ZL200910194437.2	中芯上海	2009-08-21	2012-07-18	原始取得	无
894	制作存储器的字线方法	ZL200910194567.6	中芯上海、中芯北京	2009-08-25	2013-01-16	原始取得	无
895	铜化学机械抛光的过程控制方法和系统	ZL200910194573.1	中芯上海	2009-08-25	2012-07-25	原始取得	无
896	再分布结构的形成方法	ZL200910194574.6	中芯上海	2009-08-25	2012-09-26	原始取得	无
897	检测半导体器件的测试结构的方法	ZL200910194575.0	中芯上海	2009-08-25	2012-05-30	原始取得	无
898	超再生接收装置及方法	ZL200910194576.5	中芯上海、中芯北京	2009-08-25	2013-02-13	原始取得	无
899	一种测试装置及其测试方法	ZL200910194612.8	中芯上海、成都成芯	2009-08-26	2013-03-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
			半导体制造有限公司				
900	印刷线路板植针装置	ZL200910194613.2	中芯上海	2009-08-26	2012-11-14	原始取得	无
901	适配板、双工位测试机的改装方法和测试方法	ZL200910194615.1	中芯上海	2009-08-26	2013-06-19	原始取得	无
902	对栅氧化层进行失效分析的方法	ZL200910194616.6	中芯上海	2009-08-26	2012-06-20	原始取得	无
903	铅垫的制作方法	ZL200910194618.5	中芯上海	2009-08-26	2013-01-30	原始取得	无
904	功率金属氧化物半导体场效应晶体管及其制作方法	ZL200910194779.4	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2013-01-02	原始取得	无
905	电阻随机存储器及其驱动方法	ZL200910194782.6	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2013-05-29	原始取得	无
906	凸点制作方法以及凸点结构	ZL200910194787.9	中芯上海	2009-08-28	2012-12-05	原始取得	无
907	芯片的测试数据的处理方法及系统	ZL200910194788.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2013-03-27	原始取得	无
908	CMOS 图像传感器像素、制造方法及图像捕获设备	ZL200910194789.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2012-12-12	原始取得	无
909	接触插塞及接触插塞的形成方法	ZL200910194790.0	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2012-12-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
910	失效检测方法以及失效检测装置	ZL200910194791.5	中芯上海	2009-08-28	2012-05-16	原始取得	无
911	混合燃烧装置	ZL200910194792.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2012-12-12	原始取得	无
912	金属线形成方法	ZL200910194852.8	中芯上海	2009-08-31	2012-07-25	原始取得	无
913	差分闪存器件及提高差分闪存器件耐久性的方法	ZL200910194918.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-31	2014-02-05	原始取得	无
914	双镶嵌结构制作方法	ZL200910194919.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-31	2014-01-08	原始取得	无
915	晶片包装带以及晶片真空包装方法	ZL200910194921.5	中芯上海	2009-08-31	2012-10-03	原始取得	无
916	构造浮栅的方法	ZL200910195015.7	中芯上海	2009-09-02	2012-05-30	原始取得	无
917	晶圆级芯片尺寸封装结构及其制造方法	ZL200910195185.5	中芯上海	2009-09-04	2013-01-30	原始取得	无
918	功率 MOS 管制造方法	ZL200910195193.x	中芯上海	2009-09-04	2012-12-26	原始取得	无
919	接触孔的形成方法和接触插塞的形成方法	ZL200910195257.6	中芯上海、中芯北京	2009-09-03	2012-12-12	原始取得	无
920	P 沟道金属氧化物半导体晶体管源漏注入方法	ZL200910195408.8	中芯上海	2009-09-09	2012-02-08	原始取得	无
921	减小等离子体刻蚀中的反射	ZL200910195409.2	中芯上海	2009-09-09	2012-07-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	功率的方法						
922	用于互连工艺中的半导体器件及其制造方法	ZL200910195496.1	中芯上海、中芯北京	2009-09-09	2013-01-30	原始取得	无
923	网板以及在晶片背面形成保护层的方法	ZL200910195574.8	中芯上海、芯电上海	2009-09-11	2013-03-13	原始取得	无
924	功率器件的铝插塞制作方法	ZL200910195581.8	中芯上海、成都成芯半导体制造有限公司	2009-09-11	2015-02-11	原始取得	无
925	相变存储器、存储器单元的隔离结构以及制造方法	ZL200910195629.5	中芯上海、中芯北京	2009-09-11	2013-06-19	原始取得	无
926	半导体工艺中的检测方法和检测系统	ZL200910195633.1	中芯上海	2009-09-11	2012-05-23	原始取得	无
927	电化学电镀设备和方法	ZL200910195634.6	中芯上海、中芯北京	2009-09-11	2013-01-02	原始取得	无
928	用于检测淹没式等离子枪工作状况的半导体器件及方法	ZL200910195809.3	中芯上海、中芯北京	2009-09-15	2013-05-01	原始取得	无
929	一种减小接触孔关键尺寸的方法	ZL200910195810.6	中芯上海、中芯北京	2009-09-15	2014-01-01	原始取得	无
930	用于互连工艺中的半导体器件及其制造方法	ZL200910195811.0	中芯上海、中芯北京	2009-09-15	2013-01-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
931	用于形成微细尺寸结构的半导体光刻工艺方法	ZL200910195812.5	中芯上海、中芯北京	2009-09-15	2013-06-12	原始取得	无
932	物理气相沉积设备的清洗方法	ZL200910195836.0	中芯上海	2009-09-17	2012-07-04	原始取得	无
933	掺杂的方法	ZL200910195858.7	中芯上海	2009-09-17	2012-07-25	原始取得	无
934	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL200910195864.2	中芯上海、中芯北京	2009-09-17	2013-03-27	原始取得	无
935	一种改进芯片切割的方法	ZL200910195970.0	中芯上海、中芯北京	2009-09-17	2013-02-20	原始取得	无
936	多晶硅线、半导体器件以及存储器电路	ZL200910195977.2	中芯上海	2009-09-18	2012-07-11	原始取得	无
937	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL200910195979.1	中芯上海、中芯北京	2009-09-18	2014-07-02	原始取得	无
938	凸点的形成方法	ZL200910195980.4	中芯上海	2009-09-18	2012-06-20	原始取得	无
939	电盘接线防护装置	ZL200910196116.6	中芯上海	2009-09-22	2013-03-27	原始取得	无
940	用于将晶片移出化学机械抛光设备研磨头的方法	ZL200910196265.2	中芯上海	2009-09-22	2012-03-14	原始取得	无
941	半导体器件的栅极预掺杂方法	ZL200910196427.2	中芯上海	2009-09-25	2012-02-08	原始取得	无
942	提高连接孔特征尺寸均匀性	ZL200910196545.3	中芯上海、中芯北京	2009-09-27	2013-02-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的方法						
943	栅极保护方法和装置	ZL200910196546.8	中芯上海	2009-09-27	2012-05-30	原始取得	无
944	接触孔的光刻方法	ZL200910196547.2	中芯上海、中芯北京	2009-09-27	2013-01-16	原始取得	无
945	金属互连层的制作方法	ZL200910196548.7	中芯上海、中芯北京	2009-09-27	2013-01-23	原始取得	无
946	图像传感器的互连封装方法	ZL200910196809.5	中芯上海、中芯北京	2009-09-29	2015-03-11	原始取得	无
947	用于制造包含公共源极晶体管的半导体器件的方法	ZL200910196839.6	中芯上海、中芯北京	2009-09-28	2013-06-12	原始取得	无
948	铜金属层化学机械抛光后的表面处理方法	ZL200910197083.7	中芯上海、中芯北京	2009-10-13	2015-04-29	原始取得	无
949	分立栅存储器件的形成方法	ZL200910197088.X	中芯上海、中芯北京	2009-10-13	2013-07-17	原始取得	无
950	掩模图形校正方法以及掩模版制作方法	ZL200910197089.4	中芯上海	2009-10-13	2012-05-23	原始取得	无
951	多芯片封装体中芯片的分离方法	ZL200910197106.4	中芯上海	2009-10-13	2012-08-08	原始取得	无
952	金属插塞制作方法	ZL200910197111.5	中芯上海	2009-10-13	2013-01-30	原始取得	无
953	自对准金属硅化物的形成方法	ZL200910197368.0	中芯上海	2009-10-19	2012-07-04	原始取得	无
954	一种扩展电阻测试样品制备	ZL200910197373.1	中芯上海	2009-10-19	2012-05-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法及样品研磨固定装置						
955	沟槽的形成方法	ZL200910197443.3	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2013-03-06	原始取得	无
956	芯片的清洗方法	ZL200910197445.2	中芯上海	2009-10-20	2012-04-18	原始取得	无
957	分立栅存储器件的形成方法	ZL200910197448.6	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2014-03-12	原始取得	无
958	CMOS 图像传感器	ZL200910197450.3	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2013-01-23	原始取得	无
959	用于在晶圆上喷涂显影液的方法	ZL200910197578.X	中芯上海、中芯北京	2009-10-21	2014-05-21	原始取得	无
960	制作半导体器件中的接触孔的方法	ZL200910197944.1	中芯上海、中芯北京	2009-10-30	2013-05-01	原始取得	无
961	一种重布线机构	ZL200910198066.5	中芯上海	2009-10-30	2012-12-12	原始取得	无
962	钝化层干法刻蚀方法	ZL200910198097.0	中芯上海	2009-10-29	2012-05-30	原始取得	无
963	偏移侧墙及 MOS 晶体管的形成方法	ZL200910198116.X	中芯上海	2009-11-02	2012-03-07	原始取得	无
964	改善半导体器件结深特性的方法	ZL200910198489.7	中芯上海	2009-11-05	2012-07-25	原始取得	无
965	一种掩膜版缺陷修复方法	ZL200910198555.0	中芯上海	2009-11-10	2012-08-29	原始取得	无
966	CMOS 图像传感器的制作方法	ZL200910198568.8	中芯上海	2009-11-10	2013-03-27	原始取得	无
967	形成 CMOS 器件应力膜的方	ZL200910198583.2	中芯上海、中芯北京	2009-11-10	2013-01-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
968	PMOS 晶体管的制造方法	ZL200910198584.7	中芯上海	2009-11-10	2012-06-06	原始取得	无
969	集成电路铜互连结构的制作方法	ZL200910198587.0	中芯上海、中芯北京	2009-11-10	2013-09-11	原始取得	无
970	表面氧化物的去除方法	ZL200910198597.4	中芯上海	2009-11-10	2012-05-23	原始取得	无
971	一种多晶硅层间介质刻蚀方法	ZL200910198788.0	中芯上海	2009-11-09	2012-05-30	原始取得	无
972	一种半导体封装基座	ZL200910199210.7	中芯上海	2009-11-20	2012-08-29	原始取得	无
973	检测铝连接线过热缺陷的方法	ZL200910199216.4	中芯上海、中芯北京	2009-11-16	2013-01-16	原始取得	无
974	硅基液晶器件及其制造方法	ZL200910199230.4	中芯上海、中芯北京	2009-11-20	2013-04-17	原始取得	无
975	构成 MEMS 器件的硅衬底的刻蚀方法	ZL200910199452.6	中芯上海	2009-11-26	2012-08-29	原始取得	无
976	非等离子体辅助的化学气相沉积方法	ZL200910199648.5	中芯上海、中芯北京	2009-11-26	2013-09-18	原始取得	无
977	EEPROM 的存储单元及其制造方法	ZL200910199991.X	中芯上海、中芯北京	2009-12-04	2013-03-27	原始取得	无
978	沟槽形成方法	ZL200910199995.8	中芯上海、中芯北京	2009-12-04	2013-01-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
979	采用光刻板在衬底光刻胶上形成检测图形的方法	ZL200910199999.6	中芯上海、中芯北京	2009-12-04	2012-12-05	原始取得	无
980	圆孔图案的光刻方法	ZL200910200025.5	中芯上海	2009-12-01	2012-05-30	原始取得	无
981	复合介电层及其制作方法	ZL200910200945.7	中芯上海	2009-12-25	2012-11-21	原始取得	无
982	减少 HDP CVD 工艺中的等离子体诱发损伤的方法	ZL200910200989.X	中芯上海、中芯北京	2009-12-23	2013-03-13	原始取得	无
983	PMOS 硅基底凹陷工艺	ZL200910200992.1	中芯上海	2009-12-23	2012-07-18	原始取得	无
984	晶圆的喷雾清洗方法	ZL200910201056.2	中芯上海、中芯北京	2009-12-10	2013-03-06	原始取得	无
985	接触孔的刻蚀方法	ZL200910201057.7	中芯上海、中芯北京	2009-12-10	2013-03-27	原始取得	无
986	刻蚀连接孔的方法	ZL200910201074.0	中芯上海、中芯北京	2009-12-10	2016-08-03	原始取得	无
987	存储器件制造方法	ZL200910201185.1	中芯上海、中芯北京	2009-12-15	2013-05-29	原始取得	无
988	NMOS 器件及其形成方法	ZL200910201193.6	中芯上海、中芯北京	2009-12-15	2013-01-23	原始取得	无
989	相变随机存储器及其制作方法	ZL200910201197.4	中芯上海、中芯北京	2009-12-15	2013-07-17	原始取得	无
990	栅氧化层和介质层完整性的测试结构及测试方法	ZL200910201199.3	中芯上海、中芯北京	2009-12-15	2012-12-05	原始取得	无
991	分离栅快闪存储器及其制造方法	ZL200910201351.8	中芯上海	2009-12-17	2013-02-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
992	双曝光方法及刻蚀方法	ZL200910201462.9	中芯上海、中芯北京	2009-12-14	2012-12-05	原始取得	无
993	光刻胶图案的修正方法及刻蚀方法	ZL200910201464.8	中芯上海、中芯北京	2009-12-14	2013-01-02	原始取得	无
994	CMOS 晶体管应力记忆处理方法和 CMOS 晶体管	ZL200910201465.2	中芯上海、中芯北京	2009-12-14	2013-04-17	原始取得	无
995	一种金属层的制造方法	ZL200910247206.3	中芯上海、中芯北京	2009-12-24	2014-01-15	原始取得	无
996	序列号发生器及其形成方法、集成电路及其形成方法	ZL200910247496.1	中芯上海、中芯北京	2009-12-29	2013-04-17	原始取得	无
997	CMOS 图像传感器的制造方法及其器件结构	ZL200910247497.6	中芯上海、中芯北京	2009-12-29	2013-03-27	原始取得	无
998	半导体工艺生产流程中的测量数据的监测方法和装置	ZL200910248082.0	中芯上海、中芯北京	2009-12-31	2013-01-02	原始取得	无
999	一种氧氮氧多晶硅层间介质湿法刻蚀方法	ZL201010022521.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-04	2013-03-27	原始取得	无
1000	基于无衬结标准单元库的衬结单元插入方法	ZL201010022523.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-04	2013-04-24	原始取得	无
1001	半导体器件和使用应力记忆技术工艺制造半导体器件的	ZL201010022524.2	中芯上海、中芯北京	2010-01-04	2013-11-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
1002	浅沟槽隔离结构及其制作方法	ZL201010022568.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-06-19	原始取得	无
1003	制作 STI 的衬氧化层的方法	ZL201010022570.2	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-06-19	原始取得	无
1004	浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL201010022571.7	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2016-04-20	原始取得	无
1005	监测真空泵失效的装置和方法、真空度感测器	ZL201010022574.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-06-19	原始取得	无
1006	半导体器件及形成 CMOS 器件应力膜的方法	ZL201010022575.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2014-06-04	原始取得	无
1007	形成晶圆穿通孔的方法	ZL201010022577.4	中芯上海	2010-01-08	2012-07-11	原始取得	无
1008	化学机械研磨剂及化学机械研磨方法	ZL201010022578.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-11-06	原始取得	无
1009	集成电路结构、其制作方法和使用方法	ZL201010022579.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2014-03-12	原始取得	无
1010	半导体器件的制作方法	ZL201010022581.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-01-02	原始取得	无
1011	检测结构、检测方法及形成检测结构的方法	ZL201010022583.X	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-09-11	原始取得	无
1012	低 k 值介电薄膜形成方法	ZL201010022584.4	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-05-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1013	形成快闪存储器的方法	ZL201010022585.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-04-17	原始取得	无
1014	沟槽阵列的形成方法	ZL201010022587.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-12-04	原始取得	无
1015	制作接触孔的方法	ZL201010022612.2	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-06-12	原始取得	无
1016	优化 RF MOS 变容器布局的方法和 RF MOS 变容器	ZL201010022697.4	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2015-11-25	原始取得	无
1017	相变存储器及其制造方法	ZL201010022698.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2013-07-17	原始取得	无
1018	电阻随机存储器的初始化以及设置、复位方法	ZL201010022715.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2013-07-17	原始取得	无
1019	光刻掩膜以及光刻方法	ZL201010022717.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2015-10-14	原始取得	无
1020	图像传感器及其形成方法	ZL201010022718.2	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2013-01-02	原始取得	无
1021	一种氮氧化硅栅氧化层制造方法	ZL201010022720.X	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-03-13	原始取得	无
1022	使用 LPCVD 工艺沉积薄膜的方法	ZL201010022721.4	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-03-13	原始取得	无
1023	通孔及金属线沟槽的刻蚀方法	ZL201010022722.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-04-24	原始取得	无
1024	化学机械研磨方法	ZL201010022888.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-14	2013-04-10	原始取得	无
1025	制作互补金属氧化物半导体	ZL201010022890.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-14	2013-05-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	器件的方法和结构						
1026	测试座连接板	ZL201010022987.9	中芯上海	2010-01-19	2013-06-19	原始取得	无
1027	改善半导体器件的截止漏电流发散的方法	ZL201010023134.7	中芯上海、中芯北京	2010-01-20	2013-05-01	原始取得	无
1028	互连结构的形成方法	ZL201010102323.3	中芯上海	2010-01-28	2013-07-03	原始取得	无
1029	栅驱动 MOSFET 的静电放电测试结构及系统	ZL201010102369.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-04-10	原始取得	无
1030	非易失性存储器的测试方法	ZL201010102373.1	中芯上海	2010-01-28	2013-03-13	原始取得	无
1031	一种薄膜应力分布的监测方法	ZL201010102375.0	中芯上海	2010-01-28	2012-10-17	原始取得	无
1032	等离子体损伤检测结构及其制作方法	ZL201010102399.6	中芯上海	2010-01-28	2013-02-27	原始取得	无
1033	微电容 MOS 变容管和变容二极管的开路去嵌测试结构	ZL201010102404.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-04-10	原始取得	无
1034	防起雾的安全防目镜	ZL201010102408.1	中芯上海	2010-01-28	2013-05-29	原始取得	无
1035	一种制作半导体器件的方法	ZL201010102418.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-09-04	原始取得	无
1036	用于半导体工艺腔的清洁方法	ZL201010102419.X	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-04-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1037	改善半导体工艺中光刻图案线条边缘粗糙度的方法	ZL201010102431.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-04-10	原始取得	无
1038	一种用于半导体工艺中的掩膜	ZL201010102432.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2014-06-04	原始取得	无
1039	光阻去除方法	ZL201010102456.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-09-04	原始取得	无
1040	铜互连结构的形成方法及用于该方法的 CMP 设备	ZL201010102457.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-06-12	原始取得	无
1041	栅极刻蚀的方法	ZL201010104007.X	中芯上海	2010-01-27	2012-05-30	原始取得	无
1042	提高侧墙角均匀度的方法	ZL201010104013.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-03-06	原始取得	无
1043	阱区位置检测方法	ZL201010104673.3	中芯上海、中芯北京	2010-02-03	2013-01-02	原始取得	无
1044	用于化学机械研磨机台的制造程序控制方法及其控制系统	ZL201010110196.1	中芯上海	2010-02-11	2013-02-27	原始取得	无
1045	接触孔形成方法	ZL201010110197.6	中芯上海	2010-02-11	2013-01-30	原始取得	无
1046	一种栅极制造方法	ZL201010110200.4	中芯上海	2010-02-11	2012-12-12	原始取得	无
1047	形成互连结构的方法	ZL201010110450.8	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2013-05-01	原始取得	无
1048	一种制作半导体器件的方法	ZL201010110470.5	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2013-05-01	原始取得	无
1049	形成存储器有源层图案的方	ZL201010110480.9	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2013-12-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
1050	一种去除开尔文通孔的蚀刻残余物的方法	ZL201010110490.2	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2013-06-12	原始取得	无
1051	半导体器件及其制作方法	ZL201010110494.0	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2016-02-03	原始取得	无
1052	一种形成接触孔的方法	ZL201010110512.5	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2016-02-03	原始取得	无
1053	一种测试电感的方法	ZL201010110515.9	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2013-10-30	原始取得	无
1054	用于互连工艺的半导结构及其制造方法	ZL201010110556.8	中芯上海、中芯北京	2010-02-09	2014-05-14	原始取得	无
1055	射频电路中电感的短路测试装置及短路测试方法	ZL201010110791.5	中芯上海、中芯北京	2010-02-12	2013-05-08	原始取得	无
1056	接触孔测试装置和有源区接触孔对栅极的漏电流测试方法	ZL201010110806.8	中芯上海	2010-02-12	2013-05-29	原始取得	无
1057	一种废弃芯片单元回收利用方法	ZL201010113260.1	中芯上海	2010-02-24	2012-10-17	原始取得	无
1058	多栅结构 MOSFET 模型的建模方法	ZL201010118016.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-03	2013-06-12	原始取得	无
1059	用于评价改善负偏压下温度	ZL201010118029.1	中芯上海、中芯北京	2010-03-03	2013-12-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	不稳定性效应工艺效果的方法						
1060	半导体器件	ZL201010118042.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-03	2013-10-30	原始取得	无
1061	等离子体损伤检测结构、其检测方法及其形成方法	ZL201010118827.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-05	2013-09-11	原始取得	无
1062	光学邻近修正方法	ZL201010118841.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-05	2013-07-17	原始取得	无
1063	金属层下介电层测试结构	ZL201010123607.0	中芯上海	2010-03-12	2013-01-30	原始取得	无
1064	一种半导体成膜装置装载腔	ZL201010123615.5	中芯上海	2010-03-12	2013-03-27	原始取得	无
1065	栅极介质层制造方法	ZL201010123629.7	中芯上海	2010-03-12	2013-02-27	原始取得	无
1066	一种增强高 MEEF 图形的 OPC 精度的方法	ZL201010123638.6	中芯上海	2010-03-12	2013-01-16	原始取得	无
1067	制作互补型金属氧化物半导体器件的方法	ZL201010124461.1	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-12	原始取得	无
1068	一种改进的机器人伸缩臂	ZL201010124465.X	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-09-04	原始取得	无
1069	一种互补金属氧化物半导体器件结构的制作方法	ZL201010124565.2	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-12	原始取得	无
1070	一种形成通孔的方法	ZL201010124583.0	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2016-05-11	原始取得	无
1071	一种处理光刻胶的方法	ZL201010124586.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1072	制作半导体器件栅极的方法	ZL201010124608.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-12	原始取得	无
1073	防止晶圆翘曲的方法以及由该方法得到的晶圆	ZL201010124643.9	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-04-10	原始取得	无
1074	用于动态调整化学机械抛光的时间界限的方法	ZL201010124655.1	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-04-10	原始取得	无
1075	制作半导体器件栅极的方法	ZL201010124681.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-12	原始取得	无
1076	制作半导体器件间隙壁的方法	ZL201010124693.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-07-31	原始取得	无
1077	微电容 MOS 变容管和变容二极管的短路去嵌测试结构	ZL201010124713.0	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-05-01	原始取得	无
1078	功率 MOS 中 ESD PN 结的轮廓显现溶液及方法	ZL201010128901.0	中芯上海、成都成芯半导体制造有限公司	2010-03-19	2012-10-31	原始取得	无
1079	循环使用挡片的方法	ZL201010129098.2	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-07-03	原始取得	无
1080	晶片清洗装置	ZL201010129105.9	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-02-13	原始取得	无
1081	刻蚀栅极的方法	ZL201010130254.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-07-24	原始取得	无
1082	相变存储器存储单元的制作方法	ZL201010130267.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2013-06-19	原始取得	无
1083	半导体器件的制作方法	ZL201010130286.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2013-08-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1084	用于制造半导体器件的方法	ZL201010131765.0	中芯上海、中芯北京	2010-03-22	2014-06-04	原始取得	无
1085	制造 NMOS 晶体管的方法	ZL201010131791.3	中芯上海、中芯北京	2010-03-22	2015-09-09	原始取得	无
1086	一种制作具有应力层的互补金属氧化物半导体器件的方法	ZL201010131816.X	中芯上海、中芯北京	2010-03-22	2014-03-19	原始取得	无
1087	用于增强待量测图案的可辨认度的方法	ZL201010131817.4	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2013-07-31	原始取得	无
1088	一种处理含硅的底部抗反射涂层的方法	ZL201010131818.9	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2014-05-14	原始取得	无
1089	去除间隙壁结构的方法	ZL201010131819.3	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2013-04-10	原始取得	无
1090	半导体器件的制作方法	ZL201010131820.6	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2014-01-01	原始取得	无
1091	深 N 阱工艺去除光刻胶的方法	ZL201010131833.3	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2013-04-10	原始取得	无
1092	半导体工艺机台参数优化调整的方法	ZL201010131837.1	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2013-04-10	原始取得	无
1093	用于制作半导体器件的应力层的刻蚀方法	ZL201010131920.9	中芯上海、中芯北京	2010-03-15	2016-08-03	原始取得	无
1094	一种在半导体器件中形成开	ZL201010131938.9	中芯上海	2010-03-15	2013-05-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	口结构的方法						
1095	喷墨打印机中的加热栅极区域结构及制作方法	ZL201010136674.6	中芯上海、中芯北京	2010-03-26	2013-08-14	原始取得	无
1096	半导体器件层上的氧化层刻蚀后残留物的去除方法	ZL201010136701.X	中芯上海、中芯北京	2010-03-26	2013-03-06	原始取得	无
1097	沟槽的形成方法	ZL201010144202.5	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2013-05-29	原始取得	无
1098	通孔形成方法	ZL201010144205.9	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2013-03-27	原始取得	无
1099	降低铜互连结构中铜的电迁移的方法及铜互连结构	ZL201010144213.3	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2013-03-27	原始取得	无
1100	一种晶片清洗方法	ZL201010144215.2	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2013-11-06	原始取得	无
1101	双镶嵌结构形成方法	ZL201010144234.5	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2014-07-30	原始取得	无
1102	热电装置及其形成方法	ZL201010144277.3	中芯上海、中芯北京	2010-04-02	2014-09-03	原始取得	无
1103	工艺流程的优化方法和装置	ZL201010153867.2	中芯上海、中芯北京	2010-04-13	2013-03-27	原始取得	无
1104	检测半导体器件的金属互连层的方法	ZL201010153877.6	中芯上海、中芯北京	2010-04-13	2013-03-13	原始取得	无
1105	一种去除铜导线之间铜残留的方法	ZL201010153887.X	中芯上海、中芯北京	2010-04-13	2014-02-26	原始取得	无
1106	机台恢复处理的方法和装置	ZL201010153904.X	中芯上海、中芯北京	2010-04-13	2013-07-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1107	一种电容的形成方法	ZL201010154714.X	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2014-06-04	原始取得	无
1108	增强晶圆识别码清晰度的方法	ZL201010154722.4	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2016-03-16	原始取得	无
1109	一种双镶嵌结构的形成方法	ZL201010154726.2	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2015-03-11	原始取得	无
1110	电容器及其形成方法	ZL201010154752.5	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2013-09-11	原始取得	无
1111	LED 芯片封装结构及其封装方法	ZL201010154758.2	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2013-01-02	原始取得	无
1112	LED 芯片封装结构及其封装方法	ZL201010154764.8	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2013-01-02	原始取得	无
1113	浅沟槽隔离的制作方法	ZL201010154803.4	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2014-03-12	原始取得	无
1114	检测半导体器件介质层可靠性的方法和装置	ZL201010154824.6	中芯上海、中芯北京	2010-04-14	2013-05-29	原始取得	无
1115	通孔形成方法	ZL201010154826.5	中芯上海、中芯北京	2010-04-16	2013-08-14	原始取得	无
1116	硅基液晶器件及其制作方法	ZL201010154836.9	中芯上海、中芯北京	2010-04-16	2014-04-02	原始取得	无
1117	一种样品观测载网及其制造方法	ZL201010163852.4	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-04-29	2013-05-01	原始取得	无
1118	闪存器件及其制造方法	ZL201010164280.1	武汉新芯集成电路制	2010-04-29	2013-06-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
			造有限公司、中芯上海				
1119	真空吸笔	ZL201010165015.5	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-04-29	2013-04-17	原始取得	无
1120	相变存储器单元形成方法	ZL201010168871.6	中芯上海、中芯北京	2010-04-29	2013-04-17	原始取得	无
1121	提高通孔刻蚀稳定性的方法	ZL201010168890.9	中芯上海、中芯北京	2010-04-27	2013-06-19	原始取得	无
1122	测试系统及测试方法	ZL201010169193.5	中芯上海、中芯北京	2010-04-27	2014-01-08	原始取得	无
1123	高温炉尾气处理装置	ZL201010181279.x	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-05-21	2013-05-29	原始取得	无
1124	一种脉动缓冲器及研磨液供应系统	ZL201010181297.8	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-05-21	2013-05-29	原始取得	无
1125	存储芯片位线失效分析方法	ZL201010181309.7	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-05-21	2013-07-10	原始取得	无
1126	一种存储器芯片位线失效分	ZL201010181322.2	武汉新芯集成电路制	2010-05-21	2013-06-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	析方法		造有限公司、中芯上海				
1127	用于液体颗粒测试的适配装置	ZL201010181355.7	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-05-21	2013-07-03	原始取得	无
1128	接触插塞底部轮廓的检测方法	ZL201010181380.5	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-05-21	2013-06-12	原始取得	无
1129	一种芯片失效分析方法	ZL201010181477.6	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-05-21	2013-07-31	原始取得	无
1130	一种用于半导体工艺中的掩模板	ZL201010182691.3	中芯上海、中芯北京	2010-05-24	2013-04-10	原始取得	无
1131	制作半导体器件栅极的方法	ZL201010182714.0	中芯上海、中芯北京	2010-05-24	2013-05-01	原始取得	无
1132	横向双扩散金属氧化物半导体晶体管及其制造方法	ZL201010182772.3	中芯上海、中芯北京	2010-05-20	2013-05-01	原始取得	无
1133	半导体器件结构及其制造方法	ZL201010182901.9	中芯上海、中芯北京	2010-05-20	2013-09-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1134	用于互连工艺中的半导体器件及其制造方法	ZL201010182903.8	中芯上海、中芯北京	2010-05-20	2013-12-11	原始取得	无
1135	ICP-MS 在线取样装置及金属杂质在线监测方法	ZL201010192368.4	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-06-04	2013-01-30	原始取得	无
1136	一种透射电子显微镜观测样品制备方法	ZL201010192437.1	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-06-04	2013-09-25	原始取得	无
1137	接触孔的形成方法	ZL201010192860.1	中芯上海、中芯北京	2010-05-27	2013-01-02	原始取得	无
1138	制作掩膜版的方法、对布局图形进行光学邻近修正方法	ZL201010192865.4	中芯上海、中芯北京	2010-05-27	2014-05-07	原始取得	无
1139	一种嵌入式非挥发存储器单元及其工作方法、存储阵列	ZL201010199022.7	中芯上海、北京大学	2010-06-04	2013-09-04	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1140	晶圆组分配方法	ZL201010203802.4	中芯上海、中芯北京	2010-06-13	2014-01-15	原始取得	无
1141	半导体器件及其制作方法	ZL201010203803.9	中芯上海、中芯北京	2010-06-13	2014-03-19	原始取得	无
1142	制作半导体器件结构的方法	ZL201010203828.9	中芯上海、中芯北京	2010-06-13	2013-12-11	原始取得	无
1143	一种环形结构的制作方法	ZL201010203841.4	中芯上海、中芯北京	2010-06-13	2014-03-19	原始取得	无
1144	电阻存储器存储单元的制作	ZL201010217754.4	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2014-01-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
1145	制造半导体器件栅极侧墙的方法	ZL201010217764.8	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2013-03-20	原始取得	无
1146	栅结构氧化的方法	ZL201010217775.6	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2013-03-27	原始取得	无
1147	一种金属连线刻蚀方法	ZL201010217789.8	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2014-05-21	原始取得	无
1148	相变存储器存储单元底电极的制作方法	ZL201010217798.7	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2013-06-26	原始取得	无
1149	半导体器件精细图案的制作方法	ZL201010217807.2	中芯上海、中芯北京	2010-06-28	2013-04-24	原始取得	无
1150	相变存储器存储单元的制作方法	ZL201010217837.3	中芯上海、中芯北京	2010-06-25	2013-09-18	原始取得	无
1151	化学机械研磨金属的方法	ZL201010217863.6	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2013-03-13	原始取得	无
1152	制作互补型金属氧化物半导体器件结构的方法	ZL201010218018.0	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2013-12-11	原始取得	无
1153	制作沟槽和浅沟槽隔离结构的方法	ZL201010218021.2	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2014-05-14	原始取得	无
1154	制作半导体器件结构的方法	ZL201010218040.5	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2013-04-10	原始取得	无
1155	接触孔的制作方法	ZL201010218077.8	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2014-05-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1156	刻蚀终止层的制作方法	ZL201010218369.1	中芯上海、中芯北京	2010-06-25	2014-10-01	原始取得	无
1157	一种在晶圆上淀积掺氟氧化硅薄膜的方法	ZL201010221786.1	中芯上海、中芯北京	2010-06-30	2013-07-31	原始取得	无
1158	复合掩模及其制作方法	ZL201010223464.0	中芯上海、中芯北京	2010-07-02	2013-03-27	原始取得	无
1159	混合浆料系统、应用在该系统上的排水管及清洗方法	ZL201010223469.3	中芯上海、中芯北京	2010-07-02	2013-08-14	原始取得	无
1160	复合掩模及其制作方法	ZL201010223474.4	中芯上海、中芯北京	2010-07-02	2013-03-27	原始取得	无
1161	相变存储器、底部电极及其制作方法	ZL201010223482.9	中芯上海、中芯北京	2010-07-02	2014-04-02	原始取得	无
1162	离子注入机台的检测方法	ZL201010228194.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-08	2013-06-19	原始取得	无
1163	一种激光热退火方法	ZL201010228206.1	中芯上海、中芯北京	2010-07-08	2013-09-04	原始取得	无
1164	光刻方法	ZL201010228236.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-08	2013-01-16	原始取得	无
1165	在氮化硅表面淀积氧化硅的方法	ZL201010228240.9	中芯上海、中芯北京	2010-07-09	2013-05-08	原始取得	无
1166	相变存储器存储单元的制作方法	ZL201010228246.6	中芯上海、中芯北京	2010-07-06	2013-09-18	原始取得	无
1167	相变存储器存储单元的制作方法	ZL201010228335.0	中芯上海、中芯北京	2010-07-06	2013-10-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1168	浅沟道隔离区的制作方法	ZL201010229234.5	中芯上海	2010-07-16	2013-04-17	原始取得	无
1169	一种多晶硅平坦化方法	ZL201010233192.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-15	2012-12-26	原始取得	无
1170	截面为圆环的圆柱体的半导体器件的制作方法	ZL201010233196.0	中芯上海、中芯北京	2010-07-15	2013-06-19	原始取得	无
1171	检测通孔缺陷的方法	ZL201010233233.8	中芯上海、中芯北京	2010-07-16	2014-01-15	原始取得	无
1172	一种金属铝焊垫刻蚀方法	ZL201010233241.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-16	2013-09-04	原始取得	无
1173	晶圆清洗甩干机	ZL201010236820.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-22	2013-06-12	原始取得	无
1174	化学机械研磨方法	ZL201010236837.8	中芯上海、中芯北京	2010-07-22	2013-09-18	原始取得	无
1175	一种金属栅极的形成方法	ZL201010245296.5	中芯上海、中芯北京	2010-07-30	2013-08-14	原始取得	无
1176	一种 MOCVD 加热装置、其形成方法和一种 MOCVD 形成薄膜的方法	ZL201010245306.5	中芯上海、中芯北京	2010-07-30	2013-06-19	原始取得	无
1177	样品失效分析方法	ZL201010245311.6	中芯上海、中芯北京	2010-07-30	2013-10-09	原始取得	无
1178	一种 TEM 的半导体样品制备方法	ZL201010245385.X	中芯上海、中芯北京	2010-07-26	2013-07-24	原始取得	无
1179	用于制作半导体器件的方法	ZL201010245435.4	中芯上海、中芯北京	2010-07-29	2014-01-15	原始取得	无
1180	用于等离子体工艺的系统	ZL201010245442.4	中芯上海、中芯北京	2010-07-29	2014-03-19	原始取得	无
1181	一种用于形成半导体器件结	ZL201010245449.6	中芯上海、中芯北京	2010-07-29	2014-03-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	构的方法						
1182	制作掺杂阱以及包含该掺杂阱的晶体管的方法	ZL201010245472.5	中芯上海、中芯北京	2010-07-29	2013-09-04	原始取得	无
1183	用于制造包含应力层的半导体器件结构的方法	ZL201010245483.3	中芯上海、中芯北京	2010-07-29	2013-10-30	原始取得	无
1184	制作具有 P 型多晶硅栅的半导体器件结构的方法	ZL201010245506.0	中芯上海、中芯北京	2010-07-30	2013-07-31	原始取得	无
1185	半导体器件精细图案的制作方法	ZL201010245580.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-27	2013-01-16	原始取得	无
1186	防止存储器穿通电压降低的方法及存储器	ZL201010245598.2	中芯上海、中芯北京	2010-07-28	2014-07-02	原始取得	无
1187	相变非易失性存储器及其加工方法	ZL201010248140.2	中芯上海、中芯北京	2010-08-05	2013-09-18	原始取得	无
1188	一种栅极刻蚀方法	ZL201010248154.4	中芯上海、中芯北京	2010-08-05	2013-06-12	原始取得	无
1189	相变存储器底部电极的制作方法	ZL201010248155.9	中芯上海、中芯北京	2010-08-05	2013-07-17	原始取得	无
1190	一种形成存储器件的方法	ZL201010248158.2	中芯上海、中芯北京	2010-08-05	2014-01-08	原始取得	无
1191	减小半导体器件中通孔尺寸	ZL201010251339.0	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2016-04-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的方法						
1192	接触孔的形成方法	ZL201010253549.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2013-11-06	原始取得	无
1193	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201010253555.9	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2013-08-14	原始取得	无
1194	相变存储器的形成方法	ZL201010253558.2	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2013-10-09	原始取得	无
1195	硅片夹持环的回收方法	ZL201010253562.9	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2013-07-17	原始取得	无
1196	一种合格晶粒分布图的生成方法和装置	ZL201010253589.8	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2014-04-09	原始取得	无
1197	相变存储器存储单元的制作方法	ZL201010253593.4	中芯上海、中芯北京	2010-08-10	2013-10-23	原始取得	无
1198	半导体器件精细图案的制作方法	ZL201010253783.6	中芯上海、中芯北京	2010-08-12	2013-02-13	原始取得	无
1199	半导体元器件制造过程中的显影方法	ZL201010253803.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-09	2014-06-11	原始取得	无
1200	金属刻蚀方法	ZL201010253806.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-12	2013-06-26	原始取得	无
1201	显影工艺的检测版图以及显影工艺的检测方法	ZL201010261631.0	中芯上海	2010-08-24	2013-03-13	原始取得	无
1202	用于半导体制程的排气系统和清洗该排气系统的方法	ZL201010263239.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2014-06-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1203	磁通道结存储单元及其制造方法	ZL201010263258.2	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-12-11	原始取得	无
1204	用于制作相变随机存取存储器存储单元的方法	ZL201010263267.1	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-12-11	原始取得	无
1205	形成半导体器件结构的方法	ZL201010263287.9	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-10-30	原始取得	无
1206	制造半导体器件的方法	ZL201010263295.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2015-12-16	原始取得	无
1207	CMOS 器件应力膜的形成方法	ZL201010266056.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-11-06	原始取得	无
1208	环状电极形成方法	ZL201010266059.7	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-07-17	原始取得	无
1209	抛光装置	ZL201010266066.7	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2014-09-24	原始取得	无
1210	抛光垫清理器	ZL201010266067.1	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-12-04	原始取得	无
1211	接触孔失效评估方法	ZL201010267382.6	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2013-05-29	原始取得	无
1212	相变存储器的制造方法	ZL201010267388.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2016-01-06	原始取得	无
1213	接触孔偏移检测方法以及检测结构	ZL201010267390.0	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2013-05-29	原始取得	无
1214	利用化学机械研磨设备对晶片返工的方法	ZL201010267395.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2013-07-17	原始取得	无
1215	一种短路缺陷测试装置和方法	ZL201010267402.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-25	2015-07-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1216	磁阻存储器的形成方法	ZL201010267441.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2013-08-14	原始取得	无
1217	相变存储器相变层的制作方法	ZL201010267466.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2013-10-09	原始取得	无
1218	形成接触孔的方法	ZL201010267499.4	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2014-04-02	原始取得	无
1219	晶圆表面的化学机械研磨方法	ZL201010267508.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2014-05-07	原始取得	无
1220	对前层图形进行对准的方法以及该方法适用的光罩	ZL201010267510.7	中芯上海、中芯北京	2010-08-25	2014-10-01	原始取得	无
1221	机房风机的自动控制电路	ZL201010267519.8	中芯上海、中芯北京	2010-08-25	2015-05-20	原始取得	无
1222	提高对准精度的方法	ZL201010267527.2	中芯上海、中芯北京	2010-08-25	2013-07-24	原始取得	无
1223	用于半导体工艺的灰化处理方法	ZL201010267550.1	中芯上海、中芯北京	2010-08-19	2013-09-04	原始取得	无
1224	改善双应力氮化物表面形态的方法	ZL201010267561.X	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2014-03-19	原始取得	无
1225	用于测量底部抗反射涂层材料的挥发特性的方法	ZL201010267570.9	中芯上海、中芯北京	2010-08-24	2014-05-21	原始取得	无
1226	减少对准容差的方法及其在热处理工艺中的专用设备	ZL201010272604.3	中芯上海、中芯北京	2010-08-27	2013-10-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1227	应用在存储器中的锁存放大电路及读取方法	ZL201010272725.8	中芯上海、中芯北京	2010-08-27	2014-05-21	原始取得	无
1228	一种防止分离栅闪存中堆叠栅极线倒塌的方法	ZL201010272737.0	中芯上海、中芯北京	2010-08-27	2013-10-30	原始取得	无
1229	用于透射电子显微镜检测的半导体结构的制备方法和结构	ZL201010274956.2	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-03-19	原始取得	无
1230	一种制作半导体器件的方法	ZL201010274989.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-05-14	原始取得	无
1231	一种相变存储器元件及其制作方法	ZL201010274993.3	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-12-11	原始取得	无
1232	一种制作相变存储器元件的方法	ZL201010275006.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-03-19	原始取得	无
1233	形成单晶硅层的方法	ZL201010275009.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-12-11	原始取得	无
1234	用于制作多晶硅栅结构的方法	ZL201010275041.3	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-03-19	原始取得	无
1235	用于去除半导体器件结构上的光致抗蚀剂层的方法	ZL201010275045.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-06-25	原始取得	无
1236	一种半导体器件结构	ZL201010275052.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-10-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1237	用于形成小间距图案的方法	ZL201010275055.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-06-12	原始取得	无
1238	制作用于形成双大马士革结构的半导体器件结构的方法	ZL201010275062.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-10-30	原始取得	无
1239	用于透射电子显微镜检测的样品组及其制作方法	ZL201010275065.9	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-11-05	原始取得	无
1240	制备半导体器件结构的方法	ZL201010275079.0	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-06-12	原始取得	无
1241	制作半导体器件结构的方法	ZL201010275091.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2013-12-11	原始取得	无
1242	制作半导体器件结构的方法	ZL201010275136.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-03	2014-05-21	原始取得	无
1243	栅极堆叠结构及其制作方法	ZL201010275137.X	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2014-02-05	原始取得	无
1244	晶圆位置的检测装置	ZL201010275156.2	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2013-07-17	原始取得	无
1245	平坦化晶圆表面的方法	ZL201010275157.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2014-01-08	原始取得	无
1246	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010275158.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2013-08-14	原始取得	无
1247	制备失效分析样品的方法	ZL201010275159.6	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2014-03-12	原始取得	无
1248	电镀阳极	ZL201010275171.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2014-09-24	原始取得	无
1249	半导体器件的形成方法	ZL201010275172.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-01	2015-04-29	原始取得	无
1250	高 K 栅介电层的制作方法及形成 MOS 晶体管的方法	ZL201010275175.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-05-29	原始取得	无
1251	双应力衬垫半导体器件的形	ZL2010102751810.0	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-09-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	成方法						
1252	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201010275182.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-06-19	原始取得	无
1253	钳位电路及闪速电可擦写存储器	ZL201010275183.X	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2015-04-29	原始取得	无
1254	金属栅极的形成方法	ZL201010275184.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2014-03-12	原始取得	无
1255	金属栅极的形成方法	ZL201010275185.9	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-07-17	原始取得	无
1256	MOS 晶体管及其栅介电层的制作方法	ZL201010275191.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-09-11	原始取得	无
1257	形成瓶式沟槽以及瓶式沟槽电容器的方法	ZL201010275192.9	中芯上海、中芯北京	2010-09-02	2013-09-11	原始取得	无
1258	一种激活掺杂原子的方法	ZL201010278730.X	中芯上海、中芯北京	2010-09-08	2013-11-20	原始取得	无
1259	半导体器件及其制作方法	ZL201010279881.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-09	2013-09-11	原始取得	无
1260	高效气体过滤系统	ZL201010285306.8	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-09-17	2014-03-12	原始取得	无
1261	检测掩模板污染的方法	ZL201010288076.0	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2013-12-11	原始取得	无
1262	传输模块压力平衡设备	ZL201010288077.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2014-03-19	原始取得	无
1263	一种制作相变存储器元件的	ZL201010288123.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2014-06-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
1264	一种半导体器件结构的制作方法	ZL201010288132.0	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2014-05-14	原始取得	无
1265	制作半导体器件结构的线接触孔的方法	ZL201010288142.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2014-10-29	原始取得	无
1266	浅沟槽隔离结构形成方法	ZL201010292403.X	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2014-07-30	原始取得	无
1267	等离子刻蚀方法及其装置、扩散阻挡层的等离子刻蚀方法	ZL201010292452.3	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-10-09	原始取得	无
1268	快闪存储器的制造方法	ZL201010292464.6	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-10-09	原始取得	无
1269	TEM 样品的制备方法	ZL201010292468.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-03-06	原始取得	无
1270	形成电阻布局图形的方法	ZL201010292473.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-10-09	原始取得	无
1271	电路布局的调整方法	ZL201010292482.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-03-27	原始取得	无
1272	相变存储器底部电极的制作方法	ZL201010292502.8	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2013-08-14	原始取得	无
1273	浅沟槽隔离结构形成方法	ZL201010292511.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-19	2015-09-02	原始取得	无
1274	“T”形金属栅电极的制作方法	ZL201010292576.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2013-10-16	原始取得	无
1275	倒梯形替代栅极及倒梯形金	ZL201010292584.6	中芯上海、中芯北京	2010-09-17	2013-07-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	属栅电极的制作方法						
1276	MOS 晶体管的形成方法	ZL201010299330.7	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2013-08-14	原始取得	无
1277	MOS 晶体管的形成方法	ZL201010299338.3	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2013-08-14	原始取得	无
1278	存储器件的制造方法	ZL201010299339.8	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2013-07-17	原始取得	无
1279	形成强化对准标记的方法以及半导体器件	ZL201010299341.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2017-06-13	原始取得	无
1280	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010299349.1	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2014-04-02	原始取得	无
1281	低温快速热处理的温度监控方法	ZL201010299350.4	中芯上海、中芯北京	2010-09-25	2016-05-25	原始取得	无
1282	一种制作栅极的方法	ZL201010503709.5	中芯上海、中芯北京	2010-09-30	2013-12-11	原始取得	无
1283	重新形成光刻胶图形的方法	ZL201010503721.6	中芯上海、中芯北京	2010-09-30	2013-06-05	原始取得	无
1284	相变存储器底部电极的制作方法	ZL201010503848.8	中芯上海、中芯北京	2010-10-08	2013-07-17	原始取得	无
1285	一种金属互连方法	ZL201010507012.5	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2014-06-04	原始取得	无
1286	磁性随机存取存储器及其制造方法	ZL201010508919.3	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-03-12	原始取得	无
1287	相变存储器沟槽隔离结构的制作方法	ZL201010508926.3	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-07-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1288	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010508933.3	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-02-05	原始取得	无
1289	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010508935.2	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-03-12	原始取得	无
1290	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010508947.5	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-04-02	原始取得	无
1291	互连结构的制作方法	ZL201010508949.4	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2013-09-11	原始取得	无
1292	一种金属栅极的形成方法	ZL201010508957.9	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2013-10-09	原始取得	无
1293	相变存储器沟槽隔离结构的制作方法	ZL201010508960.0	中芯上海、中芯北京	2010-10-13	2014-09-24	原始取得	无
1294	双层曝光补偿方法	ZL201010509167.2	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2013-09-11	原始取得	无
1295	待刻蚀层的刻蚀速率分布曲线的数据库,形成及使用方法	ZL201010509280.0	中芯上海、中芯北京	2010-10-18	2014-05-14	原始取得	无
1296	双层相变电阻及其形成方法、相变存储器及其形成方法	ZL201010509349.X	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2014-09-03	原始取得	无
1297	失效分析结构,其形成方法及其失效分析方法	ZL201010509365.9	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2013-11-06	原始取得	无
1298	形成互连沟槽以及通孔的方法及形成互连结构的方法	ZL201010509393.0	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2016-03-16	原始取得	无
1299	双重图形化方法	ZL201010509399.8	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2013-09-11	原始取得	无
1300	相变存储器的制造方法	ZL201010509421.9	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2014-01-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1301	互连结构的制作方法	ZL201010509437.X	中芯上海、中芯北京	2010-10-14	2013-11-06	原始取得	无
1302	测试样片及其使用方法	ZL201010509826.2	中芯上海、中芯北京	2010-10-18	2014-10-01	原始取得	无
1303	检测晶片表面形貌的方法	ZL201010509829.6	中芯上海、中芯北京	2010-10-18	2014-07-23	原始取得	无
1304	基于双应力薄膜技术的半导体器件的制作方法	ZL201010512624.3	中芯上海、中芯北京	2010-10-20	2013-12-18	原始取得	无
1305	半导体器件的制作方法	ZL201010513054.X	中芯上海、中芯北京	2010-10-20	2014-02-26	原始取得	无
1306	一种高介电常数介质-金属栅极的制造方法	ZL201010518621.0	中芯上海、中芯北京	2010-10-25	2013-10-23	原始取得	无
1307	延长光刻胶溶剂的存储期限的方法和装置	ZL201010518924.2	中芯上海、中芯北京	2010-10-25	2013-06-26	原始取得	无
1308	一种快闪存储器及其制备方法和操作方法	ZL201010523321.1	中芯上海、北京大学	2010-10-22	2013-09-04	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1309	一种掺杂阱的制作方法	ZL201010524925.8	中芯上海、中芯北京	2010-10-29	2015-05-20	原始取得	无
1310	降低固定研磨粒化学机械研磨设备的记忆效应的方法	ZL201010524968.6	中芯上海、中芯北京	2010-10-29	2014-05-14	原始取得	无
1311	生成镍合金自对准硅化物的方法	ZL201010524969.0	中芯上海、中芯北京	2010-10-29	2014-11-05	原始取得	无
1312	对半导体器件结构的焊垫进	ZL201010524970.3	中芯上海、中芯北京	2010-10-29	2014-06-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	行俄歇分析的方法						
1313	相变随机存取存储器的存储单元	ZL201010524974.1	中芯上海、中芯北京	2010-10-29	2014-06-25	原始取得	无
1314	无衬底引出半导体器件的栅介质层陷阱密度的测试方法	ZL201010528764.X	中芯上海、北京大学	2010-11-02	2012-12-12	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1315	TEM 样品的制备方法	ZL201010531228.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-03	2013-12-04	原始取得	无
1316	接触孔的形成方法	ZL201010531245.9	中芯上海、中芯北京	2010-11-03	2014-06-04	原始取得	无
1317	TEM 样品的制备方法	ZL201010531258.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-03	2013-11-06	原始取得	无
1318	便携式阀门辅助拆装工具	ZL201010531669.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-04	2014-01-01	原始取得	无
1319	在指定区域形成侧墙的方法	ZL201010531711.3	中芯上海、中芯北京	2010-11-04	2013-12-11	原始取得	无
1320	芯片固定基座和芯片固定连接方式	ZL201010532525.1	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2015-04-01	原始取得	无
1321	金属栅极的形成方法	ZL201010532550.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2013-12-04	原始取得	无
1322	互连结构的制造方法	ZL201010532558.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2015-04-29	原始取得	无
1323	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201010532573.0	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2013-11-06	原始取得	无
1324	MOS 晶体管的形成方法	ZL201010532590.4	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2014-06-04	原始取得	无
1325	栅介质层和晶体管的制作方法	ZL201010532616.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2013-12-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1326	一种半导体器件的栅极形成方法	ZL201010532653.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2017-11-28	原始取得	无
1327	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL201010532663.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2014-11-05	原始取得	无
1328	一种晶片的清洗方法	ZL201010532665.9	中芯上海、中芯北京	2010-11-01	2015-10-14	原始取得	无
1329	浅沟槽隔离结构形成方法	ZL201010546052.0	中芯上海、中芯北京	2010-11-15	2015-01-21	原始取得	无
1330	浅沟槽隔离结构形成方法	ZL201010546103.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-15	2014-03-12	原始取得	无
1331	阴影效应分析结构,其形成方法和其分析方法	ZL201010546311.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-15	2013-11-06	原始取得	无
1332	相变半导体器件的制造方法	ZL201010547506.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-17	2014-12-03	原始取得	无
1333	相变存储器及其制作方法	ZL201010548111.8	中芯上海、中芯北京	2010-11-17	2013-12-04	原始取得	无
1334	熔丝结构及其制作方法	ZL201010549165.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2014-02-05	原始取得	无
1335	晶体管的制作方法	ZL201010549358.1	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2014-02-05	原始取得	无
1336	晶圆基座及其使用,清洗方法	ZL201010550051.3	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2013-12-04	原始取得	无
1337	相变存储器的制作方法	ZL201010550137.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2014-06-04	原始取得	无
1338	金属栅电极的制作方法	ZL201010551239.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2013-10-09	原始取得	无
1339	铝的化学机械抛光方法	ZL201010551387.1	中芯上海、中芯北京	2010-11-18	2014-09-24	原始取得	无
1340	晶体管的制作方法	ZL201010551481.7	中芯上海、中芯北京	2010-11-19	2014-06-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1341	半导体结构及其形成方法	ZL201010552513.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-19	2014-11-05	原始取得	无
1342	半导体器件的形成方法	ZL201010553680.1	中芯上海、中芯北京	2010-11-19	2013-12-04	原始取得	无
1343	金属栅电极的制作方法	ZL201010553697.7	中芯上海、中芯北京	2010-11-19	2014-07-02	原始取得	无
1344	提高后层曝光工艺宽容度的方法	ZL201010554141.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-22	2014-07-16	原始取得	无
1345	形成氮氧化硅层的方法	ZL201010555454.7	中芯上海、中芯北京	2010-11-22	2013-10-23	原始取得	无
1346	一种平衡机台产能的方法和装置	ZL201010555592.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-22	2013-07-31	原始取得	无
1347	提高晶圆上源漏极退火时工作电流均匀性的方法	ZL201010555991.1	中芯上海、中芯北京	2010-11-23	2013-12-11	原始取得	无
1348	一种量测工序优化方法和装置	ZL201010556100.4	中芯上海、中芯北京	2010-11-23	2013-09-04	原始取得	无
1349	浅沟槽隔离结构中的沟槽填充方法	ZL201010557679.6	中芯上海、中芯北京	2010-11-24	2014-08-13	原始取得	无
1350	光刻方法	ZL201010557695.5	中芯上海、中芯北京	2010-11-24	2014-02-26	原始取得	无
1351	减少金属栅电极和接触孔之间寄生电容的方法	ZL201010563664.0	中芯上海、中芯北京	2010-11-29	2013-11-20	原始取得	无
1352	双大马士革结构的形成方法	ZL201010563681.4	中芯上海、中芯北京	2010-11-29	2015-01-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1353	晶片毛刷清洗装置及晶片毛刷清洗方法	ZL201010565515.8	中芯上海、中芯北京	2010-11-29	2013-09-11	原始取得	无
1354	双镶嵌结构及其形成方法	ZL201010566587.4	中芯上海、中芯北京	2010-11-30	2014-03-12	原始取得	无
1355	一种金属氧化物半导体场效应晶体管的制作方法	ZL201010567043.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-29	2014-04-26	原始取得	无
1356	CMOS 器件及其制作方法	ZL201010567602.7	中芯上海、中芯北京	2010-11-30	2014-12-24	原始取得	无
1357	一种化学机械研磨装置	ZL201010567640.2	中芯上海、中芯北京	2010-11-30	2014-05-07	原始取得	无
1358	纳米环型磁隧道结的制造方法、磁阻内存的制造方法	ZL201010568181.X	中芯上海、中芯北京	2010-11-30	2014-01-08	原始取得	无
1359	金属前层层间介质氧化物的淀积方法	ZL201010568440.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2013-09-18	原始取得	无
1360	一种检测膜层应力的方法	ZL201010568450.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2014-02-12	原始取得	无
1361	提高介质层的均匀性方法	ZL201010568457.4	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2013-08-14	原始取得	无
1362	具有多孔结构的超低介电常数的层间介质的淀积方法	ZL201010568476.7	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2014-03-19	原始取得	无
1363	形成栅极的方法	ZL201010569006.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2014-07-02	原始取得	无
1364	电压转换速率控制电路和输出电路	ZL201010569395.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2014-02-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1365	辅助侧墙的形成方法	ZL201010569396.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-01	2015-04-29	原始取得	无
1366	一种 NMOS 器件源极和漏极的制作方法	ZL201010569956.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-02	2014-06-04	原始取得	无
1367	TEM 样品的再加工方法	ZL201010571851.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-03	2013-08-14	原始取得	无
1368	光刻方法	ZL201010572023.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-03	2013-03-27	原始取得	无
1369	化学机械抛光的方法,用于化学机械抛光的清洗装置	ZL201010573216.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-03	2013-12-04	原始取得	无
1370	半导体器件的形成方法	ZL201010573218.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-03	2013-10-09	原始取得	无
1371	相变存储器阵列,相变存储器单元及其形成方法	ZL201010573359.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-03	2014-07-30	原始取得	无
1372	确定湿法刻蚀工艺窗口的方法	ZL201010574471.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-06	2014-02-26	原始取得	无
1373	半导体器件的制作方法	ZL201010575984.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-07	2014-11-05	原始取得	无
1374	延时电路及控制延时电路补偿电源电压漂移的方法及装置	ZL201010580808.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-09	2014-07-30	原始取得	无
1375	用于制作半导体器件的源/漏区的方法	ZL201010589571.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-15	2015-07-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1376	半导体器件结构及其制作方法	ZL201010589577.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-15	2014-10-01	原始取得	无
1377	反应腔的输气管道系统及其控制方法	ZL201010594837.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-17	2014-09-24	原始取得	无
1378	形成焊垫再分布的方法	ZL201010594916.6	中芯上海、中芯北京	2010-12-17	2014-04-02	原始取得	无
1379	用于制造 NMOS 半导体器件的方法	ZL201010600601.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2015-04-01	原始取得	无
1380	用于制作应变半导体器件结构的方法	ZL201010600604.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2015-07-08	原始取得	无
1381	一种晶圆清洗装置	ZL201010600605.6	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2015-07-08	原始取得	无
1382	相变存储器的制作方法	ZL201010601467.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2014-03-12	原始取得	无
1383	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201010601637.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2014-08-06	原始取得	无
1384	一种通孔刻蚀方法	ZL201010601640.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2015-05-13	原始取得	无
1385	相变存储器的制作方法	ZL201010601802.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2014-02-05	原始取得	无
1386	制作电擦除可编程存储器中的隧道氧化层窗口的方法	ZL201010601888.6	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2014-02-26	原始取得	无
1387	一种金属栅极的制作方法	ZL201010601954.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-22	2014-03-12	原始取得	无
1388	P 型金属氧化物半导体管的制	ZL201010603101.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2016-03-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	作方法						
1389	快速退火处理中晶片位置校正方法	ZL201010603138.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2014-03-19	原始取得	无
1390	一种金属栅极的形成方法	ZL201010603417.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2014-04-02	原始取得	无
1391	铝金属栅极的形成方法	ZL201010603682.7	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2015-04-29	原始取得	无
1392	制作金属硅化物的方法	ZL201010604274.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-24	2014-05-14	原始取得	无
1393	制作半导体器件的方法	ZL201010604326.7	中芯上海、中芯北京	2010-12-24	2014-03-19	原始取得	无
1394	用于制作嵌入式锗硅应变 PMOS 器件结构的方法	ZL201010604327.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-24	2015-05-20	原始取得	无
1395	金属栅极的形成方法	ZL201010604678.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2014-05-07	原始取得	无
1396	研磨垫清洗方法	ZL201010604743.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2014-12-03	原始取得	无
1397	具有高 K 金属栅极的金属氧化物半导体的形成方法	ZL201010604745.0	中芯上海、中芯北京	2010-12-23	2014-12-24	原始取得	无
1398	半导体器件、形成栓塞的方法	ZL201010608248.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-27	2014-07-30	原始取得	无
1399	一种浅沟槽隔离制作方法	ZL201010609554.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-28	2015-01-28	原始取得	无
1400	一种浅沟槽隔离制作方法	ZL201010609570.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-28	2014-03-26	原始取得	无
1401	基于压印技术的互连方法	ZL201010609581.0	中芯上海、中芯北京	2010-12-28	2014-01-01	原始取得	无
1402	一种金属栅极的制作方法	ZL201010610018.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-28	2014-03-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1403	防裂结构	ZL201010610019.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-28	2015-01-28	原始取得	无
1404	焊垫结构及其制造方法	ZL201010610257.0	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2010-12-23	2015-01-07	原始取得	无
1405	双压印方法	ZL201010612440.4	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2013-09-18	原始取得	无
1406	一种光刻方法	ZL201010612960.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2013-11-06	原始取得	无
1407	一种金属栅极的形成方法	ZL201010612985.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2014-05-07	原始取得	无
1408	投影掩膜版的测试系统	ZL201010613371.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2015-04-29	原始取得	无
1409	一种固定研磨粒抛光垫清洗装置及清洗方法	ZL201010613438.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2015-04-29	原始取得	无
1410	选择性外延工艺的监控方法	ZL201010613731.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-29	2014-11-05	原始取得	无
1411	用于芯片封装前测试的测试电路及其测试方法	ZL201010614348.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2015-07-29	原始取得	无
1412	适于源漏导通检测的检测结构及其检测方法	ZL201010614625.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-04-16	原始取得	无
1413	光刻工艺的返工方法	ZL201010615162.8	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-07-23	原始取得	无
1414	一种在晶片上生长含碳薄膜的方法	ZL201010615163.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-06-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1415	一种制作半导体器件结构的方法	ZL201010615164.7	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-07-30	原始取得	无
1416	半导体器件结构和制作该半导体器件结构的方法	ZL201010615165.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-06-25	原始取得	无
1417	一种制造半导体器件结构的方法和半导体器件结构	ZL201010615184.4	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-05-14	原始取得	无
1418	相变存储器形成方法	ZL201010616680.1	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-03-12	原始取得	无
1419	固定式颗粒研磨装置及其研磨方法	ZL201010617100.0	中芯上海、中芯北京	2010-12-30	2014-11-05	原始取得	无
1420	玻璃衬底的处理方法	ZL201010620462.5	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2014-11-05	原始取得	无
1421	光刻系统	ZL201010620463.X	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2013-11-06	原始取得	无
1422	MEMS 装置的制作方法	ZL201010620560.9	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2014-11-05	原始取得	无
1423	准 SOI 结构的制造方法	ZL201010620561.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2014-12-24	原始取得	无
1424	栅极氧化层的形成方法	ZL201010620563.2	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2014-04-02	原始取得	无
1425	存储器的制造方法、存储器	ZL201010620995.3	中芯上海、中芯北京	2010-12-31	2014-05-07	原始取得	无
1426	高掺杂注入光刻胶的剥离工艺	ZL201019063023.6	中芯上海	2010-02-05	2012-11-21	原始取得	无
1427	一种研磨垫及其制备方法、使	ZL201110023424.6	中芯上海	2011-01-20	2015-12-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	用方法						
1428	一种半导体器件的研磨方法	ZL201110023431.6	中芯上海	2011-01-20	2014-03-12	原始取得	无
1429	一种 MOS 晶体管的制造方法	ZL201110030538.3	中芯上海	2011-01-28	2016-07-13	原始取得	无
1430	反应腔室的清洗方法	ZL201110032379.0	中芯上海	2011-01-30	2014-09-24	原始取得	无
1431	金属互连的形成方法	ZL201110032380.3	中芯上海	2011-01-30	2014-11-05	原始取得	无
1432	相变存储器的形成方法	ZL201110034987.5	中芯上海	2011-02-09	2014-06-04	原始取得	无
1433	CMOS 器件的制作方法	ZL201110036743.0	中芯上海	2011-02-12	2013-11-06	原始取得	无
1434	金属栅极的形成方法	ZL201110036744.5	中芯上海	2011-02-12	2015-04-29	原始取得	无
1435	一种相变存储单元及其形成方法	ZL201110037012.8	中芯上海	2011-02-12	2014-04-02	原始取得	无
1436	一种半导体器件的制作方法	ZL201110039615.1	中芯上海	2011-02-17	2015-06-24	原始取得	无
1437	一种 MOSFET 制造方法	ZL201110039626.X	中芯上海	2011-02-17	2015-01-07	原始取得	无
1438	一种 SONOS 结构及制造方法	ZL201110039629.3	中芯上海	2011-02-17	2015-01-07	原始取得	无
1439	半导体器件及其制作方法	ZL201110039636.3	中芯上海	2011-02-17	2014-10-22	原始取得	无
1440	NMOS 晶体管的形成方法	ZL201110041936.5	中芯上海	2011-02-21	2015-05-13	原始取得	无
1441	半导体器件的形成方法	ZL201110042830.7	中芯上海	2011-02-22	2014-09-03	原始取得	无
1442	双重图形化的纳米压印模具及其形成方法	ZL201110043976.3	中芯上海	2011-02-23	2014-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1443	晶体管的制造方法	ZL201110043994.1	中芯上海	2011-02-22	2015-09-02	原始取得	无
1444	一种导电插塞的形成方法	ZL201110044681.8	中芯上海	2011-02-22	2014-07-02	原始取得	无
1445	晶体管的制造方法	ZL201110045413.8	中芯上海	2011-02-24	2014-01-08	原始取得	无
1446	双重图形化的纳米压印模具的形成方法	ZL201110045414.2	中芯上海	2011-02-24	2015-03-11	原始取得	无
1447	栅极的形成方法	ZL201110045415.7	中芯上海	2011-02-24	2014-12-24	原始取得	无
1448	晶体管的制造方法	ZL201110045416.1	中芯上海	2011-02-24	2014-09-03	原始取得	无
1449	晶体管的制备方法	ZL201110048839.9	中芯上海	2011-03-01	2014-11-05	原始取得	无
1450	一种芯片保护结构以及形成方法	ZL201110049531.6	中芯上海	2011-03-01	2015-03-11	原始取得	无
1451	SOI 晶体管及其制造方法	ZL201110051900.5	中芯上海	2011-03-04	2014-10-22	原始取得	无
1452	一种竖直二极管阵列的制造方法	ZL201110051916.6	中芯上海	2011-03-04	2014-11-26	原始取得	无
1453	电迁移测试结构	ZL201110051941.4	中芯上海	2011-03-04	2015-05-27	原始取得	无
1454	半导体结构的制作方法	ZL201110053783.6	中芯上海	2011-03-07	2014-02-05	原始取得	无
1455	抛光方法	ZL201110054477.4	中芯上海	2011-03-07	2016-02-17	原始取得	无
1456	一种金属栅极及 MOS 晶体管形成方法	ZL201110054478.9	中芯上海	2011-03-07	2016-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1457	一种互联金属电容测试结构	ZL201110058951.0	中芯上海	2011-03-11	2015-04-01	原始取得	无
1458	形成栅极图案的方法以及半导体装置	ZL201110064415.1	中芯上海	2011-03-17	2014-08-27	原始取得	无
1459	一种 MOS 晶体管的制造方法	ZL201110068717.6	中芯上海	2011-03-22	2015-02-18	原始取得	无
1460	用于制造相变随机存储器的方法	ZL201110068883.6	中芯上海	2011-03-22	2014-07-23	原始取得	无
1461	固结磨料抛光垫及其制备方法	ZL201110068907.8	中芯上海	2011-03-22	2015-04-01	原始取得	无
1462	化学机械抛光的方法	ZL201110068908.2	中芯上海	2011-03-22	2015-04-29	原始取得	无
1463	互连结构的制作方法	ZL201110068919.0	中芯上海	2011-03-22	2014-07-02	原始取得	无
1464	一种相变随机存储器及其制造方法	ZL201110068926.0	中芯上海	2011-03-22	2014-05-14	原始取得	无
1465	闪存单元及其浮栅的形成方法	ZL201110069308.8	中芯上海	2011-03-22	2015-08-05	原始取得	无
1466	一种减小 I/OMOS 器件 HCI 效应的方法	ZL201110069777.X	中芯上海	2011-03-22	2015-01-07	原始取得	无
1467	浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL201110071151.2	中芯上海	2011-03-23	2014-06-11	原始取得	无
1468	化学机械研磨方法	ZL201110072338.4	中芯上海	2011-03-24	2014-11-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1469	用于制造半导体器件的方法	ZL201110075392.4	中芯上海	2011-03-28	2016-08-03	原始取得	无
1470	一种测试光刻胶层对离子注入阻挡能力的方法	ZL201110075911.7	中芯上海	2011-03-28	2014-05-07	原始取得	无
1471	形成锗硅沟道及 PMOS 晶体管的方法	ZL201110076009.7	中芯上海	2011-03-28	2015-10-14	原始取得	无
1472	制作半导体器件的方法	ZL201110081785.6	中芯上海	2011-04-01	2014-06-04	原始取得	无
1473	一种半导体器件的制造方法	ZL201110081813.4	中芯上海	2011-04-01	2014-06-04	原始取得	无
1474	化学机械研磨系统及使用该系统研磨晶片的方法	ZL201110081814.9	中芯上海	2011-04-01	2014-10-01	原始取得	无
1475	用于制造半导体器件的方法	ZL201110081942.3	中芯上海	2011-04-01	2015-09-09	原始取得	无
1476	一种半导体器件的制造方法	ZL201110081968.8	中芯上海	2011-04-01	2015-02-11	原始取得	无
1477	半导体器件的制作方法	ZL201110082046.9	中芯上海	2011-04-01	2015-09-09	原始取得	无
1478	半导体器件负偏置温度不稳定性的测试结构及测试方法	ZL201110084197.8	中芯上海	2011-04-02	2014-11-26	原始取得	无
1479	一种套刻偏差检查标记及其制作方法	ZL201110087489.7	中芯上海	2011-04-08	2016-06-08	原始取得	无
1480	ONO 结构及其制造方法	ZL201110090575.3	中芯上海	2011-04-12	2014-08-13	原始取得	无
1481	热处理设及其温度校准方法	ZL201110092854.3	中芯上海	2011-04-13	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	和装置						
1482	一种测量晶圆旋转参数的方法及系统	ZL201110096637.1	中芯上海	2011-04-18	2015-02-11	原始取得	无
1483	互连结构形成方法	ZL201110097045.1	中芯上海	2011-04-18	2015-03-11	原始取得	无
1484	抛光方法以及栅极的形成方法	ZL201110099722.3	中芯上海	2011-04-20	2015-11-25	原始取得	无
1485	半导体器件及其形成方法、射频识别芯片及其形成方法	ZL201110099727.6	中芯上海	2011-04-20	2014-03-12	原始取得	无
1486	晶体管的制备方法	ZL201110099738.4	中芯上海	2011-04-20	2015-04-01	原始取得	无
1487	抛光方法以及浮栅的形成方法	ZL201110100318.3	中芯上海	2011-04-20	2015-04-29	原始取得	无
1488	集成无源器件及其制作方法	ZL201110103127.2	中芯上海、中芯北京	2010-04-22	2014-12-24	原始取得	无
1489	金属硅化物桥连测试结构、形成方法和测试方法	ZL201110105087.5	中芯上海	2011-04-26	2014-12-03	原始取得	无
1490	半导体检测结构及其形成方法、检测方法	ZL201110107472.3	中芯上海	2011-04-27	2015-04-01	原始取得	无
1491	互连线电迁移的测试装置及方法	ZL201110107492.0	中芯上海	2011-04-27	2015-06-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1492	半导体器件的结构及形成方法	ZL201110107496.9	中芯上海	2011-04-27	2016-03-16	原始取得	无
1493	铜互连线的刻蚀后处理方法	ZL201110107556.7	中芯上海	2011-04-27	2015-01-21	原始取得	无
1494	半导体器件、形成互连结构的方法	ZL201110107566.0	中芯上海	2011-04-27	2014-12-03	原始取得	无
1495	芯片测试结构以及测试方法	ZL201110107571.1	中芯上海	2011-04-27	2014-11-05	原始取得	无
1496	芯片测试结构以及测试方法	ZL201110107586.8	中芯上海	2011-04-27	2015-04-01	原始取得	无
1497	金属栅极的形成方法	ZL201110107591.9	中芯上海	2011-04-27	2015-03-11	原始取得	无
1498	提高反应装置表面清洁能力的方法	ZL201110108361.4	中芯上海	2011-04-28	2014-12-10	原始取得	无
1499	包括空气间隔的半导体器件及其制造方法	ZL201110109621.X	中芯上海	2011-04-28	2014-12-03	原始取得	无
1500	双镶嵌结构及其形成方法、半导体器件	ZL201110109631.3	中芯上海	2011-04-28	2014-12-24	原始取得	无
1501	半导体器件制造方法	ZL201110109821.5	中芯上海	2011-04-29	2015-03-04	原始取得	无
1502	半导体器件的制造方法和晶片	ZL201110109825.3	中芯上海	2011-04-29	2014-04-09	原始取得	无
1503	形成栅极图案的方法以及半	ZL201110109827.2	中芯上海	2011-04-29	2014-10-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	导体装置						
1504	硅通孔的形成方法	ZL201110109844.6	中芯上海	2011-04-28	2014-11-05	原始取得	无
1505	光学邻近修正的方法	ZL201110109857.3	中芯上海	2011-04-28	2014-07-30	原始取得	无
1506	相变半导体器件的制造方法以及相变半导体器件	ZL201110110144.9	中芯上海	2011-04-29	2015-06-03	原始取得	无
1507	化学机械抛光机及其抛光垫部件	ZL201110110156.1	中芯上海	2011-04-29	2015-04-22	原始取得	无
1508	半导体器件	ZL201110110159.5	中芯上海	2011-04-29	2014-12-10	原始取得	无
1509	一种应力记忆技术的 NMOS 器件制作方法	ZL201110112419.2	中芯上海	2011-05-03	2014-12-10	原始取得	无
1510	一种批处理机台派货的方法和装置	ZL201110115247.4	中芯上海	2011-05-05	2015-01-28	原始取得	无
1511	半导体器件和用于制造半导体器件的方法	ZL201110117441.6	中芯上海	2011-05-09	2015-01-21	原始取得	无
1512	半导体器件的制造方法	ZL201110117450.5	中芯上海	2011-05-09	2016-03-30	原始取得	无
1513	一种栅极刻蚀方法	ZL201110120723.1	中芯上海	2011-05-11	2015-07-29	原始取得	无
1514	半导体器件制造方法	ZL201110121644.2	中芯上海	2011-05-12	2015-05-06	原始取得	无
1515	CMOS 晶体管的制作方法	ZL201110126339.2	中芯上海	2011-05-16	2016-02-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1516	降低铜电镀工艺中边缘效应的方法及铜互连结构制造方法	ZL201110126350.9	中芯上海	2011-05-16	2015-04-29	原始取得	无
1517	晶圆控片重复利用的方法	ZL201110126352.8	中芯上海	2011-05-16	2016-07-06	原始取得	无
1518	一种互连结构及其形成方法	ZL201110126356.6	中芯上海	2011-05-16	2015-01-21	原始取得	无
1519	晶体管的制造方法	ZL201110126367.4	中芯上海	2011-05-16	2015-11-25	原始取得	无
1520	一种显影后检查方法	ZL201110126372.5	中芯上海	2011-05-16	2014-09-03	原始取得	无
1521	半导体器件及其制造方法	ZL201110131053.3	中芯上海	2011-05-20	2015-04-22	原始取得	无
1522	半导体器件的制造方法	ZL201110131055.2	中芯上海	2011-05-20	2015-04-22	原始取得	无
1523	半导体装置及其制造方法	ZL201110131061.8	中芯上海	2011-05-20	2016-04-20	原始取得	无
1524	半导体器件及其制造方法	ZL201110131064.1	中芯上海	2011-05-20	2015-03-04	原始取得	无
1525	形成栓塞结构、半导体器件的方法	ZL201110136638.4	中芯上海	2011-05-25	2014-07-30	原始取得	无
1526	抛光方法以及栅极的形成方法	ZL201110136654.3	中芯上海	2011-05-25	2015-07-08	原始取得	无
1527	相变存储单元及其形成方法	ZL201110136665.1	中芯上海	2011-05-25	2014-12-24	原始取得	无
1528	晶体管及其形成方法	ZL201110136678.9	中芯上海	2011-05-25	2015-01-21	原始取得	无
1529	半导体结构及其形成方法	ZL201110136684.4	中芯上海	2011-05-25	2015-04-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1530	晶体管形成方法	ZL201110136713.7	中芯上海	2011-05-25	2016-03-16	原始取得	无
1531	PMOS 管的制作方法	ZL201110138592.X	中芯上海	2011-05-26	2015-01-28	原始取得	无
1532	铝衬垫的晶体缺陷去除方法	ZL201110139378.6	中芯上海	2011-05-26	2015-01-28	原始取得	无
1533	NMOS 晶体管形成方法及对应 CMOS 结构形成方法	ZL201110139434.6	中芯上海	2011-05-26	2015-03-11	原始取得	无
1534	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201110139436.5	中芯上海	2011-05-26	2014-09-03	原始取得	无
1535	晶体管及其形成方法	ZL201110139441.6	中芯上海	2011-05-26	2015-04-29	原始取得	无
1536	介质层的形成方法	ZL201110139456.2	中芯上海	2011-05-26	2015-01-21	原始取得	无
1537	获取离子注入工艺参数的方法、监测晶片及其制造方法	ZL201110139469.X	中芯上海	2011-05-26	2014-09-03	原始取得	无
1538	晶片投片方法与晶片投片装置	ZL201110139479.3	中芯上海	2011-05-26	2014-11-05	原始取得	无
1539	图形化膜层的方法、形成栅极、MOS 晶体管的方法	ZL201110139487.8	中芯上海	2011-05-26	2015-09-02	原始取得	无
1540	金属栅极及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201110139496.7	中芯上海	2011-05-26	2015-07-08	原始取得	无
1541	掩膜版及其光刻方法	ZL201110142385.1	中芯上海	2011-05-30	2014-03-19	原始取得	无
1542	晶体管的形成方法	ZL201110145352.2	中芯上海	2011-05-31	2014-09-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1543	半导体器件及其形成方法	ZL201110145354.1	中芯上海	2011-05-31	2015-04-01	原始取得	无
1544	晶体管的形成方法	ZL201110145405.0	中芯上海	2011-05-31	2015-03-11	原始取得	无
1545	相变存储器的制造方法	ZL201110145417.3	中芯上海	2011-05-31	2014-09-24	原始取得	无
1546	抛光装置及抛光副产物的去除方法	ZL201110145429.6	中芯上海	2011-05-31	2015-11-25	原始取得	无
1547	半导体器件及其制造方法	ZL201110146824.6	中芯上海	2011-06-02	2015-12-02	原始取得	无
1548	一种降低干刻蚀腔体喷嘴内壁的粗糙度的方法	ZL201110149252.7	中芯上海	2011-06-03	2014-11-19	原始取得	无
1549	半导体器件的制作方法	ZL201110152388.3	中芯上海	2011-06-08	2015-09-09	原始取得	无
1550	半导体器件的制造方法	ZL201110152390.0	中芯上海	2011-06-08	2015-04-01	原始取得	无
1551	晶片的减薄方法	ZL201110152394.9	中芯上海	2011-06-08	2015-04-01	原始取得	无
1552	一种半导体器件的栅介质层陷阱密度和位置的测试方法	ZL201110153759.X	中芯上海、北京大学	2011-06-09	2014-02-19	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1553	用于形成硅通孔的方法	ZL201110157222.0	中芯上海	2011-06-13	2014-10-01	原始取得	无
1554	测试结构及测试方法	ZL201110161459.6	中芯上海	2011-06-15	2015-03-11	原始取得	无
1555	金属互连结构及其形成方法	ZL201110161470.2	中芯上海	2011-06-15	2015-11-25	原始取得	无
1556	一种半导体器件的制造方法	ZL201110163473.X	中芯上海	2011-06-17	2015-07-08	原始取得	无
1557	一种半导体器件的制造方法	ZL201110163475.9	中芯上海	2011-06-17	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1558	铜化学机械研磨终点检测装置及方法	ZL201110172589.X	中芯上海	2011-06-24	2014-12-03	原始取得	无
1559	半导体器件及其制造方法	ZL201110174754.5	中芯上海	2011-06-27	2015-08-12	原始取得	无
1560	金属栅极和 MOS 晶体管的形成方法	ZL201110180746.1	中芯上海	2011-06-29	2016-04-20	原始取得	无
1561	形成底部电极和相变电阻的方法	ZL201110180750.8	中芯上海	2011-06-29	2015-01-21	原始取得	无
1562	半导体结构及其形成方法,PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201110180763.5	中芯上海	2011-06-29	2016-12-14	原始取得	无
1563	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201110180765.4	中芯上海	2011-06-29	2015-04-29	原始取得	无
1564	半导体器件的形成方法	ZL201110180767.3	中芯上海	2011-06-29	2015-09-02	原始取得	无
1565	晶体管及其形成方法	ZL201110180768.8	中芯上海	2011-06-29	2016-04-20	原始取得	无
1566	石墨烯导电插塞及其形成方法	ZL201110180781.3	中芯上海	2011-06-29	2015-03-11	原始取得	无
1567	一种硅通孔封装方法	ZL201110180886.9	中芯上海	2011-06-30	2015-02-11	原始取得	无
1568	一种背面硅通孔制作方法	ZL201110180998.4	中芯上海	2011-06-30	2015-07-08	原始取得	无
1569	条形结构的刻蚀方法	ZL201110182359.1	中芯上海	2011-06-30	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1570	半导体器件的形成方法	ZL201110183230.2	中芯上海	2011-07-01	2015-11-25	原始取得	无
1571	半导体器件的形成方法	ZL201110183339.6	中芯上海	2011-07-01	2014-06-04	原始取得	无
1572	光刻方法	ZL201110187759.1	中芯上海	2011-07-06	2016-08-31	原始取得	无
1573	MOS 晶体管的形成方法	ZL201110188555.X	中芯上海	2011-07-06	2014-11-05	原始取得	无
1574	负偏压温度不稳定性测试附加电路及测试方法	ZL201110188627.0	中芯上海	2011-07-07	2015-09-16	原始取得	无
1575	超低介电常数层的制作方法	ZL201110193916.X	中芯上海	2011-07-12	2016-01-20	原始取得	无
1576	一种半导体器件的制作方法	ZL201110195504.X	中芯上海	2011-07-13	2014-12-17	原始取得	无
1577	一种半导体器件的制作方法	ZL201110195551.4	中芯上海	2011-07-13	2014-12-17	原始取得	无
1578	铜互连结构的制作方法	ZL201110198053.5	中芯上海	2011-07-15	2015-04-01	原始取得	无
1579	混合物配置容器、配置系统及配置方法	ZL201110198662.0	中芯上海	2011-07-15	2014-08-27	原始取得	无
1580	防止机械手臂凝结水滴的装置和方法	ZL201110198692.1	中芯上海	2011-07-15	2015-04-29	原始取得	无
1581	一种半导体器件的制作方法	ZL201110200698.8	中芯上海	2011-07-18	2015-05-20	原始取得	无
1582	半导体器件的形成方法	ZL201110201276.2	中芯上海	2011-07-18	2015-03-11	原始取得	无
1583	半导体器件形成方法	ZL201110201277.7	中芯上海	2011-07-18	2015-04-01	原始取得	无
1584	半导体集成器件及其制造方	ZL201110201310.6	中芯上海	2011-07-18	2014-09-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
1585	介质层的形成方法	ZL201110201313.X	中芯上海	2011-07-18	2015-10-14	原始取得	无
1586	一种非图案化表面缺陷的离线检测方法	ZL201110202592.1	中芯上海	2011-07-19	2014-10-01	原始取得	无
1587	去除光感显影底部抗反射层缺陷的方法	ZL201110202687.3	中芯上海	2011-07-19	2014-07-16	原始取得	无
1588	光刻散焦的检测方法,检测系统及光刻工艺的优化方法	ZL201110202734.4	中芯上海	2011-07-19	2016-05-11	原始取得	无
1589	LDMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201110202772.X	中芯上海	2011-07-19	2015-04-01	原始取得	无
1590	MOS 晶体管的结构及其形成方法	ZL201110207726.9	中芯上海	2011-07-22	2016-03-16	原始取得	无
1591	浅槽隔离结构及其形成方法	ZL201110207818.7	中芯上海	2011-07-22	2015-04-29	原始取得	无
1592	双金属栅极晶体管的制造方法	ZL201110207853.9	中芯上海	2011-07-22	2015-01-21	原始取得	无
1593	一种半导体器件的制作方法	ZL201110208142.3	中芯上海	2011-07-25	2015-04-01	原始取得	无
1594	一种横向双扩散金属氧化物半导体及其制造方法	ZL201110208155.0	中芯上海	2011-07-25	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1595	半导体器件的制作方法	ZL201110208194.0	中芯上海	2011-07-25	2015-04-01	原始取得	无
1596	MOS 晶体管的制造方法	ZL201110209589.2	中芯上海	2011-07-25	2015-05-06	原始取得	无
1597	MOS 晶体管的制造方法	ZL201110209736.6	中芯上海	2011-07-25	2015-05-06	原始取得	无
1598	半导体器件的形成方法	ZL201110211064.2	中芯上海	2011-07-26	2016-05-25	原始取得	无
1599	介质层的形成方法	ZL201110211072.7	中芯上海	2011-07-26	2015-11-25	原始取得	无
1600	一种化学机械研磨方法	ZL201110211074.6	中芯上海	2011-07-26	2015-04-29	原始取得	无
1601	用于制造半导体器件的方法	ZL201110212815.2	中芯上海	2011-07-28	2015-05-20	原始取得	无
1602	化学机械研磨方法	ZL201110218623.2	中芯上海	2011-08-01	2015-04-01	原始取得	无
1603	用于甲硅烷化的预处理方法及包括该方法的甲硅烷化方法	ZL201110219819.3	中芯上海	2011-08-03	2016-02-17	原始取得	无
1604	在半导体器件上同时制作通孔和沟槽的方法	ZL201110220660.7	中芯上海	2011-08-03	2014-12-10	原始取得	无
1605	一种半导体器件的制造方法	ZL201110222274.1	中芯上海	2011-08-04	2016-06-08	原始取得	无
1606	一种半导体器件的制作方法	ZL201110222354.7	中芯上海	2011-08-04	2014-11-05	原始取得	无
1607	一种半导体器件的制造方法	ZL201110224017.1	中芯上海	2011-08-05	2015-01-14	原始取得	无
1608	化学机械抛光设备、化学机械抛光终点检测装置和方法	ZL201110224786.1	中芯上海	2011-08-05	2016-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1609	无定形碳膜的处理方法,开口的形成方法	ZL201110224905.3	中芯上海	2011-08-05	2015-04-29	原始取得	无
1610	一种检测结构及形成方法和检测方法	ZL201110226193.9	中芯上海	2011-08-08	2015-12-09	原始取得	无
1611	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201110226194.3	中芯上海	2011-08-08	2015-09-02	原始取得	无
1612	半导体结构的形成方法,PMOS 晶体管的形成方法	ZL201110226347.4	中芯上海	2011-08-08	2015-06-03	原始取得	无
1613	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201110226348.9	中芯上海	2011-08-08	2016-03-16	原始取得	无
1614	一种制作鳍式场效应管的翅片结构方法	ZL201110226535.7	中芯上海	2011-08-09	2015-01-28	原始取得	无
1615	接垫结构的形成方法	ZL201110227636.6	中芯上海	2011-08-09	2015-12-09	原始取得	无
1616	一种半导体器件的制作方法	ZL201110227901.0	中芯上海	2011-08-10	2016-05-11	原始取得	无
1617	一种半导体器件的制造方法	ZL201110228420.1	中芯上海	2011-08-10	2015-07-08	原始取得	无
1618	金属栅极的形成方法	ZL201110231129.X	中芯上海	2011-08-12	2015-04-29	原始取得	无
1619	研磨装置及研磨方法	ZL201110231130.2	中芯上海	2011-08-12	2015-04-29	原始取得	无
1620	一种存储器件及其的形成方法	ZL201110231646.7	中芯上海	2011-08-12	2016-02-17	原始取得	无
1621	金属栅极的形成方法	ZL201110231650.3	中芯上海	2011-08-12	2015-09-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1622	电容式麦克风的薄膜结构及其的形成方法	ZL201110231666.4	中芯上海	2011-08-12	2015-09-02	原始取得	无
1623	金属栅堆叠结构的制作方法	ZL201110231878.2	中芯上海	2011-08-12	2015-06-24	原始取得	无
1624	MOS 晶体管及其制造方法	ZL201110231903.7	中芯上海	2011-08-12	2016-02-17	原始取得	无
1625	研磨液、过抛和终点检测方法及装置、抛光设备	ZL201110233369.3	中芯上海	2011-08-15	2016-05-25	原始取得	无
1626	磁隧道结、其制作方法及含磁隧道结的存储单元	ZL201110233379.7	中芯上海	2011-08-15	2017-05-17	原始取得	无
1627	一种场效应晶体管及形成方法	ZL201110233388.6	中芯上海	2011-08-15	2015-04-01	原始取得	无
1628	MOSFET 及其形成方法	ZL201110233492.5	中芯上海	2011-08-15	2015-12-16	原始取得	无
1629	半导体结构及其形成方法,PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201110233495.9	中芯上海	2011-08-15	2015-06-03	原始取得	无
1630	具有金属栅极的半导体器件上的制造电容器方法及电容器	ZL201110235623.3	中芯上海	2011-08-17	2015-05-13	原始取得	无
1631	铜互连结构及其制造方法	ZL201110236698.3	中芯上海	2011-08-17	2015-10-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1632	在制作金属栅极过程中制作金属塞的方法	ZL201110238003.5	中芯上海	2011-08-18	2015-02-18	原始取得	无
1633	一种半导体器件的制作方法	ZL201110239224.4	中芯上海	2011-08-19	2015-06-17	原始取得	无
1634	一种形成铜互连的方法	ZL201110239237.1	中芯上海	2011-08-19	2015-11-25	原始取得	无
1635	一种半导体器件的制造方法	ZL201110239272.3	中芯上海	2011-08-19	2016-03-30	原始取得	无
1636	一种半导体器件的制作方法	ZL201110239275.7	中芯上海	2011-08-19	2016-03-16	原始取得	无
1637	一种半导体器件的制作方法	ZL201110239276.1	中芯上海	2011-08-19	2015-05-20	原始取得	无
1638	一种半导体器件的制作方法	ZL201110239277.6	中芯上海	2011-08-19	2015-12-09	原始取得	无
1639	一种半导体器件的制作方法	ZL201110239278.0	中芯上海	2011-08-19	2016-01-06	原始取得	无
1640	相变存储器的制造方法	ZL201110240342.7	中芯上海	2011-08-19	2014-12-24	原始取得	无
1641	相变存储器的制造方法	ZL201110240343.1	中芯上海	2011-08-19	2016-06-29	原始取得	无
1642	内嵌式存储器件的形成方法	ZL201110240514.0	中芯上海	2011-08-19	2014-11-05	原始取得	无
1643	存储器件的形成方法	ZL201110241105.2	中芯上海	2011-08-22	2015-04-29	原始取得	无
1644	一种半导体器件的制作方法	ZL201110241146.1	中芯上海	2011-08-22	2016-03-30	原始取得	无
1645	半导体器件结构及其制作方法	ZL201110242148.2	中芯上海	2011-08-23	2015-12-02	原始取得	无
1646	半导体器件结构及其制作方法	ZL201110242226.9	中芯上海	2011-08-23	2015-05-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1647	半导体器件结构及其制作方法	ZL201110242227.3	中芯上海	2011-08-23	2015-11-25	原始取得	无
1648	半导体器件及其制作方法	ZL201110242434.9	中芯上海	2011-08-23	2015-11-25	原始取得	无
1649	半导体器件的制作方法	ZL201110242462.0	中芯上海	2011-08-23	2016-06-01	原始取得	无
1650	金属互连线的制造方法	ZL201110247538.9	中芯上海	2011-08-25	2015-06-17	原始取得	无
1651	金属互连线的制造方法	ZL201110247539.3	中芯上海	2011-08-25	2015-11-25	原始取得	无
1652	嵌入逻辑电路的分离栅极式存储器及存储器组的制作方法	ZL201110247582.X	中芯上海	2011-08-24	2014-09-03	原始取得	无
1653	半导体结构及其制作方法,MOS 晶体管及其制作方法	ZL201110247740.1	中芯上海	2011-08-24	2015-03-11	原始取得	无
1654	嵌入逻辑电路的分离栅极式存储器组的制作方法	ZL201110247766.6	中芯上海	2011-08-24	2014-07-30	原始取得	无
1655	准 SOI 结构的制造方法	ZL201110247770.2	中芯上海	2011-08-24	2014-09-03	原始取得	无
1656	一种浅槽隔离结构及制作方法	ZL201110249443.0	中芯上海	2011-08-26	2015-02-18	原始取得	无
1657	一种制作金属栅极的方法	ZL201110251239.2	中芯上海	2011-08-29	2015-01-28	原始取得	无
1658	一种相变存储器形成方法	ZL201110252215.9	中芯上海	2011-08-30	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1659	鳍式场效应晶体管的制造方法、鳍式场效应晶体管	ZL201110252227.1	中芯上海	2011-08-30	2015-06-03	原始取得	无
1660	化学机械研磨装置及化学机械研磨方法	ZL201110252696.3	中芯上海	2011-08-30	2015-08-05	原始取得	无
1661	嵌入逻辑电路的分离栅极式快闪存储器及其制作方法	ZL201110252701.0	中芯上海	2011-08-30	2014-07-30	原始取得	无
1662	鳍式场效应管的结构及形成方法	ZL201110252702.5	中芯上海	2011-08-30	2015-04-01	原始取得	无
1663	相变存储器的形成方法	ZL201110252705.9	中芯上海	2011-08-30	2016-01-06	原始取得	无
1664	晶体管及其形成方法	ZL201110252731.1	中芯上海	2011-08-30	2015-04-29	原始取得	无
1665	栅极的形成方法	ZL201110252734.5	中芯上海	2011-08-30	2015-03-11	原始取得	无
1666	形成栅极的方法、平坦化层间介质层的方法	ZL201110255736.X	中芯上海	2011-08-31	2016-05-25	原始取得	无
1667	具有 T 型鳍部的鳍式场效应管及其形成方法	ZL201110255737.4	中芯上海	2011-08-31	2015-04-01	原始取得	无
1668	一种半导体结构及其形成方法,一种晶体管及其形成方法	ZL201110255740.6	中芯上海	2011-08-31	2015-06-03	原始取得	无
1669	一种鳍型场效应晶体管的制	ZL201110256123.8	中芯上海	2011-09-01	2015-06-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	作方法						
1670	一种金属栅的制作方法	ZL201110256164.7	中芯上海	2011-09-01	2015-11-25	原始取得	无
1671	制作金属栅极的金属塞方法	ZL201110260915.2	中芯上海	2011-09-05	2015-02-18	原始取得	无
1672	应用应力临近技术的半导体器件的制造方法	ZL201110264364.7	中芯上海	2011-09-07	2015-12-09	原始取得	无
1673	CMOS 晶体管的制造方法	ZL201110264366.6	中芯上海	2011-09-07	2015-10-21	原始取得	无
1674	MOS 表面栅极侧壁层的刻蚀方法	ZL201110268002.5	中芯上海	2011-09-09	2015-12-16	原始取得	无
1675	NMOS 晶体管的制造方法	ZL201110270175.0	中芯上海	2011-09-13	2015-04-01	原始取得	无
1676	PMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201110270181.6	中芯上海	2011-09-13	2015-06-17	原始取得	无
1677	鳍型场效应晶体管及其制造方法	ZL201110270300.8	中芯上海	2011-09-13	2016-03-23	原始取得	无
1678	PMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201110270324.3	中芯上海	2011-09-13	2015-12-02	原始取得	无
1679	一种锗硅硼外延层生长方法	ZL201110271930.7	中芯上海	2011-09-14	2015-12-16	原始取得	无
1680	多栅器件的形成方法	ZL201110276274.X	中芯上海	2011-09-16	2015-10-14	原始取得	无
1681	铜互连线的形成方法	ZL201110276285.8	中芯上海	2011-09-16	2016-01-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1682	多栅器件的形成方法	ZL201110276311.7	中芯上海	2011-09-16	2015-03-11	原始取得	无
1683	NMOS 晶体管形成方法	ZL201110276316.X	中芯上海	2011-09-16	2015-07-08	原始取得	无
1684	鳍式场效应管的结构及形成方法	ZL201110276568.2	中芯上海	2011-09-16	2015-03-11	原始取得	无
1685	具有硅化镍接触区的半导体结构及形成方法	ZL201110276571.4	中芯上海	2011-09-16	2015-12-16	原始取得	无
1686	NOR 快闪存储器及其形成方法和接触孔的形成方法	ZL201110276574.8	中芯上海	2011-09-16	2015-08-05	原始取得	无
1687	半导体器件及其制作方法	ZL201110278672.5	中芯上海	2011-09-19	2015-07-08	原始取得	无
1688	一种采用应力记忆技术的 NMOS 器件制作方法	ZL201110280442.2	中芯上海	2011-09-20	2015-09-09	原始取得	无
1689	一种多栅极场效应晶体管的制作方法	ZL201110280744.X	中芯上海	2011-09-21	2016-01-06	原始取得	无
1690	一种金属互连层刻蚀方法	ZL201110284500.9	中芯上海	2011-09-20	2016-04-13	原始取得	无
1691	一种半导体器件的检测样本制作方法及检测样本	ZL201110287490.4	中芯上海	2011-09-23	2015-06-17	原始取得	无
1692	半导体器件及其制造方法	ZL201110294600.X	中芯上海	2011-09-29	2015-03-11	原始取得	无
1693	半导体器件的制造方法	ZL201110294756.8	中芯上海	2011-09-29	2015-07-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1694	镍硅化物形成方法及晶体管形成方法	ZL201110294758.7	中芯上海	2011-09-29	2016-01-06	原始取得	无
1695	无定形碳膜的形成方法	ZL201110296097.1	中芯上海	2011-09-30	2016-10-05	原始取得	无
1696	压控振荡器	ZL201110296125.X	中芯上海	2011-09-30	2015-10-14	原始取得	无
1697	晶圆后段制程控制方法	ZL201110296321.7	中芯上海	2011-09-30	2015-05-06	原始取得	无
1698	无定形碳层的处理与形成方法,半导体器件的制作方法	ZL201110296697.8	中芯上海	2011-09-27	2015-11-25	原始取得	无
1699	无定形碳处理方法及采用无定形碳作为硬掩膜的刻蚀方法	ZL201110296996.1	中芯上海	2011-09-27	2015-04-29	原始取得	无
1700	鳍式场效应管的结构及其形成方法	ZL201110297064.9	中芯上海	2011-09-27	2015-09-02	原始取得	无
1701	闪存存储器及其制作方法,不同厚度栅极的形成方法	ZL201110297121.3	中芯上海	2011-09-27	2014-09-24	原始取得	无
1702	相变存储器及其形成方法	ZL201110297157.1	中芯上海	2011-09-27	2015-10-14	原始取得	无
1703	半导体结构及其制作方法	ZL201110297225.4	中芯上海	2011-09-27	2015-06-03	原始取得	无
1704	分离栅闪存的有源区制造方法	ZL201110297802.X	中芯上海	2011-09-27	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1705	一种晶体管形成方法	ZL201110298001.5	中芯上海	2011-09-30	2016-03-16	原始取得	无
1706	半导体器件的制造方法	ZL201110298139.5	中芯上海	2011-09-30	2015-03-18	原始取得	无
1707	半导体器件的制造方法	ZL201110298165.8	中芯上海	2011-09-29	2015-03-11	原始取得	无
1708	用于铜互连的钛掺杂钽基阻挡层及其制造方法	ZL201110298197.8	中芯上海	2011-09-28	2015-12-16	原始取得	无
1709	缺陷检测方法	ZL201110298244.9	中芯上海	2011-09-27	2015-01-21	原始取得	无
1710	鳍式场效应管,CMOS 鳍式场效应管的形成方法	ZL201110298299.X	中芯上海	2011-09-27	2015-07-08	原始取得	无
1711	硅化镍层形成方法及半导体器件形成方法	ZL201110298403.5	中芯上海	2011-09-27	2015-04-29	原始取得	无
1712	平面电感器及其制造方法、半导体器件及其制造方法	ZL201110298426.6	中芯上海	2011-09-27	2015-04-29	原始取得	无
1713	栅极的制作方法、晶体管的制作方法	ZL201110298427.0	中芯上海	2011-12-01	2016-04-20	原始取得	无
1714	一种半导体结构形成方法	ZL201110298518.4	中芯上海	2011-09-29	2015-11-25	原始取得	无
1715	GDS 文件的扩展方法	ZL201110298649.2	中芯上海	2011-09-30	2015-08-05	原始取得	无
1716	接触通孔刻蚀方法	ZL201110299840.9	中芯上海	2011-10-08	2015-08-19	原始取得	无
1717	经时击穿矩阵测试电路及测	ZL201110300448.1	中芯上海	2011-10-08	2015-07-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	试方法						
1718	半导体器件的制造方法	ZL201110301067.5	中芯上海	2011-09-28	2015-03-18	原始取得	无
1719	多栅极场效应晶体管的制造方法	ZL201110301132.4	中芯上海	2011-09-28	2015-12-16	原始取得	无
1720	半导体器件的制造方法	ZL201110315285.4	中芯上海	2011-10-17	2015-04-29	原始取得	无
1721	原子层级的等离子体刻蚀方法	ZL201110315395.0	中芯上海	2011-10-17	2015-07-08	原始取得	无
1722	硅通孔的刻蚀方法	ZL201110315405.0	中芯上海	2011-10-17	2015-09-02	原始取得	无
1723	一种光刻方法	ZL201110316103.5	中芯上海	2011-10-18	2016-04-13	原始取得	无
1724	鳍式晶体管及其形成方法	ZL201110318996.7	中芯上海	2011-10-19	2015-08-05	原始取得	无
1725	CMOS 晶体管及制作方法、NMOS 晶体管及制作方法	ZL201110318999.0	中芯上海	2011-10-19	2015-07-08	原始取得	无
1726	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201110319011.2	中芯上海	2011-10-19	2016-03-16	原始取得	无
1727	立体结构的磁隧道结的形成方法及形成设备	ZL201110319026.9	中芯上海	2011-10-19	2014-11-05	原始取得	无
1728	立体结构的磁隧道结的形成方法及形成设备	ZL201110319029.2	中芯上海	2011-10-19	2015-12-16	原始取得	无
1729	化学气相沉积装置、化学气相	ZL201110319031.X	中芯上海	2011-10-19	2014-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	沉积方法						
1730	CMOS 晶体管及制作方法、PMOS 晶体管及制作方法	ZL201110319092.6	中芯上海	2011-10-19	2015-03-11	原始取得	无
1731	晶圆承载设备及晶圆承载的方法	ZL201110319207.1	中芯上海	2011-10-19	2015-08-05	原始取得	无
1732	晶圆承载设备及晶圆承载的方法	ZL201110319210.3	中芯上海	2011-10-19	2015-11-25	原始取得	无
1733	半导体器件失配特性的检测结构及检测方法	ZL201110319213.7	中芯上海	2011-10-19	2015-11-25	原始取得	无
1734	晶体管的制造方法	ZL201110319253.1	中芯上海	2011-10-19	2015-09-02	原始取得	无
1735	对准标记保护层的制作方法	ZL201110319258.4	中芯上海	2011-10-19	2015-04-01	原始取得	无
1736	清洗硅片的装置及使用该装置清洗硅片的方法	ZL201110319308.9	中芯上海	2011-10-19	2015-01-21	原始取得	无
1737	一种半导体器件的制造方法	ZL201110320507.1	中芯上海	2011-10-20	2016-03-16	原始取得	无
1738	一种制作半导体器件的方法	ZL201110320509.0	中芯上海	2011-10-20	2015-07-08	原始取得	无
1739	存储器的制造方法	ZL201110327924.9	中芯上海	2011-10-25	2015-02-11	原始取得	无
1740	连接孔形成方法	ZL201110332269.6	中芯上海	2011-10-27	2015-06-17	原始取得	无
1741	LDNMOS 结构及其制造方法	ZL201110332290.6	中芯上海	2011-10-27	2015-08-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1742	名称应为 8-bit 半导体存储单元、制作方法及其存储单元阵列	ZL201110332297.8	中芯上海	2011-10-27	2015-11-25	原始取得	无
1743	名称应为一种半导体器件的制造方法	ZL201110332816.0	中芯上海	2011-10-28	2015-04-01	原始取得	无
1744	半导体器件的制作方法	ZL201110333222.1	中芯上海	2011-10-28	2015-05-20	原始取得	无
1745	制作半导体器件的方法	ZL201110333935.8	中芯上海	2011-10-28	2015-02-11	原始取得	无
1746	用于形成自对准通孔的 T 形金属硬掩膜	ZL201110334644.0	中芯上海	2011-10-31	2015-05-20	原始取得	无
1747	半导体器件的制作方法	ZL201110335299.2	中芯上海	2011-10-29	2015-12-02	原始取得	无
1748	半导体器件的制作方法	ZL201110335709.3	中芯上海	2011-10-29	2015-07-29	原始取得	无
1749	制作半导体器件的方法	ZL201110335884.2	中芯上海	2011-10-31	2015-04-01	原始取得	无
1750	制作半导体器件的方法	ZL201110335897.X	中芯上海	2011-10-31	2016-02-03	原始取得	无
1751	一种铜互连结构的制作方法	ZL201110336844.X	中芯上海	2011-10-31	2015-04-01	原始取得	无
1752	一种静电放电保护电路	ZL201110337536.9	中芯上海	2011-11-01	2016-04-06	原始取得	无
1753	一种化学机械研磨设备	ZL201110337538.8	中芯上海	2011-11-01	2015-09-09	原始取得	无
1754	鳍式晶体管的鳍部的形成方法	ZL201110338440.4	中芯上海	2011-10-31	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1755	半导体结构及其形成方法	ZL201110338442.3	中芯上海	2011-10-31	2015-04-01	原始取得	无
1756	晶体管的制造方法	ZL201110338445.7	中芯上海	2011-10-31	2015-04-01	原始取得	无
1757	名称应为 NMOS 形成方法、CMOS 形成方法	ZL201110338452.7	中芯上海	2011-10-31	2015-12-16	原始取得	无
1758	去除氮化硅侧墙、形成晶体管、半导体器件的方法	ZL201110338455.0	中芯上海	2011-10-31	2016-01-06	原始取得	无
1759	去除氮化硅侧墙、形成晶体管、半导体器件的方法	ZL201110338466.9	中芯上海	2011-10-31	2015-09-02	原始取得	无
1760	硅通孔的形成方法	ZL201110338467.3	中芯上海	2011-10-31	2015-01-21	原始取得	无
1761	EEPROM 存储器的制作方法	ZL201110338861.7	中芯上海	2011-10-31	2016-03-16	原始取得	无
1762	CMOS 形成方法	ZL201110338864.0	中芯上海	2011-10-31	2016-03-16	原始取得	无
1763	CMOS 形成方法	ZL201110338882.9	中芯上海	2011-10-31	2016-05-25	原始取得	无
1764	晶体管的制造方法	ZL201110338884.8	中芯上海	2011-10-31	2016-04-20	原始取得	无
1765	硅通孔测试结构及测试方法	ZL201110338896.0	中芯上海	2011-10-31	2015-04-29	原始取得	无
1766	硅通孔的形成方法	ZL201110338908.X	中芯上海	2011-10-31	2015-11-25	原始取得	无
1767	互连层中空气间隙的形成方法	ZL201110340398.X	中芯上海	2011-11-01	2015-04-29	原始取得	无
1768	半导体器件的形成方法	ZL201110340412.6	中芯上海	2011-11-01	2015-04-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1769	降低层间介质层介电常数的方法	ZL201110340496.3	中芯上海	2011-11-01	2015-04-15	原始取得	无
1770	晶体管及其形成方法	ZL201110340617.4	中芯上海	2011-11-01	2015-12-16	原始取得	无
1771	半导体器件的形成方法	ZL201110340619.3	中芯上海	2011-11-01	2015-01-21	原始取得	无
1772	一种铜互连结构的制造方法	ZL201110340740.6	中芯上海	2011-11-02	2016-04-06	原始取得	无
1773	一种隧穿场效应晶体管及其制备方法	ZL201110341425.5	中芯上海、北京大学	2011-11-02	2013-11-06	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1774	半导体器件的刻蚀方法	ZL201110341447.1	中芯上海	2011-11-02	2016-03-30	原始取得	无
1775	互连结构及其制造方法	ZL201110342110.2	中芯上海	2011-11-02	2016-02-03	原始取得	无
1776	CMOS 器件金属栅极的制造方法	ZL201110342116.X	中芯上海	2011-11-02	2015-03-18	原始取得	无
1777	互连结构制造方法	ZL201110342188.4	中芯上海	2011-11-02	2015-11-25	原始取得	无
1778	金属互连结构的制造方法	ZL201110342198.8	中芯上海	2011-11-02	2015-02-18	原始取得	无
1779	半导体器件的制造方法	ZL201110342207.3	中芯上海	2011-11-02	2016-06-01	原始取得	无
1780	一种半导体器件的制造方法	ZL201110344420.8	中芯上海	2011-11-04	2015-12-09	原始取得	无
1781	制作半导体器件的方法	ZL201110344432.0	中芯上海	2011-11-04	2015-07-08	原始取得	无
1782	一种半导体器件的制造方法	ZL201110351732.1	中芯上海	2011-11-09	2015-07-08	原始取得	无
1783	一种刻蚀控制方法	ZL201110352088.X	中芯上海	2011-11-09	2015-08-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1784	一种多栅极场效应晶体管器件的制造方法	ZL201110356209.8	中芯上海	2011-11-11	2015-11-25	原始取得	无
1785	半导体测试结构及其形成方法,测试方法	ZL201110357890.8	中芯上海	2011-11-11	2015-04-01	原始取得	无
1786	金属研磨保护装置及保护方法、化学机械研磨系统	ZL201110357956.3	中芯上海	2011-11-11	2015-11-25	原始取得	无
1787	金属栅极的形成方法	ZL201110357957.8	中芯上海	2011-11-11	2016-08-10	原始取得	无
1788	一种金属栅极的形成方法	ZL201110357958.2	中芯上海	2011-11-11	2015-09-02	原始取得	无
1789	化学机械研磨装置及系统	ZL201110357979.4	中芯上海	2011-11-11	2015-09-02	原始取得	无
1790	化学机械研磨装置及使用该装置对硅片进行研磨的方法	ZL201110358288.6	中芯上海	2011-11-11	2015-11-25	原始取得	无
1791	金属栅极的形成方法	ZL201110358290.3	中芯上海	2011-11-11	2015-12-09	原始取得	无
1792	半导体器件及其形成方法	ZL201110358301.8	中芯上海	2011-11-11	2015-01-21	原始取得	无
1793	布局图形校正方法	ZL201110358302.2	中芯上海	2011-11-11	2015-04-01	原始取得	无
1794	分离栅极式快闪存储器及存储器组的制作方法	ZL201110358304.1	中芯上海	2011-11-11	2015-04-29	原始取得	无
1795	带外围电路的分离栅极式快闪存储器的制作方法	ZL201110358305.6	中芯上海	2011-11-11	2014-09-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1796	具有周围栅极结构的鳍型场效应晶体管及其制造方法	ZL201110358467.X	中芯上海	2011-11-11	2016-06-01	原始取得	无
1797	一种曝光方法	ZL201110358787.5	中芯上海	2011-11-14	2015-12-16	原始取得	无
1798	制造半导体器件的方法	ZL201110359964.1	中芯上海	2011-11-14	2016-04-06	原始取得	无
1799	IC 内连线和层间介质层之间的空气间隔形成方法	ZL201110362161.1	中芯上海	2011-11-16	2015-04-01	原始取得	无
1800	金属栅极形成方法	ZL201110363056.X	中芯上海	2011-11-16	2015-10-07	原始取得	无
1801	金属互连结构的制作方法	ZL201110366071.X	中芯上海	2011-11-17	2015-09-02	原始取得	无
1802	PECVD 装置和半导体器件的形成方法	ZL201110366072.4	中芯上海	2011-11-17	2016-06-29	原始取得	无
1803	导电插塞及形成方法	ZL201110366073.9	中芯上海	2011-11-17	2015-08-05	原始取得	无
1804	半导体器件形成方法	ZL201110366094.0	中芯上海	2011-11-17	2015-04-01	原始取得	无
1805	具有金属栅极叠层的半导体器件的制作方法	ZL201110366101.7	中芯上海	2011-11-17	2016-03-16	原始取得	无
1806	金属栅电极层的形成方法	ZL201110366102.1	中芯上海	2011-11-17	2015-11-25	原始取得	无
1807	避免浅沟槽隔离结构产生缺角的半导体器件的制作方法	ZL201110366104.0	中芯上海	2011-11-17	2015-08-05	原始取得	无
1808	一种磁性隧道结器件的制造	ZL201110371148.2	中芯上海	2011-11-21	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
1809	FinFET 器件制造方法	ZL201110372142.7	中芯上海	2011-11-21	2015-09-02	原始取得	无
1810	光刻胶移除方法	ZL201110374569.0	中芯上海	2011-11-21	2016-03-23	原始取得	无
1811	一种半导体器件的制造方法	ZL201110376940.7	中芯上海	2011-11-23	2015-12-02	原始取得	无
1812	金属氧化物半导体管及其制作方法	ZL201110377708.5	中芯上海	1900-01-04	2015-07-08	原始取得	无
1813	半导体集成器件及其形成方法	ZL201110382840.5	中芯上海	2011-11-25	2016-08-31	原始取得	无
1814	锗硅薄膜的形成方法及形成装置	ZL201110382848.1	中芯上海	2011-11-25	2015-08-05	原始取得	无
1815	一种微加热装置及形成方法	ZL201110382857.0	中芯上海	2011-11-25	2015-07-08	原始取得	无
1816	控制替代栅极结构高度的方法	ZL201110382859.X	中芯上海	2011-11-25	2015-10-14	原始取得	无
1817	MOS 器件的形成方法及其形成的 MOS 器件	ZL201110382871.0	中芯上海	2011-11-25	2015-07-08	原始取得	无
1818	气相外延装置	ZL201110382874.4	中芯上海	2011-11-25	2015-11-25	原始取得	无
1819	锁相环	ZL201110382875.9	中芯上海	2011-11-25	2016-01-06	原始取得	无
1820	自对准金属硅化物的形成方	ZL201110383149.9	中芯上海	2011-11-25	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
1821	半导体器件及其形成方法	ZL201110383462.2	中芯上海	2011-11-25	2015-08-05	原始取得	无
1822	无定形碳硬掩膜层的形成方法及刻蚀方法	ZL201110383465.6	中芯上海	2011-11-25	2015-11-25	原始取得	无
1823	介电抗反射涂层的形成方法及光刻方法	ZL201110383472.6	中芯上海	2011-11-25	2016-08-03	原始取得	无
1824	晶体管的制作方法	ZL201110383473.0	中芯上海	2011-11-25	2015-10-14	原始取得	无
1825	硅通孔测试结构及对应的测试方法	ZL201110383474.5	中芯上海	2011-11-25	2016-01-06	原始取得	无
1826	化学机械研磨装置及研磨过程中处理晶片的方法	ZL201110383477.9	中芯上海	2011-11-25	2015-04-15	原始取得	无
1827	阻挡层的形成方法和半导体器件	ZL201110397291.9	中芯上海	2011-12-02	2015-03-11	原始取得	无
1828	隧道绝缘材料层的形成方法及形成装置	ZL201110397293.8	中芯上海	2011-12-02	2016-01-06	原始取得	无
1829	磁隧道结及其形成方法	ZL201110397317.X	中芯上海	2011-12-02	2015-04-29	原始取得	无
1830	半导体器件及其制造方法	ZL201110397325.4	中芯上海	2011-12-02	2016-01-06	原始取得	无
1831	PMOS 晶体管金属栅极的制造	ZL201110397349.X	中芯上海	2011-12-02	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
1832	半导体器件的制作方法	ZL201110397350.2	中芯上海	2011-12-02	2016-03-30	原始取得	无
1833	多栅极场效应晶体管及其制作方法	ZL201110397366.3	中芯上海	2011-12-02	2015-06-24	原始取得	无
1834	伪多晶硅的移除方法及CMOS金属栅极的制作方法	ZL201110397447.3	中芯上海	2011-12-02	2015-08-19	原始取得	无
1835	半导体存储单元及其制造方法	ZL201110397450.5	中芯上海	2011-12-02	2015-08-19	原始取得	无
1836	半导体失效检测结构及形成方法、检测失效时间的方法	ZL201110397650.0	中芯上海	2011-12-02	2015-11-25	原始取得	无
1837	磁性材料层的形成方法及形成装置	ZL201110397656.8	中芯上海	2011-12-02	2016-01-06	原始取得	无
1838	磁性材料层的形成方法及形成装置	ZL201110397659.1	中芯上海	2011-12-02	2015-12-16	原始取得	无
1839	高K栅介质层的形成方法及形成装置、晶体管的形成方法	ZL201110398208.X	中芯上海	2011-12-02	2015-10-14	原始取得	无
1840	沟槽间形成孔洞的方法	ZL201110398280.2	中芯上海	2011-12-06	2014-12-03	原始取得	无
1841	形成Finfet掺杂鳍状物的方法	ZL201110398431.4	中芯上海	2011-12-05	2015-12-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1842	高介电层金属栅的制造方法	ZL201110398658.9	中芯上海	2011-12-05	2016-03-30	原始取得	无
1843	一种半导体器件的制造方法	ZL201110400078.9	中芯上海	2011-12-06	2016-05-11	原始取得	无
1844	一种半导体器件的制造方法	ZL201110400079.3	中芯上海	2011-12-06	2016-04-06	原始取得	无
1845	一种半导体器件的制造方法	ZL201110400599.4	中芯上海	2011-12-06	2016-04-06	原始取得	无
1846	一种半导体器件的制造方法	ZL201110400600.3	中芯上海	2011-12-06	2017-06-13	原始取得	无
1847	一种半导体器件的制造方法	ZL201110400652.0	中芯上海	2011-12-06	2015-12-02	原始取得	无
1848	一种硅通孔制作方法	ZL201110404060.6	中芯上海	2011-12-07	2015-07-08	原始取得	无
1849	一种半导体器件的制造方法	ZL201110404392.4	中芯上海	2011-12-07	2016-02-03	原始取得	无
1850	鳍式场效应晶体管及其制作方法	ZL201110406764.7	中芯上海	2011-12-08	2016-08-10	原始取得	无
1851	互连结构的制造方法	ZL201110406767.0	中芯上海	2011-12-08	2015-04-01	原始取得	无
1852	半导体检测结构及检测方法	ZL201110406774.0	中芯上海	2011-12-08	2016-08-31	原始取得	无
1853	毫秒退火工艺稳定性的监测方法	ZL201110406808.6	中芯上海	2011-12-08	2015-11-25	原始取得	无
1854	半导体结构及其形成方法	ZL201110406813.7	中芯上海	2011-12-08	2015-07-08	原始取得	无
1855	半导体器件的制作方法	ZL201110406845.7	中芯上海	2011-12-08	2015-03-11	原始取得	无
1856	互连结构的制造方法	ZL201110406853.1	中芯上海	2011-12-08	2014-12-24	原始取得	无
1857	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201110406861.6	中芯上海	2011-12-08	2016-01-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1858	硅通孔检测结构及对应的检测方法	ZL201110406875.8	中芯上海	2011-12-08	2015-09-02	原始取得	无
1859	降低层间介质层介电常数的方法	ZL201110406978.4	中芯上海	2011-12-08	2015-04-15	原始取得	无
1860	一种半导体器件的制造方法	ZL201110407018.X	中芯上海	2011-12-08	2015-09-09	原始取得	无
1861	互连结构的制造方法	ZL201110407271.5	中芯上海	2011-12-08	2015-06-03	原始取得	无
1862	CMOS 晶体管金属栅极的制作方法	ZL201110407288.0	中芯上海	2011-12-08	2015-09-02	原始取得	无
1863	一种形成鳍式场效应管栅极侧壁层的方法	ZL201110407321.X	中芯上海	2011-12-08	2015-07-15	原始取得	无
1864	一种半导体器件的制造方法	ZL201110407484.8	中芯上海	2011-12-08	2016-07-27	原始取得	无
1865	半导体器件的结构及制造方法	ZL201110407631.1	中芯上海	2011-12-08	2015-07-29	原始取得	无
1866	一种半导体器件的制造方法	ZL201110410407.8	中芯上海	2011-12-09	2016-01-06	原始取得	无
1867	半导体器件的制作方法	ZL201110410437.9	中芯上海	2011-12-12	2015-09-09	原始取得	无
1868	用于 CMOS 器件的测试器件、制作方法及其使用方法	ZL201110410491.3	中芯上海	2011-12-09	2015-12-02	原始取得	无
1869	准绝缘体上硅场效应晶体管	ZL201110412645.2	中芯上海	2011-12-12	2015-07-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的制备方法						
1870	高介电金属栅 MOS 及其制造方法	ZL201110412648.6	中芯上海	2011-12-12	2015-11-25	原始取得	无
1871	半导体器件及其制造方法	ZL201110413955.6	中芯上海	2011-12-13	2015-10-14	原始取得	无
1872	浅沟槽隔离结构及形成方法、半导体器件结构及形成方法	ZL201110414146.7	中芯上海	2011-12-13	2016-03-30	原始取得	无
1873	芯片版图的检测方法	ZL201110414147.1	中芯上海	2011-12-13	2015-08-05	原始取得	无
1874	MOS 器件及其形成方法	ZL201110415261.6	中芯上海	2011-12-13	2016-08-03	原始取得	无
1875	用于刻蚀的硬掩膜及其制备方法以及 MOS 器件的制造方法	ZL201110415370.8	中芯上海	2011-12-13	2015-09-30	原始取得	无
1876	制作鳍形场效应晶体管的方法	ZL201110415437.8	中芯上海	2011-12-13	2015-09-09	原始取得	无
1877	制作半导体器件的方法	ZL201110416513.7	中芯上海	2011-12-14	2015-12-09	原始取得	无
1878	光刻胶层的去除方法、晶体管的形成方法	ZL201110421342.7	中芯上海	2011-12-15	2015-09-02	原始取得	无
1879	鳍式场效应晶体管及其制作方法	ZL201110422099.0	中芯上海	2011-12-15	2016-01-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1880	金属栅极形成方法	ZL201110422106.7	中芯上海	2011-12-15	2015-11-25	原始取得	无
1881	半导体结构及半导体结构的形成方法	ZL201110422109.0	中芯上海	2011-12-13	2015-01-21	原始取得	无
1882	LDNMOS 及 LDPMOS 的制造方法	ZL201110425521.8	中芯上海	2011-12-16	2016-05-04	原始取得	无
1883	制作半导体器件的方法	ZL201110425827.3	中芯上海	2011-12-19	2016-04-06	原始取得	无
1884	互连线反向电流产生电路	ZL201110427581.3	中芯上海	2011-12-19	2015-09-16	原始取得	无
1885	互连结构的制造方法	ZL201110427588.5	中芯上海	2011-12-19	2015-08-05	原始取得	无
1886	制作半导体器件的方法	ZL201110427771.5	中芯上海	2011-12-19	2015-12-02	原始取得	无
1887	采用 e-SiGe 的 PMOS 制造方法	ZL201110427854.4	中芯上海	2011-12-19	2016-02-17	原始取得	无
1888	栅介质层及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201110428309.7	中芯上海	2011-12-19	2016-08-31	原始取得	无
1889	采用 e-SiGe 的 PMOS 制造方法	ZL201110428310.X	中芯上海	2011-12-19	2015-08-19	原始取得	无
1890	制作半导体器件的方法	ZL201110428311.4	中芯上海	2011-12-20	2015-12-16	原始取得	无
1891	一种半导体器件的制造方法	ZL201110428894.0	中芯上海	2011-12-20	2015-09-09	原始取得	无
1892	高介电常数金属栅极制造方	ZL201110430924.1	中芯上海	2011-12-20	2016-03-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
1893	鳍式场效应管的形成方法	ZL201110430948.7	中芯上海	2011-12-20	2015-10-14	原始取得	无
1894	电平移位电路	ZL201110430950.4	中芯上海	2011-12-20	2015-11-25	原始取得	无
1895	半导体器件及其形成方法	ZL201110431447.0	中芯上海	2011-12-20	2014-11-05	原始取得	无
1896	硅复合物外延生长厚度的检测方法及硅复合物的制作方法	ZL201110431450.2	中芯上海	2011-12-20	2016-12-14	原始取得	无
1897	晶体管的形成方法	ZL201110431456.X	中芯上海	2011-12-20	2015-12-09	原始取得	无
1898	处理多孔超低介电常数层的方法	ZL201110431560.9	中芯上海	2011-12-21	2016-06-01	原始取得	无
1899	鳍式场效应管的形成方法	ZL201110436138.2	中芯上海	2011-12-22	2015-11-25	原始取得	无
1900	空气隙、空气隙的形成方法及半导体器件	ZL201110436157.5	中芯上海	2011-12-22	2016-03-16	原始取得	无
1901	横向扩散金属氧化物半导体晶体管的制造方法	ZL201110436204.6	中芯上海	2011-12-22	2016-02-03	原始取得	无
1902	鳍式场效应管的鳍部以及鳍式场效应管的形成方法	ZL201110436326.5	中芯上海	2011-12-22	2015-11-25	原始取得	无
1903	晶体管及其制作方法	ZL201110436570.1	中芯上海	2011-12-22	2017-09-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1904	用于清洗和干燥晶圆盒的装置及方法	ZL201110436915.3	中芯上海	2011-12-22	2016-02-03	原始取得	无
1905	带有矩形电感耦合线圈的刻蚀装置	ZL201110443196.8	中芯上海	2011-12-26	2016-03-16	原始取得	无
1906	使用温度可控的限制环的刻蚀装置	ZL201110443713.1	中芯上海	2011-12-26	2015-12-16	原始取得	无
1907	检测层间粘附力的方法及检测试片的制作方法	ZL201110446041.X	中芯上海	2011-12-27	2015-09-09	原始取得	无
1908	集成电路的制作方法	ZL201110446090.3	中芯上海	2011-12-27	2015-06-03	原始取得	无
1909	CMP 终点检测方法与相变存储器底部接触结构形成方法	ZL201110446097.5	中芯上海	2011-12-27	2015-08-05	原始取得	无
1910	微加热装置	ZL201110446438.9	中芯上海	2011-12-27	2015-09-02	原始取得	无
1911	制作半导体器件的方法	ZL201110447592.8	中芯上海	2011-12-28	2015-11-25	原始取得	无
1912	一种半导体器件的制造方法	ZL201110447595.1	中芯上海	2011-12-28	2016-04-06	原始取得	无
1913	一种铜阻挡层制作方法	ZL201110452147.0	中芯上海	2011-12-29	2016-02-17	原始取得	无
1914	半导体结构及其形成方法、CMOS 及其形成方法	ZL201110453483.7	中芯上海	2011-12-29	2015-08-05	原始取得	无
1915	研磨垫、使用该研磨垫的研磨	ZL201110453496.4	中芯上海	2011-12-29	2015-10-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	装置及研磨方法						
1916	金属互连线的形成方法	ZL201110453497.9	中芯上海	2011-12-29	2015-07-08	原始取得	无
1917	结型场效应管及其形成方法	ZL201110453500.7	中芯上海	2011-12-29	2015-06-03	原始取得	无
1918	石墨烯场效应晶体管及其制作方法	ZL201110454051.8	中芯上海	2011-12-29	2016-02-17	原始取得	无
1919	场效应晶体管的制作方法	ZL201110454057.5	中芯上海	2011-12-29	2015-10-14	原始取得	无
1920	高 k 金属栅电极的制作方法及其高 K 金属栅结构	ZL201110454066.4	中芯上海	2011-12-29	2015-12-16	原始取得	无
1921	半导体结构及其形成方法	ZL201110454081.9	中芯上海	2011-12-29	2015-06-03	原始取得	无
1922	鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201110454092.7	中芯上海	2011-12-29	2016-08-10	原始取得	无
1923	半导体互连结构及形成方法	ZL201110454104.6	中芯上海	2011-12-29	2016-01-06	原始取得	无
1924	金属栅极的形成方法	ZL201110454114.X	中芯上海	2011-12-29	2015-07-08	原始取得	无
1925	金属栅极的形成方法	ZL201110454121.X	中芯上海	2011-12-29	2015-09-02	原始取得	无
1926	Al-Ge 键合方法	ZL201110455266.1	中芯上海	2011-12-30	2016-08-03	原始取得	无
1927	LDMOS 晶体管及其制作方法	ZL201110456264.4	中芯上海	2011-12-30	2015-10-14	原始取得	无
1928	形成互连结构的方法	ZL201110456268.2	中芯上海	2011-12-30	2016-01-06	原始取得	无
1929	浮栅制造过程中氮化硅层的	ZL201110456273.3	中芯上海	2011-12-30	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	去除方法						
1930	薄膜的热处理方法及热处理装置、化学气相沉积装置	ZL201110456281.8	中芯上海	2011-12-30	2016-02-17	原始取得	无
1931	半导体器件的保护电路	ZL201110456285.6	中芯上海	2011-12-30	2015-11-25	原始取得	无
1932	一种通过定向自组装嵌段共聚物的光刻方法	ZL201110456341.6	中芯上海	2011-12-30	2015-06-17	原始取得	无
1933	局部氧化硅隔离的形成方法	ZL201110456993.X	中芯上海	2011-12-30	2015-03-11	原始取得	无
1934	硅通孔检测结构及检测方法	ZL201110456998.2	中芯上海	2011-12-30	2015-12-16	原始取得	无
1935	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201110457000.0	中芯上海	2011-12-30	2016-06-29	原始取得	无
1936	晶体管的形成方法	ZL201110457018.0	中芯上海	2011-12-30	2016-02-17	原始取得	无
1937	多栅极场效应晶体管及其制造方法	ZL201110457448.2	中芯上海	2011-12-31	2016-02-03	原始取得	无
1938	半导体器件的制造方法	ZL201110457452.9	中芯上海	2011-12-31	2016-02-03	原始取得	无
1939	多次外延生长方法	ZL201110457595.X	中芯上海	2011-12-31	2016-02-03	原始取得	无
1940	层间粘附力的检测方法及检测试片的制造方法	ZL201110457605.X	中芯上海	2011-12-31	2015-08-19	原始取得	无
1941	改善 MIM 电容器制作中电弧放电缺陷的方法	ZL201110457616.8	中芯上海	2011-12-31	2015-10-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1942	刻蚀停止层及铜互连的形成方法	ZL201110457640.1	中芯上海	2011-12-31	2015-11-25	原始取得	无
1943	具有空气间隙的双镶嵌大马士革结构器件的制作方法	ZL201110457697.1	中芯上海	2011-12-31	2015-07-29	原始取得	无
1944	一种对焊盘表面进行清洗的方法	ZL201110457753.1	中芯上海	2011-12-31	2015-07-08	原始取得	无
1945	铜互连的制作方法	ZL201110457762.0	中芯上海	2011-12-31	2015-02-11	原始取得	无
1946	PMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201110457774.3	中芯上海	2011-12-31	2016-05-11	原始取得	无
1947	提高晶圆的刻蚀 CD 均匀度的装置和方法	ZL201110458036.0	中芯上海	2011-12-31	2016-08-24	原始取得	无
1948	多栅极场效应晶体管的制造方法	ZL201110458039.4	中芯上海	2011-12-31	2015-08-19	原始取得	无
1949	载物装置及曝光装置	ZL201110459299.3	中芯上海	2011-12-31	2014-12-24	原始取得	无
1950	相变存储器中相变电阻的形成方法	ZL201110459303.6	中芯上海	2011-12-31	2016-02-17	原始取得	无
1951	静电放电保护装置的检测电路及检测方法	ZL201110459309.3	中芯上海	2011-12-31	2015-08-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1952	硅通孔测试结构及测试方法	ZL201110459319.7	中芯上海	2011-12-31	2015-07-08	原始取得	无
1953	嵌入式闪存中晶体管的形成方法	ZL201110459323.3	中芯上海	2011-12-31	2015-06-03	原始取得	无
1954	掩膜板及其制作方法、光刻胶层的曝光方法	ZL201110459372.7	中芯上海	2011-12-31	2015-09-02	原始取得	无
1955	GGNMOS 的制作方法	ZL201110459385.4	中芯上海	2011-12-31	2015-12-16	原始取得	无
1956	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201110459388.8	中芯上海	2011-12-31	2016-04-20	原始取得	无
1957	负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法	ZL201110459390.5	中芯上海	2011-12-31	2016-08-31	原始取得	无
1958	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201110459397.7	中芯上海	2011-12-31	2015-07-08	原始取得	无
1959	晶体管的形成方法	ZL201110459401.X	中芯上海	2011-12-31	2015-11-25	原始取得	无
1960	晶圆清洗方法	ZL201110459405.8	中芯上海	2011-12-31	2015-11-25	原始取得	无
1961	鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201110459410.9	中芯上海	2011-12-31	2016-06-29	原始取得	无
1962	半导体结构及其形成方法	ZL201110459412.8	中芯上海	2011-12-31	2016-03-16	原始取得	无
1963	硅通孔检测结构及检测方法	ZL201110459415.1	中芯上海	2011-12-31	2016-02-17	原始取得	无
1964	光刻机及其扫描曝光方法	ZL201110459524.3	中芯上海	2011-12-31	2016-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1965	浸没式光刻系统的投影系统	ZL201110459541.7	中芯上海	2011-12-31	2016-01-06	原始取得	无
1966	相变存储器中的相变电阻及其形成方法	ZL201110459550.6	中芯上海	2011-12-31	2016-03-16	原始取得	无
1967	光刻对准装置、其使用方法及光刻机	ZL201110459572.2	中芯上海	2011-12-31	2014-12-03	原始取得	无
1968	金属栅极场效应晶体管及其制作方法	ZL201110459664.0	中芯上海	2011-12-31	2016-04-20	原始取得	无
1969	晶片加热器及电子迁移率检测装置	ZL201110459681.4	中芯上海	2011-12-31	2015-12-16	原始取得	无
1970	晶体管的形成方法	ZL201110459684.8	中芯上海	2011-12-31	2015-08-05	原始取得	无
1971	失效分析专用载板、测试设备、芯片电性失效分析的方法	ZL201110459688.6	中芯上海	2011-12-31	2016-01-06	原始取得	无
1972	测试结构及其形成方法、冲洗工艺的冲洗时间判定方法	ZL201110459708.X	中芯上海	2011-12-31	2016-03-16	原始取得	无
1973	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201110459718.3	中芯上海	2011-12-31	2016-03-16	原始取得	无
1974	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201110459732.3	中芯上海	2011-12-31	2016-02-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1975	光学邻近修正方法、连接孔的制作方法	ZL201110459734.2	中芯上海	2011-12-31	2016-10-05	原始取得	无
1976	半导体结构及其形成方法	ZL201110459743.1	中芯上海	2011-12-31	2016-05-25	原始取得	无
1977	金属连线结构及其形成方法	ZL201110459756.9	中芯上海	2011-12-31	2015-07-08	原始取得	无
1978	半导体失效分析结构及形成方法、检测失效时间的方法	ZL201110459759.2	中芯上海	2011-12-31	2016-03-16	原始取得	无
1979	一种纳米线围栅器件散热特性的测试结构和测试方法	ZL201210006026.8	中芯上海、北京大学	2012-01-10	2014-08-13	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
1980	MOS 晶体管及其制造方法	ZL201210009058.3	中芯上海	2012-01-12	2015-11-25	原始取得	无
1981	一种半导体器件的制造方法	ZL201210017572.1	中芯上海	2012-01-19	2017-08-01	原始取得	无
1982	清洗研磨液供给系统的方法	ZL201210021882.0	中芯上海	2012-01-31	2014-08-13	原始取得	无
1983	CIS 器件电气故障分析测试方法及测试系统	ZL201210024592.1	中芯上海	2012-02-03	2015-12-16	原始取得	无
1984	铜互连结构及其制造方法	ZL201210024611.0	中芯上海	2012-02-03	2015-11-25	原始取得	无
1985	横向扩散金属氧化物半导体场效应管及其制造方法	ZL201210024752.2	中芯上海	2012-02-03	2017-05-17	原始取得	无
1986	金属氧化物半导体场效应管的制造方法	ZL201210024753.7	中芯上海	2012-02-03	2015-09-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1987	曝光装置及曝光方法	ZL201210028871.5	中芯上海	2012-02-09	2015-07-08	原始取得	无
1988	去除掩模版上雾状缺陷的装置及方法	ZL201210029062.6	中芯上海	2012-02-09	2015-04-29	原始取得	无
1989	一种浅沟槽隔离结构及其制作方法	ZL201210030270.8	中芯上海	2012-02-10	2015-09-09	原始取得	无
1990	一种半导体器件的制作方法	ZL201210030318.5	中芯上海	2012-02-10	2015-12-16	原始取得	无
1991	用于检测离子源污染的分析器	ZL201210033028.6	中芯上海	2012-02-14	2015-11-25	原始取得	无
1992	一种半导体器件	ZL201210035696.2	中芯上海	2012-02-17	2016-06-15	原始取得	无
1993	铜互连结构及其制造方法	ZL201210037645.3	中芯上海	2012-02-17	2015-05-20	原始取得	无
1994	一种鳍型场效应晶体管的制造方法	ZL201210037667.X	中芯上海	2012-02-17	2016-07-27	原始取得	无
1995	超晶格纳米线场效应晶体管及其形成方法	ZL201210038792.2	中芯上海	2012-02-20	2016-02-17	原始取得	无
1996	闪存的存储单元及形成方法	ZL201210039334.0	中芯上海	2012-02-20	2016-02-17	原始取得	无
1997	纳米线场效应晶体管及其形成方法	ZL201210039335.5	中芯上海	2012-02-20	2016-02-17	原始取得	无
1998	晶体管的形成方法	ZL201210039634.9	中芯上海	2012-02-21	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
1999	分离栅快闪存储单元的制作方法	ZL201210039654.6	中芯上海	2012-02-21	2016-01-20	原始取得	无
2000	一种反熔丝元件及其制造方法	ZL201210041696.3	中芯上海	2012-02-23	2016-06-01	原始取得	无
2001	浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL201210045399.6	中芯上海	2012-02-27	2015-05-20	原始取得	无
2002	FinFET 器件制造方法	ZL201210045402.4	中芯上海	2012-02-27	2016-03-30	原始取得	无
2003	具有硅锗掺杂区的半导体器件的制作方法	ZL201210046187.X	中芯上海	2012-02-27	2016-03-23	原始取得	无
2004	一种多层纳米线结构的制造方法	ZL201210046312.7	中芯上海	2012-02-27	2016-05-25	原始取得	无
2005	形成半导体器件的方法	ZL201210046596.X	中芯上海	2012-02-27	2015-09-09	原始取得	无
2006	一种用于硅芯片间互连的冗余互连结构	ZL201210046598.9	中芯上海	2012-02-07	2015-11-25	原始取得	无
2007	相变存储器、其底部接触结构及其各自制作方法	ZL201210053852.8	中芯上海	2012-03-02	2015-06-03	原始取得	无
2008	半导体结构的制作方法	ZL201210053855.1	中芯上海	2012-03-02	2015-11-25	原始取得	无
2009	形成鳍部及鳍式场效应晶体管的方法	ZL201210053862.1	中芯上海	2012-03-02	2016-08-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2010	相变存储器及其制作方法	ZL201210053864.0	中芯上海	2012-03-02	2015-04-29	原始取得	无
2011	相变存储器及其制造方法	ZL201210053872.5	中芯上海	2012-03-02	2016-01-06	原始取得	无
2012	半导体结构的制造方法	ZL201210053874.4	中芯上海	2012-03-02	2015-11-25	原始取得	无
2013	嵌入逻辑电路的分离栅极式快闪存储器的制作方法	ZL201210054231.1	中芯上海	2012-03-02	2015-06-03	原始取得	无
2014	鳍式场效应管的形成方法	ZL201210054232.6	中芯上海	2012-03-02	2016-08-03	原始取得	无
2015	栅介质层的制作方法、晶体管的制作方法	ZL201210054234.5	中芯上海	2012-03-02	2016-03-16	原始取得	无
2016	相变存储器及其制造方法	ZL201210054246.8	中芯上海	2012-03-02	2015-10-14	原始取得	无
2017	CMOS 及其形成方法	ZL201210054248.7	中芯上海	2012-03-02	2016-03-16	原始取得	无
2018	高压晶体管	ZL201210059045.7	中芯上海	2012-03-07	2017-04-05	原始取得	无
2019	晶圆边缘曝光工艺的检测方法	ZL201210063076.X	中芯上海	2012-03-09	2016-08-03	原始取得	无
2020	沟槽的刻蚀方法	ZL201210064070.4	中芯上海	2012-03-12	2015-08-05	原始取得	无
2021	字线驱动电路及存储器电路	ZL201210064075.7	中芯上海	2012-03-12	2016-05-25	原始取得	无
2022	晶体管的形成方法,CMOS 的形成方法	ZL201210064086.5	中芯上海	2012-03-12	2015-11-25	原始取得	无
2023	晶体管的形成方法	ZL201210064092.0	中芯上海	2012-03-12	2016-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2024	案件半导体结构的形成方法、晶体管的形成方法	ZL201210064094.X	中芯上海	2012-03-12	2016-08-31	原始取得	无
2025	半导体检测电路及检测方法	ZL201210071313.7	中芯上海	2012-03-16	2015-11-25	原始取得	无
2026	化学机械研磨装置及系统	ZL201210071745.8	中芯上海	2012-03-16	2016-01-06	原始取得	无
2027	金属连线的制作方法、半导体结构的制作方法	ZL201210071752.8	中芯上海	2012-03-16	2015-04-29	原始取得	无
2028	一种超低功耗有机阻变存储器件及其制备方法	ZL201210082206.4	中芯上海、北京大学	2012-03-26	2014-03-26	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
2029	沟槽制备方法	ZL201210087245.3	中芯上海	2012-03-29	2015-06-10	原始取得	无
2030	高介电常数金属栅极制造方法	ZL201210087289.6	中芯上海	2012-03-29	2016-03-30	原始取得	无
2031	半导体结构的形成方法	ZL201210088172.X	中芯上海	2012-03-29	2015-09-02	原始取得	无
2032	微加热装置及形成方法	ZL201210088186.1	中芯上海	2012-03-29	2016-03-16	原始取得	无
2033	晶体管及其制造方法	ZL201210088189.5	中芯上海	2012-03-29	2016-07-06	原始取得	无
2034	晶体管以及形成方法	ZL201210088200.8	中芯上海	2012-03-29	2016-11-02	原始取得	无
2035	鳍式场效应管的形成方法	ZL201210088604.7	中芯上海	2012-03-29	2015-03-11	原始取得	无
2036	大马士革结构的制作方法	ZL201210088627.8	中芯上海	2012-03-29	2016-10-05	原始取得	无
2037	半导体结构的形成方法	ZL201210088629.7	中芯上海	2012-03-29	2015-01-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2038	半导体器件及其制作方法	ZL201210088630.X	中芯上海	2012-03-29	2016-01-06	原始取得	无
2039	形成接触孔的方法	ZL201210088632.9	中芯上海	2012-03-29	2015-04-01	原始取得	无
2040	光刻工艺分配系统及分配方法	ZL201210091522.8	中芯上海	2012-03-30	2015-07-29	原始取得	无
2041	半导体器件的制造方法	ZL201210091972.7	中芯上海	2012-03-31	2015-12-16	原始取得	无
2042	检测版图结构及检测方法	ZL201210091973.1	中芯上海	2012-03-31	2015-12-16	原始取得	无
2043	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL201210092227.4	中芯上海	2012-03-31	2016-12-28	原始取得	无
2044	半导体器件、鳍式场效应管的形成方法	ZL201210093167.8	中芯上海	2012-03-31	2016-05-25	原始取得	无
2045	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210093379.6	中芯上海	2012-03-31	2015-11-25	原始取得	无
2046	晶体管及其形成方法	ZL201210093380.9	中芯上海	2012-03-31	2016-03-16	原始取得	无
2047	电性失效分析的测试方法及装置	ZL201210093391.7	中芯上海	2012-03-31	2016-04-20	原始取得	无
2048	NMOS 晶体管及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201210093395.5	中芯上海	2012-03-31	2016-02-17	原始取得	无
2049	半导体器件的形成方法、鳍式场效应管的形成方法	ZL201210093499.6	中芯上海	2012-03-31	2015-10-14	原始取得	无
2050	晶体管及晶体管的形成方法	ZL201210093559.4	中芯上海	2012-03-31	2016-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2051	MOS 晶体管及其制造方法	ZL201210101310.3	中芯上海	2012-03-31	2016-06-01	原始取得	无
2052	双重光刻胶及其处理方法	ZL201210101344.2	中芯上海	2012-03-31	2016-01-06	原始取得	无
2053	曝光对准方法	ZL201210101351.2	中芯上海	2012-03-31	2015-01-21	原始取得	无
2054	掩膜板的光学邻近校正方法	ZL201210101392.1	中芯上海	2012-04-09	2016-03-09	原始取得	无
2055	半导体结构的形成方法	ZL201210101488.8	中芯上海	2012-04-09	2016-06-29	原始取得	无
2056	双重光刻胶结构及其处理方法	ZL201210101490.5	中芯上海	2012-04-09	2015-09-02	原始取得	无
2057	半导体结构的形成方法	ZL201210101492.4	中芯上海	2012-04-09	2015-03-11	原始取得	无
2058	改善表面结合力的方法	ZL201210101495.8	中芯上海	2012-04-09	2016-04-20	原始取得	无
2059	鳍式场效应管的形成方法	ZL201210101577.2	中芯上海	2012-03-31	2015-09-02	原始取得	无
2060	多栅极场效应晶体管及其制造方法	ZL201210101625.8	中芯上海	2012-03-31	2016-02-03	原始取得	无
2061	一种低 K 介质层及其形成方法	ZL201210101641.7	中芯上海	2012-03-31	2016-02-03	原始取得	无
2062	自对准双构图方法及其形成的图案	ZL201210101644.0	中芯上海	2012-03-31	2015-10-14	原始取得	无
2063	功函数测试方法	ZL201210101757.0	中芯上海	2012-04-09	2016-06-01	原始取得	无
2064	一种多掺杂口袋结构的隧穿	ZL201210101859.2	中芯上海、北京大学	2012-04-09	2014-04-30	北京大学：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	场效应晶体管及其制备方法					上海：继受取得	
2065	鳍部、鳍部及鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201210101863.9	中芯上海	2012-04-09	2015-11-25	原始取得	无
2066	超薄绝缘体上硅结构的制作方法、半导体器件的制作方法	ZL201210101865.8	中芯上海	2012-04-09	2016-05-25	原始取得	无
2067	用于相变随机存取存储器的底部电接触结构的制造方法	ZL201210102372.6	中芯上海	2012-04-09	2015-06-17	原始取得	无
2068	一种一维到三维边界热阻的测试结构和方法	ZL201210106835.6	中芯上海、北京大学	2012-04-12	2013-07-31	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
2069	一种小电极结构阻变存储器及其制备方法	ZL201210107418.3	中芯上海、北京大学	2012-04-12	2013-12-04	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
2070	半导体器件制造方法	ZL201210109384.1	中芯上海	2012-04-13	2017-05-10	原始取得	无
2071	硬掩膜层结构及其制造方法和半导体器件制造方法	ZL201210109919.5	中芯上海	2012-04-13	2016-06-29	原始取得	无
2072	半导体器件及其制造方法	ZL201210109964.0	中芯上海	2012-04-13	2016-02-03	原始取得	无
2073	校正布局图形的方法	ZL201210113407.6	中芯上海	2012-04-17	2015-10-14	原始取得	无
2074	半导体结构的形成方法及处理方法	ZL201210113408.0	中芯上海	2012-04-17	2015-06-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2075	悬浮纳米线场效应晶体管及其形成方法	ZL201210113567.0	中芯上海	2012-04-17	2015-11-25	原始取得	无
2076	半导体结构的形成方法、晶体管的形成方法	ZL201210113568.5	中芯上海	2012-04-17	2015-12-16	原始取得	无
2077	防止铜扩散的方法	ZL201210113569.X	中芯上海	2012-04-17	2015-04-29	原始取得	无
2078	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL201210113570.2	中芯上海	2012-04-17	2015-11-25	原始取得	无
2079	大马士革结构的制作方法	ZL201210114816.8	中芯上海	2012-04-18	2015-08-05	原始取得	无
2080	硅通孔结构	ZL201210114818.7	中芯上海	2012-04-18	2016-08-31	原始取得	无
2081	开口的形成方法	ZL201210114819.1	中芯上海	2012-04-18	2016-08-31	原始取得	无
2082	沟槽的形成方法	ZL201210115867.2	中芯上海	2012-04-18	2016-02-17	原始取得	无
2083	硅通孔结构	ZL201210115868.7	中芯上海	2012-04-18	2016-04-20	原始取得	无
2084	硅通孔结构	ZL201210115869.1	中芯上海	2012-04-18	2016-04-20	原始取得	无
2085	一种半导体器件的制造方法	ZL201210117405.4	中芯上海	2012-04-19	2016-02-17	原始取得	无
2086	一种基于阻变忆阻器的电压保护电路及其应用	ZL201210119083.7	中芯上海、北京大学	2012-04-20	2014-07-02	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
2087	光栅的制作方法	ZL201210120460.9	中芯上海	2012-04-23	2016-03-30	原始取得	无
2088	图案化的石墨烯的形成方法	ZL201210120466.6	中芯上海	2012-04-23	2016-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2089	半导体器件的刻蚀方法	ZL201210120983.3	中芯上海	2012-04-23	2016-01-20	原始取得	无
2090	一种具有应力覆盖层的CMOS器件制作方法	ZL201210120984.8	中芯上海	2012-04-23	2015-11-25	原始取得	无
2091	高介电层金属栅器件的制造方法	ZL201210120986.7	中芯上海	2012-04-23	2016-08-31	原始取得	无
2092	PMOS 晶体管及其制造方法	ZL201210120987.1	中芯上海	2012-04-23	2015-09-09	原始取得	无
2093	一种硅锗源/漏结构的形成方法	ZL201210121013.5	中芯上海	2012-04-23	2016-03-02	原始取得	无
2094	一种鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201210121024.3	中芯上海	2012-04-23	2015-12-16	原始取得	无
2095	半导体器件及其制造方法	ZL201210121114.2	中芯上海	2012-04-23	2016-04-20	原始取得	无
2096	硬掩膜层结构及低 K 介质层刻蚀方法	ZL201210121121.2	中芯上海	2012-04-23	2016-02-03	原始取得	无
2097	MOS 晶体管的制造方法	ZL201210121122.7	中芯上海	2012-04-23	2015-12-16	原始取得	无
2098	一种降低负载效应的硅锗结构及其制形成方法	ZL201210121139.2	中芯上海	2012-04-23	2016-02-03	原始取得	无
2099	半导体器件结构的制造方法	ZL201210121140.5	中芯上海	2012-04-23	2016-08-24	原始取得	无
2100	多栅极场效应晶体管鳍状结	ZL201210121162.1	中芯上海	2012-04-23	2016-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	构的制造方法						
2101	TEM 样品的精确定位的制作方法	ZL201210121163.6	中芯上海、武汉新芯集成电路制造有限公司	2012-04-23	2015-09-02	原始取得	无
2102	硅通孔结构及其制造方法	ZL201210121165.5	中芯上海	2012-04-23	2016-04-13	原始取得	无
2103	MOS 晶体管的制造方法	ZL201210121171.0	中芯上海	2012-04-23	2016-08-03	原始取得	无
2104	应力记忆技术中形成应力层的方法	ZL201210122398.7	中芯上海	2012-04-23	2015-08-12	原始取得	无
2105	半导体器件的形成方法、鳍式场效应管的形成方法	ZL201210122574.7	中芯上海	2012-04-24	2015-12-16	原始取得	无
2106	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210122575.1	中芯上海	2012-04-24	2016-02-17	原始取得	无
2107	半导体结构的形成方法、晶体管的形成方法	ZL201210122579.X	中芯上海	2012-04-24	2016-08-31	原始取得	无
2108	形成孔的方法	ZL201210122591.0	中芯上海	2012-04-24	2015-06-03	原始取得	无
2109	场效应晶体管及其制作方法	ZL201210122592.5	中芯上海	2012-04-24	2016-03-16	原始取得	无
2110	半导体器件的形成方法	ZL201210122594.4	中芯上海	2012-04-24	2015-09-02	原始取得	无
2111	一种用于 SRAM 的 P 型传输栅极晶体管及其制作方法	ZL201210124387.2	中芯上海	2012-04-25	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2112	NPN 异质结双极晶体管及其制造方法	ZL201210128958.X	中芯上海	2012-04-27	2015-10-21	原始取得	无
2113	半导体器件的清洗方法	ZL201210129476.6	中芯上海	2012-04-27	2016-04-27	原始取得	无
2114	金属互连结构及其制作方法	ZL201210133501.8	中芯上海	2012-04-28	2016-08-10	原始取得	无
2115	PMOS 晶体管及形成方法	ZL201210133563.9	中芯上海	2012-04-28	2016-08-10	原始取得	无
2116	形成双镶嵌结构的方法	ZL201210133587.4	中芯上海	2012-04-28	2016-04-20	原始取得	无
2117	相变存储器的形成方法	ZL201210133616.7	中芯上海	2012-04-28	2015-01-21	原始取得	无
2118	栅极结构及形成方法、半导体结构及形成方法	ZL201210133627.5	中芯上海	2012-04-28	2016-01-06	原始取得	无
2119	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL201210134249.2	中芯上海	2012-04-28	2015-09-02	原始取得	无
2120	MOS 晶体管的形成方法	ZL201210134258.1	中芯上海	2012-04-28	2016-01-06	原始取得	无
2121	光刻区机台实时分派方法及系统	ZL201210139804.0	中芯上海	2012-05-08	2016-02-03	原始取得	无
2122	金属氧化物半导体晶体管的制作方法	ZL201210139956.0	中芯上海	2012-05-08	2015-12-09	原始取得	无
2123	半导体集成器件及其制作方法	ZL201210141118.7	中芯上海	2012-05-08	2015-12-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2124	具有金属栅电极层的半导体结构形成方法	ZL201210141553.X	中芯上海	2012-05-08	2016-05-25	原始取得	无
2125	半导体集成器件及其制作方法	ZL201210141561.4	中芯上海	2012-05-08	2016-12-14	原始取得	无
2126	晶体管的形成方法	ZL201210141564.8	中芯上海	2012-05-08	2016-09-07	原始取得	无
2127	铜互连结构及其形成方法	ZL201210142957.0	中芯上海	2012-05-09	2015-09-30	原始取得	无
2128	铜互连结构及其形成方法	ZL201210142981.4	中芯上海	2012-05-09	2015-12-16	原始取得	无
2129	低 K 介质阻挡层及其形成方法	ZL201210142983.3	中芯上海	2012-05-09	2015-12-02	原始取得	无
2130	SiCMOSFET 结构及其制造方法	ZL201210143467.2	中芯上海	2012-05-09	2015-12-02	原始取得	无
2131	半导体器件的制造方法	ZL201210143482.7	中芯上海	2012-05-09	2016-08-31	原始取得	无
2132	整理盘、研磨垫整理器及研磨装置	ZL201210143486.5	中芯上海	2012-05-09	2015-11-25	原始取得	无
2133	用于形成硬掩膜层的方法	ZL201210147052.2	中芯上海	2012-05-11	2016-03-30	原始取得	无
2134	源漏区的制备方法和 MOS 器件	ZL201210147814.9	中芯上海	2012-05-14	2016-06-22	原始取得	无
2135	浅沟槽隔离的制造方法和	ZL201210147848.8	中芯上海	2012-05-11	2015-08-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	CMOS 的制造方法						
2136	一种大马士革金属栅极制作方法	ZL201210148848.X	中芯上海	2012-05-14	2015-10-07	原始取得	无
2137	晶体管的形成方法	ZL201210149005.1	中芯上海	2012-05-14	2016-03-16	原始取得	无
2138	正偏压温度不稳定性的恢复电路及恢复方法	ZL201210149008.5	中芯上海	2012-05-14	2016-01-06	原始取得	无
2139	形成膜层的方法	ZL201210149010.2	中芯上海	2012-05-14	2015-09-02	原始取得	无
2140	半导体结构及其形成方法、PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201210149349.2	中芯上海	2012-05-14	2016-05-25	原始取得	无
2141	开口的形成方法和堆叠结构	ZL201210149357.7	中芯上海	2012-05-14	2015-11-25	原始取得	无
2142	半导体结构的形成方法	ZL201210149360.9	中芯上海	2012-05-14	2018-09-07	原始取得	无
2143	半导体器件及其形成方法	ZL201210149373.6	中芯上海	2012-05-14	2015-12-09	原始取得	无
2144	Ω形鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201210150639.9	中芯上海	2012-05-15	2016-01-06	原始取得	无
2145	后段制程中双重图形化方法	ZL201210150780.9	中芯上海	2012-05-15	2015-09-30	原始取得	无
2146	深耗尽沟道场效应晶体管及其制备方法	ZL201210150813.X	中芯上海	2012-05-15	2016-02-24	原始取得	无
2147	围栏间隔的设计规则测试电	ZL201210155011.8	中芯上海	2012-05-17	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	路						
2148	基于标准 CMOSIC 工艺制备互补隧穿场效应晶体管的方法	ZL201210156899.7	中芯上海、北京大学	2012-05-18	2014-06-04	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
2149	一种 MOSFET 器件以及制备方法	ZL201210158060.7	中芯上海	2012-05-18	2016-08-31	原始取得	无
2150	一种基于自对准双图案的半导体制造方法	ZL201210162459.2	中芯上海	2012-05-18	2016-02-03	原始取得	无
2151	用于对低介电常数材料层进行蚀刻后处理的方法	ZL201210162540.0	中芯上海	2012-05-21	2016-02-03	原始取得	无
2152	晶体管的制造方法	ZL201210164980.X	中芯上海	2012-05-24	2015-11-25	原始取得	无
2153	半导体结构以及晶体管的形成方法	ZL201210164991.8	中芯上海	2012-05-24	2016-06-29	原始取得	无
2154	半导体结构的形成方法	ZL201210164993.7	中芯上海	2012-05-24	2015-12-09	原始取得	无
2155	偏压温度不稳定性的检测电路及检测方法	ZL201210164995.6	中芯上海	2012-05-24	2015-12-09	原始取得	无
2156	填充金属的方法	ZL201210165002.7	中芯上海	2012-05-24	2015-04-01	原始取得	无
2157	晶体管的形成方法	ZL201210165854.6	中芯上海	2012-05-24	2015-12-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2158	半导体器件的形成方法、鳍式场效应管的形成方法	ZL201210165855.0	中芯上海	2012-05-24	2016-12-14	原始取得	无
2159	PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201210165881.3	中芯上海	2012-05-24	2016-04-20	原始取得	无
2160	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201210165882.8	中芯上海	2012-05-24	2016-01-06	原始取得	无
2161	半导体结构的形成方法及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201210165884.7	中芯上海	2012-05-24	2016-08-10	原始取得	无
2162	CMOS 的制造方法	ZL201210171864.0	中芯上海	2012-05-29	2015-07-29	原始取得	无
2163	浅沟槽隔离的制造方法和 CMOS 的制造方法	ZL201210171879.7	中芯上海	2012-05-29	2015-11-25	原始取得	无
2164	MOS 管及其形成方法	ZL201210174059.3	中芯上海	2012-05-30	2016-02-17	原始取得	无
2165	测量方法	ZL201210174109.8	中芯上海	2012-05-30	2016-01-06	原始取得	无
2166	曝光的方法	ZL201210174126.1	中芯上海	2012-05-30	2015-11-25	原始取得	无
2167	MOS 管及其形成方法	ZL201210174590.0	中芯上海	2012-05-30	2016-04-20	原始取得	无
2168	相变存储器、其底部接触结构及其各自制作方法	ZL201210174591.5	中芯上海	2012-05-30	2015-11-25	原始取得	无
2169	肖特基二极管及其制造方法	ZL201210174594.9	中芯上海	2012-05-30	2016-03-16	原始取得	无
2170	MOS 管及其形成方法	ZL201210174700.3	中芯上海	2012-05-30	2016-07-06	原始取得	无
2171	互补型金属氧化物半导体管	ZL201210174716.4	中芯上海	2012-05-30	2015-03-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的形成方法						
2172	用于静态随机存储器的驱动器和静态随机存储器	ZL201210180139.X	中芯上海	2012-06-04	2016-04-06	原始取得	无
2173	MOS 器件及其制造方法	ZL201210181130.0	中芯上海	2012-06-04	2016-06-01	原始取得	无
2174	一种用于形成硬掩膜层的方法	ZL201210181395.0	中芯上海	2012-06-04	2016-04-06	原始取得	无
2175	MOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201210183105.6	中芯上海	2012-06-05	2015-11-25	原始取得	无
2176	SiGe 源/漏区制造方法	ZL201210183117.9	中芯上海	2012-06-05	2016-01-06	原始取得	无
2177	金属互连线电迁移测试结构	ZL201210183140.8	中芯上海	2012-06-05	2016-03-23	原始取得	无
2178	相变随机存取存储器的制造方法	ZL201210183163.9	中芯上海	2012-06-05	2016-07-06	原始取得	无
2179	一种全包围栅极器件形成纳米线的方法	ZL201210183171.3	中芯上海	2012-06-05	2016-04-20	原始取得	无
2180	MOS 结构及其制造方法	ZL201210183269.9	中芯上海	2012-06-05	2017-12-22	原始取得	无
2181	自对准 GaAsFinFET 结构及其制造方法	ZL201210183270.1	中芯上海	2012-06-05	2016-02-03	原始取得	无
2182	一种掩膜版及套刻精度的测	ZL201210183489.1	中芯上海	2012-06-05	2016-07-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	量方法						
2183	互连结构及其制造方法	ZL201210183504.2	中芯上海	2012-06-05	2016-02-03	原始取得	无
2184	低 K 介质层中形成孔槽的方法	ZL201210183531.X	中芯上海	2012-06-05	2015-11-25	原始取得	无
2185	互连结构及其形成方法	ZL201210184900.7	中芯上海	2012-06-06	2017-12-01	原始取得	无
2186	校正光学邻近校正模型的方法	ZL201210184916.8	中芯上海	2012-06-06	2016-01-06	原始取得	无
2187	电感及其形成方法	ZL201210184945.4	中芯上海	2012-06-06	2016-03-16	原始取得	无
2188	电感及其形成方法	ZL201210184958.1	中芯上海	2012-06-06	2016-08-31	原始取得	无
2189	金属互连结构的制作方法	ZL201210184977.4	中芯上海	2012-06-06	2016-03-02	原始取得	无
2190	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210184979.3	中芯上海	2012-06-06	2016-01-06	原始取得	无
2191	NMOS 晶体管及其形成方法、包括该 NMOS 晶体管的 CMOS 晶体管	ZL201210185001.9	中芯上海	2012-06-06	2017-02-22	原始取得	无
2192	形成高介电层金属栅器件接触孔的方法	ZL201210186767.9	中芯上海	2012-06-07	2015-07-15	原始取得	无
2193	控制灵敏放大器开启的追踪电路和采用追踪电路的 SRAM	ZL201210186811.6	中芯上海	2012-06-07	2016-08-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2194	一种无需侧墙制作半导体器件的方法	ZL201210186815.4	中芯上海	2012-06-07	2016-03-30	原始取得	无
2195	一种鳍片和 STI 结构制作方法	ZL201210187233.8	中芯上海	2012-06-08	2016-01-20	原始取得	无
2196	沟槽间形成空气间隔的方法	ZL201210187234.2	中芯上海	2012-06-08	2016-04-20	原始取得	无
2197	沟槽间形成空气间隔的方法	ZL201210187235.7	中芯上海	2012-06-08	2015-12-16	原始取得	无
2198	NMOS 金属栅电极的制作方法	ZL201210189781.4	中芯上海	2012-06-11	2016-06-22	原始取得	无
2199	一种半导体器件的制造方法	ZL201210190200.9	中芯上海	2012-06-11	2016-03-30	原始取得	无
2200	一种半导体器件的制造方法	ZL201210191209.1	中芯上海	2012-06-11	2016-12-14	原始取得	无
2201	鳍式场效应管基体的形成方法及鳍式场效应管	ZL201210195209.9	中芯上海	2012-06-13	2016-02-17	原始取得	无
2202	一种离子注入的阻挡层制作方法	ZL201210196951.1	中芯上海	2012-06-14	2015-11-25	原始取得	无
2203	一种用于形成硬掩膜层的方法	ZL201210196978.0	中芯上海	2012-06-14	2016-08-03	原始取得	无
2204	一种半导体器件的制造方法	ZL201210202204.4	中芯上海	2012-06-18	2016-03-30	原始取得	无
2205	一种纳米量子点浮栅的制备方法	ZL201210203458.8	中芯上海	2012-06-19	2016-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2206	半导体结构的形成方法	ZL201210203519.0	中芯上海	2012-06-19	2015-10-14	原始取得	无
2207	氧化层、HKMG 结构中界面层、MOS 晶体管形成方法及 MOS 晶体管	ZL201210203540.0	中芯上海	2012-06-19	2016-08-10	原始取得	无
2208	鳍式场效应晶体管及其制造方法	ZL201210203734.0	中芯上海	2012-06-19	2016-08-10	原始取得	无
2209	鳍部和鳍式场效应管的形成方法	ZL201210203735.5	中芯上海	2012-06-19	2016-01-06	原始取得	无
2210	金属硅化物层和闪存的存储单元栅电极的形成方法	ZL201210203742.5	中芯上海	2012-06-19	2016-10-05	原始取得	无
2211	半导体结构及其形成方法	ZL201210203744.4	中芯上海	2012-06-19	2016-04-20	原始取得	无
2212	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210203757.1	中芯上海	2012-06-19	2017-07-14	原始取得	无
2213	一种 CMOS 器件及其形成方法	ZL201210206269.6	中芯上海	2012-06-20	2016-02-03	原始取得	无
2214	CMOS 全硅化物金属栅制备方法	ZL201210206298.2	中芯上海	2012-06-20	2016-03-02	原始取得	无
2215	形成 CMOS 全硅化物金属栅的方法	ZL201210206306.3	中芯上海	2012-06-20	2015-08-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2216	FinFET 制造方法	ZL201210206310.X	中芯上海	2012-06-20	2016-12-07	原始取得	无
2217	一种后栅极工艺晶体管及其形成方法	ZL201210206327.5	中芯上海	2012-06-20	2016-03-23	原始取得	无
2218	浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL201210206376.9	中芯上海	2012-06-20	2016-02-17	原始取得	无
2219	防止金属硅化物桥接的半导体器件的制造方法	ZL201210206518.1	中芯上海	2012-06-20	2017-03-22	原始取得	无
2220	水汽检测器件及水汽检测方法	ZL201210206555.2	中芯上海	2012-06-20	2016-03-23	原始取得	无
2221	半导体结构及其形成方法	ZL201210206563.7	中芯上海	2012-06-20	2016-05-25	原始取得	无
2222	一种用于形成接触孔的方法	ZL201210209344.4	中芯上海	2012-06-25	2016-03-30	原始取得	无
2223	形成 FinFET 栅介质层的方法和形成 FinFET 的方法	ZL201210209736.0	中芯上海	2012-06-25	2017-04-12	原始取得	无
2224	形成 FinFET 的方法	ZL201210211019.1	中芯上海	2012-06-25	2016-12-21	原始取得	无
2225	一种 NAND 器件的制造方法	ZL201210211647.X	中芯上海	2012-06-25	2016-01-13	原始取得	无
2226	半导体器件及其形成方法	ZL201210214114.7	中芯上海	2012-06-26	2016-06-29	原始取得	无
2227	NMOS 晶体管及其形成方法、SRAM 存储单元电路	ZL201210214126.X	中芯上海	2012-06-26	2016-01-06	原始取得	无
2228	等离子体刻蚀装置	ZL201210214130.6	中芯上海	2012-06-26	2016-11-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2229	通孔的处理方法	ZL201210214164.5	中芯上海	2012-06-26	2015-09-02	原始取得	无
2230	MOS 晶体管及其形成方法、SRAM 存储单元电路	ZL201210214272.2	中芯上海	2012-06-26	2016-01-06	原始取得	无
2231	平坦化导电插塞的方法	ZL201210214275.6	中芯上海	2012-06-26	2015-10-14	原始取得	无
2232	稳压电路及稳压装置	ZL201210214292.X	中芯上海	2012-06-26	2016-01-06	原始取得	无
2233	NMOS 晶体管及形成方法、CMOS 结构及形成方法	ZL201210214305.3	中芯上海	2012-06-26	2016-03-16	原始取得	无
2234	MOS 晶体管及其形成方法、SRAM 存储单元电路	ZL201210214317.6	中芯上海	2012-06-26	2016-12-21	原始取得	无
2235	SRAM 存储单元、形成存储单元的电路及形成方法	ZL201210214726.6	中芯上海	2012-06-26	2017-02-22	原始取得	无
2236	半导体器件的侧墙形成方法	ZL201210219026.6	中芯上海	2012-06-28	2016-07-27	原始取得	无
2237	半导体器件精细图案的制作方法	ZL201210219509.6	中芯上海	2012-06-28	2016-03-30	原始取得	无
2238	一种鳍式场效应管制作方法	ZL201210219546.7	中芯上海	2012-06-28	2016-06-29	原始取得	无
2239	一种半导体器件的制造方法	ZL201210219550.3	中芯上海	2012-06-28	2016-03-30	原始取得	无
2240	一种低介电常数金属间介质层刻蚀方法	ZL201210219759.X	中芯上海	2012-06-28	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2241	一种 FinFET 沟道掺杂方法	ZL201210219760.2	中芯上海	2012-06-28	2016-03-23	原始取得	无
2242	浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL201210223844.3	中芯上海	2012-06-29	2017-03-01	原始取得	无
2243	沟槽的形成方法	ZL201210224449.7	中芯上海	2012-06-29	2016-02-03	原始取得	无
2244	含有空气隙的互连结构的制备方法	ZL201210225939.9	中芯上海	2012-07-02	2017-02-08	原始取得	无
2245	研磨垫整理方法、研磨垫整理器及研磨机台	ZL201210225955.8	中芯上海	2012-07-02	2018-07-20	原始取得	无
2246	半导体器件及其形成方法	ZL201210225965.1	中芯上海	2012-07-02	2016-08-03	原始取得	无
2247	半导体结构及其形成方法	ZL201210225972.1	中芯上海	2012-07-02	2016-03-23	原始取得	无
2248	一种 MOS 晶体管及其制作方法	ZL201210225974.0	中芯上海	2012-07-02	2018-05-08	原始取得	无
2249	半导体结构的形成方法	ZL201210225975.5	中芯上海	2012-07-02	2016-05-25	原始取得	无
2250	相变存储器及其制作方法	ZL201210225978.9	中芯上海	2012-07-02	2015-12-09	原始取得	无
2251	互补型金属氧化物半导体管的形成方法	ZL201210225982.5	中芯上海	2012-07-02	2016-01-06	原始取得	无
2252	金属栅极晶体管的制作方法	ZL201210225983.X	中芯上海	2012-07-02	2018-03-30	原始取得	无
2253	CMOS 管的形成方法	ZL201210226016.5	中芯上海	2012-07-02	2015-12-16	原始取得	无
2254	研磨头及研磨装置	ZL201210226406.2	中芯上海	2012-07-02	2015-11-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2255	一种半导体器件以及制作半导体器件的方法	ZL201210226442.9	中芯上海	2012-07-02	2018-10-23	原始取得	无
2256	CMOS 管的形成方法	ZL201210226457.5	中芯上海	2012-07-02	2016-01-06	原始取得	无
2257	振荡器	ZL201210226459.4	中芯上海	2012-07-02	2016-04-20	原始取得	无
2258	金属互连结构的制作方法	ZL201210226475.3	中芯上海	2012-07-02	2016-01-06	原始取得	无
2259	半导体集成器件及其制作方法	ZL201210226537.0	中芯上海	2012-07-02	2016-12-21	原始取得	无
2260	占空比调整电路、双端转单端电路及振荡器	ZL201210226676.3	中芯上海	2012-07-02	2015-12-16	原始取得	无
2261	参考电流源及参考电流产生电路	ZL201210226680.X	中芯上海	2012-07-02	2016-07-06	原始取得	无
2262	一种 MOSFET 及其制备方法	ZL201210228418.9	中芯上海	2012-07-03	2016-03-30	原始取得	无
2263	一种 MOSFET 器件及其制备方法	ZL201210228655.5	中芯上海	2012-07-03	2016-05-11	原始取得	无
2264	金属互连结构及其制作方法	ZL201210228796.7	中芯上海	2012-07-03	2015-10-14	原始取得	无
2265	金属互连结构的制作方法	ZL201210228828.3	中芯上海	2012-07-03	2016-07-06	原始取得	无
2266	倒梯形替代栅极的制作方法	ZL201210230815.X	中芯上海	2012-07-05	2016-03-30	原始取得	无
2267	一种用于制造半导体器件的	ZL201210232175.6	中芯上海	2012-07-05	2016-08-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
2268	半导体器件及其制造方法	ZL201210232193.4	中芯上海	2012-07-05	2016-08-31	原始取得	无
2269	半导体器件及其制造方法	ZL201210232194.9	中芯上海	2012-07-05	2016-06-22	原始取得	无
2270	一种双栅鳍型场效应晶体管及其制造方法	ZL201210232236.9	中芯上海	2012-07-05	2016-06-01	原始取得	无
2271	PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201210238192.0	中芯上海	2012-07-10	2016-02-17	原始取得	无
2272	浮栅晶体管的制造方法	ZL201210238206.9	中芯上海	2012-07-10	2016-01-06	原始取得	无
2273	PMOS 晶体管的制作方法	ZL201210238209.2	中芯上海	2012-07-10	2016-06-29	原始取得	无
2274	浮栅晶体管的制作方法	ZL201210238222.8	中芯上海	2012-07-10	2016-08-10	原始取得	无
2275	MOS 器件及其形成方法	ZL201210238234.0	中芯上海	2012-07-10	2016-01-06	原始取得	无
2276	非易失性存储器及其形成方法	ZL201210238268.X	中芯上海	2012-07-10	2015-11-25	原始取得	无
2277	具有氟残留或氯残留的半导体结构的处理方法	ZL201210238276.4	中芯上海	2012-07-10	2016-11-16	原始取得	无
2278	互连结构最小间距的测试结构及测试方法	ZL201210238280.0	中芯上海	2012-07-10	2015-12-16	原始取得	无
2279	多晶硅电迁移测试结构及测试方法	ZL201210238569.2	中芯上海	2012-07-10	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2280	半导体结构的形成方法及处理方法	ZL201210238582.8	中芯上海	2012-07-10	2016-04-20	原始取得	无
2281	半导体器件及其形成方法	ZL201210238596.X	中芯上海	2012-07-10	2016-05-25	原始取得	无
2282	金属栅极的形成方法	ZL201210238599.3	中芯上海	2012-07-10	2017-07-14	原始取得	无
2283	一种采用虚设栅极制造半导体器件的方法	ZL201210239702.6	中芯上海	2012-07-11	2017-06-16	原始取得	无
2284	一种半导体器件的制造方法	ZL201210239753.9	中芯上海	2012-07-11	2016-02-03	原始取得	无
2285	半导体结构的形成方法	ZL201210241509.6	中芯上海	2012-07-12	2016-08-10	原始取得	无
2286	硅通孔封装结构及形成方法	ZL201210241511.3	中芯上海	2012-07-12	2016-02-17	原始取得	无
2287	晶体管和晶体管的形成方法	ZL201210241515.1	中芯上海	2012-07-12	2015-12-09	原始取得	无
2288	半导体检测结构及检测方法	ZL201210241516.6	中芯上海	2012-07-12	2016-01-06	原始取得	无
2289	形成 CMOS 器件的方法	ZL201210241586.1	中芯上海	2012-07-12	2016-01-06	原始取得	无
2290	静电放电保护电路	ZL201210241828.7	中芯上海	2012-07-12	2016-03-16	原始取得	无
2291	CMOS 器件及其制作方法	ZL201210241829.1	中芯上海	2012-07-12	2016-06-29	原始取得	无
2292	金属栅极、其形成方法及 CMOS 晶体管	ZL201210243490.9	中芯上海	2012-07-13	2017-03-01	原始取得	无
2293	金属互连线的制造方法	ZL201210243500.9	中芯上海	2012-07-13	2017-04-19	原始取得	无
2294	深度耗尽沟道场效应晶体管	ZL201210243573.8	中芯上海	2012-07-13	2015-12-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	及其制备方法						
2295	一种采用伪栅极制造半导体器件的方法	ZL201210243837.X	中芯上海	2012-07-13	2017-06-13	原始取得	无
2296	一种制造金属栅半导体器件的方法	ZL201210243838.4	中芯上海	2012-07-13	2016-05-25	原始取得	无
2297	一种用于高 k 金属栅极 NMOS 晶体管的测试装置和测试方法	ZL201210243866.6	中芯上海	2012-07-13	2016-03-30	原始取得	无
2298	CMOS 晶体管及其形成方法	ZL201210244015.3	中芯上海	2012-07-13	2017-03-01	原始取得	无
2299	金属塞制备方法及其在相变随机存储器中的应用	ZL201210244021.9	中芯上海	2012-07-13	2016-08-03	原始取得	无
2300	CMOS 管的 PMOS 替代栅极的去除方法	ZL201210244037.X	中芯上海	2012-07-13	2016-11-02	原始取得	无
2301	半导体结构的形成方法	ZL201210253734.1	中芯上海	2012-07-20	2016-07-06	原始取得	无
2302	开口的形成方法	ZL201210253893.1	中芯上海	2012-07-20	2016-04-20	原始取得	无
2303	鳍部、鳍式场效应管及鳍部和鳍式场效应管的形成方法	ZL201210254002.4	中芯上海	2012-07-20	2016-03-16	原始取得	无
2304	多重图形化的掩膜层的形成	ZL201210254222.7	中芯上海	2012-07-20	2017-07-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法、半导体结构						
2305	MOS 器件及其制作方法、CMOS 器件的制作方法	ZL201210254234.X	中芯上海	2012-07-20	2017-03-22	原始取得	无
2306	半导体结构和鳍式场效应管的形成方法、刻蚀装置	ZL201210254236.9	中芯上海	2012-07-20	2016-12-28	原始取得	无
2307	平行金属互连结构的形成方法	ZL201210254239.2	中芯上海	2012-07-20	2016-11-30	原始取得	无
2308	一种 CMOS 图像传感器及其制备方法	ZL201210258467.7	中芯上海	2012-07-24	2016-09-21	原始取得	无
2309	一种用于形成接触孔的方法	ZL201210258506.3	中芯上海	2012-07-24	2016-05-25	原始取得	无
2310	一种用于缩小金属硬掩膜层的关键尺寸的方法	ZL201210258574.X	中芯上海	2012-07-24	2016-12-21	原始取得	无
2311	一种晶体管阈值电压的测试电路	ZL201210258616.X	中芯上海	2012-07-24	2017-05-03	原始取得	无
2312	一种三维集成电路结构的制作方法和三维集成电路结构	ZL201210261929.0	中芯上海	2012-07-26	2016-03-16	原始取得	无
2313	一种用于晶圆可接受度测试的焊垫	ZL201210261931.8	中芯上海	2012-07-26	2016-08-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2314	一种半导体器件的形成方法	ZL201210261932.2	中芯上海	2012-07-26	2016-06-01	原始取得	无
2315	一种半导体器件的制造方法	ZL201210261967.6	中芯上海	2012-07-26	2016-04-27	原始取得	无
2316	形成浅沟槽隔离区的方法	ZL201210261968.0	中芯上海	2012-07-26	2016-08-03	原始取得	无
2317	一种半导体器件的制造方法	ZL201210261969.5	中芯上海	2012-07-26	2016-04-06	原始取得	无
2318	一种制作半导体器件的方法	ZL201210261971.2	中芯上海	2012-07-26	2016-04-06	原始取得	无
2319	一种金属栅半导体器件的制造方法	ZL201210261972.7	中芯上海	2012-07-26	2016-08-03	原始取得	无
2320	一种半导体器件硅通孔的制备方法	ZL201210261979.9	中芯上海	2012-07-26	2016-09-21	原始取得	无
2321	一种半导体器件的形成方法	ZL201210261980.1	中芯上海	2012-07-26	2016-06-01	原始取得	无
2322	一种焊盘结构及其制备方法	ZL201210261996.2	中芯上海	2012-07-26	2017-11-10	原始取得	无
2323	一种半导体器件热载流子寿命的测量方法	ZL201210262027.9	中芯上海	2012-07-26	2017-05-10	原始取得	无
2324	一种高介电金属栅极制造方法	ZL201210262046.1	中芯上海	2012-07-26	2015-12-16	原始取得	无
2325	绿色晶体管、纳米硅铁电存储器及其驱动方法	ZL201210262439.2	中芯上海	2009-10-20	2015-04-01	原始取得	无
2326	形成 FinFET 的方法	ZL201210264522.3	中芯上海	2012-07-27	2015-12-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2327	MOS 晶体管器件及其制造方法	ZL201210264939.X	中芯上海	2012-07-27	2016-08-10	原始取得	无
2328	铝金属栅极的形成方法	ZL201210264971.8	中芯上海	2012-07-27	2016-02-03	原始取得	无
2329	晶体管制造方法	ZL201210265042.9	中芯上海	2012-07-27	2016-09-28	原始取得	无
2330	一种半导体结构及其形成方法	ZL201210265059.4	中芯上海	2012-07-27	2016-03-23	原始取得	无
2331	半导体结构及其形成方法	ZL201210270426.X	中芯上海	2012-07-31	2016-09-28	原始取得	无
2332	实现自对准型双重图形的方法	ZL201210275760.4	中芯上海	2012-08-03	2016-01-06	原始取得	无
2333	CMOS 及其形成方法	ZL201210275789.2	中芯上海	2012-08-03	2017-01-25	原始取得	无
2334	一种半导体器件的制造方法	ZL201210276049.0	中芯上海	2012-08-03	2016-09-21	原始取得	无
2335	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201210276064.5	中芯上海	2012-08-03	2016-04-20	原始取得	无
2336	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201210276076.8	中芯上海	2012-08-03	2016-08-31	原始取得	无
2337	一种金属硅化物半导体的形成方法	ZL201210276233.5	中芯上海	2012-08-03	2017-02-22	原始取得	无
2338	一种半导体器件、集成电路以	ZL201210276375.1	中芯上海	2012-08-06	2016-05-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	及它们的制造方法和电子装置						
2339	一种掩膜版的光学临近修正方法	ZL201210279039.2	中芯上海	2012-08-07	2016-07-06	原始取得	无
2340	一种半导体器件的漏电测试结构及测试方法	ZL201210279111.1	中芯上海	2012-08-07	2016-04-06	原始取得	无
2341	一种闪存隧道氧化层的制备方法	ZL201210279231.1	中芯上海	2012-08-07	2017-04-05	原始取得	无
2342	一种 CMOS 图像传感器及其制备方法	ZL201210279610.0	中芯上海	2012-08-07	2017-05-10	原始取得	无
2343	形成鳍部的方法和形成鳍式场效应晶体管的方法	ZL201210287328.7	中芯上海	2012-08-13	2016-03-16	原始取得	无
2344	半导体器件的形成方法	ZL201210287337.6	中芯上海	2012-08-13	2016-12-21	原始取得	无
2345	光学邻近修正方法	ZL201210287339.5	中芯上海	2012-08-13	2016-08-10	原始取得	无
2346	一种双重图形化方法	ZL201210287344.6	中芯上海	2012-08-13	2016-05-25	原始取得	无
2347	一种形成双镶嵌结构的方法	ZL201210287350.1	中芯上海	2012-08-13	2016-09-21	原始取得	无
2348	相变存储器及其形成方法	ZL201210287381.7	中芯上海	2012-08-13	2016-03-16	原始取得	无
2349	鳍式场效应晶体管及其制造	ZL201210287382.1	中芯上海	2012-08-13	2017-02-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
2350	CDSEM 校准方法	ZL201210287385.5	中芯上海	2012-08-13	2016-08-10	原始取得	无
2351	一种半导体器件的电可编程熔丝结构	ZL201210287397.8	中芯上海	2012-08-13	2016-04-27	原始取得	无
2352	一种半导体器件的制造方法	ZL201210289041.8	中芯上海	2012-08-14	2016-06-08	原始取得	无
2353	LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL201210289301.1	中芯上海	2012-08-14	2016-12-28	原始取得	无
2354	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201210289305.X	中芯上海	2012-08-14	2016-06-29	原始取得	无
2355	双重图形化方法	ZL201210289337.X	中芯上海	2012-08-14	2016-05-25	原始取得	无
2356	一种晶体管及其形成方法	ZL201210290638.4	中芯上海	2012-08-15	2018-02-09	原始取得	无
2357	集成电路中介质击穿可靠性分析的测试结构及其测试方法	ZL201210290647.3	中芯上海	2012-08-15	2016-07-06	原始取得	无
2358	半导体器件及其制造方法	ZL201210290649.2	中芯上海	2012-08-15	2016-08-10	原始取得	无
2359	三维晶体管的制造方法	ZL201210290687.8	中芯上海	2012-08-15	2016-06-01	原始取得	无
2360	增进沟道阈值电压稳定性的方法	ZL201210290691.4	中芯上海	2012-08-15	2016-05-11	原始取得	无
2361	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210291299.1	中芯上海	2012-08-16	2017-04-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2362	一种半导体器件的形成方法	ZL201210291312.3	中芯上海	2012-08-16	2017-04-05	原始取得	无
2363	去除高剂量离子注入后的光刻胶层的方法	ZL201210292492.7	中芯上海	2012-08-16	2016-08-03	原始取得	无
2364	一种半导体器件的形成方法	ZL201210292495.0	中芯上海	2012-08-16	2016-12-21	原始取得	无
2365	一种半导体器件的制造方法	ZL201210292591.5	中芯上海	2012-08-16	2016-11-30	原始取得	无
2366	一种半导体器件的制造方法	ZL201210292719.8	中芯上海	2012-08-16	2016-07-06	原始取得	无
2367	一种半导体器件的制造方法	ZL201210292727.2	中芯上海	2012-08-16	2016-06-08	原始取得	无
2368	一种光学邻近修正的焦平面选择方法	ZL201210297030.4	中芯上海	2012-08-20	2016-08-31	原始取得	无
2369	离子注入的方法	ZL201210297036.1	中芯上海	2012-08-20	2016-02-17	原始取得	无
2370	互补型金属氧化物半导体管的形成方法	ZL201210299231.8	中芯上海	2012-08-21	2016-02-17	原始取得	无
2371	MOS 晶体管的形成方法	ZL201210299232.2	中芯上海	2012-08-21	2016-01-06	原始取得	无
2372	化学机械抛光装置及化学机械抛光的方法	ZL201210299234.1	中芯上海	2012-08-21	2016-04-20	原始取得	无
2373	一种半导体结构的形成方法	ZL201210299446.X	中芯上海	2012-08-21	2016-03-16	原始取得	无
2374	半导体器件的形成方法、晶体管的形成方法	ZL201210299450.6	中芯上海	2012-08-21	2016-02-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2375	晶体管及其形成方法	ZL201210299452.5	中芯上海	2012-08-21	2016-10-05	原始取得	无
2376	硅通孔封装结构的形成方法	ZL201210299744.9	中芯上海	2012-08-21	2016-06-29	原始取得	无
2377	一种晶片的单片清洗方法	ZL201210303055.0	中芯上海	2012-08-23	2015-11-25	原始取得	无
2378	一种半导体器件的制造方法	ZL201210303059.9	中芯上海	2012-08-23	2016-05-11	原始取得	无
2379	一种半导体器件的制造方法	ZL201210303540.8	中芯上海	2012-08-23	2016-12-21	原始取得	无
2380	一种半导体器件的制造方法	ZL201210303558.8	中芯上海	2012-08-23	2016-04-06	原始取得	无
2381	一种形成源漏区双外延层的方法	ZL201210303567.7	中芯上海	2012-08-23	2016-12-21	原始取得	无
2382	一种半导体器件双外延层的形成方法	ZL201210303569.6	中芯上海	2012-08-23	2016-12-21	原始取得	无
2383	形成全包围栅极器件纳米线的方法	ZL201210304030.2	中芯上海	2012-08-23	2016-06-29	原始取得	无
2384	一种用于在 CVD 反应腔体中校准硅片位置的方法	ZL201210307976.4	中芯上海	2012-08-27	2016-09-21	原始取得	无
2385	PMOS 晶体管及其制作方法	ZL201210312944.3	中芯上海	2012-08-29	2017-03-29	原始取得	无
2386	晶体管的形成方法	ZL201210312947.7	中芯上海	2012-08-29	2016-06-29	原始取得	无
2387	半导体结构的形成方法	ZL201210312959.X	中芯上海	2012-08-29	2017-05-31	原始取得	无
2388	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201210312964.0	中芯上海	2012-08-29	2016-05-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
2389	半导体结构及形成方法	ZL201210312974.4	中芯上海	2012-08-29	2016-02-17	原始取得	无
2390	静态随机存取存储器及其存储性能的改善方法	ZL201210312975.9	中芯上海	2012-08-29	2017-03-29	原始取得	无
2391	光学邻近修正方法	ZL201210312992.2	中芯上海	2012-08-29	2016-08-31	原始取得	无
2392	半导体散热结构及其形成方法、半导体芯片	ZL201210312996.0	中芯上海	2012-08-29	2017-02-08	原始取得	无
2393	全硅化物金属栅的形成方法	ZL201210313464.9	中芯上海	2012-08-29	2016-03-16	原始取得	无
2394	半导体结构的形成方法	ZL201210313474.2	中芯上海	2012-08-29	2016-07-06	原始取得	无
2395	半导体结构的形成方法	ZL201210313483.1	中芯上海	2012-08-29	2016-03-16	原始取得	无
2396	互连结构的形成方法	ZL201210313492.0	中芯上海	2012-08-29	2016-03-16	原始取得	无
2397	光学邻近校正模型的校正方法	ZL201210313494.X	中芯上海	2012-08-29	2016-08-31	原始取得	无
2398	芯片测试电路及其形成方法	ZL201210313499.2	中芯上海	2012-08-29	2016-01-06	原始取得	无
2399	MOS 晶体管的制作方法	ZL201210316623.0	中芯上海	2012-08-30	2016-12-21	原始取得	无
2400	选择性形成高 K 介质层的方法	ZL201210321917.2	中芯上海	2012-09-03	2016-06-29	原始取得	无
2401	金属栅极的形成方法	ZL201210322184.4	中芯上海	2012-09-03	2016-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2402	一种对掩膜版图形进行曝光的方法	ZL201210322267.3	中芯上海	2012-09-03	2016-04-27	原始取得	无
2403	一种半导体器件的制造方法	ZL201210322628.4	中芯上海	2012-09-04	2016-04-27	原始取得	无
2404	一种鳍片场效应晶体管的制备方法	ZL201210323840.2	中芯上海	2012-09-04	2016-08-03	原始取得	无
2405	一种半导体器件的制备方法	ZL201210323854.4	中芯上海	2012-09-04	2018-03-20	原始取得	无
2406	一种半导体器件结构及其制作方法	ZL201210324133.5	中芯上海	2012-09-04	2016-05-25	原始取得	无
2407	一种半导体器件的制造方法	ZL201210324163.6	中芯上海	2012-09-04	2017-02-01	原始取得	无
2408	一种浅沟槽隔离结构及其制作方法	ZL201210324178.2	中芯上海	2012-09-04	2017-05-10	原始取得	无
2409	一种半导体器件的制造方法	ZL201210324637.7	中芯上海	2012-09-04	2017-06-13	原始取得	无
2410	提高金属前介质层空隙填充能力的方法	ZL201210324712.X	中芯上海	2012-09-05	2016-03-30	原始取得	无
2411	半导体器件精细图案的制作方法	ZL201210325783.1	中芯上海	2012-09-05	2017-07-28	原始取得	无
2412	CMOS 管的形成方法	ZL201210328206.8	中芯上海	2012-09-06	2016-01-06	原始取得	无
2413	一种半导体结构及其形成方	ZL201210328441.5	中芯上海	2012-09-06	2017-02-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
2414	金属栅极制作方法	ZL201210328443.4	中芯上海	2012-09-06	2018-04-27	原始取得	无
2415	沟槽隔离结构及其制作方法	ZL201210328477.3	中芯上海	2012-09-06	2016-11-23	原始取得	无
2416	互连电迁移的测试结构	ZL201210328711.2	中芯上海	2012-09-06	2016-08-03	原始取得	无
2417	机械性刮伤检测的方法	ZL201210328713.1	中芯上海	2012-09-06	2016-05-04	原始取得	无
2418	一种超厚金属层制作方法	ZL201210330647.1	中芯上海	2012-09-07	2017-03-22	原始取得	无
2419	带有自对准接触孔的半导体器件及其制备方法	ZL201210330895.6	中芯上海	2012-09-07	2017-11-14	原始取得	无
2420	鳍部及其形成方法	ZL201210332967.0	中芯上海	2012-09-10	2016-03-16	原始取得	无
2421	半导体检测结构及形成方法	ZL201210332980.6	中芯上海	2012-09-10	2016-03-16	原始取得	无
2422	有源区的离子注入方法	ZL201210332986.3	中芯上海	2012-09-10	2016-12-21	原始取得	无
2423	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210332988.2	中芯上海	2012-09-10	2016-06-29	原始取得	无
2424	自对准双重图形化方法	ZL201210333003.8	中芯上海	2012-09-10	2016-04-20	原始取得	无
2425	自对准双重图形的形成方法	ZL201210333005.7	中芯上海	2012-09-10	2016-03-16	原始取得	无
2426	晶体管的形成方法、半导体器件的形成方法	ZL201210333018.4	中芯上海	2012-09-10	2016-03-16	原始取得	无
2427	一种半导体器件的制造方法	ZL201210335448.X	中芯上海	2012-09-12	2016-03-30	原始取得	无
2428	一种半导体器件的制造方法	ZL201210336453.2	中芯上海	2012-09-12	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2429	一种半导体器件的制造方法	ZL201210336509.4	中芯上海	2012-09-12	2017-08-01	原始取得	无
2430	一种半导体器件的制造方法	ZL201210336591.0	中芯上海	2012-09-12	2017-08-01	原始取得	无
2431	一种半导体器件的制造方法	ZL201210337269.X	中芯上海	2012-09-12	2016-04-27	原始取得	无
2432	一种双大马士革结构的制备方法	ZL201210337282.5	中芯上海	2012-09-12	2016-12-21	原始取得	无
2433	一种形成光刻胶图案的方法及装置	ZL201210337284.4	中芯上海	2012-09-12	2017-03-08	原始取得	无
2434	一种金属硅化物的形成方法	ZL201210337318.X	中芯上海	2012-09-12	2016-09-21	原始取得	无
2435	一种具有高度可控鳍片的半导体器件以及制备方法	ZL201210337320.7	中芯上海	2012-09-12	2016-07-27	原始取得	无
2436	一种半导体器件的制造方法	ZL201210337347.6	中芯上海	2012-09-12	2016-03-30	原始取得	无
2437	光罩装置	ZL201210338681.3	中芯上海	2012-09-13	2016-08-31	原始取得	无
2438	SRAM 的 I/O 电路	ZL201210339320.0	中芯上海	2012-09-13	2016-08-03	原始取得	无
2439	一种 NMOS 阈值电压测量方法	ZL201210339342.7	中芯上海	2012-09-13	2016-03-09	原始取得	无
2440	半导体器件的形成方法	ZL201210348126.9	中芯上海	2012-09-18	2016-08-31	原始取得	无
2441	半导体结构的形成方法	ZL201210348128.8	中芯上海	2012-09-18	2016-02-17	原始取得	无
2442	鳍式场效应晶体管及其形成	ZL201210348131.X	中芯上海	2012-09-18	2016-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
2443	半导体器件的形成方法	ZL201210348133.9	中芯上海	2012-09-18	2016-10-05	原始取得	无
2444	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201210348142.8	中芯上海	2012-09-18	2016-03-16	原始取得	无
2445	刻蚀方法	ZL201210348144.7	中芯上海	2012-09-18	2016-04-20	原始取得	无
2446	金属栅极、MOS 晶体管及 CMOS 结构分别的形成方法	ZL201210348153.6	中芯上海	2012-09-18	2016-08-31	原始取得	无
2447	半导体器件及其制造方法	ZL201210349744.5	中芯上海	2012-09-18	2016-06-08	原始取得	无
2448	互连结构的制作方法	ZL201210349798.1	中芯上海	2012-09-18	2016-03-16	原始取得	无
2449	埋层的形成方法	ZL201210349799.6	中芯上海	2012-09-18	2016-08-10	原始取得	无
2450	3DNAND 存储器以及制作方法	ZL201210349821.7	中芯上海	2012-09-18	2017-05-31	原始取得	无
2451	半导体器件及其制造方法	ZL201210350791.1	中芯上海	2012-09-19	2016-08-10	原始取得	无
2452	半导体装置及其制造方法	ZL201210351667.7	中芯上海	2012-09-20	2017-02-08	原始取得	无
2453	一种监控弱点形成原因的方法	ZL201210353296.6	中芯上海	2012-09-20	2015-11-25	原始取得	无
2454	一种半导体器件的制造方法	ZL201210356058.0	中芯上海	2012-09-20	2017-02-01	原始取得	无
2455	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210356066.5	中芯上海	2012-09-20	2017-04-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2456	一种半导体器件的制造方法	ZL201210356068.4	中芯上海	2012-09-20	2016-06-01	原始取得	无
2457	一种半导体器件的制造方法	ZL201210356070.1	中芯上海	2012-09-20	2016-08-03	原始取得	无
2458	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210356107.0	中芯上海	2012-09-20	2017-02-01	原始取得	无
2459	一种源漏双外延层的形成方法	ZL201210356120.6	中芯上海	2012-09-20	2016-08-31	原始取得	无
2460	一种晶体管阈值电压的测试电路	ZL201210356131.4	中芯上海	2012-09-20	2016-12-21	原始取得	无
2461	一种 PMOS 源漏的形成方法	ZL201210356135.2	中芯上海	2012-09-20	2016-06-01	原始取得	无
2462	一种磁随机存取存储器及其制造方法	ZL201210356158.3	中芯上海	2012-09-20	2016-08-03	原始取得	无
2463	半导体器件及其制造方法	ZL201210358628.X	中芯上海	2012-09-24	2016-12-21	原始取得	无
2464	一种导电沟道制作方法	ZL201210361835.0	中芯上海	2012-09-25	2017-03-29	原始取得	无
2465	一种化学机械研磨方法、模块及装置	ZL201210361846.9	中芯上海	2012-09-25	2016-06-15	原始取得	无
2466	low-k 芯片的封装结构及其制造方法	ZL201210362067.0	中芯上海	2012-09-25	2016-08-03	原始取得	无
2467	硅化物的形成方法	ZL201210364884.X	中芯上海	2012-09-26	2016-08-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2468	半导体器件及其形成方法	ZL201210364952.2	中芯上海	2012-09-26	2016-12-21	原始取得	无
2469	半导体结构及其制作方法	ZL201210365175.3	中芯上海	2012-09-26	2016-08-31	原始取得	无
2470	双重图形化膜层的方法	ZL201210365182.3	中芯上海	2012-09-26	2016-08-10	原始取得	无
2471	晶体管及其形成方法	ZL201210365187.6	中芯上海	2012-09-26	2016-05-25	原始取得	无
2472	晶体管的形成方法	ZL201210365223.9	中芯上海	2012-09-26	2016-07-06	原始取得	无
2473	半导体器件的形成方法以及 MOS 晶体管的形成方法	ZL201210365225.8	中芯上海	2012-09-26	2016-11-23	原始取得	无
2474	TEM 样品的制备方法	ZL201210375596.4	中芯上海	2012-09-27	2016-09-28	原始取得	无
2475	自对准双重图形的形成方法	ZL201210378503.3	中芯上海	2012-09-29	2016-08-10	原始取得	无
2476	鳍式场效应晶体管及其制造方法	ZL201210378505.2	中芯上海	2012-09-29	2016-12-21	原始取得	无
2477	晶体管及晶体管的形成方法	ZL201210378506.7	中芯上海	2012-09-29	2016-08-10	原始取得	无
2478	晶体管的形成方法	ZL201210378716.6	中芯上海	2012-09-29	2016-06-29	原始取得	无
2479	晶体管及其形成方法	ZL201210378719.X	中芯上海	2012-09-29	2018-05-01	原始取得	无
2480	金属互连结构的形成方法	ZL201210378741.4	中芯上海	2012-09-29	2017-12-01	原始取得	无
2481	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201210378742.9	中芯上海	2012-09-29	2016-01-06	原始取得	无
2482	NOR 快闪存储器的形成方法	ZL201210378745.2	中芯上海	2012-09-29	2017-07-14	原始取得	无
2483	MOS 管及其形成方法	ZL201210379976.5	中芯上海	2012-09-29	2016-08-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2484	半导体器件及其形成方法	ZL201210379979.9	中芯上海	2012-09-29	2016-05-25	原始取得	无
2485	一种形成接触孔的方法	ZL201210382820.2	中芯上海	2012-10-10	2016-08-03	原始取得	无
2486	一种半导体器件的制造方法	ZL201210382865.X	中芯上海	2012-10-10	2016-06-08	原始取得	无
2487	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210382954.4	中芯上海	2012-10-10	2016-08-31	原始取得	无
2488	一种半导体器件结构及其制作方法	ZL201210383005.8	中芯上海	2012-10-10	2016-08-03	原始取得	无
2489	一种化学机械研磨方法及装置	ZL201210384562.1	中芯上海	2012-10-11	2016-10-05	原始取得	无
2490	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210384567.4	中芯上海	2012-10-11	2017-06-16	原始取得	无
2491	一种浅沟槽隔离的制作方法	ZL201210385109.2	中芯上海	2012-10-11	2016-11-30	原始取得	无
2492	铜连线结构及其形成方法	ZL201210385133.6	中芯上海	2012-10-11	2018-03-06	原始取得	无
2493	半导体结构及其形成方法、SRAM 存储单元、SRAM 存储器	ZL201210393117.1	中芯上海	2012-10-16	2017-12-01	原始取得	无
2494	导电栓塞及导电栓塞的形成方法	ZL201210393120.3	中芯上海	2012-10-16	2016-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2495	键合工具的检测方法	ZL201210393136.4	中芯上海	2012-10-16	2016-08-31	原始取得	无
2496	半导体器件的制作方法、清洗方法和清洗系统	ZL201210393608.6	中芯上海	2012-10-16	2016-12-28	原始取得	无
2497	一种半导体器件的制造方法	ZL201210396670.0	中芯上海	2012-10-18	2017-02-01	原始取得	无
2498	一种 SOI 半导体氧化物晶体管及其制作方法	ZL201210398041.1	中芯上海	2012-10-18	2016-08-31	原始取得	无
2499	一种用于接触孔图形设计的光学邻近修正的方法	ZL201210398044.5	中芯上海	2012-10-18	2017-03-08	原始取得	无
2500	读取晶圆标识的方法及晶圆标识读取装置	ZL201210398528.X	中芯上海	2012-10-18	2018-01-12	原始取得	无
2501	GOI 测试电路结构	ZL201210398529.4	中芯上海	2012-10-18	2016-09-21	原始取得	无
2502	SRAM 的存储单元	ZL201210398530.7	中芯上海	2012-10-18	2017-03-15	原始取得	无
2503	IMD 测量电路结构和 IMD 性能测试方法	ZL201210398546.8	中芯上海	2012-10-18	2017-03-15	原始取得	无
2504	一种半导体器件的测试结构及其测试方法	ZL201210398728.5	中芯上海	2012-10-18	2016-08-31	原始取得	无
2505	一种半导体器件制备过程的监控系统及方法	ZL201210398775.X	中芯上海	2012-10-18	2016-11-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2506	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210398804.2	中芯上海	2012-10-18	2016-09-21	原始取得	无
2507	半导体器件及其制造方法	ZL201210398918.7	中芯上海	2012-10-19	2016-09-07	原始取得	无
2508	一种半导体器件的制造方法	ZL201210398958.1	中芯上海	2012-10-18	2016-08-03	原始取得	无
2509	一种半导体器件的制造方法	ZL201210398960.9	中芯上海	2012-10-18	2017-06-13	原始取得	无
2510	一种基于双图案的半导体器件的制造方法	ZL201210399295.5	中芯上海	2012-10-18	2016-08-31	原始取得	无
2511	一种基于自对准双图案的半导体器件的制造方法	ZL201210399303.6	中芯上海	2012-10-18	2017-03-08	原始取得	无
2512	一种半导体器件的制备方法	ZL201210399305.5	中芯上海	2012-10-18	2016-09-21	原始取得	无
2513	半导体器件及其制造方法	ZL201210406039.4	中芯上海	2012-10-23	2017-10-31	原始取得	无
2514	半导体器件及半导体器件的制造方法	ZL201210406251.0	中芯上海	2012-10-22	2016-08-31	原始取得	无
2515	半导体器件及其形成方法	ZL201210406263.3	中芯上海	2012-10-22	2016-04-20	原始取得	无
2516	相变存储单元的制作方法	ZL201210413488.1	中芯上海	2012-10-25	2017-07-28	原始取得	无
2517	一种半导体结构的形成方法	ZL201210413489.6	中芯上海	2012-10-25	2017-03-01	原始取得	无
2518	一种 OPC 方法以及制备掩膜版的方法	ZL201210413530.X	中芯上海	2012-10-25	2017-02-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2519	纳米线的制造方法	ZL201210413840.1	中芯上海	2012-10-25	2016-08-24	原始取得	无
2520	互连结构中形成图案化金属硬掩膜的方法	ZL201210414625.3	中芯上海	2012-10-26	2016-08-31	原始取得	无
2521	半导体器件主动区失效分析样品的制备方法	ZL201210414644.6	中芯上海	2012-10-26	2016-03-09	原始取得	无
2522	等离子体引入损伤检测结构及制作方法	ZL201210414665.8	中芯上海	2012-10-25	2016-09-07	原始取得	无
2523	TEM 样品的制备方法	ZL201210414676.6	中芯上海	2012-10-26	2016-08-03	原始取得	无
2524	一种半导体器件的制造方法	ZL201210415041.8	中芯上海	2012-10-26	2017-09-01	原始取得	无
2525	一种半导体器件的制造方法	ZL201210415044.1	中芯上海	2012-10-26	2016-08-31	原始取得	无
2526	一种半导体器件的制造方法	ZL201210415061.5	中芯上海	2012-10-26	2016-08-03	原始取得	无
2527	高介电层金属栅器件的制造方法	ZL201210415303.0	中芯上海	2012-10-26	2017-07-28	原始取得	无
2528	半导体器件的制作方法	ZL201210417953.9	中芯上海	2012-10-26	2016-04-06	原始取得	无
2529	标准晶片及其制造方法	ZL201210419099.X	中芯上海	2012-10-29	2016-08-10	原始取得	无
2530	一种制作金属互连线的方法	ZL201210419391.1	中芯上海	2012-10-29	2016-03-30	原始取得	无
2531	一种低介电常数层的制作方法	ZL201210419650.0	中芯上海	2012-10-29	2019-05-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2532	一种制作金属栅极的方法	ZL201210420931.8	中芯上海	2012-10-29	2016-12-21	原始取得	无
2533	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210422103.8	中芯上海	2012-10-29	2017-08-01	原始取得	无
2534	一种半导体器件的制造方法	ZL201210422123.5	中芯上海	2012-10-29	2016-08-03	原始取得	无
2535	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210422156.X	中芯上海	2012-10-29	2016-06-08	原始取得	无
2536	一种半导体器件的制造方法	ZL201210422159.3	中芯上海	2012-10-29	2016-06-01	原始取得	无
2537	高 k 金属栅极结构及其制造方法	ZL201210422214.9	中芯上海	2012-10-30	2016-10-05	原始取得	无
2538	一种对具有低图像对比度的图形进行光学邻近修正的方法	ZL201210422410.6	中芯上海	2012-10-29	2017-03-08	原始取得	无
2539	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210422427.1	中芯上海	2012-10-29	2016-12-21	原始取得	无
2540	一种热电散热装置	ZL201210422441.1	中芯上海	2012-10-29	2016-12-21	原始取得	无
2541	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210422474.6	中芯上海	2012-10-29	2017-04-05	原始取得	无
2542	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201210422891.0	中芯上海	2012-10-30	2017-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2543	自对准三重图形化方法	ZL201210422892.5	中芯上海	2012-10-30	2016-10-05	原始取得	无
2544	金属栅极的形成方法	ZL201210422991.3	中芯上海	2012-10-30	2016-10-05	原始取得	无
2545	半导体衬底的形成方法	ZL201210423009.4	中芯上海	2012-10-30	2016-06-29	原始取得	无
2546	晶体管及其形成方法	ZL201210424653.3	中芯上海	2012-10-30	2016-07-06	原始取得	无
2547	晶体管及其形成方法	ZL201210424660.3	中芯上海	2012-10-30	2016-08-31	原始取得	无
2548	具有金属栅极的半导体器件的制作方法	ZL201210424674.5	中芯上海	2012-10-30	2016-12-21	原始取得	无
2549	具有接地屏蔽结构的半导体器件	ZL201210425591.8	中芯上海	2012-10-30	2016-10-05	原始取得	无
2550	自对准三重图形的形成方法	ZL201210425609.4	中芯上海	2012-10-30	2017-09-22	原始取得	无
2551	自对准双图形的形成方法	ZL201210425630.4	中芯上海	2012-10-30	2017-02-22	原始取得	无
2552	晶体管的形成方法	ZL201210425644.6	中芯上海	2012-10-30	2016-04-20	原始取得	无
2553	晶体管的形成方法	ZL201210425656.9	中芯上海	2012-10-30	2017-02-22	原始取得	无
2554	监测扫描电子显微镜的电子束状态的方法和装置	ZL201210427489.1	中芯上海	2012-10-31	2016-03-16	原始取得	无
2555	局域互连结构的形成方法	ZL201210428518.6	中芯上海	2012-10-31	2016-02-17	原始取得	无
2556	半导体结构的形成方法	ZL201210428527.5	中芯上海	2012-10-31	2016-08-10	原始取得	无
2557	电互连结构的形成方法	ZL201210429412.8	中芯上海	2012-10-31	2016-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2558	隔离结构及其形成方法	ZL201210429603.4	中芯上海	2012-10-31	2018-07-10	原始取得	无
2559	提供化学物品的控制系统	ZL201210434971.8	中芯上海	2012-11-02	2016-11-02	原始取得	无
2560	TEM 样品的制备方法	ZL201210435237.3	中芯上海	2012-11-02	2016-04-20	原始取得	无
2561	负偏压温度不稳定性检测电路及其检测方法	ZL201210435238.8	中芯上海	2012-11-02	2016-08-03	原始取得	无
2562	GOI_TDDB 测试电路结构	ZL201210442011.6	中芯上海	2012-11-07	2016-10-05	原始取得	无
2563	电迁移测试结构	ZL201210442014.X	中芯上海	2012-11-07	2016-07-06	原始取得	无
2564	晶圆背面金属化的方法	ZL201210442362.7	中芯上海	2012-11-07	2016-08-03	原始取得	无
2565	产品缺陷检测方法	ZL201210442363.1	中芯上海	2012-11-07	2016-06-15	原始取得	无
2566	非易失性存储器的钳位电路	ZL201210442460.0	中芯上海	2012-11-08	2016-08-31	原始取得	无
2567	透射电子显微镜样品的制作方法	ZL201210444665.2	中芯上海	2012-11-08	2017-02-15	原始取得	无
2568	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210445624.5	中芯上海	2012-11-08	2016-08-31	原始取得	无
2569	一种半导体器件的制造方法	ZL201210445650.8	中芯上海	2012-11-08	2017-02-22	原始取得	无
2570	一种半导体器件的制造方法	ZL201210445671.X	中芯上海	2012-11-08	2017-06-13	原始取得	无
2571	一种半导体器件及其制备方法	ZL201210445686.6	中芯上海	2012-11-08	2016-12-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2572	一种形成高 k 金属栅极的方法	ZL201210445689.X	中芯上海	2012-11-08	2018-06-08	原始取得	无
2573	一种半导体器件的制备方法	ZL201210445692.1	中芯上海	2012-11-08	2016-12-21	原始取得	无
2574	一种芯片失效点定位方法	ZL201210445693.6	中芯上海	2012-11-08	2017-02-08	原始取得	无
2575	一种结型场效应晶体管及其制备方法	ZL201210445716.3	中芯上海	2012-11-08	2016-12-21	原始取得	无
2576	半导体结构及其形成方法	ZL201210454418.0	中芯上海	2012-11-13	2016-03-16	原始取得	无
2577	晶体管的形成方法	ZL201210454774.2	中芯上海	2012-11-13	2018-03-06	原始取得	无
2578	形成焊垫的方法	ZL201210454789.9	中芯上海	2012-11-13	2016-03-16	原始取得	无
2579	鳍式场效应管的形成方法	ZL201210454797.3	中芯上海	2012-11-13	2016-08-31	原始取得	无
2580	MOS 器件及其形成方法	ZL201210454951.7	中芯上海	2012-11-13	2018-03-09	原始取得	无
2581	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201210454954.0	中芯上海	2012-11-13	2016-05-25	原始取得	无
2582	鳍式场效应管的形成方法	ZL201210454955.5	中芯上海	2012-11-13	2016-12-21	原始取得	无
2583	存储器件的形成方法	ZL201210455016.2	中芯上海	2012-11-13	2016-07-06	原始取得	无
2584	扫描电镜的电子束的检测方法、微细图形的检测方法	ZL201210455060.3	中芯上海	2012-11-13	2016-01-06	原始取得	无
2585	电迁移测试结构及测试方法	ZL201210460884.X	中芯上海	2012-11-15	2017-03-15	原始取得	无
2586	集成电路中可靠性分析的测试结构及其测试方法	ZL201210465725.9	中芯上海	2012-11-16	2016-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2587	掩膜版及对其进行缺陷检测的方法	ZL201210465858.6	中芯上海	2012-11-16	2016-09-07	原始取得	无
2588	去除封装结构的方法	ZL201210466450.0	中芯上海	2012-11-16	2017-12-05	原始取得	无
2589	TEM 样品制备方法	ZL201210466615.4	中芯上海	2012-11-16	2016-06-29	原始取得	无
2590	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210475974.6	中芯上海	2012-11-21	2016-12-21	原始取得	无
2591	一种半导体器件的制造方法	ZL201210476462.1	中芯上海	2012-11-21	2016-09-21	原始取得	无
2592	鳍式场效应晶体管芯片及其制造方法	ZL201210476465.5	中芯上海	2012-11-21	2017-02-22	原始取得	无
2593	一种半导体器件的制造方法	ZL201210476677.3	中芯上海	2012-11-21	2017-09-08	原始取得	无
2594	一种半导体器件的制造方法	ZL201210476904.2	中芯上海	2012-11-21	2017-05-10	原始取得	无
2595	自对准双重图形的形成方法	ZL201210477219.1	中芯上海	2012-11-21	2017-06-09	原始取得	无
2596	半导体精细图案的形成方法	ZL201210477231.2	中芯上海	2012-11-21	2016-05-25	原始取得	无
2597	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201210477234.6	中芯上海	2012-11-21	2017-05-17	原始取得	无
2598	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201210477241.6	中芯上海	2012-11-21	2016-12-21	原始取得	无
2599	NMOS 晶体管的形成方法	ZL201210477286.3	中芯上海	2012-11-21	2017-09-26	原始取得	无
2600	金属互连结构及其制作方法	ZL201210477288.2	中芯上海	2012-11-21	2016-04-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2601	集成电路 SPICE 模型中的应力影响模型的优化	ZL201210480135.3	中芯上海	2012-11-23	2017-03-29	原始取得	无
2602	电极的制造方法、熔丝装置及其制造方法	ZL201210483777.9	中芯上海	2012-11-23	2018-09-14	原始取得	无
2603	半导体器件及其制造方法	ZL201210483778.3	中芯上海	2012-11-23	2016-12-21	原始取得	无
2604	关键尺寸的测量方法	ZL201210484767.7	中芯上海	2012-11-23	2016-09-28	原始取得	无
2605	图形检测方法	ZL201210484780.2	中芯上海	2012-11-23	2017-09-26	原始取得	无
2606	半导体器件的形成方法及检测方法	ZL201210485213.9	中芯上海	2012-11-23	2016-05-11	原始取得	无
2607	激光退火装置及退火方法	ZL201210485215.8	中芯上海	2012-11-23	2016-09-28	原始取得	无
2608	MIM 电容及其形成方法	ZL201210492190.4	中芯上海	2012-11-27	2017-08-25	原始取得	无
2609	晶体管及其制造方法	ZL201210492206.1	中芯上海	2012-11-27	2016-08-31	原始取得	无
2610	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201210492207.6	中芯上海	2012-11-27	2017-08-25	原始取得	无
2611	晶体管的形成方法	ZL201210492208.0	中芯上海	2012-11-27	2016-12-28	原始取得	无
2612	相变存储器的制作方法	ZL201210492209.5	中芯上海	2012-11-27	2016-04-20	原始取得	无
2613	相变存储器的制作方法	ZL201210492217.X	中芯上海	2012-11-27	2017-05-17	原始取得	无
2614	半导体测试结构及其测试方	ZL201210492219.9	中芯上海	2012-11-27	2017-06-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、检测方法						
2615	MOS 晶体管的外部寄生电阻的测量方法	ZL201210492232.4	中芯上海	2012-11-27	2016-05-25	原始取得	无
2616	半导体结构及其形成方法	ZL201210492655.6	中芯上海	2012-11-27	2016-12-21	原始取得	无
2617	半导体结构的形成方法	ZL201210492711.6	中芯上海	2012-11-27	2017-07-14	原始取得	无
2618	焊垫结构及其制作方法	ZL201210492714.X	中芯上海	2012-11-27	2017-07-14	原始取得	无
2619	半导体器件及其制作方法	ZL201210492739.X	中芯上海	2012-11-27	2016-05-25	原始取得	无
2620	半导体器件及其制作方法	ZL201210492757.8	中芯上海	2012-11-27	2017-08-25	原始取得	无
2621	相变存储器、其底部接触结构及其各自制作方法	ZL201210492760.X	中芯上海	2012-11-27	2016-06-29	原始取得	无
2622	参数控制方法和参数控制系统	ZL201210492770.3	中芯上海	2012-11-27	2016-12-21	原始取得	无
2623	晶体管的形成方法	ZL201210496331.X	中芯上海	2012-11-28	2016-06-29	原始取得	无
2624	晶圆刻蚀后的清洗方法	ZL201210496738.2	中芯上海	2012-11-28	2017-05-17	原始取得	无
2625	一种半导体器件的制造方法	ZL201210513184.2	中芯上海	2012-12-04	2016-09-21	原始取得	无
2626	一种横向扩散半导体器件	ZL201210513695.4	中芯上海	2012-12-04	2018-10-23	原始取得	无
2627	一种半导体器件的制造方法	ZL201210513725.1	中芯上海	2012-12-04	2017-02-22	原始取得	无
2628	一种半导体器件的制造方法	ZL201210513750.X	中芯上海	2012-12-04	2016-09-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2629	一种半导体器件的制备方法	ZL201210513831.X	中芯上海	2012-12-04	2016-08-31	原始取得	无
2630	薄膜沉积方法和半导体器件	ZL201210513885.6	中芯上海	2012-12-04	2018-05-01	原始取得	无
2631	纳米线的制造方法、纳米线场效应晶体管的制造方法	ZL201210513894.5	中芯上海	2012-12-04	2016-10-05	原始取得	无
2632	闪存的存储单元的形成方法	ZL201210513903.0	中芯上海	2012-12-04	2017-05-17	原始取得	无
2633	相变存储器及其形成方法	ZL201210513905.X	中芯上海	2012-12-04	2017-03-29	原始取得	无
2634	MOS 晶体管测试电路及对应的测试方法	ZL201210513912.X	中芯上海	2012-12-04	2016-04-20	原始取得	无
2635	刻蚀条件的采集方法	ZL201210513915.3	中芯上海	2012-12-04	2016-08-10	原始取得	无
2636	一种 FinFET 器件的制造方法	ZL201210514156.2	中芯上海	2012-12-04	2017-04-05	原始取得	无
2637	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201210514534.7	中芯上海	2012-12-04	2016-06-29	原始取得	无
2638	伪栅的形成方法、选择性沉积硅的方法和插塞的形成方法	ZL201210514547.4	中芯上海	2012-12-04	2017-08-25	原始取得	无
2639	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201210514550.6	中芯上海	2012-12-04	2017-06-13	原始取得	无
2640	一种电可编程熔丝结构及其制备方法	ZL201210514582.6	中芯上海	2012-12-04	2016-09-21	原始取得	无
2641	NMOS 晶体管及其制作方法	ZL201210516329.4	中芯上海	2012-12-05	2017-06-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2642	断面测试结构	ZL201210526016.7	中芯上海	2012-12-07	2017-04-05	原始取得	无
2643	晶体管结构及其形成方法	ZL201210526017.1	中芯上海	2012-12-07	2016-09-07	原始取得	无
2644	振荡器自动校准装置及其校对方法	ZL201210526391.1	中芯上海	2012-12-07	2016-11-23	原始取得	无
2645	制备半导体失效分析样品的方法	ZL201210526393.0	中芯上海	2012-12-07	2016-12-28	原始取得	无
2646	灯具拆装工具及方法	ZL201210526394.5	中芯上海	2012-12-07	2016-08-03	原始取得	无
2647	半导体测试结构、其测试方法及其制造方法	ZL201210526395.X	中芯上海	2012-12-07	2016-09-07	原始取得	无
2648	光罩及其设计方法	ZL201210529178.6	中芯上海	2012-12-10	2017-03-29	原始取得	无
2649	可用于 PID 与 ILD 测试的测试结构及晶圆	ZL201210530102.5	中芯上海	2012-12-11	2017-02-15	原始取得	无
2650	静电放电保护电路的制作方法	ZL201210530228.2	中芯上海	2012-12-11	2016-04-06	原始取得	无
2651	一种相移掩膜在二次曝光中侧蚀宽度安全范围的确定方法	ZL201210533032.9	中芯上海	2012-12-11	2017-11-24	原始取得	无
2652	一种 MOS 晶体管阵列栅氧化	ZL201210533034.8	中芯上海	2012-12-11	2016-09-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	层完整性测试结构						
2653	激光退火设备和方法	ZL201210533375.5	中芯上海	2012-12-12	2016-08-10	原始取得	无
2654	光刻系统以及光刻方法	ZL201210537189.9	中芯上海	2012-12-13	2016-03-16	原始取得	无
2655	半导体装置及其制造方法	ZL201210545982.3	中芯上海	2012-12-17	2016-09-28	原始取得	无
2656	互连结构及其制造方法	ZL201210548617.8	中芯上海	2012-12-17	2017-11-03	原始取得	无
2657	互连结构及其制造方法	ZL201210550003.3	中芯上海	2012-12-17	2017-08-25	原始取得	无
2658	鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201210552970.3	中芯上海	2012-12-18	2016-12-28	原始取得	无
2659	电可编程熔丝结构	ZL201210552992.X	中芯上海	2012-12-18	2016-08-31	原始取得	无
2660	鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201210552994.9	中芯上海	2012-12-18	2016-08-10	原始取得	无
2661	晶体管的形成方法	ZL201210552997.2	中芯上海	2012-12-18	2017-12-01	原始取得	无
2662	金属栅极的形成方法	ZL201210553000.5	中芯上海	2012-12-18	2016-08-31	原始取得	无
2663	沟槽填充方法	ZL201210553011.3	中芯上海	2012-12-18	2016-07-06	原始取得	无
2664	半导体结构及其形成方法	ZL201210553015.1	中芯上海	2012-12-18	2017-11-03	原始取得	无
2665	PMOS 晶体管、NMOS 晶体管及其各自的制作方法	ZL201210553265.5	中芯上海	2012-12-18	2016-10-05	原始取得	无
2666	互连结构及其制造方法	ZL201210553292.2	中芯上海	2012-12-18	2017-12-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2667	半导体器件的形成方法	ZL201210553295.6	中芯上海	2012-12-18	2017-09-26	原始取得	无
2668	半导体器件及其形成方法	ZL201210553317.9	中芯上海	2012-12-18	2017-09-29	原始取得	无
2669	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201210553320.0	中芯上海	2012-12-18	2016-06-29	原始取得	无
2670	MOS 晶体管的制作方法	ZL201210553341.2	中芯上海	2012-12-18	2016-08-10	原始取得	无
2671	自对准多重图形化方法及硅基硬掩模组合物的应用	ZL201210553343.1	中芯上海	2012-12-18	2017-06-13	原始取得	无
2672	注入装置的离子源和离子注入方法	ZL201210559934.X	中芯上海	2012-12-20	2016-12-28	原始取得	无
2673	一种混合反馈式先进过程控制系统	ZL201210568146.7	中芯上海	2012-12-24	2016-08-31	原始取得	无
2674	一种半导体工艺的检测方法和检测系统	ZL201210568149.0	中芯上海	2012-12-24	2016-08-31	原始取得	无
2675	一种半导体器件及其制造方法	ZL201210568155.6	中芯上海	2012-12-24	2017-02-08	原始取得	无
2676	一种半导体器件的制造方法	ZL201210568167.9	中芯上海	2012-12-24	2017-06-16	原始取得	无
2677	一种半导体器件的制造方法	ZL201210568208.4	中芯上海	2012-12-24	2017-11-10	原始取得	无
2678	一种半导体器件的制造方法	ZL201210568218.8	中芯上海	2012-12-24	2017-08-01	原始取得	无
2679	一种半导体器件的制造方法	ZL201210568222.4	中芯上海	2012-12-24	2017-02-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2680	一种半导体器件中粘附力检测结构及其制备方法	ZL201210568227.7	中芯上海	2012-12-24	2016-08-31	原始取得	无
2681	信号接收器和信号传输设备	ZL201210572447.7	中芯上海	2012-12-25	2018-05-25	原始取得	无
2682	转动装置及其允交检测方法	ZL201210592039.8	中芯上海	2012-12-31	2017-02-08	原始取得	无
2683	晶圆边缘清洗方法	ZL201210592057.6	中芯上海	2012-12-31	2016-12-28	原始取得	无
2684	LDMOS 及其形成方法	ZL201210592622.9	中芯上海	2012-12-31	2016-09-07	原始取得	无
2685	集成电路的可靠性分析测试结构及其测试方法	ZL201210592644.5	中芯上海	2012-12-31	2016-12-28	原始取得	无
2686	多垫式化学机械研磨装置	ZL201210593395.1	中芯上海	2012-12-31	2016-06-22	原始取得	无
2687	半导体器件的制备方法	ZL201210594284.2	中芯上海	2012-12-31	2016-12-28	原始取得	无
2688	晶体管及其形成方法	ZL201310006384.3	中芯上海	2013-01-08	2016-12-28	原始取得	无
2689	半导体器件的形成方法	ZL201310006387.7	中芯上海	2013-01-08	2016-08-31	原始取得	无
2690	无结晶体管和互补无结晶体管的形成方法	ZL201310006388.1	中芯上海	2013-01-08	2016-08-31	原始取得	无
2691	半导体结构及其形成方法	ZL201310006390.9	中芯上海	2013-01-08	2016-08-10	原始取得	无
2692	自对准金属硅化物的形成方法和半导体器件	ZL201310006397.0	中芯上海	2013-01-08	2019-01-29	原始取得	无
2693	MIM 电容及其形成方法	ZL201310006411.7	中芯上海	2013-01-08	2016-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2694	半导体器件和半导体器件的制作方法	ZL201310006413.6	中芯上海	2013-01-08	2017-06-13	原始取得	无
2695	晶体管的制作方法	ZL201310006415.5	中芯上海	2013-01-08	2016-08-31	原始取得	无
2696	检测晶体管重叠电容的方法、消除晶体管重叠电容的方法	ZL201310006436.7	中芯上海	2013-01-08	2016-08-10	原始取得	无
2697	CMOS 晶体管及其形成方法、鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310006452.6	中芯上海	2013-01-08	2016-12-28	原始取得	无
2698	CMOS 晶体管及其形成方法	ZL201310006455.X	中芯上海	2013-01-08	2017-05-17	原始取得	无
2699	晶体管及其形成方法	ZL201310006471.9	中芯上海	2013-01-08	2016-08-31	原始取得	无
2700	半导体器件的形成方法	ZL201310006513.9	中芯上海	2013-01-08	2016-08-03	原始取得	无
2701	图案的形成方法	ZL201310007114.4	中芯上海	2013-01-08	2016-11-30	原始取得	无
2702	三维量子阱晶体管及其形成方法	ZL201310007117.8	中芯上海	2013-01-08	2016-05-25	原始取得	无
2703	半导体结构的形成方法	ZL201310007119.7	中芯上海	2013-01-08	2016-05-25	原始取得	无
2704	电编程熔丝结构	ZL201310007165.7	中芯上海	2013-01-08	2016-12-28	原始取得	无
2705	可多次编程器件、半导体器件的制作方法	ZL201310007172.7	中芯上海	2013-01-08	2017-09-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2706	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310007186.9	中芯上海	2013-01-08	2016-06-29	原始取得	无
2707	半导体器件及其形成方法	ZL201310007187.3	中芯上海	2013-01-08	2017-02-22	原始取得	无
2708	晶体管的形成方法	ZL201310009243.7	中芯上海	2013-01-10	2017-06-13	原始取得	无
2709	双金属栅极结构的形成方法及 CMOS 晶体管	ZL201310009244.1	中芯上海	2013-01-10	2016-08-31	原始取得	无
2710	图案的形成方法	ZL201310009256.4	中芯上海	2013-01-10	2016-12-28	原始取得	无
2711	磁阻存储器的形成方法	ZL201310009261.5	中芯上海	2013-01-10	2017-05-17	原始取得	无
2712	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310009265.3	中芯上海	2013-01-10	2017-07-14	原始取得	无
2713	半导体结构的形成方法	ZL201310009273.8	中芯上海	2013-01-10	2017-02-22	原始取得	无
2714	互连结构的制作方法	ZL201310009281.2	中芯上海	2013-01-10	2016-10-05	原始取得	无
2715	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310009285.0	中芯上海	2013-01-10	2016-12-28	原始取得	无
2716	电平移位电路	ZL201310009294.X	中芯上海	2013-01-10	2017-09-22	原始取得	无
2717	局部互连结构的制作方法	ZL201310009755.3	中芯上海	2013-01-10	2017-05-17	原始取得	无
2718	连接件及其制造方法	ZL201310009776.5	中芯上海	2013-01-10	2018-02-16	原始取得	无
2719	静态存储单元及其形成方法	ZL201310009777.X	中芯上海	2013-01-10	2017-05-17	原始取得	无
2720	金属互连结构的制作方法	ZL201310009778.4	中芯上海	2013-01-10	2016-05-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2721	MEMS 反射系统阵列、MEMS 反射系统及其制作方法	ZL201310009779.9	中芯上海	2013-01-10	2017-12-01	原始取得	无
2722	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201310009780.1	中芯上海	2013-01-10	2016-08-03	原始取得	无
2723	半导体结构的形成方法和半导体结构	ZL201310009786.9	中芯上海	2013-01-10	2017-05-24	原始取得	无
2724	含应变硅层的半导体器件的形成方法	ZL201310009788.8	中芯上海	2013-01-10	2016-08-10	原始取得	无
2725	晶体管的形成方法、高 K 栅介质层的形成方法	ZL201310009790.5	中芯上海	2013-01-10	2016-08-31	原始取得	无
2726	具有不同长度的晶体管栅极阵列及其制作方法	ZL201310011492.X	中芯上海	2013-01-11	2016-08-03	原始取得	无
2727	晶圆边缘的刻蚀方法	ZL201310011495.3	中芯上海	2013-01-11	2016-08-10	原始取得	无
2728	半导体结构及其形成方法	ZL201310011741.5	中芯上海	2013-01-11	2017-05-24	原始取得	无
2729	共用栅极的半导体结构及对应的形成方法	ZL201310011743.4	中芯上海	2013-01-11	2016-09-07	原始取得	无
2730	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310011744.9	中芯上海	2013-01-11	2016-08-10	原始取得	无
2731	静电放电保护电路	ZL201310011745.3	中芯上海	2013-01-11	2016-10-05	原始取得	无
2732	条形结构的形成方法	ZL201310011752.3	中芯上海	2013-01-11	2016-09-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2733	晶体管及其形成方法	ZL201310011753.8	中芯上海	2013-01-11	2016-08-31	原始取得	无
2734	选择性外延生长锗硅的晶片预处理方法	ZL201310014766.0	中芯上海	2013-01-15	2016-12-28	原始取得	无
2735	一种 PMOS 晶体管及其制备方法	ZL201310015010.8	中芯上海	2013-01-16	2017-05-03	原始取得	无
2736	一种场效应管重叠电容的测试结构及方法	ZL201310015035.8	中芯上海	2013-01-16	2017-02-08	原始取得	无
2737	一种锁相环电路	ZL201310015138.4	中芯上海	2013-01-15	2017-09-29	原始取得	无
2738	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL201310015142.0	中芯上海	2013-01-15	2017-03-15	原始取得	无
2739	SCM 样品横断面的制备方法	ZL201310020360.3	中芯上海	2013-01-18	2015-12-23	原始取得	无
2740	顶层金属互连层的制造方法	ZL201310020365.6	中芯上海	2013-01-18	2016-07-27	原始取得	无
2741	半导体生产过程中的抽样量测方法	ZL201310020648.0	中芯上海	2013-01-21	2016-08-31	原始取得	无
2742	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310023625.5	中芯上海	2013-01-22	2016-08-31	原始取得	无
2743	鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201310023629.3	中芯上海	2013-01-22	2016-08-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2744	一种半导体器件的制造方法	ZL201310023818.0	中芯上海	2013-01-22	2016-12-28	原始取得	无
2745	三维量子阱晶体管及其形成方法	ZL201310024090.3	中芯上海	2013-01-22	2016-08-10	原始取得	无
2746	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310024103.7	中芯上海	2013-01-22	2017-12-01	原始取得	无
2747	半导体测试结构及测试方法	ZL201310024105.6	中芯上海	2013-01-22	2017-05-17	原始取得	无
2748	半导体测试装置及测试方法	ZL201310024112.6	中芯上海	2013-01-22	2016-12-28	原始取得	无
2749	一种用于测量阈值电压漂移的芯片上传感器	ZL201310024231.1	中芯上海	2013-01-22	2017-06-16	原始取得	无
2750	一种半导体器件中缺陷的检测结构及检测方法	ZL201310024232.6	中芯上海	2013-01-22	2017-05-10	原始取得	无
2751	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310024234.5	中芯上海	2013-01-22	2017-11-14	原始取得	无
2752	一种反熔丝结构及其制备方法	ZL201310025834.3	中芯上海	2013-01-22	2017-11-14	原始取得	无
2753	一种生成离线辅助程式方案的方法	ZL201310025840.9	中芯上海	2013-01-22	2017-05-10	原始取得	无
2754	一种半导体器件及其制造方	ZL201310026101.1	中芯上海	2013-01-22	2017-05-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
2755	晶体管的制作方法和确定栅极周围侧墙厚度的方法	ZL201310036535.X	中芯上海	2013-01-30	2016-08-10	原始取得	无
2756	鳍式场效应晶体管牺牲栅极的制作方法	ZL201310036546.8	中芯上海	2013-01-30	2018-03-06	原始取得	无
2757	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310036549.1	中芯上海	2013-01-30	2017-02-08	原始取得	无
2758	金属填充沟槽的方法	ZL201310036612.1	中芯上海	2013-01-30	2016-08-10	原始取得	无
2759	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310037646.2	中芯上海	2013-01-30	2016-12-28	原始取得	无
2760	半导体器件及其制造方法	ZL201310037707.5	中芯上海	2013-01-30	2017-05-10	原始取得	无
2761	半导体结构的形成方法	ZL201310037709.4	中芯上海	2013-01-30	2017-02-22	原始取得	无
2762	半导体器件的制备方法	ZL201310041862.4	中芯上海	2013-02-01	2017-08-08	原始取得	无
2763	芯片键合方法	ZL201310041873.2	中芯上海	2013-02-01	2018-10-16	原始取得	无
2764	插塞的形成方法	ZL201310044553.2	中芯上海	2013-02-01	2017-04-05	原始取得	无
2765	一种 DRC 结果审查时自动截图的方法	ZL201310045943.1	中芯上海	2013-02-05	2017-09-01	原始取得	无
2766	半导体互连结构及其制作方法	ZL201310047322.7	中芯上海	2013-02-06	2016-09-14	原始取得	无
2767	终点侦测方法及化学机械抛	ZL201310048694.1	中芯上海	2013-02-07	2017-04-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	光系统的抛光方法						
2768	一种 PMOS 晶体管的制备方法	ZL201310050746.9	中芯上海	2013-02-08	2017-10-20	原始取得	无
2769	一种 PMOS 晶体管的制造方法	ZL201310050747.3	中芯上海	2013-02-08	2016-12-28	原始取得	无
2770	一种 MOS 晶体管的制备方法	ZL201310050836.8	中芯上海	2013-02-08	2017-10-20	原始取得	无
2771	一种半导体器件及其制备方法	ZL201310057472.6	中芯上海	2013-02-22	2017-09-01	原始取得	无
2772	一种半导体器件的制造方法	ZL201310057964.5	中芯上海	2013-02-25	2017-06-13	原始取得	无
2773	一种薄膜结构、压力传感器及电子装置	ZL201310058108.1	中芯上海	2013-02-25	2019-05-17	原始取得	无
2774	无结晶体管及其制造方法	ZL201310060565.4	中芯上海	2013-02-26	2016-12-28	原始取得	无
2775	半导体结构的形成方法	ZL201310063976.9	中芯上海	2013-02-28	2017-05-17	原始取得	无
2776	晶体管重叠电容的测试结构及其测试方法	ZL201310063988.1	中芯上海	2013-02-28	2017-11-03	原始取得	无
2777	晶体管及其形成方法	ZL201310064001.8	中芯上海	2013-02-28	2016-08-31	原始取得	无
2778	静态存储单元及其形成方法	ZL201310064003.7	中芯上海	2013-02-28	2016-12-28	原始取得	无
2779	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201310064010.7	中芯上海	2013-02-28	2017-06-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
2780	半导体结构及其形成方法	ZL201310064743.0	中芯上海	2013-02-28	2017-03-29	原始取得	无
2781	半导体结构及其形成方法	ZL201310064744.5	中芯上海	2013-02-28	2017-09-22	原始取得	无
2782	互连结构的形成方法	ZL201310064745.X	中芯上海	2013-02-28	2016-08-31	原始取得	无
2783	晶体管重叠电容的测试结构及其测试方法	ZL201310064746.4	中芯上海	2013-02-28	2017-05-17	原始取得	无
2784	互连结构的形成方法	ZL201310064751.5	中芯上海	2013-02-28	2017-02-08	原始取得	无
2785	静态存储单元及其形成方法	ZL201310064755.3	中芯上海	2013-02-28	2017-08-25	原始取得	无
2786	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310064769.5	中芯上海	2013-02-28	2016-08-31	原始取得	无
2787	半导体制造控制方法	ZL201310065198.7	中芯上海	2013-03-01	2018-03-09	原始取得	无
2788	一种半导体器件的制造方法	ZL201310065204.9	中芯上海	2013-03-01	2017-06-16	原始取得	无
2789	浅槽的形成方法	ZL201310066219.7	中芯上海	2013-03-01	2017-09-29	原始取得	无
2790	多次离子注入的方法	ZL201310066357.5	中芯上海	2013-03-01	2016-09-28	原始取得	无
2791	一种半导体器件的制造方法	ZL201310066661.X	中芯上海	2013-03-01	2017-04-05	原始取得	无
2792	多晶硅栅极的形成方法	ZL201310066824.4	中芯上海	2013-03-01	2016-08-03	原始取得	无
2793	半导体器件的制造方法	ZL201310066831.4	中芯上海	2013-03-01	2017-11-14	原始取得	无
2794	间隙壁去除方法	ZL201310066832.9	中芯上海	2013-03-01	2017-07-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2795	告警监控方法和装置	ZL201310066956.7	中芯上海	2013-03-01	2017-02-08	原始取得	无
2796	一种半导体器件的制作方法	ZL201310068026.5	中芯上海	2013-03-04	2017-05-10	原始取得	无
2797	一种半导体器件的制造方法	ZL201310068069.3	中芯上海	2013-03-04	2016-12-28	原始取得	无
2798	一种半导体器件的制造方法	ZL201310068146.5	中芯上海	2013-03-04	2017-02-22	原始取得	无
2799	一种半导体器件的制备方法	ZL201310068220.3	中芯上海	2013-03-04	2017-02-01	原始取得	无
2800	半导体结构及其形成方法	ZL201310069587.7	中芯上海	2013-03-05	2017-12-29	原始取得	无
2801	半导体结构的形成方法	ZL201310069589.6	中芯上海	2013-03-05	2016-12-28	原始取得	无
2802	CMOS 晶体管的制作方法	ZL201310069590.9	中芯上海	2013-03-05	2017-09-22	原始取得	无
2803	圆筒形掩模板系统、曝光装置和曝光方法	ZL201310069607.0	中芯上海	2013-03-05	2016-08-03	原始取得	无
2804	曝光装置及其曝光方法	ZL201310069610.2	中芯上海	2013-03-05	2016-06-29	原始取得	无
2805	铜互连结构及铜互连结构的制作方法	ZL201310069905.X	中芯上海	2013-03-05	2017-02-08	原始取得	无
2806	圆筒形掩模板系统、曝光装置和曝光方法	ZL201310069922.3	中芯上海	2013-03-05	2015-12-23	原始取得	无
2807	曝光装置及其曝光方法	ZL201310069924.2	中芯上海	2013-03-05	2016-03-16	原始取得	无
2808	半导体器件及其制造方法	ZL201310074758.5	中芯上海	2013-03-08	2016-10-19	原始取得	无
2809	多晶硅电阻结构及其形成方	ZL201310074770.6	中芯上海	2013-03-08	2017-05-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
2810	一种闪存存储器的制备方法	ZL201310077001.1	中芯上海	2013-03-11	2018-01-30	原始取得	无
2811	金属栅阻挡层针孔的检测方法	ZL201310077026.1	中芯上海	2013-03-11	2016-08-17	原始取得	无
2812	一种半导体器件的制备方法	ZL201310077046.9	中芯上海	2013-03-11	2019-06-28	原始取得	无
2813	一种制作半导体器件的方法	ZL201310077521.2	中芯上海	2013-03-11	2019-01-18	原始取得	无
2814	高 K 金属栅结构的制备方法	ZL201310077624.9	中芯上海	2013-03-11	2017-04-05	原始取得	无
2815	一种铜制程整合无源器件制造工艺及其制成的无源器件	ZL201310077668.1	中芯上海	2013-03-11	2017-12-29	原始取得	无
2816	一种接触孔电阻测试结构及方法	ZL201310078658.X	中芯上海	2013-03-13	2016-12-28	原始取得	无
2817	一种提高高压栅氧可靠性的方法	ZL201310079068.9	中芯上海	2013-03-13	2017-02-08	原始取得	无
2818	一种采用应力接近技术的晶体管的制作方法	ZL201310080080.1	中芯上海	2013-03-13	2017-02-08	原始取得	无
2819	一种 MOS 晶体管的制作方法	ZL201310080081.6	中芯上海	2013-03-13	2017-06-16	原始取得	无
2820	一种用于后栅工艺的光刻胶去除方法	ZL201310080082.0	中芯上海	2013-03-13	2017-02-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2821	一种高K金属栅工艺中TiN表面界面层的去除工艺	ZL201310080084.X	中芯上海	2013-03-13	2016-12-28	原始取得	无
2822	测试线的形成方法	ZL201310080496.3	中芯上海	2013-03-13	2016-12-28	原始取得	无
2823	栅极的形成方法	ZL201310080498.2	中芯上海	2013-03-13	2017-03-22	原始取得	无
2824	电熔丝结构及其形成方法	ZL201310080500.6	中芯上海	2013-03-13	2016-08-31	原始取得	无
2825	一种半导体封装结构及其制备方法	ZL201310080595.1	中芯上海	2013-03-13	2017-12-29	原始取得	无
2826	自对准双构图方法	ZL201310080600.9	中芯上海	2013-03-13	2017-06-13	原始取得	无
2827	一种半导体器件的制造方法	ZL201310088607.5	中芯上海	2013-03-19	2017-02-22	原始取得	无
2828	一种硅通孔质量检测方法	ZL201310088609.4	中芯上海	2013-03-19	2017-08-01	原始取得	无
2829	一种电可编程熔丝器件结构及其制作方法	ZL201310089210.8	中芯上海	2013-03-19	2017-08-01	原始取得	无
2830	晶体管及其形成方法	ZL201310092797.8	中芯上海	2013-03-21	2017-06-09	原始取得	无
2831	半导体器件的形成方法	ZL201310092800.6	中芯上海	2013-03-21	2017-07-14	原始取得	无
2832	分段沟道晶体管及其形成方法	ZL201310093703.9	中芯上海	2013-03-21	2017-03-22	原始取得	无
2833	热载流子注入测试电路及方法	ZL201310093705.8	中芯上海	2013-03-21	2017-09-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2834	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310093717.0	中芯上海	2013-03-21	2017-05-17	原始取得	无
2835	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310093720.2	中芯上海	2013-03-21	2017-08-25	原始取得	无
2836	半导体器件及其形成方法	ZL201310093736.3	中芯上海	2013-03-21	2017-07-14	原始取得	无
2837	一种量测机台监测图规格界限设定的方法	ZL201310099835.2	中芯上海	2013-03-26	2018-07-20	原始取得	无
2838	一种 SRAM 存储器及其制备方法	ZL201310099850.7	中芯上海	2013-03-26	2017-02-08	原始取得	无
2839	一种对沉积薄膜反应腔室的处理方法及沉积薄膜的方法	ZL201310100846.8	中芯上海	2013-03-26	2019-05-21	原始取得	无
2840	晶圆清洗方法及晶圆清洗装置	ZL201310103214.7	中芯上海	2013-03-27	2017-06-27	原始取得	无
2841	CMOS 图像传感器及其制造方法	ZL201310103221.7	中芯上海	2013-03-27	2017-02-01	原始取得	无
2842	自对准浅槽隔离的形成方法	ZL201310103223.6	中芯上海	2013-03-27	2017-02-08	原始取得	无
2843	接触孔的制造方法	ZL201310103937.7	中芯上海	2013-03-27	2019-04-02	原始取得	无
2844	键合对准标记及计算偏移量	ZL201310103939.6	中芯上海	2013-03-27	2016-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的方法						
2845	晶体管的形成方法	ZL201310103947.0	中芯上海	2013-03-27	2017-04-19	原始取得	无
2846	硅通孔及其形成方法	ZL201310105369.4	中芯上海	2013-03-28	2017-02-08	原始取得	无
2847	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310105370.7	中芯上海	2013-03-28	2016-11-30	原始取得	无
2848	分段沟道晶体管及其形成方法	ZL201310105855.6	中芯上海	2013-03-28	2016-10-05	原始取得	无
2849	鳍式场效应管的形成方法	ZL201310105896.5	中芯上海	2013-03-28	2017-08-25	原始取得	无
2850	静电保护结构及静电保护电路	ZL201310105961.4	中芯上海	2013-03-28	2016-12-28	原始取得	无
2851	自对准三重图形的形成方法	ZL201310106678.3	中芯上海	2013-03-28	2018-03-06	原始取得	无
2852	自对准多重图形的形成方法	ZL201310106682.X	中芯上海	2013-03-28	2019-05-28	原始取得	无
2853	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310106691.9	中芯上海	2013-03-28	2016-11-23	原始取得	无
2854	硅通孔布局结构、硅通孔互联结构的形成方法	ZL201310106719.9	中芯上海	2013-03-28	2017-02-22	原始取得	无
2855	静电保护结构及静电保护电路	ZL201310106740.9	中芯上海	2013-03-28	2017-02-08	原始取得	无
2856	MOS 晶体管的制造方法	ZL201310109162.4	中芯上海	2013-03-29	2017-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2857	一种 MIM 电容器及其制作方法	ZL201310113065.2	中芯上海	2013-04-02	2016-12-28	原始取得	无
2858	电熔丝结构及其形成方法	ZL201310113259.2	中芯上海	2013-04-02	2016-12-28	原始取得	无
2859	晶体管的形成方法	ZL201310113277.0	中芯上海	2013-04-02	2017-02-22	原始取得	无
2860	半导体测试结构及测试方法	ZL201310113279.X	中芯上海	2013-04-02	2016-08-10	原始取得	无
2861	多孔低 k 介质层的形成方法及多孔低 k 介质层	ZL201310113287.4	中芯上海	2013-04-02	2017-02-08	原始取得	无
2862	PMOS 晶体管的制作方法与 NMOS 晶体管的制作方法	ZL201310113296.3	中芯上海	2013-04-02	2017-02-08	原始取得	无
2863	一种具有降低纵向寄生晶体管效应的器件结构及其制作方法	ZL201310113439.0	中芯上海	2013-04-02	2018-07-06	原始取得	无
2864	有源区衬垫氧化前的晶片预清洗方法	ZL201310113447.5	中芯上海	2013-04-02	2018-02-13	原始取得	无
2865	半导体结构及其形成方法	ZL201310113655.5	中芯上海	2013-04-02	2017-06-16	原始取得	无
2866	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL201310113662.5	中芯上海	2013-04-02	2018-02-16	原始取得	无
2867	掩膜层的形成方法、互连结构	ZL201310113665.9	中芯上海	2013-04-02	2017-12-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的形成方法和检测方法						
2868	半导体器件	ZL201310113669.7	中芯上海	2013-04-02	2016-12-28	原始取得	无
2869	晶体管重叠电容的测试结构及其测试方法	ZL201310113683.7	中芯上海	2013-04-02	2017-02-22	原始取得	无
2870	静电放电保护结构	ZL201310113685.6	中芯上海	2013-04-02	2016-12-28	原始取得	无
2871	有效控制过刻蚀量的方法	ZL201310113918.2	中芯上海	2013-04-02	2016-12-28	原始取得	无
2872	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310116110.X	中芯上海	2013-04-03	2017-03-08	原始取得	无
2873	一种芯片上传感器	ZL201310116158.0	中芯上海	2013-04-03	2017-11-14	原始取得	无
2874	一种半导体器件的制备方法	ZL201310116171.6	中芯上海	2013-04-03	2017-03-08	原始取得	无
2875	一种半导体器件的制造方法	ZL201310116173.5	中芯上海	2013-04-03	2017-10-20	原始取得	无
2876	半导体器件的制作方法	ZL201310123423.8	中芯上海	2013-04-10	2017-12-29	原始取得	无
2877	等离子体损伤检测结构及其检测方法	ZL201310123425.7	中芯上海	2013-04-10	2017-02-22	原始取得	无
2878	栅极的形成方法	ZL201310124027.7	中芯上海	2013-04-10	2017-03-29	原始取得	无
2879	半导体器件的形成方法	ZL201310124028.1	中芯上海	2013-04-10	2017-03-22	原始取得	无
2880	一种晶体管制造方法	ZL201310124029.6	中芯上海	2013-04-10	2016-08-31	原始取得	无
2881	反熔丝结构及其形成方法	ZL201310124030.9	中芯上海	2013-04-10	2017-03-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2882	铜互连线的形成方法	ZL201310124031.3	中芯上海	2013-04-10	2017-12-29	原始取得	无
2883	反熔丝电路及其编程方法、反熔丝结构	ZL201310125660.8	中芯上海	2013-04-11	2017-08-25	原始取得	无
2884	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310129640.8	中芯上海	2013-04-15	2017-06-09	原始取得	无
2885	绝缘层形成方法	ZL201310129648.4	中芯上海	2013-04-15	2018-03-30	原始取得	无
2886	一种减少炉管中颗粒的方法	ZL201310129649.9	中芯上海	2013-04-15	2016-10-19	原始取得	无
2887	半导体器件的制造方法	ZL201310130298.3	中芯上海	2013-04-15	2017-05-17	原始取得	无
2888	一种解决硅通孔分层和 CMP 后铜表面凹陷问题的方案	ZL201310136082.8	中芯上海	2013-04-18	2017-07-14	原始取得	无
2889	一种改善铜填充质量的方法	ZL201310136098.9	中芯上海	2013-04-18	2017-09-15	原始取得	无
2890	一种高 k 金属栅器件金属电阻结构及其制作方法	ZL201310136100.2	中芯上海	2013-04-18	2017-04-26	原始取得	无
2891	一种硬掩膜叠层结构及其制作方法	ZL201310136109.3	中芯上海	2013-04-18	2017-03-29	原始取得	无
2892	双嵌套铜互连结构及其制作方法	ZL201310136117.8	中芯上海	2013-04-18	2017-02-15	原始取得	无
2893	在半导体结构中消除凸点效应的方法	ZL201310136250.3	中芯上海	2013-04-18	2017-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2894	一种改善闪存存储器外围电路区栅氧化层可靠性的方法	ZL201310138654.6	中芯上海	2013-04-18	2016-11-02	原始取得	无
2895	一种基于原子层沉积技术的氮化钽薄膜的制作工艺	ZL201310138674.3	中芯上海	2013-04-18	2016-07-06	原始取得	无
2896	一种改善金属互连工艺中线路断裂缺陷的方法	ZL201310138681.3	中芯上海	2013-04-18	2017-03-29	原始取得	无
2897	一种 MEMS 晶圆的切割方法	ZL201310138683.2	中芯上海	2013-04-18	2015-12-09	原始取得	无
2898	一种 MOS 器件的制造方法	ZL201310138691.7	中芯上海	2013-04-18	2016-12-28	原始取得	无
2899	一种 MOS 器件的制造方法	ZL201310138693.6	中芯上海	2013-04-18	2016-12-28	原始取得	无
2900	半导体结构及其制造方法	ZL201310138925.8	中芯上海	2013-04-18	2017-05-03	原始取得	无
2901	在半导体制造中降低超低 k 介电层损伤的方法	ZL201310138936.6	中芯上海	2013-04-18	2016-12-28	原始取得	无
2902	金属互连结构及其制作方法	ZL201310140861.5	中芯上海	2013-04-22	2016-12-28	原始取得	无
2903	半导体装置及其制造方法	ZL201310142017.6	中芯上海	2013-04-23	2016-12-28	原始取得	无
2904	一种制作半导体器件的方法	ZL201310143122.1	中芯上海	2013-04-23	2018-10-23	原始取得	无
2905	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310143239.X	中芯上海	2013-04-23	2018-08-21	原始取得	无
2906	栅极侧壁层的形成方法	ZL201310143277.5	中芯上海	2013-04-23	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2907	栅极侧壁层的形成方法	ZL201310144021.6	中芯上海	2013-04-23	2017-02-08	原始取得	无
2908	电镀铜的方法	ZL201310145100.9	中芯上海	2013-04-24	2016-09-07	原始取得	无
2909	一种半导体器件的制备方法	ZL201310145232.1	中芯上海	2013-04-24	2017-09-01	原始取得	无
2910	一种测试结构及测试方法	ZL201310151381.9	中芯上海	2013-04-27	2017-08-01	原始取得	无
2911	一种半导体器件的制造方法	ZL201310151396.5	中芯上海	2013-04-27	2017-03-01	原始取得	无
2912	一种半导体器件的制造方法	ZL201310151399.9	中芯上海	2013-04-27	2018-02-06	原始取得	无
2913	一种半导体器件的制造方法	ZL201310151401.2	中芯上海	2013-04-27	2018-02-06	原始取得	无
2914	导电结构的形成方法	ZL201310156920.8	中芯上海	2013-04-28	2017-12-01	原始取得	无
2915	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310156923.1	中芯上海	2013-04-28	2017-07-14	原始取得	无
2916	半导体结构的形成方法	ZL201310156924.6	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2917	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310156941.X	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2918	半导体结构的形成方法	ZL201310156943.9	中芯上海	2013-04-28	2017-11-28	原始取得	无
2919	NMOS 晶体管及其形成方法、CMOS 晶体管及其形成方法	ZL201310156945.8	中芯上海	2013-04-28	2018-06-01	原始取得	无
2920	鳍式双极结型晶体管及其形成方法	ZL201310156946.2	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2921	双极晶体管、半导体器件及双	ZL201310156949.6	中芯上海	2013-04-28	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	极晶体管的形成方法						
2922	沟槽的形成方法	ZL201310156972.5	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2923	P 型鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310157812.2	中芯上海	2013-04-28	2017-12-29	原始取得	无
2924	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310157814.1	中芯上海	2013-04-28	2017-07-14	原始取得	无
2925	半导体结构及其形成方法	ZL201310157828.3	中芯上海	2013-04-28	2017-02-22	原始取得	无
2926	互连结构的形成方法	ZL201310157853.1	中芯上海	2013-04-28	2017-11-03	原始取得	无
2927	半导体器件的形成方法	ZL201310157855.0	中芯上海	2013-04-28	2016-10-05	原始取得	无
2928	半导体器件的形成方法	ZL201310157871.X	中芯上海	2013-04-28	2017-06-16	原始取得	无
2929	图形化方法	ZL201310157874.3	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2930	半导体结构的形成方法	ZL201310157910.6	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2931	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310158820.9	中芯上海	2013-04-28	2016-12-28	原始取得	无
2932	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310163051.1	中芯上海	2013-05-06	2017-12-05	原始取得	无
2933	一种用于锗硅外延生长的反应室、方法及半导体制造设备	ZL201310165713.9	中芯上海	2013-05-07	2016-08-31	原始取得	无
2934	PMOS 晶体管的制作方法	ZL201310169514.5	中芯上海	2013-05-09	2016-12-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2935	PMOS 晶体管的制作方法	ZL201310169528.7	中芯上海	2013-05-09	2017-02-22	原始取得	无
2936	纳米真空场效应电子管及其形成方法	ZL201310170430.3	中芯上海	2013-05-09	2016-12-28	原始取得	无
2937	互连结构的形成方法	ZL201310170457.2	中芯上海	2013-05-09	2017-06-13	原始取得	无
2938	金属插塞的形成方法和 NAND 闪存的形成方法	ZL201310170458.7	中芯上海	2013-05-09	2016-10-05	原始取得	无
2939	多栅极场效应晶体管的形成方法	ZL201310170459.1	中芯上海	2013-05-09	2017-09-26	原始取得	无
2940	半导体检测电路及检测方法	ZL201310170460.4	中芯上海	2013-05-09	2017-07-14	原始取得	无
2941	半导体器件老化测试方法	ZL201310170462.3	中芯上海	2013-05-09	2017-05-17	原始取得	无
2942	晶体管及其制作方法	ZL201310170481.6	中芯上海	2013-05-09	2017-12-01	原始取得	无
2943	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310170482.0	中芯上海	2013-05-09	2017-12-01	原始取得	无
2944	一种浅沟槽的形成方法	ZL201310170494.3	中芯上海	2013-05-09	2017-05-24	原始取得	无
2945	尘埃检测系统及尘埃检测方法	ZL201310177641.X	中芯上海	2013-05-14	2017-06-16	原始取得	无
2946	APCVD 炉管复机保养方法	ZL201310177643.9	中芯上海	2013-05-14	2017-07-28	原始取得	无
2947	改善刻蚀后关键尺寸均匀性的方法	ZL201310178481.0	中芯上海	2013-05-15	2016-12-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2948	一种高压晶体管及其制备方法	ZL201310178587.0	中芯上海	2013-05-15	2017-07-21	原始取得	无
2949	TEM 平面样品的制备方法	ZL201310178632.2	中芯上海	2013-05-14	2017-04-19	原始取得	无
2950	用于 I/O 接口的降压转换电路	ZL201310178635.6	中芯上海	2013-05-14	2017-06-23	原始取得	无
2951	LDNMOS 管的制备方法	ZL201310179570.7	中芯上海	2013-05-15	2017-03-01	原始取得	无
2952	一种增强金属铜与 NDC 界面结合强度的方法	ZL201310179587.2	中芯上海	2013-05-15	2017-02-08	原始取得	无
2953	闪存存储器的制备方法	ZL201310180041.9	中芯上海	2013-05-15	2017-03-22	原始取得	无
2954	金属硬掩模开口刻蚀方法	ZL201310180042.3	中芯上海	2013-05-15	2017-08-25	原始取得	无
2955	改善互连工艺中半导体器件可靠性的方法	ZL201310180680.5	中芯上海	2013-05-16	2017-03-15	原始取得	无
2956	形成间隔物图案掩模的方法	ZL201310183224.6	中芯上海	2013-05-17	2017-02-22	原始取得	无
2957	一种晶片货架提示方法、装置和系统	ZL201310188443.3	中芯上海	2013-05-20	2016-12-28	原始取得	无
2958	一种确定晶圆测试数据规范的界限的方法及晶粒标记方法	ZL201310190022.4	中芯上海	2013-05-21	2017-10-20	原始取得	无
2959	一种半导体器件的制造方法	ZL201310190043.6	中芯上海	2013-05-21	2017-09-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2960	一种半导体器件及其制备方法	ZL201310190073.7	中芯上海	2013-05-21	2018-05-08	原始取得	无
2961	一种晶圆监控方法	ZL201310190083.0	中芯上海	2013-05-21	2017-04-05	原始取得	无
2962	一种制作半导体器件的方法	ZL201310190085.X	中芯上海	2013-05-21	2017-10-20	原始取得	无
2963	一种制作半导体器件的方法	ZL201310190106.8	中芯上海	2013-05-21	2017-05-10	原始取得	无
2964	一种制作半导体器件的方法	ZL201310190108.7	中芯上海	2013-05-21	2017-11-14	原始取得	无
2965	一种半导体器件的制造方法	ZL201310190198.X	中芯上海	2013-05-21	2018-03-30	原始取得	无
2966	一种半导体器件的制造方法	ZL201310190221.5	中芯上海	2013-05-21	2018-11-16	原始取得	无
2967	一种半导体器件的制造方法	ZL201310190257.3	中芯上海	2013-05-21	2019-12-31	原始取得	无
2968	一种半导体器件的检测方法	ZL201310190272.8	中芯上海	2013-05-21	2018-05-04	原始取得	无
2969	栅极结构及其形成方法	ZL201310190298.2	中芯上海	2013-05-21	2016-12-28	原始取得	无
2970	晶体管及其形成方法	ZL201310190300.6	中芯上海	2013-05-21	2017-05-17	原始取得	无
2971	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310190312.9	中芯上海	2013-05-21	2017-11-28	原始取得	无
2972	金属栅极晶体管的形成方法及半导体器件	ZL201310190331.1	中芯上海	2013-05-21	2017-07-14	原始取得	无
2973	晶体管的形成方法	ZL201310190595.7	中芯上海	2013-05-21	2018-05-01	原始取得	无
2974	PMOS 晶体管的制作方法	ZL201310190613.1	中芯上海	2013-05-21	2016-10-05	原始取得	无
2975	静态随机存储器结构	ZL201310190614.6	中芯上海	2013-05-21	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2976	半导体器件及其制备方法	ZL201310191041.9	中芯上海	2013-05-21	2017-08-01	原始取得	无
2977	修复介质 K 值的方法	ZL201310192549.0	中芯上海	2013-05-22	2017-03-01	原始取得	无
2978	电熔丝结构及其形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201310192826.8	中芯上海	2013-05-22	2017-11-03	原始取得	无
2979	静电放电保护结构	ZL201310193679.6	中芯上海	2013-05-22	2017-08-25	原始取得	无
2980	静电放电保护结构	ZL201310193680.9	中芯上海	2013-05-22	2017-06-13	原始取得	无
2981	电熔丝结构及其形成方法、半导体器件	ZL201310193706.X	中芯上海	2013-05-22	2017-02-22	原始取得	无
2982	浅沟槽的制作方法	ZL201310202800.7	中芯上海	2013-05-27	2017-05-10	原始取得	无
2983	半导体测试结构及测试方法	ZL201310206572.0	中芯上海	2013-05-22	2017-02-08	原始取得	无
2984	单像素结构,包括其的数字微镜器件以及它们的制备方法	ZL201310214576.3	中芯上海	2013-05-31	2017-02-08	原始取得	无
2985	高迁移率鳍型场效应晶体管及其制造方法	ZL201310218019.9	中芯上海	2013-06-04	2017-08-25	原始取得	无
2986	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310220137.3	中芯上海	2013-06-04	2018-03-20	原始取得	无
2987	一种半导体器件的制造方法	ZL201310220138.8	中芯上海	2013-06-04	2017-11-10	原始取得	无
2988	一种半导体器件的制造方法	ZL201310220515.8	中芯上海	2013-06-04	2017-05-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
2989	半导体结构及其形成方法	ZL201310222153.6	中芯上海	2013-06-05	2016-12-28	原始取得	无
2990	采样量测方法和系统	ZL201310222154.0	中芯上海	2013-06-05	2016-12-28	原始取得	无
2991	半导体批次产品的处理系统和方法	ZL201310222155.5	中芯上海	2013-06-05	2017-05-17	原始取得	无
2992	互连结构的形成方法	ZL201310222161.0	中芯上海	2013-06-05	2017-05-17	原始取得	无
2993	曝光方法	ZL201310222163.X	中芯上海	2013-06-05	2016-08-10	原始取得	无
2994	圆筒形掩模板的涂布装置和涂布方法	ZL201310222164.4	中芯上海	2013-06-05	2018-06-05	原始取得	无
2995	双极晶体管、半导体器件和双极晶体管的形成方法	ZL201310222181.8	中芯上海	2013-06-05	2017-05-17	原始取得	无
2996	半导体检测结构及检测方法	ZL201310222182.2	中芯上海	2013-06-05	2017-05-31	原始取得	无
2997	涂布装置和涂布方法	ZL201310222183.7	中芯上海	2013-06-05	2019-02-12	原始取得	无
2998	栅极的形成方法	ZL201310222184.1	中芯上海	2013-06-05	2017-02-22	原始取得	无
2999	芯片密封圈及包括该密封圈的芯片	ZL201310222185.6	中芯上海	2013-06-05	2017-08-25	原始取得	无
3000	SRAM 单元	ZL201310222192.6	中芯上海	2013-06-05	2017-09-22	原始取得	无
3001	半导体器件及其形成方法	ZL201310222193.0	中芯上海	2013-06-05	2017-03-01	原始取得	无
3002	晶体管的形成方法	ZL201310222194.5	中芯上海	2013-06-05	2017-06-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3003	PMOS 晶体管及其制作方法	ZL201310222207.9	中芯上海	2013-06-05	2017-06-13	原始取得	无
3004	光刻系统光源对称性的检测方法	ZL201310224037.8	中芯上海	2013-06-05	2016-05-25	原始取得	无
3005	接地屏蔽结构及半导体器件	ZL201310224040.X	中芯上海	2013-06-05	2017-05-24	原始取得	无
3006	导电插塞的形成方法	ZL201310224049.0	中芯上海	2013-06-05	2017-12-29	原始取得	无
3007	浅沟槽隔离结构的制作方法和 NAND 闪存的制作方法	ZL201310224056.0	中芯上海	2013-06-05	2017-09-22	原始取得	无
3008	静电放电保护结构及其形成方法	ZL201310224057.5	中芯上海	2013-06-05	2018-03-30	原始取得	无
3009	晶体管及其形成方法	ZL201310224058.X	中芯上海	2013-06-05	2017-06-13	原始取得	无
3010	磁性随机存储器单元的形成方法	ZL201310224060.7	中芯上海	2013-06-05	2017-03-22	原始取得	无
3011	半导体测试结构及其测试方法	ZL201310224076.8	中芯上海	2013-06-05	2017-02-22	原始取得	无
3012	N 型晶体管及其制作方法、互补金属氧化物半导体	ZL201310224077.2	中芯上海	2013-06-05	2017-11-03	原始取得	无
3013	PMOS 晶体管及其制作方法	ZL201310224079.1	中芯上海	2013-06-05	2017-05-17	原始取得	无
3014	一种石墨烯图案的形成方法	ZL201310224082.3	中芯上海	2013-06-05	2017-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3015	晶体管及其形成方法	ZL201310224085.7	中芯上海	2013-06-05	2017-09-22	原始取得	无
3016	一种高 k/金属栅极结构及其制作方法	ZL201310231660.6	中芯上海	2013-06-09	2017-06-13	原始取得	无
3017	一种垂直 SiGe FinFET 的制备方法（中间有一处空格）	ZL201310231911.0	中芯上海	2013-06-09	2018-08-21	原始取得	无
3018	一种半导体器件的制造方法	ZL201310231922.9	中芯上海	2013-06-09	2017-11-10	原始取得	无
3019	LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL201310231955.3	中芯上海	2013-06-09	2018-03-06	原始取得	无
3020	金属栅极晶体管的形成方法	ZL201310231961.9	中芯上海	2013-06-09	2017-12-01	原始取得	无
3021	PMOS 晶体管及其形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201310231963.8	中芯上海	2013-06-09	2018-04-27	原始取得	无
3022	金属栅极晶体管的形成方法	ZL201310231964.2	中芯上海	2013-06-09	2017-08-25	原始取得	无
3023	反熔丝结构及编程方法	ZL201310231965.7	中芯上海	2013-06-09	2018-06-01	原始取得	无
3024	一种半导体器件及其形成方法	ZL201310231976.5	中芯上海	2013-06-09	2016-04-20	原始取得	无
3025	电熔丝结构及其形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201310231978.4	中芯上海	2013-06-09	2018-02-16	原始取得	无
3026	自对准双图形工艺	ZL201310232002.9	中芯上海	2013-06-09	2017-09-29	原始取得	无
3027	背离率的计算方法和二次离	ZL201310232003.3	中芯上海	2013-06-09	2017-07-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	子质谱分析方法						
3028	接地屏蔽结构及半导体器件	ZL201310232109.3	中芯上海	2013-06-09	2017-12-29	原始取得	无
3029	半导体器件及其形成方法	ZL201310232121.4	中芯上海	2013-06-09	2017-06-13	原始取得	无
3030	条形结构的形成方法	ZL201310232124.8	中芯上海	2013-06-09	2017-07-14	原始取得	无
3031	图形化方法	ZL201310232131.8	中芯上海	2013-06-09	2017-05-17	原始取得	无
3032	静电放电保护结构	ZL201310232133.7	中芯上海	2013-06-09	2017-05-17	原始取得	无
3033	半导体器件的测试结构	ZL201310232134.1	中芯上海	2013-06-09	2017-07-14	原始取得	无
3034	电熔丝电路	ZL201310232136.0	中芯上海	2013-06-09	2017-09-22	原始取得	无
3035	非晶半导体材料的形成方法及金属硅化物的形成方法	ZL201310232183.5	中芯上海	2013-06-09	2017-11-03	原始取得	无
3036	金属垫的形成方法及半导体结构	ZL201310232232.5	中芯上海	2013-06-09	2017-10-31	原始取得	无
3037	一种制作半导体器件的方法	ZL201310237598.1	中芯上海	2013-06-17	2017-05-10	原始取得	无
3038	一种金属膜厚度测量方法	ZL201310240197.1	中芯上海	2013-06-18	2017-08-04	原始取得	无
3039	一种硅通孔结构	ZL201310241943.9	中芯上海	2013-06-18	2019-04-09	原始取得	无
3040	一种改进半导体器件工艺窗口的方法	ZL201310242416.X	中芯上海	2013-06-18	2019-04-09	原始取得	无
3041	一种在 CPI 测试中防止衬垫剥	ZL201310244627.7	中芯上海	2013-06-19	2017-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	离的方法以及产生的器件						
3042	半导体互连结构及其制作方法	ZL201310247932.1	中芯上海	2013-06-20	2017-10-27	原始取得	无
3043	硅通孔互连结构及其制作方法	ZL201310253184.8	中芯上海	2013-06-21	2017-03-22	原始取得	无
3044	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310259904.1	中芯上海	2013-06-26	2016-12-28	原始取得	无
3045	静电放电保护结构	ZL201310259916.4	中芯上海	2013-06-26	2017-05-17	原始取得	无
3046	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310259920.0	中芯上海	2013-06-26	2017-11-03	原始取得	无
3047	半导体器件的形成方法	ZL201310259951.6	中芯上海	2013-06-26	2017-09-22	原始取得	无
3048	半导体结构及其形成方法	ZL201310259955.4	中芯上海	2013-06-26	2017-09-22	原始取得	无
3049	石英管的防护方法	ZL201310259990.6	中芯上海	2013-06-26	2017-05-24	原始取得	无
3050	防止钨损失的半导体器件及相应的制造方法	ZL201310261111.3	中芯上海	2013-06-26	2018-03-30	原始取得	无
3051	测量晶圆电阻率的装置及方法	ZL201310261115.1	中芯上海	2013-06-26	2018-03-06	原始取得	无
3052	MEMS 器件及其制作方法	ZL201310261321.2	中芯上海	2013-06-26	2016-08-10	原始取得	无
3053	晶体管的形成方法	ZL201310261324.6	中芯上海	2013-06-26	2017-11-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3054	晶体管的形成方法	ZL201310261332.0	中芯上海	2013-06-26	2017-08-25	原始取得	无
3055	晶体管及其形成方法	ZL201310261335.4	中芯上海	2013-06-26	2017-03-29	原始取得	无
3056	双重图形及其形成方法	ZL201310261349.6	中芯上海	2013-06-26	2017-08-25	原始取得	无
3057	电迁移可靠性测试结构及其使用方法	ZL201310261357.0	中芯上海	2013-06-26	2017-10-31	原始取得	无
3058	半导体器件的制造方法	ZL201310261394.1	中芯上海	2013-06-26	2018-03-06	原始取得	无
3059	衬底间通孔连接结构及其制造方法	ZL201310270969.6	中芯上海	2013-06-28	2017-09-29	原始取得	无
3060	一种半导体器件浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL201310271030.1	中芯上海	2013-07-01	2017-04-19	原始取得	无
3061	半导体制造方法	ZL201310272054.9	中芯上海	2013-07-02	2017-08-25	原始取得	无
3062	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310272064.2	中芯上海	2013-07-01	2017-03-08	原始取得	无
3063	一种半导体器件的制造方法	ZL201310273049.X	中芯上海	2013-07-01	2017-11-10	原始取得	无
3064	一种形成浅沟槽隔离结构的方法	ZL201310273050.2	中芯上海	2013-07-01	2017-09-01	原始取得	无
3065	一种制作闪存的方法	ZL201310274904.9	中芯上海	2013-07-02	2017-05-10	原始取得	无
3066	一种可编程硅通孔结构及其	ZL201310275443.7	中芯上海	2013-07-02	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	制备方法						
3067	一种纳米相变 ESD 器件、纳米相变 ESD 结构及其制备方法	ZL201310275444.1	中芯上海	2013-07-02	2017-09-01	原始取得	无
3068	一种制作半导体器件的方法	ZL201310275461.5	中芯上海	2013-07-02	2017-11-14	原始取得	无
3069	绿色晶体管、电阻随机存储器及其驱动方法	ZL201310277106.1	中芯上海、中芯北京	2009-09-11	2015-11-25	原始取得	无
3070	测试结构及测试方法、对应的晶圆、熔丝的激光切割方法	ZL201310277119.9	中芯上海	2013-07-03	2018-05-01	原始取得	无
3071	晶体管及其形成方法	ZL201310277133.9	中芯上海	2013-07-03	2017-09-22	原始取得	无
3072	测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201310277149.X	中芯上海	2013-07-03	2017-11-03	原始取得	无
3073	晶圆边缘缺陷的检测方法	ZL201310277565.X	中芯上海	2013-07-03	2019-05-31	原始取得	无
3074	半导体器件和鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310277589.5	中芯上海	2013-07-03	2018-12-21	原始取得	无
3075	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310277616.9	中芯上海	2013-07-03	2017-08-25	原始取得	无
3076	硅通孔的形成方法	ZL201310277620.5	中芯上海	2013-07-03	2017-11-03	原始取得	无
3077	压力传感器及其形成方法	ZL201310277644.0	中芯上海	2013-07-03	2016-10-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3078	压力传感器及其形成方法	ZL201310277659.7	中芯上海	2013-07-03	2016-08-31	原始取得	无
3079	图像传感器的形成方法	ZL201310277684.5	中芯上海	2013-07-03	2017-11-03	原始取得	无
3080	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310277694.9	中芯上海	2013-07-03	2017-12-29	原始取得	无
3081	集成电路中可靠性分析的测试结构及其测试方法	ZL201310284563.3	中芯上海	2013-07-08	2017-06-16	原始取得	无
3082	光刻的迭对值校准方法	ZL201310284581.1	中芯上海	2013-07-08	2016-02-17	原始取得	无
3083	半导体器件的制备方法	ZL201310285557.X	中芯上海	2013-07-08	2017-04-05	原始取得	无
3084	可调节反射率膜的形成方法	ZL201310285559.9	中芯上海	2013-07-08	2017-08-25	原始取得	无
3085	半导体互连结构的制作方法	ZL201310285574.3	中芯上海	2013-07-08	2017-10-27	原始取得	无
3086	闪存单元的形成方法	ZL201310298078.1	中芯上海	2013-07-16	2017-09-26	原始取得	无
3087	快闪存储器及其形成方法	ZL201310298080.9	中芯上海	2013-07-16	2018-07-10	原始取得	无
3088	倒装芯片的测试结构、倒装芯片和倒装芯片的制作方法	ZL201310298103.6	中芯上海	2013-07-16	2017-05-24	原始取得	无
3089	互连结构的形成方法	ZL201310299375.8	中芯上海	2013-07-16	2017-09-22	原始取得	无
3090	互连结构及互连结构的形成方法	ZL201310299403.6	中芯上海	2013-07-16	2018-11-16	原始取得	无
3091	晶体管及晶体管的形成方法	ZL201310299405.5	中芯上海	2013-07-16	2017-07-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3092	无结晶体管及其制造方法	ZL201310299418.2	中芯上海	2013-07-16	2017-05-17	原始取得	无
3093	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310299419.7	中芯上海	2013-07-16	2018-03-30	原始取得	无
3094	用于多晶硅层的失效点定位的方法	ZL201310309536.7	中芯上海	2013-07-22	2017-08-04	原始取得	无
3095	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310312323.X	中芯上海	2013-07-23	2018-06-08	原始取得	无
3096	半导体互连结构、包括其的半导体器件及它们的制备方法	ZL201310312617.2	中芯上海	2013-07-23	2017-04-12	原始取得	无
3097	一种栅控二极管反熔丝单元结构及其制作方法	ZL201310313550.4	中芯上海	2013-07-24	2017-04-19	原始取得	无
3098	双重图形结构及其形成方法	ZL201310315127.8	中芯上海	2013-07-24	2017-02-08	原始取得	无
3099	晶体管及其形成方法	ZL201310315128.2	中芯上海	2013-07-24	2017-12-29	原始取得	无
3100	电容结构的形成方法	ZL201310315145.6	中芯上海	2013-07-24	2017-11-03	原始取得	无
3101	半导体结构的形成方法	ZL201310315154.5	中芯上海	2013-07-24	2018-06-01	原始取得	无
3102	极紫外光刻机光源系统及极紫外曝光方法	ZL201310315161.5	中芯上海	2013-07-24	2017-03-29	原始取得	无
3103	半导体器件的形成方法	ZL201310315199.2	中芯上海	2013-07-24	2017-07-14	原始取得	无
3104	半导体结构的形成方法	ZL201310315277.9	中芯上海	2013-07-24	2017-11-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3105	半导体结构的形成方法	ZL201310315297.6	中芯上海	2013-07-24	2017-06-13	原始取得	无
3106	极紫外光刻机光源系统及极紫外曝光方法	ZL201310315299.5	中芯上海	2013-07-24	2017-03-29	原始取得	无
3107	半导体结构及其形成方法	ZL201310315306.1	中芯上海	2013-07-24	2017-05-17	原始取得	无
3108	半导体结构的形成方法	ZL201310315308.0	中芯上海	2013-07-24	2017-05-17	原始取得	无
3109	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310315309.5	中芯上海	2013-07-24	2017-12-29	原始取得	无
3110	对准标记的成像和测量装置、光刻装置	ZL201310315310.8	中芯上海	2013-07-24	2016-08-10	原始取得	无
3111	硅通孔测试结构及其测试方法和形成方法	ZL201310315324.X	中芯上海	2013-07-24	2017-02-22	原始取得	无
3112	电熔丝结构	ZL201310315333.9	中芯上海	2013-07-24	2017-09-26	原始取得	无
3113	半导体器件的制备方法	ZL201310323523.5	中芯上海	2013-07-29	2018-03-06	原始取得	无
3114	半导体器件的制备方法	ZL201310323524.X	中芯上海	2013-07-29	2017-04-05	原始取得	无
3115	一种应力沟道 PMOS 器件及其制作方法	ZL201310323926.X	中芯上海	2013-07-29	2017-06-16	原始取得	无
3116	磁性随机存储器及其制造方法	ZL201310323978.7	中芯上海	2013-07-29	2018-12-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3117	用于双大马士革结构的蚀刻方法	ZL201310324006.X	中芯上海	2013-07-29	2017-11-14	原始取得	无
3118	一种闪存存储单元阵列	ZL201310325930.X	中芯上海	2013-07-30	2017-05-24	原始取得	无
3119	一种半导体器件及其制作方法	ZL201310326645.X	中芯上海	2013-07-30	2017-09-01	原始取得	无
3120	一种运动传感器的制备方法	ZL201310326677.X	中芯上海	2013-07-30	2016-12-28	原始取得	无
3121	半导体装置及其制造方法	ZL201310327029.6	中芯上海	2013-07-31	2017-10-31	原始取得	无
3122	半导体装置及其制造方法	ZL201310327038.5	中芯上海	2013-07-31	2017-12-26	原始取得	无
3123	亚微米级掩模版的制造方法	ZL201310330563.2	中芯上海	2013-07-31	2018-07-20	原始取得	无
3124	一种闪存存储器的制备方法	ZL201310332786.2	中芯上海	2013-08-01	2018-04-03	原始取得	无
3125	一种制作嵌入式闪存的方法	ZL201310335564.6	中芯上海	2013-08-02	2017-06-13	原始取得	无
3126	一种 TDDB 的测试结构及测试方法	ZL201310335567.X	中芯上海	2013-08-02	2017-11-10	原始取得	无
3127	一种反熔丝结构	ZL201310335568.4	中芯上海	2013-08-02	2017-04-05	原始取得	无
3128	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310335576.9	中芯上海	2013-08-02	2018-02-06	原始取得	无
3129	一种制作 FinFET 半导体器件的方法	ZL201310335581.X	中芯上海	2013-08-02	2016-12-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3130	一种半导体器件以及制作半导体器件的方法	ZL201310335597.0	中芯上海	2013-08-02	2019-07-26	原始取得	无
3131	TEM 样品的制备方法	ZL201310338128.4	中芯上海	2013-08-05	2017-05-03	原始取得	无
3132	鳍式场效应管的形成方法	ZL201310338252.0	中芯上海	2013-08-05	2017-07-14	原始取得	无
3133	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310338254.X	中芯上海	2013-08-05	2018-03-30	原始取得	无
3134	倒装芯片的封装方法和封装基板	ZL201310338262.4	中芯上海	2013-08-05	2017-05-24	原始取得	无
3135	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310338358.0	中芯上海	2013-08-05	2017-12-29	原始取得	无
3136	电熔丝结构	ZL201310338360.8	中芯上海	2013-08-05	2017-09-26	原始取得	无
3137	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310338366.5	中芯上海	2013-08-05	2018-01-02	原始取得	无
3138	MOS 晶体管的形成方法	ZL201310338368.4	中芯上海	2013-08-05	2019-11-01	原始取得	无
3139	一种半导体器件的制造方法	ZL201310340566.4	中芯上海	2013-08-06	2018-03-30	原始取得	无
3140	一种形成接触孔的方法	ZL201310340567.9	中芯上海	2013-08-06	2017-08-01	原始取得	无
3141	一种 ESD 保护器件及其制作方法	ZL201310340606.5	中芯上海	2013-08-06	2017-12-22	原始取得	无
3142	一种半导体器件及其制作的	ZL201310340761.7	中芯上海	2013-08-06	2018-03-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3143	半导体器件的形成方法	ZL201310342567.2	中芯上海	2013-08-07	2017-07-14	原始取得	无
3144	NMOS 金属栅极晶体管的形成方法	ZL201310342569.1	中芯上海	2013-08-07	2018-03-30	原始取得	无
3145	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310342916.0	中芯上海	2013-08-07	2017-07-14	原始取得	无
3146	互连结构的形成方法	ZL201310342918.X	中芯上海	2013-08-07	2017-06-13	原始取得	无
3147	半导体器件的形成方法	ZL201310342929.8	中芯上海	2013-08-07	2017-07-14	原始取得	无
3148	芯片的密封环结构	ZL201310345408.8	中芯上海	2013-08-08	2017-02-08	原始取得	无
3149	鳍式场效应晶体管结构及其制作方法	ZL201310360739.9	中芯上海	2013-08-16	2017-07-14	原始取得	无
3150	半导体集成电路生产中晶圆制造调度方法及调度系统	ZL201310365494.9	中芯上海	2013-08-20	2017-06-16	原始取得	无
3151	一种电镜样品制备方法	ZL201310365495.3	中芯上海	2013-08-20	2017-09-26	原始取得	无
3152	PMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201310365513.8	中芯上海	2013-08-20	2017-11-14	原始取得	无
3153	硅通孔的抛光方法	ZL201310365548.1	中芯上海	2013-08-20	2019-12-27	原始取得	无
3154	芯片失效分析方法及芯片失效分析标记	ZL201310365572.5	中芯上海	2013-08-20	2017-10-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3155	离子源以及离子注入装置	ZL201310365575.9	中芯上海	2013-08-20	2017-08-08	原始取得	无
3156	浮栅器件结构及其形成方法	ZL201310365601.8	中芯上海	2013-08-20	2017-12-22	原始取得	无
3157	电熔丝结构及其使用方法	ZL201310365603.7	中芯上海	2013-08-20	2017-12-29	原始取得	无
3158	半导体结构的形成方法	ZL201310365611.1	中芯上海	2013-08-20	2017-06-13	原始取得	无
3159	用于鳍式场效应晶体管的浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310365613.0	中芯上海	2013-08-20	2017-09-22	原始取得	无
3160	半导体结构的形成方法	ZL201310365614.5	中芯上海	2013-08-20	2017-06-13	原始取得	无
3161	反相器的形成方法及反相器	ZL201310365628.7	中芯上海	2013-08-20	2017-07-14	原始取得	无
3162	去除栅介质层的方法	ZL201310365793.2	中芯上海	2013-08-20	2018-02-09	原始取得	无
3163	半导体结构的形成方法	ZL201310365795.1	中芯上海	2013-08-20	2018-10-16	原始取得	无
3164	晶体管及其形成方法	ZL201310365802.8	中芯上海	2013-08-20	2017-06-16	原始取得	无
3165	相变存储器的形成方法	ZL201310365803.2	中芯上海	2013-08-20	2017-07-14	原始取得	无
3166	相变存储器及其形成方法	ZL201310365805.1	中芯上海	2013-08-20	2017-05-17	原始取得	无
3167	半导体器件及其形成方法、静态随机存储器及其形成方法	ZL201310365829.7	中芯上海	2013-08-20	2017-12-29	原始取得	无
3168	半导体图形化方法	ZL201310365836.7	中芯上海	2013-08-20	2017-11-03	原始取得	无
3169	PMOS 晶体管的形成方法及 CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310365840.3	中芯上海	2013-08-20	2017-07-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3170	隧道场效应晶体管及其形成方法	ZL201310365871.9	中芯上海	2013-08-20	2017-12-29	原始取得	无
3171	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310365874.2	中芯上海	2013-08-20	2018-07-10	原始取得	无
3172	CMOS 结构的形成方法	ZL201310365882.7	中芯上海	2013-08-20	2017-05-17	原始取得	无
3173	导电插塞的形成方法	ZL201310379843.2	中芯上海	2013-08-27	2017-12-01	原始取得	无
3174	一种 TEM 样品的制备方法	ZL201310379861.0	中芯上海	2013-08-27	2017-02-22	原始取得	无
3175	一种芯片失效分析样品的制备方法	ZL201310379862.5	中芯上海	2013-08-27	2017-03-29	原始取得	无
3176	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310379938.4	中芯上海	2013-08-27	2017-10-20	原始取得	无
3177	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310379947.3	中芯上海	2013-08-27	2018-12-21	原始取得	无
3178	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310379961.3	中芯上海	2013-08-27	2017-07-14	原始取得	无
3179	半导体器件及形成方法	ZL201310379965.1	中芯上海	2013-08-27	2017-06-16	原始取得	无
3180	在制品测量采样方法及装置	ZL201310380160.9	中芯上海	2013-08-28	2017-08-04	原始取得	无
3181	一种半导体器件的制造方法	ZL201310380190.X	中芯上海	2013-08-27	2017-06-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3182	双镶嵌结构的形成方法	ZL201310380203.3	中芯上海	2013-08-27	2017-12-01	原始取得	无
3183	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310380205.2	中芯上海	2013-08-27	2017-07-14	原始取得	无
3184	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310382846.1	中芯上海	2013-08-28	2018-12-21	原始取得	无
3185	图形化方法	ZL201310382866.9	中芯上海	2013-08-28	2017-12-01	原始取得	无
3186	电容式压力传感器及其形成方法	ZL201310382867.3	中芯上海	2013-08-28	2016-12-28	原始取得	无
3187	半导体结构的形成方法,	ZL201310382868.8	中芯上海	2013-08-28	2017-09-22	原始取得	无
3188	半导体结构及其形成方法	ZL201310382881.3	中芯上海	2013-08-28	2017-06-13	原始取得	无
3189	多晶硅栅极的形成方法	ZL201310383307.X	中芯上海	2013-08-28	2017-06-16	原始取得	无
3190	图形化方法	ZL201310383308.4	中芯上海	2013-08-28	2018-09-07	原始取得	无
3191	图形化方法	ZL201310383321.X	中芯上海	2013-08-28	2017-11-03	原始取得	无
3192	电容式压力传感器及其形成方法	ZL201310383322.4	中芯上海	2013-08-28	2017-03-01	原始取得	无
3193	半导体结构的形成方法	ZL201310398623.4	中芯上海	2013-09-04	2018-07-10	原始取得	无
3194	布局图形的检查方法	ZL201310398625.3	中芯上海	2013-09-04	2018-07-10	原始取得	无
3195	晶体管及晶体管的形成方法	ZL201310398638.0	中芯上海	2013-09-04	2017-12-01	原始取得	无
3196	CMOS 反相器的栅极的形成方	ZL201310398646.5	中芯上海	2013-09-04	2017-07-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3197	半导体器件的缺陷检测方法及装置	ZL201310398712.9	中芯上海	2013-09-04	2017-09-22	原始取得	无
3198	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310398715.2	中芯上海	2013-09-04	2017-06-16	原始取得	无
3199	检测结构及其形成方法、检测方法	ZL201310398726.0	中芯上海	2013-09-04	2017-09-22	原始取得	无
3200	一种半导体器件	ZL201310398727.5	中芯上海	2013-09-04	2017-05-17	原始取得	无
3201	晶体管的形成方法	ZL201310398728.X	中芯上海	2013-09-04	2017-12-29	原始取得	无
3202	半导体器件及半导体器件的形成方法	ZL201310398733.0	中芯上海	2013-09-04	2018-12-21	原始取得	无
3203	半导体结构的形成方法	ZL201310398736.4	中芯上海	2013-09-04	2017-12-29	原始取得	无
3204	一种 MOM 电容器	ZL201310398737.9	中芯上海	2013-09-04	2017-12-29	原始取得	无
3205	鳍式场效应晶体管及其形成方法、半导体器件	ZL201310398738.3	中芯上海	2013-09-04	2018-03-06	原始取得	无
3206	隧穿场效应晶体管及其形成方法	ZL201310398740.0	中芯上海	2013-09-04	2017-12-01	原始取得	无
3207	一种金属薄膜电阻率的测量	ZL201310398839.0	中芯上海	2013-09-05	2018-04-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3208	导电插塞的形成方法	ZL201310401291.0	中芯上海	2013-09-05	2017-05-17	原始取得	无
3209	无结晶体管及其制作方法	ZL201310401293.X	中芯上海	2013-09-05	2017-07-14	原始取得	无
3210	过刻蚀率的测试结构及其形成方法、过刻蚀率的测量方法	ZL201310401295.9	中芯上海	2013-09-05	2017-07-14	原始取得	无
3211	CMOS 反相器栅极的形成方法	ZL201310401303.X	中芯上海	2013-09-05	2017-09-26	原始取得	无
3212	通孔的形成方法	ZL201310401307.8	中芯上海	2013-09-05	2017-12-29	原始取得	无
3213	测量导电层厚度的方法	ZL201310401311.4	中芯上海	2013-09-05	2018-10-16	原始取得	无
3214	互连结构及其形成方法	ZL201310401313.3	中芯上海	2013-09-05	2018-07-10	原始取得	无
3215	互连线的形成方法	ZL201310401315.2	中芯上海	2013-09-05	2017-07-14	原始取得	无
3216	化学清洗装置	ZL201310401334.5	中芯上海	2013-09-05	2017-07-14	原始取得	无
3217	半导体器件的制备方法	ZL201310407704.6	中芯上海	2013-09-09	2017-10-17	原始取得	无
3218	半导体器件结构及其形成方法	ZL201310407723.9	中芯上海	2013-09-09	2018-08-14	原始取得	无
3219	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201310407724.3	中芯上海	2013-09-09	2018-06-01	原始取得	无
3220	连接线的形成方法	ZL201310407726.2	中芯上海	2013-09-09	2017-09-29	原始取得	无
3221	半导体器件的制造方法	ZL201310407727.7	中芯上海	2013-09-09	2017-11-14	原始取得	无
3222	浅沟槽隔离结构边沟问题的	ZL201310407941.2	中芯上海	2013-09-09	2017-06-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	测试结构和方法						
3223	半导体器件的制备方法	ZL201310407943.1	中芯上海	2013-09-09	2017-07-11	原始取得	无
3224	集成无源器件的结构及制造方法	ZL201310407947.X	中芯上海	2013-09-09	2018-08-24	原始取得	无
3225	半导体器件的形成方法	ZL201310407948.4	中芯上海	2013-09-09	2018-08-24	原始取得	无
3226	浅沟槽隔离的制备方法	ZL201310407961.X	中芯上海	2013-09-09	2017-12-08	原始取得	无
3227	用于非晶硅沉积的炉管底座	ZL201310407964.3	中芯上海	2013-09-09	2017-02-08	原始取得	无
3228	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310410801.0	中芯上海	2013-09-10	2017-10-20	原始取得	无
3229	一种半导体器件的制造方法	ZL201310410802.5	中芯上海	2013-09-10	2017-09-01	原始取得	无
3230	一种微型沟槽的测试结构及测试方法	ZL201310410805.9	中芯上海	2013-09-10	2018-08-21	原始取得	无
3231	一种反熔丝结构	ZL201310410836.4	中芯上海	2013-09-10	2019-04-09	原始取得	无
3232	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310411038.3	中芯上海	2013-09-10	2017-08-01	原始取得	无
3233	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310411051.9	中芯上海	2013-09-10	2017-08-01	原始取得	无
3234	一种半导体器件的制造方法	ZL201310411054.2	中芯上海	2013-09-10	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3235	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310411062.7	中芯上海	2013-09-10	2017-09-01	原始取得	无
3236	一种半导体器件的制备方法	ZL201310411063.1	中芯上海	2013-09-10	2017-06-16	原始取得	无
3237	一种监控栅氧化层掺氮量漂移的测试结构及方法	ZL201310413057.X	中芯上海	2013-09-11	2017-05-10	原始取得	无
3238	一种测试结构失效分析方法	ZL201310413335.1	中芯上海	2013-09-11	2017-05-10	原始取得	无
3239	光刻胶图形的形成方法、晶体管栅极的形成方法	ZL201310424744.1	中芯上海	2013-09-17	2017-12-29	原始取得	无
3240	磁性隧道结及其形成方法	ZL201310424875.X	中芯上海	2013-09-17	2017-02-22	原始取得	无
3241	P 型鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310424882.X	中芯上海	2013-09-17	2017-09-29	原始取得	无
3242	一种半导体器件及其形成方法	ZL201310424885.3	中芯上海	2013-09-17	2017-12-01	原始取得	无
3243	晶体管及其形成方法	ZL201310425291.4	中芯上海	2013-09-17	2018-03-30	原始取得	无
3244	PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201310425758.5	中芯上海	2013-09-17	2018-10-16	原始取得	无
3245	形成栅极的方法	ZL201310425760.2	中芯上海	2013-09-17	2017-12-01	原始取得	无
3246	互补 TFET 及其制造方法	ZL201310428652.0	中芯上海	2013-09-22	2017-10-20	原始取得	无
3247	半导体器件的制作方法	ZL201310429739.X	中芯上海	2013-09-18	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3248	测试结构和对应的测试方法	ZL201310429747.4	中芯上海	2013-09-18	2017-02-22	原始取得	无
3249	半导体器件及形成方法	ZL201310429750.6	中芯上海	2013-09-18	2017-06-13	原始取得	无
3250	用于获取晶圆级键合结构电阻的方法及其半导体结构	ZL201310430011.9	中芯上海	2013-09-18	2017-06-16	原始取得	无
3251	半导体器件的制作方法	ZL201310430036.9	中芯上海	2013-09-18	2018-06-01	原始取得	无
3252	半导体器件的形成方法	ZL201310430040.5	中芯上海	2013-09-18	2017-12-29	原始取得	无
3253	一种闪存存储器的制作方法	ZL201310432541.7	中芯上海	2013-09-22	2017-07-28	原始取得	无
3254	频率产生装置、方法与设备	ZL201310433310.8	中芯上海	2013-09-23	2017-05-17	原始取得	无
3255	MOS 晶体管源漏形成方法	ZL201310435686.2	中芯上海	2013-09-23	2017-07-28	原始取得	无
3256	监测源/漏极与栅极接合处漏电流和结电容的结构	ZL201310435701.3	中芯上海	2013-09-23	2018-02-09	原始取得	无
3257	集成电路的可靠性分析测试结构及其测试方法	ZL201310435704.7	中芯上海	2013-09-23	2017-10-27	原始取得	无
3258	半导体器件的制备方法	ZL201310435716.X	中芯上海	2013-09-23	2017-08-25	原始取得	无
3259	静电保护用可控硅结构	ZL201310435717.4	中芯上海	2013-09-23	2017-06-09	原始取得	无
3260	NMOS 晶体管结构及其制造方法	ZL201310435732.9	中芯上海	2013-09-23	2017-06-23	原始取得	无
3261	金属互连层的形成方法	ZL201310438334.2	中芯上海	2013-09-23	2018-01-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3262	穿透硅通孔结构的形成方法以及集成电路制造方法	ZL201310438557.9	中芯上海	2013-09-23	2018-03-16	原始取得	无
3263	降低 MOS 晶体管短沟道效应的方法	ZL201310438559.8	中芯上海	2013-09-23	2018-03-06	原始取得	无
3264	无源器件结构及其形成方法	ZL201310438676.4	中芯上海	2013-09-23	2017-06-09	原始取得	无
3265	仿真方法以及仿真系统	ZL201310438680.0	中芯上海	2013-09-23	2017-04-05	原始取得	无
3266	硅通孔填充结构以及硅通孔的填充方法	ZL201310438705.7	中芯上海	2013-09-23	2018-07-20	原始取得	无
3267	ESD 防护器件及其制备方法	ZL201310438760.6	中芯上海	2013-09-23	2017-06-23	原始取得	无
3268	重复性缺陷的分析方法	ZL201310438764.4	中芯上海	2013-09-23	2017-05-17	原始取得	无
3269	检测结构及检测方法	ZL201310439124.5	中芯上海	2013-09-24	2017-09-26	原始取得	无
3270	栅极制作方法	ZL201310439144.2	中芯上海	2013-09-24	2017-09-22	原始取得	无
3271	晶振的形成方法	ZL201310439580.X	中芯上海	2013-09-24	2016-02-17	原始取得	无
3272	MEMS 器件形成方法	ZL201310439622.X	中芯上海	2013-09-24	2016-08-03	原始取得	无
3273	半导体测试结构	ZL201310442521.8	中芯上海	2013-09-24	2017-07-14	原始取得	无
3274	MOS 晶体管及对应的形成方法	ZL201310442522.2	中芯上海	2013-09-24	2017-09-22	原始取得	无
3275	缺陷分析法	ZL201310444792.7	中芯上海	2013-09-23	2017-07-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3276	嵌入式源/漏 MOS 晶体管的制造方法	ZL201310444795.0	中芯上海	2013-09-23	2017-07-28	原始取得	无
3277	闪存器件的测试结构及其制造方法	ZL201310446024.5	中芯上海	2013-09-23	2017-10-27	原始取得	无
3278	分离栅闪存结构的形成方法	ZL201310446046.1	中芯上海	2013-09-23	2017-12-08	原始取得	无
3279	硅通孔的形成方法	ZL201310449898.6	中芯上海	2013-09-24	2018-03-30	原始取得	无
3280	晶振的形成方法	ZL201310449899.0	中芯上海	2013-09-24	2017-08-25	原始取得	无
3281	硅通孔的形成方法	ZL201310450092.9	中芯上海	2013-09-24	2017-11-03	原始取得	无
3282	一种优化光学临近修正拟合结果的方法	ZL201310451397.1	中芯上海	2013-09-27	2017-03-08	原始取得	无
3283	一种制作半导体器件的方法	ZL201310451411.8	中芯上海	2013-09-27	2018-07-20	原始取得	无
3284	一种半导体器件的制造方法	ZL201310451415.6	中芯上海	2013-09-27	2018-06-08	原始取得	无
3285	一种半导体器件的制作方法	ZL201310454311.0	中芯上海	2013-09-27	2017-07-07	原始取得	无
3286	一种半导体器件及其制作方法	ZL201310454314.4	中芯上海	2013-09-27	2018-10-19	原始取得	无
3287	一种制作半导体器件的方法	ZL201310454685.2	中芯上海	2013-09-27	2018-02-06	原始取得	无
3288	一种制作半导体器件的方法	ZL201310454689.0	中芯上海	2013-09-27	2017-11-14	原始取得	无
3289	一种半导体器件的制造方法	ZL201310454692.2	中芯上海	2013-09-27	2017-09-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3290	半导体存储控制单元、集成电路及集成电路的制造方法	ZL201310455095.1	中芯上海	2013-09-27	2019-01-22	原始取得	无
3291	图像传感单元及其形成方法	ZL201310455828.1	中芯上海	2013-09-29	2018-09-07	原始取得	无
3292	半导体器件的形成方法	ZL201310455829.6	中芯上海	2013-09-29	2017-09-22	原始取得	无
3293	晶体管的制作方法	ZL201310455830.9	中芯上海	2013-09-29	2017-12-29	原始取得	无
3294	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310456090.0	中芯上海	2013-09-29	2017-09-22	原始取得	无
3295	一种制作半导体器件的方法	ZL201310459542.0	中芯上海	2013-09-27	2018-07-20	原始取得	无
3296	一种制作半导体器件的方法	ZL201310459548.8	中芯上海	2013-09-27	2017-11-14	原始取得	无
3297	一种半导体器件的制造方法	ZL201310459557.7	中芯上海	2013-09-27	2018-06-08	原始取得	无
3298	一种制作半导体器件的方法	ZL201310459990.0	中芯上海	2013-09-27	2017-09-01	原始取得	无
3299	一种制作半导体器件的方法	ZL201310460013.2	中芯上海	2013-09-27	2017-10-20	原始取得	无
3300	磁性隧道结的形成方法	ZL201310460145.5	中芯上海	2013-09-29	2018-02-16	原始取得	无
3301	相变存储器及其形成方法	ZL201310460164.8	中芯上海	2013-09-29	2017-11-03	原始取得	无
3302	测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201310460181.1	中芯上海	2013-09-29	2017-06-13	原始取得	无
3303	半导体结构及其形成方法	ZL201310460183.0	中芯上海	2013-09-29	2018-10-16	原始取得	无
3304	无结晶体管及其形成方法	ZL201310460185.X	中芯上海	2013-09-29	2017-07-14	原始取得	无
3305	硅基液晶面板的制作方法	ZL201310460926.4	中芯上海	2013-09-29	2017-09-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3306	隔离结构的形成方法	ZL201310462446.1	中芯上海	2013-09-30	2018-07-10	原始取得	无
3307	数字微镜器件的形成方法	ZL201310462456.5	中芯上海	2013-09-30	2017-02-08	原始取得	无
3308	快闪存储器的形成方法	ZL201310463674.0	中芯上海	2013-09-30	2017-09-22	原始取得	无
3309	建立 OPC 模型的方法、布局图形的检查方法	ZL201310463702.9	中芯上海	2013-09-30	2018-10-16	原始取得	无
3310	晶体管的形成方法	ZL201310463703.3	中芯上海	2013-09-30	2018-02-16	原始取得	无
3311	键合基底及其形成方法、三维封装结构及其形成方法	ZL201310463714.1	中芯上海	2013-09-30	2017-09-22	原始取得	无
3312	SRAM 单元	ZL201310464309.1	中芯上海	2013-09-30	2017-09-22	原始取得	无
3313	数字微镜器件的形成方法	ZL201310464324.6	中芯上海	2013-09-30	2017-09-26	原始取得	无
3314	一种监控浅掺杂漏离子注入角度偏移的测试结构及方法	ZL201310467477.6	中芯上海	2013-10-09	2017-09-22	原始取得	无
3315	一种反熔丝结构	ZL201310471001.X	中芯上海	2013-10-10	2018-10-23	原始取得	无
3316	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310471004.3	中芯上海	2013-10-10	2018-09-21	原始取得	无
3317	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310471016.6	中芯上海	2013-10-10	2018-09-21	原始取得	无
3318	一种半导体器件及其制造方	ZL201310471092.7	中芯上海	2013-10-10	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法和电子装置						
3319	一种金属熔丝结构	ZL201310471662.2	中芯上海	2013-10-10	2018-04-13	原始取得	无
3320	从多芯片封装结构中获取底层芯片的方法	ZL201310472781.X	中芯上海	2013-10-11	2018-02-27	原始取得	无
3321	一种半导体器件的制造方法	ZL201310473656.0	中芯上海	2013-10-11	2017-12-05	原始取得	无
3322	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310473657.5	中芯上海	2013-10-11	2017-10-20	原始取得	无
3323	LDMOS 及其制造方法	ZL201310473815.7	中芯上海	2013-10-12	2018-01-05	原始取得	无
3324	鳍式场效应管及其制作方法	ZL201310479778.0	中芯上海	2013-10-14	2018-07-20	原始取得	无
3325	鳍式场效应管及其制作方法	ZL201310479801.6	中芯上海	2013-10-14	2017-11-21	原始取得	无
3326	一种反熔丝结构	ZL201310482866.6	中芯上海	2013-10-15	2017-10-20	原始取得	无
3327	一种接合焊盘结构	ZL201310482869.X	中芯上海	2013-10-15	2017-09-01	原始取得	无
3328	一种缺口线端的 OPC 修正方法	ZL201310485216.7	中芯上海	2013-10-16	2019-06-28	原始取得	无
3329	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310485342.2	中芯上海	2013-10-16	2018-03-16	原始取得	无
3330	补偿关键尺寸扫描电子显微镜检测图案倾斜的方法	ZL201310489519.6	中芯上海	2013-10-18	2017-09-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3331	SEM 样品的制备方法	ZL201310492652.7	中芯上海	2013-10-18	2017-05-03	原始取得	无
3332	一种半导体器件的制备方法	ZL201310492653.1	中芯上海	2013-10-18	2017-07-14	原始取得	无
3333	一种 TEM 样品的制备方法	ZL201310492791.X	中芯上海	2013-10-18	2017-05-17	原始取得	无
3334	一种 PMOS 器件及其制备方法	ZL201310492816.6	中芯上海	2013-10-18	2018-02-06	原始取得	无
3335	一种鳍式场效应管的制备方法	ZL201310492818.5	中芯上海	2013-10-18	2018-05-04	原始取得	无
3336	一种磁隧道结、其制造方法及含磁隧道结的存储单元	ZL201310492822.1	中芯上海	2013-10-18	2017-05-17	原始取得	无
3337	一种集成无源器件的制备方法	ZL201310493375.1	中芯上海	2013-10-18	2017-09-01	原始取得	无
3338	一种制作半导体器件的方法	ZL201310496523.5	中芯上海	2013-10-21	2017-10-20	原始取得	无
3339	一种寄生 FinFET 的横向双扩散半导体器件	ZL201310496879.9	中芯上海	2013-10-21	2018-02-06	原始取得	无
3340	一种制作嵌入分离栅极式闪存栅极的方法	ZL201310501141.7	中芯上海	2013-10-22	2017-11-10	原始取得	无
3341	一种制作半导体器件的方法	ZL201310502941.0	中芯上海	2013-10-22	2017-10-20	原始取得	无
3342	一种化学机械研磨的方法	ZL201310502944.4	中芯上海	2013-10-22	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3343	TEM 分析样品的制备方法	ZL201310503887.1	中芯上海	2013-10-23	2017-03-15	原始取得	无
3344	半导体结构形成方法	ZL201310504863.8	中芯上海	2013-10-23	2017-08-25	原始取得	无
3345	基于硅通孔技术的三维封装方法	ZL201310504865.7	中芯上海、中芯宁波	2013-10-23	2018-08-10	原始取得	无
3346	半导体器件及其形成方法	ZL201310504875.0	中芯上海	2013-10-23	2017-09-22	原始取得	无
3347	晶圆减薄方法	ZL201310504876.5	中芯上海	2013-10-23	2018-06-01	原始取得	无
3348	测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201310504880.1	中芯上海	2013-10-23	2016-04-20	原始取得	无
3349	硅通孔的形成方法	ZL201310504882.0	中芯上海	2013-10-23	2017-09-22	原始取得	无
3350	化学机械研磨方法	ZL201310504885.4	中芯上海	2013-10-23	2017-09-22	原始取得	无
3351	隔离结构及其形成方法	ZL201310505093.9	中芯上海	2013-10-23	2018-08-10	原始取得	无
3352	光学邻近修正方法	ZL201310505098.1	中芯上海	2013-10-23	2018-10-16	原始取得	无
3353	半导体结构及其形成方法	ZL201310505108.1	中芯上海	2013-10-23	2017-09-22	原始取得	无
3354	测试结构及其形成方法、测试结构的测试方法	ZL201310505134.4	中芯上海	2013-10-23	2017-09-26	原始取得	无
3355	图像传感单元及其形成方法	ZL201310505156.0	中芯上海	2013-10-23	2017-09-22	原始取得	无
3356	一种避免通孔金属发生电化学腐蚀的处理方法	ZL201310517771.3	中芯上海	2013-10-28	2017-12-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3357	一种晶圆版图的 CDSEM 测量方法	ZL201310520068.8	中芯上海	2013-10-29	2018-03-20	原始取得	无
3358	涂层材料的光刻方法	ZL201310520177.X	中芯上海	2013-10-29	2019-05-31	原始取得	无
3359	防止铜扩散的双层阻挡层及相应的制造方法	ZL201310520214.7	中芯上海	2013-10-29	2017-08-08	原始取得	无
3360	栅极氧化层的制造方法	ZL201310520215.1	中芯上海	2013-10-29	2018-03-06	原始取得	无
3361	控片及涂胶显影机中喷嘴的检测方法	ZL201310520271.5	中芯上海	2013-10-29	2017-12-22	原始取得	无
3362	一种制作半导体器件的方法	ZL201310522011.1	中芯上海	2013-10-28	2017-10-20	原始取得	无
3363	超深孔等离子刻蚀工艺后关键尺寸一致性的控制方法	ZL201310522892.7	中芯上海	2013-10-29	2016-12-07	原始取得	无
3364	电迁移测试方法及结构	ZL201310524353.7	中芯上海	2013-10-29	2017-08-25	原始取得	无
3365	测试结构及其制造方法和牺牲层刻蚀工艺的监控方法	ZL201310524364.5	中芯上海	2013-10-29	2017-10-31	原始取得	无
3366	多栅极晶体管及其制备方法	ZL201310524373.4	中芯上海	2013-10-29	2018-04-27	原始取得	无
3367	半导体器件的制备方法	ZL201310529013.3	中芯上海	2013-10-29	2017-11-24	原始取得	无
3368	自偏置锁相环	ZL201310530018.8	中芯上海	2013-10-31	2018-07-10	原始取得	无
3369	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201310541695.X	中芯上海	2013-11-05	2017-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3370	金属栅极的形成方法	ZL201310541712.X	中芯上海	2013-11-05	2017-09-29	原始取得	无
3371	半导体器件结构及其制作方法	ZL201310541713.4	中芯上海	2013-11-05	2017-09-22	原始取得	无
3372	气体传感器及其形成方法	ZL201310541714.9	中芯上海	2013-11-05	2017-12-29	原始取得	无
3373	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310541727.6	中芯上海	2013-11-05	2018-06-01	原始取得	无
3374	圆筒形掩模板的涂布装置和涂布方法	ZL201310541729.5	中芯上海	2013-11-05	2019-03-12	原始取得	无
3375	金属栅极的形成方法	ZL201310542003.3	中芯上海	2013-11-05	2017-11-28	原始取得	无
3376	形成层间互连线结构的方法	ZL201310542067.3	中芯上海	2013-11-05	2019-09-27	原始取得	无
3377	晶圆级封装方法	ZL201310542070.5	中芯上海、中芯宁波	2013-11-05	2018-09-14	原始取得	无
3378	电容式 MEMS 惯性传感器的形成方法	ZL201310542227.4	中芯上海	2013-11-05	2016-03-16	原始取得	无
3379	建立 OPC 模型的方法、光学邻近校准用户目标图形的方法	ZL201310542524.9	中芯上海	2013-11-05	2019-01-22	原始取得	无
3380	一种制作半导体器件的方法	ZL201310542586.X	中芯上海	2013-11-05	2017-11-14	原始取得	无
3381	压力传感器及其形成方法	ZL201310542786.5	中芯上海	2013-11-05	2017-11-28	原始取得	无
3382	快闪存储器及其形成方法	ZL201310542809.2	中芯上海	2013-11-05	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3383	测试键结构及其形成方法	ZL201310542821.3	中芯上海	2013-11-05	2017-08-25	原始取得	无
3384	半导体器件的形成方法	ZL201310542823.2	中芯上海	2013-11-05	2018-03-06	原始取得	无
3385	半导体结构及其形成方法	ZL201310542825.1	中芯上海	2013-11-05	2018-02-16	原始取得	无
3386	沟道区应变的测量方法	ZL201310543023.2	中芯上海	2013-11-05	2017-09-22	原始取得	无
3387	压力传感器及其形成方法	ZL201310543025.1	中芯上海	2013-11-05	2018-03-06	原始取得	无
3388	晶体管及其制作方法	ZL201310543037.4	中芯上海	2013-11-05	2018-08-10	原始取得	无
3389	SRAM 存储单元阵列、SRAM 存储器及其控制方法	ZL201310548823.3	中芯上海	2013-11-07	2017-11-14	原始取得	无
3390	SRAM 存储单元阵列、SRAM 存储器及其控制方法	ZL201310552338.3	中芯上海	2013-11-07	2017-12-05	原始取得	无
3391	SRAM 存储单元阵列、SRAM 存储器及其控制方法	ZL201310552340.0	中芯上海	2013-11-07	2017-11-10	原始取得	无
3392	浅沟槽隔离结构及其制备方法	ZL201310553598.2	中芯上海	2013-11-08	2017-10-20	原始取得	无
3393	一种具有栅偏压补偿的 MOS 晶体管电路	ZL201310553599.7	中芯上海	2013-11-08	2017-10-20	原始取得	无
3394	一种鳍式场效应晶体管及其制备方法	ZL201310557069.X	中芯上海	2013-11-11	2017-10-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3395	MOS 晶体管及其制备方法	ZL201310557545.8	中芯上海	2013-11-11	2018-04-17	原始取得	无
3396	闪存存储单元及其制备方法	ZL201310557571.0	中芯上海	2013-11-11	2017-10-20	原始取得	无
3397	场效应晶体管、半导体器件及其制造方法	ZL201310562469.X	中芯上海	2013-11-12	2017-11-21	原始取得	无
3398	半导体器件收缩尺寸的封装结构及方法	ZL201310567418.6	中芯上海	2013-11-14	2017-12-22	原始取得	无
3399	一种半导体器件的制作方法	ZL201310567441.5	中芯上海	2013-11-14	2018-08-14	原始取得	无
3400	用于栅介质完整性的测试结构及其测试方法	ZL201310567444.9	中芯上海	2013-11-14	2018-04-27	原始取得	无
3401	套刻对准标记及其测量方法	ZL201310567482.4	中芯上海	2013-11-14	2017-08-25	原始取得	无
3402	CMOS 图像传感器的孔洞中金属丢失的解决方法	ZL201310567485.8	中芯上海	2013-11-14	2017-09-22	原始取得	无
3403	偏差修正方法	ZL201310567502.8	中芯上海	2013-11-14	2018-06-01	原始取得	无
3404	制作非对称 FinFET 的方法	ZL201310567526.3	中芯上海	2013-11-14	2018-03-20	原始取得	无
3405	应用自对准双构图技术制作半导体器件的方法	ZL201310567557.9	中芯上海	2013-11-14	2017-11-10	原始取得	无
3406	光阻剂剩余量的监测装置、监控方法和芯片制造装置	ZL201310577894.6	中芯上海	2013-11-18	2017-10-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3407	蚀刻方法、半导体器件	ZL201310582336.9	中芯上海	2013-11-19	2017-12-29	原始取得	无
3408	上拉电阻电路	ZL201310582339.2	中芯上海	2013-11-19	2018-04-27	原始取得	无
3409	上拉电阻电路	ZL201310582609.X	中芯上海	2013-11-19	2018-06-01	原始取得	无
3410	晶圆正面的器件图形与背面的背孔对准的检测方法	ZL201310582610.2	中芯上海	2013-11-19	2017-09-22	原始取得	无
3411	金属插塞的形成方法	ZL201310582617.4	中芯上海	2013-11-19	2018-03-30	原始取得	无
3412	通孔的形成方法	ZL201310582619.3	中芯上海	2013-11-19	2017-09-22	原始取得	无
3413	测量硅化物层片电阻值的方法及结构	ZL201310582626.3	中芯上海	2013-11-19	2017-06-16	原始取得	无
3414	晶圆处理方法	ZL201310582750.X	中芯上海	2013-11-19	2017-08-25	原始取得	无
3415	半导体晶片的键合减薄优化方法	ZL201310582811.2	中芯上海	2013-11-19	2018-03-30	原始取得	无
3416	曝光方法及系统,曝光设备控制系统	ZL201310582812.7	中芯上海	2013-11-19	2016-08-31	原始取得	无
3417	检测半导体器件图形的方法及系统	ZL201310583027.3	中芯上海	2013-11-19	2017-09-22	原始取得	无
3418	一种开孔的清洗方法	ZL201310583029.2	中芯上海	2013-11-19	2018-06-01	原始取得	无
3419	一种对场效应晶体管进行建	ZL201310583177.4	中芯上海	2013-11-19	2017-12-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	模的方法及电路仿真方法						
3420	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310585587.2	中芯上海	2013-11-19	2017-11-14	原始取得	无
3421	快闪存储器及其形成方法	ZL201310585791.4	中芯上海	2013-11-19	2017-11-03	原始取得	无
3422	MEMS 器件的接触插塞及其形成方法	ZL201310585822.6	中芯上海	2013-11-19	2016-03-16	原始取得	无
3423	半导体器件的形成方法	ZL201310588957.8	中芯上海	2013-11-19	2017-06-13	原始取得	无
3424	一种反熔丝结构、半导体器件和硅通孔的修复方法	ZL201310589538.6	中芯上海	2013-11-20	2018-03-20	原始取得	无
3425	通孔的形成方法	ZL201310589696.1	中芯上海	2013-11-19	2017-12-01	原始取得	无
3426	制作高 k 金属栅晶体管的接触孔的方法	ZL201310591094.X	中芯上海	2013-11-21	2018-06-05	原始取得	无
3427	一种压力传感器及其制备方法	ZL201310593892.6	中芯上海	2013-11-21	2017-04-05	原始取得	无
3428	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310594715.X	中芯上海	2013-11-21	2017-10-20	原始取得	无
3429	一种用于测量硅化物电阻的测试结构	ZL201310594762.4	中芯上海	2013-11-21	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3430	一种改善半导体样品定点研磨过程中平坦性的方法	ZL201310596022.4	中芯上海	2013-11-21	2018-05-04	原始取得	无
3431	一种磁阻内存单元的制造方法	ZL201310596402.8	中芯上海	2013-11-22	2018-07-20	原始取得	无
3432	一种蚀刻栅极介电层的方法	ZL201310597012.2	中芯上海	2013-11-22	2017-11-10	原始取得	无
3433	一种 LDMOS 晶体管结构及其制备方法	ZL201310597408.7	中芯上海	2013-11-22	2017-07-14	原始取得	无
3434	芯片封装体的开封方法	ZL201310597783.1	中芯上海	2013-11-22	2018-06-08	原始取得	无
3435	用于自对准双构图技术的关键尺寸补偿方法	ZL201310598204.5	中芯上海	2013-11-22	2017-11-10	原始取得	无
3436	闪存单元形成方法	ZL201310612087.3	中芯上海	2013-11-26	2018-03-06	原始取得	无
3437	半导体器件的形成方法	ZL201310612553.8	中芯上海	2013-11-26	2018-06-01	原始取得	无
3438	版图修正方法及设备	ZL201310612554.2	中芯上海	2013-11-26	2018-10-16	原始取得	无
3439	测试图形的标记方法和标记装置	ZL201310612564.6	中芯上海	2013-11-26	2019-03-12	原始取得	无
3440	晶体管及其形成方法	ZL201310612576.9	中芯上海	2013-11-26	2018-05-01	原始取得	无
3441	接触孔及其形成方法	ZL201310612577.3	中芯上海	2013-11-26	2017-09-22	原始取得	无
3442	一种提高湿法蚀刻效率的方	ZL201310613330.3	中芯上海	2013-11-27	2017-11-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3443	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310616492.2	中芯上海	2013-11-27	2018-05-04	原始取得	无
3444	半导体器件和栅极的形成方法	ZL201310616514.5	中芯上海	2013-11-27	2017-11-03	原始取得	无
3445	器件表面的保护方法	ZL201310616516.4	中芯上海	2013-11-27	2017-07-14	原始取得	无
3446	电性匹配的对称电路的获取方法	ZL201310616533.8	中芯上海	2013-11-27	2019-03-12	原始取得	无
3447	半导体器件和栅极的形成方法	ZL201310617880.2	中芯上海	2013-11-27	2017-11-03	原始取得	无
3448	一种半导体器件及其形成方法	ZL201310617894.4	中芯上海	2013-11-27	2016-08-31	原始取得	无
3449	半导体器件的形成方法	ZL201310617898.2	中芯上海	2013-11-27	2018-09-07	原始取得	无
3450	半导体结构的形成方法	ZL201310617901.0	中芯上海	2013-11-27	2017-12-29	原始取得	无
3451	半导体结构的形成方法	ZL201310617911.4	中芯上海	2013-11-27	2018-08-10	原始取得	无
3452	晶体管的形成方法	ZL201310617916.7	中芯上海	2013-11-27	2018-07-10	原始取得	无
3453	一种集成电路及其制造方法和电子装置	ZL201310627052.7	中芯上海	2013-11-28	2017-11-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3454	一种集成电路及其制造方法和电子装置	ZL201310627131.8	中芯上海	2013-11-28	2017-12-05	原始取得	无
3455	一种集成电路及其制造方法和电子装置	ZL201310627590.6	中芯上海	2013-11-28	2017-11-10	原始取得	无
3456	一种离子注入测试方法、测试结构和半导体器件	ZL201310627594.4	中芯上海	2013-11-28	2017-11-10	原始取得	无
3457	一种集成电路及其制造方法和电子装置	ZL201310627667.X	中芯上海	2013-11-28	2017-11-14	原始取得	无
3458	一种半导体器件的制造方法	ZL201310630320.0	中芯上海	2013-11-29	2018-06-08	原始取得	无
3459	半导体器件及其制作方法	ZL201310631600.3	中芯上海	2013-11-29	2017-11-10	原始取得	无
3460	一种半导体器件的制造方法	ZL201310631753.8	中芯上海	2013-11-29	2017-11-14	原始取得	无
3461	一种半导体存储器件及其制备方法	ZL201310631754.2	中芯上海	2013-11-29	2017-11-10	原始取得	无
3462	一种制作半导体器件的方法	ZL201310631755.7	中芯上海	2013-11-29	2017-12-05	原始取得	无
3463	一种 FinFET 器件及其制造方法	ZL201310631893.5	中芯上海	2013-11-29	2017-11-14	原始取得	无
3464	制作 FinFET 的方法	ZL201310636675.0	中芯上海	2013-11-27	2017-11-10	原始取得	无
3465	半导体结构的形成方法	ZL201310636738.2	中芯上海	2013-11-27	2018-05-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3466	MEMS 加速度传感器的形成方法	ZL201310637615.0	中芯上海	2013-11-27	2019-07-02	原始取得	无
3467	防止结构层脱落的 MEMS 器件及其制备方法	ZL201310643712.0	中芯上海	2013-12-03	2016-08-17	原始取得	无
3468	半导体器件及其形成方法	ZL201310646201.4	中芯上海	2013-12-04	2017-12-01	原始取得	无
3469	半导体处理系统	ZL201310646453.7	中芯上海	2013-12-04	2017-11-03	原始取得	无
3470	一种浅沟槽的形成方法	ZL201310647706.2	中芯上海	2013-12-04	2019-01-25	原始取得	无
3471	半导体器件的形成方法	ZL201310647707.7	中芯上海	2013-12-04	2017-11-03	原始取得	无
3472	MEMS 器件及其形成方法	ZL201310647709.6	中芯上海	2013-12-04	2017-06-13	原始取得	无
3473	晶体管的形成方法	ZL201310647735.9	中芯上海	2013-12-04	2018-09-07	原始取得	无
3474	晶体管的形成方法	ZL201310647757.5	中芯上海	2013-12-04	2017-12-01	原始取得	无
3475	半导体器件的形成方法	ZL201310652259.X	中芯上海	2013-12-04	2017-11-03	原始取得	无
3476	半导体器件的边角蚀刻方法	ZL201310654423.0	中芯上海	2013-12-05	2017-11-03	原始取得	无
3477	电熔丝结构	ZL201310654425.X	中芯上海	2013-12-05	2018-02-16	原始取得	无
3478	自对准双重图形的形成方法	ZL201310654447.6	中芯上海	2013-12-05	2017-09-22	原始取得	无
3479	栅氧化层完整性测试结构及测试方法	ZL201310654505.5	中芯上海	2013-12-05	2017-11-03	原始取得	无
3480	电容器、半导体器件及其形成	ZL201310654526.7	中芯上海	2013-12-05	2018-09-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3481	晶体管的形成方法	ZL201310654694.6	中芯上海	2013-12-05	2018-08-10	原始取得	无
3482	半导体器件及其形成方法	ZL201310654701.2	中芯上海	2013-12-05	2018-02-16	原始取得	无
3483	接触孔的刻蚀方法	ZL201310654703.1	中芯上海	2013-12-05	2018-10-16	原始取得	无
3484	基于面积的 OPC 模型校准方法	ZL201310654729.6	中芯上海	2013-12-05	2017-03-01	原始取得	无
3485	半导体器件及其形成方法	ZL201310654745.5	中芯上海	2013-12-05	2017-12-29	原始取得	无
3486	晶体管的形成方法	ZL201310655000.0	中芯上海	2013-12-05	2017-09-22	原始取得	无
3487	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310655009.1	中芯上海	2013-12-05	2018-03-30	原始取得	无
3488	电熔丝结构及其形成方法	ZL201310655116.4	中芯上海	2013-12-05	2018-05-01	原始取得	无
3489	晶体管的形成方法	ZL201310655119.8	中芯上海	2013-12-05	2017-08-25	原始取得	无
3490	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310655131.9	中芯上海	2013-12-05	2017-09-22	原始取得	无
3491	VDMOS 场效应晶体管及其形成方法	ZL201310655132.3	中芯上海	2013-12-05	2018-03-09	原始取得	无
3492	电熔丝结构及其形成方法和半导体器件	ZL201310655162.4	中芯上海	2013-12-05	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3493	双重曝光的图案拆分方法以及系统	ZL201310655176.6	中芯上海	2013-12-05	2018-06-01	原始取得	无
3494	FinFET 器件及其形成方法	ZL201310655186.X	中芯上海	2013-12-05	2018-02-16	原始取得	无
3495	SRAM 中的存储单元的检测方法	ZL201310655188.9	中芯上海	2013-12-05	2017-09-22	原始取得	无
3496	机台恢复检验系统以及机台恢复检验方法	ZL201310661863.9	中芯上海	2013-12-09	2019-09-17	原始取得	无
3497	通孔填充方法	ZL201310661878.5	中芯上海	2013-12-09	2018-05-11	原始取得	无
3498	缺陷杀伤率分析方法及分析系统	ZL201310662114.8	中芯上海	2013-12-09	2017-11-14	原始取得	无
3499	工艺流程控制方法以及工艺流程控制系统	ZL201310665173.0	中芯上海	2013-12-09	2018-03-06	原始取得	无
3500	一种金属层间介质测试结构及测试方法	ZL201310666274.X	中芯上海	2013-12-10	2017-09-22	原始取得	无
3501	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310666946.7	中芯上海	2013-12-10	2018-05-01	原始取得	无
3502	一种半导体器件的形成方法	ZL201310669771.5	中芯上海	2013-12-10	2017-11-03	原始取得	无
3503	隧穿场效应晶体管及其形成	ZL201310669773.4	中芯上海	2013-12-10	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3504	一种半导体器件的评估方法和 RC 时序测试方法	ZL201310669787.6	中芯上海	2013-12-10	2018-06-01	原始取得	无
3505	一种半导体器件的形成方法	ZL201310671279.1	中芯上海	2013-12-10	2017-11-03	原始取得	无
3506	晶体管的形成方法	ZL201310673659.9	中芯上海	2013-12-10	2018-07-10	原始取得	无
3507	半导体结构的形成方法	ZL201310673666.9	中芯上海	2013-12-10	2018-08-10	原始取得	无
3508	圆筒形掩模板的刻蚀系统和圆筒形掩模板的刻蚀方法	ZL201310675696.3	中芯上海	2013-12-11	2017-09-22	原始取得	无
3509	一种半导体器件的制造方法	ZL201310681446.0	中芯上海	2013-12-12	2017-11-14	原始取得	无
3510	一种半导体器件的制造方法	ZL201310681641.3	中芯上海	2013-12-12	2017-11-14	原始取得	无
3511	半导体器件及其制作方法	ZL201310681667.8	中芯上海	2013-12-12	2018-03-20	原始取得	无
3512	半导体器件的制作方法	ZL201310681725.7	中芯上海	2013-12-12	2017-12-05	原始取得	无
3513	闪存的制作方法	ZL201310683410.6	中芯上海	2013-12-12	2018-05-25	原始取得	无
3514	一种半导体器件的制造方法	ZL201310683483.5	中芯上海	2013-12-12	2018-03-20	原始取得	无
3515	半导体器件及其制作方法	ZL201310684018.3	中芯上海	2013-12-12	2018-10-23	原始取得	无
3516	半导体器件及其制作方法	ZL201310684020.0	中芯上海	2013-12-12	2018-03-20	原始取得	无
3517	N 阱和深 N 阱的着色方法和混合溶液	ZL201310684651.2	中芯上海	2013-12-13	2017-08-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3518	一种测试方法和测试结构	ZL201310693541.2	中芯上海	2013-12-17	2018-06-08	原始取得	无
3519	一种低触发电压和高维持电压的硅控整流器及其电路	ZL201310693635.X	中芯上海	2013-12-17	2018-02-06	原始取得	无
3520	一种测试方法和测试结构	ZL201310693671.6	中芯上海	2013-12-17	2018-02-06	原始取得	无
3521	一种 TEM 的样品制备方法	ZL201310693745.6	中芯上海	2013-12-17	2018-05-04	原始取得	无
3522	半导体膜厚度量测校准标准片及其制造方法	ZL201310695221.0	中芯上海	2013-12-17	2018-11-02	原始取得	无
3523	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310697455.9	中芯上海	2013-12-17	2018-03-20	原始取得	无
3524	一种晶圆键合方法	ZL201310697478.X	中芯上海	2013-12-17	2018-04-13	原始取得	无
3525	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310697480.7	中芯上海	2013-12-17	2018-09-21	原始取得	无
3526	硅通孔形成方法及半导体器件的对准结构	ZL201310697675.1	中芯上海	2013-12-18	2018-08-10	原始取得	无
3527	伪栅的去除方法和 MOS 晶体管的形成方法	ZL201310697874.2	中芯上海	2013-12-18	2017-12-01	原始取得	无
3528	半导体器件的形成方法	ZL201310697886.5	中芯上海	2013-12-18	2018-08-10	原始取得	无
3529	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201310698747.4	中芯上海	2013-12-18	2018-09-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3530	半导体器件的形成方法	ZL201310698748.9	中芯上海	2013-12-18	2017-12-01	原始取得	无
3531	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310698757.8	中芯上海	2013-12-18	2018-02-16	原始取得	无
3532	半导体结构及其形成方法	ZL201310698759.7	中芯上海	2013-12-18	2018-05-01	原始取得	无
3533	半导体结构的形成方法	ZL201310698760.X	中芯上海	2013-12-18	2017-11-28	原始取得	无
3534	浅沟槽隔离结构的减薄方法	ZL201310700216.4	中芯上海	2013-12-18	2018-05-25	原始取得	无
3535	一种晶圆允收测试结构	ZL201310703869.8	中芯上海	2013-12-19	2017-08-04	原始取得	无
3536	一种半导体器件的制造方法	ZL201310703905.0	中芯上海	2013-12-19	2019-12-17	原始取得	无
3537	一种嵌入闪存栅极的制作方法	ZL201310703947.4	中芯上海	2013-12-19	2018-05-04	原始取得	无
3538	一种制作半导体器件的方法	ZL201310705256.8	中芯上海	2013-12-19	2018-07-20	原始取得	无
3539	TEM 样品载网支持膜及其制备方法、TEM 样品分析方法	ZL201310705738.3	中芯上海	2013-12-19	2017-12-29	原始取得	无
3540	一种消除浅沟道隔离刻蚀过程中硅基底缺陷的方法	ZL201310705772.0	中芯上海	2013-12-19	2018-01-30	原始取得	无
3541	螺旋差分电感器	ZL201310705806.6	中芯上海	2013-12-19	2018-09-25	原始取得	无
3542	底部抗反射涂层的涂覆方法	ZL201310705829.7	中芯上海	2013-12-19	2017-11-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3543	一种半导体器件的制造方法	ZL201310706301.1	中芯上海	2013-12-19	2018-05-04	原始取得	无
3544	芯片、集成电路和微电子机械系统以及形成芯片的方法	ZL201310706302.6	中芯上海	2013-12-19	2017-11-14	原始取得	无
3545	高介电常数绝缘层金属栅半导体器件制造方法	ZL201310706433.4	中芯上海	2013-12-20	2017-10-31	原始取得	无
3546	晶体管的形成方法	ZL201310713229.5	中芯上海	2013-12-20	2018-11-16	原始取得	无
3547	有机图像传感器及其形成方法	ZL201310713271.7	中芯上海	2013-12-20	2017-11-03	原始取得	无
3548	FinFET 器件及其形成方法	ZL201310713272.1	中芯上海	2013-12-20	2018-03-30	原始取得	无
3549	晶体管的形成方法	ZL201310713274.0	中芯上海	2013-12-20	2018-03-09	原始取得	无
3550	半导体结构及其形成方法、电阻存储器	ZL201310713307.1	中芯上海	2013-12-20	2018-07-06	原始取得	无
3551	大马士革结构的制作方法	ZL201310713317.5	中芯上海	2013-12-20	2018-08-10	原始取得	无
3552	有机图像传感器及其形成方法	ZL201310713319.4	中芯上海	2013-12-20	2017-11-03	原始取得	无
3553	栅极的形成方法	ZL201310713341.9	中芯上海	2013-12-20	2017-10-03	原始取得	无
3554	CMOS 反相器	ZL201310713406.X	中芯上海	2013-12-20	2017-09-22	原始取得	无
3555	一种半导体器件及其制造方	ZL201310714424.X	中芯上海	2013-12-20	2017-08-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3556	一种选择器及其制造方法	ZL201310714436.2	中芯上海、中芯宁波	2013-12-20	2018-11-27	原始取得	无
3557	一种键合晶片的减薄方法	ZL201310717819.5	中芯上海	2013-12-23	2018-09-25	原始取得	无
3558	场效应晶体管及其制备方法	ZL201310724300.X	中芯上海	2013-12-24	2018-01-30	原始取得	无
3559	一种浅沟槽隔离结构及其制造方法	ZL201310727286.9	中芯上海	2013-12-25	2018-03-20	原始取得	无
3560	一种制作半导体器件的方法	ZL201310728082.7	中芯上海	2013-12-25	2018-03-20	原始取得	无
3561	一种测试结构及其制造方法	ZL201310729232.6	中芯上海	2013-12-26	2018-02-06	原始取得	无
3562	一种半导体器件的制造方法	ZL201310731501.2	中芯上海	2013-12-26	2017-11-10	原始取得	无
3563	一种制作半导体器件的方法	ZL201310732641.1	中芯上海	2013-12-26	2018-08-21	原始取得	无
3564	用于判定 GOX 击穿失效的样品制备方法	ZL201310733400.9	中芯上海	2013-12-26	2018-03-27	原始取得	无
3565	MOS 管电容器的布线结构及布线方法	ZL201310736978.X	中芯上海	2013-12-27	2017-11-03	原始取得	无
3566	一种金属桥连缺陷的检测结构以及制备方法	ZL201310737681.5	中芯上海	2013-12-27	2017-10-20	原始取得	无
3567	一种集成无源器件及其制造方法	ZL201310737683.4	中芯上海	2013-12-27	2018-08-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3568	化学机械研磨方法及化学机械研磨装置	ZL201310737786.0	中芯上海	2013-12-27	2017-03-22	原始取得	无
3569	一种半导体器件及其制造方法	ZL201310738813.6	中芯上海	2013-12-27	2018-05-04	原始取得	无
3570	一种制作半导体器件的方法	ZL201310738844.1	中芯上海	2013-12-27	2018-04-13	原始取得	无
3571	形成掩模板图形的方法	ZL201310739011.7	中芯上海	2013-12-27	2019-07-02	原始取得	无
3572	半导体器件及其形成方法	ZL201310739021.0	中芯上海	2013-12-27	2017-11-03	原始取得	无
3573	金属栅极的形成方法	ZL201310739022.5	中芯上海	2013-12-27	2017-12-29	原始取得	无
3574	光学邻近修正方法	ZL201310739023.X	中芯上海	2013-12-27	2016-10-05	原始取得	无
3575	可穿戴智能设备的交互方法及穿戴智能设备系统	ZL201310739025.9	中芯上海	2013-12-27	2017-12-29	原始取得	无
3576	半导体器件的形成方法	ZL201310739057.9	中芯上海	2013-12-27	2019-01-22	原始取得	无
3577	工程变更临界点的确认系统及确认方法	ZL201310739258.9	中芯上海	2013-12-27	2019-04-02	原始取得	无
3578	产品混合处理系统及方法	ZL201310739262.5	中芯上海	2013-12-27	2019-03-12	原始取得	无
3579	用于封装测试的半导体结构及其形成方法	ZL201310739276.7	中芯上海	2013-12-27	2019-01-25	原始取得	无
3580	监控 MEMS 释放过程性能的	ZL201310739278.6	中芯上海	2013-12-27	2016-06-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3581	Trench MOS 器件的制造方法及结构（中间有空格）	ZL201310739288.X	中芯上海	2013-12-27	2017-12-08	原始取得	无
3582	TrenchMOS 器件的制造方法	ZL201310739296.4	中芯上海	2013-12-27	2018-04-27	原始取得	无
3583	导电孔阵列图形的形成方法	ZL201310739672.X	中芯上海	2013-12-27	2017-12-01	原始取得	无
3584	可穿戴智能设备的互动方法	ZL201310739674.9	中芯上海	2013-12-27	2017-09-26	原始取得	无
3585	半导体器件的测试结构及其形成方法	ZL201310739680.4	中芯上海	2013-12-27	2017-12-29	原始取得	无
3586	半导体器件及其形成方法	ZL201310739683.8	中芯上海	2013-12-27	2017-12-29	原始取得	无
3587	嵌入式动态随机存储器单元及其形成方法	ZL201310739694.6	中芯上海	2013-12-27	2017-11-03	原始取得	无
3588	半导体器件的制造方法	ZL201310739719.2	中芯上海	2013-12-27	2018-01-02	原始取得	无
3589	一种单芯片微机电系统及其制备方法	ZL201310740267.X	中芯上海	2013-12-27	2016-02-03	原始取得	无
3590	一种具有小尺寸间隙的反射镜平坦化方法	ZL201310740270.1	中芯上海	2013-12-27	2017-11-14	原始取得	无
3591	一种 HKMG 器件及其制备方法	ZL201310740795.5	中芯上海	2013-12-27	2018-03-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3592	一种微机电系统及其制备方法	ZL201310743095.1	中芯上海	2013-12-27	2016-07-27	原始取得	无
3593	一种硅通孔的测试结构	ZL201310743147.5	中芯上海	2013-12-27	2017-10-20	原始取得	无
3594	一种半导体器件及其制备方法	ZL201310743149.4	中芯上海	2013-12-27	2018-03-20	原始取得	无
3595	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310743156.4	中芯上海、中芯宁波	2013-12-27	2019-05-17	原始取得	无
3596	一种制作半导体器件的方法	ZL201310743194.X	中芯上海	2013-12-27	2017-12-05	原始取得	无
3597	一种集成电路及其制造方法	ZL201310743201.6	中芯上海	2013-12-27	2018-03-20	原始取得	无
3598	一种半导体器件及其制作方法	ZL201310743215.8	中芯上海	2013-12-27	2017-12-05	原始取得	无
3599	一种运动传感器的制备方法	ZL201310743292.3	中芯上海	2013-12-27	2016-08-31	原始取得	无
3600	一种具有 STI 结构的半导体器件及制备方法	ZL201310743496.7	中芯上海、中芯北京	2013-12-27	2017-11-28	原始取得	无
3601	用于测试刻蚀工艺的测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201310745522.X	中芯上海	2013-12-30	2017-02-22	原始取得	无
3602	SRAM 单元的形成方法	ZL201310745628.X	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3603	半导体器件及其形成方法	ZL201310745634.5	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3604	光学邻近修正方法	ZL201310745648.7	中芯上海	2013-12-20	2017-02-01	原始取得	无
3605	掩膜图形的形成方法	ZL201310745658.0	中芯上海	2013-12-30	2018-12-21	原始取得	无
3606	电熔丝结构	ZL201310745666.5	中芯上海	2013-12-30	2017-09-22	原始取得	无
3607	晶体管的制造方法	ZL201310745667.X	中芯上海	2013-12-30	2017-12-01	原始取得	无
3608	辅助图形的形成方法和曝光目标图形的修正方法	ZL201310745670.1	中芯上海	2013-12-20	2016-12-28	原始取得	无
3609	采用 CDSEM 测试图形的方法	ZL201310745676.9	中芯上海	2013-12-30	2018-02-16	原始取得	无
3610	存储器的形成方法	ZL201310745680.5	中芯上海	2013-12-30	2018-02-16	原始取得	无
3611	存储器件及其形成方法	ZL201310745692.8	中芯上海	2013-12-30	2017-12-29	原始取得	无
3612	存储器件及其形成方法	ZL201310745701.3	中芯上海	2013-12-30	2018-11-16	原始取得	无
3613	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201310745705.1	中芯上海	2013-12-30	2018-12-21	原始取得	无
3614	晶体管的形成方法	ZL201310745717.4	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3615	双端口 SRAM 结构	ZL201310745731.4	中芯上海	2013-12-30	2018-02-16	原始取得	无
3616	鳍式场效应管的形成方法	ZL201310745732.9	中芯上海	2013-12-30	2018-06-01	原始取得	无
3617	晶体管的形成方法	ZL201310745735.2	中芯上海	2013-12-30	2017-12-29	原始取得	无
3618	读写分离的双端口 SRAM 结构及其单元	ZL201310745737.1	中芯上海	2013-12-30	2018-03-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3619	晶体管的形成方法	ZL201310745740.3	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3620	可控硅静电保护器件及其形成方法	ZL201310745752.6	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3621	信号接收电路	ZL201310745758.3	中芯上海	2013-12-30	2018-08-10	原始取得	无
3622	半导体器件及其形成方法、提高晶圆切割成品率的方法	ZL201310745759.8	中芯上海	2013-12-30	2017-12-29	原始取得	无
3623	FinFET 器件的制造方法	ZL201310745766.8	中芯上海	2013-12-30	2017-12-01	原始取得	无
3624	形成互连结构的方法	ZL201310745769.1	中芯上海	2013-12-30	2018-09-07	原始取得	无
3625	半导体器件的形成方法	ZL201310745796.9	中芯上海	2013-12-30	2017-07-14	原始取得	无
3626	半导体器件的形成方法	ZL201310745797.3	中芯上海	2013-12-30	2018-08-10	原始取得	无
3627	存储器件及其形成方法	ZL201310745799.2	中芯上海	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3628	对具有与工艺水平不相称良率的芯片的分类方法	ZL201310745806.9	中芯上海	2013-12-30	2018-02-16	原始取得	无
3629	半导体器件的形成方法	ZL201310745807.3	中芯上海	2013-12-30	2019-03-29	原始取得	无
3630	双重图形化的形成方法	ZL201310745809.2	中芯上海、中芯北京	2013-12-30	2017-11-03	原始取得	无
3631	工艺流程的变更方法、对变更的工艺流程进行监控的方法	ZL201310745816.2	中芯上海	2013-12-30	2018-04-27	原始取得	无
3632	半导体结构及其形成方法	ZL201310745826.6	中芯上海、中芯北京	2013-12-30	2017-09-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3633	去除伪栅的方法	ZL201310745827.0	中芯上海	2013-12-30	2018-07-10	原始取得	无
3634	LDMOS 器件及其形成方法	ZL201310745831.7	中芯上海	2013-12-30	2017-12-01	原始取得	无
3635	导电插塞的形成方法	ZL201310745861.8	中芯上海	2013-12-30	2017-09-22	原始取得	无
3636	半导体结构的形成方法	ZL201310745866.0	中芯上海	2013-12-30	2019-02-12	原始取得	无
3637	一种虚拟图案填充程式的质量合格保证方法以及版图结构	ZL201310746362.0	中芯上海	2013-12-30	2018-03-20	原始取得	无
3638	一种用于填充虚拟图案和参考图层相关性检查的版图结构	ZL201310746373.9	中芯上海	2013-12-30	2018-03-30	原始取得	无
3639	互连结构的形成方法	ZL201310746414.4	中芯上海	2013-12-30	2017-12-01	原始取得	无
3640	用于反射式光刻技术的掩模版、制作方法及其使用方法	ZL201310747065.8	中芯上海	2013-12-30	2019-09-03	原始取得	无
3641	一种半导体器件、制备方法及封装方法	ZL201310753305.5	中芯上海、中芯宁波	2013-12-31	2019-07-23	原始取得	无
3642	用于检测 CDSEM 机台的方法、晶圆、晶圆的制作方法	ZL201310753940.3	中芯上海	2013-12-31	2018-05-25	原始取得	无
3643	半导体器件及其制作方法	ZL201310753947.5	中芯上海	2013-12-31	2018-03-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3644	一种半导体器件的制造方法	ZL201310754004.4	中芯上海	2013-12-31	2018-05-04	原始取得	无
3645	存储器、电熔丝存储阵列的检测电路及方法	ZL201310754015.2	中芯上海	2013-12-31	2018-08-10	原始取得	无
3646	浮栅的形成方法	ZL201310754027.5	中芯上海	2013-12-31	2018-08-10	原始取得	无
3647	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310754030.7	中芯上海	2013-12-31	2017-11-03	原始取得	无
3648	用于多构图工艺的光学临近修正方法	ZL201310754035.X	中芯上海	2013-12-31	2019-09-03	原始取得	无
3649	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201310754037.9	中芯上海	2013-12-31	2018-10-16	原始取得	无
3650	半导体器件及其形成方法	ZL201310754038.3	中芯上海	2013-12-31	2017-12-29	原始取得	无
3651	半导体器件及其形成方法	ZL201310754040.0	中芯上海、中芯北京	2013-12-31	2016-08-31	原始取得	无
3652	第一金属互连层的制作方法	ZL201310754043.4	中芯上海	2013-12-31	2018-07-03	原始取得	无
3653	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201310754079.2	中芯上海	2013-12-31	2018-08-21	原始取得	无
3654	互连介质层、其制作方法及包括其的半导体器件	ZL201310754177.6	中芯上海	2013-12-31	2019-06-04	原始取得	无
3655	封装结构的交互作用的测试	ZL201310754207.3	中芯上海	2013-12-31	2017-12-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法和测试装置						
3656	用于测量电路器件中接触孔和栅极套准精度的测试结构	ZL201310754208.8	中芯上海	2013-12-31	2017-11-03	原始取得	无
3657	半导体器件的形成方法	ZL201310754213.9	中芯上海	2013-12-31	2018-03-09	原始取得	无
3658	半导体器件的形成方法	ZL201310754214.3	中芯上海	2013-12-31	2018-05-01	原始取得	无
3659	存储器的形成方法	ZL201310754227.0	中芯上海	2013-12-31	2019-01-22	原始取得	无
3660	用于对介质层进行可靠性测试的测试结构	ZL201310754228.5	中芯上海	2013-12-31	2017-11-28	原始取得	无
3661	FinFET 器件及其制作方法	ZL201310754231.7	中芯上海	2013-12-31	2018-03-09	原始取得	无
3662	晶体管的形成方法	ZL201310754232.1	中芯上海	2013-12-31	2017-12-29	原始取得	无
3663	测试结构的形成方法	ZL201310754234.0	中芯上海	2013-12-31	2017-08-25	原始取得	无
3664	参考电压产生电路及一种参考电压校准方法	ZL201310754243.X	中芯上海	2013-12-31	2017-01-25	原始取得	无
3665	晶体管的形成方法	ZL201310754245.9	中芯上海	2013-12-31	2018-05-01	原始取得	无
3666	快闪存储器的形成方法	ZL201310754246.3	中芯上海	2013-12-31	2017-11-03	原始取得	无
3667	接触插塞的形成方法	ZL201310754248.2	中芯上海	2013-12-31	2017-12-01	原始取得	无
3668	金属栅极的形成方法	ZL201310754250.X	中芯上海	2013-12-31	2018-06-01	原始取得	无
3669	互连层、其制作方法及半导体	ZL201310754256.7	中芯上海	2013-12-31	2018-09-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	器件						
3670	一种半导体器件的制造方法	ZL201410005283.9	中芯上海	2014-01-06	2018-06-08	原始取得	无
3671	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410005589.4	中芯上海	2014-01-06	2017-12-05	原始取得	无
3672	一种增大 flash 器件栅电容的方法及 flash 器件	ZL201410009073.7	中芯上海、中芯北京	2014-01-08	2018-01-05	原始取得	无
3673	一种制作半导体器件的方法	ZL201410010191.X	中芯上海	2014-01-09	2017-11-14	原始取得	无
3674	一种 FinFET 器件及其制造方法	ZL201410010682.4	中芯上海	2014-01-09	2019-01-22	原始取得	无
3675	FINFET 半导体器件及其制备方法	ZL201410011019.6	中芯上海	2014-01-09	2018-07-10	原始取得	无
3676	一种 NMOSFET 器件及其制备方法	ZL201410012365.6	中芯上海、中芯北京	2014-01-10	2018-03-06	原始取得	无
3677	一种晶圆接合质量的检测结构及检测方法	ZL201410012656.5	中芯上海	2014-01-10	2018-08-21	原始取得	无
3678	闪存的制造方法	ZL201410014227.1	中芯上海	2014-01-13	2018-07-20	原始取得	无
3679	一种测试版图中数字标记的设计方法	ZL201410014345.2	中芯上海	2014-01-13	2018-02-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3680	底部防反射层形成方法	ZL201410014457.8	中芯上海	2014-01-13	2018-10-16	原始取得	无
3681	派货系统及派货方法	ZL201410014462.9	中芯上海	2014-01-13	2017-07-28	原始取得	无
3682	去嵌入的测试方法	ZL201410014472.2	中芯上海	2014-01-13	2018-02-09	原始取得	无
3683	去嵌入的测试结构及其测试方法和芯片	ZL201410014553.2	中芯上海	2014-01-13	2018-02-09	原始取得	无
3684	一种虚拟图案多层堆栈单元的自我双图型分解方法	ZL201410014615.X	中芯上海	2014-01-13	2018-02-06	原始取得	无
3685	铝残留的去除方法	ZL201410015037.1	中芯上海	2014-01-13	2017-10-17	原始取得	无
3686	一种晶圆接合的检测结构、制备方法以及检测方法	ZL201410016061.7	中芯上海	2014-01-14	2016-09-21	原始取得	无
3687	一种金属栅极结构及其制备方法	ZL201410016255.7	中芯上海、中芯北京	2014-01-14	2018-07-10	原始取得	无
3688	一种制作半导体器件的方法	ZL201410016472.6	中芯上海	2014-01-14	2019-07-26	原始取得	无
3689	一种制作半导体器件的方法	ZL201410020190.3	中芯上海	2014-01-16	2018-03-30	原始取得	无
3690	一种 TEM 样品的制备方法	ZL201410022539.7	中芯上海	2014-01-17	2018-06-26	原始取得	无
3691	设定测试针压的方法	ZL201410022551.8	中芯上海	2014-01-17	2017-11-03	原始取得	无
3692	一种 TEM 样品的制备方法	ZL201410023148.7	中芯上海	2014-01-17	2017-08-29	原始取得	无
3693	射频集成电路芯片及其形成	ZL201410025041.6	中芯上海	2014-01-20	2018-06-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3694	曝光装置、掩膜板及曝光方法	ZL201410025069.X	中芯上海	2014-01-20	2017-05-17	原始取得	无
3695	射频集成电路芯片及其形成方法	ZL201410025095.2	中芯上海	2014-01-20	2017-12-01	原始取得	无
3696	静态随机存储器及其形成方法	ZL201410025102.9	中芯上海	2014-01-20	2018-08-10	原始取得	无
3697	隔离结构的形成方法	ZL201410025112.2	中芯上海、中芯北京	2014-01-20	2018-03-30	原始取得	无
3698	图形化装置和形成抗刻蚀图形的方法	ZL201410025114.1	中芯上海	2014-01-20	2017-07-14	原始取得	无
3699	对准标记、对准标记的检测方法和对准标记检测装置	ZL201410025187.0	中芯上海	2014-01-20	2017-11-03	原始取得	无
3700	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410025557.0	中芯上海	2014-01-20	2018-03-30	原始取得	无
3701	晶体管的形成方法	ZL201410027709.0	中芯上海	2014-01-21	2018-08-10	原始取得	无
3702	半导体器件的形成方法	ZL201410027719.4	中芯上海	2014-01-21	2018-06-01	原始取得	无
3703	静电放电保护结构	ZL201410027721.1	中芯上海、中芯北京	2014-01-21	2018-12-21	原始取得	无
3704	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410027723.0	中芯上海、中芯北京	2014-01-21	2018-02-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3705	存储单元、存储器及其布局结构	ZL201410027725.X	中芯上海、中芯北京	2014-01-21	2018-11-16	原始取得	无
3706	硅通孔结构的制备方法	ZL201410027745.7	中芯上海、中芯北京	2014-01-21	2018-09-07	原始取得	无
3707	电荷泵电路及能在读操作时进行放电的 EEPROM	ZL201410027806.X	中芯上海	2014-01-22	2018-07-31	原始取得	无
3708	用于读取数据的灵敏放大器及存储器	ZL201410027809.3	中芯上海	2014-01-22	2017-08-25	原始取得	无
3709	灵敏放大器及存储器	ZL201410028042.6	中芯上海	2014-01-22	2018-03-27	原始取得	无
3710	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410029928.2	中芯上海	2014-01-22	2018-10-23	原始取得	无
3711	一种 TEM 样品的制备方法	ZL201410030012.9	中芯上海	2014-01-22	2017-05-17	原始取得	无
3712	一种半导体器件的制造方法	ZL201410032408.7	中芯上海	2014-01-23	2018-11-16	原始取得	无
3713	一种扩展电阻测试样品的制备方法	ZL201410032756.4	中芯上海	2014-01-23	2017-08-29	原始取得	无
3714	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410032806.9	中芯上海	2014-01-23	2018-02-06	原始取得	无
3715	一种制作半导体器件的方法	ZL201410033148.5	中芯上海	2014-01-24	2017-12-05	原始取得	无
3716	一种 OPC 中双掩膜版的检测	ZL201410033150.2	中芯上海	2014-01-24	2019-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3717	一种半导体器件的制造方法	ZL201410035087.6	中芯上海	2014-01-24	2017-11-14	原始取得	无
3718	底部抗反射涂层的涂布方法	ZL201410035650.X	中芯上海	2014-01-24	2018-07-06	原始取得	无
3719	一种测试结构及其制作方法	ZL201410035657.1	中芯上海	2014-01-24	2017-12-19	原始取得	无
3720	一种差分电感器	ZL201410035674.5	中芯上海	2014-01-24	2017-12-29	原始取得	无
3721	生产派工的方法和装置	ZL201410035722.0	中芯上海	2014-01-24	2018-07-03	原始取得	无
3722	化学机械抛光方法	ZL201410035833.1	中芯上海	2014-01-24	2017-05-10	原始取得	无
3723	一种集成电路及其制造方法	ZL201410037719.2	中芯上海	2014-01-26	2018-03-30	原始取得	无
3724	一种半导体器件的制造方法、半导体器件和电子装置	ZL201410038081.4	中芯上海、中芯宁波	2014-01-26	2018-12-18	原始取得	无
3725	一种集成电路及其制造方法	ZL201410038083.3	中芯上海、中芯宁波	2014-01-26	2018-09-11	原始取得	无
3726	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410038085.2	中芯上海	2014-01-26	2018-04-13	原始取得	无
3727	晶圆及其处理方法和半导体结构的形成方法	ZL201410042095.3	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2017-12-01	原始取得	无
3728	CMOS 晶体管及其形成方法	ZL201410042128.4	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2017-12-29	原始取得	无
3729	MOS 晶体管的测试结构及测试方法	ZL201410042176.3	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2018-02-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3730	半导体器件的形成方法	ZL201410042193.7	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2018-10-16	原始取得	无
3731	金属栅极的形成方法	ZL201410042195.6	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2018-07-10	原始取得	无
3732	半导体器件的形成方法	ZL201410042208.X	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2018-02-16	原始取得	无
3733	半导体存储器件及其制作方法	ZL201410042210.7	中芯上海、中芯北京	2014-01-28	2018-03-30	原始取得	无
3734	MOS 晶体管的制作方法	ZL201410045265.3	中芯上海	2014-01-30	2018-08-10	原始取得	无
3735	半导体器件及其形成方法	ZL201410045280.8	中芯上海	2014-01-30	2017-11-28	原始取得	无
3736	晶体管的形成方法	ZL201410045281.2	中芯上海、中芯北京	2014-01-30	2018-11-16	原始取得	无
3737	半导体结构的形成方法	ZL201410045283.1	中芯上海、中芯北京	2014-01-30	2017-06-13	原始取得	无
3738	图像传感器的形成方法	ZL201410045285.0	中芯上海、中芯北京	2014-01-30	2017-09-22	原始取得	无
3739	半导体器件的形成方法	ZL201410045296.9	中芯上海、中芯北京	2014-01-30	2018-05-01	原始取得	无
3740	一种制作半导体器件的方法	ZL201410045802.4	中芯上海	2014-02-08	2018-12-21	原始取得	无
3741	一种提高半导体器件键合可靠性的方法	ZL201410045835.9	中芯上海	2014-02-08	2018-09-25	原始取得	无
3742	一种浅沟道隔离结构的制备方法	ZL201410045876.8	中芯上海	2014-02-08	2018-01-30	原始取得	无
3743	TSV 盲孔的制作方法	ZL201410045878.7	中芯上海、中芯宁波	2014-02-08	2018-09-07	原始取得	无
3744	一种制作半导体器件的方法	ZL201410045879.1	中芯上海	2014-02-08	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3745	化学机械研磨的方法	ZL201410045890.8	中芯上海	2014-02-08	2018-03-20	原始取得	无
3746	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410045903.1	中芯上海	2014-02-08	2017-11-14	原始取得	无
3747	一种嵌入式存储器件侧墙的制备方法	ZL201410045908.4	中芯上海	2014-02-08	2017-10-31	原始取得	无
3748	化学机械研磨设备及化学机械研磨的方法	ZL201410045955.9	中芯上海	2014-02-08	2018-07-20	原始取得	无
3749	一种制作半导体器件的方法	ZL201410045964.8	中芯上海	2014-02-08	2018-07-20	原始取得	无
3750	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410045984.5	中芯上海	2014-02-08	2018-03-30	原始取得	无
3751	一种半导体器件的制作方法	ZL201410045985.X	中芯上海	2014-02-08	2017-12-05	原始取得	无
3752	一种 EEPROM 存储器件以及制备方法	ZL201410046805.X	中芯上海	2014-02-10	2018-03-16	原始取得	无
3753	离子注入机台基准起始注入角度的校准方法	ZL201410047153.1	中芯上海	2014-02-11	2018-07-20	原始取得	无
3754	金属互连结构及其形成方法	ZL201410050434.2	中芯上海、中芯北京	2014-02-13	2018-12-21	原始取得	无
3755	一种半导体器件的制造方法	ZL201410050493.X	中芯上海	2014-02-13	2018-03-30	原始取得	无
3756	半导体生产仿真系统	ZL201410050556.1	中芯上海、中芯北京	2014-02-13	2018-11-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3757	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410051810.X	中芯上海	2014-02-14	2018-04-13	原始取得	无
3758	用于背面光刻工艺的对准标记及其对准方法	ZL201410051869.9	中芯上海	2014-02-14	2017-08-11	原始取得	无
3759	一种锗硅硼外延层生长方法	ZL201410051888.1	中芯上海	2014-02-14	2018-05-01	原始取得	无
3760	介质层缺陷的检测方法和检测装置	ZL201410052303.8	中芯上海	2014-02-14	2017-12-22	原始取得	无
3761	半导体器件及其制作方法	ZL201410053296.3	中芯上海	2014-02-17	2017-12-05	原始取得	无
3762	一种晶圆级封装工艺中致密化钝化层的方法	ZL201410053533.6	中芯上海	2014-02-17	2018-02-06	原始取得	无
3763	一种半导体器件可靠性测试结构的保护电路及保护方法	ZL201410053565.6	中芯上海	2014-02-17	2018-03-20	原始取得	无
3764	一种提高存储器性能的方法	ZL201410053601.9	中芯上海、中芯北京	2014-02-17	2019-05-28	原始取得	无
3765	一种实时派工方法及系统	ZL201410053665.9	中芯上海	2014-02-17	2018-03-30	原始取得	无
3766	去除铝残余缺陷的方法	ZL201410053960.4	中芯上海	2014-02-18	2017-12-08	原始取得	无
3767	一种半导体器件及其制备方法	ZL201410054968.2	中芯上海	2014-02-18	2018-07-20	原始取得	无
3768	一种半导体器件的制备方法	ZL201410055254.3	中芯上海	2014-02-18	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3769	一种半导体器件的制造方法	ZL201410055275.5	中芯上海	2014-02-18	2017-11-14	原始取得	无
3770	YE 在线检测管控方法	ZL201410057303.7	中芯上海	2014-02-20	2018-03-23	原始取得	无
3771	一种平面 TEM 样品的制备方法	ZL201410058095.2	中芯上海	2014-02-20	2017-08-25	原始取得	无
3772	一种半导体器件结构的制作方法	ZL201410058151.2	中芯上海	2014-02-20	2017-12-08	原始取得	无
3773	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL201410058168.8	中芯上海	2014-02-20	2017-10-20	原始取得	无
3774	一种半导体器件的制造方法	ZL201410060803.6	中芯上海	2014-02-21	2018-03-20	原始取得	无
3775	一种半导体器件的制造方法	ZL201410061224.3	中芯上海	2014-02-21	2018-09-25	原始取得	无
3776	一种半导体器件的制作方法	ZL201410062292.1	中芯上海、中芯北京	2014-02-24	2018-03-20	原始取得	无
3777	减少锗硅源漏区外延工艺中的颗粒缺陷的方法	ZL201410064092.X	中芯上海	2014-02-25	2018-06-08	原始取得	无
3778	一种半导体器件的制造方法	ZL201410068196.8	中芯上海	2014-02-27	2018-08-21	原始取得	无
3779	一种半导体器件的制造方法	ZL201410068197.2	中芯上海	2014-02-27	2018-09-25	原始取得	无
3780	电子元器件及电子元器件的制备方法	ZL201410070428.3	中芯上海	2014-02-27	2018-10-23	原始取得	无
3781	SOI 器件及其形成方法	ZL201410071542.8	中芯上海	2014-02-28	2018-06-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3782	环形磁性随机存取存储器单元结构的制造方法	ZL201410071631.2	中芯上海	2014-02-28	2017-09-22	原始取得	无
3783	透射电子显微镜样品的制备方法	ZL201410071685.9	中芯上海	2014-02-28	2018-01-02	原始取得	无
3784	嵌入逻辑式闪存器件及其侧墙形成方法	ZL201410071745.7	中芯上海	2014-02-28	2018-02-13	原始取得	无
3785	一种可动电感电极结构以及制备方法	ZL201410073069.7	中芯上海	2014-02-28	2016-11-30	原始取得	无
3786	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410073314.4	中芯上海	2014-02-28	2018-08-17	原始取得	无
3787	一种 FinFET 器件及其制造方法	ZL201410073328.6	中芯上海	2014-02-28	2019-02-01	原始取得	无
3788	晶体管及其制造方法	ZL201410073625.0	中芯上海	2014-03-03	2018-10-26	原始取得	无
3789	半导体结构及其形成方法	ZL201410076828.5	中芯上海	2014-03-04	2017-11-28	原始取得	无
3790	存储器及其驱动电路	ZL201410076847.8	中芯上海、中芯北京	2014-03-04	2019-03-29	原始取得	无
3791	垂直纳米线 MOS 晶体管及其形成方法	ZL201410076899.5	中芯上海	2014-03-04	2019-02-15	原始取得	无
3792	鳍式场效应晶体管及其形成	ZL201410076905.7	中芯上海	2014-03-04	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
3793	存储器及其形成方法	ZL201410076930.5	中芯上海	2014-03-04	2018-02-16	原始取得	无
3794	自对准双重图形化方法及鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201410076954.0	中芯上海	2014-03-04	2018-03-30	原始取得	无
3795	半导体器件的形成方法	ZL201410076992.6	中芯上海	2014-03-04	2018-02-16	原始取得	无
3796	半导体结构及其形成方法	ZL201410076994.5	中芯上海、中芯北京	2014-03-04	2018-03-06	原始取得	无
3797	清洗焊盘的方法	ZL201410077012.4	中芯上海	2014-03-04	2018-06-01	原始取得	无
3798	光耦合器件及其形成方法	ZL201410077106.1	中芯上海、中芯北京	2014-03-04	2017-05-17	原始取得	无
3799	半导体器件及其形成方法	ZL201410077116.5	中芯上海	2014-03-04	2018-09-07	原始取得	无
3800	半导体器件的形成方法	ZL201410077118.4	中芯上海	2014-03-04	2017-11-03	原始取得	无
3801	栅极工艺的监测版图及监测方法	ZL201410077173.3	中芯上海	2014-03-04	2017-12-01	原始取得	无
3802	一种晶圆质量管控方法和装置	ZL201410077174.8	中芯上海、中芯北京	2014-03-04	2018-03-06	原始取得	无
3803	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410077191.1	中芯上海	2014-03-04	2018-08-10	原始取得	无
3804	MOS 晶体管的制作方法及半导体器件的制作方法	ZL201410077192.6	中芯上海	2014-03-04	2017-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3805	晶体管的形成方法	ZL201410077193.0	中芯上海	2014-03-04	2018-03-09	原始取得	无
3806	栅介质层的形成方法和 MOS 晶体管的形成方法	ZL201410077194.5	中芯上海	2014-03-04	2017-11-28	原始取得	无
3807	半导体器件的形成方法	ZL201410077201.1	中芯上海、中芯北京	2014-03-04	2018-05-01	原始取得	无
3808	一种肖特基二极管及其制造方法	ZL201410077494.3	中芯上海	2014-03-05	2018-04-17	原始取得	无
3809	一种检测偏移的测试结构	ZL201410077518.5	中芯上海	2014-03-04	2017-08-25	原始取得	无
3810	一种在线数据监控系统及监控方法	ZL201410079362.4	中芯天津、中芯上海	2014-03-05	2018-07-10	原始取得	无
3811	一种晶圆完整性的侦测方法及晶圆导向器	ZL201410080793.2	中芯上海	2014-03-06	2018-12-14	原始取得	无
3812	一种特征尺寸收缩的半导体器件的封装方法及结构	ZL201410081016.X	中芯上海	2014-03-06	2018-02-13	原始取得	无
3813	一种半导体器件及其制备方法	ZL201410081136.X	中芯上海	2014-03-06	2018-02-06	原始取得	无
3814	一种横向扩散半导体器件及其制备方法	ZL201410081257.4	中芯上海	2014-03-06	2018-04-13	原始取得	无
3815	一种半导体器件的制作方法	ZL201410081261.0	中芯上海、中芯北京	2014-03-06	2018-04-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3816	延时选择器	ZL201410083003.6	中芯上海、中芯北京	2014-03-07	2018-08-24	原始取得	无
3817	晶圆缺陷检测方法	ZL201410083015.9	中芯上海、中芯北京	2014-03-07	2018-05-01	原始取得	无
3818	用于静态随机存储器的存储单元和静态随机存储器	ZL201410083038.X	中芯上海	2014-03-07	2018-04-27	原始取得	无
3819	用于静态随机存储器的存储单元和静态随机存储器	ZL201410083939.9	中芯上海	2014-03-07	2018-03-06	原始取得	无
3820	栅极氧化层的制备方法	ZL201410084501.2	中芯上海	2014-03-10	2018-03-06	原始取得	无
3821	去除 HASTI 制备过程中形成的残留颗粒的方法	ZL201410084595.3	中芯上海	2014-03-10	2017-12-22	原始取得	无
3822	订单生产周期和产量的测量方法	ZL201410087606.3	中芯上海	2014-03-11	2018-01-26	原始取得	无
3823	半导体器件的制造方法	ZL201410088208.3	中芯上海	2014-03-11	2018-01-12	原始取得	无
3824	一种半导体器件的制造方法	ZL201410088290.X	中芯上海	2014-03-11	2018-03-16	原始取得	无
3825	一种制作半导体器件的方法	ZL201410090726.9	中芯上海	2014-03-12	2018-08-21	原始取得	无
3826	一种光罩的检测结构及检测方法	ZL201410093026.5	中芯上海	2014-03-13	2019-12-17	原始取得	无
3827	一种半浮栅存储器结构及其制作方法	ZL201410093029.9	中芯上海	2014-03-13	2018-09-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3828	一种半浮栅存储器结构	ZL201410093030.1	中芯上海、中芯北京	2014-03-13	2018-07-20	原始取得	无
3829	一种激光诱导热生长氧化硅的方法	ZL201410093052.8	中芯上海	2014-03-13	2018-02-06	原始取得	无
3830	一种化学机械研磨的方法	ZL201410093053.2	中芯上海	2014-03-13	2018-09-21	原始取得	无
3831	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410093071.0	中芯上海	2014-03-13	2018-10-23	原始取得	无
3832	一种应变沟道晶体管及其制备方法	ZL201410093072.5	中芯上海、中芯北京	2014-03-13	2018-05-01	原始取得	无
3833	用于 EEPROM 的温度补偿延迟电路	ZL201410098514.5	中芯上海	2014-03-17	2018-12-04	原始取得	无
3834	栅极及其制作方法	ZL201410098617.1	中芯上海	2014-03-17	2018-07-20	原始取得	无
3835	PMOS 晶体管、其制作方法及半导体器件	ZL201410098684.3	中芯上海	2014-03-17	2019-01-08	原始取得	无
3836	刻蚀方法、在半导体基材上形成凹槽的方法、PMOS 晶体管及其制作方法	ZL201410098686.2	中芯上海	2014-03-17	2018-08-03	原始取得	无
3837	在半导体器件中形成金属结构的方法及互连层的制作方	ZL201410098689.6	中芯上海	2014-03-17	2018-09-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3838	一种金属层图形化方法	ZL201410100060.0	中芯上海	2014-03-18	2017-12-22	原始取得	无
3839	一种半导体器件间隙壁的制造方法	ZL201410100513.X	中芯上海	2014-03-18	2018-09-25	原始取得	无
3840	一种制作半导体器件的方法	ZL201410100745.5	中芯上海	2014-03-18	2019-01-18	原始取得	无
3841	一种运动传感器的制备方法	ZL201410100750.6	中芯上海	2014-03-18	2017-03-08	原始取得	无
3842	重叠对准标记和具有该重叠对准标记的基片	ZL201410100759.7	中芯上海	2014-03-18	2018-03-23	原始取得	无
3843	一种半导体器件的制造方法	ZL201410101098.X	中芯上海	2014-03-18	2018-03-16	原始取得	无
3844	一种 PVD 系统工艺参数的优化方法	ZL201410101122.X	中芯上海、中芯北京	2014-03-18	2018-03-30	原始取得	无
3845	图像传感器及其制作方法	ZL201410101127.2	中芯上海	2014-03-18	2018-09-18	原始取得	无
3846	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410101128.7	中芯上海	2014-03-18	2018-06-08	原始取得	无
3847	闪存单元及其制造方法	ZL201410101129.1	中芯上海	2014-03-19	2018-04-13	原始取得	无
3848	一种利用激光退火改善热键合质量的方法	ZL201410103443.3	中芯上海	2014-03-19	2017-06-16	原始取得	无
3849	一种半导体器件的制造方法	ZL201410103866.5	中芯上海	2014-03-19	2018-09-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3850	光电二极管、其制作方法及图像传感器件	ZL201410103890.9	中芯上海	2014-03-19	2017-06-06	原始取得	无
3851	浅沟槽的制作方法及存储器件的制作方法	ZL201410103919.3	中芯上海	2014-03-19	2018-03-23	原始取得	无
3852	一种提高晶圆间键合强度的方法	ZL201410103977.6	中芯上海	2014-03-19	2017-06-13	原始取得	无
3853	一种处理异常晶片的方法	ZL201410105748.8	中芯上海	2014-03-20	2018-05-04	原始取得	无
3854	一种晶片生长装置及方法	ZL201410105926.7	中芯上海	2014-03-20	2019-04-23	原始取得	无
3855	一种半导体器件的制作方法	ZL201410105947.9	中芯上海	2014-03-20	2018-07-06	原始取得	无
3856	一种闪存器件及其制备方法	ZL201410105950.0	中芯上海	2014-03-20	2018-03-02	原始取得	无
3857	一种 MEMS 器件切割方法	ZL201410105966.1	中芯上海	2014-03-20	2017-03-01	原始取得	无
3858	MEMS 半导体器件的形成方法	ZL201410105998.1	中芯上海、中芯北京	2014-03-20	2016-09-07	原始取得	无
3859	一种具有金属填充物结构的电感器	ZL201410106306.5	中芯上海	2014-03-20	2017-11-24	原始取得	无
3860	一种标准单元漏电流的测试电路及测试方法	ZL201410108433.9	中芯上海	2014-03-21	2018-07-06	原始取得	无
3861	一种 Flash 器件及其制备方法	ZL201410109948.0	中芯上海、中芯北京	2014-03-21	2018-08-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3862	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410111576.5	中芯上海	2014-03-24	2018-02-06	原始取得	无
3863	一种半导体器件的制造方法	ZL201410111827.X	中芯上海	2014-03-24	2017-11-14	原始取得	无
3864	一种 MIM 结构的制备方法	ZL201410113669.1	中芯上海	2014-03-25	2018-03-27	原始取得	无
3865	半导体器件及其形成方法	ZL201410113737.4	中芯上海、中芯北京	2014-03-25	2018-03-30	原始取得	无
3866	半导体结构的形成方法	ZL201410113739.3	中芯上海	2014-03-25	2018-02-16	原始取得	无
3867	半导体结构及其形成方法	ZL201410113740.6	中芯上海	2014-03-25	2018-05-01	原始取得	无
3868	MEMS 器件及其形成方法	ZL201410113757.1	中芯上海	2014-03-25	2017-02-22	原始取得	无
3869	MEMS 器件及其形成方法	ZL201410113760.3	中芯上海	2014-03-25	2017-05-17	原始取得	无
3870	电互连结构及其形成方法	ZL201410113767.5	中芯上海	2014-03-25	2018-07-10	原始取得	无
3871	半导体结构的形成方法	ZL201410113838.1	中芯上海	2014-03-25	2017-12-01	原始取得	无
3872	晶体管及其形成方法	ZL201410114598.7	中芯上海	2014-03-25	2018-07-10	原始取得	无
3873	闪存存储单元的形成方法	ZL201410114599.1	中芯上海	2014-03-25	2018-08-10	原始取得	无
3874	涂层的形成方法	ZL201410114618.0	中芯上海	2014-03-25	2017-12-01	原始取得	无
3875	半导体器件的形成方法	ZL201410114628.4	中芯上海	2014-03-25	2018-12-21	原始取得	无
3876	具有金属柱的芯片封装结构及其形成方法	ZL201410114630.1	中芯上海	2014-03-25	2018-10-16	原始取得	无
3877	一种金属-绝缘体-金属电容结	ZL201410114832.6	中芯上海	2014-03-25	2018-12-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	构						
3878	一种接合晶圆及其制备方法	ZL201410114959.8	中芯上海、中芯北京	2014-03-26	2019-05-21	原始取得	无
3879	一种 MEMS 器件结构的制作方法	ZL201410114998.8	中芯上海、中芯北京	2014-03-26	2017-01-25	原始取得	无
3880	一种 MEMS 器件结构的制作方法	ZL201410115027.5	中芯上海、中芯北京	2014-03-26	2017-12-19	原始取得	无
3881	一种硅片电学测试的早期侦测系统及方法	ZL201410115031.1	中芯上海	2014-03-26	2017-11-24	原始取得	无
3882	一种半导体器件的制备方法	ZL201410116267.7	中芯上海	2014-03-26	2019-01-18	原始取得	无
3883	一种半导体器件的制造方法	ZL201410116344.9	中芯上海	2014-03-26	2018-07-20	原始取得	无
3884	一种图案化接地屏蔽结构	ZL201410116374.X	中芯上海	2014-03-26	2017-11-14	原始取得	无
3885	一种半导体器件的制备方法	ZL201410116748.8	中芯上海	2014-03-26	2018-03-20	原始取得	无
3886	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410117475.9	中芯上海	2014-03-26	2018-05-04	原始取得	无
3887	鳍型场效应晶体管及其制造方法	ZL201410118033.6	中芯上海	2014-03-27	2019-05-21	原始取得	无
3888	定义最佳电子束对焦点的方法	ZL201410122490.2	中芯上海、中芯北京	2014-03-28	2017-12-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3889	检测喷头静电结构和方法	ZL201410123971.5	中芯上海、中芯北京	2014-03-28	2018-05-11	原始取得	无
3890	叠层标记	ZL201410124013.X	中芯上海、中芯北京	2014-03-28	2018-07-20	原始取得	无
3891	一种制作嵌入式闪存的方法	ZL201410126816.9	中芯上海	2014-03-31	2018-07-20	原始取得	无
3892	用于硅通孔制作的对准结构及硅通孔的制作方法	ZL201410126923.1	中芯上海	2014-03-31	2018-05-25	原始取得	无
3893	互连介质层、其制作方法及包括其的互连层	ZL201410126925.0	中芯上海	2014-03-31	2019-01-08	原始取得	无
3894	一种制作嵌入式闪存的方法	ZL201410127513.9	中芯上海	2014-03-31	2018-11-16	原始取得	无
3895	TiN 复合硬掩膜、用于形成互连层结构的硬掩及互连层的制作方法	ZL201410127662.5	中芯上海	2014-03-31	2018-07-20	原始取得	无
3896	芯片结构、其制作方法及包括其的 MEMS 器件	ZL201410127665.9	中芯上海	2014-03-31	2017-11-14	原始取得	无
3897	掩膜的沉积方法、掩膜及半导体器件的刻蚀方法	ZL201410127676.7	中芯上海	2014-03-31	2017-12-19	原始取得	无
3898	用于硅通孔制作的对准结构及硅通孔的制作方法	ZL201410127763.2	中芯上海	2014-03-31	2019-01-08	原始取得	无
3899	介电薄膜的后处理方法、互连	ZL201410127765.1	中芯上海	2014-03-31	2018-10-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	层及半导体器件						
3900	一种射频测试结构及射频测试方法	ZL201410127772.1	中芯上海、中芯北京	2014-03-31	2018-02-06	原始取得	无
3901	一种沟槽型半导体器件结构的制作方法	ZL201410128233.X	中芯上海、中芯北京	2014-04-01	2018-09-25	原始取得	无
3902	沟槽隔离结构、其制作方法及半导体器件和图像传感器	ZL201410129079.8	中芯上海	2014-03-31	2019-01-08	原始取得	无
3903	去除光刻胶的后处理方法及互连层结构的制作方法	ZL201410129087.2	中芯上海	2014-03-31	2018-03-23	原始取得	无
3904	一种半导体装置及其制造方法	ZL201410129139.6	中芯上海	2014-04-01	2018-04-13	原始取得	无
3905	半导体结构及切断其中存储单元区块连接的方法	ZL201410129853.5	中芯上海	2014-04-01	2018-07-06	原始取得	无
3906	用于芯片缺陷扫描的关注区域划分方法	ZL201410129891.0	中芯上海、中芯北京	2014-04-01	2018-05-04	原始取得	无
3907	对准标记及其对准方法	ZL201410130687.0	中芯上海、中芯北京	2014-03-28	2017-11-14	原始取得	无
3908	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410131205.3	中芯上海	2014-04-02	2018-09-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3909	绝缘栅双极晶体管及其形成方法	ZL201410131211.9	中芯上海、中芯北京	2014-04-02	2018-12-21	原始取得	无
3910	半导体器件的形成方法	ZL201410131218.0	中芯上海	2014-04-02	2018-03-30	原始取得	无
3911	光学邻近校正方法以及优化光学邻近校正模型的方法	ZL201410131227.X	中芯上海	2014-04-02	2019-04-26	原始取得	无
3912	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410131233.5	中芯上海	2014-04-02	2018-03-30	原始取得	无
3913	半导体数据收集方法及系统	ZL201410131242.4	中芯上海	2014-04-02	2018-03-30	原始取得	无
3914	一种静电放电保护电路	ZL201410131248.1	中芯上海	2014-04-02	2017-12-29	原始取得	无
3915	能快速读数据的读电路及存储器	ZL201410131361.X	中芯上海	2014-04-02	2018-12-14	原始取得	无
3916	半导体结构及其形成方法	ZL201410131364.3	中芯上海	2014-04-02	2018-02-16	原始取得	无
3917	MEMS 麦克风的形成方法	ZL201410131408.2	中芯上海	2014-04-02	2019-03-29	原始取得	无
3918	无线收发装置和方法	ZL201410131439.8	中芯上海	2014-04-02	2018-09-07	原始取得	无
3919	存储器及其读取电路	ZL201410131492.8	中芯上海、中芯北京	2014-04-02	2019-01-22	原始取得	无
3920	晶圆传送盒的存储方法及实现晶圆传送盒存储的系统	ZL201410131501.3	中芯上海	2014-04-02	2017-09-22	原始取得	无
3921	叠层结构的形成方法以及互	ZL201410131503.2	中芯上海	2014-04-02	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	连结构的形成方法						
3922	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201410131577.6	中芯上海	2014-04-02	2019-03-29	原始取得	无
3923	一种晶圆键合工艺	ZL201410133223.5	中芯上海、中芯北京	2014-04-03	2019-05-24	原始取得	无
3924	基于实时派工系统的机台组下的晶圆批次派工方法和系统	ZL201410133233.9	中芯上海	2014-04-03	2018-09-07	原始取得	无
3925	一种半导体器件的形成方法	ZL201410133364.7	中芯上海	2014-04-03	2018-03-09	原始取得	无
3926	互连结构的形成方法	ZL201410133367.0	中芯上海	2014-04-03	2017-12-29	原始取得	无
3927	互连结构的形成方法	ZL201410133369.X	中芯上海	2014-04-03	2018-03-30	原始取得	无
3928	半导体器件的形成方法	ZL201410133522.9	中芯上海	2014-04-03	2018-06-01	原始取得	无
3929	半导体器件的形成方法	ZL201410133524.8	中芯上海	2014-04-03	2018-04-27	原始取得	无
3930	栅极及晶体管的形成方法	ZL201410133562.3	中芯上海	2014-04-03	2018-12-18	原始取得	无
3931	半导体器件的形成方法	ZL201410133563.8	中芯上海	2014-04-03	2018-03-06	原始取得	无
3932	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410133597.7	中芯上海	2014-04-03	2018-07-20	原始取得	无
3933	更换机台上化学制剂的方法及系统	ZL201410134558.9	中芯天津、中芯上海	2014-04-03	2018-07-10	原始取得	无
3934	一种半导体器件及其制作方	ZL201410135858.9	中芯上海	2014-04-04	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
3935	晶体管的形成方法	ZL201410135884.1	中芯上海	2014-04-04	2019-05-28	原始取得	无
3936	栅极的制作方法、晶体管的制作方法	ZL201410135908.3	中芯上海	2014-04-04	2019-07-30	原始取得	无
3937	MOS 晶体管和导电插塞的形成方法	ZL201410135921.9	中芯上海	2014-04-04	2018-06-01	原始取得	无
3938	互连结构及其形成方法	ZL201410135922.3	中芯上海	2014-04-04	2018-03-30	原始取得	无
3939	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410135924.2	中芯上海	2014-04-04	2018-07-10	原始取得	无
3940	晶体管的形成方法	ZL201410135925.7	中芯上海	2014-04-04	2018-02-16	原始取得	无
3941	晶体管的形成方法	ZL201410136263.5	中芯上海	2014-04-04	2018-04-27	原始取得	无
3942	形成互连结构的方法	ZL201410136507.X	中芯上海	2014-04-04	2018-02-16	原始取得	无
3943	硅通孔形成方法	ZL201410136509.9	中芯上海	2014-04-04	2018-08-10	原始取得	无
3944	一种降低晶圆报废率的方法	ZL201410136511.6	中芯上海	2014-04-04	2018-02-16	原始取得	无
3945	MOS 晶体管的制作方法	ZL201410136566.7	中芯上海	2014-04-04	2019-04-26	原始取得	无
3946	CMOS 器件结构及其制作方法	ZL201410136567.1	中芯上海	2014-04-04	2018-08-10	原始取得	无
3947	隧道场效应晶体管及其制作方法	ZL201410136576.0	中芯上海	2014-04-04	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3948	栅极结构及其制作方法	ZL201410136590.0	中芯上海	2014-04-04	2017-12-01	原始取得	无
3949	用于集成电路设计的测量电路和方法	ZL201410136719.8	中芯上海	2014-04-04	2018-03-23	原始取得	无
3950	用于集成电路的器件模拟方法	ZL201410136956.4	中芯上海	2014-04-04	2018-03-23	原始取得	无
3951	一种半导体器件的制造方法	ZL201410138082.6	中芯上海	2014-04-08	2018-03-20	原始取得	无
3952	一种半导体器件的制造方法	ZL201410138464.9	中芯上海	2014-04-08	2018-05-04	原始取得	无
3953	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410140183.7	中芯上海	2014-04-09	2018-10-23	原始取得	无
3954	一种半导体器件的制造方法	ZL201410141013.0	中芯上海	2014-04-09	2018-05-08	原始取得	无
3955	一种优化光掩模图案制备参数的方法	ZL201410141068.1	中芯上海	2014-04-09	2019-10-18	原始取得	无
3956	一种晶圆出货检验方法	ZL201410141119.0	中芯上海	2014-04-09	2018-05-01	原始取得	无
3957	嵌入式分栅闪存器件的制造方法	ZL201410141213.6	中芯上海	2014-04-10	2018-05-04	原始取得	无
3958	一种半导体器件的制造方法	ZL201410142632.1	中芯上海	2014-04-10	2018-03-20	原始取得	无
3959	一种半导体器件的制造方法	ZL201410142686.8	中芯上海	2014-04-10	2019-10-25	原始取得	无
3960	一种半导体器件的制造方法	ZL201410143509.1	中芯上海	2014-04-10	2018-02-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3961	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410143547.7	中芯上海、中芯宁波	2014-04-10	2018-08-10	原始取得	无
3962	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410143729.4	中芯上海	2014-04-11	2018-03-20	原始取得	无
3963	纳米线器件及其制造方法	ZL201410145605.X	中芯上海	2014-04-10	2018-03-06	原始取得	无
3964	一种测试器件热载流子注入效应的方法	ZL201410150300.8	中芯上海	2014-04-11	2017-11-24	原始取得	无
3965	晶体管的形成方法	ZL201410155750.6	中芯上海	2014-04-17	2019-03-12	原始取得	无
3966	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410157805.7	中芯上海	2014-04-18	2018-09-07	原始取得	无
3967	一种半导体器件及其制备方法	ZL201410160575.X	中芯上海	2014-04-21	2019-01-18	原始取得	无
3968	一种半导体器件的制造方法	ZL201410163088.9	中芯上海	2014-04-22	2018-05-08	原始取得	无
3969	一种半导体器件的制造方法	ZL201410163096.3	中芯上海	2014-04-22	2018-12-21	原始取得	无
3970	一种主节点版图中半节点 CMP 模型的运行方法	ZL201410163106.3	中芯上海	2014-04-22	2018-12-21	原始取得	无
3971	一种振荡电路和电子装置	ZL201410163804.3	中芯上海	2014-04-22	2018-02-06	原始取得	无
3972	一种半导体器件的制造方法	ZL201410163805.8	中芯上海	2014-04-22	2018-05-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3973	一种垂直型平面螺旋电感及其制备方法、电子装置	ZL201410163827.4	中芯上海	2014-04-22	2017-09-01	原始取得	无
3974	一种建立金属-绝缘体-金属电容模型的方法	ZL201410163870.0	中芯上海、中芯北京	2014-04-22	2018-09-21	原始取得	无
3975	一种半导体器件的制造方法	ZL201410163931.3	中芯上海	2014-04-22	2018-06-08	原始取得	无
3976	用于改进斜坡电流测试检验能力的通孔阵列测试结构	ZL201410164309.4	中芯上海	2014-04-23	2019-03-12	原始取得	无
3977	一种半导体器件	ZL201410166713.5	中芯上海	2014-04-24	2018-11-16	原始取得	无
3978	一种半导体器件的制备方法	ZL201410166802.X	中芯上海、中芯北京	2014-04-24	2018-04-13	原始取得	无
3979	一种半导体器件的制备方法	ZL201410166999.7	中芯上海、中芯北京	2014-04-24	2018-07-20	原始取得	无
3980	一种用于 LVS 验证的对晶体管的栅极进行识别的方法	ZL201410167023.1	中芯上海	2014-04-24	2018-02-06	原始取得	无
3981	一种电迁移的检测结构及检测方法	ZL201410167096.0	中芯上海、中芯北京	2014-04-24	2018-05-11	原始取得	无
3982	半导体装置及其制造方法	ZL201410169272.4	中芯上海	2014-04-25	2018-09-11	原始取得	无
3983	鳍片式场效应晶体管及其制造方法	ZL201410169353.4	中芯上海	2014-04-25	2018-04-13	原始取得	无
3984	一种 FinFET 器件及其制造方	ZL201410171113.8	中芯上海	2014-04-25	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
3985	一种 FinFET 器件及其制造方法、电子装置	ZL201410171202.2	中芯上海	2014-04-25	2019-01-18	原始取得	无
3986	闪存制造方法	ZL201410171809.0	中芯上海	2014-04-25	2018-02-09	原始取得	无
3987	一种对沉积薄膜反应装置的处理方法、薄膜沉积方法	ZL201410171811.8	中芯上海	2014-04-25	2018-09-25	原始取得	无
3988	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410172007.1	中芯上海	2014-04-25	2019-02-01	原始取得	无
3989	一种 FinFET 器件及其制造方法、电子装置	ZL201410172010.3	中芯上海	2014-04-25	2018-07-20	原始取得	无
3990	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201410172282.3	中芯上海	2014-04-25	2018-03-20	原始取得	无
3991	静态存储单元的形成方法	ZL201410172511.1	中芯上海	2014-04-25	2017-11-03	原始取得	无
3992	用于检测 STI 结构的电隔离性能的检测结构和检测方法	ZL201410172644.9	中芯上海	2014-04-25	2017-12-19	原始取得	无
3993	一种制作半导体器件的方法	ZL201410175156.3	中芯上海	2014-04-28	2019-02-01	原始取得	无
3994	一种金属互连可靠性的检测结构及检测方法	ZL201410175158.2	中芯上海	2014-04-28	2018-06-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
3995	存储阵列的操作方法和存储器	ZL201410181422.3	中芯上海	2014-04-30	2019-07-30	原始取得	无
3996	ESD 检测方法、装置以及 ESD 调试方法、装置	ZL201410181425.7	中芯上海、中芯北京	2014-04-30	2017-11-28	原始取得	无
3997	双端口 SRAM	ZL201410182749.2	中芯上海	2014-04-30	2018-02-23	原始取得	无
3998	一种制作半导体器件的方法	ZL201410183949.X	中芯上海	2014-05-04	2018-12-21	原始取得	无
3999	半导体结构的形成方法	ZL201410184366.9	中芯上海	2014-05-04	2018-09-07	原始取得	无
4000	闪存器件及其形成方法	ZL201410184368.8	中芯上海	2014-05-04	2018-02-16	原始取得	无
4001	半导体器件的形成方法	ZL201410184425.2	中芯上海	2014-05-04	2018-03-30	原始取得	无
4002	半导体器件及其形成方法	ZL201410184447.9	中芯上海	2014-05-04	2018-09-07	原始取得	无
4003	存储器、存储阵列的检测电路及方法	ZL201410184492.4	中芯上海	2014-05-04	2017-12-29	原始取得	无
4004	一种工艺开发包中参数化单元的 DRC 验证方法	ZL201410184633.2	中芯上海	2014-05-04	2019-09-03	原始取得	无
4005	互连结构的形成方法	ZL201410184635.1	中芯上海	2014-05-04	2018-02-16	原始取得	无
4006	存储器及其编程电路	ZL201410184849.9	中芯上海	2014-05-04	2019-07-30	原始取得	无
4007	MOS 晶体管的形成方法和 CMOS 晶体管的形成方法	ZL201410184850.1	中芯上海	2014-05-04	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4008	半导体结构的形成方法	ZL201410184867.7	中芯上海	2014-05-04	2017-11-03	原始取得	无
4009	CMOS 晶体管的形成方法	ZL201410184868.1	中芯上海	2014-05-04	2017-11-03	原始取得	无
4010	半导体器件的形成方法	ZL201410184869.6	中芯上海	2014-05-04	2018-06-29	原始取得	无
4011	半导体器件及其形成方法	ZL201410184886.X	中芯上海	2014-05-04	2018-03-30	原始取得	无
4012	接触插塞的形成方法	ZL201410184887.4	中芯上海	2014-05-04	2018-11-16	原始取得	无
4013	动态静电放电钳位电路	ZL201410184890.6	中芯上海	2014-05-04	2018-09-18	原始取得	无
4014	低压差稳压器	ZL201410184906.3	中芯上海	2014-05-04	2017-06-30	原始取得	无
4015	一种 MEMS 器件的制备方法	ZL201410184910.X	中芯上海	2014-05-04	2017-04-05	原始取得	无
4016	FinFET 器件的制作方法	ZL201410184974.X	中芯上海	2014-05-04	2018-10-23	原始取得	无
4017	场效应晶体管及其制造方法	ZL201410185027.2	中芯上海	2014-05-05	2018-12-04	原始取得	无
4018	隧穿碳纳米管场效应晶体管及其制造方法	ZL201410185138.3	中芯上海	2014-05-05	2019-01-25	原始取得	无
4019	MIM 电容结构及其制作方法	ZL201410186602.0	中芯上海	2014-05-05	2018-07-24	原始取得	无
4020	一种半导体器件的制造方法	ZL201410186626.6	中芯上海、中芯宁波	2014-05-05	2019-06-28	原始取得	无
4021	一种缺陷扫描机台对准系统的改进方法	ZL201410186904.8	中芯上海	2014-05-05	2018-02-06	原始取得	无
4022	引线键合结构及引线键合方法	ZL201410187038.4	中芯上海	2014-05-05	2019-09-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4023	一种硅纳米线的制备方法	ZL201410187278.4	中芯上海	2014-05-06	2017-11-24	原始取得	无
4024	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410188472.4	中芯上海	2014-05-06	2018-07-20	原始取得	无
4025	一种改善栅极结构线宽粗糙度的方法	ZL201410188492.1	中芯上海、中芯北京	2014-05-06	2018-04-10	原始取得	无
4026	生产系统的控制方法及装置	ZL201410188627.4	中芯上海	2014-05-06	2018-02-02	原始取得	无
4027	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410189140.8	中芯上海	2014-05-06	2018-05-08	原始取得	无
4028	一种半导体器件的制作方法	ZL201410190671.9	中芯上海	2014-05-07	2019-01-18	原始取得	无
4029	一种 FinFET 鳍片掺杂浓度分布的测量方法和测量样品制备方法	ZL201410191352.X	中芯上海	2014-05-07	2018-03-20	原始取得	无
4030	一种硅基液晶显示装置反射镜面及其制作方法	ZL201410191463.0	中芯上海	2014-05-07	2018-08-17	原始取得	无
4031	一种半导体器件的制造方法	ZL201410191465.X	中芯上海	2014-05-07	2018-12-21	原始取得	无
4032	电可擦可编程只读存储器及其数据处理方法	ZL201410191468.3	中芯上海	2014-05-07	2018-03-23	原始取得	无
4033	一种印刷电路板的拼板方法	ZL201410191474.9	中芯上海	2014-05-07	2018-09-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4034	一种硅通孔的结构及其制作方法	ZL201410191475.3	中芯上海	2014-05-07	2018-05-08	原始取得	无
4035	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201410192788.0	中芯上海	2014-05-08	2019-01-22	原始取得	无
4036	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201410192832.8	中芯上海	2014-05-08	2019-01-22	原始取得	无
4037	一种半导体器件的制作方法	ZL201410193157.0	中芯上海	2014-05-08	2018-08-17	原始取得	无
4038	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201410193158.5	中芯上海	2014-05-08	2018-05-04	原始取得	无
4039	光检测器	ZL201410193166.X	中芯上海	2014-05-08	2018-07-20	原始取得	无
4040	喷嘴位置的检测方法及检测晶圆	ZL201410193183.3	中芯上海	2014-05-08	2018-11-16	原始取得	无
4041	一种防止曝光系统中半影入射光掩模的方法及结构	ZL201410193657.4	中芯上海、中芯北京	2014-05-09	2018-09-07	原始取得	无
4042	一种监测晶圆固定器应力的方法	ZL201410195850.1	中芯上海	2014-05-09	2018-02-06	原始取得	无
4043	半导体结构的形成方法	ZL201410195991.3	中芯上海	2014-05-09	2018-06-29	原始取得	无
4044	温度计译码器	ZL201410195995.1	中芯上海	2014-05-09	2018-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4045	一种半导体器件终端结构的制造方法	ZL201410196017.9	中芯上海、中芯北京	2014-05-09	2018-09-25	原始取得	无
4046	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410196076.6	中芯上海	2014-05-09	2019-04-09	原始取得	无
4047	晶圆处理方法	ZL201410196551.X	中芯上海	2014-05-09	2019-03-12	原始取得	无
4048	一种制作半导体器件的方法	ZL201410197826.1	中芯上海	2014-05-12	2018-06-08	原始取得	无
4049	半导体结构的形成方法	ZL201410198240.7	中芯上海	2014-05-12	2018-06-29	原始取得	无
4050	芯片封装结构的处理方法	ZL201410198249.8	中芯上海	2014-05-12	2018-03-30	原始取得	无
4051	一种制作半导体器件的方法	ZL201410198540.5	中芯上海	2014-05-12	2018-08-21	原始取得	无
4052	一种制作半导体器件的方法	ZL201410198629.1	中芯上海	2014-05-12	2018-10-23	原始取得	无
4053	半导体器件制造工艺和半导体器件	ZL201410199414.1	中芯上海	2014-05-12	2019-01-08	原始取得	无
4054	键合结构及其形成方法	ZL201410199435.3	中芯上海	2014-05-12	2019-02-12	原始取得	无
4055	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410199457.X	中芯上海	2014-05-12	2019-09-27	原始取得	无
4056	半导体结构的形成方法	ZL201410199458.4	中芯上海	2014-05-12	2017-02-01	原始取得	无
4057	反熔丝元件、反熔丝元件的制造方法及半导体器件	ZL201410199530.3	中芯上海	2014-05-12	2017-12-19	原始取得	无
4058	等离子体反应器及清除等离	ZL201410199553.4	中芯上海	2014-05-12	2018-09-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	子体反应腔室颗粒污染的方法						
4059	闪存的接触结构及其制造方法	ZL201410199555.3	中芯上海	2014-05-12	2018-10-23	原始取得	无
4060	晶体管的形成方法	ZL201410201379.2	中芯上海	2014-05-13	2018-07-10	原始取得	无
4061	半浮栅晶体管结构	ZL201410201614.6	中芯上海	2014-05-13	2018-08-03	原始取得	无
4062	一种焊盘下装置的检测结构及检测方法	ZL201410201704.5	中芯上海	2014-05-14	2018-11-16	原始取得	无
4063	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410203092.3	中芯上海	2014-05-14	2018-05-08	原始取得	无
4064	一种压力传感器及其制备方法、电子装置	ZL201410203115.0	中芯上海	2014-05-14	2018-09-21	原始取得	无
4065	芯片晶圆及其制作方法	ZL201410203523.6	中芯上海	2014-05-14	2019-04-09	原始取得	无
4066	半浮栅晶体管结构及其制作方法	ZL201410203559.4	中芯上海	2014-05-14	2018-08-03	原始取得	无
4067	肖特基二极管 SPICE 模型及其形成方法、应用方法	ZL201410203971.6	中芯上海	2014-05-14	2018-03-23	原始取得	无
4068	一种半导体器件及其制备方	ZL201410205470.1	中芯上海	2014-05-15	2017-12-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
4069	半导体器件的形成方法	ZL201410205499.X	中芯上海	2014-05-15	2018-03-30	原始取得	无
4070	半导体器件制造过程中的工艺控制方法及系统	ZL201410205533.3	中芯上海	2014-05-15	2017-12-29	原始取得	无
4071	曝光机散射光参量的监测方法	ZL201410205559.8	中芯上海	2014-05-15	2017-05-24	原始取得	无
4072	一种相变存储器及其制造方法和电子装置	ZL201410205887.8	中芯上海	2014-05-15	2017-05-10	原始取得	无
4073	半导体器件的形成方法	ZL201410206054.3	中芯上海	2014-05-15	2018-07-10	原始取得	无
4074	半导体器件的形成方法	ZL201410206055.8	中芯上海	2014-05-15	2018-06-01	原始取得	无
4075	半导体器件、互连层和互连层的制作方法	ZL201410206393.1	中芯上海	2014-05-15	2018-05-25	原始取得	无
4076	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410209030.3	中芯上海	2014-05-16	2018-06-08	原始取得	无
4077	一种 SRAM 输出锁存电路	ZL201410216693.8	中芯上海	2014-05-21	2018-04-17	原始取得	无
4078	一种掩膜版雾化控制方法及装置	ZL201410216694.2	中芯上海	2014-05-21	2019-08-13	原始取得	无
4079	一种芯片失效分析方法	ZL201410216695.7	中芯上海	2014-05-21	2017-09-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4080	一种晶圆版图的 CDSEM 测量方法	ZL201410216745.1	中芯上海	2014-05-21	2018-05-04	原始取得	无
4081	一种栅氧化层完整性的测试结构及测试方法	ZL201410217663.9	中芯上海	2014-05-20	2019-01-22	原始取得	无
4082	电流舵结构的补偿电路和电流镜像电路	ZL201410217761.2	中芯上海	2014-05-21	2017-08-01	原始取得	无
4083	锁相环系统	ZL201410217767.X	中芯上海	2014-05-20	2018-04-17	原始取得	无
4084	一种 MEMS 压力传感器及其制备方法	ZL201410217858.3	中芯上海	2014-05-21	2017-12-05	原始取得	无
4085	一种 FinFET 半导体器件以及制备方法	ZL201410217869.1	中芯上海	2014-05-21	2018-08-21	原始取得	无
4086	一种 MEMS 压力传感器及其制备方法	ZL201410217875.7	中芯上海	2014-05-21	2018-03-20	原始取得	无
4087	一种调节 HRP 电阻值的方法	ZL201410217876.1	中芯上海	2014-05-21	2017-12-29	原始取得	无
4088	增强光刻工艺窗口的光学邻近修正方法	ZL201410218385.9	中芯上海	2014-05-22	2019-09-27	原始取得	无
4089	半导体存储器、半导体存储阵列及其操作方法	ZL201410218841.X	中芯上海	2014-05-22	2019-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4090	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410218843.9	中芯上海	2014-05-22	2018-06-08	原始取得	无
4091	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410219009.1	中芯上海	2014-05-22	2018-08-21	原始取得	无
4092	晶圆抽取方法和装置	ZL201410219057.0	中芯上海、中芯北京	2014-05-22	2018-05-04	原始取得	无
4093	降低关键尺寸的光学邻近修正的边缘定位误差的方法	ZL201410219282.4	中芯上海	2014-05-22	2019-09-27	原始取得	无
4094	快闪存储器的形成方法	ZL201410219995.0	中芯上海	2014-05-22	2018-09-25	原始取得	无
4095	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410220002.1	中芯上海	2014-05-22	2018-10-23	原始取得	无
4096	晶圆自动分批与传送的方法及装置	ZL201410220004.0	中芯上海、中芯北京	2014-05-22	2018-10-23	原始取得	无
4097	沉积炉、沉积方法、薄膜及半导体器件	ZL201410220005.5	中芯上海、中芯北京	2014-05-22	2018-05-04	原始取得	无
4098	应变硅层的制作方法、PMOS器件的制作方法及半导体器件	ZL201410220026.7	中芯上海	2014-05-22	2018-03-23	原始取得	无
4099	一种半导体器件及其制造方	ZL201410220028.6	中芯上海	2014-05-22	2018-07-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
4100	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410220030.3	中芯上海	2014-05-22	2018-11-16	原始取得	无
4101	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410220037.5	中芯上海	2014-05-22	2019-12-31	原始取得	无
4102	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410220163.0	中芯上海	2014-05-23	2018-11-16	原始取得	无
4103	一种化学机械研磨方法	ZL201410222131.4	中芯上海	2014-05-23	2017-09-26	原始取得	无
4104	一种追踪半导体产品队列时间的系统及方法	ZL201410222758.X	中芯上海	2014-05-23	2019-06-04	原始取得	无
4105	电容结构及其制作方法,包含电容结构的半导体存储器	ZL201410222759.4	中芯上海	2014-05-23	2019-08-13	原始取得	无
4106	浅沟槽隔离结构的形成方法	ZL201410222819.2	中芯上海	2014-05-23	2018-11-16	原始取得	无
4107	一种晶圆测试结果比对方法和系统	ZL201410225255.8	中芯上海	2014-05-26	2018-06-08	原始取得	无
4108	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410226155.7	中芯上海	2014-05-26	2019-10-25	原始取得	无
4109	一种半导体器件的制造方法	ZL201410226180.5	中芯上海	2014-05-26	2018-08-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	和电子装置						
4110	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410226194.7	中芯上海	2014-05-26	2018-11-16	原始取得	无
4111	一种半导体器件以及制备方法、电子装置	ZL201410226204.7	中芯上海	2014-05-26	2017-04-05	原始取得	无
4112	一种 SRAM 存储单元、SRAM 存储器及其控制方法	ZL201410228075.5	中芯上海	2014-05-27	2019-01-22	原始取得	无
4113	晶体管的形成方法	ZL201410228507.2	中芯上海	2014-05-27	2018-09-07	原始取得	无
4114	振荡电路	ZL201410230774.3	中芯上海	2014-05-28	2018-06-01	原始取得	无
4115	互连结构的形成方法和半导体结构	ZL201410230783.2	中芯上海	2014-05-28	2018-08-10	原始取得	无
4116	半导体结构及其形成方法	ZL201410230793.6	中芯上海	2014-05-28	2018-07-10	原始取得	无
4117	一种 SRAM 存储单元、SRAM 存储器及其控制方法	ZL201410231080.1	中芯上海	2014-05-28	2019-01-22	原始取得	无
4118	半导体器件及其形成方法	ZL201410231338.8	中芯上海	2014-05-28	2018-03-30	原始取得	无
4119	半导体结构的形成方法	ZL201410231339.2	中芯上海	2014-05-28	2018-06-01	原始取得	无
4120	半导体结构的形成方法	ZL201410231340.5	中芯上海	2014-05-28	2018-07-10	原始取得	无
4121	一种鳍式场效应晶体管的形	ZL201410233841.7	中芯上海	2014-05-29	2018-07-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	成方法						
4122	半导体器件的形成方法	ZL201410233857.8	中芯上海	2014-05-29	2019-01-22	原始取得	无
4123	半导体结构的形成方法	ZL201410234765.1	中芯上海	2014-05-29	2018-06-01	原始取得	无
4124	半导体结构的形成方法	ZL201410234793.3	中芯上海	2014-05-29	2017-12-29	原始取得	无
4125	半导体器件的形成方法	ZL201410235131.8	中芯上海	2014-05-29	2018-06-29	原始取得	无
4126	鳍式场效应晶体管的形成方法、MOS 晶体管的形成方法	ZL201410235132.2	中芯上海	2014-05-29	2018-03-30	原始取得	无
4127	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410239067.0	中芯上海	2014-05-30	2018-03-06	原始取得	无
4128	去除伪栅的方法	ZL201410239069.X	中芯上海	2014-05-30	2019-01-22	原始取得	无
4129	双镶嵌结构的形成方法	ZL201410239086.3	中芯上海	2014-05-30	2018-06-01	原始取得	无
4130	金属互连结构的形成方法	ZL201410239105.2	中芯上海	2014-05-30	2018-11-16	原始取得	无
4131	一种改善栅氧厚度均匀性的方法	ZL201410239131.5	中芯上海	2014-05-30	2018-02-06	原始取得	无
4132	氨气浓度侦测方法和控制光刻工艺中图形 CD 的方法	ZL201410239134.9	中芯上海、中芯北京	2014-05-30	2017-07-28	原始取得	无
4133	半导体测试结构及导电插塞与有源区接触性能的检测方	ZL201410240692.7	中芯上海	2014-05-30	2018-06-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4134	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410240693.1	中芯上海	2014-05-30	2018-08-10	原始取得	无
4135	形成互连结构的方法	ZL201410240705.0	中芯上海	2014-05-30	2018-10-16	原始取得	无
4136	一种去除 MEMS 焊垫上残留物的方法	ZL201410242664.9	中芯上海	2014-06-03	2017-02-15	原始取得	无
4137	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410243258.4	中芯上海	2014-06-03	2017-04-05	原始取得	无
4138	一种用于监控 SRAM 存储阵列中上拉晶体管的测试结构及测试方法	ZL201410243329.0	中芯上海	2014-06-03	2018-05-04	原始取得	无
4139	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410244354.0	中芯上海	2014-06-04	2018-04-13	原始取得	无
4140	一种半导体制造工艺中炉管机台运行的控制系统及方法	ZL201410245482.7	中芯上海	2014-06-04	2018-11-16	原始取得	无
4141	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410245731.2	中芯上海	2014-06-05	2018-10-23	原始取得	无
4142	一种浅沟槽隔离结构的制作	ZL201410252905.8	中芯上海	2014-06-09	2018-05-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
4143	一种确定 SRAM 电性能目标的仿真方法	ZL201410255400.7	中芯上海	2014-06-10	2018-11-16	原始取得	无
4144	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410256238.0	中芯上海	2014-06-10	2018-05-04	原始取得	无
4145	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410256271.3	中芯上海	2014-06-10	2018-07-20	原始取得	无
4146	一种 FinFET 及其制造方法、电子装置	ZL201410260429.4	中芯上海	2014-06-12	2018-08-21	原始取得	无
4147	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410260442.X	中芯上海	2014-06-12	2019-04-09	原始取得	无
4148	MRAM 器件的形成方法	ZL201410260635.5	中芯上海	2014-06-12	2018-01-09	原始取得	无
4149	MRAM 器件的形成方法	ZL201410260647.8	中芯上海	2014-06-12	2018-01-09	原始取得	无
4150	一种 FinFET 器件及其制造方法、电子装置	ZL201410260807.9	中芯上海	2014-06-12	2018-11-16	原始取得	无
4151	晶体管及其形成方法	ZL201410260890.X	中芯上海	2014-06-12	2019-04-26	原始取得	无
4152	横向双扩散场效应管及其形成方法	ZL201410260908.6	中芯上海	2014-06-12	2018-07-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4153	铜互连结构的形成方法	ZL201410260910.3	中芯上海	2014-06-12	2019-01-22	原始取得	无
4154	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410260925.X	中芯上海	2014-06-12	2018-03-30	原始取得	无
4155	MRAM 器件形成工艺中的对准方法	ZL201410261096.7	中芯上海	2014-06-12	2018-04-10	原始取得	无
4156	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410261126.4	中芯上海	2014-06-12	2018-08-10	原始取得	无
4157	互连结构的形成方法	ZL201410261136.8	中芯上海	2014-06-12	2019-01-22	原始取得	无
4158	含有多个晶片样品的抛光样品及制备方法	ZL201410264176.8	中芯上海	2014-06-13	2018-06-22	原始取得	无
4159	用于形成嵌入式锗硅源/漏结构的方法	ZL201410264458.8	中芯上海	2014-06-13	2018-01-09	原始取得	无
4160	一种晶圆盒组件、系统及监控晶圆制程的方法	ZL201410264578.8	中芯上海	2014-06-13	2018-07-10	原始取得	无
4161	接触插塞、MOS、鳍式场效应晶体管,及其形成方法	ZL201410264579.2	中芯上海	2014-06-13	2018-08-10	原始取得	无
4162	半导体器件的形成方法	ZL201410264580.5	中芯上海	2014-06-13	2018-11-16	原始取得	无
4163	刻蚀方法	ZL201410265002.3	中芯上海	2014-06-13	2018-06-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4164	形成栅极的方法	ZL201410265004.2	中芯上海	2014-06-13	2018-03-30	原始取得	无
4165	互连结构的形成方法	ZL201410265005.7	中芯上海	2014-06-13	2018-06-01	原始取得	无
4166	金属互连结构的制作方法	ZL201410265013.1	中芯上海	2014-06-13	2018-10-16	原始取得	无
4167	研磨方法	ZL201410265015.0	中芯上海	2014-06-13	2018-11-16	原始取得	无
4168	一种 Flash 器件及其制备方法	ZL201410268365.2	中芯上海、中芯北京	2014-06-16	2018-09-07	原始取得	无
4169	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410269703.4	中芯上海	2014-06-17	2018-12-21	原始取得	无
4170	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201410272652.0	中芯上海	2014-06-18	2018-06-08	原始取得	无
4171	半导体结构的形成方法	ZL201410272775.4	中芯上海	2014-06-18	2018-12-21	原始取得	无
4172	半导体器件有源区结构的制造方法及用该方法制造的产品	ZL201410275648.X	中芯上海	2014-06-19	2019-04-26	原始取得	无
4173	基于超低 K 电介质的互连结构的制造方法及制造的产品	ZL201410275812.7	中芯上海	2014-06-19	2019-01-29	原始取得	无
4174	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410276112.X	中芯上海	2014-06-19	2018-05-08	原始取得	无
4175	一种 MEMS 压力传感器的制	ZL201410276142.0	中芯上海	2014-06-19	2018-04-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	造方法和电子装置						
4176	基于嵌入式金属纳米点的晶体管的制造方法及制造的产品	ZL201410276267.3	中芯上海	2014-06-19	2018-06-22	原始取得	无
4177	基于金属硬掩模的超低 K 互连的制造方法及制造的产品	ZL201410276464.5	中芯上海	2014-06-19	2019-06-18	原始取得	无
4178	一种制作闪存的方法	ZL201410276470.0	中芯上海	2014-06-19	2018-07-20	原始取得	无
4179	一种半导体器件的制造方法	ZL201410276851.9	中芯上海	2014-06-19	2019-01-22	原始取得	无
4180	一种版图设计方法和版图设计系统	ZL201410276868.4	中芯上海	2014-06-19	2019-01-22	原始取得	无
4181	基于金属纳米点沟道的晶体管的制造方法及制得产品	ZL201410279462.1	中芯上海	2014-06-20	2018-09-04	原始取得	无
4182	一种半导体器件以及制备方法、电子装置	ZL201410279762.X	中芯上海	2014-06-20	2018-10-23	原始取得	无
4183	一种半导体器件以及制备方法、电子装置	ZL201410279852.9	中芯上海	2014-06-20	2017-04-05	原始取得	无
4184	一种晶圆的切割方法	ZL201410279926.9	中芯上海	2014-06-20	2017-04-05	原始取得	无
4185	图案接地屏蔽结构和电感器	ZL201410280141.3	中芯上海、中芯北京	2014-06-20	2017-11-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4186	CMP 终点探测系统的加权校准方法	ZL201410280249.2	中芯上海	2014-06-20	2018-02-02	原始取得	无
4187	掺杂栅极和源漏极的方法及半导体器件的制备方法	ZL201410280322.6	中芯上海	2014-06-20	2018-06-08	原始取得	无
4188	数据的处理装置、方法及控制信号的使能、处理电路	ZL201410280871.3	中芯上海	2014-06-20	2018-03-23	原始取得	无
4189	栅极氧化层的制作方法及半导体器件的制作方法	ZL201410283556.6	中芯上海	2014-06-23	2018-11-16	原始取得	无
4190	磁性隧道结单元和制备磁性隧道结单元的方法	ZL201410283814.0	中芯上海、中芯北京	2014-06-23	2019-02-12	原始取得	无
4191	MOS 晶体管及其制作方法	ZL201410284146.3	中芯上海	2014-06-23	2018-09-07	原始取得	无
4192	一种带空腔晶片的键合方法	ZL201410286773.0	中芯上海	2014-06-24	2018-03-20	原始取得	无
4193	通过重复曝光改进光刻胶形貌的方法	ZL201410286807.6	中芯上海	2014-06-24	2018-11-20	原始取得	无
4194	只读存储器	ZL201410289150.9	中芯上海	2014-06-24	2019-07-16	原始取得	无
4195	测试真空度的方法和装置	ZL201410290189.2	中芯上海	2014-06-24	2018-04-13	原始取得	无
4196	一种浮栅的制作方法	ZL201410293127.7	中芯上海	2014-06-25	2018-02-02	原始取得	无
4197	一种半导体结构的检测方法	ZL201410294223.3	中芯上海	2014-06-26	2019-01-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4198	半导体器件及其形成方法	ZL201410294585.2	中芯上海	2014-06-26	2018-03-30	原始取得	无
4199	晶圆的处理方法	ZL201410294602.2	中芯上海	2014-06-26	2018-09-07	原始取得	无
4200	介质层结构、其制备方法及半导体器件	ZL201410298533.2	中芯上海	2014-06-26	2018-10-23	原始取得	无
4201	用于互连层结构的掩膜组件及互连层的制作方法	ZL201410298612.3	中芯上海	2014-06-26	2019-02-26	原始取得	无
4202	一种测量键合腔中的真空度的方法	ZL201410300724.8	中芯上海	2014-06-27	2018-03-30	原始取得	无
4203	半导体器件的制作方法	ZL201410301168.6	中芯上海	2014-06-27	2018-06-01	原始取得	无
4204	互连结构的形成方法	ZL201410301170.3	中芯上海	2014-06-27	2018-07-10	原始取得	无
4205	一种精确的剪切测试方法	ZL201410301614.3	中芯上海	2014-06-27	2018-06-29	原始取得	无
4206	刻蚀方法	ZL201410301926.4	中芯上海	2014-06-27	2018-06-29	原始取得	无
4207	一种氧含量递增的硬掩模	ZL201410307262.2	中芯上海	2014-06-30	2018-01-23	原始取得	无
4208	半导体结构的形成方法	ZL201410307558.4	中芯上海	2014-06-30	2019-07-02	原始取得	无
4209	晶体管及其形成方法	ZL201410308753.9	中芯上海	2014-06-30	2018-08-10	原始取得	无
4210	互连结构的形成方法	ZL201410308791.4	中芯上海	2014-06-30	2019-03-29	原始取得	无
4211	半导体结构的形成方法	ZL201410308794.8	中芯上海	2014-06-30	2018-11-16	原始取得	无
4212	半导体器件的形成方法	ZL201410308810.3	中芯上海	2014-06-30	2018-03-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4213	半导体测试结构	ZL201410308816.0	中芯上海	2014-06-30	2018-03-06	原始取得	无
4214	半导体器件的形成方法	ZL201410308831.5	中芯上海	2014-06-30	2018-12-21	原始取得	无
4215	双极结型晶体管及其形成方法	ZL201410308835.3	中芯上海	2014-06-30	2018-07-10	原始取得	无
4216	晶圆的处理方法	ZL201410308855.0	中芯上海	2014-06-30	2018-06-29	原始取得	无
4217	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410308867.3	中芯上海	2014-06-30	2018-07-10	原始取得	无
4218	芯片、其制作方法及层叠芯片的制作方法	ZL201410308869.2	中芯上海	2014-06-30	2018-10-23	原始取得	无
4219	一种用于 EDM 的管理方法及系统	ZL201410309094.0	中芯上海	2014-06-30	2019-04-26	原始取得	无
4220	管控机台生产数据的系统及其方法	ZL201410309316.9	中芯上海	2014-06-30	2018-09-07	原始取得	无
4221	半导体器件的形成方法	ZL201410310706.8	中芯上海	2014-07-01	2018-06-01	原始取得	无
4222	半导体结构的形成方法和半导体结构	ZL201410310726.5	中芯上海	2014-07-01	2018-06-01	原始取得	无
4223	半导体器件的形成方法	ZL201410310748.1	中芯上海	2014-07-01	2018-10-16	原始取得	无
4224	浮栅的制作方法	ZL201410310911.4	中芯上海	2014-07-01	2018-10-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4225	半导体器件及其制造方法	ZL201410311783.5	中芯上海	2014-07-02	2019-03-26	原始取得	无
4226	一种晶片角度校准方法	ZL201410314289.4	中芯上海	2014-07-03	2018-03-27	原始取得	无
4227	相变存储单元测试结构及测试方法、相变存储器	ZL201410314346.9	中芯上海	2014-07-03	2018-10-19	原始取得	无
4228	一种 SOI 晶圆的激光标记方法	ZL201410314613.2	中芯上海	2014-07-03	2018-09-25	原始取得	无
4229	一种存储器的制造方法	ZL201410321309.0	中芯上海	2014-07-07	2019-07-05	原始取得	无
4230	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410322525.7	中芯上海	2014-07-08	2018-09-21	原始取得	无
4231	在后栅工艺中形成不同厚度的栅氧化层的方法	ZL201410322652.7	中芯上海	2014-07-08	2018-09-21	原始取得	无
4232	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410322716.3	中芯上海	2014-07-08	2018-06-01	原始取得	无
4233	改善多孔低 k 薄膜的机械强度的方法	ZL201410323121.X	中芯上海	2014-07-08	2018-12-11	原始取得	无
4234	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201410323237.3	中芯上海	2014-07-08	2018-06-12	原始取得	无
4235	在 FinFET 中形成鳍状物的方法	ZL201410323256.6	中芯上海	2014-07-08	2018-12-07	原始取得	无
4236	半导体结构的形成方法、晶体	ZL201410323378.5	中芯上海	2014-07-08	2018-12-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	管及其形成方法						
4237	一种硅化镍后形成工艺	ZL201410325210.8	中芯上海	2014-07-09	2018-11-20	原始取得	无
4238	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410325525.2	中芯上海	2014-07-09	2018-07-20	原始取得	无
4239	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410325537.5	中芯上海	2014-07-09	2019-01-18	原始取得	无
4240	一种半导体器件及其制造方法	ZL201410325676.8	中芯上海	2014-07-09	2018-10-23	原始取得	无
4241	形成高 K 金属栅极器件的后栅极工艺	ZL201410325699.9	中芯上海	2014-07-09	2018-04-10	原始取得	无
4242	半导体结构的形成方法	ZL201410325768.6	中芯上海	2014-07-09	2018-10-16	原始取得	无
4243	磁性随机访问存储器及其制造方法	ZL201410325809.1	中芯上海	2014-07-09	2019-11-15	原始取得	无
4244	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410325922.X	中芯上海	2014-07-09	2019-09-03	原始取得	无
4245	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410325958.8	中芯上海	2014-07-09	2018-07-20	原始取得	无
4246	一种半导体器件和电子装置	ZL201410326153.5	中芯上海	2014-07-09	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4247	测试结构、测试结构的制作方法及测试方法	ZL201410328202.9	中芯上海	2014-07-10	2018-10-23	原始取得	无
4248	一种芯片的密封环	ZL201410328204.8	中芯上海	2014-07-10	2018-03-23	原始取得	无
4249	半导体器件的制造方法	ZL201410328482.3	中芯上海	2014-07-10	2018-11-16	原始取得	无
4250	闪存及其制作方法	ZL201410328532.8	中芯上海	2014-07-10	2019-02-12	原始取得	无
4251	分离栅极式存储器的制作方法及其字线 CMP 量测结构	ZL201410328596.8	中芯上海	2014-07-10	2018-05-04	原始取得	无
4252	接触通孔蚀刻方法	ZL201410329093.2	中芯上海	2014-07-11	2018-06-29	原始取得	无
4253	一种制作半导体器件的方法	ZL201410330527.0	中芯上海	2014-07-11	2018-11-16	原始取得	无
4254	半导体结构的形成方法	ZL201410334107.X	中芯上海	2014-07-14	2019-01-22	原始取得	无
4255	半导体结构及其形成方法	ZL201410334110.1	中芯上海	2014-07-14	2018-07-10	原始取得	无
4256	微机电系统压力传感器	ZL201410334686.8	中芯上海	2014-07-15	2018-02-02	原始取得	无
4257	接触孔的制作方法	ZL201410339008.0	中芯上海	2014-07-16	2019-01-08	原始取得	无
4258	半导体结构的形成方法	ZL201410339403.9	中芯上海	2014-07-16	2019-03-12	原始取得	无
4259	半导体器件、半导体器件的制作方法及 LCD 驱动芯片	ZL201410339766.2	中芯上海、中芯北京	2014-07-16	2019-09-10	原始取得	无
4260	一种测试结构及测试方法	ZL201410341355.7	中芯上海	2014-07-17	2018-09-28	原始取得	无
4261	MEMS 麦克风及其形成方法	ZL201410341556.7	中芯上海	2014-07-17	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4262	芯片的制作方法、芯片及 MEMS 器件	ZL201410341933.7	中芯上海	2014-07-17	2018-05-25	原始取得	无
4263	CD-SEM 装置的校正方法、应用 CD-SEM 装置的方法及 CD-SEM 装置	ZL201410341944.5	中芯上海	2014-07-17	2019-04-09	原始取得	无
4264	光掩膜版、半导体器件的制作方法、半导体器件及存储芯片	ZL201410345526.3	中芯上海	2014-07-18	2019-11-08	原始取得	无
4265	一种半导体器件及制备方法	ZL201410345551.1	中芯上海	2014-07-18	2019-05-17	原始取得	无
4266	栅极的制作方法及存储器的制作方法	ZL201410345741.3	中芯上海	2014-07-18	2018-03-23	原始取得	无
4267	半导体器件	ZL201410345745.1	中芯上海	2014-07-18	2018-10-23	原始取得	无
4268	半导体结构的形成方法	ZL201410347625.5	中芯上海	2014-07-21	2018-08-10	原始取得	无
4269	辅助光刻区机台切换光罩的方法、装置及机台	ZL201410347657.5	中芯上海	2014-07-21	2017-11-03	原始取得	无
4270	NAND 闪存器件的形成方法	ZL201410350413.2	中芯上海	2014-07-22	2018-12-21	原始取得	无
4271	MEMS 器件的形成方法	ZL201410350576.0	中芯上海	2014-07-22	2017-07-14	原始取得	无
4272	半导体结构的形成方法	ZL201410350579.4	中芯上海	2014-07-22	2018-07-10	原始取得	无
4273	Efuse 模块及其熔断电流的校	ZL201410352688.X	中芯上海	2014-07-23	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	准系统和校准方法						
4274	用于集成电路的检测电路和方法	ZL201410353856.7	中芯上海	2014-07-23	2019-01-08	原始取得	无
4275	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201410356785.6	中芯上海	2014-07-24	2019-01-22	原始取得	无
4276	半导体器件的制备方法	ZL201410360718.1	中芯上海	2014-07-25	2018-11-16	原始取得	无
4277	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410362418.7	中芯上海、中芯宁波	2014-07-28	2018-12-25	原始取得	无
4278	PMOS 晶体管的修复电路及方法	ZL201410363404.7	中芯上海	2014-07-28	2017-12-01	原始取得	无
4279	互连结构及其形成方法	ZL201410363410.2	中芯上海	2014-07-28	2018-03-30	原始取得	无
4280	自对准多重图形掩膜的形成方法	ZL201410363413.6	中芯上海	2014-07-28	2018-06-01	原始取得	无
4281	互连结构的形成方法	ZL201410363420.6	中芯上海	2014-07-28	2018-06-29	原始取得	无
4282	半导体结构的形成方法	ZL201410363912.5	中芯上海	2014-07-28	2018-06-01	原始取得	无
4283	半导体器件的制作方法及半导体器件	ZL201410363920.X	中芯上海	2014-07-28	2018-05-04	原始取得	无
4284	用于形成嵌入式锗硅的方法	ZL201410365793.7	中芯上海	2014-07-29	2019-09-06	原始取得	无
4285	互连结构及其形成方法	ZL201410366450.2	中芯上海	2014-07-29	2019-03-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4286	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410366662.0	中芯上海	2014-07-29	2018-03-16	原始取得	无
4287	接触插塞的形成方法	ZL201410367341.2	中芯上海	2014-07-29	2018-07-10	原始取得	无
4288	SRAM 单元和 SRAM 存储器	ZL201410367345.0	中芯上海	2014-07-29	2018-11-16	原始取得	无
4289	半导体器件及其形成方法	ZL201410367354.X	中芯上海	2014-07-29	2018-09-07	原始取得	无
4290	半导体结构及其形成方法	ZL201410367357.3	中芯上海	2014-07-29	2019-03-12	原始取得	无
4291	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410369690.8	中芯上海	2014-07-30	2018-06-08	原始取得	无
4292	半导体器件及其形成方法	ZL201410369864.0	中芯上海	2014-07-30	2018-07-10	原始取得	无
4293	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410369904.1	中芯上海	2014-07-30	2019-04-26	原始取得	无
4294	半浮栅器件及其形成方法	ZL201410370627.6	中芯上海	2014-07-30	2018-09-07	原始取得	无
4295	MEMS 麦克风及其形成方法	ZL201410370628.0	中芯上海	2014-07-30	2018-03-30	原始取得	无
4296	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410370667.0	中芯上海	2014-07-30	2017-06-13	原始取得	无
4297	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410370709.0	中芯上海	2014-07-30	2018-03-30	原始取得	无
4298	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410370715.6	中芯上海	2014-07-30	2018-07-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4299	半导体装置及其制造方法	ZL201410371055.3	中芯上海	2014-07-31	2019-01-15	原始取得	无
4300	用于减少硅损耗的方法	ZL201410373544.2	中芯上海	2014-07-31	2018-09-04	原始取得	无
4301	悬臂梁的制作方法、悬臂梁及 MEMS 器件	ZL201410375165.7	中芯上海	2014-07-31	2017-10-27	原始取得	无
4302	半导体结构的形成方法	ZL201410376692.X	中芯上海	2014-08-01	2018-10-16	原始取得	无
4303	用于首层金属至栅极的异常检测的层间介质测试结构	ZL201410377113.3	中芯上海	2014-08-01	2018-11-02	原始取得	无
4304	肖特基二极管及其形成方法	ZL201410377156.1	中芯上海	2014-08-01	2018-12-07	原始取得	无
4305	用于并行测试系统的栅氧化层完整性的测试结构	ZL201410377234.8	中芯上海	2014-08-01	2018-03-16	原始取得	无
4306	去除铝残留物的方法	ZL201410377280.8	中芯上海	2014-08-01	2019-01-29	原始取得	无
4307	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410377487.5	中芯上海	2014-08-01	2017-06-06	原始取得	无
4308	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410380294.5	中芯上海	2014-08-04	2018-08-21	原始取得	无
4309	互连结构的形成方法	ZL201410381338.6	中芯上海	2014-08-05	2018-08-10	原始取得	无
4310	晶体管的形成方法	ZL201410381673.6	中芯上海	2014-08-05	2018-11-16	原始取得	无
4311	LDMOS 器件及其形成方法	ZL201410381682.5	中芯上海	2014-08-05	2018-06-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4312	LDMOS 器件及其形成方法	ZL201410381705.2	中芯上海	2014-08-05	2018-06-29	原始取得	无
4313	电容器以及制备方法	ZL201410384052.3	中芯上海	2014-08-06	2018-10-16	原始取得	无
4314	一种 FinFET 及其制备方法	ZL201410384118.9	中芯上海	2014-08-06	2018-09-07	原始取得	无
4315	一种形成金属互连结构的方法	ZL201410386315.4	中芯上海	2014-08-07	2018-08-21	原始取得	无
4316	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410386885.3	中芯上海	2014-08-07	2018-09-21	原始取得	无
4317	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410389156.3	中芯上海	2014-08-08	2017-11-10	原始取得	无
4318	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410389664.1	中芯上海	2014-08-08	2018-08-21	原始取得	无
4319	导电插塞的形成方法	ZL201410392081.4	中芯上海	2014-08-11	2018-10-16	原始取得	无
4320	形成多晶硅电阻的方法及半导体器件	ZL201410392176.6	中芯上海	2014-08-11	2018-05-25	原始取得	无
4321	测试结构及测试方法	ZL201410392190.6	中芯上海	2014-08-11	2018-05-04	原始取得	无
4322	样品制备方法以及二次离子质谱分析方法	ZL201410395360.6	中芯上海	2014-08-12	2018-03-20	原始取得	无
4323	PMU 泵浦结构及其形成方法	ZL201410395376.7	中芯上海	2014-08-12	2018-03-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4324	一种基于双图案的半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410401106.2	中芯上海	2014-08-14	2018-07-20	原始取得	无
4325	降低光学邻近修正的边缘定位误差的方法	ZL201410405863.7	中芯上海	2014-08-18	2019-10-25	原始取得	无
4326	改进的双掺杂浮栅晶体管	ZL201410405898.0	中芯上海	2014-08-18	2018-10-12	原始取得	无
4327	一种半导体存储器件及其制备方法、电子装置	ZL201410407085.5	中芯上海	2014-08-18	2018-09-21	原始取得	无
4328	一种电路和电子装置	ZL201410407383.4	中芯上海	2014-08-18	2018-04-13	原始取得	无
4329	静态随机存储器	ZL201410409377.2	中芯上海	2014-08-19	2018-10-23	原始取得	无
4330	一种半导体生产工艺配方的管控方法及系统	ZL201410410124.7	中芯上海、中芯北京	2014-08-20	2018-04-17	原始取得	无
4331	半导体器件结构及其制作方法	ZL201410410171.1	中芯上海	2014-08-20	2019-08-30	原始取得	无
4332	对准测量方法	ZL201410410237.7	中芯上海	2014-08-20	2018-07-20	原始取得	无
4333	引线焊垫结构的制造方法	ZL201410410360.9	中芯上海	2014-08-20	2018-03-30	原始取得	无
4334	焊盘的表面处理方法及焊盘的制作方法	ZL201410414953.2	中芯上海	2014-08-21	2018-10-23	原始取得	无
4335	等离子体损伤测试结构及其	ZL201410414962.1	中芯上海	2014-08-21	2019-01-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	制作方法						
4336	非易失性存储器的制作方法及非易失性存储器	ZL201410414972.5	中芯上海	2014-08-21	2018-10-23	原始取得	无
4337	在凹槽中形成光阻图形的方法、沟槽隔离结构及其制作方法	ZL201410415009.9	中芯上海	2014-08-21	2019-01-29	原始取得	无
4338	相变存储器的测试方法	ZL201410415020.5	中芯上海	2014-08-21	2018-10-23	原始取得	无
4339	半导体器件及其制作方法	ZL201410415055.9	中芯上海	2014-08-21	2018-07-03	原始取得	无
4340	半导体器件的光刻方法、闪存器件的制作方法及闪存器件	ZL201410415519.6	中芯上海	2014-08-21	2019-06-04	原始取得	无
4341	隔离结构的制作方法及半导体器件	ZL201410415530.2	中芯上海	2014-08-21	2018-07-03	原始取得	无
4342	接触槽的清洁工艺和接触层的形成方法	ZL201410415548.2	中芯上海	2014-08-21	2018-05-04	原始取得	无
4343	一种半导体器件的制作方法	ZL201410415560.3	中芯上海	2014-08-21	2018-10-23	原始取得	无
4344	层间介质层、层间介质层的制作方法和半导体器件	ZL201410415587.2	中芯上海	2014-08-21	2019-02-26	原始取得	无
4345	栅极的制作方法及存储器件	ZL201410415615.0	中芯上海	2014-08-21	2019-04-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的制作方法						
4346	利用应力记忆效应的 CMOS 器件的制作方法	ZL201410416185.4	中芯上海	2014-08-19	2018-10-23	原始取得	无
4347	使用激光定向自组装嵌段共聚物的方法	ZL201410417661.4	中芯上海	2014-08-22	2019-09-06	原始取得	无
4348	一种深槽隔离结构的制作方法	ZL201410417668.6	中芯上海	2014-08-22	2019-01-11	原始取得	无
4349	存储单元可靠性的测试方法	ZL201410418006.0	中芯上海	2014-08-22	2018-09-25	原始取得	无
4350	半导体器件及其形成方法	ZL201410418112.9	中芯上海	2014-08-22	2019-07-30	原始取得	无
4351	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410418523.8	中芯上海	2014-08-22	2018-06-08	原始取得	无
4352	芯片的失效分析方法	ZL201410419238.8	中芯上海	2014-08-22	2018-05-25	原始取得	无
4353	半导体装置及其制造方法	ZL201410421826.5	中芯上海	2014-08-26	2019-03-26	原始取得	无
4354	半导体装置及其制造方法	ZL201410421827.X	中芯上海	2014-08-26	2018-12-25	原始取得	无
4355	半导体器件及其形成方法	ZL201410425450.5	中芯上海	2014-08-26	2018-11-16	原始取得	无
4356	半导体结构的形成方法	ZL201410425451.X	中芯上海	2014-08-26	2018-09-07	原始取得	无
4357	半导体结构的形成方法	ZL201410425453.9	中芯上海	2014-08-26	2018-06-29	原始取得	无
4358	半导体结构的形成方法	ZL201410425711.3	中芯上海	2014-08-26	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4359	TEM 放大率校准方法及用于校准的样品的形成方法	ZL201410425713.2	中芯上海、中芯北京	2014-08-26	2018-09-07	原始取得	无
4360	LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL201410425848.9	中芯上海	2014-08-26	2019-07-02	原始取得	无
4361	金属栅极结构及其形成方法	ZL201410425850.6	中芯上海	2014-08-26	2018-07-10	原始取得	无
4362	半导体结构的形成方法	ZL201410425882.6	中芯上海	2014-08-26	2018-09-07	原始取得	无
4363	掩模版及其形成方法	ZL201410425884.5	中芯上海	2014-08-26	2019-11-01	原始取得	无
4364	一种刻蚀方法	ZL201410427703.2	中芯上海	2014-08-27	2019-03-19	原始取得	无
4365	相变存储器及其形成方法	ZL201410427770.4	中芯上海	2014-08-27	2018-02-16	原始取得	无
4366	显影液喷嘴检验模板及方法	ZL201410429457.4	中芯上海	2014-08-28	2019-10-22	原始取得	无
4367	待切割的半导体芯片结构及其制造方法	ZL201410430618.1	中芯上海	2014-08-28	2018-09-18	原始取得	无
4368	半导体器件的制造方法	ZL201410430698.0	中芯上海	2014-08-28	2019-01-18	原始取得	无
4369	一种用于接触孔对位的对位标记及其形成方法	ZL201410431192.1	中芯上海	2014-08-28	2019-07-26	原始取得	无
4370	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201410431676.6	中芯上海	2014-08-28	2018-09-07	原始取得	无
4371	半导体结构的形成方法	ZL201410431686.X	中芯上海	2014-08-28	2019-01-22	原始取得	无
4372	一种光刻方法	ZL201410432069.1	中芯上海	2014-08-28	2019-03-08	原始取得	无
4373	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201410432180.0	中芯上海	2014-08-28	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4374	一种麦克风结构的形成方法	ZL201410432197.6	中芯上海	2014-08-28	2019-03-29	原始取得	无
4375	晶体管的形成方法	ZL201410432202.3	中芯上海	2014-08-28	2018-12-21	原始取得	无
4376	半导体器件及其形成方法	ZL201410432213.1	中芯上海	2014-08-28	2019-07-02	原始取得	无
4377	半导体结构及其形成方法	ZL201410432231.X	中芯上海	2014-08-28	2019-12-03	原始取得	无
4378	半导体结构的形成方法	ZL201410432233.9	中芯上海	2014-08-28	2019-01-22	原始取得	无
4379	半导体器件的形成方法	ZL201410432237.7	中芯上海	2014-08-28	2018-09-07	原始取得	无
4380	微机电系统器件及其形成方法	ZL201410432240.9	中芯上海	2014-08-28	2017-09-22	原始取得	无
4381	SRAM 测试键、测试装置以及 SRAM 测试方法	ZL201410437349.1	中芯上海	2014-08-29	2019-08-27	原始取得	无
4382	半导体器件的制作方法	ZL201410437366.5	中芯上海	2014-08-29	2018-07-10	原始取得	无
4383	栅极结构的形成方法以及栅极结构	ZL201410437368.4	中芯上海	2014-08-29	2018-09-07	原始取得	无
4384	半导体结构的形成方法	ZL201410437369.9	中芯上海	2014-08-29	2018-12-21	原始取得	无
4385	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410437370.1	中芯上海	2014-08-29	2018-10-16	原始取得	无
4386	半导体器件的形成方法	ZL201410437392.8	中芯上海	2014-08-29	2018-07-10	原始取得	无
4387	晶体管及其形成方法	ZL201410437401.3	中芯上海	2014-08-29	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4388	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410438307.X	中芯上海	2014-08-29	2018-09-25	原始取得	无
4389	半导体结构的形成方法	ZL201410438399.1	中芯上海	2014-08-29	2018-11-16	原始取得	无
4390	半导体结构的形成方法	ZL201410438412.3	中芯上海、中芯宁波	2014-08-29	2019-07-02	原始取得	无
4391	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410438535.7	中芯上海	2014-08-29	2018-10-23	原始取得	无
4392	半导体结构及返工方法	ZL201410438895.7	中芯上海	2014-08-30	2018-07-10	原始取得	无
4393	静态随机存储器、静态随机存储器存储单元及其布局	ZL201410439751.3	中芯上海	2014-08-30	2018-07-10	原始取得	无
4394	半导体结构的形成方法	ZL201410439752.8	中芯上海	2014-08-30	2019-02-12	原始取得	无
4395	晶圆键合的方法以及晶圆的键合部件	ZL201410439755.1	中芯上海	2014-08-30	2019-07-02	原始取得	无
4396	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410439757.0	中芯上海	2014-08-30	2019-01-25	原始取得	无
4397	半导体结构及其形成方法	ZL201410439760.2	中芯上海	2014-08-30	2018-10-16	原始取得	无
4398	静态随机存储器及其布局和存取方法	ZL201410440248.X	中芯上海	2014-09-01	2018-08-10	原始取得	无
4399	相变存储器单元的形成方法	ZL201410440261.5	中芯上海	2014-09-01	2018-06-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4400	晶体管及其形成方法	ZL201410440271.9	中芯上海	2014-09-01	2019-05-28	原始取得	无
4401	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410440321.3	中芯上海	2014-09-01	2018-09-25	原始取得	无
4402	工艺腔室的派货方法和系统	ZL201410440424.X	中芯上海	2014-09-01	2019-04-26	原始取得	无
4403	一种芯片密封环结构及其制作方法	ZL201410441162.9	中芯上海	2014-09-02	2018-05-04	原始取得	无
4404	一种芯片密封环结构及其制作方法	ZL201410441164.8	中芯上海	2014-09-02	2018-04-17	原始取得	无
4405	半导体结构及其形成方法	ZL201410441272.5	中芯上海	2014-09-01	2019-03-29	原始取得	无
4406	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410441304.1	中芯上海	2014-09-01	2019-04-09	原始取得	无
4407	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201410443001.3	中芯上海	2014-09-02	2019-04-26	原始取得	无
4408	焊盘、半导体器件和半导体器件的制造工艺	ZL201410443164.1	中芯上海	2014-09-02	2018-05-04	原始取得	无
4409	多孔低介电薄膜、其制作方法及包括其的层间介质层	ZL201410443187.2	中芯上海	2014-09-02	2019-01-08	原始取得	无
4410	化学机械研磨方法以及化学	ZL201410443217.X	中芯上海	2014-09-02	2018-08-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	机械研磨装置						
4411	半导体结构的形成方法	ZL201410443233.9	中芯上海	2014-09-02	2019-03-12	原始取得	无
4412	用于形成 SRAM 鳍部的掩膜版组件以及鳍部的制作方法	ZL201410443536.0	中芯上海	2014-09-02	2018-06-12	原始取得	无
4413	形成有源区的方法及半导体器件	ZL201410443795.3	中芯上海	2014-09-02	2018-07-20	原始取得	无
4414	接触孔的清洗方法及半导体器件	ZL201410443811.9	中芯上海	2014-09-02	2018-09-18	原始取得	无
4415	OTP 存储单元、OTP 存储单元的制作方法及芯片	ZL201410443812.3	中芯上海	2014-09-02	2018-10-23	原始取得	无
4416	测试结构及测试方法	ZL201410443827.X	中芯上海	2014-09-02	2019-01-08	原始取得	无
4417	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410445807.6	中芯上海	2014-09-03	2018-08-10	原始取得	无
4418	晶圆键合方法	ZL201410446753.5	中芯上海	2014-09-03	2018-03-06	原始取得	无
4419	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410446864.6	中芯上海	2014-09-04	2017-05-10	原始取得	无
4420	一种获得光罩雾化风险系数并进行处理的方法	ZL201410446974.2	中芯上海	2014-09-03	2019-12-27	原始取得	无
4421	一种分频电路和电子装置	ZL201410447098.5	中芯上海	2014-09-04	2018-07-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4422	用于管理调度程序的系统和方法	ZL201410448408.5	中芯上海	2014-09-04	2019-04-09	原始取得	无
4423	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410448623.5	中芯上海	2014-09-04	2017-10-20	原始取得	无
4424	一种多模分频器和电子装置	ZL201410448881.3	中芯上海	2014-09-04	2019-07-26	原始取得	无
4425	一种提高反应室使用效率的方法	ZL201410449044.2	中芯上海	2014-09-04	2018-08-14	原始取得	无
4426	一种日志文件查询系统及查询方法	ZL201410449082.8	中芯上海	2014-09-04	2019-07-23	原始取得	无
4427	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410451995.3	中芯上海	2014-09-05	2018-08-21	原始取得	无
4428	一种压力传感器及电子装置	ZL201410452315.X	中芯上海	2014-09-05	2019-05-17	原始取得	无
4429	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410453194.0	中芯上海	2014-09-05	2017-11-14	原始取得	无
4430	一种基于双图案的半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410455652.4	中芯上海	2014-09-09	2018-08-21	原始取得	无
4431	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410455906.2	中芯上海	2014-09-09	2019-06-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4432	栅介质层的完整性检测方法	ZL201410455920.2	中芯上海	2014-09-09	2018-08-24	原始取得	无
4433	一种基于 RTD 的量测工艺	ZL201410456338.8	中芯上海	2014-09-09	2018-09-04	原始取得	无
4434	一种光电二极管制备方法	ZL201410459546.3	中芯上海	2014-09-10	2017-06-06	原始取得	无
4435	采用双重图形化技术形成栅极的方法	ZL201410472558.X	中芯上海、中芯北京	2014-09-16	2019-01-08	原始取得	无
4436	一种 FinFET 器件及其制作方法和电子装置	ZL201410475129.8	中芯上海	2014-09-17	2019-01-22	原始取得	无
4437	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201410475181.3	中芯上海	2014-09-17	2017-05-10	原始取得	无
4438	半导体结构及其形成方法、半导体结构的处理方法	ZL201410478745.9	中芯上海	2014-09-18	2018-03-09	原始取得	无
4439	高电阻结构的原位温度检测装置、芯片和失效检测方法	ZL201410478920.4	中芯上海	2014-09-18	2019-01-29	原始取得	无
4440	源端开关的电荷泵、锁相环电路及抑制馈通效应的方法	ZL201410483106.1	中芯上海	2014-09-19	2018-10-23	原始取得	无
4441	半导体结构及其形成方法	ZL201410483649.3	中芯上海	2014-09-19	2017-06-13	原始取得	无
4442	防止光刻胶结晶的方法	ZL201410486805.1	中芯上海	2014-09-22	2019-11-08	原始取得	无
4443	一种半导体器件的制作方法	ZL201410486976.4	中芯上海	2014-09-22	2018-06-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4444	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410486979.8	中芯上海	2014-09-22	2018-12-21	原始取得	无
4445	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410486996.1	中芯上海	2014-09-22	2018-12-21	原始取得	无
4446	金属填充塞的制备方法	ZL201410487204.2	中芯上海	2014-09-22	2018-11-16	原始取得	无
4447	TEM 样品的制备方法	ZL201410487272.9	中芯上海	2014-09-22	2019-11-01	原始取得	无
4448	灵敏放大器以及存储器	ZL201410487273.3	中芯上海	2014-09-22	2018-08-14	原始取得	无
4449	非易失性存储器及其制作方法	ZL201410487435.3	中芯上海	2014-09-22	2018-07-24	原始取得	无
4450	高电阻结构的原位温度检测装置、芯片和失效检测方法	ZL201410487446.1	中芯上海	2014-09-22	2018-09-18	原始取得	无
4451	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410490638.8	中芯上海	2014-09-23	2017-09-01	原始取得	无
4452	一种光栅及其制造方法、电子装置	ZL201410490639.2	中芯上海	2014-09-23	2018-03-20	原始取得	无
4453	晶体管的形成方法	ZL201410491230.2	中芯上海	2014-09-24	2019-12-31	原始取得	无
4454	MEMS 器件的形成方法	ZL201410491246.3	中芯上海	2014-09-24	2017-05-24	原始取得	无
4455	一种阻变存储器及其制备方	ZL201410494486.9	中芯上海	2014-09-24	2018-09-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
4456	半导体器件及其形成方法、静态随机存储器的形成方法	ZL201410494936.4	中芯上海	2014-09-24	2018-11-16	原始取得	无
4457	一种图像传感器装置及其制造方法	ZL201410495034.2	中芯上海、中芯宁波	2014-09-25	2018-10-09	原始取得	无
4458	一种半导体装置及其制造方法	ZL201410495194.7	中芯上海	2014-09-25	2017-08-25	原始取得	无
4459	防止钨腐蚀的晶圆清洗方法	ZL201410499268.4	中芯上海	2014-09-25	2018-07-06	原始取得	无
4460	LDMOS 器件及其制造方法	ZL201410499784.7	中芯上海	2014-09-26	2019-05-07	原始取得	无
4461	半导体装置及其制造方法	ZL201410500106.8	中芯上海	2014-09-26	2019-05-03	原始取得	无
4462	晶体管的形成方法	ZL201410504611.X	中芯上海	2014-09-26	2018-12-21	原始取得	无
4463	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410504671.1	中芯上海	2014-09-26	2018-08-10	原始取得	无
4464	晶体管的形成方法	ZL201410504707.6	中芯上海	2014-09-26	2019-01-22	原始取得	无
4465	可穿戴智能设备及其交互的方法、可穿戴智能设备系统	ZL201410504709.5	中芯上海	2014-09-26	2018-08-10	原始取得	无
4466	半导体结构的形成方法	ZL201410504710.8	中芯上海	2014-09-26	2018-09-07	原始取得	无
4467	晶圆键合的方法以及晶圆键合结构	ZL201410504766.3	中芯上海	2014-09-26	2018-12-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4468	晶体管的形成方法	ZL201410505412.0	中芯上海	2014-09-26	2018-12-21	原始取得	无
4469	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410505413.5	中芯上海	2014-09-26	2018-08-10	原始取得	无
4470	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410505454.4	中芯上海	2014-09-26	2018-09-07	原始取得	无
4471	晶体管的形成方法	ZL201410505488.3	中芯上海	2014-09-26	2018-11-16	原始取得	无
4472	光刻对准标记结构及形成方法、半导体结构的形成方法	ZL201410505490.0	中芯上海	2014-09-26	2017-11-03	原始取得	无
4473	光学量测方法	ZL201410505496.8	中芯上海	2014-09-26	2018-08-10	原始取得	无
4474	用于检验显影能力的光罩及显影能力的检验方法	ZL201410510063.1	中芯上海	2014-09-28	2019-11-26	原始取得	无
4475	半导体器件的形成方法	ZL201410513588.0	中芯上海	2014-09-29	2018-07-10	原始取得	无
4476	MEMS 器件及其形成方法	ZL201410513657.8	中芯上海	2014-09-29	2017-08-25	原始取得	无
4477	半导体器件的形成方法	ZL201410513667.1	中芯上海	2014-09-29	2019-03-29	原始取得	无
4478	DRAM 器件及其形成方法	ZL201410513692.X	中芯上海	2014-09-29	2018-11-16	原始取得	无
4479	半导体结构及其制作方法	ZL201410514075.1	中芯上海	2014-09-29	2018-08-10	原始取得	无
4480	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410519468.1	中芯上海	2014-09-29	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4481	LDMOS 晶体管的形成方法及 LDMOS 晶体管	ZL201410521972.5	中芯上海	2014-09-30	2019-01-25	原始取得	无
4482	MEMS 器件的形成方法	ZL201410521986.7	中芯上海	2014-09-30	2017-06-13	原始取得	无
4483	LDMOS 晶体管的形成方法及 LDMOS 晶体管	ZL201410522011.6	中芯上海	2014-09-30	2019-07-02	原始取得	无
4484	测量栅介质层厚度的半导体结构及栅介质层厚度测量方法	ZL201410522576.4	中芯上海	2014-09-30	2018-06-01	原始取得	无
4485	半导体器件及其形成方法	ZL201410522582.X	中芯上海	2014-09-30	2019-01-25	原始取得	无
4486	检测样品的制备方法及检测样品	ZL201410522596.1	中芯上海	2014-09-30	2018-06-29	原始取得	无
4487	刻蚀方法	ZL201410522599.5	中芯上海	2014-09-30	2018-08-10	原始取得	无
4488	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410527705.9	中芯上海	2014-10-09	2018-05-08	原始取得	无
4489	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410527831.4	中芯上海	2014-10-09	2018-11-16	原始取得	无
4490	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410527833.3	中芯上海	2014-10-09	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4491	分离栅极式闪存的制作方法及分离栅极式闪存	ZL201410527890.1	中芯上海	2014-10-09	2018-09-18	原始取得	无
4492	一种半导体器件的制作方法	ZL201410528396.7	中芯上海	2014-10-09	2018-10-23	原始取得	无
4493	半导体结构的形成方法	ZL201410528397.1	中芯上海	2014-10-09	2018-11-16	原始取得	无
4494	栅极结构、其制作方法及闪存器件	ZL201410528425.X	中芯上海	2014-10-09	2019-02-12	原始取得	无
4495	光罩底部接触面的颗粒侦测方法及辅助工具	ZL201410528445.7	中芯上海	2014-10-10	2018-12-14	原始取得	无
4496	一种半导体结构的制作方法	ZL201410528473.9	中芯上海	2014-10-10	2019-01-11	原始取得	无
4497	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410531380.1	中芯上海	2014-10-10	2018-04-10	原始取得	无
4498	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410531473.4	中芯上海	2014-10-10	2018-03-30	原始取得	无
4499	一种沟槽式 MOSFET 的制造方法	ZL201410531557.8	中芯上海	2014-10-10	2019-02-01	原始取得	无
4500	光刻胶去除方法和光刻工艺的返工方法	ZL201410531606.8	中芯上海	2014-10-10	2019-11-05	原始取得	无
4501	一种侦测掩膜图形保真度的	ZL201410531631.6	中芯上海	2014-10-10	2019-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	系统及方法						
4502	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410534315.4	中芯上海	2014-10-11	2018-12-21	原始取得	无
4503	晶体管的形成方法	ZL201410534688.1	中芯上海	2014-10-11	2019-03-12	原始取得	无
4504	一种半导体器件的制作方法	ZL201410534793.5	中芯上海	2014-10-11	2018-09-21	原始取得	无
4505	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410534804.X	中芯上海	2014-10-11	2019-04-09	原始取得	无
4506	磁性随机存储器及其制作方法	ZL201410534813.9	中芯上海	2014-10-11	2019-02-22	原始取得	无
4507	升压转换电路	ZL201410534857.1	中芯上海	2014-10-11	2018-07-24	原始取得	无
4508	沉积方法、层间介质层及半导体器件	ZL201410534859.0	中芯上海	2014-10-11	2018-06-08	原始取得	无
4509	光刻版及晶圆或晶圆承载台沾污的检测方法	ZL201410535256.2	中芯上海	2014-10-11	2018-10-23	原始取得	无
4510	MTP 器件及其制造方法	ZL201410535258.1	中芯上海	2014-10-11	2018-07-24	原始取得	无
4511	热点定位方法	ZL201410535267.0	中芯上海	2014-10-11	2018-03-23	原始取得	无
4512	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410537804.5	中芯上海	2014-10-13	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4513	一种混合互连结构及其制造方法、电子装置	ZL201410537822.3	中芯上海	2014-10-13	2018-08-21	原始取得	无
4514	一种半导体器件的制作方法	ZL201410537891.4	中芯上海	2014-10-13	2018-10-23	原始取得	无
4515	用于测量 SRAM 阵列电容的测试电路及测量 SRAM 阵列电容的方法	ZL201410537903.3	中芯上海	2014-10-13	2019-01-22	原始取得	无
4516	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410538013.4	中芯上海	2014-10-13	2019-02-01	原始取得	无
4517	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410538014.9	中芯上海	2014-10-13	2018-09-21	原始取得	无
4518	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410538075.5	中芯上海	2014-10-13	2018-09-21	原始取得	无
4519	一种光学临近修正模型的优化方法	ZL201410538086.3	中芯上海	2014-10-13	2019-12-17	原始取得	无
4520	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410538118.X	中芯上海	2014-10-13	2018-06-08	原始取得	无
4521	静态随机存储器	ZL201410538416.9	中芯上海	2014-10-13	2018-08-03	原始取得	无
4522	一种混合互连结构及其制造	ZL201410538591.8	中芯上海	2014-10-13	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法、电子装置						
4523	一种混合互连结构及其制造方法、电子装置	ZL201410538594.1	中芯上海	2014-10-13	2018-11-16	原始取得	无
4524	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410538607.5	中芯上海	2014-10-13	2018-07-20	原始取得	无
4525	一种铜互连结构及其制造方法、电子装置	ZL201410538609.4	中芯上海	2014-10-13	2018-11-16	原始取得	无
4526	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410538619.8	中芯上海	2014-10-13	2018-10-23	原始取得	无
4527	用于工程改变数据分析的方法和系统	ZL201410538630.4	中芯上海	2014-10-13	2018-10-23	原始取得	无
4528	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410538677.0	中芯上海	2014-10-13	2018-10-23	原始取得	无
4529	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410538684.0	中芯上海	2014-10-13	2019-09-03	原始取得	无
4530	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410538688.9	中芯上海	2014-10-13	2019-12-24	原始取得	无
4531	静态随机存储器	ZL201410539357.7	中芯上海	2014-10-13	2018-09-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4532	数据的保存方法和电可擦编程只读存储器	ZL201410539372.1	中芯上海	2014-10-13	2018-07-20	原始取得	无
4533	静态随机存储器	ZL201410539431.5	中芯上海	2014-10-13	2018-07-03	原始取得	无
4534	一种湿法刻蚀中清除晶圆表面缺陷的方法	ZL201410541481.7	中芯上海	2014-10-14	2018-07-06	原始取得	无
4535	晶圆、切割晶圆的方法及芯片	ZL201410541802.3	中芯上海	2014-10-14	2018-05-04	原始取得	无
4536	用于检测栅极的底部缺陷的方法	ZL201410541821.6	中芯上海	2014-10-14	2019-06-04	原始取得	无
4537	一种用于锁相环的电路结构	ZL201410541945.4	中芯上海	2014-10-14	2018-10-19	原始取得	无
4538	半导体器件的制作方法及半导体器件	ZL201410542129.5	中芯上海	2014-10-14	2018-07-24	原始取得	无
4539	FinFET 鳍片的制作方法	ZL201410542130.8	中芯上海	2014-10-14	2019-01-29	原始取得	无
4540	半导体器件的制作方法及半导体器件	ZL201410542467.9	中芯上海	2014-10-14	2019-07-16	原始取得	无
4541	化学机械抛光方法、其抛光时间制程的设置方法及晶圆	ZL201410542490.8	中芯上海	2014-10-14	2017-11-21	原始取得	无
4542	CMOS 图像传感器的制造方法	ZL201410542501.2	中芯上海	2014-10-14	2019-04-12	原始取得	无
4543	ESD 器件、ESD 器件的制作方	ZL201410542504.6	中芯上海	2014-10-14	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法及 EEPROM						
4544	光罩的缺陷修复方法及光罩	ZL201410542511.6	中芯上海	2014-10-14	2019-11-08	原始取得	无
4545	互连介质层的制作方法、互连介质层和互连层的制作方法	ZL201410542517.3	中芯上海	2014-10-14	2019-01-08	原始取得	无
4546	压力传感器形成方法	ZL201410545227.4	中芯上海	2014-10-15	2018-09-07	原始取得	无
4547	应力层的形成方法和晶体管的形成方法	ZL201410546258.1	中芯上海	2014-10-15	2018-02-16	原始取得	无
4548	半导体结构及其形成方法	ZL201410546261.3	中芯上海	2014-10-15	2019-03-12	原始取得	无
4549	半导体结构的形成方法	ZL201410546263.2	中芯上海	2014-10-15	2018-09-07	原始取得	无
4550	一种半导体器件中饱和电流性能的控制方法	ZL201410546364.X	中芯上海	2014-10-15	2018-09-07	原始取得	无
4551	一种半导体器件的制作方法	ZL201410548605.4	中芯上海	2014-10-16	2019-04-09	原始取得	无
4552	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201410548682.X	中芯上海	2014-10-16	2018-12-21	原始取得	无
4553	EUV 光源和曝光装置、校准装置和校准方法	ZL201410548939.1	中芯上海	2014-10-16	2017-12-01	原始取得	无
4554	一种晶圆测试数据的处理方法及系统	ZL201410549126.4	中芯上海、中芯北京	2014-10-16	2019-05-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4555	EUV 光源和曝光装置	ZL201410549348.6	中芯上海	2014-10-16	2019-03-29	原始取得	无
4556	半导体结构的形成方法	ZL201410549362.6	中芯上海	2014-10-16	2018-02-16	原始取得	无
4557	互连结构的形成方法	ZL201410549365.X	中芯上海	2014-10-16	2018-10-16	原始取得	无
4558	EUV 光源和曝光装置	ZL201410549374.9	中芯上海	2014-10-16	2018-03-06	原始取得	无
4559	半导体测试结构	ZL201410549402.7	中芯上海	2014-10-16	2019-01-11	原始取得	无
4560	半导体器件及其制备方法	ZL201410550472.4	中芯上海	2014-10-16	2018-11-16	原始取得	无
4561	半导体器件及其形成方法	ZL201410553884.3	中芯上海	2014-10-17	2018-09-07	原始取得	无
4562	EUV 光源和曝光装置	ZL201410553891.3	中芯上海	2014-10-17	2018-03-09	原始取得	无
4563	金属栅极的形成方法	ZL201410553899.X	中芯上海	2014-10-17	2019-01-22	原始取得	无
4564	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410553975.7	中芯上海	2014-10-17	2019-01-18	原始取得	无
4565	一种嵌入式闪存及其制备方法、电子装置	ZL201410554069.9	中芯上海	2014-10-17	2019-05-17	原始取得	无
4566	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410554510.3	中芯上海	2014-10-17	2018-04-13	原始取得	无
4567	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201410554566.9	中芯上海	2014-10-17	2019-01-22	原始取得	无
4568	半导体器件的形成方法	ZL201410554567.3	中芯上海	2014-10-17	2017-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4569	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410554589.X	中芯上海	2014-10-17	2019-06-28	原始取得	无
4570	信号接收机	ZL201410554629.0	中芯上海	2014-10-17	2018-09-25	原始取得	无
4571	用于测量 SRAM 的上拉或下拉器件的阈值电压的方法和电路	ZL201410554641.1	中芯上海	2014-10-17	2018-09-21	原始取得	无
4572	用于测量 SRAM 的传输门器件的阈值电压的方法和电路	ZL201410554697.7	中芯上海	2014-10-17	2018-09-21	原始取得	无
4573	用于芯片封装相互作用的评估的测试电路和测试器件	ZL201410554698.1	中芯上海	2014-10-17	2019-01-22	原始取得	无
4574	一种形成HARP层间介质层的方法	ZL201410554779.1	中芯上海	2014-10-17	2019-01-22	原始取得	无
4575	一种半导体器件的制作方法	ZL201410554811.6	中芯上海	2014-10-17	2017-10-20	原始取得	无
4576	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410554875.6	中芯上海	2014-10-17	2017-11-14	原始取得	无
4577	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410559225.0	中芯上海	2014-10-20	2018-09-25	原始取得	无
4578	一种背照式图像传感器及其	ZL201410559251.3	中芯上海	2014-10-20	2019-01-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	制备方法、电子装置						
4579	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410559253.2	中芯上海	2014-10-20	2017-10-20	原始取得	无
4580	静电测试控片以及静电测试方法	ZL201410563733.6	中芯上海	2014-10-21	2019-01-18	原始取得	无
4581	声音传感器的制备方法	ZL201410563735.5	中芯上海	2014-10-21	2019-07-02	原始取得	无
4582	版图数据的处理方法及光掩膜数据	ZL201410568446.4	中芯上海	2014-10-22	2019-07-16	原始取得	无
4583	一种纳米线器件的制作方法	ZL201410572401.4	中芯上海	2014-10-24	2019-01-25	原始取得	无
4584	晶体管及其形成方法	ZL201410582483.0	中芯上海	2014-10-27	2019-01-22	原始取得	无
4585	MIM 电容及其形成方法	ZL201410582526.5	中芯上海	2014-10-27	2018-09-07	原始取得	无
4586	一种半导体器件的制作方法	ZL201410587117.4	中芯上海	2014-10-28	2018-10-23	原始取得	无
4587	测试装置、测试系统以及测试方法	ZL201410587887.9	中芯上海	2014-10-28	2018-03-06	原始取得	无
4588	熔丝结构及其形成方法	ZL201410587888.3	中芯上海	2014-10-28	2018-11-16	原始取得	无
4589	半导体结构及其形成方法	ZL201410588176.3	中芯上海	2014-10-28	2018-07-06	原始取得	无
4590	薄膜晶体管及其形成方法	ZL201410588179.7	中芯上海	2014-10-28	2019-01-22	原始取得	无
4591	鳍式场效应晶体管及其形成	ZL201410588197.5	中芯上海	2014-10-28	2018-09-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
4592	半导体栅极版图及其修正方法、半导体结构形成方法	ZL201410588199.4	中芯上海	2014-10-28	2019-08-27	原始取得	无
4593	半导体结构的形成方法	ZL201410588908.9	中芯上海	2014-10-28	2018-11-16	原始取得	无
4594	一种半导体器件及其制作方法	ZL201410593736.4	中芯上海	2014-10-29	2018-12-21	原始取得	无
4595	一种 MEMS 麦克风及其制备方法、电子装置	ZL201410593751.9	中芯上海	2014-10-29	2019-06-28	原始取得	无
4596	测量结构和对测量结构进行测量的测量方法	ZL201410597136.5	中芯上海	2014-10-29	2019-01-08	原始取得	无
4597	一种麦克风器件及其制作方法	ZL201410597192.9	中芯上海	2014-10-30	2019-04-05	原始取得	无
4598	一种用于制造半导体器件的方法	ZL201410597654.7	中芯上海	2014-10-30	2019-01-22	原始取得	无
4599	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201410598161.5	中芯上海	2014-10-30	2018-11-16	原始取得	无
4600	半导体结构的形成方法	ZL201410598391.1	中芯上海	2014-10-30	2019-01-22	原始取得	无
4601	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201410598394.5	中芯上海	2014-10-30	2019-12-03	原始取得	无
4602	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201410598408.3	中芯上海	2014-10-30	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4603	半导体结构的形成方法	ZL201410598410.0	中芯上海	2014-10-30	2018-08-10	原始取得	无
4604	晶体管的形成方法	ZL201410599013.5	中芯上海	2014-10-30	2019-07-02	原始取得	无
4605	PMOS 晶体管的形成方法	ZL201410603287.7	中芯上海	2014-10-30	2018-09-07	原始取得	无
4606	透射电镜样品的形成方法	ZL201410604119.X	中芯上海	2014-10-30	2019-04-26	原始取得	无
4607	互连结构及其制作方法	ZL201410604130.6	中芯上海	2014-10-30	2019-01-22	原始取得	无
4608	半导体结构及其形成方法	ZL201410604149.0	中芯上海	2014-10-30	2018-10-16	原始取得	无
4609	鳍式场效应管及其形成方法	ZL201410604150.3	中芯上海	2014-10-30	2018-11-16	原始取得	无
4610	MEMS 器件及其形成方法	ZL201410612412.0	中芯上海	2014-11-04	2017-08-25	原始取得	无
4611	半导体制造机台的参数监控系统及方法	ZL201410616533.2	中芯上海	2014-11-05	2018-06-01	原始取得	无
4612	电荷泵电路以及存储器	ZL201410617432.7	中芯上海	2014-11-05	2019-01-25	原始取得	无
4613	金属的化学机械研磨方法	ZL201410617671.2	中芯上海	2014-11-05	2017-12-01	原始取得	无
4614	半导体结构形成方法	ZL201410621485.6	中芯上海	2014-11-06	2019-07-30	原始取得	无
4615	晶体管及其形成方法	ZL201410624231.X	中芯上海	2014-11-06	2019-03-12	原始取得	无
4616	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410624471.X	中芯上海	2014-11-07	2019-02-01	原始取得	无
4617	一种半导体器件及其制造方	ZL201410625184.0	中芯上海	2014-11-07	2018-12-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
4618	半导体结构及其形成方法	ZL201410627869.9	中芯上海	2014-11-10	2019-01-29	原始取得	无
4619	半导体结构形成方法	ZL201410627923.X	中芯上海	2014-11-10	2019-01-22	原始取得	无
4620	半导体结构及其形成方法	ZL201410628894.9	中芯上海	2014-11-10	2019-01-29	原始取得	无
4621	一种针对特殊批次货物进行预排程的系统及其方法	ZL201410635860.2	中芯上海	2014-11-12	2018-11-16	原始取得	无
4622	一种生产机台的管控系统及管控方法	ZL201410637226.2	中芯上海	2014-11-13	2018-09-25	原始取得	无
4623	晶体管的形成方法	ZL201410640550.X	中芯上海	2014-11-13	2019-05-28	原始取得	无
4624	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201410640608.0	中芯上海	2014-11-13	2019-03-29	原始取得	无
4625	压力传感器及其形成方法	ZL201410648299.1	中芯上海	2014-11-14	2018-07-06	原始取得	无
4626	相变存储器及其形成方法	ZL201410658849.8	中芯上海	2014-11-18	2018-03-30	原始取得	无
4627	电容的制造方法、以及 CMOS 图像传感器的制造方法	ZL201410658850.0	中芯上海	2014-11-18	2018-09-07	原始取得	无
4628	鳍式场效应晶体管及其制造方法	ZL201410658857.2	中芯上海	2014-11-18	2018-09-07	原始取得	无
4629	主动式的设备自动化程序的仿真测试方法和系统	ZL201410659442.7	中芯上海	2014-11-18	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4630	半导体加工设备模拟仿真系统及其工作方法	ZL201410673982.0	中芯天津、中芯上海	2014-11-21	2018-07-10	原始取得	无
4631	电阻式随机存储器的形成方法	ZL201410674484.8	中芯上海	2014-11-21	2018-10-16	原始取得	无
4632	一种 FinFET 虚拟图案的插入方法	ZL201410705663.3	中芯上海	2014-11-27	2019-01-22	原始取得	无
4633	半导体结构的形成方法	ZL201410707060.7	中芯上海	2014-11-27	2018-12-21	原始取得	无
4634	半导体器件及其形成方法	ZL201410707067.9	中芯上海	2014-11-27	2019-01-22	原始取得	无
4635	互连结构及其形成方法	ZL201410707068.3	中芯上海	2014-11-27	2018-11-16	原始取得	无
4636	套准标记及其形成方法	ZL201410707589.9	中芯上海	2014-11-27	2018-12-21	原始取得	无
4637	互连结构的制作方法	ZL201410707599.2	中芯上海	2014-11-27	2019-01-22	原始取得	无
4638	废水处理方法	ZL201410709482.8	中芯上海	2014-11-28	2019-04-19	原始取得	无
4639	一种静态存储电路、静态存储单元及其制作方法	ZL201410712009.5	中芯上海	2014-12-01	2018-12-07	原始取得	无
4640	一种提高产品良率的方法及系统	ZL201410713121.0	中芯天津、中芯上海	2014-11-28	2018-09-07	原始取得	无
4641	MEMS 器件的形成方法	ZL201410714490.1	中芯上海	2014-11-28	2017-08-29	原始取得	无
4642	NLDMOS 及其制作方法	ZL201410720351.X	中芯上海	2014-12-02	2019-01-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4643	互连结构及其形成方法	ZL201410720353.9	中芯上海	2014-12-02	2019-03-12	原始取得	无
4644	MEMS 器件的制作方法	ZL201410720429.8	中芯上海	2014-12-02	2018-03-30	原始取得	无
4645	半导体结构的形成方法	ZL201410720493.6	中芯上海	2014-12-02	2019-01-22	原始取得	无
4646	半导体器件的制作方法	ZL201410720639.7	中芯上海	2014-12-02	2017-09-26	原始取得	无
4647	相变存储器及其形成方法	ZL201410720640.X	中芯上海	2014-12-02	2018-06-01	原始取得	无
4648	半导体器件及其制作方法	ZL201410728307.3	中芯上海	2014-12-03	2019-01-29	原始取得	无
4649	半导体器件的形成方法	ZL201410734496.5	中芯上海	2014-12-04	2018-10-16	原始取得	无
4650	半导体结构的形成方法	ZL201410734499.9	中芯上海	2014-12-04	2017-09-22	原始取得	无
4651	半导体结构的形成方法	ZL201410734541.7	中芯上海	2014-12-04	2018-09-07	原始取得	无
4652	半导体结构的形成方法	ZL201410734632.0	中芯上海	2014-12-04	2018-11-16	原始取得	无
4653	鳍式场效应管的形成方法	ZL201410734651.3	中芯上海	2014-12-04	2019-01-22	原始取得	无
4654	电容结构及其形成方法	ZL201410734655.1	中芯上海	2014-12-04	2018-08-10	原始取得	无
4655	SRAM 存储器和形成 SRAM 存储器的方法	ZL201410734696.0	中芯上海	2014-12-04	2019-03-29	原始取得	无
4656	可穿戴式设备交互方法及系统	ZL201410734715.X	中芯上海	2014-12-04	2018-12-21	原始取得	无
4657	MOS 晶体管的制作方法	ZL201410736199.4	中芯上海	2014-12-04	2019-11-01	原始取得	无
4658	可穿戴式设备之间的通信方	ZL201410736201.8	中芯上海	2014-12-04	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法及通讯系统						
4659	半导体器件的形成方法	ZL201410736211.1	中芯上海	2014-12-04	2019-05-28	原始取得	无
4660	可穿戴式设备的信息交互方法和系统	ZL201410736213.0	中芯上海	2014-12-04	2019-04-26	原始取得	无
4661	半导体结构的形成方法	ZL201410736226.8	中芯上海	2014-12-04	2018-12-21	原始取得	无
4662	超低 K 介质层的形成方法	ZL201410736227.2	中芯上海	2014-12-04	2019-04-26	原始取得	无
4663	半导体结构的形成方法	ZL201410736243.1	中芯上海	2014-12-04	2019-05-28	原始取得	无
4664	半导体结构的形成方法	ZL201410736246.5	中芯上海	2014-12-04	2018-12-21	原始取得	无
4665	MEMS 器件的形成方法	ZL201410736247.X	中芯上海	2014-12-04	2017-09-22	原始取得	无
4666	半导体结构及其形成方法	ZL201410736249.9	中芯上海	2014-12-04	2018-09-07	原始取得	无
4667	半导体结构的形成方法	ZL201410736250.1	中芯上海	2014-12-04	2019-07-02	原始取得	无
4668	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201410742327.6	中芯上海	2014-12-08	2018-08-17	原始取得	无
4669	分频器及其方法以及包含该分频器的锁相环和半导体装置	ZL201410743029.9	中芯上海	2014-12-08	2018-12-07	原始取得	无
4670	用于快闪存储器的双位线读出电路和读出方法	ZL201410743255.7	中芯上海	2014-12-08	2019-10-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4671	制备 FinFET 器件的方法	ZL201410747457.9	中芯上海、中芯北京	2014-12-08	2018-12-21	原始取得	无
4672	改善介质层中通孔和沟槽形貌的方法	ZL201410747458.3	中芯上海	2014-12-08	2019-02-12	原始取得	无
4673	改善 MOS 器件性能的方法及 MOS 器件结构	ZL201410747645.1	中芯上海	2014-12-08	2019-12-27	原始取得	无
4674	抑制集成无源器件品质因子漂移的方法	ZL201410747733.1	中芯上海	2014-12-08	2018-09-07	原始取得	无
4675	形成应力结构的方法	ZL201410747759.6	中芯上海、中芯北京	2014-12-08	2019-10-25	原始取得	无
4676	基于工艺设计包的版图与原理图一致性验证方法	ZL201410752111.8	中芯上海	2014-12-09	2019-08-23	原始取得	无
4677	MEMS 传感器及其制备方法	ZL201410752823.X	中芯上海	2014-12-09	2017-10-10	原始取得	无
4678	半导体结构的形成方法	ZL201410756554.4	中芯上海	2014-12-10	2018-12-21	原始取得	无
4679	半导体结构的形成方法	ZL201410756740.8	中芯上海	2014-12-10	2018-10-16	原始取得	无
4680	半导体结构的形成方法	ZL201410756741.2	中芯上海	2014-12-10	2018-09-07	原始取得	无
4681	半导体结构的形成方法	ZL201410756762.4	中芯上海	2014-12-10	2019-01-22	原始取得	无
4682	功率晶体管芯片的制作方法及功率晶体管芯片	ZL201410784914.1	中芯上海	2014-12-16	2019-02-12	原始取得	无
4683	一种侧墙的形成方法	ZL201410784934.9	中芯上海	2014-12-16	2019-01-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4684	MEMS 器件的制作方法及 MEMS 器件	ZL201410785492.X	中芯上海	2014-12-26	2018-04-13	原始取得	无
4685	硅衬底、其制作方法及包括其的 IPD 器件	ZL201410785493.4	中芯上海	2014-12-16	2018-09-18	原始取得	无
4686	台阶高度校准模板、其制作方法及校准方法	ZL201410788501.0	中芯上海	2014-12-16	2019-04-12	原始取得	无
4687	半导体器件形成方法	ZL201410790514.1	中芯上海	2014-12-17	2017-12-01	原始取得	无
4688	一种半导体生产机台硬件性能的动态监控系统及监控方法	ZL201410801945.3	中芯上海	2014-12-18	2018-09-25	原始取得	无
4689	半导体结构的形成方法	ZL201410802075.1	中芯上海	2014-12-18	2019-03-12	原始取得	无
4690	半导体结构的形成方法	ZL201410802122.2	中芯上海	2014-12-18	2019-01-22	原始取得	无
4691	存储器件的形成方法	ZL201410804573.X	中芯上海	2014-12-18	2018-12-21	原始取得	无
4692	半导体结构及其形成方法	ZL201410820226.6	中芯上海	2014-12-19	2019-03-29	原始取得	无
4693	半导体结构的形成方法	ZL201410820269.4	中芯上海	2014-12-19	2019-01-25	原始取得	无
4694	输出缓冲器	ZL201410837907.3	中芯上海	2014-12-25	2018-12-21	原始取得	无
4695	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410837917.7	中芯上海	2014-12-25	2018-08-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4696	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201410837987.2	中芯上海	2014-12-25	2018-08-21	原始取得	无
4697	一种半导体存储器件及其制备方法、电子装置	ZL201410838205.7	中芯上海	2014-12-25	2019-07-26	原始取得	无
4698	半导体器件及其制备方法	ZL201410839964.5	中芯上海	2014-12-26	2019-12-27	原始取得	无
4699	半导体装置及其制造方法	ZL201410840374.4	中芯上海	2014-12-29	2018-12-07	原始取得	无
4700	栅氧化层失效分析方法	ZL201410840409.4	中芯上海	2014-12-24	2019-02-15	原始取得	无
4701	一种半导体存储器件及其制备方法、电子装置	ZL201410841378.4	中芯上海	2014-12-25	2019-01-22	原始取得	无
4702	一种半导体存储器件及其制备方法、电子装置	ZL201410841380.1	中芯上海	2014-12-25	2019-01-22	原始取得	无
4703	正偏压温度不稳定性的恢复装置和恢复方法	ZL201410841394.3	中芯上海	2014-12-25	2018-12-21	原始取得	无
4704	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201410842713.2	中芯上海	2014-12-25	2019-06-28	原始取得	无
4705	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201410843455.X	中芯上海	2014-12-25	2018-10-23	原始取得	无
4706	一种半导体器件及其制备方	ZL201410843468.7	中芯上海	2014-12-25	2019-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
4707	半导体装置及其制造方法	ZL201410856188.X	中芯上海	2014-12-29	2018-09-11	原始取得	无
4708	一种碳纳米管神经元器件及其制作方法	ZL201410856215.3	中芯上海	2014-12-29	2019-02-01	原始取得	无
4709	晶体管的形成方法	ZL201510005016.6	中芯上海	2015-01-06	2019-05-28	原始取得	无
4710	半导体结构的形成方法	ZL201510005047.1	中芯上海	2015-01-06	2019-05-28	原始取得	无
4711	版图设计方法以及版图设计单元集合	ZL201510005136.6	中芯上海	2015-01-06	2019-02-12	原始取得	无
4712	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510005158.2	中芯上海	2015-01-06	2019-07-02	原始取得	无
4713	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510005174.1	中芯上海	2015-01-06	2019-03-12	原始取得	无
4714	半导体结构的形成方法	ZL201510005567.2	中芯上海	2015-01-06	2018-11-16	原始取得	无
4715	半导体结构及其形成方法	ZL201510005570.4	中芯上海	2015-01-06	2018-10-16	原始取得	无
4716	反熔丝及其形成方法	ZL201510005594.X	中芯上海	2015-01-06	2018-08-10	原始取得	无
4717	N 型鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510005631.7	中芯上海	2015-01-06	2019-11-01	原始取得	无
4718	LDMOS 晶体管的形成方法及	ZL201510005633.6	中芯上海	2015-01-06	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	LDMOS 晶体管						
4719	半导体结构及其形成方法	ZL201510005634.0	中芯上海	2015-01-06	2018-08-10	原始取得	无
4720	减少焊盘结构结晶缺陷的方法	ZL201510005746.6	中芯上海	2015-01-06	2019-10-25	原始取得	无
4721	一种光罩派工方法及系统	ZL201510005957.X	中芯上海	2015-01-06	2019-05-28	原始取得	无
4722	延时电路和压控振荡器	ZL201510006052.4	中芯上海	2015-01-06	2018-09-07	原始取得	无
4723	N 型鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510006054.3	中芯上海	2015-01-06	2019-08-27	原始取得	无
4724	半导体器件的形成方法	ZL201510006064.7	中芯上海	2015-01-06	2018-11-16	原始取得	无
4725	半导体器件及其形成方法	ZL201510006069.X	中芯上海	2015-01-06	2018-11-16	原始取得	无
4726	晶圆键合方法以及晶圆键合结构	ZL201510006070.2	中芯上海	2015-01-06	2018-12-21	原始取得	无
4727	半导体结构的形成方法	ZL201510006078.9	中芯上海	2015-01-06	2019-01-22	原始取得	无
4728	改善惯性传感器中金属损失的方法	ZL201510006098.6	中芯上海	2015-01-06	2017-04-05	原始取得	无
4729	一种快速限定机台跑货的方法及系统	ZL201510006100.X	中芯上海	2015-01-06	2019-05-28	原始取得	无
4730	一种 HASTI 填充工艺	ZL201510006122.6	中芯上海	2015-01-06	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4731	半导体器件的制造方法	ZL201510006164.X	中芯上海	2015-01-07	2019-01-18	原始取得	无
4732	浅沟槽隔离结构的制备方法	ZL201510006176.2	中芯上海	2015-01-07	2019-09-17	原始取得	无
4733	防止 ONO 结构剥落缺陷的方法	ZL201510006179.6	中芯上海	2015-01-07	2018-05-04	原始取得	无
4734	半导体器件的制造方法	ZL201510006660.5	中芯上海	2015-01-07	2018-11-16	原始取得	无
4735	避免晶圆产生尖端放电缺陷的方法	ZL201510006761.2	中芯上海	2015-01-07	2019-05-31	原始取得	无
4736	晶体管及其形成方法	ZL201510006913.9	中芯上海	2015-01-07	2019-01-29	原始取得	无
4737	三维封装结构的形成方法	ZL201510006918.1	中芯上海	2015-01-07	2019-01-22	原始取得	无
4738	互连结构及其形成方法	ZL201510006942.5	中芯上海	2015-01-07	2019-01-29	原始取得	无
4739	掩模式只读存储器及其形成方法	ZL201510006957.1	中芯上海	2015-01-07	2018-12-21	原始取得	无
4740	降低铝焊垫氟结晶的方法以及半导体器件制作方法	ZL201510007117.7	中芯上海	2015-01-07	2017-12-08	原始取得	无
4741	芯片结构及其制作方法	ZL201510007132.1	中芯上海	2015-01-07	2019-07-02	原始取得	无
4742	HRP 电阻的制备方法及改变其阻值的方法	ZL201510007133.6	中芯上海	2015-01-07	2019-08-27	原始取得	无
4743	通孔的清洗方法及半导体器	ZL201510007145.9	中芯上海	2015-01-07	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	件的制备方法						
4744	快闪存储器及其形成方法	ZL201510007183.4	中芯上海	2015-01-07	2019-07-02	原始取得	无
4745	去除图案晶圆上的氮化硅层的方法	ZL201510007185.3	中芯上海	2015-01-07	2018-10-16	原始取得	无
4746	二极管 SPICE 仿真模型等效电路	ZL201510007223.5	中芯上海	2015-01-07	2019-08-27	原始取得	无
4747	闪存的形成方法	ZL201510007252.1	中芯上海	2015-01-07	2019-01-22	原始取得	无
4748	闪存的形成方法	ZL201510007255.5	中芯上海	2015-01-07	2019-05-28	原始取得	无
4749	半导体器件、制备半导体器件的方法	ZL201510007371.7	中芯上海、中芯北京	2015-01-07	2019-01-22	原始取得	无
4750	用于快闪存储器的负电压开关电路	ZL201510009259.7	中芯上海	2015-01-08	2019-10-25	原始取得	无
4751	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510009274.1	中芯上海	2015-01-08	2019-10-25	原始取得	无
4752	半导体结构及其形成方法	ZL201510009320.8	中芯上海	2015-01-08	2019-01-22	原始取得	无
4753	半导体器件的形成方法	ZL201510009338.8	中芯上海	2015-01-08	2018-10-16	原始取得	无
4754	半导体器件的形成方法	ZL201510009352.8	中芯上海	2015-01-08	2019-01-22	原始取得	无
4755	半导体器件的形成方法	ZL201510009359.X	中芯上海	2015-01-08	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4756	晶体管的形成方法	ZL201510010126.1	中芯上海	2015-01-08	2019-05-28	原始取得	无
4757	半导体器件的形成方法	ZL201510010127.6	中芯上海	2015-01-08	2019-01-22	原始取得	无
4758	晶体管的形成方法	ZL201510010128.0	中芯上海	2015-01-08	2018-11-16	原始取得	无
4759	灵敏放大器的版图及其形成方法、存储器的版图	ZL201510011857.8	中芯上海	2015-01-09	2018-08-10	原始取得	无
4760	半导体结构的形成方法	ZL201510011859.7	中芯上海	2015-01-09	2018-08-10	原始取得	无
4761	芯片运行状态监测系统及监测方法	ZL201510011901.5	中芯上海	2015-01-09	2019-05-28	原始取得	无
4762	芯片运行状态监测系统及监测方法	ZL201510011903.4	中芯上海	2015-01-09	2018-11-16	原始取得	无
4763	对芯片进行检测及对芯片测试结果进行验证的方法	ZL201510011959.X	中芯上海	2015-01-09	2018-10-16	原始取得	无
4764	半导体结构的形成方法	ZL201510011973.X	中芯上海	2015-01-09	2019-12-03	原始取得	无
4765	晶体管及其形成方法	ZL201510011981.4	中芯上海	2015-01-09	2018-11-16	原始取得	无
4766	半导体器件的形成方法	ZL201510012068.6	中芯上海	2015-01-09	2019-08-27	原始取得	无
4767	半导体器件及其形成方法	ZL201510012071.8	中芯上海	2015-01-09	2019-05-28	原始取得	无
4768	半导体器件的形成方法	ZL201510012074.1	中芯上海	2015-01-09	2019-05-28	原始取得	无
4769	半导体结构的形成方法	ZL201510012082.6	中芯上海	2015-01-09	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4770	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510012084.5	中芯上海	2015-01-09	2018-11-16	原始取得	无
4771	一种硅通孔结构及其制作方法	ZL201510014276.X	中芯上海	2015-01-12	2018-10-23	原始取得	无
4772	一种半导体器件及其制作方法	ZL201510014277.4	中芯上海	2015-01-12	2018-12-21	原始取得	无
4773	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510014320.7	中芯上海	2015-01-12	2018-10-23	原始取得	无
4774	一种用于稳压二极管的建模方法和模型电路	ZL201510014322.6	中芯上海	2015-01-12	2018-11-16	原始取得	无
4775	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510014336.8	中芯上海	2015-01-12	2019-01-22	原始取得	无
4776	一种 MEMS 悬臂梁结构及其制备方法	ZL201510016386.X	中芯上海	2015-01-13	2017-05-24	原始取得	无
4777	一种防止铜氧化扩散的方法	ZL201510016588.4	中芯上海	2015-01-13	2019-07-19	原始取得	无
4778	一种检测金属缺陷的方法	ZL201510016711.2	中芯上海	2015-01-13	2019-12-10	原始取得	无
4779	一种控制氧化硅沟槽底部平坦化的刻蚀方法	ZL201510018733.2	中芯上海	2015-01-14	2018-10-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4780	半导体器件的制造方法	ZL201510019215.2	中芯上海	2015-01-14	2019-05-03	原始取得	无
4781	一种用于化学气相沉积的清洗工艺	ZL201510019284.3	中芯上海	2015-01-14	2019-03-01	原始取得	无
4782	一种半导体器件的制作方法	ZL201510019313.6	中芯上海	2015-01-14	2019-01-22	原始取得	无
4783	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510019318.9	中芯上海	2015-01-14	2019-10-25	原始取得	无
4784	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510019320.6	中芯上海	2015-01-14	2018-09-21	原始取得	无
4785	引线焊垫结构及其形成方法	ZL201510019493.8	中芯上海	2015-01-15	2019-04-26	原始取得	无
4786	一种高耐压半导体器件及其制造方法	ZL201510020385.2	中芯上海	2015-01-15	2019-01-22	原始取得	无
4787	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510020388.6	中芯上海	2015-01-15	2019-04-09	原始取得	无
4788	半导体器件及其制作方法	ZL201510020471.3	中芯上海	2015-01-15	2019-06-18	原始取得	无
4789	失效点的定位方法及芯片的失效分析方法	ZL201510020474.7	中芯上海	2015-01-15	2018-10-23	原始取得	无
4790	一种研磨液、制备研磨液的方法和化学机械研磨方法	ZL201510021240.4	中芯上海	2015-01-15	2019-04-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4791	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510021267.3	中芯上海	2015-01-15	2019-04-09	原始取得	无
4792	用于修改后的芯片设计的冗余填充方法	ZL201510021301.7	中芯上海	2015-01-15	2019-03-08	原始取得	无
4793	LDMOS 器件	ZL201510021363.8	中芯上海	2015-01-15	2019-04-26	原始取得	无
4794	一种静电吸盘及其制造方法	ZL201510023342.X	中芯上海	2015-01-16	2019-03-22	原始取得	无
4795	一种监测离子注入角度的方法	ZL201510023599.5	中芯上海	2015-01-16	2018-12-21	原始取得	无
4796	用于失效分析的方法	ZL201510023600.4	中芯上海	2015-01-16	2018-11-16	原始取得	无
4797	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510024420.8	中芯上海	2015-01-16	2018-10-23	原始取得	无
4798	半导体器件的形成方法及超出 Q-time 时的处理方法	ZL201510024488.6	中芯上海	2015-01-17	2019-07-02	原始取得	无
4799	MIM 电容结构及其制作方法	ZL201510024491.8	中芯上海	2015-01-17	2018-10-16	原始取得	无
4800	半导体器件的制造方法	ZL201510025480.1	中芯上海	2015-01-19	2019-03-12	原始取得	无
4801	半导体结构及其形成方法	ZL201510026369.4	中芯上海	2015-01-19	2019-03-29	原始取得	无
4802	半导体器件的形成方法	ZL201510026426.9	中芯上海	2015-01-19	2019-04-26	原始取得	无
4803	半导体结构及其形成方法	ZL201510026450.2	中芯上海	2015-01-19	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4804	焊垫结构及制作方法	ZL201510028304.3	中芯上海	2015-01-20	2019-03-12	原始取得	无
4805	半导体结构的制作方法	ZL201510028546.2	中芯上海	2015-01-20	2019-01-11	原始取得	无
4806	研磨部件外形的调整方法	ZL201510028558.5	中芯上海	2015-01-20	2019-07-12	原始取得	无
4807	P 沟道快闪存储器的制作方法	ZL201510033108.5	中芯上海	2015-01-22	2019-07-16	原始取得	无
4808	用于芯片切割过程的保护结构	ZL201510033783.8	中芯上海	2015-01-22	2018-07-24	原始取得	无
4809	一种制备失效分析样品的方法	ZL201510036438.X	中芯上海	2015-01-23	2018-09-18	原始取得	无
4810	芯片翘曲值的分析方法及芯片的制造方法	ZL201510036440.7	中芯上海	2015-01-23	2019-02-01	原始取得	无
4811	MIM 电容器的制作方法及 MIM 电容器	ZL201510039678.5	中芯上海	2015-01-26	2018-09-18	原始取得	无
4812	硬掩膜层的制作方法、层间介质层的制作方法及半导体器件	ZL201510041746.1	中芯上海	2015-01-27	2019-01-08	原始取得	无
4813	金属互连结构及其制作方法	ZL201510041947.1	中芯上海	2015-01-27	2019-01-29	原始取得	无
4814	半导体器件及其制作方法	ZL201510044141.8	中芯上海	2015-01-28	2019-01-08	原始取得	无
4815	芯片通孔连接缺陷的检测方	ZL201510044143.7	中芯上海	2015-01-28	2019-01-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4816	半导体工艺制程信息的生成方法与生成装置	ZL201510044192.0	中芯上海	2015-01-28	2019-01-08	原始取得	无
4817	废水的处理方法	ZL201510044708.1	中芯上海	2015-01-28	2019-01-29	原始取得	无
4818	晶圆良率分析方法和装置	ZL201510044709.6	中芯上海	2015-01-28	2019-01-29	原始取得	无
4819	金属垫的形成方法	ZL201510044757.5	中芯上海	2015-01-28	2018-10-23	原始取得	无
4820	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL201510046868.X	中芯上海	2015-01-29	2019-01-29	原始取得	无
4821	测量系统和测量方法	ZL201510046870.7	中芯上海	2015-01-29	2019-03-12	原始取得	无
4822	互连结构及其形成方法	ZL201510047360.1	中芯上海	2015-01-29	2019-03-12	原始取得	无
4823	电压调节装置及电压调节方法	ZL201510047395.5	中芯上海	2015-01-29	2017-09-22	原始取得	无
4824	半导体结构的形成方法	ZL201510051477.7	中芯上海	2015-01-30	2019-02-12	原始取得	无
4825	异步逐次逼近型模数转换电路	ZL201510051478.1	中芯上海	2015-01-30	2019-07-02	原始取得	无
4826	半导体结构及其形成方法	ZL201510051480.9	中芯上海	2015-01-30	2019-08-27	原始取得	无
4827	晶体管及其形成方法、半导体结构及其形成方法	ZL201510051493.6	中芯上海	2015-01-30	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4828	晶体管及其形成方法	ZL201510051501.7	中芯上海	2015-01-30	2019-08-27	原始取得	无
4829	半导体结构的形成方法	ZL201510051526.7	中芯上海	2015-01-30	2018-11-16	原始取得	无
4830	时钟信号占空比调节电路	ZL201510051532.2	中芯上海	2015-01-30	2019-01-22	原始取得	无
4831	异步逐次逼近型模数转换电路	ZL201510051537.5	中芯上海	2015-01-30	2019-05-28	原始取得	无
4832	异步逐次逼近型模数转换电路	ZL201510051557.2	中芯上海	2015-01-30	2019-08-27	原始取得	无
4833	晶圆的键合方法和化学机械平坦化方法	ZL201510051560.4	中芯上海	2015-01-30	2019-03-29	原始取得	无
4834	管理信息系统及其产品流程的配置数据更新方法与装置	ZL201510051592.4	中芯上海	2015-01-30	2018-06-01	原始取得	无
4835	化学机械研磨设备及方法	ZL201510051593.9	中芯上海	2015-01-30	2018-06-29	原始取得	无
4836	晶体管及其形成方法	ZL201510051608.1	中芯上海	2015-01-30	2018-12-21	原始取得	无
4837	半导体器件的形成方法	ZL201510051610.9	中芯上海	2015-01-30	2019-07-02	原始取得	无
4838	半导体结构及其形成方法	ZL201510051756.3	中芯上海	2015-01-30	2019-11-01	原始取得	无
4839	半导体器件的形成方法	ZL201510051761.4	中芯上海	2015-01-30	2019-05-28	原始取得	无
4840	半导体器件的形成方法	ZL201510051766.7	中芯上海	2015-01-30	2019-04-26	原始取得	无
4841	测试掩模版以及测试方法	ZL201510051782.6	中芯上海	2015-01-30	2019-09-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4842	反相器电路、输出稳定的动态比较器及比较方法	ZL201510051785.X	中芯上海	2015-01-30	2019-04-26	原始取得	无
4843	掺杂多晶硅层的形成方法以及半导体器件的形成方法	ZL201510053246.X	中芯上海	2015-02-02	2019-03-29	原始取得	无
4844	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510053292.X	中芯上海	2015-02-02	2019-01-22	原始取得	无
4845	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510053319.5	中芯上海	2015-02-02	2017-12-19	原始取得	无
4846	半导体结构及其形成方法	ZL201510053554.2	中芯上海	2015-02-02	2019-01-22	原始取得	无
4847	一种掩膜板及扫描曝光机台焦距的监测方法	ZL201510053564.6	中芯上海	2015-02-02	2017-11-10	原始取得	无
4848	一种静电放电保护结构和电子装置	ZL201510053595.1	中芯上海	2015-02-02	2019-04-09	原始取得	无
4849	半导体器件及其形成方法	ZL201510053617.4	中芯上海	2015-02-02	2019-07-02	原始取得	无
4850	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510054485.7	中芯上海	2015-02-03	2019-07-26	原始取得	无
4851	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510054912.1	中芯上海	2015-02-03	2019-01-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4852	半导体器件及制备方法、半导体器件的测试结构及方法	ZL201510056613.1	中芯上海	2015-02-03	2019-07-26	原始取得	无
4853	平坦化方法	ZL201510056936.0	中芯上海	2015-02-04	2019-01-18	原始取得	无
4854	形成金属互连的方法	ZL201510057248.6	中芯上海	2015-02-04	2019-01-29	原始取得	无
4855	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201510057250.3	中芯上海	2015-02-04	2019-12-10	原始取得	无
4856	双掩膜自对准图案化的方法	ZL201510057277.2	中芯上海	2015-02-04	2019-10-22	原始取得	无
4857	一种半导体器件及其制作方法	ZL201510058300.X	中芯上海	2015-02-04	2017-12-05	原始取得	无
4858	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510058324.5	中芯上海	2015-02-04	2019-01-22	原始取得	无
4859	用于光学邻近修正的方法	ZL201510058385.1	中芯上海	2015-02-04	2018-03-30	原始取得	无
4860	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510058467.6	中芯上海	2015-02-04	2019-06-28	原始取得	无
4861	用于检查测试图形库的覆盖率的方法和光学邻近修正方法	ZL201510058510.9	中芯上海	2015-02-04	2018-03-16	原始取得	无
4862	一种半导体器件及其制造方	ZL201510058517.0	中芯上海	2015-02-04	2019-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法和电子装置						
4863	一种压力传感器及其制备方法	ZL201510058554.1	中芯上海	2015-02-04	2019-05-28	原始取得	无
4864	分离栅式闪存器件及制备方法	ZL201510058562.6	中芯上海	2015-02-04	2019-02-12	原始取得	无
4865	一种形成超低介电常数介质层的方法	ZL201510058564.5	中芯上海	2015-02-04	2019-03-12	原始取得	无
4866	用于调平验证测试的方法及校准光刻投影设备的方法	ZL201510058612.0	中芯上海	2015-02-04	2018-11-16	原始取得	无
4867	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510058666.7	中芯上海	2015-02-04	2019-01-22	原始取得	无
4868	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201510058669.0	中芯上海	2015-02-04	2019-02-01	原始取得	无
4869	一种对版图进行 DRC 验证的方法	ZL201510058670.3	中芯上海	2015-02-04	2019-04-09	原始取得	无
4870	监测制造机台的方法及其系统	ZL201510059296.9	中芯上海	2015-02-04	2019-06-25	原始取得	无
4871	一种集成传感器及其制备方	ZL201510059298.8	中芯上海	2015-02-04	2018-07-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4872	分离栅式闪存器件及制备方法	ZL201510059303.5	中芯上海	2015-02-04	2019-02-15	原始取得	无
4873	制备 ESD 器件的方法、ESD 器件	ZL201510059306.9	中芯上海	2015-02-04	2019-04-26	原始取得	无
4874	一种 PSM 对准标记结构的制备方法	ZL201510061273.1	中芯上海、中芯北京	2015-02-05	2019-03-12	原始取得	无
4875	金属栅制备方法	ZL201510061913.9	中芯上海、中芯北京	2015-02-05	2019-03-12	原始取得	无
4876	基于均值小漂移预测机台故障的方法	ZL201510073621.7	中芯上海	2015-02-11	2019-01-18	原始取得	无
4877	一种基于动态预测机台载荷量的产能优化方法	ZL201510075982.5	中芯上海	2015-02-12	2018-10-19	原始取得	无
4878	MIM 电容器及其制备方法	ZL201510080421.4	中芯上海	2015-02-13	2019-01-18	原始取得	无
4879	MOS 晶体管的开启电压测试系统及测试方法	ZL201510083050.5	中芯上海	2015-02-15	2019-04-19	原始取得	无
4880	用于铜/低 k 互连结构的光罩优化方法和光罩	ZL201510084491.7	中芯上海	2015-02-06	2019-04-09	原始取得	无
4881	一种 MEMS 器件及其制作方	ZL201510084494.0	中芯上海	2015-02-16	2017-11-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法和电子装置						
4882	一种互连结构的制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510084984.0	中芯上海	2015-02-16	2019-04-09	原始取得	无
4883	一种 SRAM 及其制造方法、电子装置	ZL201510086298.7	中芯上海	2015-02-17	2019-10-25	原始取得	无
4884	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510086334.X	中芯上海	2015-02-17	2019-05-17	原始取得	无
4885	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510086441.2	中芯上海	2015-02-17	2019-12-17	原始取得	无
4886	TEM 样品及其制备方法	ZL201510086443.1	中芯上海	2015-02-17	2018-10-23	原始取得	无
4887	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510086502.5	中芯上海	2015-02-16	2019-06-28	原始取得	无
4888	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510086591.3	中芯上海	2015-02-17	2019-10-25	原始取得	无
4889	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510086617.4	中芯上海	2015-02-17	2019-04-09	原始取得	无
4890	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510086621.0	中芯上海	2015-02-17	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4891	一种芯片的密封环	ZL201510086640.3	中芯上海	2015-02-17	2019-01-29	原始取得	无
4892	熔丝单元工作区间的确定方法和装置	ZL201510086644.1	中芯上海	2015-02-17	2019-06-04	原始取得	无
4893	缺陷定位方法	ZL201510087311.0	中芯上海	2015-02-25	2019-01-18	原始取得	无
4894	晶圆存放记录方法、设备和系统	ZL201510087487.6	中芯上海	2015-02-25	2019-01-08	原始取得	无
4895	异常机台的检测方法和检测设备	ZL201510087644.3	中芯上海	2015-02-25	2019-01-08	原始取得	无
4896	光刻方法及晶圆	ZL201510088074.X	中芯上海	2015-02-26	2019-06-04	原始取得	无
4897	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510089794.8	中芯上海	2015-02-27	2019-01-22	原始取得	无
4898	晶圆减薄方法	ZL201510089795.2	中芯上海	2015-02-27	2019-05-28	原始取得	无
4899	一种电流源及用于 DAC 的偏置电路	ZL201510089888.5	中芯上海	2015-02-27	2018-02-16	原始取得	无
4900	金属连线的制作方法及半导体器件	ZL201510089967.6	中芯上海	2015-02-27	2019-11-08	原始取得	无
4901	定制化虚拟图案填充方法	ZL201510090145.X	中芯上海	2015-02-27	2019-04-09	原始取得	无
4902	一种导电薄膜的制作方法及	ZL201510090151.5	中芯上海	2015-02-27	2017-11-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	导电薄膜						
4903	晶圆键合方法	ZL201510090153.4	中芯上海、中芯宁波	2015-02-27	2018-12-21	原始取得	无
4904	静态随机存储器	ZL201510090162.3	中芯上海	2015-02-27	2019-01-29	原始取得	无
4905	用于具有时间间隔限制的制造流程处理方法及装置	ZL201510090163.8	中芯上海	2015-02-27	2019-01-08	原始取得	无
4906	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510090206.2	中芯上海	2015-02-27	2017-11-14	原始取得	无
4907	用于 SRAM 的存储单元及其读写方法	ZL201510090262.6	中芯上海	2015-02-27	2019-01-29	原始取得	无
4908	一种对准图形及其制作方法	ZL201510094928.5	中芯上海	2015-03-03	2018-03-16	原始取得	无
4909	MIM 电容器及其制作方法	ZL201510095276.7	中芯上海	2015-03-03	2019-05-31	原始取得	无
4910	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510095432.X	中芯上海	2015-03-04	2019-06-28	原始取得	无
4911	绝缘层的形成方法、EEPROM 及其形成方法	ZL201510100632.X	中芯上海	2015-03-06	2019-04-26	原始取得	无
4912	一种改善半导体结构轮廓的方法	ZL201510100760.4	中芯上海	2015-03-06	2019-03-01	原始取得	无
4913	一种半导体器件及其制作方	ZL201510101515.5	中芯上海	2015-03-09	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4914	光学邻近修正方法	ZL201510104815.9	中芯上海	2015-03-10	2019-11-01	原始取得	无
4915	一种区域隔离装置、区域隔离系统和刻蚀方法	ZL201510104822.9	中芯上海	2015-03-10	2018-11-16	原始取得	无
4916	一种 CMEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510107387.5	中芯上海	2015-03-11	2018-02-06	原始取得	无
4917	用于振荡器的修调电路	ZL201510107405.X	中芯上海	2015-03-11	2019-01-22	原始取得	无
4918	用于晶圆上坏点的失效分析的方法	ZL201510107417.2	中芯上海	2015-03-11	2019-12-17	原始取得	无
4919	形成金属硅化物的方法	ZL201510107508.6	中芯上海	2015-03-11	2019-10-25	原始取得	无
4920	一种晶圆减薄方法	ZL201510107555.0	中芯上海	2015-03-11	2019-01-22	原始取得	无
4921	派工系统及派工方法	ZL201510119534.0	中芯上海	2015-03-18	2019-01-08	原始取得	无
4922	用于光学邻近修正修复的方法	ZL201510121332.X	中芯上海	2015-03-19	2019-12-17	原始取得	无
4923	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510121334.9	中芯上海	2015-03-19	2019-04-09	原始取得	无
4924	一种 MEMS 器件及其制作方法和电子装置	ZL201510121611.6	中芯上海	2015-03-19	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4925	熔丝的熔断电流的校准方法与电路	ZL201510122461.0	中芯上海	2015-03-19	2019-04-12	原始取得	无
4926	半导体结构的形成方法	ZL201510125779.4	中芯上海	2015-03-20	2019-03-29	原始取得	无
4927	半导体结构的形成方法	ZL201510125951.6	中芯上海	2015-03-20	2019-11-05	原始取得	无
4928	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510131193.9	中芯上海	2015-03-24	2018-12-21	原始取得	无
4929	晶体管的形成方法	ZL201510131246.7	中芯上海	2015-03-24	2019-07-02	原始取得	无
4930	半导体结构的形成方法	ZL201510131248.6	中芯上海	2015-03-24	2019-03-12	原始取得	无
4931	电阻式随机存储器的形成方法	ZL201510131863.7	中芯上海	2015-03-24	2018-12-21	原始取得	无
4932	掩模及其形成方法	ZL201510131864.1	中芯上海	2015-03-24	2019-11-01	原始取得	无
4933	半导体结构及其形成方法	ZL201510136674.9	中芯上海	2015-03-26	2019-08-27	原始取得	无
4934	纳米线场效应晶体管的形成方法	ZL201510136675.3	中芯上海	2015-03-26	2019-07-02	原始取得	无
4935	半导体结构的形成方法	ZL201510136849.6	中芯上海	2015-03-26	2019-03-29	原始取得	无
4936	半导体器件的制造方法	ZL201510140843.6	中芯上海	2015-03-27	2019-05-31	原始取得	无
4937	驱动电路	ZL201510142095.5	中芯上海	2015-03-27	2019-06-04	原始取得	无
4938	晶体管及其形成方法	ZL201510149074.6	中芯上海	2015-03-31	2019-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4939	掩膜式只读存储阵列、其制作方法以及存储器的制作方法	ZL201510149093.9	中芯上海	2015-03-31	2019-04-26	原始取得	无
4940	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510149625.9	中芯上海	2015-03-31	2019-04-26	原始取得	无
4941	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510152381.X	中芯上海	2015-04-01	2019-03-29	原始取得	无
4942	半导体器件的形成方法	ZL201510152602.3	中芯上海	2015-04-01	2019-01-29	原始取得	无
4943	一种 SRAM 器件及其电子装置	ZL201510156122.4	中芯上海	2015-04-03	2019-10-25	原始取得	无
4944	一种 SRAM 器件及其电子装置	ZL201510157884.6	中芯上海	2015-04-03	2019-05-17	原始取得	无
4945	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510158085.0	中芯上海	2015-04-03	2019-09-27	原始取得	无
4946	一种 MEMS 加速度传感器及其制作方法	ZL201510158096.9	中芯上海	2015-04-03	2019-05-17	原始取得	无
4947	修正图形的方法	ZL201510158375.5	中芯上海	2015-04-03	2019-03-29	原始取得	无
4948	利用 PECVD 工艺淀积薄膜的方法和 PECVD 装置	ZL201510158382.5	中芯上海	2015-04-03	2019-01-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4949	finFET 器件及其制作方法	ZL201510158698.4	中芯上海	2015-04-03	2019-06-04	原始取得	无
4950	光刻胶厚度异常的检测方法	ZL201510158716.9	中芯上海	2015-04-03	2018-03-23	原始取得	无
4951	轻掺杂漏注入方法与采用该法形成的半导体器件	ZL201510158718.8	中芯上海	2015-04-03	2018-10-23	原始取得	无
4952	接触孔栓塞的形成方法	ZL201510161233.4	中芯上海	2015-04-03	2019-12-03	原始取得	无
4953	浮栅结构、其制作方法及包括其的闪存	ZL201510161268.8	中芯上海	2015-04-03	2019-07-16	原始取得	无
4954	半导体结构的形成方法	ZL201510163917.8	中芯上海	2015-04-08	2019-12-03	原始取得	无
4955	晶体管的形成方法	ZL201510163918.2	中芯上海	2015-04-08	2019-05-28	原始取得	无
4956	半导体结构及其形成方法	ZL201510163919.7	中芯上海	2015-04-08	2019-03-12	原始取得	无
4957	一种获取非对称装置栅的堆叠电容的方法	ZL201510173295.7	中芯上海	2015-04-13	2019-03-12	原始取得	无
4958	制备 FinFET 器件的方法	ZL201510174056.3	中芯上海、中芯北京	2015-04-13	2019-12-27	原始取得	无
4959	芯片及其制作方法	ZL201510174058.2	中芯上海	2015-04-13	2018-10-23	原始取得	无
4960	一种半导体器件和电子装置	ZL201510176176.7	中芯上海	2015-04-14	2019-07-26	原始取得	无
4961	半导体器件的形成方法	ZL201510176679.4	中芯上海	2015-04-14	2019-05-28	原始取得	无
4962	半导体结构的形成方法	ZL201510176691.5	中芯上海	2015-04-14	2019-05-28	原始取得	无
4963	输出缓冲器	ZL201510176835.7	中芯上海	2015-04-14	2019-05-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4964	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510176872.8	中芯上海	2015-04-15	2019-09-27	原始取得	无
4965	一种半导体器件和电子装置	ZL201510176990.9	中芯上海	2015-04-15	2019-06-28	原始取得	无
4966	互连结构的形成方法	ZL201510178919.4	中芯上海	2015-04-15	2019-11-05	原始取得	无
4967	自动化信息系统漏洞风险的处理方法和装置	ZL201510179461.4	中芯上海	2015-04-15	2019-12-03	原始取得	无
4968	静态随机存储器和时序控制电路	ZL201510179465.2	中芯上海	2015-04-15	2019-04-12	原始取得	无
4969	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510179812.1	中芯上海	2015-04-16	2019-01-22	原始取得	无
4970	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510179852.6	中芯上海	2015-04-16	2019-09-03	原始取得	无
4971	晶片边缘剥落缺陷源头的清除方法	ZL201510181032.0	中芯上海	2015-04-16	2019-04-12	原始取得	无
4972	半导体机台的机台警报信息的处理方法及装置	ZL201510181034.X	中芯上海	2015-04-16	2019-11-08	原始取得	无
4973	LDMOS 晶体管的形成方法及 LDMOS 晶体管	ZL201510181790.2	中芯上海	2015-04-16	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4974	用于裸芯片的测试接口板和用于裸芯片的测试系统	ZL201510181821.4	中芯上海	2015-04-16	2019-09-06	原始取得	无
4975	金属互连层的金属化工艺	ZL201510181835.6	中芯上海	2015-04-16	2019-02-12	原始取得	无
4976	一种提高制造机台腔体产出效率的方法及系统	ZL201510186200.5	中芯上海	2015-04-17	2018-12-14	原始取得	无
4977	SRAM 访问时间的测试电路与测试方法	ZL201510186271.5	中芯上海	2015-04-17	2019-06-18	原始取得	无
4978	半导体结构的形成方法	ZL201510189778.6	中芯上海	2015-04-20	2019-04-26	原始取得	无
4979	半导体器件的形成方法	ZL201510192196.3	中芯上海	2015-04-20	2019-03-12	原始取得	无
4980	MOS 晶体管的形成方法	ZL201510192218.6	中芯上海	2015-04-20	2019-07-02	原始取得	无
4981	环形压控振荡器电路	ZL201510192254.2	中芯上海	2015-04-20	2019-02-12	原始取得	无
4982	晶圆聚焦补偿的曝光方法与装置	ZL201510192269.9	中芯上海	2015-04-20	2018-03-23	原始取得	无
4983	一种机台制程参数偏移的管控系统及方法	ZL201510195207.3	中芯上海	2015-04-22	2019-01-04	原始取得	无
4984	套刻测量装置	ZL201510196999.6	中芯上海	2015-04-23	2018-03-30	原始取得	无
4985	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510198772.5	中芯上海	2015-04-21	2019-02-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
4986	一种线路连接装置	ZL201510199011.1	中芯上海	2015-04-23	2018-11-27	原始取得	无
4987	套刻测量装置	ZL201510199057.3	中芯上海	2015-04-23	2018-12-21	原始取得	无
4988	一种检测晶体振荡器电路是否起振的方法和电路结构	ZL201510201675.7	中芯上海	2015-04-24	2019-06-21	原始取得	无
4989	芯片的地址测试方法及芯片的失效分析方法	ZL201510206462.3	中芯上海	2015-04-24	2018-10-23	原始取得	无
4990	半导体器件及其形成方法	ZL201510214828.1	中芯上海	2015-04-29	2019-04-02	原始取得	无
4991	SRAM 单元的形成方法	ZL201510215852.7	中芯上海	2015-04-29	2019-01-25	原始取得	无
4992	晶体管的形成方法	ZL201510215854.6	中芯上海	2015-04-29	2019-04-26	原始取得	无
4993	存储器结构的形成方法	ZL201510215855.0	中芯上海	2015-04-29	2019-07-30	原始取得	无
4994	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510215866.9	中芯上海	2015-04-29	2019-09-27	原始取得	无
4995	环形振荡电路和环形振荡器	ZL201510215867.3	中芯上海	2015-04-29	2019-07-16	原始取得	无
4996	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510215899.3	中芯上海	2015-04-30	2019-06-28	原始取得	无
4997	N 型鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510215957.2	中芯上海	2015-04-30	2019-09-27	原始取得	无
4998	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201510215959.1	中芯上海	2015-04-29	2019-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
4999	半导体结构的形成方法	ZL201510215960.4	中芯上海	2015-04-29	2019-07-30	原始取得	无
5000	重复利用半导体芯片的方法	ZL201510215996.2	中芯上海	2015-04-29	2019-08-27	原始取得	无
5001	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510216034.9	中芯上海	2015-04-30	2018-04-13	原始取得	无
5002	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510217734.X	中芯上海	2015-04-30	2018-02-06	原始取得	无
5003	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510217735.4	中芯上海	2015-04-30	2018-02-06	原始取得	无
5004	N 型鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510218752.X	中芯上海	2015-04-30	2019-09-27	原始取得	无
5005	半导体结构及其形成方法	ZL201510224824.1	中芯上海	2015-05-05	2019-04-26	原始取得	无
5006	嵌入逻辑电路的快闪存储器的制作方法	ZL201510224825.6	中芯上海	2015-05-05	2019-03-29	原始取得	无
5007	半导体结构的形成方法	ZL201510224851.9	中芯上海	2015-05-05	2019-03-12	原始取得	无
5008	半导体结构的形成方法	ZL201510224852.3	中芯上海	2015-05-05	2019-05-28	原始取得	无
5009	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201510224853.8	中芯上海	2015-05-05	2019-08-27	原始取得	无
5010	芯片测试结构及硅片	ZL201510225522.6	中芯上海	2015-05-05	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5011	半导体结构及其形成方法	ZL201510225523.0	中芯上海	2015-05-05	2018-03-30	原始取得	无
5012	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510225524.5	中芯上海	2015-05-05	2019-07-02	原始取得	无
5013	半导体结构及其形成方法	ZL201510225526.4	中芯上海	2015-05-05	2019-03-29	原始取得	无
5014	晶体管的形成方法	ZL201510225528.3	中芯上海	2015-05-05	2019-03-12	原始取得	无
5015	半导体加工过程中的控制方法和系统	ZL201510225548.0	中芯上海	2015-05-05	2019-03-12	原始取得	无
5016	半导体器件测试方法	ZL201510230999.3	中芯上海	2015-05-07	2019-01-25	原始取得	无
5017	监测晶圆以及金属污染的监测方法	ZL201510231037.X	中芯上海	2015-05-07	2019-01-22	原始取得	无
5018	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510232427.9	中芯上海	2015-05-08	2019-09-27	原始取得	无
5019	一种确定连通存储元件中的接触塞的缺陷的方法	ZL201510233147.X	中芯上海	2015-05-08	2019-01-22	原始取得	无
5020	一种半导体器件和电子装置	ZL201510245546.8	中芯上海	2015-05-14	2019-05-21	原始取得	无
5021	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510245871.4	中芯上海	2015-05-14	2019-05-17	原始取得	无
5022	高电压电平转换电路	ZL201510246614.2	中芯上海	2015-05-14	2019-09-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5023	制造执行系统的数据备份系统及方法	ZL201510249796.9	中芯上海	2015-05-15	2019-07-02	原始取得	无
5024	半导体器件及其制备方法	ZL201510250206.4	中芯上海	2015-05-15	2019-05-31	原始取得	无
5025	TEM 样品的制备方法	ZL201510250349.5	中芯上海	2015-05-15	2019-04-02	原始取得	无
5026	制程异常诊断系统及方法	ZL201510250376.2	中芯上海	2015-05-15	2019-04-19	原始取得	无
5027	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510252857.7	中芯上海	2015-05-18	2019-09-03	原始取得	无
5028	一种 FinFET 器件界面态的测量结构及测量方法、电子装置	ZL201510255703.3	中芯上海	2015-05-19	2019-05-21	原始取得	无
5029	一种半导体器件和电子装置	ZL201510255838.X	中芯上海	2015-05-19	2019-06-28	原始取得	无
5030	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510255840.7	中芯上海	2015-05-19	2019-09-03	原始取得	无
5031	D 型触发器及其信号传输方法	ZL201510256949.2	中芯上海	2015-05-19	2019-02-26	原始取得	无
5032	半导体器件制作方法、半导体器件及电子装置	ZL201510257168.5	中芯上海	2015-05-19	2019-09-27	原始取得	无
5033	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510258284.9	中芯上海	2015-05-20	2019-05-17	原始取得	无
5034	一种半导体器件及其制造方	ZL201510259120.8	中芯上海	2015-05-20	2019-09-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
5035	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201510259140.5	中芯上海、中芯宁波	2015-05-20	2019-06-28	原始取得	无
5036	半导体结构的形成方法	ZL201510260087.0	中芯上海	2015-05-20	2019-11-05	原始取得	无
5037	掩模版的修正方法	ZL201510260090.2	中芯上海	2015-05-20	2019-12-31	原始取得	无
5038	一种半导体器件的制造方法和电子装置	ZL201510264407.X	中芯上海、中芯宁波	2015-05-21	2019-04-09	原始取得	无
5039	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510264464.8	中芯上海	2015-05-21	2019-05-21	原始取得	无
5040	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510264465.2	中芯上海	2015-05-21	2019-09-03	原始取得	无
5041	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510264471.8	中芯上海	2015-05-21	2019-12-24	原始取得	无
5042	半导体器件的制造方法	ZL201510264656.9	中芯上海	2015-05-21	2019-11-01	原始取得	无
5043	半导体测试结构的制备方法以及测试方法	ZL201510264660.5	中芯上海	2015-05-21	2019-02-12	原始取得	无
5044	一种超低 K 介质材料刻蚀深度的控制方法	ZL201510266174.7	中芯上海	2015-05-22	2019-05-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5045	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510266271.6	中芯上海	2015-05-22	2019-04-09	原始取得	无
5046	一种 TEM 样品制备方法	ZL201510266340.3	中芯上海	2015-05-22	2019-10-18	原始取得	无
5047	一种控制机台自动测机的时间间隔约束方法	ZL201510266362.X	中芯上海	2015-05-22	2018-10-19	原始取得	无
5048	一种二次离子质谱分析方法	ZL201510266363.4	中芯上海	2015-05-22	2019-04-16	原始取得	无
5049	研磨垫修整装置及研磨垫修整方法	ZL201510267030.3	中芯上海	2015-05-22	2019-05-31	原始取得	无
5050	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510270812.2	中芯上海	2015-05-25	2019-04-09	原始取得	无
5051	PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201510271631.1	中芯上海	2015-05-25	2019-04-26	原始取得	无
5052	存储器及其形成方法	ZL201510271915.0	中芯上海	2015-05-25	2019-07-02	原始取得	无
5053	半导体结构的形成方法	ZL201510271980.3	中芯上海	2015-05-25	2019-03-29	原始取得	无
5054	芯片压降、结构的测试方法以及芯片改进方法	ZL201510272047.8	中芯上海	2015-05-25	2019-03-12	原始取得	无
5055	半导体结构的形成方法	ZL201510274780.3	中芯上海	2015-05-26	2019-04-26	原始取得	无
5056	差分激励电路	ZL201510288731.5	中芯上海	2015-05-29	2018-10-16	原始取得	无
5057	多晶硅栅极的制作方法以及	ZL201510290022.0	中芯上海	2015-05-31	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	嵌入式闪存的制作方法						
5058	半导体器件、鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510290564.8	中芯上海	2015-05-29	2019-08-27	原始取得	无
5059	准绝缘体上硅场效应晶体管器件的制作方法	ZL201510292699.8	中芯上海	2015-06-01	2019-05-28	原始取得	无
5060	PMOS 晶体管及其形成方法	ZL201510292726.1	中芯上海	2015-06-01	2019-07-30	原始取得	无
5061	浅沟槽隔离结构及其形成方法	ZL201510292728.0	中芯上海	2015-06-01	2019-09-27	原始取得	无
5062	MOS 晶体管的形成方法	ZL201510292970.8	中芯上海	2015-06-01	2019-03-12	原始取得	无
5063	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510292990.5	中芯上海	2015-06-01	2019-08-27	原始取得	无
5064	半导体器件、鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510293006.7	中芯上海	2015-06-01	2019-07-02	原始取得	无
5065	时钟信号产生电路	ZL201510293013.7	中芯上海	2015-06-01	2019-07-30	原始取得	无
5066	半导体结构的形成方法	ZL201510293278.7	中芯上海	2015-06-01	2019-05-28	原始取得	无
5067	结型场效应晶体管及其制作方法	ZL201510296529.7	中芯上海	2015-06-02	2019-03-12	原始取得	无
5068	离子注入角的检测方法	ZL201510296748.5	中芯上海	2015-06-02	2019-03-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5069	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510323059.9	中芯上海	2015-06-12	2019-04-09	原始取得	无
5070	鳍式场效应管的形成方法	ZL201510324674.1	中芯上海	2015-06-12	2019-11-01	原始取得	无
5071	存储器结构及其形成方法	ZL201510325294.X	中芯上海	2015-06-12	2019-07-02	原始取得	无
5072	封装结构及其制造方法	ZL201510325542.0	中芯上海	2015-06-13	2019-07-02	原始取得	无
5073	垂直导电功率器件及其制作方法	ZL201510325803.9	中芯上海	2015-06-12	2019-11-05	原始取得	无
5074	实现再布线金属层光刻的方法	ZL201510325804.3	中芯上海	2015-06-12	2019-05-28	原始取得	无
5075	半导体存储器及其制造方法	ZL201510325805.8	中芯上海	2015-06-12	2019-05-28	原始取得	无
5076	掩模板图形结构及半导体芯片的制作方法	ZL201510329579.0	中芯上海	2015-06-13	2019-04-02	原始取得	无
5077	一种 CMOS 图像传感器及其制作方法	ZL201510340925.5	中芯上海	2015-06-18	2019-12-17	原始取得	无
5078	一种半导体器件和电子装置	ZL201510340942.9	中芯上海	2015-06-18	2019-07-26	原始取得	无
5079	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510340966.4	中芯上海	2015-06-18	2019-09-27	原始取得	无
5080	一种半导体器件及其制作方	ZL201510340968.3	中芯上海	2015-06-18	2019-05-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法和电子装置						
5081	高电压阈值器件的传输门及其后续下拉电路结构	ZL201510341803.8	中芯上海	2015-06-18	2019-04-09	原始取得	无
5082	用于光学邻近修正修复的方法	ZL201510345788.4	中芯上海	2015-06-18	2019-12-17	原始取得	无
5083	离子注入的测量方法	ZL201510345847.8	中芯上海	2015-06-18	2019-04-09	原始取得	无
5084	施密特触发器	ZL201510348843.5	中芯上海	2015-06-19	2019-01-22	原始取得	无
5085	半导体器件及其制备方法	ZL201510348852.4	中芯上海	2015-06-19	2019-07-02	原始取得	无
5086	半导体器件及其制备方法	ZL201510348871.7	中芯上海	2015-06-19	2019-12-27	原始取得	无
5087	晶圆中氧沉淀的检测方法	ZL201510349911.X	中芯上海	2015-06-19	2019-04-02	原始取得	无
5088	半导体器件的形成方法	ZL201510350801.5	中芯上海	2015-06-23	2019-12-31	原始取得	无
5089	半导体器件的形成方法	ZL201510354360.6	中芯上海	2015-06-24	2019-09-27	原始取得	无
5090	制程管控线的生成方法和装置及制程管控系统	ZL201510355094.9	中芯上海	2015-06-24	2019-02-12	原始取得	无
5091	EUV 光源、曝光装置和一体式旋转结构制作方法	ZL201510363583.9	中芯上海	2015-06-26	2018-03-30	原始取得	无
5092	半导体器件的形成方法	ZL201510367484.8	中芯上海	2015-06-29	2019-11-01	原始取得	无
5093	鳍式场效应晶体管的形成方	ZL201510372784.5	中芯上海	2015-06-30	2019-05-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
5094	半导体器件的形成方法	ZL201510372837.3	中芯上海	2015-06-30	2019-07-02	原始取得	无
5095	半导体结构的形成方法	ZL201510372884.8	中芯上海、中芯北京	2015-06-30	2019-08-27	原始取得	无
5096	静态随机存储单元	ZL201510373294.7	中芯上海、中芯北京	2015-06-30	2019-03-26	原始取得	无
5097	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201510373347.5	中芯上海	2015-06-30	2019-07-30	原始取得	无
5098	半导体结构的形成方法	ZL201510373552.1	中芯上海	2015-06-30	2019-07-02	原始取得	无
5099	半导体结构及其形成方法	ZL201510373554.0	中芯上海	2015-06-30	2019-01-25	原始取得	无
5100	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510373975.3	中芯上海、中芯北京	2015-06-30	2019-12-03	原始取得	无
5101	半导体器件及其形成方法	ZL201510377725.7	中芯上海	2015-07-01	2019-05-28	原始取得	无
5102	半导体器件及其形成方法	ZL201510377767.0	中芯上海、中芯北京	2015-07-01	2019-11-01	原始取得	无
5103	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510377770.2	中芯上海	2015-07-01	2019-07-02	原始取得	无
5104	存储器的选择门驱动电路及其控制装置、控制方法	ZL201510377793.3	中芯上海	2015-07-01	2019-12-03	原始取得	无
5105	半导体结构的形成方法	ZL201510377833.4	中芯上海	2015-07-01	2019-07-30	原始取得	无
5106	光刻图形的形成方法	ZL201510378617.1	中芯上海	2015-07-01	2019-07-02	原始取得	无
5107	半导体结构的形成方法	ZL201510381676.4	中芯上海	2015-07-02	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5108	晶圆键合方法以及晶圆键合结构	ZL201510381677.9	中芯上海	2015-07-02	2019-05-28	原始取得	无
5109	晶体管的形成方法	ZL201510381679.8	中芯上海	2015-07-02	2019-08-27	原始取得	无
5110	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510387733.X	中芯上海	2015-07-02	2019-11-01	原始取得	无
5111	MOS 晶体管及其形成方法	ZL201510387736.3	中芯上海、中芯北京	2015-07-02	2019-08-27	原始取得	无
5112	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510387770.0	中芯上海	2015-07-02	2019-08-27	原始取得	无
5113	占空比调整电路和模数转换系统	ZL201510387786.1	中芯上海	2015-07-02	2019-12-31	原始取得	无
5114	半导体结构的形成方法	ZL201510387788.0	中芯上海	2015-07-02	2019-03-12	原始取得	无
5115	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510401759.5	中芯上海	2015-07-09	2019-01-22	原始取得	无
5116	套刻精度补偿方法及装置	ZL201510404693.5	中芯上海	2015-07-10	2019-01-22	原始取得	无
5117	光源偏振优化方法和光源-掩膜-偏振优化方法	ZL201510418311.4	中芯上海	2015-07-16	2019-07-26	原始取得	无
5118	二氧化硅介电薄膜制备方法	ZL201510418312.9	中芯上海	2015-07-16	2019-10-25	原始取得	无
5119	铜互连的电介质覆盖层的形	ZL201510418313.3	中芯上海	2015-07-16	2019-05-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	成方法						
5120	用于评估光学邻近修正模型的精度的方法	ZL201510418429.7	中芯上海	2015-07-16	2019-12-17	原始取得	无
5121	一种层间介电层的化学机械抛光方法及其器件和电子装置	ZL201510418436.7	中芯上海	2015-07-16	2019-03-08	原始取得	无
5122	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510418474.2	中芯上海	2015-07-16	2019-12-17	原始取得	无
5123	光源-掩膜优化方法和光源-掩膜-偏振优化方法	ZL201510422557.9	中芯上海	2015-07-17	2019-10-25	原始取得	无
5124	半导体结构的形成方法	ZL201510423235.6	中芯上海、中芯北京	2015-07-17	2019-03-29	原始取得	无
5125	半导体结构的形成方法	ZL201510427175.5	中芯上海、中芯北京	2015-07-20	2019-09-27	原始取得	无
5126	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510437189.5	中芯上海、中芯北京	2015-07-23	2018-02-06	原始取得	无
5127	半导体结构及其形成方法	ZL201510437373.X	中芯上海、中芯北京	2015-07-23	2018-01-02	原始取得	无
5128	I/O 驱动器控制信号生成单元、I/O 驱动器及电子装置	ZL201510437688.4	中芯上海	2015-07-23	2019-09-03	原始取得	无
5129	晶体管的形成方法	ZL201510438174.0	中芯上海、中芯北京	2015-07-23	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5130	用于消除因光罩随机错误而产生的晶圆坏点的方法	ZL201510442738.8	中芯上海	2015-07-24	2018-09-21	原始取得	无
5131	一种生产工艺流程建模系统及方法	ZL201510443064.3	中芯上海	2015-07-24	2019-01-11	原始取得	无
5132	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201510443534.6	中芯上海、中芯北京	2015-07-24	2019-12-13	原始取得	无
5133	鳍式双极结型晶体管的形成方法	ZL201510451932.2	中芯上海、中芯北京	2015-07-28	2019-07-30	原始取得	无
5134	半导体器件的制造方法	ZL201510452100.2	中芯上海、中芯北京	2015-07-28	2019-07-30	原始取得	无
5135	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510456542.4	中芯上海、中芯北京	2015-07-29	2019-07-30	原始取得	无
5136	半导体结构及其形成方法	ZL201510464307.1	中芯上海、中芯北京	2015-07-30	2019-11-01	原始取得	无
5137	半导体结构及其形成方法	ZL201510465541.6	中芯上海、中芯北京	2015-07-31	2019-07-30	原始取得	无
5138	半导体结构的形成方法	ZL201510465545.4	中芯上海、中芯北京	2015-07-31	2019-07-30	原始取得	无
5139	半导体结构的形成方法	ZL201510465602.9	中芯上海	2015-07-31	2018-09-07	原始取得	无
5140	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510465603.3	中芯上海、中芯北京	2015-07-31	2019-11-01	原始取得	无
5141	半导体器件的形成方法	ZL201510465605.2	中芯上海	2015-07-31	2019-09-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5142	MIM 电容结构	ZL201510493002.3	中芯上海	2015-08-12	2018-12-21	原始取得	无
5143	半导体结构及其形成方法	ZL201510493003.8	中芯上海	2015-08-12	2019-05-28	原始取得	无
5144	半导体结构的形成方法	ZL201510493286.6	中芯上海	2015-08-12	2019-05-28	原始取得	无
5145	晶体管及其形成方法	ZL201510493296.X	中芯上海	2015-08-12	2019-07-02	原始取得	无
5146	一种半导体结构的制作方法	ZL201510507796.4	中芯上海	2015-08-18	2019-06-28	原始取得	无
5147	金属缺陷的检测方法及检测结构的形成方法	ZL201510511296.8	中芯上海	2015-08-19	2019-07-30	原始取得	无
5148	校正电路及装置、温度检测电路及方法、测试方法	ZL201510511595.1	中芯上海	2015-08-19	2019-02-12	原始取得	无
5149	静电保护结构及集成电路系统	ZL201510519610.7	中芯上海	2015-08-21	2019-03-29	原始取得	无
5150	半导体器件及其形成方法	ZL201510520205.7	中芯上海	2015-08-21	2019-07-30	原始取得	无
5151	灵敏放大器	ZL201510531697.X	中芯上海	2015-08-26	2019-07-02	原始取得	无
5152	半导体器件的形成方法	ZL201510531698.4	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-11-01	原始取得	无
5153	半导体器件的形成方法	ZL201510531700.8	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-11-12	原始取得	无
5154	环栅场效应管的形成方法	ZL201510532178.5	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-07-30	原始取得	无
5155	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510532179.X	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5156	掩膜结构的制造方法	ZL201510532180.2	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-05-28	原始取得	无
5157	半导体结构的形成方法	ZL201510532211.4	中芯上海、中芯北京	2015-08-26	2019-09-27	原始取得	无
5158	光刻胶图形的形成方法	ZL201510536201.8	中芯上海	2015-08-27	2019-04-26	原始取得	无
5159	半导体器件的形成方法	ZL201510536224.9	中芯上海	2015-08-27	2019-03-29	原始取得	无
5160	MEMS 器件及其形成方法	ZL201510540807.9	中芯上海	2015-08-28	2018-03-30	原始取得	无
5161	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510540809.8	中芯上海、中芯北京	2015-08-28	2019-07-30	原始取得	无
5162	半导体结构的形成方法	ZL201510541058.1	中芯上海、中芯北京	2015-08-28	2019-08-27	原始取得	无
5163	温度检测结构	ZL201510546372.9	中芯上海	2015-08-31	2019-02-12	原始取得	无
5164	存储器解码系统控制方法及装置	ZL201510546373.3	中芯上海	2015-08-31	2019-08-27	原始取得	无
5165	半导体结构的形成方法	ZL201510546719.X	中芯上海、中芯北京	2015-08-31	2019-07-30	原始取得	无
5166	LDMOS 晶体管的自热效应评价方法以及自热效应评价系统	ZL201510547846.1	中芯上海	2015-08-31	2019-05-28	原始取得	无
5167	套刻精度补偿方法	ZL201510547980.1	中芯上海	2015-08-31	2018-08-10	原始取得	无
5168	鳍片式半导体器件及其制造方法	ZL201510551016.6	中芯上海、中芯北京	2015-09-01	2019-11-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5169	鳍式场效应管的形成方法	ZL201510555549.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-02	2019-07-02	原始取得	无
5170	封装芯片失效分析样品及其制备方法	ZL201510559204.3	中芯天津、中芯上海	2015-09-06	2019-08-27	原始取得	无
5171	提高关键尺寸精确性的方法	ZL201510559205.8	中芯天津、中芯上海	2015-09-06	2019-12-27	原始取得	无
5172	晶圆运载箱及其制备方法	ZL201510559271.5	中芯天津、中芯上海	2015-09-06	2019-05-03	原始取得	无
5173	光刻失焦的检测方法	ZL201510561068.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-06	2019-04-19	原始取得	无
5174	离子形成容器以及离子源	ZL201510561097.8	中芯上海、中芯北京	2015-09-06	2019-01-25	原始取得	无
5175	硅通孔结构的制备方法	ZL201510561098.2	中芯上海、中芯北京	2015-09-06	2019-07-26	原始取得	无
5176	一种铜互连结构的制作方法、铜互连结构及电子装置	ZL201510563368.3	中芯上海、中芯北京	2015-09-07	2019-12-31	原始取得	无
5177	电压探测电路以及上电复位电路	ZL201510564040.3	中芯上海、中芯北京	2015-09-07	2019-04-19	原始取得	无
5178	半导体器件的制备方法	ZL201510564057.9	中芯上海、中芯北京	2015-09-07	2019-04-19	原始取得	无
5179	检测晶圆中铁含量异常的装置及其方法	ZL201510564059.8	中芯上海、中芯北京	2015-09-07	2019-05-03	原始取得	无
5180	回流机台腔体的清洗方法	ZL201510565776.2	中芯上海	2015-09-07	2019-05-03	原始取得	无
5181	一种 EEPROM 存储器件及其制备方法、电子装置	ZL201510566157.5	中芯上海、中芯北京	2015-09-08	2019-09-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5182	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510566198.4	中芯上海、中芯北京	2015-09-08	2019-09-27	原始取得	无
5183	芯片封装结构及其制作方法、静电粉末喷涂装置	ZL201510567125.7	中芯天津、中芯上海	2015-09-07	2019-02-22	原始取得	无
5184	半导体器件的制备方法	ZL201510567541.7	中芯天津、中芯上海	2015-09-07	2019-07-23	原始取得	无
5185	半导体结构及其形成方法	ZL201510570274.9	中芯天津、中芯上海	2015-09-08	2019-08-27	原始取得	无
5186	LDMOS 晶体管的自热效应评价方法以及自热效应评价系统	ZL201510570375.6	中芯上海	2015-09-09	2019-05-28	原始取得	无
5187	一体式旋转结构动平衡的修正装置和修正方法	ZL201510570722.5	中芯上海	2015-09-09	2018-02-16	原始取得	无
5188	浅沟槽隔离结构及其形成方法、CMOS 图像传感器	ZL201510571223.8	中芯天津、中芯上海	2015-09-08	2019-11-01	原始取得	无
5189	用于光源-掩膜优化的图形选择方法	ZL201510572327.0	中芯上海	2015-09-10	2019-09-03	原始取得	无
5190	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510573964.X	中芯上海、中芯北京	2015-09-10	2019-09-03	原始取得	无
5191	半导体器件及其形成方法	ZL201510612767.4	中芯上海、中芯北京	2015-09-23	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5192	一种用于 ESD 防护的栅控二极管	ZL201510613288.4	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-07-26	原始取得	无
5193	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510615428.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-07-26	原始取得	无
5194	晶圆键合方法	ZL201510615665.8	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-03-29	原始取得	无
5195	半导体器件及其形成方法	ZL201510615851.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-11-05	原始取得	无
5196	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510615977.9	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-09-27	原始取得	无
5197	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510615979.8	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-12-24	原始取得	无
5198	侦测金属离子沾污的方法	ZL201510616402.9	中芯上海、中芯北京	2015-09-24	2019-05-28	原始取得	无
5199	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510618400.3	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-07-26	原始取得	无
5200	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510618421.5	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-12-24	原始取得	无
5201	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510621562.2	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-09-03	原始取得	无
5202	一种 FinFET 器件接触电阻的	ZL201510621766.6	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-09-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	测量结构及测量方法、电子装置						
5203	一种 ESD 布局结构、电子装置	ZL201510621797.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-05-17	原始取得	无
5204	金属电极结构的制造方法	ZL201510621880.9	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2018-06-29	原始取得	无
5205	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510623123.5	中芯上海、中芯北京	2015-09-25	2019-09-03	原始取得	无
5206	半导体器件的形成方法	ZL201510631673.1	中芯上海、中芯北京	2015-09-29	2019-05-28	原始取得	无
5207	半导体结构及其形成方法	ZL201510631720.2	中芯上海、中芯北京	2015-09-29	2019-07-02	原始取得	无
5208	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510631734.4	中芯上海、中芯北京	2015-09-29	2019-07-05	原始取得	无
5209	半导体结构及其形成方法	ZL201510640874.8	中芯上海、中芯北京	2015-09-30	2019-11-01	原始取得	无
5210	光刻照明系统以及光刻设备	ZL201510642571.X	中芯上海	2015-09-30	2019-04-26	原始取得	无
5211	测试结构及其形成方法、测试方法	ZL201510642572.4	中芯上海、中芯北京	2015-09-30	2019-05-28	原始取得	无
5212	MOS 晶体管的形成方法	ZL201510642573.9	中芯上海、中芯北京	2015-09-30	2019-09-27	原始取得	无
5213	上电复位电路和方法	ZL201510646620.7	中芯上海、中芯北京	2015-10-09	2019-07-02	原始取得	无
5214	半导体结构的形成方法	ZL201510653680.1	中芯上海、中芯北京	2015-10-10	2019-07-30	原始取得	无
5215	硅通孔的测试器件及其测试	ZL201510653699.6	中芯上海、中芯北京	2015-10-10	2019-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
5216	用于自对准双重构图的方法及半导体器件的制造方法	ZL201510661320.6	中芯上海、中芯北京	2015-10-14	2019-09-03	原始取得	无
5217	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510661897.7	中芯上海、中芯北京	2015-10-14	2019-09-03	原始取得	无
5218	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510661899.6	中芯上海、中芯北京	2015-10-14	2019-10-25	原始取得	无
5219	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510661906.2	中芯上海、中芯北京	2015-10-14	2019-07-26	原始取得	无
5220	一种密封环结构及电子装置	ZL201510665797.1	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-05-17	原始取得	无
5221	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510665802.9	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-09-03	原始取得	无
5222	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510666124.8	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-09-03	原始取得	无
5223	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201510666379.4	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-09-27	原始取得	无
5224	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510666466.X	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-12-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5225	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510666567.7	中芯上海、中芯北京	2015-10-15	2019-09-27	原始取得	无
5226	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510669883.X	中芯上海、中芯北京	2015-10-13	2019-07-26	原始取得	无
5227	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201510669891.4	中芯上海、中芯北京	2015-10-13	2019-12-31	原始取得	无
5228	一种嵌入式闪存及其制造方法和电子装置	ZL201510670125.X	中芯上海、中芯北京	2015-10-13	2019-09-03	原始取得	无
5229	用于监测光刻机成像平面异常的方法	ZL201510672885.4	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-03-08	原始取得	无
5230	一种半导体器件和电子装置	ZL201510672891.X	中芯上海、中芯宁波	2015-10-16	2019-04-09	原始取得	无
5231	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510672970.0	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-10-25	原始取得	无
5232	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510672973.4	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-09-27	原始取得	无
5233	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510673706.9	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-10-25	原始取得	无
5234	一种半导体器件及其制备方	ZL201510673877.1	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-10-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
5235	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510674342.6	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-10-25	原始取得	无
5236	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510674345.X	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-09-27	原始取得	无
5237	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510675632.2	中芯上海、中芯北京	2015-10-16	2019-09-27	原始取得	无
5238	NMOS 器件、半导体装置及其制造方法	ZL201510676869.2	中芯上海、中芯北京	2015-10-19	2019-09-20	原始取得	无
5239	一种阻挡型化学机械研磨垫及研磨装置	ZL201510690195.1	中芯上海、中芯北京	2015-10-22	2019-01-22	原始取得	无
5240	半导体结构的形成方法	ZL201510702088.6	中芯上海、中芯北京	2015-10-26	2019-12-03	原始取得	无
5241	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510702090.3	中芯上海、中芯北京	2015-10-26	2019-07-02	原始取得	无
5242	半导体结构的形成方法	ZL201510703668.7	中芯上海、中芯北京	2015-10-26	2019-11-05	原始取得	无
5243	曝光工艺的检验方法、检验系统及测试掩膜板	ZL201510703676.1	中芯上海、中芯北京	2015-10-26	2019-12-31	原始取得	无
5244	电熔丝位单元及其读、写方法	ZL201510707364.8	中芯上海、中芯北京	2015-10-27	2019-12-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	和电熔丝阵列						
5245	改善核心器件和输入输出器件性能的方法	ZL201510736925.7	中芯上海、中芯北京	2015-11-03	2019-07-02	原始取得	无
5246	改善半导体结构漏电流的方法	ZL201510740744.1	中芯上海、中芯北京	2015-11-04	2019-08-27	原始取得	无
5247	鳍式场效应管的形成方法	ZL201510741802.2	中芯上海、中芯北京	2015-11-04	2019-11-01	原始取得	无
5248	半导体器件的可靠性测试结构及其测试方法	ZL201510746428.5	中芯上海、中芯北京	2015-11-05	2019-09-27	原始取得	无
5249	半导体结构的制造方法	ZL201510746439.3	中芯上海、中芯北京	2015-11-05	2019-11-01	原始取得	无
5250	半导体结构的制造方法	ZL201510749620.X	中芯上海、中芯北京	2015-11-05	2019-11-01	原始取得	无
5251	存储装置	ZL201510750357.6	中芯上海	2015-11-06	2019-04-26	原始取得	无
5252	互连结构的形成方法	ZL201510817979.6	中芯上海、中芯北京	2015-11-23	2019-11-01	原始取得	无
5253	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510818102.9	中芯上海、中芯北京	2015-11-23	2019-11-01	原始取得	无
5254	存储器的控制方法及装置	ZL201510824800.X	中芯上海、中芯北京	2015-11-24	2019-12-03	原始取得	无
5255	一种等离子体处理装置	ZL201510837495.8	中芯上海、中芯北京	2015-11-26	2019-01-22	原始取得	无
5256	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510846048.9	中芯上海、中芯北京	2015-11-27	2019-12-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5257	一种等离子体处理装置	ZL201510846236.1	中芯上海、中芯北京	2015-11-27	2019-10-25	原始取得	无
5258	一种半导体器件的制造方法	ZL201510854196.5	中芯上海、中芯北京	2015-11-27	2019-09-27	原始取得	无
5259	半导体结构的形成方法	ZL201510868767.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-01	2019-11-05	原始取得	无
5260	半导体结构和 CMOS 晶体管的形成方法	ZL201510870357.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-01	2019-11-05	原始取得	无
5261	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510875811.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-02	2019-07-30	原始取得	无
5262	半导体结构的形成方法	ZL201510875812.5	中芯上海、中芯北京	2015-12-02	2019-07-30	原始取得	无
5263	SACVD 腔室的清洁方法	ZL201510881898.2	中芯上海、中芯北京	2015-12-03	2019-08-27	原始取得	无
5264	半导体器件的形成方法	ZL201510881899.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-03	2019-09-27	原始取得	无
5265	一种堆叠电容器的制作方法	ZL201510887802.3	中芯上海、中芯北京	2015-12-04	2019-12-03	原始取得	无
5266	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510887996.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-04	2019-11-05	原始取得	无
5267	半导体器件以及改善半导体器件性能的方法	ZL201510896813.8	中芯上海、中芯北京	2015-12-07	2019-09-27	原始取得	无
5268	半导体结构的形成方法	ZL201510904212.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-11-05	原始取得	无
5269	晶体管及其形成方法	ZL201510904217.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-09-27	原始取得	无
5270	半导体结构的形成方法	ZL201510904219.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5271	电感结构及其形成方法	ZL201510906559.5	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-04-26	原始取得	无
5272	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510906567.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-11-29	原始取得	无
5273	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201510906921.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-12-31	原始取得	无
5274	半导体结构及其形成方法	ZL201510906938.4	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-11-01	原始取得	无
5275	电感结构及其制作方法	ZL201510907939.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2018-10-16	原始取得	无
5276	一种腔体温度检测方法	ZL201510908262.2	中芯上海、中芯北京	2015-12-09	2019-09-13	原始取得	无
5277	电容式指纹传感器及其形成方法和电子产品	ZL201510916676.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-10	2019-04-26	原始取得	无
5278	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL201510916698.6	中芯上海、中芯北京	2015-12-10	2019-07-30	原始取得	无
5279	半导体结构的制作方法	ZL201510916709.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-10	2019-11-05	原始取得	无
5280	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510919587.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-09-27	原始取得	无
5281	半导体测试结构及应力迁移测试方法	ZL201510923178.8	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-05-28	原始取得	无
5282	射频识别中的限幅电路及射	ZL201510923204.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-12-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	频识别标签						
5283	半导体结构的制造方法	ZL201510923214.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-12-03	原始取得	无
5284	一种超级电容电池及其制造方法	ZL201510924181.1	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-04-09	原始取得	无
5285	具有不对称结构的晶体管的形成方法	ZL201510926288.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-11	2019-11-01	原始取得	无
5286	一种半导体器件的制造方法	ZL201510939766.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-15	2019-12-17	原始取得	无
5287	一种半导体器件的制造方法	ZL201510943662.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-15	2019-09-27	原始取得	无
5288	晶圆边缘所受冲击力的监测方法以及设备调整方法	ZL201510960366.8	中芯天津、中芯上海	2015-12-18	2019-08-27	原始取得	无
5289	芯片保护环、半导体芯片、半导体晶圆及封装方法	ZL201510960946.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-18	2019-05-03	原始取得	无
5290	产品验收系统及产品验收方法	ZL201510960988.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-18	2019-12-27	原始取得	无
5291	产品的批优先级调整装置及调整方法	ZL201510961048.3	中芯上海、中芯北京	2015-12-18	2019-05-03	原始取得	无
5292	一种半导体器件及其制造方法、电子装置	ZL201510970671.5	中芯上海、中芯北京	2015-12-21	2019-12-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5293	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510974153.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-22	2019-06-28	原始取得	无
5294	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510974154.5	中芯上海、中芯北京	2015-12-22	2018-09-25	原始取得	无
5295	一种 FinFET 器件的自加热测量结构及测量方法、电子装置	ZL201510974176.1	中芯上海、中芯北京	2015-12-22	2019-07-26	原始取得	无
5296	静电保护电路	ZL201510974300.4	中芯天津、中芯上海	2015-12-18	2019-01-18	原始取得	无
5297	一种介电层及互连结构的制作方法、半导体器件	ZL201510976482.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-10-25	原始取得	无
5298	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510976484.8	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2018-09-21	原始取得	无
5299	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201510976485.2	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-12-17	原始取得	无
5300	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201510976848.2	中芯上海、中芯宁波	2015-12-23	2019-11-08	原始取得	无
5301	一种半导体器件及其制造方法	ZL201510976849.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-12-17	原始取得	无
5302	一种半导体器件及其制备方	ZL201510979120.5	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-12-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
5303	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201510980329.3	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-06-28	原始取得	无
5304	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510980336.3	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-07-26	原始取得	无
5305	一种低噪声放大器	ZL201510981252.1	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-06-28	原始取得	无
5306	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201510981254.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-23	2019-10-25	原始取得	无
5307	用于透射电子显微镜俯视观察的芯片样品制备方法	ZL201510982438.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-24	2019-09-27	原始取得	无
5308	鳍式晶体管的形成方法	ZL201510993741.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-25	2019-12-03	原始取得	无
5309	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201510995347.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-25	2019-11-05	原始取得	无
5310	静电放电保护结构及其形成方法	ZL201510995357.2	中芯上海、中芯北京	2015-12-25	2019-12-03	原始取得	无
5311	鳍部掺杂方法及鳍式场效应晶体管的制作方法	ZL201511003228.7	中芯上海、中芯北京	2015-12-28	2019-09-27	原始取得	无
5312	金属栅晶体管源漏区接触塞	ZL201511003230.4	中芯上海、中芯北京	2015-12-28	2019-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的制作方法						
5313	MEMS 器件、MEMS 温度传感器及各自的制作方法	ZL201511005347.6	中芯上海、中芯北京	2015-12-28	2019-09-27	原始取得	无
5314	半导体器件的形成方法	ZL201511025300.6	中芯上海、中芯北京	2015-12-30	2019-07-02	原始取得	无
5315	半导体结构及其形成方法	ZL201511025312.9	中芯上海、中芯北京	2015-12-30	2019-11-01	原始取得	无
5316	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201511025328.X	中芯上海、中芯北京	2015-12-30	2019-09-27	原始取得	无
5317	半导体器件的形成方法	ZL201511025332.6	中芯上海、中芯北京	2015-12-30	2019-12-31	原始取得	无
5318	一种 MEMS 压力传感器及其制备方法、电子装置	ZL201511029874.0	中芯上海、中芯北京	2015-12-31	2019-09-27	原始取得	无
5319	氮化钛的形成方法	ZL201610003779.1	中芯上海、中芯北京	2016-01-04	2019-01-22	原始取得	无
5320	波导及其形成方法	ZL201610005308.4	中芯上海、中芯北京	2016-01-05	2019-12-31	原始取得	无
5321	快闪存储器及其制作方法	ZL201610005514.5	中芯上海、中芯北京	2016-01-05	2019-11-01	原始取得	无
5322	鳍式半导体器件的形成方法	ZL201610006596.5	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-11-01	原始取得	无
5323	多阈值电压鳍式晶体管的形成方法	ZL201610006598.4	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-11-01	原始取得	无
5324	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201610006616.9	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-11-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5325	取样量测系统及其取样量测方法	ZL201610006634.7	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-09-27	原始取得	无
5326	半导体结构的形成方法	ZL201610006670.3	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-11-05	原始取得	无
5327	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201610006672.2	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-12-03	原始取得	无
5328	半导体结构及其形成方法	ZL201610006673.7	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-11-01	原始取得	无
5329	半导体结构及其形成方法	ZL201610006691.5	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-05-28	原始取得	无
5330	获得绝缘层厚度的方法以及晶圆级键合封装方法	ZL201610006695.3	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-12-31	原始取得	无
5331	半导体结构的制备方法	ZL201610006707.2	中芯上海、中芯北京	2016-01-06	2019-07-26	原始取得	无
5332	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201610007847.1	中芯上海、中芯北京	2016-01-07	2019-09-27	原始取得	无
5333	一种 CMOS 图像传感器的制造方法	ZL201610008022.1	中芯上海、中芯北京	2016-01-07	2019-11-01	原始取得	无
5334	石墨烯场效应晶体管及其形成方法	ZL201610008855.8	中芯上海、中芯北京	2016-01-07	2019-12-03	原始取得	无
5335	鳍式场效应管的形成方法	ZL201610008863.2	中芯上海、中芯北京	2016-01-07	2019-11-01	原始取得	无
5336	一种半导体器件及其制造方	ZL201610009948.2	中芯上海、中芯北京	2016-01-08	2019-10-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
5337	分离栅快闪存储单元互连的制作方法	ZL201610011593.0	中芯上海	2016-01-08	2019-10-22	原始取得	无
5338	一种 MEMS 器件及其制造方法和电子装置	ZL201610011755.0	中芯上海、中芯北京	2016-01-08	2019-09-27	原始取得	无
5339	双重图形化的方法	ZL201610011927.4	中芯上海、中芯北京	2016-01-08	2019-09-27	原始取得	无
5340	一种半导体器件及其制作方法、电子装置	ZL201610014814.X	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-10-29	原始取得	无
5341	晶体管及其形成方法	ZL201610015637.7	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-12-03	原始取得	无
5342	NMOS 晶体管及其形成方法	ZL201610015638.1	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-12-03	原始取得	无
5343	低压差线性稳压器	ZL201610015656.X	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2018-07-10	原始取得	无
5344	基于衍射的套刻测量标记、套刻测量方法和测量装置	ZL201610016077.7	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-07-02	原始取得	无
5345	静电保护器件及其形成方法	ZL201610016114.4	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-07-02	原始取得	无
5346	鳍部的形成方法和鳍式场效应管的形成方法	ZL201610016115.9	中芯上海、中芯北京	2016-01-11	2019-11-05	原始取得	无
5347	参考电压发生装置	ZL201610016282.3	中芯上海、中芯北京	2016-01-12	2019-08-27	原始取得	无
5348	一种半导体器件及其制作方	ZL201610017721.2	中芯上海、中芯北京	2016-01-12	2019-12-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法、电子装置						
5349	半导体器件失效分析样品及其制备方法、失效分析方法	ZL201610020339.7	中芯天津、中芯上海	2016-01-13	2019-08-27	原始取得	无
5350	一种半导体器件及其制造方法	ZL201610020744.9	中芯上海、中芯宁波	2016-01-13	2019-12-24	原始取得	无
5351	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201610023885.6	中芯上海、中芯北京	2016-01-14	2019-06-28	原始取得	无
5352	一种 CMOS 图像传感器及其制作方法	ZL201610025386.0	中芯上海、中芯北京	2016-01-15	2019-10-25	原始取得	无
5353	一种半导体器件以及制备方法、电子装置	ZL201610039853.5	中芯上海、中芯北京	2016-01-21	2019-12-17	原始取得	无
5354	相变存储器及其制造方法和电子设备	ZL201610044348.X	中芯上海、中芯北京	2016-01-22	2019-11-26	原始取得	无
5355	带隙基准电路	ZL201610044755.0	中芯上海、中芯北京	2016-01-22	2018-10-16	原始取得	无
5356	一种半导体器件及其检测结构、电子装置	ZL201610048652.1	中芯上海、中芯北京	2016-01-25	2019-10-25	原始取得	无
5357	半导体装置及其制造方法	ZL201610073071.3	中芯上海、中芯北京	2016-02-02	2019-11-01	原始取得	无
5358	半导体结构及包含所述半导	ZL201610078036.0	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-10-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	体结构的传声器的制备方法						
5359	掩膜组件及对准量测方法	ZL201610078404.1	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-03-22	原始取得	无
5360	半导体结构的形成方法	ZL201610079378.4	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5361	半导体结构的形成方法	ZL201610079397.7	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5362	标记结构的形成方法	ZL201610079408.1	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-01-29	原始取得	无
5363	离子注入测试样品的制备方法及测试方法	ZL201610079576.0	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5364	存储单元及其形成方法	ZL201610079607.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5365	晶体管的形成方法	ZL201610079609.1	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-12-03	原始取得	无
5366	半导体结构的形成方法	ZL201610079616.1	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5367	追踪电路及静态随机存取存储器	ZL201610079638.8	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-05-28	原始取得	无
5368	半导体器件的形成方法	ZL201610079660.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-07-02	原始取得	无
5369	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201610079724.9	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-12-03	原始取得	无
5370	非易失性存储电路及其读、写、存储和恢复方法	ZL201610079734.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-09-27	原始取得	无
5371	电容器件及其形成方法	ZL201610079741.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-03	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5372	半导体结构及其形成方法	ZL201610080746.7	中芯上海、中芯北京	2016-02-04	2019-11-05	原始取得	无
5373	半导体结构及其形成方法	ZL201610080796.5	中芯上海、中芯北京	2016-02-04	2019-05-28	原始取得	无
5374	半导体结构及其形成方法	ZL201610081033.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-04	2019-12-31	原始取得	无
5375	半导体结构的形成方法	ZL201610082716.X	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-11-01	原始取得	无
5376	晶体管的形成方法	ZL201610082752.6	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-11-01	原始取得	无
5377	半导体结构的形成方法	ZL201610082753.0	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-09-27	原始取得	无
5378	静电放电保护器件和集成电路	ZL201610083829.1	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-12-03	原始取得	无
5379	电迁移测试装置、电迁移测试系统及其测试方法	ZL201610083841.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-12-03	原始取得	无
5380	静电放电保护结构及其形成方法	ZL201610083844.6	中芯上海、中芯北京	2016-02-05	2019-08-27	原始取得	无
5381	半导体器件的制造方法	ZL201610085604.X	中芯天津、中芯上海	2016-02-15	2019-02-22	原始取得	无
5382	一种电流偏置电路	ZL201610113200.7	中芯上海、中芯北京	2016-02-29	2018-12-21	原始取得	无
5383	半导体器件的形成方法	ZL201610128530.3	中芯上海、中芯北京	2016-03-07	2019-08-27	原始取得	无
5384	鳍式场效应晶体管的形成方法	ZL201610130609.X	中芯上海、中芯北京	2016-03-08	2019-12-31	原始取得	无
5385	静电放电保护器件及其形成	ZL201610134352.5	中芯上海、中芯北京	2016-03-09	2019-05-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
5386	半导体结构及其形成方法	ZL201610134369.0	中芯上海、中芯北京	2016-03-09	2019-12-03	原始取得	无
5387	隔离结构的形成方法和半导体结构的形成方法	ZL201610134386.4	中芯上海、中芯北京	2016-03-09	2019-11-01	原始取得	无
5388	形成具有扩展空气间隙的半导体器件的方法	ZL201610178733.3	中芯上海、中芯北京	2016-03-25	2019-11-01	原始取得	无
5389	一种稳压电路及电子装置	ZL201610182160.1	中芯上海、中芯北京	2016-03-28	2019-01-18	原始取得	无
5390	半导体器件及其制造方法	ZL201610185826.9	中芯上海	2012-09-24	2019-05-03	原始取得	无
5391	静电放电 ESD 保护器件和半导体装置	ZL201610185829.2	中芯上海、中芯北京	2016-03-29	2019-09-20	原始取得	无
5392	半导体器件及其形成方法	ZL201610192692.3	中芯上海、中芯北京	2016-03-30	2019-11-01	原始取得	无
5393	用于预测芯片高温操作寿命的方法及装置	ZL201610196265.2	中芯上海、中芯北京	2016-03-31	2019-12-31	原始取得	无
5394	测试结构及其测试方法	ZL201610208066.9	中芯上海、中芯北京	2016-04-05	2019-12-03	原始取得	无
5395	半导体结构及其形成方法	ZL201610210757.2	中芯上海、中芯北京	2016-04-06	2019-12-31	原始取得	无
5396	半导体结构及其形成方法和检测方法	ZL201610210758.7	中芯上海、中芯北京	2016-04-06	2019-12-31	原始取得	无
5397	一种带隙基准电路	ZL201610213319.1	中芯上海、中芯北京	2016-04-07	2018-11-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5398	检测样品的制备方法和检测方法	ZL201610213349.2	中芯上海、中芯北京	2016-04-07	2019-12-03	原始取得	无
5399	LDO 上下电次序控制电路及供电装置	ZL201610213365.1	中芯上海、中芯北京	2016-04-07	2019-01-22	原始取得	无
5400	机台控制方法和机台控制系统	ZL201610213591.X	中芯上海、中芯北京	2016-04-07	2019-08-27	原始取得	无
5401	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201610216320.X	中芯上海、中芯北京	2016-04-08	2019-12-17	原始取得	无
5402	软启动电路及其复位信号产生电路	ZL201610216922.5	中芯上海、中芯北京	2016-04-08	2019-07-02	原始取得	无
5403	片上变压器巴伦	ZL201610221561.3	中芯上海、中芯北京	2016-04-11	2019-04-26	原始取得	无
5404	参考电压产生电路	ZL201610236347.5	中芯上海、中芯北京	2016-04-15	2018-11-16	原始取得	无
5405	光刻设备的微粒检测方法	ZL201610236693.3	中芯上海	2016-04-15	2019-09-17	原始取得	无
5406	相变存储器的制备方法	ZL201610240350.4	中芯上海	2016-04-18	2019-11-26	原始取得	无
5407	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201610240551.4	中芯上海、中芯北京	2016-04-18	2019-10-25	原始取得	无
5408	一种 MEMS 器件及其制备方法、电子装置	ZL201610240785.9	中芯上海、中芯北京	2016-04-18	2019-06-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5409	半导体器件的制备方法	ZL201610256875.7	中芯上海、中芯北京	2016-04-22	2019-11-26	原始取得	无
5410	一种半导体器件封装结构和电子装置	ZL201610268504.0	中芯上海、中芯北京	2016-04-27	2019-12-24	原始取得	无
5411	一种半导体结构的制作方法	ZL201610270102.4	中芯上海、中芯北京	2016-04-27	2019-09-24	原始取得	无
5412	套刻测量系统以及测量套刻精度的方法	ZL201610274369.0	中芯上海、中芯北京	2016-04-28	2019-01-22	原始取得	无
5413	模拟信号检测系统和模拟信号检测方法	ZL201610274375.6	中芯上海、中芯北京	2016-04-28	2019-11-01	原始取得	无
5414	改善半导体器件性能的方法	ZL201610293059.3	中芯上海、中芯北京	2016-05-05	2019-09-27	原始取得	无
5415	半导体结构及其制造方法	ZL201610297864.3	中芯上海、中芯北京	2016-05-06	2019-09-27	原始取得	无
5416	对准方法及对准系统	ZL201610309546.4	中芯上海、中芯北京	2016-05-11	2019-02-15	原始取得	无
5417	多阈值电压晶体管及其形成方法	ZL201610309549.8	中芯上海、中芯北京	2016-05-11	2019-12-31	原始取得	无
5418	一种半导体器件及制备方法、电子装置	ZL201610312168.5	中芯上海、中芯北京	2016-05-12	2019-09-03	原始取得	无
5419	电荷泄放电路	ZL201610318329.1	中芯天津、中芯上海	2016-05-13	2019-12-27	原始取得	无
5420	计算存储盒搬运距离的系统及方法	ZL201610338846.5	中芯上海、中芯北京	2016-05-20	2019-12-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5421	半导体器件的制备方法	ZL201610341694.4	中芯天津、中芯上海	2016-05-20	2019-12-27	原始取得	无
5422	一种带隙基准电压电路及其控制方法	ZL201610345155.8	中芯上海、中芯北京	2016-05-23	2019-09-27	原始取得	无
5423	用于检测电源电压的系统	ZL201610357282.X	中芯上海、中芯北京	2016-05-26	2019-01-22	原始取得	无
5424	半导体器件的形成方法	ZL201610364782.6	中芯上海、中芯北京	2016-05-27	2019-11-01	原始取得	无
5425	半导体结构的形成方法	ZL201610365162.4	中芯上海、中芯北京	2016-05-27	2019-11-05	原始取得	无
5426	半导体装置及其制造方法	ZL201610379443.5	中芯上海、中芯北京	2016-06-01	2019-11-01	原始取得	无
5427	半导体结构及其制造方法	ZL201610388842.8	中芯上海、中芯北京	2016-06-02	2019-11-26	原始取得	无
5428	一种半导体器件及其制作方法和电子装置	ZL201610403030.6	中芯上海、中芯北京	2016-06-08	2019-12-17	原始取得	无
5429	半导体结构的制造方法	ZL201610404103.3	中芯上海、中芯北京	2016-06-08	2019-09-27	原始取得	无
5430	半导体结构及其形成方法和水印识别方法	ZL201610407328.4	中芯上海、中芯北京	2016-06-12	2019-11-01	原始取得	无
5431	半导体结构及其制造方法	ZL201610407359.X	中芯上海、中芯北京	2016-06-12	2019-12-31	原始取得	无
5432	半导体结构及其制造方法	ZL201610407517.1	中芯上海、中芯北京	2016-06-12	2019-12-03	原始取得	无
5433	电压电流转换电路	ZL201610407623.X	中芯上海、中芯北京	2016-06-12	2019-11-05	原始取得	无
5434	研磨垫修整器及研磨垫修整方法	ZL201610410692.6	中芯天津、中芯上海	2016-06-08	2019-12-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5435	半导体器件的形成方法	ZL201610424879.1	中芯上海、中芯北京	2016-06-15	2019-11-05	原始取得	无
5436	一种半导体器件及其制作方法	ZL201610458068.3	中芯上海、中芯北京	2016-06-22	2019-12-17	原始取得	无
5437	半导体器件的形成方法	ZL201610518861.8	中芯上海、中芯北京	2016-07-04	2019-07-02	原始取得	无
5438	半导体结构及其形成方法和光刻偏移的测量方法	ZL201610518877.9	中芯上海、中芯北京	2016-07-04	2019-11-01	原始取得	无
5439	鳍式场效应管的形成方法	ZL201610527809.9	中芯上海、中芯北京	2016-07-06	2019-12-31	原始取得	无
5440	半导体结构的形成方法	ZL201610531691.7	中芯上海、中芯北京	2016-07-07	2019-11-01	原始取得	无
5441	测试结构以及测试方法	ZL201610531759.1	中芯上海、中芯北京	2016-07-07	2019-12-03	原始取得	无
5442	半导体器件的形成方法	ZL201610536743.X	中芯上海	2013-04-28	2019-01-22	原始取得	无
5443	用于温度测量的半导体结构和温度测量方法	ZL201610620959.4	中芯上海、中芯北京	2016-08-02	2019-07-26	原始取得	无
5444	反熔丝结构、半导体器件及电子装置	ZL201610716528.8	中芯上海、中芯北京	2016-08-24	2019-12-10	原始取得	无
5445	一种半导体晶圆移送装置及移送半导体晶圆的方法	ZL201610939543.9	中芯上海、中芯北京	2016-10-25	2019-12-24	原始取得	无
5446	变压器	ZL201610942121.7	中芯上海、中芯北京	2016-11-01	2019-11-01	原始取得	无
5447	一种 MEMS 器件及其制造方	ZL201610949826.1	中芯上海、中芯北京	2016-11-02	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
5448	设备安全监测系统及方法	ZL201610976941.8	中芯上海、中芯北京	2016-11-07	2019-12-27	原始取得	无
5449	鳍式场效应管的形成方法	ZL201610980549.0	中芯上海、中芯北京	2016-11-08	2019-12-03	原始取得	无
5450	运算放大器电路及带隙基准源	ZL201610982393.X	中芯上海、中芯北京	2016-11-08	2019-12-03	原始取得	无
5451	半导体结构及其制造方法	ZL201611001696.5	中芯上海、中芯北京	2016-11-11	2019-09-27	原始取得	无
5452	化学机械抛光设备和化学机械抛光方法	ZL201611066947.8	中芯上海、中芯北京	2016-11-29	2019-11-29	原始取得	无
5453	一种半导体器件及其制备方法、电子装置	ZL201611067310.0	中芯上海、中芯北京	2016-11-28	2019-12-17	原始取得	无
5454	半导体结构及其形成方法	ZL201611067425.X	中芯上海、中芯北京	2016-11-28	2019-11-01	原始取得	无
5455	半导体结构及其制造方法	ZL201611073169.5	中芯上海、中芯北京	2016-11-29	2019-07-02	原始取得	无
5456	改善 MIM 电容器电弧放电缺陷的方法	ZL201611073794.X	中芯上海、中芯北京	2016-11-29	2019-12-27	原始取得	无
5457	SRAM 器件及其制造方法	ZL201611081243.8	中芯上海、中芯北京	2016-11-30	2019-09-27	原始取得	无
5458	半导体器件及其形成方法	ZL201611082506.7	中芯上海、中芯北京	2016-11-30	2019-09-27	原始取得	无
5459	SRAM 器件及其制造方法	ZL201611082508.6	中芯上海、中芯北京	2016-11-30	2019-11-01	原始取得	无
5460	半导体结构及其形成方法	ZL201611089174.5	中芯上海、中芯北京	2016-11-30	2019-12-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5461	半导体装置及其制造方法	ZL201710027198.6	中芯上海、中芯北京	2017-01-16	2019-12-13	原始取得	无
5462	一种熔丝结构及电子装置	ZL201710060330.3	中芯上海、中芯北京	2017-01-24	2019-12-24	原始取得	无
5463	曝光目标图形的修正方法	ZL201710073602.3	中芯上海	2013-12-30	2019-01-22	原始取得	无
5464	半导体结构及其形成方法	ZL201710087343.X	中芯上海、中芯北京	2017-02-17	2019-12-31	原始取得	无
5465	电熔丝结构及其形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201710516564.4	中芯上海	2013-05-22	2019-11-01	原始取得	无
5466	凸块结构、封装组件及其形成方法	ZL201510549539.7	中芯长电	2015-08-31	2019-03-01	原始取得	无
5467	一种芯片封装方法	ZL201510575637.8	中芯长电	2015-09-10	2019-02-10	原始取得	无
5468	一种封装结构及再分布引线层的制作方法	ZL201510595988.5	中芯长电	2015-09-17	2019-03-01	原始取得	无
5469	一种芯片封装结构及封装方法	ZL201510618538.3	中芯长电	2015-09-24	2019-01-11	原始取得	无
5470	焊料层的体积测量方法	ZL201510621605.7	中芯长电	2015-09-24	2019-01-11	原始取得	无
5471	一种铜柱凸块结构的制作方法	ZL201510738820.5	中芯长电	2015-11-03	2018-05-04	原始取得	无
5472	一种扇出型封装结构及其制作方法	ZL201510741725.0	中芯长电	2015-11-03	2019-01-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5473	一种铜柱凸块封装结构及其制作方法	ZL201510976588.9	中芯长电	2015-12-23	2019-02-15	原始取得	无
5474	一种铜柱凸点的封装方法及封装结构	ZL201610029829.3	中芯长电	2016-01-15	2019-02-15	原始取得	无
5475	一种扇出型芯片的封装方法及封装结构	ZL201610046292.1	中芯长电	2016-01-22	2019-01-25	原始取得	无
5476	一种用于堆叠式封装的铜针结构及其制备方法	ZL201610301929.7	中芯长电	2016-05-09	2019-05-07	原始取得	无
5477	一种近间距铜针封装结构及其制备方法	ZL201610302068.4	中芯长电	2016-05-09	2018-12-04	原始取得	无
5478	一种扇出型封装结构及其封装方法	ZL201610302513.7	中芯长电	2016-05-09	2019-01-04	原始取得	无
5479	集成有供电传输系统的封装件的封装方法	ZL201710124498.6	中芯长电	2017-03-03	2019-06-18	原始取得	无
5480	集成有供电传输系统的封装件的封装方法	ZL201710124760.7	中芯长电	2017-03-03	2018-09-07	原始取得	无
5481	集成有功率传输芯片的封装结构的封装方法	ZL201710172466.3	中芯长电	2017-03-22	2019-11-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5482	集成有功率传输芯片的封装结构的封装方法	ZL201710172468.2	中芯长电	2017-03-22	2018-10-19	原始取得	无
5483	一种改善边缘形貌的成型方法	ZL201710403482.9	中芯长电	2017-06-01	2019-08-13	原始取得	无
5484	一种凸块缺陷检测方法	ZL201710411744.6	中芯长电	2017-06-05	2019-10-01	原始取得	无
5485	指纹识别芯片的封装结构及封装方法	ZL201710801546.0	中芯长电	2017-09-07	2019-11-15	原始取得	无
5486	应变半导体 CMOS 晶体管的制造结构和方法	ZL200480021901.3	中芯国际	2004-08-04	2008-10-22	继受取得	无
5487	能够改善等离子体诱导损伤的半导体器件及其制造方法	ZL201110262629.X	中芯北京	2011-09-07	2017-6-16	原始取得	无
5488	用于处理晶圆的反应装置、静电吸盘和晶圆温度控制方法	ZL201110434708.4	中芯北京	2011-12-22	2017-3-15	原始取得	无
5489	一种互补结型场效应晶体管 c-JFET 器件及其后栅极的制造方法	ZL201110459296.X	中芯北京	2011-12-31	2017-3-15	原始取得	无
5490	一种半导体器件的制造方法	ZL201310379312.3	中芯北京、中芯上海	2013-08-27	2017-10-20	原始取得	无
5491	存储阵列中的 MOS 管阈值电	ZL201310425323.0	中芯北京、中芯上海	2013-09-17	2017-12-1	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	压的测试方法						
5492	闪存存储器的制造方法	ZL201310439584.8	中芯北京、中芯上海	2013-09-24	2017-8-25	原始取得	无
5493	磁性隧道结及其形成方法	ZL201310425240.1	中芯北京、中芯上海	2013-11-17	2017-8-25	原始取得	无
5494	互连结构及其形成方法	ZL201310652962.0	中芯北京、中芯上海	2013-12-05	2017-12-29	原始取得	无
5495	半导体结构的形成方法	ZL201310657174.0	中芯北京、中芯上海	2013-12-06	2017-12-29	原始取得	无
5496	化学机械研磨装置和化学机械研磨方法	ZL201310744276.6	中芯北京、中芯上海	2013-12-30	2017-8-25	原始取得	无
5497	用于量测机台的派货的方法和系统	ZL201410553971.9	中芯上海	2014-10-17	2018-08-21	原始取得	无
5498	衬底结构、半导体器件以及制造方法	ZL201510735985.7	中芯上海、中芯宁波	2015-11-03	2019-12-24	原始取得	无
5499	半导体装置的制造方法	ZL201510860803.9	中芯北京、中芯上海	2015-12-01	2019-10-8	原始取得	无
5500	具有浅沟槽隔离结构的器件及其制造方法	ZL201510969869.1	中芯北京、中芯上海	2015-12-22	2019-12-6	原始取得	无
5501	半导体装置及其制造方法	ZL201510968184.5	中芯北京、中芯上海	2015-12-22	2019-10-1	原始取得	无
5502	电可编程熔丝单元阵列及其操作方法	ZL201510974772.X	中芯北京、中芯上海	2015-12-23	2019-9-20	原始取得	无
5503	半导体装置及其制造方法	ZL201610094545.2	中芯上海、中芯北京	2016-02-22	2019-12-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5504	浅沟槽隔离结构制作方法	ZL201010022702.1	中芯北京、中芯上海	2010-01-12	2013-06-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5505	一种低电压栅氧化层制备方法	ZL201010187390.X	中芯北京、中芯上海	2010-05-28	2013-06-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5506	半导体场效应晶体管的测试方法及测试结构	ZL201010229225.6	中芯北京、中芯上海	2010-07-16	2013-06-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5507	一种在重新粘合过程中防止待测芯片损伤的方法	ZL201010285770.7	中芯北京、中芯上海	2010-09-17	2013-06-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5508	在铜镶嵌制程中形成金属－绝缘－金属型（MIM）电容器的方法	ZL02101550.3	中芯上海、中芯北京	2002-01-09	2005-05-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5509	在氮化硅层上形成氮氧化硅层的方法	ZL02101551.1	中芯上海、中芯北京	2002-01-09	2005-05-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5510	可降低微粒污染的真空吸引装置	ZL02106280.3	中芯上海、中芯北京	2002-04-08	2005-08-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5511	双镶嵌制程	ZL02106882.8	中芯上海、中芯北京	2002-03-07	2006-09-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5512	自动对准漂浮栅极的电可擦	ZL02118930.7	中芯上海、中芯北京	2002-04-30	2006-02-08	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	除可编程只读存储器的制造方法					北京：继受取得	
5513	下电极的制造方法	ZL02122004.2	中芯上海、中芯北京	2002-05-28	2005-06-01	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5514	可重复使用的晶圆控片及其形成方法	ZL02122807.8	中芯上海、中芯北京	2002-06-04	2006-08-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5515	半导体装置测试结构与形成方法	ZL02136843.0	中芯上海、中芯北京	2002-09-06	2006-03-15	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5516	静电放电保护装置及其制造方法	ZL02136844.9	中芯上海、中芯北京	2002-09-06	2006-10-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5517	快速热退火工艺的每日监控的控片	ZL02137394.9	中芯上海、中芯北京	2002-10-11	2005-08-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5518	静电放电保护电路	ZL02137765.0	中芯上海、中芯北京	2002-10-31	2006-11-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5519	多孔电介质中镶嵌铜结构的制造方法	ZL02160505.X	中芯上海、中芯北京	2002-12-27	2006-02-08	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5520	一种掩膜式只读存储器工艺与元件	ZL02160506.8	中芯上海、中芯北京	2002-12-27	2005-11-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5521	一种电子产品的安全装置及其方法	ZL02160507.6	中芯上海、中芯北京	2002-12-27	2007-07-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5522	可耐受高电压输出暂存器	ZL02160509.2	中芯上海、中芯北京	2002-12-27	2005-08-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5523	用于掩膜植入编码 ROM 的生根的双层编码光罩	ZL02160578.5	中芯上海、中芯北京	2002-12-30	2005-10-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5524	静电放电保护电路	ZL03115398.4	中芯上海、中芯北京	2003-02-14	2007-01-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5525	热探针的监控晶圆片的制成方法及其产品	ZL03115709.2	中芯上海、中芯北京	2003-03-10	2006-08-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5526	使用聚焦离子束的化学汽相沉积的光罩图案化方法	ZL03115764.5	中芯上海、中芯北京	2003-03-13	2006-04-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5527	铝材质堆迭式金属电容器及电感器的集成制程方法	ZL03115796.3	中芯上海、中芯北京	2003-03-14	2006-12-06	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5528	浅沟道隔离处理的双衬垫氧化物工艺	ZL03141564.4	中芯上海、中芯北京	2003-07-11	2008-07-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5529	利用检测闸门氧化硅层中氮化物含量的半导体元件制成	ZL03142094.X	中芯上海、中芯北京	2003-08-06	2007-08-08	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
5530	集成电路的斜有源区域半导体组件结构	ZL03143423.1	中芯上海、中芯北京	2003-09-30	2007-05-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5531	利用氧化线间隙壁与回蚀刻制造 DRAM 单元结构的方法	ZL03143424.X	中芯上海、中芯北京	2003-09-30	2007-01-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5532	一种电可擦除可编程只读存储器的制造方法	ZL03150637.2	中芯上海、中芯北京	2003-08-29	2007-07-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5533	一种电压基准电路	ZL03150639.9	中芯上海、中芯北京	2003-08-29	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5534	一种掩膜制造方法	ZL03150650.X	中芯上海、中芯北京	2003-08-29	2006-03-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5535	等离子体增强式化学气相沉积处理方法	ZL03151022.1	中芯上海、中芯北京	2003-09-18	2007-05-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5536	片状金属导电装置及使用所述装置的处理室	ZL03151023.X	中芯上海、中芯北京	2003-09-18	2009-06-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5537	多沉积步骤的高浓度等离子化学气相沉积方法	ZL03151024.8	中芯上海、中芯北京	2003-09-18	2007-06-06	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5538	在掩膜式只读存储器制造工	ZL03151025.6	中芯上海、中芯北京	2003-09-18	2007-02-14	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	艺中进行信号注入的方法					北京：继受取得	
5539	集成电路的倾斜镶嵌内连接结构的形成方法	ZL03151282.8	中芯上海、中芯北京	2003-09-28	2007-02-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5540	垂直式快闪存储器的结构及其制造方法	ZL03151284.4	中芯上海、中芯北京	2003-09-28	2007-07-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5541	排气罩	ZL03151419.7	中芯上海、中芯北京	2003-09-29	2009-06-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5542	半导体晶片的清洗液及清洗方法	ZL03151423.5	中芯上海、中芯北京	2003-09-29	2006-02-15	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5543	一种集成电路光罩及其制作方法	ZL03151440.5	中芯上海、中芯北京	2003-09-29	2006-09-13	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5544	具有源极端选择晶体管的嵌入式闪存	ZL200310107854.1	中芯上海、中芯北京	2003-10-10	2006-11-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5545	一种离子布植制程的监控方法	ZL200310108324.9	中芯上海、中芯北京	2003-10-31	2008-06-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5546	用于高电压输入的上拉晶体管的栅极控制电路	ZL200310108419.0	中芯上海、中芯北京	2003-11-05	2007-01-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5547	形成金属-绝缘体-金属电容的	ZL200310109109.0	中芯上海、中芯北京	2003-12-05	2007-06-13	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法					北京：继受取得	
5548	堆叠式金属-绝缘体-金属电容器及其制造方法	ZL200310109110.3	中芯上海、中芯北京	2003-12-05	2007-03-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5549	使用离子注入过的晶片监测低温急速热退火工艺	ZL200310109111.8	中芯上海、中芯北京	2003-12-05	2007-06-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5550	制作高紫外-阈值电压电可擦除可编程只读存储器的方法	ZL200310121632.5	中芯上海、中芯北京	2003-12-31	2007-03-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5551	穿透式电子显微镜试片的制备方法	ZL200310121634.4	中芯上海、中芯北京	2003-12-31	2009-05-06	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5552	穿透式电子显微镜试片的制备方法	ZL200310121635.9	中芯上海、中芯北京	2003-12-31	2008-04-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5553	晶片金属互连线可靠性在线测试方法	ZL200310121636.3	中芯上海、中芯北京	2003-12-31	2007-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5554	同步化逻辑电路接口及其同步化方法	ZL200310122705.2	中芯上海、中芯北京	2003-12-19	2007-05-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5555	一种集成电路的电感	ZL200310122886.9	中芯上海、中芯北京	2003-12-25	2007-01-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5556	消除金属导电层的静电使蚀	ZL200310122915.1	中芯上海、中芯北京	2003-12-29	2007-10-24	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	刻完全的方法					北京：继受取得	
5557	铝金属的化学机械研磨方法及研磨剂	ZL200310122916.6	中芯上海、中芯北京	2003-12-29	2008-10-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5558	用于钛硅化物制造工艺窗口的 pMOS 的制作方法	ZL200310122921.7	中芯上海、中芯北京	2003-12-29	2007-03-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5559	评估半导体制程的方法	ZL200310122955.6	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2007-03-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5560	在集成电路器件的大马士革铜工艺中电容器制造的方法及其结构	ZL200310122959.4	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5561	硅基液晶显示装置的金属反射层的制作方法	ZL200310122960.7	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2007-12-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5562	可观测离子束造成的表面损伤的 TEM 样片的制备方法	ZL200310122961.1	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-06-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5563	用于将铜与金属-绝缘体-金属电容器结合的方法和结构	ZL200310122962.6	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5564	用铜制造高电容量电容器的方法及其结构	ZL200310122963.0	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-09-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5565	光掩模的静电放电保护的方法和结构	ZL200310122964.5	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5566	用于制造半导体晶片的半色调掩模的制造方法和结构	ZL200310122965.X	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2008-12-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5567	控制回蚀刻截面轮廓的方法和装置	ZL200310122966.4	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2008-05-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5568	ROM 存储器及其制造方法	ZL200310122970.0	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-04-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5569	半导体集成电路隧道氧化窗口区域设计的结构及方法	ZL200310122971.5	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5570	用做测试装置的多金属层 SRAM 存储器	ZL200310122972.X	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2007-07-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5571	利用注入晶片的注入机的低能量剂量监测	ZL200310122977.2	中芯上海、中芯北京	2003-12-30	2008-05-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5572	采用两次离子注入的高操作电压双扩散漏极 MOS 器件	ZL200410017771.8	中芯上海、中芯北京	2004-04-14	2007-10-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5573	半导体器件的制造方法	ZL200410018232.6	中芯上海、中芯北京	2004-05-11	2008-06-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5574	对镜结构进行化学机械抛光的方法	ZL200410018564.4	中芯上海、中芯北京	2004-05-18	2009-09-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5575	集成电路器件形成隔离物后修复等离子体损伤的方法	ZL200410025739.4	中芯上海、中芯北京	2004-06-28	2007-06-06	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5576	改善蚀刻后光刻胶残余的半导体器件制造方法	ZL200410052845.1	中芯上海、中芯北京	2004-07-14	2008-06-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5577	半导体装置的制造方法	ZL200410054343.2	中芯上海、中芯北京	2004-09-08	2007-07-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5578	半导体集成电路硅单晶片衬底背面氮化硅层的新腐蚀方法	ZL200410066298.2	中芯上海、中芯北京	2004-09-10	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5579	一种制造嵌入式闪存的方法	ZL200410066464.9	中芯上海、中芯北京	2004-09-16	2007-10-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5580	具有低待机电流的调压器用器件和方法	ZL200410066516.2	中芯上海、中芯北京	2004-09-16	2008-05-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5581	具有稳定快速响应和低待机电流的调压器用器件	ZL200410066517.7	中芯上海、中芯北京	2004-09-16	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5582	闪存储器用的多层叠层多晶	ZL200410066575.X	中芯上海、中芯北京	2004-09-22	2008-09-10	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	硅栅的平整方法					北京：继受取得	
5583	在半导体器件的双镶嵌结构中降低接触电阻的方法和结构	ZL200410066664.4	中芯上海、中芯北京	2004-09-21	2007-12-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5584	高压线路中引入第二路电力线进行无中断切换的方法	ZL200410067201.X	中芯上海、中芯北京	2004-10-15	2008-08-13	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5585	改进的集成电路电容器制造方法	ZL200410067202.4	中芯上海、中芯北京	2004-10-15	2008-09-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5586	测试半导体器件内的通孔中的残留物的测试结构	ZL200410067452.8	中芯上海、中芯北京	2004-10-25	2008-04-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5587	用于多透射率光掩模结构的镶嵌的方法和所得结构	ZL200410068071.1	中芯上海、中芯北京	2004-11-08	2010-07-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5588	用于金属阻挡层与晶种集成的方法与系统	ZL200410084788.5	中芯上海、中芯北京	2004-11-24	2008-01-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5589	半导体集成电路的内连焊盘	ZL200410093466.7	中芯上海、中芯北京	2004-12-22	2008-01-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5590	带有改进电源范围的低功率快响应稳压器的器件与方法	ZL200410099391.3	中芯上海、中芯北京	2004-12-28	2008-06-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5591	用于避免多电源输入/输出的瞬态短路电流的集成电路	ZL200510024850.6	中芯上海、中芯北京	2005-03-30	2008-08-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5592	一种改进深沟槽 DRAM 钨金属位线的 CMP 工艺窗的方法	ZL200510026258.X	中芯上海、中芯北京	2005-05-27	2008-09-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5593	产生差分信号的高带宽仪器	ZL200510026471.0	中芯上海、中芯北京	2005-05-30	2009-12-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5594	半导体制造工艺中更换清洗剂的方法	ZL200510027043.X	中芯上海、中芯北京	2005-06-21	2008-10-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5595	多晶硅栅极掺杂方法	ZL200510027415.9	中芯上海、中芯北京	2005-06-30	2008-12-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5596	利用独立的源极形成的CMOS图像传感器件和方法	ZL200510027511.3	中芯上海、中芯北京	2005-06-28	2008-06-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5597	具有氧化物间隔层的应变源漏 CMOS 的集成方法	ZL200510027616.9	中芯上海、中芯北京	2005-07-07	2009-02-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5598	应变 CMOS 的集成制作方法	ZL200510029094.6	中芯上海、中芯北京	2005-08-25	2008-06-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5599	多层膜作为硬掩模和抗反射层的应变源漏 CMOS 的制作	ZL200510029095.0	中芯上海、中芯北京	2005-08-25	2009-01-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法						
5600	大功率电容性和电阻性两用声光控制器	ZL200510029144.0	中芯上海、中芯北京	2005-08-26	2009-08-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5601	金属硅化物制作中的选择性离子注入预非晶化方法	ZL200510029146.X	中芯上海、中芯北京	2005-08-26	2009-06-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5602	低电压触发与保存区静电放电器件	ZL200510029193.4	中芯上海、中芯北京	2005-08-24	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5603	表面更平整的金凸点的制造方法	ZL200510029564.9	中芯上海、中芯北京	2005-09-12	2010-04-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5604	多步骤低温间隔层制作方法	ZL200510029705.7	中芯上海、中芯北京	2005-09-15	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5605	用于向片上系统提供自适应电源的系统与方法	ZL200510029766.3	中芯上海、中芯北京	2005-09-15	2009-11-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5606	降低功耗的自适应电源系统与方法	ZL200510029767.8	中芯上海、中芯北京	2005-09-15	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5607	形成 CMOS 半导体器件的方法	ZL200510029992.1	中芯上海、中芯北京	2005-09-19	2009-09-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5608	用低温氮气/氢气灰化制程减	ZL200510030301.X	中芯上海、中芯北京	2005-09-29	2009-08-26	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	少聚合物残余的方法					北京：继受取得	
5609	用于嵌入式 EEPROM 中的一次可编程存储器器件的结构与方法	ZL200510030303.9	中芯上海、中芯北京	2005-09-28	2008-12-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5610	带有密封环拐角结构的集成电路器件	ZL200510030304.3	中芯上海、中芯北京	2005-09-28	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5611	用于半导体器件的使用预处理的材料原子层沉积的方法	ZL200510030307.7	中芯上海、中芯北京	2005-09-28	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5612	用于 CMOS 技术的应变感应迁移率增强纳米器件及工艺	ZL200510030311.3	中芯上海、中芯北京	2005-09-29	2008-12-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5613	用于浅沟槽隔离的双制衬的方法与结构	ZL200510030312.8	中芯上海、中芯北京	2005-09-29	2009-04-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5614	用于输入/输出驱动器的加电控制的系统与方法	ZL200510030369.8	中芯上海、中芯北京	2005-09-27	2009-09-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5615	测试半导体器件栅氧化物整体性的带解码器的测试键	ZL200510030381.9	中芯上海、中芯北京	2005-10-11	2008-10-15	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5616	用于在高电压和低电压之间开关的系统与方法	ZL200510030579.7	中芯上海、中芯北京	2005-10-12	2009-09-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5617	使用应变硅用于晶体管的集成设计方法与结构	ZL200510110068.6	中芯上海、中芯北京	2005-10-31	2010-05-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5618	用于应变硅 MOS 晶体管的多晶硅栅极掺杂方法和结构	ZL200510110069.0	中芯上海、中芯北京	2005-10-31	2010-05-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5619	使用应变硅用于集成 PMOS 和 NMOS 晶体管的单掩模设计方法和结构	ZL200510110071.8	中芯上海、中芯北京	2005-10-31	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5620	低 K 介电材料的接合焊盘和用于制造半导体器件的方法	ZL200510111133.7	中芯上海、中芯北京	2005-11-30	2008-08-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5621	用于制造集成电路的电容器器件的方法与结构	ZL200510111134.1	中芯上海、中芯北京	2005-11-30	2008-08-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5622	制造用于闪存半导体器件的隔离结构的方法	ZL200510111386.4	中芯上海、中芯北京	2005-12-05	2009-02-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5623	改进低介电常数层的粘附强度的方法	ZL200510111389.8	中芯上海、中芯北京	2005-12-12	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5624	利用阵列与解码器进行器件表征的方法与系统	ZL200510111997.9	中芯上海、中芯北京	2005-12-22	2009-06-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5625	具有不全接触通孔栈的密封	ZL200510111999.8	中芯上海、中芯北京	2005-12-22	2009-04-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	环结构					北京：继受取得	
5626	利用浮动和/或偏置多晶硅区域的静电保护系统和方法	ZL200610023162.2	中芯上海、中芯北京	2006-01-04	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5627	使用所选掩模的双大马士革铜工艺	ZL200610023301.1	中芯上海、中芯北京	2006-01-13	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5628	用于基于通用串行总线的装置的节电系统和方法	ZL200610023916.4	中芯上海、中芯北京	2006-02-16	2008-08-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5629	半导体叠层电容器	ZL200610024666.6	中芯上海、中芯北京	2006-03-14	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5630	半导体器件栅极结构的制造方法	ZL200610024667.0	中芯上海、中芯北京	2006-03-14	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5631	真空泵的运输工具	ZL200610025303.4	中芯上海、中芯北京	2006-03-30	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5632	硅化金属阻止区的形成方法及半导体器件的制造方法	ZL200610025420.0	中芯上海、中芯北京	2006-04-03	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5633	抑制等离子体不稳定的方法	ZL200610025490.6	中芯上海、中芯北京	2006-04-06	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5634	通过自对准形成多晶硅浮栅	ZL200610025646.0	中芯上海、中芯北京	2006-04-12	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	结构的方法					北京：继受取得	
5635	半导体存储器件的制造方法	ZL200610025651.1	中芯上海、中芯北京	2006-04-12	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5636	电子束曝光方法	ZL200610026324.8	中芯上海、中芯北京	2006-04-30	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5637	半导体器件及其制造方法	ZL200610026326.7	中芯上海、中芯北京	2006-04-30	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5638	半导体晶片焊料凸块结构及其制造方法	ZL200610026560.X	中芯上海、中芯北京	2006-05-15	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5639	金属氧化物半导体场效应晶体管保护电路的制造方法	ZL200610027257.1	中芯上海、中芯北京	2006-06-02	2009-05-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5640	半导体存储器件及其制造方法	ZL200610027580.9	中芯上海、中芯北京	2006-06-12	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5641	硅基液晶显示器件及其制造和检测方法	ZL200610027586.6	中芯上海、中芯北京	2006-06-12	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5642	用于 ASIC 器件功率控制的系统和方法	ZL200610027590.2	中芯上海、中芯北京	2006-06-12	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5643	互补金属氧化物半导体器件	ZL200610028768.5	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2008-10-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5644	存储电容器的制造方法	ZL200610028769.X	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5645	硅基液晶显示芯片基板的制造及检测方法	ZL200610028770.2	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5646	化学机械研磨方法	ZL200610028771.7	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5647	互补金属氧化物半导体器件的制造方法	ZL200610028774.0	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5648	存储器件分离栅极的制造方法	ZL200610028779.3	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5649	抛光垫以及化学机械抛光方法	ZL200610028780.6	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5650	可去除刻蚀后残留聚合物的半导体器件制造方法	ZL200610028782.5	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5651	非挥发性半导体存储器的制造方法	ZL200610028783.X	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5652	闪存器件分离栅极的制造方	ZL200610028788.2	中芯上海、中芯北京	2006-07-10	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法					北京：继受取得	
5653	延长等离子蚀刻系统中反应腔使用寿命的方法	ZL200610028977.X	中芯上海、中芯北京	2006-07-14	2009-06-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5654	确定半导体特征的方法和用于制造集成电路的方法	ZL200610029292.7	中芯上海、中芯北京	2006-07-21	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5655	半导体晶片中埋入式电阻器的制作方法	ZL200610029515.X	中芯上海、中芯北京	2006-07-28	2009-08-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5656	凹槽的填充方法及其结构	ZL200610029903.8	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5657	形成浅沟槽隔离结构的方法和浅沟槽隔离结构	ZL200610029904.2	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5658	接触孔形成方法	ZL200610029906.1	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5659	集成电路的可制造性设计方法	ZL200610029907.6	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5660	双镶嵌结构的制造方法	ZL200610029908.0	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5661	与非型快闪存储器选择栅的	ZL200610029909.5	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	制造方法					北京：继受取得	
5662	半导体隔离结构及其形成方法	ZL200610029912.7	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5663	电平转换电器	ZL200610029913.1	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5664	存储电容器的制造方法	ZL200610029916.5	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5665	芯片互连结构及系统	ZL200610029918.4	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5666	金属前绝缘层的填充方法	ZL200610029921.6	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5667	栅极结构的制造方法	ZL200610029922.0	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5668	光刻图形的形成方法	ZL200610029925.4	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5669	栅极结构的制造方法	ZL200610029926.9	中芯上海、中芯北京	2006-08-10	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5670	半导体器件及其制造方法	ZL200610030015.8	中芯上海、中芯北京	2006-08-11	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5671	CMOS 图像传感器表面介质层制造方法	ZL200610030016.2	中芯上海、中芯北京	2006-08-11	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5672	化学机械研磨终点的控制方法	ZL200610030018.1	中芯上海、中芯北京	2006-08-11	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5673	薄膜覆盖层的形成方法	ZL200610030022.8	中芯上海、中芯北京	2006-08-11	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5674	化学机械研磨设备和用于化学机械研磨设备的防溅装置	ZL200610030076.4	中芯上海、中芯北京	2006-08-14	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5675	半导体器件的制造方法	ZL200610030077.9	中芯上海、中芯北京	2006-08-14	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5676	半导体器件的制造方法	ZL200610030627.7	中芯上海、中芯北京	2006-08-31	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5677	铜互连的半导体器件的制造方法及其结构	ZL200610030628.1	中芯上海、中芯北京	2006-08-31	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5678	金属氧化物半导体器件及其制造方法	ZL200610030629.6	中芯上海、中芯北京	2006-08-31	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5679	金属氧化物半导体器件的制	ZL200610030792.2	中芯上海、中芯北京	2006-09-04	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	造方法					北京：继受取得	
5680	通孔刻蚀方法	ZL200610030795.6	中芯上海、中芯北京	2006-09-04	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5681	通孔刻蚀方法	ZL200610030796.0	中芯上海、中芯北京	2006-09-04	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5682	接触孔的填充方法	ZL200610030809.4	中芯上海、中芯北京	2006-09-04	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5683	半导体器件栅极的制造方法	ZL200610030811.1	中芯上海、中芯北京	2006-09-04	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5684	用于高电压输入的上拉晶体管的栅极控制电路	ZL200610079821.4	中芯上海、中芯北京	2003-11-05	2009-01-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5685	一种减小钝化晶片表面漏电电流的方法及其反应装置	ZL200610116168.4	中芯上海、中芯北京	2006-09-18	2009-01-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5686	栅极侧壁层的形成方法	ZL200610116843.3	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5687	金属氧化物半导体器件及其制造方法	ZL200610116846.7	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5688	镶嵌结构的制造方法	ZL200610116848.6	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5689	用于 ASIC 器件的功率控制的系统和方法	ZL200610116852.2	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5690	平坦化方法及顶层金属层隔离结构的形成方法	ZL200610116853.7	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-02-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5691	等离子刻蚀方法	ZL200610116855.6	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5692	非挥发性半导体存储器及其制作方法	ZL200610116859.4	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5693	浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL200610116877.2	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5694	双镶嵌结构的形成方法	ZL200610116880.4	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5695	返工处理方法	ZL200610116882.3	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2010-06-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5696	非挥发性半导体存储器及其制作方法	ZL200610116884.2	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5697	硅基液晶显示装置反射镜面	ZL200610116885.7	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的制作方法					北京：继受取得	
5698	在铜化学机械研磨工艺中减少晶片被腐蚀的方法	ZL200610116896.5	中芯上海、中芯北京	2006-10-08	2010-03-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5699	防止铜扩散的方法及半导体器件的制造方法	ZL200610116901.2	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5700	双镶嵌结构的形成方法	ZL200610116906.5	中芯上海、中芯北京	2006-09-30	2009-01-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5701	不对称高压 MOS 器件栅氧化层保护方法及其应用	ZL200610118022.3	中芯上海、中芯北京	2006-11-07	2010-02-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5702	半导体叠层结构及其制造方法	ZL200610118299.6	中芯上海、中芯北京	2006-11-13	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5703	硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅快闪存储器及其制作方法	ZL200610118300.5	中芯上海、中芯北京	2006-11-13	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5704	沟槽的制造方法及其应用于制造图像传感器方法	ZL200610118301.X	中芯上海、中芯北京	2006-11-13	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5705	一种半导体器件及其制造方法、蚀刻阻挡层的形成方法	ZL200610118817.4	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2010-06-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5706	静态随机存取存储器	ZL200610118818.9	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5707	动态随机存储器	ZL200610118819.3	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5708	金属氧化物半导体器件栅极的制造方法	ZL200610118838.6	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5709	半导体器件的栅极制造方法和半导体器件	ZL200610118839.0	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5710	CMOS 器件应力膜的形成方法和 CMOS 器件	ZL200610118840.3	中芯上海、中芯北京	2006-11-28	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5711	使用蚀刻阻挡区的干法蚀刻系统的系统和方法	ZL200610119026.3	中芯上海、中芯北京	2006-11-30	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5712	具有缓冲器控制的数据传输的系统和方法	ZL200610119027.8	中芯上海、中芯北京	2006-11-30	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5713	半导体器件中金属布线结构的制作方法	ZL200610119048.X	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5714	金属布线结构的制作方法	ZL200610119049.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5715	直接访问存储装置及直接访	ZL200610119052.6	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	问存储操作方法					北京：继受取得	
5716	SONOS 快闪存储器的制作方法	ZL200610119053.0	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5717	检测钨化学气相淀积设备异常情况的方法	ZL200610119054.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5718	半导体器件及其制造方法	ZL200610119057.9	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5719	硅基液晶显示器单元及其形成方法	ZL200610119059.8	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5720	P 型 MOS 晶体管及其形成方法	ZL200610119060.0	中芯上海、中芯北京	2006-12-04	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5721	晶片的清洗方法	ZL200610119140.6	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5722	半导体器件及其制造方法	ZL200610119141.0	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5723	自对准接触孔的制造方法	ZL200610119142.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5724	半导体器件的制造方法和半	ZL200610119143.X	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	导体器件					北京：继受取得	
5725	金属氧化物半导体器件的制造方法	ZL200610119145.9	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5726	隔离沟槽的填充方法	ZL200610119146.3	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-03-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5727	半导体器件及其制造方法以及接触刻蚀停止层	ZL200610119148.2	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5728	浅沟槽隔离区氧化物沉积方法	ZL200610119150.X	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-06-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5729	硅基液晶显示器单元及其形成方法	ZL200610119155.2	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5730	栅极侧墙的制造方法	ZL200610119167.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5731	CMOS 图像传感器和 CMOS 图像传感器的制造方法	ZL200610119171.1	中芯上海、中芯北京	2006-12-05	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5732	一种低介电常数电介质的金属单镶嵌结构制作方法	ZL200610119212.7	中芯上海、中芯北京	2006-12-06	2009-07-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5733	SONOS 快闪存储器及其制作	ZL200610119354.3	中芯上海、中芯北京	2006-12-08	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法					北京：继受取得	
5734	硅基液晶显示装置反射镜面的制作方法	ZL200610119367.0	中芯上海、中芯北京	2006-12-08	2009-04-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5735	一种突波滤波器及具有该滤波器的时钟数据恢复电路	ZL200610119549.8	中芯上海、中芯北京	2006-12-13	2010-05-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5736	CMOS 图像传感器的像素单元的形成方法	ZL200610147318.8	中芯上海、中芯北京	2006-12-15	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5737	半导体存储器及其形成方法	ZL200610147320.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-15	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5738	双镶嵌结构形成过程中光刻胶图形的去除方法	ZL200610147322.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-15	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5739	半导体存储器及其形成方法	ZL200610147431.6	中芯上海、中芯北京	2006-12-18	2010-08-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5740	光刻检测图形及光刻版版图	ZL200610147433.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-18	2010-08-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5741	具有非晶硅 MONOS 存储单元结构的半导体器件及其制造方法	ZL200610147446.2	中芯上海、中芯北京	2006-12-12	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5742	一种提高非挥发性存储器数据擦除速度的方法	ZL200610147627.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-20	2009-12-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5743	通孔的形成方法	ZL200610147795.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5744	镶嵌结构的制造方法	ZL200610147803.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5745	半导体器件的制作方法	ZL200610147805.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5746	焊料凸块的制造方法	ZL200610147806.9	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5747	半导体器件金属连接孔的制造方法和半导体器件	ZL200610147807.3	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-07-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5748	通孔的形成方法	ZL200610147808.8	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5749	金属氧化物半导体器件的制造方法	ZL200610147812.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-22	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5750	形成集成电路器件自对准接触的方法	ZL200610147850.X	中芯上海、中芯北京	2006-12-20	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5751	光刻胶的去除方法	ZL200610147868.X	中芯上海、中芯北京	2006-12-25	2010-08-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5752	高分子聚合物层的清洗方法	ZL200610147869.4	中芯上海、中芯北京	2006-12-25	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5753	沟槽轮廓参数检测方法	ZL200610147871.1	中芯上海、中芯北京	2006-12-25	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5754	将三维函数用于掩模规格制定的方法	ZL200610148018.1	中芯上海、中芯北京	2006-12-26	2010-01-13	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5755	多路漏液检测器	ZL200610148086.8	中芯上海、中芯北京	2006-12-27	2010-06-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5756	一种晶片金属引线及其制作方法	ZL200610148089.1	中芯上海、中芯北京	2006-12-27	2009-08-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5757	半导体芯片封装结构及封装方法	ZL200610148242.0	中芯上海、中芯北京	2006-12-28	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5758	故障报警装置及故障报警方法	ZL200610148247.3	中芯上海、中芯北京	2006-12-28	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5759	半导体器件及其制作方法	ZL200610148250.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-28	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5760	制造 DRAM 电容器结构的方法	ZL200610148388.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-27	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5761	用于化学气相沉积装置的保温器	ZL200610148810.7	中芯上海、中芯北京	2006-12-28	2010-06-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5762	硅基液晶微显示器及其形成方法	ZL200610148821.5	中芯上海、中芯北京	2006-12-28	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5763	SONOS 快闪存储器的制作方法	ZL200710037672.X	中芯上海、中芯北京	2007-02-13	2010-08-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5764	光学近距修正的方法	ZL200710037675.3	中芯上海、中芯北京	2007-02-13	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5765	减少晶圆缺陷的制造方法	ZL200710038222.2	中芯上海、中芯北京	2007-03-20	2009-10-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5766	浅沟槽形成方法及浅沟槽结构	ZL200710039251.0	中芯上海、中芯北京	2007-04-03	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5767	快闪存储器及其制作方法	ZL200710039564.6	中芯上海、中芯北京	2007-04-17	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5768	一种可提高同一晶圆上栅极凹槽均匀性的刻蚀方法	ZL200710039780.0	中芯上海、中芯北京	2007-04-20	2009-08-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5769	半导体器件的制作方法	ZL200710039810.8	中芯上海、中芯北京	2007-04-20	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5770	半导体器件的制造方法	ZL200710039872.9	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5771	用于热插拔的系统和方法	ZL200710039874.8	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5772	半导体器件的制造方法	ZL200710039876.7	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5773	金属-绝缘体-金属电容器及其制造方法	ZL200710040236.8	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5774	双镶嵌结构的形成方法	ZL200710040240.4	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5775	测试基体、测试基体掩膜及测试基体的形成方法	ZL200710040262.0	中芯上海、中芯北京	2007-04-24	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5776	CMOS 图像传感器的形成方法	ZL200710040423.6	中芯上海、中芯北京	2007-05-08	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5777	集成电路芯片的钝化层及其制造方法	ZL200710040534.7	中芯上海、中芯北京	2007-05-11	2009-09-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5778	一种消除蚀刻图形偏移的方法及装置	ZL200710040535.1	中芯上海、中芯北京	2007-05-11	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5779	栅极的制造方法	ZL200710040628.4	中芯上海、中芯北京	2007-05-11	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5780	多晶硅的刻蚀方法	ZL200710040642.4	中芯上海、中芯北京	2007-05-15	2009-08-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5781	一种改善晶片氧化硅层生长的装置及方法	ZL200710040654.7	中芯上海、中芯北京	2007-05-15	2009-12-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5782	闪存器件的制造方法	ZL200710040970.4	中芯上海、中芯北京	2007-05-21	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5783	通孔的形成方法	ZL200710040980.8	中芯上海、中芯北京	2007-05-21	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5784	双镶嵌结构的形成方法	ZL200710040986.5	中芯上海、中芯北京	2007-05-21	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5785	电平转换电路	ZL200710041094.7	中芯上海、中芯北京	2007-05-23	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5786	熔丝结构及其形成方法	ZL200710041095.1	中芯上海、中芯北京	2007-05-23	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5787	浅沟槽隔离的制造方法	ZL200710041106.6	中芯上海、中芯北京	2007-05-23	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5788	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL200710041164.9	中芯上海、中芯北京	2007-05-23	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5789	互补金属氧化物半导体器件应力层的形成方法	ZL200710042138.8	中芯上海、中芯北京	2007-06-18	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5790	确定沟槽刻蚀时间的方法和浅沟槽隔离的制造方法	ZL200710042139.2	中芯上海、中芯北京	2007-06-18	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5791	栅极刻蚀方法、栅极刻蚀终点检测方法与系统	ZL200710042154.7	中芯上海、中芯北京	2007-06-18	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5792	晶片表面材料层的处理系统和方法	ZL200710042157.0	中芯上海、中芯北京	2007-06-18	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5793	原子层沉积方法以及形成的半导体器件	ZL200710042457.9	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5794	原子层沉积方法以及形成的半导体器件	ZL200710042461.5	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5795	原子层沉积方法以及形成的半导体器件	ZL200710042463.4	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5796	一种改善深沟槽刻蚀的氧化物硬掩模轮廓的方法	ZL200710043587.4	中芯上海、中芯北京	2007-07-09	2009-12-02	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5797	半导体器件阱的制造方法	ZL200710043875.X	中芯上海、中芯北京	2007-07-17	2010-01-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5798	一种制造 NOR FLASH 芯片的离子注入方法	ZL200710044055.2	中芯上海、中芯北京	2007-07-20	2010-02-24	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5799	一种测试自动上料卸料机台的方法	ZL200710044056.7	中芯上海、中芯北京	2007-07-20	2010-05-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5800	在低介电常数介质层中形成通孔的方法	ZL200710044345.7	中芯上海、中芯北京	2007-07-27	2010-05-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5801	隔离环基层、隔离环基层掩膜版及隔离环基层形成方法	ZL200710044352.7	中芯上海、中芯北京	2007-07-27	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5802	布局方法和装置	ZL200710044391.7	中芯上海、中芯北京	2007-07-30	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5803	栅极及半导体器件的制造方法、用于制造栅极的结构	ZL200710044805.6	中芯上海、中芯北京	2007-08-09	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5804	形成 CMOS 图像传感器、栅极侧墙及改善刻蚀不均匀的方	ZL200710045013.0	中芯上海、中芯北京	2007-08-17	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法						
5805	改善绝缘介电层缺陷及形成双镶嵌结构的方法	ZL200710045014.5	中芯上海、中芯北京	2007-08-17	2010-01-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5806	闪存单元结构及其制作方法	ZL200710045015.X	中芯上海、中芯北京	2007-08-17	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5807	晶片清洗方法	ZL200710046215.7	中芯上海、中芯北京	2007-09-17	2010-04-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5808	一种反应离子蚀刻方法	ZL200710046255.1	中芯上海、中芯北京	2007-09-21	2010-01-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5809	栅极及 NMOS 晶体管的制作方法	ZL200710046810.0	中芯上海、中芯北京	2007-09-30	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5810	栅极结构及非挥发性半导体存储器的制作方法	ZL200710046812.X	中芯上海、中芯北京	2007-09-30	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5811	一种炉管干式清洗方法	ZL200710046836.5	中芯上海、中芯北京	2007-10-09	2010-05-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5812	离子植入方法	ZL200710047121.1	中芯上海、中芯北京	2007-10-17	2010-04-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5813	一种可提高刻蚀性能的光刻	ZL200710047353.7	中芯上海、中芯北京	2007-10-24	2010-05-19	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	方法					北京：继受取得	
5814	一种堆叠式光刻对准标记	ZL200710047360.7	中芯上海、中芯北京	2007-10-24	2010-05-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5815	一种分开优化源/漏极的方法	ZL200710047994.2	中芯上海、中芯北京	2007-11-08	2010-04-07	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5816	蚀刻底层抗反射层及制作布线沟槽的方法	ZL200710094489.3	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5817	通孔及通孔形成方法	ZL200710094495.9	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5818	半导体基底清洗方法	ZL200710094525.6	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-08-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5819	避免刻蚀腔室打开后产生污染物的方法	ZL200710094532.6	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5820	晶圆在线检测方法及在线检测装置	ZL200710094542.X	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-08-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5821	化学机械抛光中凹陷现象检测单元、制作方法及检测方法	ZL200710094554.2	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-06-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5822	金属硅化物接触层的制造方	ZL200710094567.X	中芯上海、中芯北京	2007-12-13	2010-02-17	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法					北京：继受取得	
5823	形成器件隔离区的方法	ZL200710126588.5	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2009-12-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5824	光学近距修正的方法	ZL200710126596.X	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2009-11-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5825	在光罩上制作倾斜线路的方法	ZL200710126598.9	中芯上海、中芯北京	2007-06-22	2009-09-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5826	一种可避免氮氧化硅残留的沟槽隔离结构制作方法	ZL200710170745.2	中芯上海、中芯北京	2007-11-21	2010-07-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5827	一种双栅氧器件的栅极侧墙制造方法	ZL200810032346.4	中芯上海、中芯北京	2008-01-07	2010-08-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5828	一种可降低漏电流的氮化硅制作方法	ZL200810033052.3	中芯上海、中芯北京	2008-01-24	2010-08-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5829	TFT MONOS 或 SONOS 存储单元结构	ZL200810040283.7	中芯上海、中芯北京	2008-07-02	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5830	CMOS 图像传感器及其形成方法、半导体器件形成方法	ZL200810041370.4	中芯上海、中芯北京	2008-08-04	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5831	存储器装置及其提供电压供	ZL200810201786.8	中芯上海、中芯北京	2008-10-24	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	给的方法					北京：继受取得	
5832	半导体器件、双镶嵌结构的制作方法	ZL200810202963.4	中芯上海、中芯北京	2008-11-18	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5833	轻掺杂漏极的形成方法	ZL200810205381.1	中芯上海、中芯北京	2008-12-31	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5834	接触孔形成方法	ZL200810205386.4	中芯上海、中芯北京	2008-12-31	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5835	电荷泵	ZL200810205391.5	中芯上海、中芯北京	2008-12-31	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5836	结构为金属-绝缘体-金属的电容器制造方法	ZL200910045603.2	中芯上海、中芯新技术	2009-01-20	2012-05-30	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5837	半导体装置及其制造方法	ZL200910045898.3	中芯上海、中芯北京	2009-01-23	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5838	导电插塞的形成方法	ZL200910050664.8	中芯上海、中芯北京	2009-05-05	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5839	相变随机存取存储器的制造方法	ZL200910050988.1	中芯上海、中芯北京	2009-05-08	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5840	一种电容器及其制造方法	ZL200910052270.6	中芯上海、中芯北京	2009-05-31	2013-03-13	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5841	电阻存储器、含有电阻存储器的集成电路的制作方法、	ZL200910052942.3	中芯上海、中芯北京	2009-06-11	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5842	相似性检测方法和装置	ZL200910053144.2	中芯上海、中芯北京	2009-06-16	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5843	形成沟槽的方法	ZL200910053372.X	中芯上海、中芯北京	2009-06-18	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5844	提供晶圆的高温氧化物层均匀性的方法	ZL200910053376.8	中芯上海、中芯北京	2009-06-18	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5845	钝化光刻胶表面的方法以及光刻方法	ZL200910053501.5	中芯上海、中芯北京	2009-06-19	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5846	光刻方法	ZL200910054405.2	中芯上海、中芯北京	2009-07-03	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5847	化学机械抛光方法	ZL200910054547.9	中芯上海、中芯北京	2009-07-09	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5848	在晶圆上构造铜金属线的方法和铜的 CMP 方法	ZL200910054802.X	中芯上海、中芯北京	2009-07-14	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5849	抑制具有 STI 的硅片缺陷的方	ZL200910054804.9	中芯上海、中芯北京	2009-07-14	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	法及在硅片上构造 STI 的方法					北京：继受取得	
5850	刻蚀方法	ZL200910054941.2	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5851	掩模版图修正方法、掩模版制作方法和光学邻近校正方法，	ZL200910054943.1	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5852	形成相变材料的装置以及制造相变存储器的系统	ZL200910054946.5	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5853	失效检测方法以及失效检测装置	ZL200910054951.6	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5854	提高 MOS 晶体管载流子迁移率的方法	ZL200910054972.8	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-06-20	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5855	电阻存储器的制造方法	ZL200910054978.5	中芯上海、中芯北京	2009-07-16	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5856	检测半导体器件的大马士革结构的方法	ZL200910055431.7	中芯上海、中芯北京	2009-07-27	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5857	化学机械研磨方法	ZL200910055432.1	中芯上海、中芯北京	2009-07-27	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5858	闪存器件的多晶字线顶端区	ZL200910055433.6	中芯上海、中芯北京	2009-07-27	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	域的制作方法					北京：继受取得	
5859	减少浅沟道隔离槽的边角缺陷的方法	ZL200910055761.6	中芯上海、中芯北京	2009-07-31	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5860	半导体器件及其制造方法	ZL200910056015.9	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5861	存储器测试方法和外部测试仪	ZL200910056020.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5862	半导体器件的测试结构和测试方法	ZL200910056021.4	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5863	NMOS 晶体管的制造方法	ZL200910056022.9	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5864	应变记忆作用的半导体器件制造方法	ZL200910056023.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5865	CMOS 图像传感器介质层的抛光方法	ZL200910056029.0	中芯上海、中芯北京	2009-08-06	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5866	静态随机存取存储器	ZL200910056134.4	中芯上海、中芯北京	2009-08-07	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5867	化学机械研磨方法和装置	ZL200910056137.8	中芯上海、中芯北京	2009-08-07	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5868	沉积低介电常数绝缘材料层的方法	ZL200910056251.0	中芯上海、中芯北京	2009-08-11	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5869	半导体器件的制作方法	ZL200910056253.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-11	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5870	CMOS 图像传感器及其制造方法	ZL200910056518.6	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5871	多层互连结构及其形成方法	ZL200910056519.0	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5872	铜互连工艺中的化学机械抛光方法	ZL200910056524.1	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5873	半导体器件的形成方法	ZL200910056525.6	中芯上海、中芯北京	2009-08-14	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5874	STI 的形成方法	ZL200910056730.2	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5875	化学气相沉积设备的安装方法及化学气相沉积设备	ZL200910056731.7	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5876	颗粒自动控制方法及系统	ZL200910056736.x	中芯上海、中芯北京	2009-08-20	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5877	集成电路器件及其制备方法	ZL200910057964.9	中芯上海、中芯北京	2009-09-28	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5878	半导体器件、含包围圆柱形沟道的栅的晶体管及制造方法	ZL200910057965.3	中芯上海、中芯北京	2009-09-28	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5879	MOS 晶体管及制备其的方法	ZL200910057969.1	中芯上海、中芯北京	2009-09-28	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5880	超再生接收装置及方法	ZL200910194577.X	中芯上海、中芯北京	2009-08-25	2012-12-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5881	栅极及功率场效应管的制造方法	ZL200910194780.7	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5882	加热器及加热炉管	ZL200910194793.4	中芯上海、中芯北京	2009-08-28	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5883	提高芯片键合块抗腐蚀性的方法	ZL200910194850.9	中芯上海、中芯北京	2009-08-31	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5884	负偏压温度不稳定性的测试方法	ZL200910194851.3	中芯上海、中芯北京	2009-08-31	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5885	浮栅的构造方法	ZL200910194956.9	中芯上海、中芯北京	2009-09-01	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5886	构造浮栅的方法	ZL200910195016.1	中芯上海、中芯北京	2009-09-02	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5887	半导体装置的快速热退火方法	ZL200910195955.6	中芯上海、中芯北京	2009-09-17	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5888	半导体器件制造方法	ZL200910195978.7	中芯上海、中芯北京	2009-09-18	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5889	半导体器件、其制造方法以及包含其的集成电路和电子设备	ZL200910196266.7	中芯上海、中芯北京	2009-09-22	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5890	增大 PMOS 核心器件的工艺窗口的方法	ZL200910196423.4	中芯上海、中芯北京	2009-09-25	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5891	用于半导体制造的标准机械界面及其激光装配支架	ZL200910197247.6	中芯上海、中芯北京	2009-10-15	2013-01-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5892	用于半导体器件失效分析的检测方法	ZL200910197447.1	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5893	锗硅薄膜制备方法以及半导体器件制作方法	ZL200910197453.7	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
5894	具有共源结构的 MOS 晶体管及其制造方法	ZL200910197457.5	中芯上海、中芯北京	2009-10-20	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5895	承载晶圆的制作方法和承载晶圆	ZL200910197669.3	中芯上海、中芯北京	2009-10-23	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5896	有源区的制造方法	ZL200910197673.X	中芯上海、中芯北京	2009-10-23	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5897	用于化学机械抛光工艺中对抛光参数进行动态调整的方法	ZL200910197948.X	中芯上海、中芯北京	2009-10-30	2012-09-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5898	提高半导体元器件的性能的方法	ZL200910198092.8	中芯上海、中芯北京	2009-10-29	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5899	控制化学机械研磨时间的方法及系统	ZL200910198096.6	中芯上海、中芯北京	2009-10-29	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5900	偏移侧墙及 MOS 晶体管的形成方法	ZL200910198117.4	中芯上海、中芯北京	2009-11-02	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5901	互连结构及其制作方法	ZL200910198579.6	中芯上海、中芯北京	2009-11-10	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5902	半导体结构的形成方法	ZL200910198581.3	中芯上海、中芯北京	2009-11-10	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
						北京：继受取得	
5903	半导体器件的制造方法	ZL200910198599.3	中芯上海、中芯北京	2009-11-10	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5904	晶圆清洗方法	ZL200910199225.3	中芯上海、中芯北京	2009-11-20	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5905	形成栅极结构侧墙的方法	ZL200910199229.1	中芯上海、中芯北京	2009-11-20	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5906	改善等离子体工艺中反应腔室内部颗粒状况的方法	ZL200910200026.X	中芯上海、中芯北京	2009-12-04	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5907	掩模版图、掩模版制造方法和掩模版图校正方法	ZL200910201194.0	中芯上海、中芯北京	2009-12-15	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5908	半导体制造过程中的机台参数数据的处理方法和装置	ZL200910248081.6	中芯上海、中芯北京	2009-12-31	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5909	一种光学邻近修正方法	ZL201010022522.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-04	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5910	变容管及其制造方法	ZL201010022580.6	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5911	金属氧化物半导体场效应管	ZL201010022582.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	的制造方法					北京：继受取得	
5912	对用于湿法刻蚀的溶液进行预处理的方法	ZL201010022610.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2013-01-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5913	自动控制光刻胶厚度的方法和系统	ZL201010022613.7	中芯上海、中芯北京	2010-01-08	2012-07-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5914	金属硅化物接触层的形成方法以及场效应晶体管	ZL201010022699.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5915	亚分辨率辅助图形的设置以及光刻掩膜版的制作方法	ZL201010022716.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5916	光刻胶图形的修正方法	ZL201010022719.7	中芯上海、中芯北京	2010-01-12	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5917	掩膜版缺陷的判断方法及判断系统	ZL201010022874.9	中芯上海、中芯北京	2010-01-15	2012-08-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5918	衰减相移掩膜	ZL201010022875.3	中芯上海、中芯北京	2010-01-15	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5919	衰减相移掩膜制作方法	ZL201010022876.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-15	2012-10-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5920	一种辅助图案填充方法和装	ZL201010022887.6	中芯上海、中芯北京	2010-01-13	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	置					北京：继受取得	
5921	修复晶片边缘成像块散焦的方法	ZL201010022891.2	中芯上海、中芯北京	2010-01-14	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5922	一种监测曝光机台的曝光能量的方法和系统	ZL201010023132.8	中芯上海、中芯北京	2010-01-20	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5923	光阻去除方法	ZL201010102305.5	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5924	检测合金方块电阻的方法	ZL201010102366.1	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2013-01-30	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5925	一种在晶圆上制作定位标记的方法	ZL201010102382.0	中芯上海、中芯北京	2010-01-27	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5926	化学机械研磨终点的检测方法	ZL201010103998.X	中芯上海、中芯北京	2010-01-26	2012-09-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5927	绿色晶体管	ZL201010118815.1	中芯上海、中芯北京	2010-03-05	2012-08-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5928	热电装置	ZL201010118828.9	中芯上海、中芯北京	2010-03-05	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5929	光掩模版和使用所述光掩模	ZL201010123603.2	中芯上海、中芯北京	2010-03-12	2012-12-05	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	版的测试方法					北京：继受取得	
5930	设计光掩膜版的方法	ZL201010124698.X	中芯上海、中芯北京	2010-03-11	2012-09-05	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5931	曝光能量的控制方法	ZL201010136672.7	中芯上海、中芯北京	2010-03-26	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5932	光栅的制作方法	ZL201010153859.8	中芯上海、中芯北京	2010-04-13	2012-11-28	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5933	一种显影方法	ZL201010218057.0	中芯上海、中芯北京	2010-06-23	2012-10-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5934	一种改进的金属前介质层的构造方法	ZL201010272614.7	中芯上海、中芯北京	2010-08-27	2016-03-16	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
5935	一种制作鳍式场效应管的翅片结构方法	ZL201110227626.2	中芯上海、中芯新技术	2011-08-09	2015-08-19	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5936	FinFET 器件制造方法	ZL201110372141.2	中芯上海、中芯新技术	2011-11-21	2015-09-30	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5937	分栅快闪存储器及其形成方法	ZL201110427586.6	中芯上海、中芯新技术	2011-12-19	2016-01-06	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5938	一种 FinFET 器件的制造方法	ZL201110434023.X	中芯上海、中芯新技	2011-12-21	2016-02-17	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
			术			新技术：继受取得	
5939	n 型 MOS 场效管及形成方法，半导体器件及形成方法	ZL201110446082.9	中芯上海、中芯新技术	2011-12-27	2016-01-06	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5940	半导体防静电保护结构	ZL201110456995.9	中芯上海、中芯新技术	2011-12-30	2015-11-25	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5941	鳍式晶体管的形成方法	ZL201210071314.1	中芯上海、中芯新技术	2012-03-16	2015-12-16	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5942	鳍型反熔丝结构及其制造方法	ZL201210183500.4	中芯上海、中芯新技术	2012-06-05	2016-03-23	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5943	一种鳍片场效应晶体管的制备方法	ZL201210352666.4	中芯上海、中芯新技术	2012-09-20	2016-09-21	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5944	分立栅存储器件及其形成方法	ZL201210378507.1	中芯上海、中芯新技术	2012-09-29	2016-02-17	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5945	鳍式场效应晶体管及其形成方法	ZL201210406252.5	中芯上海、中芯新技术	2012-10-22	2016-05-25	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5946	鳍部的制作方法、鳍式场效应晶体管及其制作方法	ZL201210454786.5	中芯上海、中芯新技术	2012-11-13	2016-05-25	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5947	晶体管及其形成方法	ZL201210513882.2	中芯上海、中芯新技	2012-12-04	2016-06-29	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
			术			新技术：继受取得	
5948	鳍式双极结型晶体管及其形成方法	ZL201310156947.7	中芯上海、中芯新技术	2013-04-28	2016-08-31	中芯上海：原始取得；中芯新技术：继受取得	无
5949	一种嵌入式闪存的制作方法	ZL201310325281.3	中芯北方、中芯上海	2013-07-30	2017-08-01	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5950	半导体结构的形成方法	ZL201310337245.9	中芯北方、中芯上海	2013-08-05	2018-10-16	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5951	浮栅及其形成方法、闪存单元及其形成方法	ZL201310365627.2	中芯北方、中芯上海	2013-08-20	2017-12-29	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5952	硅通孔及其形成方法	ZL201310365827.8	中芯上海、中芯宁波	2013-08-20	2018-02-16	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
5953	半导体封装结构及其形成方法	ZL201310542790.1	中芯上海、中芯宁波	2013-11-05	2018-05-01	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
5954	提高数据保持能力的方法	ZL201310567433.0	中芯北方、中芯上海	2013-11-14	2017-11-24	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5955	一种集成电路及其制造方法	ZL201310697533.5	中芯上海、中芯宁波	2013-12-17	2018-02-06	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
5956	一种绝缘体上硅衬底及其制	ZL201310740266.5	中芯上海、中芯宁波	2013-12-27	2018-02-06	中芯上海：原始取得；中芯	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[3]	他项权利
	造方法					宁波：继受取得	
5957	一种制作嵌入式闪存栅极的方法	ZL201310740775.8	中芯北方、中芯上海	2013-12-27	2017-11-10	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5958	闪存器件及其形成方法	ZL201310745691.3	中芯北方、中芯上海	2013-12-30	2019-01-22	中芯上海：原始取得；中芯北方：继受取得	无
5959	接触孔的制作工艺	ZL200910049279.1	中芯深圳、中芯上海	2009-04-14	2012-05-09	中芯上海：原始取得；中芯深圳：继受取得	无
5960	提高刻蚀硬掩膜氧化层和氮化硅层刻蚀选择比的方法	ZL200910196428.7	中芯深圳	2009-09-25	2012-07-25	继受取得	无
5961	去除晶片上的光刻胶层的方法	ZL201010228209.5	中芯深圳、中芯上海、中芯北京	2010-07-08	2013-07-31	中芯上海：原始取得；中芯深圳、中芯上海：继受取得	无
5962	一种 CIS 图像传感器的失效信息自动分类方法及系统	ZL201310015074.8	中芯深圳、中芯上海	2013-01-15	2017-10-31	中芯上海：原始取得；中芯深圳：继受取得	无
5963	CMOS 图像传感器的像素结构及其形成方法	ZL201310461748.7	中芯深圳、中芯北京、中芯上海	2013-09-30	2018-03-30	中芯北京、中芯上海：原始取得；中芯深圳：继受取得	无
5964	半导体结构及其形成方法	ZL201410367329.1	中芯新技术	2014-07-29	2018-08-10	继受取得	无
5965	FinFET 器件及其形成方法	ZL201510005573.8	中芯新技术	2015-01-06	2018-12-21	继受取得	无

（二） 主要境内实用新型专利权[1]

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1	电荷耦合装置支架与导片机	ZL201220520491.9	中芯北京	2012-10-11	2013-03-13	原始取得	无
2	研磨垫调整器清洗装置及化学机械研磨装置	ZL201220521040.7	中芯北京	2012-10-11	2013-03-27	原始取得	无
3	晶圆盒抓扣器	ZL201220521055.3	中芯北京	2012-10-11	2013-03-13	原始取得	无
4	一种用于化学电镀机台的化学溶剂泄漏报警系统	ZL201220564508.0	中芯北京	2012-10-30	2013-04-24	原始取得	无
5	用于监控晶片加工机台的工序进度的装置	ZL201220603701.0	中芯北京	2012-11-15	2013-07-31	原始取得	无
6	一种三维预烧板	ZL201220680752.3	中芯北京	2012-12-11	2013-05-29	原始取得	无
7	液体连续供应装置	ZL201220748816.9	中芯北京	2012-12-31	2013-06-19	原始取得	无
8	一种用于半导体退火腔室的晶圆定位装置	ZL201320021256.1	中芯北京	2013-01-15	2013-09-04	原始取得	无
9	掩模板样品横断面切割工具	ZL201320028904.6	中芯北京	2013-01-18	2013-07-10	原始取得	无
10	晶舟及晶圆存放机构	ZL201320061526.1	中芯北京	2013-02-01	2013-07-31	原始取得	无
11	测量装置	ZL201320061818.5	中芯北京	2013-02-01	2013-07-31	原始取得	无
12	一种气体分流面板	ZL201320094041.2	中芯北京	2013-03-01	2013-08-14	原始取得	无

[1] 本表所列第 528 条至第 562 条取得方式为继受取得的实用新型专利权属于由发行人及其子公司自主研发、自主向国家知识产权局申请相应专利并于获得该专利权后将该专利权转让给本表所列的当前专利权人的情形。

[2] 本表中取得方式为继受取得系指在专利权授权后发生专利权人著录信息变更的情况，本表中取得方式为原始取得系指在专利权授权后未发生专利权人著录信息变更的情况。

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
13	冷凝水回收装置	ZL201320095323.4	中芯北京	2013-03-01	2013-09-04	原始取得	无
14	嵌件和电镀腔室设备	ZL201320188398.7	中芯北京	2013-04-15	2013-09-25	原始取得	无
15	一种晶圆洗边工艺的侦测系统	ZL201320263144.7	中芯北京	2013-05-15	2013-11-06	原始取得	无
16	插入式风道阀门及废气处理系统	ZL201320403970.7	中芯北京	2013-07-08	2013-12-18	原始取得	无
17	电迁移测试工具	ZL201320455924.1	中芯北京	2013-07-29	2014-01-08	原始取得	无
18	一种芯片封装测试结构	ZL201320456561.3	中芯北京	2013-07-29	2014-01-01	原始取得	无
19	清洁装置及检测机台	ZL201320456572.1	中芯北京	2013-07-29	2014-01-08	原始取得	无
20	静态随机存储晶胞的布局	ZL201320456575.5	中芯北京	2013-07-29	2014-02-12	原始取得	无
21	清洗设备	ZL201320456652.7	中芯北京	2013-07-29	2014-02-12	原始取得	无
22	切削工具	ZL201320509148.9	中芯北京	2013-08-20	2014-02-12	原始取得	无
23	检测电阻率的装置	ZL201320557521.8	中芯北京	2013-09-09	2014-02-19	原始取得	无
24	开门延时报警器	ZL201320557981.0	中芯北京	2013-09-09	2014-03-12	原始取得	无
25	晶圆识别结构	ZL201320587902.0	中芯北京	2013-09-23	2014-08-13	原始取得	无
26	酸槽清洗装置	ZL201320588164.1	中芯北京	2013-09-23	2014-03-19	原始取得	无
27	不间断电源电池管理装置	ZL201320588433.4	中芯北京	2013-09-23	2014-02-19	原始取得	无
28	一种衬垫及所适用的化学气相沉积反应设备	ZL201320645760.9	中芯北京	2013-10-18	2014-03-26	原始取得	无
29	气体喷嘴装置	ZL201320804019.2	中芯北京	2013-12-09	2014-06-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
30	屏蔽结构	ZL201320804357.6	中芯北京	2013-12-09	2014-06-04	原始取得	无
31	缺陷标准片	ZL201320804370.1	中芯北京	2013-12-09	2014-06-04	原始取得	无
32	晶圆盒传输驱动装置	ZL201320804569.4	中芯北京	2013-12-09	2014-06-04	原始取得	无
33	一种 MOM 电容结构	ZL201320804612.7	中芯北京	2013-12-09	2014-08-13	原始取得	无
34	终点探测装置和化学机械研磨装置	ZL201320805342.1	中芯北京	2013-12-09	2014-06-18	原始取得	无
35	光罩传送夹具	ZL201320878776.4	中芯北京	2013-12-27	2014-06-11	原始取得	无
36	保护晶圆表面的装置	ZL201320879155.8	中芯北京	2013-12-27	2014-10-22	原始取得	无
37	MIM 电容及包括该 MIM 电容的半导体器件	ZL201420042258.3	中芯北京	2014-01-22	2014-10-01	原始取得	无
38	一种用于光罩盒的除尘装置	ZL201420059997.3	中芯北京	2014-02-08	2014-07-09	原始取得	无
39	一种湿法蚀刻装置	ZL201420060913.8	中芯北京	2014-02-10	2014-07-23	原始取得	无
40	一种监测晶圆键合质量的测试结构	ZL201420070211.8	中芯北京	2014-02-18	2014-07-09	原始取得	无
41	一种用于识别光掩膜待量测图形的结构	ZL201420072328.X	中芯北京	2014-02-19	2014-09-10	原始取得	无
42	一种前端开口硅片片盒	ZL201420074436.0	中芯北京	2014-02-20	2014-10-22	原始取得	无
43	一种干燥设备	ZL201420101067.X	中芯北京	2014-03-06	2014-07-23	原始取得	无
44	一种封装结构	ZL201420103451.3	中芯北京	2014-03-07	2014-08-13	原始取得	无
45	一种接触孔搭桥测试结构	ZL201420103460.2	中芯北京	2014-03-07	2014-10-22	原始取得	无
46	一种间距记录装置	ZL201420103778.0	中芯北京	2014-03-07	2014-08-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
47	一种芯片保护结构	ZL201420107333.X	中芯北京	2014-03-11	2014-07-23	原始取得	无
48	一种洁净室鞋柜显示装置	ZL201420121815.0	中芯北京	2014-03-18	2014-07-30	原始取得	无
49	一种 MEMS 晶圆辅助切割的对准装置	ZL201420128522.5	中芯北京	2014-03-20	2014-07-30	原始取得	无
50	MIM 测试结构	ZL201420147550.1	中芯北京	2014-03-28	2014-08-13	原始取得	无
51	隔离结构及装载装置	ZL201420147567.7	中芯北京	2014-03-28	2014-10-22	原始取得	无
52	对准标记	ZL201420148077.9	中芯北京	2014-03-28	2014-08-13	原始取得	无
53	检测装置	ZL201420148714.2	中芯北京	2014-03-28	2014-11-26	原始取得	无
54	监控晶圆	ZL201420148820.0	中芯北京	2014-03-28	2014-08-13	原始取得	无
55	应力迁移测试结构	ZL201420148838.0	中芯北京	2014-03-28	2014-08-13	原始取得	无
56	一种主传动装置	ZL201420171059.2	中芯北京	2014-04-09	2014-08-20	原始取得	无
57	一种硅片放置装置	ZL201420204377.4	中芯北京	2014-04-24	2014-08-20	原始取得	无
58	一种用于晶圆的存储腔装置	ZL201420225691.0	中芯北京	2014-05-05	2014-09-10	原始取得	无
59	一种电熔丝结构	ZL201420226039.0	中芯北京	2014-05-05	2014-09-10	原始取得	无
60	一种检测键合准确性的测试结构	ZL201420226934.2	中芯北京	2014-05-05	2014-09-10	原始取得	无
61	一种 TSV 孔结构	ZL201420229532.8	中芯北京	2014-05-07	2014-09-24	原始取得	无
62	一种晶圆托盘	ZL201420231335.X	中芯北京	2014-05-07	2014-09-10	原始取得	无
63	研磨砂轮结构	ZL201420231651.7	中芯北京	2014-05-07	2014-09-01	原始取得	无
64	密封环结构	ZL201420231706.4	中芯北京	2014-05-07	2014-09-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
65	芯片放置装置	ZL201420234762.3	中芯北京	2014-05-08	2014-09-03	原始取得	无
66	一种自清洗过滤器	ZL201420234854.1	中芯北京	2014-05-09	2014-09-24	原始取得	无
67	一种晶圆温度监控装置	ZL201420237945.0	中芯北京	2014-05-09	2014-09-10	原始取得	无
68	一种变频冷却水泵热回收系统及热水供应系统	ZL201420237947.X	中芯北京	2014-05-09	2014-09-10	原始取得	无
69	去封装装置	ZL201420241887.9	中芯北京	2014-05-12	2014-11-26	原始取得	无
70	晶圆的切割道结构	ZL201420241890.0	中芯北京	2014-05-12	2014-10-22	原始取得	无
71	一种测试机台校准系统	ZL201420249877.X	中芯北京	2014-05-15	2014-10-01	原始取得	无
72	一种用于监测金属层短路的测试结构	ZL201420250467.7	中芯北京	2014-05-15	2014-09-24	原始取得	无
73	磨轮结构及研磨设备	ZL201420258867.2	中芯北京	2014-05-20	2014-10-22	原始取得	无
74	扶正装置及夹持系统	ZL201420258868.7	中芯北京	2014-05-20	2014-10-22	原始取得	无
75	一种限速气缸	ZL201420259138.9	中芯北京	2014-05-21	2014-11-26	原始取得	无
76	漏液侦测带及漏液侦测系统	ZL201420260116.4	中芯北京	2014-05-20	2014-10-22	原始取得	无
77	冲洗装置	ZL201420260156.9	中芯北京	2014-05-20	2014-11-26	原始取得	无
78	一种物理气相沉积室的屏蔽罩结构	ZL201420261997.1	中芯北京	2014-05-21	2014-09-24	原始取得	无
79	一种屏蔽板结构	ZL201420268517.4	中芯北京	2014-05-23	2014-10-15	原始取得	无
80	一种晶圆烘烤盘	ZL201420268744.7	中芯北京	2014-05-23	2014-09-24	原始取得	无
81	芯片结构	ZL201420275924.8	中芯北京	2014-05-27	2014-10-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
82	研磨头清洗装置和化学机械研磨设备	ZL201420276003.3	中芯北京	2014-05-27	2014-10-22	原始取得	无
83	一种测试结构	ZL201420287577.0	中芯北京	2014-05-30	2015-01-14	原始取得	无
84	用于除错的金属连线测试结构	ZL201420291026.1	中芯北京	2014-06-03	2014-10-22	原始取得	无
85	翻转机控制电路和晶圆翻转系统	ZL201420291258.7	中芯北京	2014-06-03	2014-10-22	原始取得	无
86	硅通孔结构	ZL201420291727.5	中芯北京	2014-06-03	2014-10-22	原始取得	无
87	显影液喷嘴组件和显影装置	ZL201420304963.6	中芯北京	2014-06-09	2014-10-15	原始取得	无
88	底盘调整工具	ZL201420313543.4	中芯北京	2014-06-12	2014-10-22	原始取得	无
89	导流装置以及电镀装置	ZL201420317685.8	中芯北京	2014-06-13	2014-10-22	原始取得	无
90	一种半导体测试结构	ZL201420347325.2	中芯北京	2014-06-26	2014-10-29	原始取得	无
91	MEMS 压力传感器和半导体结构	ZL201420348337.7	中芯北京	2014-06-26	2014-11-12	原始取得	无
92	一种芯片保护结构	ZL201420365691.0	中芯北京	2014-07-03	2014-11-12	原始取得	无
93	一种晶圆定位装置	ZL201420390825.4	中芯北京	2014-07-15	2014-11-26	原始取得	无
94	一种监测拉应力的测试结构	ZL201420413056.5	中芯北京	2014-07-24	2014-12-03	原始取得	无
95	辅助照射装置及晶圆检查系统	ZL201420416145.5	中芯北京	2014-07-25	2014-12-10	原始取得	无
96	键合晶圆、器件晶圆及键合结构	ZL201420416544.1	中芯北京	2014-07-25	2015-01-07	原始取得	无
97	底盘自动清洗装置	ZL201420416559.8	中芯北京	2014-07-25	2014-12-10	原始取得	无
98	研磨液供应系统和研磨装置	ZL201420417078.9	中芯北京	2014-07-25	2014-12-10	原始取得	无
99	悬臂式探针卡	ZL201420423514.3	中芯北京	2014-07-29	2014-12-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
100	可旋转式测试线缆接头	ZL201420429553.4	中芯北京	2014-07-31	2014-12-03	原始取得	无
101	一种测试光罩	ZL201420443996.9	中芯北京	2014-08-07	2014-12-03	原始取得	无
102	相变存储器	ZL201420470068.1	中芯北京	2014-08-20	2014-12-10	原始取得	无
103	一种接线工具	ZL201420470076.6	中芯北京	2014-08-20	2014-12-10	原始取得	无
104	一种物料传输系统	ZL201420471689.1	中芯北京	2014-08-20	2015-01-14	原始取得	无
105	一种焊盘结构	ZL201420479372.2	中芯北京	2014-08-22	2014-12-10	原始取得	无
106	鳍式场效晶体管	ZL201420547258.9	中芯北京	2014-09-22	2015-01-07	原始取得	无
107	可编程电子熔丝的测试结构	ZL201420547278.6	中芯北京	2014-09-22	2015-03-18	原始取得	无
108	供液系统	ZL201420547287.5	中芯北京	2014-09-22	2015-02-11	原始取得	无
109	一种化学品接头结构	ZL201420581402.0	中芯北京	2014-10-09	2015-04-29	原始取得	无
110	一种麦克风器件	ZL201420585027.7	中芯北京	2014-10-10	2015-01-14	原始取得	无
111	一种 MEMS 器件结构	ZL201420599699.3	中芯北京	2014-10-16	2015-01-14	原始取得	无
112	一种焊垫结构	ZL201420600038.8	中芯北京	2014-10-16	2015-03-25	原始取得	无
113	一种虚拟重布线层结构	ZL201420600489.1	中芯北京	2014-10-16	2015-03-18	原始取得	无
114	一种半导体测试结构	ZL201420603899.1	中芯北京	2014-10-17	2015-01-14	原始取得	无
115	铝焊垫以及金属连接结构	ZL201420611586.0	中芯北京	2014-10-21	2015-03-18	原始取得	无
116	MEMS 器件结构	ZL201420635945.6	中芯北京	2014-10-29	2015-04-08	原始取得	无
117	基座及 LPCVD 炉管	ZL201420774773.0	中芯北京	2014-12-10	2015-05-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
118	一种探针卡	ZL201420812301.X	中芯北京	2014-12-18	2015-04-15	原始取得	无
119	金属键合对准监控结构	ZL201520009969.5	中芯北京	2015-01-07	2015-05-06	原始取得	无
120	一种可靠性测试结构	ZL201520025452.5	中芯北京	2015-01-14	2015-05-13	原始取得	无
121	机械手臂辅助装置及机械手臂系统	ZL201520025537.3	中芯北京	2015-01-14	2015-06-17	原始取得	无
122	测试板装置及测试系统	ZL201520100596.2	中芯北京	2015-02-11	2015-06-24	原始取得	无
123	FinFET 自热效应检测结构	ZL201520100598.1	中芯北京	2015-02-11	2015-08-12	原始取得	无
124	相变存储器检测结构	ZL201520109516.X	中芯北京	2015-02-13	2015-05-27	原始取得	无
125	拆除工具	ZL201520111024.4	中芯北京	2015-02-15	2015-07-22	原始取得	无
126	掩模板定位装置	ZL201520111363.2	中芯北京	2015-02-15	2015-06-17	原始取得	无
127	电熔丝结构	ZL201520111365.1	中芯北京	2015-02-15	2015-05-27	原始取得	无
128	集成电路的虚拟图案以及半导体集成电路	ZL201520116170.6	中芯北京	2015-02-25	2015-06-17	原始取得	无
129	一种新风机组的冷却水热回收系统	ZL201520138309.7	中芯北京	2015-03-11	2015-07-22	原始取得	无
130	PIP 电容和嵌入式快闪存储器	ZL201520138365.0	中芯北京	2015-03-11	2015-06-17	原始取得	无
131	用于测试相变存储器的半导体结构	ZL201520162498.1	中芯北京	2015-03-20	2015-06-24	原始取得	无
132	硅通孔结构	ZL201520165910.5	中芯北京	2015-03-23	2015-06-24	原始取得	无
133	一种测试结构	ZL201520257661.2	中芯北京	2015-04-24	2015-09-16	原始取得	无
134	高空保护罩拆装装置	ZL201520334053.7	中芯北京	2015-05-22	2015-09-16	原始取得	无
135	一种 NH3 气供应系统的侦测装置	ZL201520334479.2	中芯北京	2015-05-22	2015-10-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
136	一种防止芯片切割分层的结构	ZL201520334592.0	中芯北京	2015-05-22	2015-08-26	原始取得	无
137	含鳍式场效应晶体管的静态随机存储器单元	ZL201520373254.8	中芯北京	2015-06-02	2015-09-23	原始取得	无
138	电迁移测试结构	ZL201520408049.0	中芯北京	2015-06-12	2015-10-21	原始取得	无
139	用于承载 Foup 的装载端口及设备前端装置	ZL201520431632.3	中芯北京	2015-06-19	2015-10-07	原始取得	无
140	静态随机存储器	ZL201520431866.8	中芯北京	2015-06-20	2016-01-20	原始取得	无
141	管路粉尘清洁器	ZL201520543423.8	中芯北京	2015-07-24	2015-12-09	原始取得	无
142	一种 SMIF 激光传感器检测及调整辅助工具	ZL201520567069.2	中芯北京	2015-07-31	2015-11-25	原始取得	无
143	一种屏蔽袋	ZL201520567070.5	中芯北京、中芯上海	2015-07-31	2016-02-17	原始取得	无
144	喷吐装置	ZL201520684721.9	中芯北京	2015-09-06	2016-02-03	原始取得	无
145	一种监测下层金属层间是否桥连的测试结构	ZL201520788447.X	中芯北京、中芯上海	2015-10-12	2016-02-03	原始取得	无
146	一种过滤器预湿系统	ZL201520788450.1	中芯北京、中芯上海	2015-10-12	2016-03-16	原始取得	无
147	一种半导体布局结构	ZL201520798554.0	中芯北京、中芯上海	2015-10-15	2016-02-03	原始取得	无
148	一种 MIM 结构	ZL201520801892.5	中芯北京、中芯上海	2015-10-13	2016-04-20	原始取得	无
149	一种静电保护二极管	ZL201520802428.8	中芯北京、中芯上海	2015-10-13	2016-02-03	原始取得	无
150	一种探测芯片分层的测试结构	ZL201520802604.8	中芯北京、中芯上海	2015-10-13	2016-02-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
151	翘曲晶圆承载器	ZL201520934572.7	中芯北京、中芯上海	2015-11-20	2016-03-16	原始取得	无
152	一种电镀装置	ZL201520999683.6	中芯北京、中芯上海	2015-12-04	2016-04-20	原始取得	无
153	一种具有浮渣检测功能的 CD 测试结构	ZL201521084198.2	中芯北京、中芯上海	2015-12-23	2016-05-18	原始取得	无
154	一种可靠性测试结构	ZL201521084406.9	中芯北京、中芯上海	2015-12-23	2016-05-18	原始取得	无
155	一种清洁器	ZL201521087460.9	中芯北京、中芯上海	2015-12-23	2016-06-15	原始取得	无
156	一种调节装置及调节组件	ZL201521089867.5	中芯北京、中芯上海	2015-12-24	2016-06-22	原始取得	无
157	一种微光显微镜装置	ZL201521089922.0	中芯北京、中芯上海	2015-12-24	2016-08-10	原始取得	无
158	一种重布线层结构	ZL201521091683.2	中芯北京、中芯上海	2015-12-24	2016-06-22	原始取得	无
159	一种盖板开启装置	ZL201620054359.1	中芯北京、中芯上海	2016-01-20	2016-06-15	原始取得	无
160	一种电迁移测试结构	ZL201620065682.9	中芯北京、中芯上海	2016-01-22	2016-07-06	原始取得	无
161	一种电迁移测试结构	ZL201620065685.2	中芯北京、中芯上海	2016-01-22	2016-07-06	原始取得	无
162	一种硅通孔的电迁移测试结构	ZL201620066266.0	中芯北京、中芯上海	2016-01-22	2016-08-31	原始取得	无
163	一种硅通孔的电迁移测试结构	ZL201620067522.8	中芯北京、中芯上海	2016-01-22	2016-07-06	原始取得	无
164	一种自热效应检测结构	ZL201620068011.8	中芯北京、中芯上海	2016-01-22	2016-07-06	原始取得	无
165	一种双列直插封装保护装置	ZL201620077557.X	中芯北京、中芯上海	2016-01-26	2016-07-06	原始取得	无
166	防静电破坏光罩	ZL201620110657.8	中芯北京、中芯上海	2016-02-03	2016-07-06	原始取得	无
167	晶圆固定装置及晶圆真空包装盒	ZL201620111134.5	中芯北京、中芯上海	2016-02-03	2016-07-06	原始取得	无
168	可防止开裂的半导体结构	ZL201620111960.X	中芯北京、中芯上海	2016-02-03	2016-07-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
169	一种晶体管电容测试结构	ZL201620117352.X	中芯北京、中芯上海	2016-02-05	2016-08-24	原始取得	无
170	一种研磨垫调整器	ZL201620133058.8	中芯北京、中芯上海	2016-02-22	2016-07-06	原始取得	无
171	一种炉管装置	ZL201620133333.6	中芯北京、中芯上海	2016-02-22	2016-07-06	原始取得	无
172	便携式硅片 P 型和 N 型快速区分仪	ZL201620133335.5	中芯北京、中芯上海	2016-02-22	2016-07-06	原始取得	无
173	一种实现晶圆传送盒粉尘收集的底盘装置	ZL201620144213.6	中芯北京、中芯上海	2016-02-25	2016-07-27	原始取得	无
174	一种 FFU 风压监测装置	ZL201620164370.3	中芯北京、中芯上海	2016-03-03	2016-07-27	原始取得	无
175	一种半导体测试结构	ZL201620195460.9	中芯北京、中芯上海	2016-03-14	2016-08-10	原始取得	无
176	具有对准标记的半导体结构	ZL201620223877.1	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-08-10	原始取得	无
177	研磨垫调整器及调整装置	ZL201620224125.7	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-08-10	原始取得	无
178	半导体测试结构	ZL201620224134.6	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-08-10	原始取得	无
179	研磨垫调整器	ZL201620224158.1	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-11-16	原始取得	无
180	具有对准标记的半导体结构	ZL201620224289.X	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-08-10	原始取得	无
181	研磨垫调整器	ZL201620224291.7	中芯北京、中芯上海	2016-03-22	2016-08-10	原始取得	无
182	自冷却半导体器件结构	ZL201620331461.1	中芯北京	2016-04-19	2016-08-24	原始取得	无
183	一种集成封装的芯片测试结构	ZL201620367664.6	中芯北京、中芯上海	2016-04-27	2016-09-14	原始取得	无
184	一种密封环布局结构	ZL201620372857.0	中芯北京、中芯上海	2016-04-27	2016-09-14	原始取得	无
185	一种可靠性测试装置	ZL201620384903.9	中芯北京、中芯上海	2016-04-29	2016-09-28	原始取得	无
186	一种晶圆显微镜光源结构	ZL201620386809.7	中芯北京、中芯上海	2016-04-29	2016-09-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
187	一种静电放电监测结构	ZL201620387602.1	中芯北京、中芯上海	2016-04-29	2016-09-14	原始取得	无
188	一种高压 MOS 器件栅氧层完整性测试结构	ZL201620402070.4	中芯北京、中芯上海	2016-05-05	2016-09-21	原始取得	无
189	一种化学品管路拆卸装置	ZL201620438544.0	中芯北京、中芯上海	2016-05-13	2016-09-28	原始取得	无
190	SMIF 加载端口下降保护装置及其 SMIF 装置	ZL201620438937.1	中芯北京、中芯上海	2016-05-13	2016-09-28	原始取得	无
191	一种电阻测试结构	ZL201620497278.9	中芯北京、中芯上海	2016-05-26	2016-12-07	原始取得	无
192	一种金属层间电介质性能的测试结构	ZL201620497296.7	中芯北京、中芯上海	2016-05-26	2016-11-30	原始取得	无
193	一种电迁移测试结构	ZL201620499361.X	中芯北京、中芯上海	2016-05-26	2016-12-07	原始取得	无
194	一种老化测试装置	ZL201620500549.1	中芯北京、中芯上海	2016-05-27	2016-11-30	原始取得	无
195	一种自热效应检测结构	ZL201620500587.7	中芯北京、中芯上海	2016-05-27	2016-12-07	原始取得	无
196	一种鳍式场效应晶体管寄生电容的测试结构	ZL201620502335.8	中芯北京、中芯上海	2016-05-27	2016-12-07	原始取得	无
197	一种鳍式场效应晶体管器件测试结构	ZL201620502354.0	中芯北京、中芯上海	2016-05-27	2016-12-07	原始取得	无
198	一种用于温度传感器芯片封装测试的封装结构	ZL201620502359.3	中芯北京、中芯上海	2016-05-27	2016-11-30	原始取得	无
199	一种半导体测试结构	ZL201620515398.7	中芯北京、中芯上海	2016-05-31	2016-12-07	原始取得	无
200	一种深 N 阱隔离测试结构	ZL201620517578.9	中芯北京、中芯上海	2016-05-31	2016-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
201	一种阀门装置	ZL201620640927.6	中芯北京、中芯上海	2016-06-24	2016-12-07	原始取得	无
202	定位安装装置	ZL201620713851.5	中芯北京、中芯上海	2016-07-07	2016-12-14	原始取得	无
203	一种用于静电放电保护的高密度栅极二极管	ZL201620749938.8	中芯北京、中芯上海	2016-07-15	2016-12-21	原始取得	无
204	半导体测试结构	ZL201620826110.8	中芯北京、中芯上海	2016-08-01	2017-01-04	原始取得	无
205	一种可靠性测试结构	ZL201620831432.1	中芯北京、中芯上海	2016-08-02	2017-01-18	原始取得	无
206	一种用于清洁刻蚀机台表面颗粒的清洁器	ZL201621079524.5	中芯北京、中芯上海	2016-09-26	2017-04-19	原始取得	无
207	3D 双栅极 GOI 测试结构	ZL201621082924.1	中芯北京、中芯上海	2016-09-26	2017-03-22	原始取得	无
208	滤毒盒储存装置	ZL201621094770.8	中芯北京、中芯上海	2016-09-29	2017-10-24	原始取得	无
209	SMIF 底盘调整及检测辅助工具	ZL201621113576.X	中芯北京、中芯上海	2016-10-11	2017-04-19	原始取得	无
210	校准模具	ZL201621147482.4	中芯北京、中芯上海	2016-10-21	2017-04-26	原始取得	无
211	离子源终止器及离子注入装置	ZL201621147484.3	中芯北京、中芯上海	2016-10-21	2017-04-19	原始取得	无
212	一种毛细检测管及真空度检测装置	ZL201621157685.1	中芯北京、中芯上海	2016-10-25	2017-05-24	原始取得	无
213	套准标记结构	ZL201621166257.5	中芯北京、中芯上海	2016-10-25	2017-04-19	原始取得	无
214	用于半导体制造车间火灾烟尘扩散抑制的气流系统	ZL201621167917.1	中芯北京、中芯上海	2016-11-01	2017-06-17	原始取得	无
215	晶圆托盘及晶圆支架	ZL201621167918.6	中芯北京、中芯上海	2016-11-01	2017-04-26	原始取得	无
216	法兰组件	ZL201621176451.1	中芯北京、中芯上海	2016-10-25	2017-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
217	后段工艺可靠性测试结构	ZL201621184399.4	中芯北京、中芯上海	2016-11-03	2017-05-03	原始取得	无
218	释放焊垫等离子体的 PID 测试结构	ZL201621184400.3	中芯北京、中芯上海	2016-11-03	2017-08-18	原始取得	无
219	一种 TDDB 测试结构	ZL201621192272.7	中芯北京、中芯上海	2016-11-03	2017-04-26	原始取得	无
220	一种应用于化学机械研磨的防护装置	ZL201621197169.1	中芯北京、中芯上海	2016-11-03	2017-08-29	原始取得	无
221	检测金属层间断裂的测试结构	ZL201621197189.9	中芯北京、中芯上海	2016-11-03	2017-04-26	原始取得	无
222	一种半导体器件及其制造方法和电子装置	ZL201621198320.3	中芯北京、中芯上海	2016-11-04	2017-05-03	原始取得	无
223	雨淋阀组	ZL201621198332.6	中芯北京、中芯上海	2016-11-04	2017-05-31	原始取得	无
224	一种测试结构	ZL201621345757.5	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-06-16	原始取得	无
225	识别超低 k 介质 TDDB 失效模式的测试结构	ZL201621347255.6	中芯北京、中芯上海	2016-12-08	2017-06-27	原始取得	无
226	一种晶圆可接受测试结构	ZL201621349542.0	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-07-07	原始取得	无
227	晶圆固定装置及晶圆测试夹具	ZL201621353171.3	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-09-08	原始取得	无
228	一种清洁装置	ZL201621353551.7	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-06-06	原始取得	无
229	一种接触电阻测试结构	ZL201621353554.0	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-06-16	原始取得	无
230	一种晶圆测试结构	ZL201621354110.9	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-07-07	原始取得	无
231	液位传感器校准装置	ZL201621354122.1	中芯北京、中芯上海	2016-12-09	2017-06-16	原始取得	无
232	电迁移测试结构	ZL201621360987.9	中芯北京、中芯上海	2016-12-12	2017-07-14	原始取得	无
233	离子萃取器及离子植入设备	ZL201621363132.1	中芯北京、中芯上海	2016-12-12	2017-06-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
234	离子中和反应器及离子植入设备	ZL201621363158.6	中芯北京、中芯上海	2016-12-12	2017-06-16	原始取得	无
235	半导体测试结构	ZL201621381185.6	中芯北京、中芯上海	2016-12-15	2017-06-27	原始取得	无
236	一种温控烤箱	ZL201621381353.1	中芯北京、中芯上海	2016-12-15	2017-07-11	原始取得	无
237	晶圆承载工具	ZL201621391986.0	中芯北京、中芯上海	2016-12-16	2017-07-28	原始取得	无
238	一种晶圆固定装置及晶圆清洗系统	ZL201621391987.5	中芯北京、中芯上海	2016-12-16	2017-06-16	原始取得	无
239	锁眼钥匙用定位工具	ZL201621392338.7	中芯北京、中芯上海	2016-12-16	2017-06-16	原始取得	无
240	研磨组件	ZL201621392840.8	中芯北京、中芯上海	2016-12-16	2017-06-27	原始取得	无
241	晶圆载台	ZL201621392873.2	中芯北京、中芯上海	2016-12-16	2017-08-11	原始取得	无
242	用于封装级可靠性测试的封装件	ZL201621408379.0	中芯北京、中芯上海	2016-12-20	2017-06-27	原始取得	无
243	一种测试结构	ZL201621424683.4	中芯北京、中芯上海	2016-12-22	2017-06-27	原始取得	无
244	一种 dome 温度补偿系统	ZL201621432164.2	中芯北京、中芯上海	2016-12-23	2017-06-27	原始取得	无
245	一种测试结构	ZL201621436041.6	中芯北京、中芯上海	2016-12-23	2017-08-18	原始取得	无
246	用于晶片盒的充抽气装置	ZL201621478047.X	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-21	原始取得	无
247	DIP 芯片引脚修复器	ZL201621487903.8	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-08-11	原始取得	无
248	研磨盘、研磨垫调整器及研磨装置	ZL201621492421.1	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-28	原始取得	无
249	接触电阻测试结构	ZL201621492590.5	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-21	原始取得	无
250	一种 IMD 可靠性测试结构	ZL201621492914.5	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-14	原始取得	无
251	一种 MOS 器件 HCI 可靠性测试结构	ZL201621492931.9	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
252	一种 TEM 样品承载装置	ZL201621492933.8	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-14	原始取得	无
253	一种降低颗粒污染的离子注入机	ZL201621493048.1	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-09-08	原始取得	无
254	一种光刻胶供应装置	ZL201621493050.9	中芯北京、中芯上海	2016-12-30	2017-07-21	原始取得	无
255	一种调整治具	ZL201720031227.1	中芯北京、中芯上海	2017-01-11	2017-08-11	原始取得	无
256	一种提高晶圆洗边精度的装置	ZL201720033202.5	中芯北京、中芯上海	2017-01-11	2017-08-11	原始取得	无
257	一种检测金属线短路的测试结构	ZL201720038222.1	中芯北京、中芯上海	2017-01-12	2017-10-24	原始取得	无
258	晶圆切割道结构	ZL201720067532.6	中芯北京、中芯上海	2017-01-18	2017-08-18	原始取得	无
259	老化测试扩展板	ZL201720098387.8	中芯北京、中芯上海	2017-01-26	2017-08-18	原始取得	无
260	半导体测试结构	ZL201720098391.4	中芯北京、中芯上海	2017-01-26	2017-08-29	原始取得	无
261	石英外管组件及炉管装置	ZL201720174656.4	中芯北京、中芯上海	2017-02-24	2017-10-20	原始取得	无
262	陶瓷管壳剥离清理设备	ZL201720268755.9	中芯北京、中芯上海	2017-03-17	2017-10-10	原始取得	无
263	半导体测试结构	ZL201720301547.4	中芯北京、中芯上海	2017-03-27	2017-10-20	原始取得	无
264	具有晶圆测试与激光修复功能的装置	ZL201720338320.7	中芯北京、中芯上海	2017-03-31	2017-11-21	原始取得	无
265	光刻机及其掩膜机台	ZL201720384958.4	中芯北京、中芯上海	2017-04-13	2017-12-15	原始取得	无
266	制备测试样品的工具	ZL201720384960.1	中芯北京、中芯上海	2017-04-13	2017-12-15	原始取得	无
267	晶圆测试结构	ZL201720384979.6	中芯北京、中芯上海	2017-04-13	2017-12-01	原始取得	无
268	晶圆传输装置	ZL201720385156.5	中芯北京、中芯上海	2017-04-13	2017-12-01	原始取得	无
269	半导体密封环和半导体装置	ZL201720390901.5	中芯北京、中芯上海	2017-04-14	2017-12-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
270	基座载台、基座组件及研磨装置	ZL201720458516.X	中芯北京、中芯上海	2017-04-27	2017-12-19	原始取得	无
271	光检测器测量设备	ZL201720463626.5	中芯北京、中芯上海	2017-04-28	2017-12-15	原始取得	无
272	晶圆盒底盘及晶圆盒	ZL201720505651.5	中芯北京、中芯上海	2017-05-09	2018-02-06	原始取得	无
273	一种干式真空泵余热再利用装置	ZL201720505652.X	中芯北京、中芯上海	2017-05-09	2017-12-29	原始取得	无
274	半导体测试结构	ZL201720510495.1	中芯北京、中芯上海	2017-05-09	2017-12-29	原始取得	无
275	半导体测试单元及半导体测试结构	ZL201720539267.7	中芯北京、中芯上海	2017-05-15	2018-03-30	原始取得	无
276	晶圆边缘缺陷去除装置	ZL201720778657.X	中芯北京、中芯上海	2017-06-30	2018-01-30	原始取得	无
277	测试连线结构及半导体测试结构	ZL201721331718.4	中芯北京、中芯上海	2017-10-16	2018-08-28	原始取得	无
278	旋转晶圆设备	ZL201820631446.8	中芯北京、中芯上海	2018-04-28	2018-11-16	原始取得	无
279	半导体测试结构	ZL201821131152.5	中芯北京、中芯上海	2018-07-17	2019-01-11	原始取得	无
280	用于污染物处理系统的 PH 值测量装置	ZL201020181599.0	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-04-29	2010-12-22	原始取得	无
281	一种水封箱	ZL201020200887.6	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上海	2010-05-21	2010-12-22	原始取得	无
282	安装模具	ZL201420103144.5	中芯天津、中芯上海	2014-03-07	2014-08-27	原始取得	无
283	FinFET 检测结构	ZL201521080660.1	中芯天津、中芯上海	2015-12-18	2016-05-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
284	用于消除集成电路天线效应的电路及射频功率放大器	ZL201620064263.3	中芯天津、中芯上海	2016-01-22	2016-08-24	原始取得	无
285	探针卡及测试系统	ZL201620064514.8	中芯天津、中芯上海	2016-01-22	2016-07-06	原始取得	无
286	半导体存储装置及其版图结构	ZL201620066783.8	中芯天津、中芯上海	2016-01-22	2016-06-22	原始取得	无
287	芯片	ZL201620242976.4	中芯天津、中芯上海	2016-03-25	2016-08-03	原始取得	无
288	测试座及测试装置	ZL201620324582.3	中芯天津、中芯上海	2016-04-15	2016-08-24	原始取得	无
289	半导体测试结构	ZL201620354317.X	中芯天津、中芯上海	2016-04-22	2016-09-14	原始取得	无
290	CMOS 器件测试结构及 CMOS 器件	ZL201620354804.6	中芯天津、中芯上海	2016-04-22	2016-08-24	原始取得	无
291	测试板	ZL201620360300.5	中芯北京	2016-04-26	2016-09-07	原始取得	无
292	半导体结构	ZL201620365429.5	中芯天津、中芯上海	2016-04-26	2016-09-07	原始取得	无
293	用于监控LDD掺杂区电阻的测试版图及测试结构	ZL201620427533.2	中芯天津、中芯上海	2016-05-10	2016-10-12	原始取得	无
294	栅氧化层完整性测试结构	ZL201620541909.2	中芯天津、中芯上海	2016-06-02	2016-11-23	原始取得	无
295	多图形光刻的检测结构	ZL201620541929.X	中芯天津、中芯上海	2016-06-02	2016-10-12	原始取得	无
296	FinFET 检测结构	ZL201620561686.6	中芯天津、中芯上海	2016-06-08	2016-11-02	原始取得	无
297	晶舟	ZL201620647353.5	中芯天津、中芯上海	2016-06-22	2016-11-09	原始取得	无
298	TSV 测试结构	ZL201620860472.9	中芯天津、中芯上海	2016-08-08	2017-01-04	原始取得	无
299	一种探针卡	ZL201620960220.3	中芯天津、中芯上海	2016-08-26	2017-04-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
300	监控 FinFET 器件自发热效应的结构	ZL201621163461.1	中芯天津、中芯上海	2016-10-25	2017-04-19	原始取得	无
301	半导体测试结构	ZL201621174162.8	中芯天津、中芯上海	2016-11-02	2017-04-19	原始取得	无
302	一种电化学电镀设备	ZL201621232155.9	中芯天津、中芯上海	2016-11-15	2017-05-24	原始取得	无
303	破片侦测装置	ZL201621430973.X	中芯天津、中芯上海	2016-12-23	2017-06-20	原始取得	无
304	流体供应装置及研磨设备	ZL201621472873.3	中芯天津、中芯上海	2016-12-30	2017-07-11	原始取得	无
305	清洁装置	ZL201720038126.7	中芯天津、中芯上海	2017-01-11	2017-11-14	原始取得	无
306	传输装置监控系统	ZL201720101638.3	中芯天津、中芯上海	2017-01-25	2017-11-14	原始取得	无
307	版图结构以及半导体结构	ZL201720105045.4	中芯天津、中芯上海	2017-01-24	2017-11-24	原始取得	无
308	晶边位置调整装置	ZL201720167709.X	中芯天津、中芯上海	2017-02-23	2017-09-19	原始取得	无
309	一种晶圆级环境可靠性测试载具及测试机台	ZL201720171046.9	中芯天津、中芯上海	2017-02-24	2017-09-19	原始取得	无
310	自热效应检测结构	ZL201720174214.X	中芯天津、中芯上海	2017-02-24	2017-12-19	原始取得	无
311	保护套件、机械手臂以及机台	ZL201720175101.1	中芯天津、中芯上海	2017-02-24	2017-09-19	原始取得	无
312	晶圆清洗装置	ZL201720219432.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-08	2017-10-20	原始取得	无
313	主轴驱动装置	ZL201720221555.8	中芯天津、中芯上海	2017-03-08	2017-12-19	原始取得	无
314	用于晶圆装卸台的检测工具	ZL201720231848.4	中芯天津、中芯上海	2017-03-10	2017-10-20	原始取得	无
315	提拉装置及搬运系统	ZL201720232905.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-10	2017-10-20	原始取得	无
316	晶圆盒测试装置、晶圆盒监测系统	ZL201720240274.7	中芯天津、中芯上海	2017-03-13	2017-11-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
317	晶圆量测机台	ZL201720249961.5	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-09-26	原始取得	无
318	一种升降机构及化学气相沉积装置	ZL201720250121.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-12-05	原始取得	无
319	半导体可靠性测试结构	ZL201720250132.9	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-10-20	原始取得	无
320	晶圆承载装置	ZL201720250932.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-10-20	原始取得	无
321	半导体测试结构	ZL201720252904.2	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-09-26	原始取得	无
322	底座	ZL201720253861.X	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-11-14	原始取得	无
323	研磨垫及化学机械研磨装置	ZL201720255456.1	中芯天津、中芯上海	2017-03-15	2017-10-20	原始取得	无
324	化学机械研磨设备	ZL201720257500.2	中芯天津、中芯上海	2017-03-16	2017-10-20	原始取得	无
325	清洗装置及机械研磨设备	ZL201720257511.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-16	2017-10-20	原始取得	无
326	旋转检测装置和基板清洗设备	ZL201720264235.0	中芯天津、中芯上海	2017-03-17	2017-10-20	原始取得	无
327	喷气装置以及包含该喷气装置的生产机台	ZL201720265850.3	中芯天津、中芯上海	2017-03-17	2017-10-20	原始取得	无
328	光罩及检测结构	ZL201720276071.3	中芯天津、中芯上海	2017-03-17	2017-12-05	原始取得	无
329	张紧装置及输送系统	ZL201720311532.6	中芯天津、中芯上海	2017-03-28	2017-11-14	原始取得	无
330	保护罩以及涂胶设备	ZL201720336072.2	中芯天津、中芯上海	2017-03-31	2018-03-27	原始取得	无
331	聚集器以及刻蚀机台	ZL201720516200.1	中芯天津、中芯上海	2017-05-09	2018-03-27	原始取得	无
332	探针卡及测试系统	ZL201720519102.3	中芯天津、中芯上海	2017-05-11	2018-01-30	原始取得	无
333	晶圆盒自动开关装置	ZL201720527980.X	中芯天津、中芯上海	2017-05-12	2018-03-02	原始取得	无
334	测试结构	ZL201720607616.4	中芯天津、中芯上海	2017-05-26	2017-12-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
335	工件检测工具、中和器系统和离子注入设备	ZL201720631088.6	中芯天津、中芯上海	2017-06-01	2017-12-19	原始取得	无
336	晶圆测试结构	ZL201720679463.4	中芯天津、中芯上海	2017-06-13	2018-02-13	原始取得	无
337	芯片及晶圆	ZL201720686106.0	中芯天津、中芯上海	2017-06-13	2018-05-15	原始取得	无
338	WAT 测试监控系统	ZL201720722359.9	中芯天津、中芯上海	2017-06-20	2018-01-26	原始取得	无
339	环形防护罩的变形修复装置	ZL201720790169.0	中芯天津、中芯上海	2017-07-03	2018-03-06	原始取得	无
340	尾气处理塔燃烧室端口清理装置和尾气处理塔	ZL201721017680.3	中芯天津、中芯上海	2017-08-15	2018-05-15	原始取得	无
341	晶舟包装工具和晶舟包装台	ZL201721188210.3	中芯天津、中芯上海	2017-09-18	2018-05-25	原始取得	无
342	喷嘴清洗装置及晶圆清洗装置	ZL201721193371.1	中芯天津、中芯上海	2017-09-18	2018-05-15	原始取得	无
343	晶圆测试装置	ZL201721194716.5	中芯天津、中芯上海	2017-09-18	2018-05-15	原始取得	无
344	晶圆及其晶圆允收测试结构	ZL201721198688.4	中芯天津、中芯上海	2017-09-19	2018-05-15	原始取得	无
345	心轴和晶圆清洗装置	ZL201721198745.9	中芯天津、中芯上海	2018-03-06	2018-05-15	原始取得	无
346	芯片	ZL201721406408.4	中芯天津、中芯上海	2017-10-27	2018-08-14	原始取得	无
347	晶圆传输装置及其机械手臂	ZL201721407149.7	中芯天津、中芯上海	2017-10-27	2018-06-15	原始取得	无
348	一种降低薄膜缺陷的晶圆定位结构	ZL201721509215.1	中芯天津、中芯上海	2017-11-13	2018-05-22	原始取得	无
349	半导体器件	ZL201721626458.3	中芯天津、中芯上海	2017-11-28	2018-07-13	原始取得	无
350	卡环结构件以及化学机械研磨装置	ZL201721697489.8	中芯天津、中芯上海	2017-12-08	2018-08-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
351	测试结构	ZL201721725841.4	中芯上海、中芯新技术	2017-12-12	2018-08-14	原始取得	无
352	晶舟	ZL201721751620.4	中芯天津、中芯上海	2017-12-15	2018-08-14	原始取得	无
353	晶圆刷盘	ZL201820244182.0	中芯天津、中芯上海	2018-02-11	2018-08-31	原始取得	无
354	晶圆夹具	ZL201820252057.4	中芯天津、中芯上海	2018-02-12	2018-08-31	原始取得	无
355	击穿栅氧化层的检测结构	ZL201820630282.7	中芯天津、中芯上海	2018-04-28	2018-11-16	原始取得	无
356	撬针,撬棒及撬起系统	ZL201420158116.3	中芯天津、中芯上海	2014-03-28	2014-08-27	原始取得	无
357	凸块结构及封装组件	ZL201520670333.5	中芯长电	2015-08-31	2015-12-16	原始取得	无
358	一种封装结构	ZL201520722893.0	中芯长电	2015-09-17	2015-12-30	原始取得	无
359	一种芯片封装结构	ZL201520749164.4	中芯长电	2015-09-24	2016-02-17	原始取得	无
360	一种堆叠型芯片封装结构	ZL201520749446.4	中芯长电	2015-09-24	2016-02-17	原始取得	无
361	一种扇出型封装结构	ZL201520869747.0	中芯长电	2015-11-03	2016-03-02	原始取得	无
362	一种铜柱凸点的封装结构	ZL201620042419.8	中芯长电	2016-01-15	2016-08-17	原始取得	无
363	一种扇出型芯片的封装结构	ZL201620067097.2	中芯长电	2016-01-22	2016-06-29	原始取得	无
364	一种扇出型芯片的封装结构	ZL201620067650.2	中芯长电	2016-01-22	2016-08-31	原始取得	无
365	双面扇出型晶圆级封装结构	ZL201620076472.X	中芯长电	2016-01-26	2016-09-14	原始取得	无
366	一种近间距铜针封装结构	ZL201620412905.4	中芯长电	2016-05-09	2016-09-28	原始取得	无
367	一种扇出型封装结构	ZL201620413420.7	中芯长电	2016-05-09	2017-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
368	一种用于堆叠式封装的铜针结构	ZL201620413831.6	中芯长电	2016-05-09	2016-09-21	原始取得	无
369	一种扇出型晶圆级封装件	ZL201620859975.4	中芯长电	2016-08-09	2017-03-22	原始取得	无
370	一种加热装置	ZL201720025828.1	中芯长电	2017-01-10	2017-08-15	原始取得	无
371	一种集成供电系统的封装件	ZL201720028551.8	中芯长电	2017-01-11	2017-08-15	原始取得	无
372	一种双面扇出型晶圆级封装结构	ZL201720039593.1	中芯长电	2017-01-13	2017-10-17	原始取得	无
373	一种双面扇出型晶圆级封装结构	ZL201720040002.2	中芯长电	2017-01-13	2017-10-17	原始取得	无
374	塑封材料过孔	ZL201720053598.X	中芯长电	2017-01-17	2017-10-17	原始取得	无
375	一种电镀机及其隔膜支撑件	ZL201720136539.9	中芯长电	2017-02-15	2017-10-17	原始取得	无
376	一种晶圆片级芯片规模封装结构	ZL201720228557.X	中芯长电	2017-03-10	2018-05-04	原始取得	无
377	一种晶圆片级芯片规模封装结构	ZL201720228565.4	中芯长电	2017-03-10	2018-05-04	原始取得	无
378	具有凸块保护结构的倒装芯片	ZL201720282131.2	中芯长电	2017-03-22	2017-10-17	原始取得	无
379	一种扇出型晶圆级封装结构	ZL201720282135.0	中芯长电	2017-03-22	2017-10-17	原始取得	无
380	一种扇出型晶圆级封装结构	ZL201720282824.1	中芯长电	2017-03-22	2017-10-17	原始取得	无
381	一种封装结构	ZL201720473077.X	中芯长电	2017-04-28	2017-12-15	原始取得	无
382	扇出型晶圆级封装结构	ZL201720531294.X	中芯长电	2017-05-15	2017-12-15	原始取得	无
383	重新布线层及具有所述重新布线层的封装结构	ZL201720531295.4	中芯长电	2017-05-15	2018-03-30	原始取得	无
384	扇出型晶圆级封装结构	ZL201720532367.7	中芯长电	2017-05-15	2017-12-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
385	一种半导体制程检测装置	ZL201720726312.X	中芯长电	2017-06-21	2018-01-26	原始取得	无
386	扇出型单裸片封装结构	ZL201720729863.1	中芯长电	2017-06-21	2018-01-26	原始取得	无
387	具有 3D 堆叠天线的扇出型封装结构	ZL201720729865.0	中芯长电	2017-06-21	2018-01-26	原始取得	无
388	扇出型晶圆级封装结构	ZL201720729908.5	中芯长电	2017-06-21	2018-01-26	原始取得	无
389	指纹识别芯片的封装结构	ZL201720780717.1	中芯长电	2017-06-30	2018-04-17	原始取得	无
390	指纹识别芯片的封装结构	ZL201720781358.1	中芯长电	2017-06-30	2018-03-30	原始取得	无
391	指纹识别芯片的封装结构	ZL201720781880.X	中芯长电	2017-06-30	2018-05-11	原始取得	无
392	扇出型叠层封装结构	ZL201720806310.1	中芯长电	2017-07-05	2018-01-26	原始取得	无
393	扇出型系统级封装结构	ZL201720806935.8	中芯长电	2017-07-05	2018-04-17	原始取得	无
394	双面塑封扇出型系统级叠层封装结构	ZL201720807453.4	中芯长电	2017-07-05	2018-01-26	原始取得	无
395	EMI 防护的芯片封装结构	ZL201720856663.2	中芯长电	2017-07-14	2018-03-30	原始取得	无
396	人脸识别芯片的封装结构	ZL201720930351.1	中芯长电	2017-07-28	2018-02-13	原始取得	无
397	人脸识别芯片的封装结构	ZL201720931793.8	中芯长电	2017-07-28	2018-04-10	原始取得	无
398	半导体芯片的封装结构	ZL201720931811.2	中芯长电	2017-07-28	2018-05-04	原始取得	无
399	扇出型封装结构	ZL201720956156.6	中芯长电	2017-08-02	2018-06-15	原始取得	无
400	扇出型封装结构	ZL201720956158.5	中芯长电	2017-08-02	2018-03-16	原始取得	无
401	3D 系统级扇出型封装结构	ZL201720956173.X	中芯长电	2017-08-02	2018-03-16	原始取得	无
402	扇出型封装结构	ZL201720956807.1	中芯长电	2017-08-02	2018-03-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
403	半导体结构及扇出型封装结构	ZL201720957269.8	中芯长电	2017-08-02	2018-04-10	原始取得	无
404	半导体芯片的封装结构	ZL201721130419.4	中芯长电	2017-09-05	2018-03-30	原始取得	无
405	集成图像传感器芯片及逻辑芯片的封装结构	ZL201721131033.5	中芯长电	2017-09-05	2018-03-30	原始取得	无
406	背照式 CMOS 传感器的封装结构	ZL201721131593.0	中芯长电	2017-09-05	2018-05-11	原始取得	无
407	指纹识别芯片的封装结构	ZL201721136285.7	中芯长电	2017-09-06	2018-07-06	原始取得	无
408	指纹识别芯片的封装结构	ZL201721136336.6	中芯长电	2017-09-06	2018-06-15	原始取得	无
409	CMOS 图像传感器扇出型封装结构	ZL201721136991.1	中芯长电	2017-09-06	2018-06-15	原始取得	无
410	指纹识别芯片的封装结构	ZL201721142911.3	中芯长电	2017-09-07	2018-06-15	原始取得	无
411	一种三维芯片封装结构	ZL201721271536.2	中芯长电	2017-09-29	2018-04-17	原始取得	无
412	一种封装结构	ZL201721305892.1	中芯长电	2017-10-11	2018-04-17	原始取得	无
413	一种重新布线层结构	ZL201721310241.1	中芯长电	2017-10-12	2018-09-11	原始取得	无
414	一种水冷型扇出封装结构	ZL201721310319.X	中芯长电	2017-10-12	2018-05-22	原始取得	无
415	晶圆级芯片封装结构	ZL201721319954.4	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
416	晶圆级芯片封装结构	ZL201721319985.X	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
417	晶圆级芯片封装结构	ZL201721320009.6	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
418	晶圆级芯片封装结构	ZL201721320689.1	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
419	半导体封装结构	ZL201721320690.4	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
420	晶圆级芯片封装结构	ZL201721320704.2	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
421	晶圆级芯片封装结构	ZL201721321262.3	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
422	晶圆级芯片封装结构	ZL201721321264.2	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
423	EMI 防护的芯片封装结构	ZL201721321272.7	中芯长电	2017-10-13	2018-06-12	原始取得	无
424	3D 芯片封装结构	ZL201721321344.8	中芯长电	2017-10-13	2018-04-17	原始取得	无
425	扇出型天线封装结构	ZL201721385505.X	中芯长电	2017-10-25	2018-09-11	原始取得	无
426	扇出型天线结构	ZL201721386243.9	中芯长电	2017-10-25	2018-09-11	原始取得	无
427	扇出型天线封装结构	ZL201721392633.7	中芯长电	2017-10-25	2018-09-11	原始取得	无
428	一种封装结构	ZL201721443330.3	中芯长电	2017-11-01	2018-05-22	原始取得	无
429	背照式图像传感器封装结构	ZL201721512629.X	中芯长电	2017-11-14	2018-06-19	原始取得	无
430	芯片尺寸封装结构	ZL201721646937.1	中芯长电	2017-12-01	2018-06-15	原始取得	无
431	一种扇出型天线封装结构	ZL201721662203.2	中芯长电	2017-12-04	2018-06-15	原始取得	无
432	扇出型天线封装结构	ZL201721662883.8	中芯长电	2017-12-04	2018-06-15	原始取得	无
433	半导体封装结构	ZL201721686009.8	中芯长电	2017-12-07	2018-06-19	原始取得	无
434	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721686036.5	中芯长电	2017-12-07	2018-06-19	原始取得	无
435	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721686038.4	中芯长电	2017-12-07	2018-06-19	原始取得	无
436	具有天线组件的半导体结构	ZL201721686053.9	中芯长电	2017-12-07	2018-06-19	原始取得	无
437	扇出型封装结构	ZL201721686076.X	中芯长电	2017-12-07	2018-06-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
438	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721686204.0	中芯长电	2017-12-07	2018-07-06	原始取得	无
439	具有天线组件的扇出型半导体封装结构	ZL201721686212.5	中芯长电	2017-12-07	2018-10-16	原始取得	无
440	具有天线结构的双面塑封扇出型封装结构	ZL201721686213.X	中芯长电	2017-12-07	2018-09-11	原始取得	无
441	一种扇出型晶圆级封装结构	ZL201721827868.4	中芯长电	2017-12-22	2018-07-17	原始取得	无
442	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721855101.2	中芯长电	2017-12-27	2018-09-11	原始取得	无
443	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721855105.0	中芯长电	2017-12-27	2018-09-11	原始取得	无
444	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721855634.0	中芯长电	2017-12-27	2018-09-11	原始取得	无
445	具有天线组件的半导体封装结构	ZL201721855671.1	中芯长电	2017-12-27	2018-09-11	原始取得	无
446	发光二极管芯片的封装结构	ZL201721889096.7	中芯长电	2017-12-29	2018-09-11	原始取得	无
447	发光二极管芯片的封装结构	ZL201721889098.6	中芯长电	2017-12-29	2018-09-11	原始取得	无
448	半导体芯片的封装结构	ZL201721901346.4	中芯长电	2017-12-29	2018-09-11	原始取得	无
449	半导体芯片的封装结构	ZL201721904125.2	中芯长电	2017-12-29	2018-09-11	原始取得	无
450	一种 MEMS 晶圆级封装结构	ZL201721920803.4	中芯长电	2017-12-29	2018-10-16	原始取得	无
451	具有电磁防护的扇出型天线封装结构	ZL201820017432.7	中芯长电	2018-01-05	2018-09-11	原始取得	无
452	指纹识别芯片的封装结构	ZL201820145785.5	中芯长电	2018-01-29	2018-09-11	原始取得	无
453	指纹识别芯片的封装结构	ZL201820146523.0	中芯长电	2018-01-29	2018-10-16	原始取得	无
454	天线的封装结构	ZL201820359326.7	中芯长电	2018-03-16	2018-10-02	原始取得	无
455	天线的封装结构	ZL201820359524.3	中芯长电	2018-03-16	2019-01-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
456	天线的封装结构	ZL201820359825.6	中芯长电	2018-03-16	2019-01-04	原始取得	无
457	快速冷却系统	ZL201820504502.1	中芯长电	2018-04-09	2019-01-04	原始取得	无
458	自动清洗系统	ZL201820585003.X	中芯长电	2018-04-23	2018-04-23	原始取得	无
459	天线的封装结构	ZL201820685341.0	中芯长电	2018-05-09	2019-05-07	原始取得	无
460	具有曝光功能的涂胶机	ZL201820708249.1	中芯长电	2018-05-14	2018-11-23	原始取得	无
461	具有曝光功能的显影机	ZL201820708262.7	中芯长电	2018-05-14	2018-11-23	原始取得	无
462	垂直打线结构及堆叠芯片封装结构	ZL201820728461.4	中芯长电	2018-05-16	2018-12-21	原始取得	无
463	一种基于 RDL 金属线的结构	ZL201821192504.8	中芯长电	2018-07-25	2019-03-22	原始取得	无
464	一种半导体垂直打线结构	ZL201821264947.3	中芯长电	2018-08-06	2019-05-10	原始取得	无
465	扇出型天线封装结构	ZL201821346487.9	中芯长电	2018-08-20	2019-04-12	原始取得	无
466	扇出型天线封装结构	ZL201821346590.3	中芯长电	2018-08-20	2019-03-22	原始取得	无
467	扇出型天线封装结构	ZL201821755416.4	中芯长电	2018-10-26	2019-04-30	原始取得	无
468	扇出型天线封装结构	ZL201821755419.8	中芯长电	2018-10-26	2019-04-30	原始取得	无
469	半导体封装装置	ZL201821881567.4	中芯长电	2018-11-15	2019-05-24	原始取得	无
470	天线封装结构	ZL201822019564.6	中芯长电	2018-12-03	2019-06-04	原始取得	无
471	天线封装结构	ZL201822019596.6	中芯长电	2018-12-03	2019-07-09	原始取得	无
472	天线封装结构	ZL201822019599.X	中芯长电	2018-12-03	2019-06-14	原始取得	无
473	扇出型天线封装结构	ZL201822037818.7	中芯长电	2018-12-06	2019-09-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
474	具有空气腔的扇出型天线封装结构	ZL201822037827.6	中芯长电	2018-12-06	2019-06-04	原始取得	无
475	MEMS 封装结构及晶圆级 MEMS 封装结构	ZL201822037983.2	中芯长电	2018-12-06	2019-11-05	原始取得	无
476	三维封装天线	ZL201822157059.8	中芯长电	2018-12-21	2019-07-09	原始取得	无
477	封装结构	ZL201822232712.2	中芯长电	2018-12-28	2019-07-12	原始取得	无
478	封装结构	ZL201920034289.7	中芯长电	2019-01-09	2019-07-19	原始取得	无
479	半导体结构	ZL201920148614.2	中芯长电	2019-01-28	2019-12-17	原始取得	无
480	半导体结构	ZL201920148747.X	中芯长电	2019-01-28	2019-12-17	原始取得	无
481	半导体结构	ZL201920148750.1	中芯长电	2019-01-28	2019-12-17	原始取得	无
482	天线的封装结构	ZL201920206411.4	中芯长电	2019-02-18	2019-08-16	原始取得	无
483	扇出型封装结构	ZL201920269683.9	中芯长电	2019-03-04	2019-08-30	原始取得	无
484	天线的封装结构	ZL201920269698.5	中芯长电	2019-03-04	2019-08-30	原始取得	无
485	天线的封装结构	ZL201920270043.X	中芯长电	2019-03-04	2019-08-30	原始取得	无
486	半导体封装结构	ZL201920344217.2	中芯长电	2019-03-19	2019-09-13	原始取得	无
487	半导体封装结构	ZL201920344328.3	中芯长电	2019-03-19	2019-09-13	原始取得	无
488	扇出型 LED 的封装结构及电子显示屏	ZL201920354004.8	中芯长电	2019-03-20	2019-11-19	原始取得	无
489	晶圆级扇出型 LED 的封装结构	ZL201920354021.1	中芯长电	2019-03-20	2019-11-29	原始取得	无
490	扇出型 LED 的封装结构及电子显示屏	ZL201920354025.X	中芯长电	2019-03-20	2019-12-17	原始取得	无
491	扇出型 LED 的封装结构及电子显示屏	ZL201920354044.2	中芯长电	2019-03-20	2019-12-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
492	一种封装结构	ZL201920390906.7	中芯长电	2019-03-26	2019-03-26	原始取得	无
493	天线封装结构	ZL201920433772.2	中芯长电	2019-04-02	2019-10-18	原始取得	无
494	天线封装结构	ZL201920433922.X	中芯长电	2019-04-02	2019-10-18	原始取得	无
495	天线封装结构	ZL201920433959.2	中芯长电	2019-04-02	2019-09-24	原始取得	无
496	扇出型 LED 的封装结构及电子设备	ZL201920451896.3	中芯长电	2019-04-03	2019-10-11	原始取得	无
497	一种半导体封装结构以及半导体多层芯片封装结构	ZL201920667688.7	中芯长电	2019-05-10	2019-12-31	原始取得	无
498	一种晶圆级芯片封装结构	ZL201920675939.6	中芯长电	2019-05-13	2019-10-25	原始取得	无
499	半导体封装结构	ZL201920735268.8	中芯长电	2019-05-22	2019-11-15	原始取得	无
500	天线封装结构	ZL201920747858.2	中芯长电	2019-05-23	2019-11-15	原始取得	无
501	天线封装结构	ZL201920748307.8	中芯长电	2019-05-23	2019-11-15	原始取得	无
502	具有空气腔室的天线封装结构	ZL201920759738.4	中芯长电	2019-05-24	2019-11-26	原始取得	无
503	具有空气腔室的天线封装结构	ZL201920760439.2	中芯长电	2019-05-24	2019-11-26	原始取得	无
504	芯片封装结构	ZL201920789104.3	中芯长电	2019-05-29	2019-11-19	原始取得	无
505	芯片封装结构	ZL201920789122.1	中芯长电	2019-05-29	2019-11-19	原始取得	无
506	半导体封装结构	ZL201920824527.4	中芯长电	2019-06-03	2019-12-17	原始取得	无
507	半导体封装结构	ZL201920824530.6	中芯长电	2019-06-03	2019-11-26	原始取得	无
508	半导体封装结构	ZL201920834721.0	中芯长电	2019-06-04	2019-12-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
509	半导体封装结构	ZL201920834726.3	中芯长电	2019-06-04	2019-12-17	原始取得	无
510	扇出型天线封装结构	ZL201920852097.7	中芯长电	2019-06-06	2019-12-17	原始取得	无
511	3D 芯片封装结构	ZL201920852233.2	中芯长电	2019-06-06	2019-12-17	原始取得	无
512	一种指纹识别芯片的封装结构	ZL201920855038.5	中芯长电	2019-06-06	2019-12-17	原始取得	无
513	CP 探针机	ZL201920859032.5	中芯长电	2019-06-06	2019-12-24	原始取得	无
514	扇出型指纹识别芯片的封装结构	ZL201920869199.X	中芯长电	2019-06-11	2019-12-24	原始取得	无
515	半导体封装结构	ZL201920942482.0	中芯长电	2019-06-21	2019-12-31	原始取得	无
516	三维扇出型指纹识别芯片的封装结构	ZL201920987730.3	中芯长电	2019-06-28	2019-12-31	原始取得	无
517	扇出型指纹识别芯片的封装结构	ZL201920987747.9	中芯长电	2019-06-28	2019-12-31	原始取得	无
518	三维扇出型指纹识别芯片的封装结构	ZL201920987763.8	中芯长电	2019-06-28	2019-12-31	原始取得	无
519	扇出型指纹识别芯片的封装结构	ZL201920987830.6	中芯长电	2019-06-28	2019-12-31	原始取得	无
520	双极化封装天线	ZL201921013188.8	中芯长电	2019-07-01	2019-12-31	原始取得	无
521	单极化封装天线	ZL201921013314.X	中芯长电	2019-07-01	2019-12-31	原始取得	无
522	半导体封装结构	ZL201921034849.5	中芯长电	2019-07-04	2019-12-31	原始取得	无
523	半导体封装结构	ZL201921037791.X	中芯长电	2019-07-04	2019-12-31	原始取得	无
524	WB 金属线	ZL201921039983.4	中芯长电	2019-07-04	2019-12-31	原始取得	无
525	检测晶片	ZL201120130636.X	武汉新芯集成电路制造有限公司、中芯上	2011-04-28	2011-10-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
			海				
526	用于保护芯片的密封环结构和芯片单元	ZL201420456122.7	中芯北京	2014-08-12	2015-01-07	原始取得	无
527	晶片测试样品	ZL201420827513.5	中芯北京	2014-12-23	2015-04-15	原始取得	无
528	应用于预真空腔室托盘的销	ZL201020210210.0	中芯北京	2010-05-28	2011-02-02	继受取得	无
529	电子标签架	ZL201020216098.1	中芯北京	2010-06-04	2011-02-02	继受取得	无
530	一种避免 PVD 腔室中射频和热辐射泄漏的保护罩	ZL201020216107.7	中芯北京	2010-06-04	2011-02-02	继受取得	无
531	一种电压压降警报输出装置	ZL201020246399.9	中芯北京	2010-06-30	2011-04-20	继受取得	无
532	一种固定对准装置	ZL201020246551.3	中芯北京	2010-06-30	2011-03-23	继受取得	无
533	用于在退火工艺中放置晶圆的工艺设备	ZL201020266002.2	中芯北京	2011-04-08	2011-08-24	继受取得	无
534	一种 SMIF 装置	ZL201020266018.3	中芯北京	2010-07-21	2011-06-01	继受取得	无
535	定位销及包含该定位销的预清洗腔室	ZL201020506060.8	中芯北京	2010-08-26	2011-06-08	继受取得	无
536	防信号干扰装置及包含该防信号干扰装置的溅射机台	ZL201020506230.2	中芯北京	2010-08-26	2011-06-08	继受取得	无
537	一种探针卡	ZL201020565136.4	中芯北京	2010-10-16	2011-05-25	继受取得	无
538	抗变形的晶舟	ZL201020600885.6	中芯北京	2010-11-09	2011-06-08	继受取得	无
539	用于清洗仪表探头的气洗装置及氢氟处理系统	ZL201020639425.4	中芯北京	2010-12-02	2011-08-24	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
540	一种化学机械研磨设备	ZL201020673640.6	中芯北京	2010-12-21	2011-08-03	继受取得	无
541	一种化学机械研磨设备	ZL201020674172.4	中芯北京	2010-12-21	2011-10-05	继受取得	无
542	一种抛光垫	ZL201020683507.9	中芯北京	2010-12-27	2011-11-30	继受取得	无
543	用于灌溉供水阀的支架	ZL201020694394.2	中芯北京	2010-12-30	2011-09-07	继受取得	无
544	研磨头	ZL201120054526.X	中芯北京	2011-03-03	2011-11-30	继受取得	无
545	研磨头,研磨垫修整器及研磨装置	ZL201120092541.3	中芯北京	2011-03-31	2011-11-30	继受取得	无
546	研磨头和研磨装置	ZL201120160501.8	中芯北京	2011-05-19	2011-12-28	继受取得	无
547	晶圆清洗装置以及化学机械研磨设备	ZL201120294010.2	中芯北京	2011-08-12	2012-03-28	继受取得	无
548	研磨装置	ZL201120294220.1	中芯北京	2011-08-12	2012-03-28	继受取得	无
549	等离子体反应器	ZL201120322309.4	中芯北京	2011-08-30	2012-05-02	继受取得	无
550	等离子体反应器	ZL201120372913.8	中芯北京	2011-09-30	2012-05-23	继受取得	无
551	光罩盒存放柜	ZL201120395791.4	中芯北京	2011-10-17	2012-06-20	继受取得	无
552	防金属腐蚀装置及研磨设备	ZL201120465091.8	中芯北京	2011-11-21	2012-07-11	继受取得	无
553	研磨装置	ZL201120465096.0	中芯北京	2011-11-21	2012-08-01	继受取得	无
554	自给水型散热片自动冲洗器及空调机组	ZL201120468249.7	中芯北京	2011-11-21	2012-07-11	继受取得	无
555	接头固定装置及炉管	ZL201120510277.0	中芯北京	2011-12-08	2012-08-01	继受取得	无
556	校准模具	ZL201120545530.6	中芯北京	2011-12-22	2012-08-08	继受取得	无
557	一种热电偶保护装置	ZL201120571321.9	中芯北京	2011-12-30	2012-09-12	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
558	清洗刷及清洗装置	ZL201120571992.5	中芯北京	2011-12-30	2012-08-29	继受取得	无
559	研磨温控系统和研磨装置	ZL201220079635.1	中芯北京	2012-03-05	2012-10-03	继受取得	无
560	晶圆升降机	ZL201220227458.7	中芯北京	2012-05-17	2012-12-12	继受取得	无
561	晶圆清洗刷及晶圆清洗装置	ZL201220293460.4	中芯北京	2012-06-20	2012-12-26	继受取得	无
562	一种测量关键尺寸的扫描电子显微镜校准用样品	ZL201220328146.5	中芯北京	2012-07-06	2013-01-30	继受取得	无

（三） 主要境外专利权[1]

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1	Method of making strained semiconductor cmos transistors having lattice-mismatched regions	DE602004032035	DE20046032035T	中芯国际	德国	发明	2004-08-04	2011-05-12	继受取得	无

[1] 本表所列第 1551 条至第 1595 条取得方式为继受取得的专利权属于由发行人及其子公司自主研发、自主向有关国家或地区的专利主管部门申请相应专利并于获得该专利权后将该专利权转让给本表所列的当前专利权人的情形。

[2] 本表中取得方式为继受取得系指在专利权授权后发生专利权人著录信息变更的情况，本表中取得方式为原始取得系指在专利权授权后未发生专利权人著录信息变更的情况。

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
2	Method of Making Strained Semiconductor CMOS Transistors Having Lattice-Mismatched Regions	EP1654770	EP04780054.5(CH)	中芯国际	瑞士	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无
3	Method of Making Strained Semiconductor CMOS Transistors Having Lattice-Mismatched Regions	EP1654770	EP04780054.5(FR)	中芯国际	法国	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无
4	Method of Making Strained Semiconductor CMOS Transistors Having Lattice-Mismatched Regions	EP1654770	EP04780054.5(GB)	中芯国际	英国	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无
5	Method of Making Strained Semiconductor CMOS	EP1654770	EP04780054.5(IE)	中芯国际	爱尔兰	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	Transistors Having Lattice-Mismatched Regions									
6	Method of Making Strained Semiconductor CMOS Transistors Having Lattice-Mismatched Regions	EP1654770	EP04780054.5(NL)	中芯国际	荷兰	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无
7	Method of Making Strained Semiconductor CMOS Transistors Having Lattice-Mismatched Regions	EP1654770	EP04780054.5(SE)	中芯国际	瑞典	发明	2004-08-04	2011-03-30	继受取得	无
8	Resistive Random Access Memory and Fabrication Method Thereof	EP3151295	EP16190539.3(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-09-26	2019-12-25	原始取得	无
9	Resistive Random Access	EP3151295	EP16190539.3(F	中芯上	法国	发明	2016-09-26	2019-12-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	Memory and Fabrication Method Thereof		R)	海、中芯北京						
10	Resistive Random Access Memory and Fabrication Method Thereof	EP3151295	EP16190539.3(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-09-26	2019-12-25	原始取得	无
11	Resistive Random Access Memory and Fabrication Method Thereof	EP3151295	EP16190539.3(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-09-26	2019-12-25	原始取得	无
12	Electrostatic discharge protection device and method for forming the same	EP3154086	EP16191888.3(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-09-30	2018-09-05	原始取得	无
13	Electrostatic discharge protection device and method for forming the same	EP3154086	EP16191888.3(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-09-30	2018-09-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
14	Electrostatic discharge protection device and method for forming the same	EP3154086	EP16191888.3(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-09-30	2018-09-05	原始取得	无
15	Electrostatic discharge protection device and method for forming the same	EP3154086	EP16191888.3(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-09-30	2018-09-05	原始取得	无
16	Method and Device for Compact eFuse Array	EP3163580	EP16196134.7(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-10-27	2019-09-04	原始取得	无
17	Method and Device for Compact eFuse Array	EP3163580	EP16196134.7(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-10-27	2019-09-04	原始取得	无
18	Method and Device for Compact eFuse Array	EP3163580	EP16196134.7(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-10-27	2019-09-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
19	Method and Device for Compact eFuse Array	EP3163580	EP16196134.7(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-10-27	2019-09-04	原始取得	无
20	Well Implantation Process for Finet Device	EP3176816	EP16199529.5(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-11-18	2018-09-05	原始取得	无
21	Well Implantation Process for Finet Device	EP3176816	EP16199529.5(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-11-18	2018-09-05	原始取得	无
22	Well Implantation Process for Finet Device	EP3176816	EP16199529.5(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-11-18	2018-09-05	原始取得	无
23	Well Implantation Process for Finet Device	EP3176816	EP16199529.5(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-11-18	2018-09-05	原始取得	无
24	Cmos image sensor and	EP3179512	EP16202206.5(	中芯上	德国	发明	2016-12-05	2018-10-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof		DE)	海、中芯北京						
25	Cmos image sensor and fabrication method thereof	EP3179512	EP16202206.5(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-12-05	2018-10-03	原始取得	无
26	Cmos image sensor and fabrication method thereof	EP3179512	EP16202206.5(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-12-05	2018-10-03	原始取得	无
27	Cmos image sensor and fabrication method thereof	EP3179512	EP16202206.5(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-05	2018-10-03	原始取得	无
28	Method and device to improve shallow trench isolation	EP3185286	EP16204236.0(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-12-15	2019-02-06	原始取得	无
29	Method and device to improve shallow trench	EP3185286	EP16204236.0(FR)	中芯上海、中芯	法国	发明	2016-12-15	2019-02-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	isolation			北京						
30	Method and device to improve shallow trench isolation	EP3185286	EP16204236.0(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-12-15	2019-02-06	原始取得	无
31	Method and device to improve shallow trench isolation	EP3185286	EP16204236.0(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-15	2019-02-06	原始取得	无
32	Compact efuse array with different mos sizes according to physical location in a word line	EP3188189	EP16204643.7(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-12-16	2019-02-06	原始取得	无
33	Compact efuse array with different mos sizes according to physical location in a word line	EP3188189	EP16204643.7(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-12-16	2019-02-06	原始取得	无
34	Compact efuse array with	EP3188189	EP16204643.7(I	中芯上	意大	发明	2016-12-16	2019-02-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	different mos sizes according to physical location in a word line		T)	海、中芯北京	利					
35	Compact efuse array with different mos sizes according to physical location in a word line	EP3188189	EP16204643.7(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-16	2019-02-06	原始取得	无
36	Finfet and Fabrication Method Thereof	EP3188245	EP16205796.2(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-12-21	2018-08-29	原始取得	无
37	Finfet and Fabrication Method Thereof	EP3188245	EP16205796.2(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-12-21	2018-08-29	原始取得	无
38	Finfet and Fabrication Method Thereof	EP3188245	EP16205796.2(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-12-21	2018-08-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
39	Finfet and Fabrication Method Thereof	EP3188245	EP16205796.2(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-21	2018-08-29	原始取得	无
40	Fabrication method of a cmos image sensor	EP3190620	EP16207190.6(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2016-12-28	2019-05-01	原始取得	无
41	Fabrication method of a cmos image sensor	EP3190620	EP16207190.6(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-12-28	2019-05-01	原始取得	无
42	Fabrication method of a cmos image sensor	EP3190620	EP16207190.6(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-12-28	2019-05-01	原始取得	无
43	Fabrication method of a cmos image sensor	EP3190620	EP16207190.6(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-28	2019-05-01	原始取得	无
44	Reference Voltage	EP3193231	EP16207487.6(	中芯上	德国	发明	2016-12-30	2019-10-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	Generator and Related Method		DE)	海、中芯北京						
45	Reference voltage generator and related method	EP3193231	EP16207487.6(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2016-12-30	2019-10-30	原始取得	无
46	Reference voltage generator and related method	EP3193231	EP16207487.6(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2016-12-30	2019-10-30	原始取得	无
47	Reference Voltage Generator and Related Method	EP3193231	EP16207487.6(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2016-12-30	2019-10-30	原始取得	无
48	Method and System for Uniform Deposition of Metal	EP3206222	EP17152662.7(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-01-23	2018-09-05	原始取得	无
49	Method and System for Uniform Deposition of	EP3206222	EP17152662.7(FR)	中芯上海、中芯	法国	发明	2017-01-23	2018-09-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	Metal			北京						
50	Method and System for Uniform Deposition of Metal	EP3206222	EP17152662.7(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-01-23	2018-09-05	原始取得	无
51	Method and System for Uniform Deposition of Metal	EP3206222	EP17152662.7(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-01-23	2018-09-05	原始取得	无
52	Semiconductor structure and fabrication method thereof	EP3203507	EP17153091.8(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-01-25	2019-03-06	原始取得	无
53	Semiconductor structure and fabrication method thereof	EP3203507	EP17153091.8(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-01-25	2019-03-06	原始取得	无
54	Semiconductor structure and fabrication method thereof	EP3203507	EP17153091.8(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-01-25	2019-03-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
55	Semiconductor structure and fabrication method thereof	EP3203507	EP17153091.8(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-01-25	2019-03-06	原始取得	无
56	A Method to Improve HCI Performance for Finet	EP3208836	EP17155783.8(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-02-13	2019-12-25	原始取得	无
57	A Method to Improve HCI Performance for Finet	EP3208836	EP17155783.8(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-02-13	2019-12-25	原始取得	无
58	A Method to Improve HCI Performance for Finet	EP3208836	EP17155783.8(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-02-13	2019-12-25	原始取得	无
59	A Method to Improve HCI Performance for Finet	EP3208836	EP17155783.8(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-02-13	2019-12-25	原始取得	无
60	High voltage esd device for	EP3226297	EP17162365.5(	中芯上	德国	发明	2017-03-22	2018-12-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	finfet technology		DE)	海、中芯北京						
61	High voltage esd device for finfet technology	EP3226297	EP17162365.5(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-03-22	2018-12-12	原始取得	无
62	High voltage esd device for finfet technology	EP3226297	EP17162365.5(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-03-22	2018-12-12	原始取得	无
63	High voltage esd device for finfet technology	EP3226297	EP17162365.5(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-03-22	2018-12-12	原始取得	无
64	Low core power leakage structure in io receiver during io power down	EP3240193	EP17166521.9(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-04-13	2019-07-03	原始取得	无
65	Low core power leakage structure in io receiver	EP3240193	EP17166521.9(FR)	中芯上海、中芯	法国	发明	2017-04-13	2019-07-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	during io power down			北京						
66	Low core power leakage structure in io receiver during io power down	EP3240193	EP17166521.9(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-04-13	2019-07-03	原始取得	无
67	Low core power leakage structure in io receiver during io power down	EP3240193	EP17166521.9(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-04-13	2019-07-03	原始取得	无
68	Memory and reference circuit calibration method thereof	EP3244416	EP17169809.5(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-05-05	2019-11-27	原始取得	无
69	MEMORY AND REFERENCE CIRCUIT CALIBRATION METHOD THEREOF	EP3244416	EP17169809.5(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-05-05	2019-11-27	原始取得	无
70	MEMORY AND REFERENCE CIRCUIT	EP3244416	EP17169809.5(IT)	中芯上海、中芯	意大利	发明	2017-05-05	2019-11-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	CALIBRATION METHOD THEREOF			北京						
71	MEMORY AND REFERENCE CIRCUIT CALIBRATION METHOD THEREOF	EP3244416	EP17169809.5(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-05-05	2019-11-27	原始取得	无
72	Esd protection device and method	EP3252814	EP17173928.7(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-06-01	2018-12-26	原始取得	无
73	ESD PROTECTION DEVICE AND METHOD	EP3252814	EP17173928.7(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-06-01	2018-12-26	原始取得	无
74	Esd protection device and method	EP3252814	EP17173928.7(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-06-01	2018-12-26	原始取得	无
75	ESD PROTECTION	EP3252814	EP17173928.7(	中芯上	荷兰	发明	2017-06-01	2018-12-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	DEVICE AND METHOD		NL)	海、中芯北京						
76	Ldmos design for a finfet device	EP3258498	EP17174806.4(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-06-07	2019-12-18	原始取得	无
77	Ldmos design for a finfet device	EP3258498	EP17174806.4(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-06-07	2019-12-18	原始取得	无
78	Ldmos design for a finfet device	EP3258498	EP17174806.4(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-06-07	2019-12-18	原始取得	无
79	Ldmos design for a finfet device	EP3258498	EP17174806.4(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-06-07	2019-12-18	原始取得	无
80	Structure and method for memory cell array	EP3267488	EP17179530.5(DE)	中芯上海、中芯	德国	发明	2017-07-04	2019-01-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
81	Structure and method for memory cell array	EP3267488	EP17179530.5(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-07-04	2019-01-09	原始取得	无
82	Structure and method for memory cell array	EP3267488	EP17179530.5(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-07-04	2019-01-09	原始取得	无
83	Structure and method for memory cell array	EP3267488	EP17179530.5(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-07-04	2019-01-09	原始取得	无
84	Semiconductor device and fabrication method thereof	EP3267472	EP17179738.4(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-07-05	2019-05-01	原始取得	无
85	Semiconductor device and fabrication method thereof	EP3267472	EP17179738.4(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-07-05	2019-05-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
86	Semiconductor device and fabrication method thereof	EP3267472	EP17179738.4(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-07-05	2019-05-01	原始取得	无
87	Semiconductor device and fabrication method thereof	EP3267472	EP17179738.4(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-07-05	2019-05-01	原始取得	无
88	Fabrication method for semiconductor structure	EP3288070	EP17186344.2(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-08-16	2019-05-15	原始取得	无
89	Fabrication method for semiconductor structure	EP3288070	EP17186344.2(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-08-16	2019-05-15	原始取得	无
90	Fabrication method for semiconductor structure	EP3288070	EP17186344.2(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-08-16	2019-05-15	原始取得	无
91	Fabrication method for	EP3288070	EP17186344.2(	中芯上	荷兰	发明	2017-08-16	2019-05-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor structure		NL)	海、中芯北京						
92	MEMORY ARRAY AND METHOD FOR READING PROGRAMMING AND ERASING MEMORY ARRAY	EP3291238	EP17186992.8(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-08-21	2019-10-23	原始取得	无
93	MEMORY ARRAY AND METHOD FOR READING PROGRAMMING AND ERASING MEMORY ARRAY	EP3291238	EP17186992.8(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-08-21	2019-10-23	原始取得	无
94	MEMORY ARRAY AND METHOD FOR READING PROGRAMMING AND ERASING MEMORY ARRAY	EP3291238	EP17186992.8(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-08-21	2019-10-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
95	MEMORY ARRAY AND METHOD FOR READING PROGRAMMING AND ERASING MEMORY ARRAY	EP3291238	EP17186992.8(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-08-21	2019-10-23	原始取得	无
96	Semiconductor Device and Fabrication Method Thereof	EP3291291	EP17188710.2(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-08-31	2019-10-02	原始取得	无
97	Semiconductor Device and Fabrication Method Thereof	EP3291291	EP17188710.2(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-08-31	2019-10-02	原始取得	无
98	Semiconductor Device and Fabrication Method Thereof	EP3291291	EP17188710.2(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-08-31	2019-10-02	原始取得	无
99	SEMICONDUCTOR DEVICE AND FABRICATION METHOD	EP321291	EP17188710.2(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-08-31	2019-10-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	THEREOF									
100	Method of Structuring a Semiconductor Device without Pattern Collapse	EP3316281	EP17198885.0(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-10-27	2019-08-14	原始取得	无
101	Method of Structuring a Semiconductor Device without Pattern Collapse	EP3316281	EP17198885.0(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-10-27	2019-08-14	原始取得	无
102	Method of Structuring a Semiconductor Device without Pattern Collapse	EP3316281	EP17198885.0(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-10-27	2019-08-14	原始取得	无
103	MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE	EP3316281	EP17198885.0(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-10-27	2019-08-14	原始取得	无
104	A semiconductor device and manufacturing method	EP3327752	EP17202874.8(DE)	中芯上海、中芯	德国	发明	2017-11-21	2019-07-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof			北京						
105	A semiconductor device and manufacturing method thereof	EP3327752	EP17202874.8(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-11-21	2019-07-03	原始取得	无
106	A semiconductor device and manufacturing method thereof	EP3327752	EP17202874.8(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-11-21	2019-07-03	原始取得	无
107	A semiconductor device and manufacturing method thereof	EP3327752	EP17202874.8(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-11-21	2019-07-03	原始取得	无
108	INTERCONNECT STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	EP3327762	EP17203759.0(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-11-27	2019-09-11	原始取得	无
109	INTERCONNECT STRUCTURE AND	EP3327762	EP17203759.0(FR)	中芯上海、中芯	法国	发明	2017-11-27	2019-09-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	MANUFACTURING METHOD THEREOF			北京						
110	INTERCONNECT STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	EP3327762	EP17203759.0(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-11-27	2019-09-11	原始取得	无
111	INTERCONNECT STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	EP3327762	EP17203759.0(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-11-27	2019-09-11	原始取得	无
112	Sram semiconductor devices and fabrication methods thereof	EP3331012	EP17204264.0(DE)	中芯上海、中芯北京	德国	发明	2017-11-29	2019-09-04	原始取得	无
113	Sram semiconductor devices and fabrication methods thereof	EP3331012	EP17204264.0(FR)	中芯上海、中芯北京	法国	发明	2017-11-29	2019-09-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
114	Sram semiconductor devices and fabrication methods thereof	EP3331012	EP17204264.0(IT)	中芯上海、中芯北京	意大利	发明	2017-11-29	2019-09-04	原始取得	无
115	Sram semiconductor devices and fabrication methods thereof	EP3331012	EP17204264.0(NL)	中芯上海、中芯北京	荷兰	发明	2017-11-29	2019-09-04	原始取得	无
116	Structure and method of making strained semiconductor cmos transistors having lattice-mismatched source and drain regions	IL173422	IL20060173422	中芯国际	以色列	发明	2004-08-04	2011-12-29	继受取得	无
117	Structure and method of making strained semiconductor cmos transistors having lattice-mismatches source	IN275631	IN1099/DELNP/2006	中芯国际	印度	发明	2004-08-04	2016-09-15	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and drain regions									
118	TRUCTURE AND METHOD OF MAKING STRAINED SEMICONDUCTOR CMOS TRANSISTORS HAVING LATTICE-MISMATCHED SOURCE AND DRAIN REGIONS	JP4808618	JP20060522694	中芯国际	日本	发明	2004-08-04	2011-08-26	继受取得	无
119	Structure and method of making strained semiconductor cmos transistors having lattice-mismatched source and drain regions	KR100791441	KR20067000237	中芯国际	韩国	发明	2006-01-04	2007-12-27	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
120	반도체 장치및그 제초 방법	KR101519457	KR20130050554	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-06	2015-05-06	原始取得	无
121	반도제 소자 구조제의 제조 방명	KR101446661	KR20130051645	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-08	2014-09-25	原始取得	无
122	반도체 소자 구조체의 제조 방법	KR101433779	KR20130051837	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-08	2014-08-19	原始取得	无
123	반도체 구조 및 반도체 구조의 형성방법	KR101478272	KR20130054964	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2014-12-24	原始取得	无
124	반도체 소자의 형성방법	KR101491548	KR20130054965	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2015-02-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
125	반도체 구조의 형성방법	KR101477606	KR20130054966	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2014-12-23	原始取得	无
126	MOS 트랜지스터 및 그 형성 방법	KR101466846	KR20130055017	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2014-11-24	原始取得	无
127	반도제 소자 및 그 형성방법	KR101466847	KR20130055018	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2014-11-24	原始取得	无
128	판도제 구조 및 그 형성 방법，SRAM 메모리 유보，및 SRAM 메모리	KR101479153	KR20130055019	中芯上海、中芯北京	韩国	发明	2013-05-15	2014-12-29	原始取得	无
129	반도체 구조의 형성방법	KR101465711	KR20130055020	中芯上海、中芯	韩国	发明	2013-05-15	2014-11-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
130	自動偵測半導體晶片位置之濺鍍系統	I242254	TW091119995	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-02	2005-10-21	原始取得	无
131	半导体装置测试结构与形成方法	207717	TW091119996	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-02	2004-02-01	原始取得	无
132	拉線、球剪力與晶片剪力測量之重複性與再現性測試裝置	I295488	TW091119998	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-02	2008-04-01	原始取得	无
133	形成介电质层的方法	207782	TW091119999	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-02	2004-01-01	原始取得	无
134	應用於半導體產品生產之植入式可靠度分析系統	207372	TW091120000	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-02	2004-02-01	原始取得	无
135	測試加燒機(testduringburn-inTDBI)系統	I227786	TW091120660	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-10	2005-02-11	原始取得	无
136	石英管清洗台之超純水回	I299188	TW091120808	中芯上海	中国	发明	2002-09-11	2008-07-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	收管理系統				台湾					
137	檢測探針接觸電阻之測試結構與方法	I257002	TW091120809	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-11	2006-06-21	原始取得	无
138	可重複使用的晶圓控片及其形成方法	I309860	TW091134976	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-02	2009-05-11	原始取得	无
139	高壓雙擴散汲極裝置之制程整合方法	I304606	TW091135901	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-11	2008-12-21	原始取得	无
140	測量晶圓之零傾斜角度的方法	207532	TW091136202	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-13	2004-06-01	原始取得	无
141	具有安全裝置的電子產品及其使用方法	206942	TW091137798	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-27	2004-06-21	原始取得	无
142	於半導體制程中改善足部效應缺陷的方法	I247357	TW092134501	中芯上海	中国台湾	发明	2003-12-05	2006-01-11	原始取得	无
143	製造具有晶格配錯源極與汲極區域的應變半導體互補式金氧半電晶體之結構	TWI284961	TW093121639	中芯国际	中国台湾	发明	2004-07-20	2007-08-01	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	及方法									
144	半導體結構的形成方法	TWI539600	TW102113276	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-06-21	原始取得	无
145	半導體結構及其形成方法、SRAM 儲存單元、SRAM 儲存器	TWI559503	TW102113277	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-11-21	原始取得	无
146	半導體裝置及其形成方法	TWI520338	TW102113279	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-02-01	原始取得	无
147	半導體結構的形成方法和半導體結構	TWI523115	TW102113280	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-02-21	原始取得	无
148	埋層的形成方法	TWI564942	TW102113282	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2017-01-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
149	MOS 電晶體及其形成方法	TWI527096	TW102113286	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-03-21	原始取得	无
150	一種半導體器件結構及其製造方法	TWI506791	TW102113287	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2015-11-01	原始取得	无
151	半導體原件結構及其製作方法	TWI550869	TW102113288	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-09-21	原始取得	无
152	半導體裝置及其製造方法	TWI539533	TW102113289	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-06-21	原始取得	无
153	半導體元件及其製造方法	TWI557914	TW102113290	中芯上海、中芯北京	中国台湾	发明	2013-04-15	2016-11-11	原始取得	无
154	在銅鑲嵌製程中形成金屬	I231973	TW90133443	中芯上海	中国	发明	2001-12-31	2005-05-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	一絕緣一金屬型（ＭＩＭ）電容器的方法				台湾					
155	在氮化矽層上形成氮氧化矽層的方法	I233634	TW91100643	中芯上海	中国台湾	发明	2002-01-02	2005-06-01	原始取得	无
156	半導體晶圓儲存之容器組件及箱具組件	I304996	TW91111834	中芯上海	中国台湾	发明	2002-06-03	2009-01-01	原始取得	无
157	半導體晶圓刷洗後的乾燥方法	188224	TW91111994	中芯上海	中国台湾	发明	2002-06-04	2003-10-01	原始取得	无
158	靜電放電保護裝置及其製造方法	207684	TW91120263	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-05	2004-01-21	原始取得	无
159	動態隨機存取記憶體	I284900	TW91122130	中芯上海	中国台湾	发明	2002-09-26	2007-08-01	原始取得	无
160	快速熱退火製程之每日監控的控片及其方法	I286794	TW91123564	中芯上海	中国台湾	发明	2002-10-14	2007-09-11	原始取得	无
161	金屬一絕緣體一金屬電容器及其製造方法	I221300	TW91134087	中芯上海	中国台湾	发明	2002-11-22	2004-09-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
162	具有磁場／電場之雜質過濾器	I222893	TW91134194	中芯上海	中国台湾	发明	2002-11-25	2004-11-01	原始取得	无
163	自動檔案輸入之遮罩量測方法	I229270	TW91135820	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-11	2005-03-11	原始取得	无
164	一種整合高壓元件製程及混合信號元件製程之方法	207676	TW91136400	中芯上海	中国台湾	发明	2002-12-17	2004-01-21	原始取得	无
165	靜電放電保護電路	207685	TW92103057	中芯上海	中国台湾	发明	2003-02-14	2004-02-21	原始取得	无
166	化學機械研磨墊	I221106	TW92103142	中芯上海	中国台湾	发明	2003-02-14	2004-09-21	原始取得	无
167	晶圓乾燥方法和裝置	I222126	TW92103804	中芯国际	中国台湾	发明	2003-02-24	2004-10-11	原始取得	无
168	熱探針之監視晶圓之形成方法和該監視晶圓	I222691	TW92104087	中芯上海	中国台湾	发明	2003-02-26	2004-10-21	原始取得	无
169	射頻電路之銅／低 k 材料的整合方法改良	I297944	TW92105366	中芯上海	中国台湾	发明	2003-03-12	2008-06-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
170	使用聚焦離子束之化學汽相沈積的光罩圖案化	I301633	TW92105515	中芯上海	中国台湾	发明	2003-03-13	2008-10-01	原始取得	无
171	鋁材質堆疊式金屬電容器以及鋁材質堆疊式電感器之積體製程方法	207478	TW92108565	中芯上海	中国台湾	发明	2003-04-14	2004-05-01	原始取得	无
172	淺溝道隔離（ＳＴＩ）處理之雙襯墊氧化物製程	206771	TW92119063	中芯上海	中国台湾	发明	2003-07-11	2004-06-21	原始取得	无
173	銅電鍍方法	I221315	TW92119065	中芯上海	中国台湾	发明	2003-07-11	2004-09-21	原始取得	无
174	電解式遮罩銘膜之蝕刻製程方法	I223350	TW92119595	中芯上海	中国台湾	发明	2003-07-17	2004-11-01	原始取得	无
175	決定化學機械研磨的過渡研磨時間的方法	I227921	TW92123027	中芯上海	中国台湾	发明	2003-08-21	2005-02-11	原始取得	无
176	快速熱處理（ＲＴＰ）系統之排氣壓力控制方法	I324794	TW92129786	中芯上海	中国台湾	发明	2003-10-27	2010-05-11	原始取得	无
177	用於高電壓輸入之拉升電	I227595	TW92130976	中芯上海	中国	发明	2003-11-05	2005-02-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	晶體的閘極控制電路				台湾					
178	電容器之製造方法	I236102	TW92132334	中芯上海	中国台湾	发明	2003-11-18	2005-07-11	原始取得	无
179	堆疊式金屬－絕緣體－金屬電容器及其製造方法	I223404	TW92134073	中芯上海	中国台湾	发明	2003-12-03	2004-11-01	原始取得	无
180	形成金屬－絕緣體－金屬電容之方法	I227929	TW92134076	中芯上海	中国台湾	发明	2003-12-03	2005-02-11	原始取得	无
181	光罩處理器及使用此光罩處理器來處理光罩之方法	I242693	TW92137334	中芯上海	中国台湾	发明	2003-12-29	2005-11-01	原始取得	无
182	增加金屬－絕緣體－金屬電容器之單位面積電容密度的方法	I229385	TW92137335	中芯上海	中国台湾	发明	2003-12-29	2005-03-11	原始取得	无
183	遮罩式唯讀記憶體及其製造方法	I234241	TW93106746	中芯上海	中国台湾	发明	2004-03-12	2005-06-11	原始取得	无
184	动态随机存取记忆体	TWI283045	TW93110710	中芯上海	中国台湾	发明	2004-04-16	2007-06-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
185	半導體裝置之製造方法	I234229	TW93127013	中芯上海	中国台湾	发明	2004-09-07	2005-06-11	原始取得	无
186	晶圓處理裝置及晶圓處理方法	TWI310206	TW94103264	中芯上海	中国台湾	发明	2005-02-02	2009-05-21	原始取得	无
187	Method of forming an isolated-grain rugged polysilicon surface via a temperature ramping step	US6723613	US10/188910	中芯上海	美国	发明	2002-07-02	2004-04-20	原始取得	无
188	High voltage tolerant output buffer	US6803789	US10/265283	中芯上海	美国	发明	2002-10-04	2004-10-12	原始取得	无
189	Mask-rom process and device to prevent punch through using a halo implant process	US6940135	US10/391537	中芯上海	美国	发明	2003-03-17	2005-09-06	原始取得	无
190	Method for fabricating copper damascene	US6972251	US10/391538	中芯上海	美国	发明	2003-03-17	2005-12-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	structures in porous dielectric materials									
191	Method and system for monitoring implantation of ions into semiconductor substrates	US6844208	US10/462028	中芯上海	美国	发明	2003-06-12	2005-01-18	原始取得	无
192	Structure and method of making strained semiconductor cmos transistors having lattice-mismatched semiconductor regions underlying source and drain regions	US6891192	US10/604607	中芯国际	美国	发明	2003-08-04	2005-05-10	继受取得	无
193	Method and structure for fabricating patterns on phase shift mask for the	US7033709	US10/701035	中芯上海	美国	发明	2003-11-03	2006-04-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacture of semiconductor wafers									
194	Monitoring low temperature rapid thermal anneal process using implanted wafers	US6962884	US10/743689	中芯上海	美国	发明	2003-12-19	2005-11-08	原始取得	无
195	Method and apparatus for rapid cooldown of annealed wafer	US7241672	US10/773517	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2007-07-10	原始取得	无
196	Method and structure for fabricating a halftone mask for the manufacture of semiconductor wafers	US7229932	US10/773519	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2007-06-12	原始取得	无
197	Method for making an opening for electrical contact by etch back profile control	US7084054	US10/773565	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2006-08-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
198	Method and structure to form capacitor in copper damascene process for integrated circuit devices	US6972492	US10/773592	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2005-12-06	原始取得	无
199	Method and structure for electrostatic discharge protection of photomasks	US7125755	US10/773597	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2006-10-24	原始取得	无
200	Method and structure of manufacturing high capacitance metal on insulator capacitors in copper	US7015110	US10/773727	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2006-03-21	原始取得	无
201	Low energy dose monitoring of implanter using implanted wafers	US7259027	US10/773728	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2007-08-21	原始取得	无
202	Method and resulting structure for fabricating	US6967161	US10/773799	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2005-11-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	dram cell structure using oxide line spacer									
203	Method and structure for integrating metal insulator metal capacitor with copper	US6853082	US10/773954	中芯上海	美国	发明	2004-02-06	2005-02-08	原始取得	无
204	Method for manufacturing semiconductor devices by monitoring nitrogen bearing species in gate oxide layer	US7033846	US10/796614	中芯上海	美国	发明	2004-03-08	2006-04-25	原始取得	无
205	Method for operating chemical mechanical polishing ("cmp") tool for the manufacture of semiconductor devices	US6852633	US10/796700	中芯上海	美国	发明	2004-03-08	2005-02-08	原始取得	无
206	Device and method for low non-linearity analog-to-digital converter	US7030801	US10/808721	中芯上海	美国	发明	2004-03-24	2006-04-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
207	Hydrogenated oxidized silicon carbon material	US6953984	US10/827065	中芯国际	美国	发明	2004-04-19	2005-10-11	继受取得	无
208	Method and system for processing stability of semiconductor devices	US6965844	US10/880761	中芯上海	美国	发明	2004-06-29	2005-11-15	原始取得	无
209	Method and system for yield similarity of semiconductor devices	US7024334	US10/881739	中芯上海	美国	发明	2004-06-29	2006-04-04	原始取得	无
210	Method and system for processing commonality of semiconductor devices	US7003430	US10/882081	中芯上海	美国	发明	2004-06-29	2006-02-21	原始取得	无
211	Method and structure for fabricating smooth mirrors for liquid crystal on silicon devices	US7527993	US10/927707	中芯上海	美国	发明	2004-08-26	2009-05-05	原始取得	无
212	Method and structure for	US7250350	US10/927730	中芯上海	美国	发明	2004-08-27	2007-07-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	integrated stacked capacitor formation									
213	Method and structure for low k interlayer dielectric layer	US7507656	US10/927828	中芯上海	美国	发明	2004-08-27	2009-03-24	原始取得	无
214	Mos device for high voltage operation and method of manufacture	US7335543	US10/928004	中芯上海	美国	发明	2004-08-27	2008-02-26	原始取得	无
215	Method for repairing plasma damage after spacer formation for integrated circuit devices	US7132368	US10/928716	中芯上海	美国	发明	2004-08-26	2006-11-07	原始取得	无
216	Method of forming a via structure dual damascene structure for the manufacture of semiconductor integrated	US8158520	US10/969886	中芯上海	美国	发明	2004-10-20	2012-04-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	circuit devices									
217	Device and method for voltage regulator with stable and fast response and low standby current	US7190189	US11/060922	中芯上海	美国	发明	2005-02-17	2007-03-13	原始取得	无
218	Device and method for voltage regulator with low standby current	US7162380	US11/061062	中芯上海	美国	发明	2005-02-17	2007-01-09	原始取得	无
219	Device and method for low-power fast-response voltage regulator with improved power supply range	US7196505	US11/061197	中芯上海	美国	发明	2005-02-17	2007-03-27	原始取得	无
220	Power-on solution to avoid crowbar current for multiple power supplies' inputs/outputs	US7233178	US11/110655	中芯上海	美国	发明	2005-04-19	2007-06-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
221	High bandwidth apparatus and method for generating differential signals	US7205839	US11/156236	中芯上海	美国	发明	2005-06-17	2007-04-17	原始取得	无
222	Method of forming low stress multi-layer metallurgical structures and high reliable lead free solder termination electrodes	US7462556	US11/176871	中芯上海	美国	发明	2005-07-06	2008-12-09	原始取得	无
223	Method and device for cmos image sensing with separate source formation	US7335546	US11/185444	中芯上海	美国	发明	2005-07-19	2008-02-26	原始取得	无
224	Method and structure for aluminum chemical mechanical polishing and protective layer	US7241692	US11/190218	中芯上海	美国	发明	2005-07-26	2007-07-10	原始取得	无
225	Method and resulting	US7914950	US11/190390	中芯上海	美国	发明	2005-07-26	2011-03-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	structure for mosaic of multi-transmission rate optical mask structures									
226	Method and structure for landing polysilicon contact	US7670902	US11/190392	中芯上海	美国	发明	2005-07-26	2010-03-02	原始取得	无
227	Planar bond pad design and method of making the same	US7053490	US11/191463	中芯上海	美国	发明	2005-07-27	2006-05-30	原始取得	无
228	Method and system for calibrating measurement tools for semiconductor device manufacturing	US8044668	US11/193016	中芯上海	美国	发明	2005-07-29	2011-10-25	原始取得	无
229	Knowledge-based statistical method and system to determine reliability compatibility for semiconductor integrated circuits	US7660699	US11/200497	中芯上海	美国	发明	2005-08-08	2010-02-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
230	Low voltage trigger and save area electrostatic discharge device	US7265422	US11/215492	中芯上海	美国	发明	2005-08-29	2007-09-04	原始取得	无
231	Method and system for derivation of breakdown voltage for mos integrated circuit devices	US7462497	US11/227012	中芯上海	美国	发明	2005-09-14	2008-12-09	原始取得	无
232	Multiple point gate oxide integrity test method and system for the manufacture of semiconductor integrated circuits	US7396693	US11/227182	中芯上海	美国	发明	2005-09-14	2008-07-08	原始取得	无
233	Method and structure for second spacer formation for strained silicon mos transistors	US7591659	US11/243707	中芯上海	美国	发明	2005-10-04	2009-09-22	原始取得	无
234	Method for atomic layer	US7887884	US11/243735	中芯上海	美国	发明	2005-10-04	2011-02-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	deposition of materials using an atmospheric pressure for semiconductor devices									
235	Techniques for removal of photolithographic films	US7598179	US11/243883	中芯上海	美国	发明	2005-10-04	2009-10-06	原始取得	无
236	Seal ring corner design	US7663159	US11/245339	中芯上海	美国	发明	2005-10-05	2010-02-16	原始取得	无
237	Method and structure using a pure silicon dioxide hardmask for gate patterning for strained silicon mos transistors	US7425488	US11/245412	中芯上海	美国	发明	2005-10-05	2008-09-16	原始取得	无
238	Method and system for operating a physical vapor deposition process	US7351596	US11/246871	中芯上海	美国	发明	2005-10-07	2008-04-01	原始取得	无
239	System and method for	US7414450	US11/251107	中芯上海	美国	发明	2005-10-13	2008-08-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	adaptive power supply to reduce power consumption									
240	System and method for providing adaptive power supply to system on a chip	US7233868	US11/251583	中芯上海	美国	发明	2005-10-13	2007-06-19	原始取得	无
241	Method and system for reliability similarity of semiconductor devices	US7447610	US11/252968	中芯上海	美国	发明	2005-10-17	2008-11-04	原始取得	无
242	High performance sense amplifier and method thereof for memory system	US7180804	US11/253052	中芯上海	美国	发明	2005-10-17	2007-02-20	原始取得	无
243	Method of Making CMOS Image Sensor - Hybrid Silicide	US7700399	US11/258973	中芯上海	美国	发明	2005-10-25	2010-04-20	原始取得	无
244	Method and system for selective optical pattern	US7424700	US11/261455	中芯上海	美国	发明	2005-10-27	2008-09-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	compensation									
245	System and method for power-on control of input/output drivers	US7239186	US11/262505	中芯上海	美国	发明	2005-10-28	2007-07-03	原始取得	无
246	System and method for switching between high voltage and low voltage	US7307464	US11/283061	中芯上海	美国	发明	2005-11-17	2007-12-11	原始取得	无
247	Method and system for processing commonality of semiconductor devices	US7319938	US11/286255	中芯上海	美国	发明	2005-11-22	2008-01-15	原始取得	无
248	Metal hard mask method and structure for strained silicon mos transistors	US7709336	US11/321767	中芯上海	美国	发明	2005-12-28	2010-05-04	原始取得	无
249	Phase lock loop indicator	US7372339	US11/321768	中芯上海	美国	发明	2005-12-28	2008-05-13	原始取得	无
250	Method and system for yield similarity of	US7286958	US11/326089	中芯上海	美国	发明	2006-01-04	2007-10-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor devices									
251	Method and apparatus for testing gate oxide with fuse	US7135868	US11/339310	中芯上海	美国	发明	2006-01-24	2006-11-14	原始取得	无
252	Method and system for device characterization with array and decoder	US7345500	US11/339337	中芯上海	美国	发明	2006-01-24	2008-03-18	原始取得	无
253	Method to eliminate cu dislocation for reliability and yield	US7897508	US11/361070	中芯上海	美国	发明	2006-02-22	2011-03-01	原始取得	无
254	Method for making split dual gate field effect transistor	US7582517	US11/377236	中芯上海	美国	发明	2006-03-15	2009-09-01	原始取得	无
255	Split dual gate field effect transistor	US8614487	US11/377936	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2006-03-15	2013-12-24	原始取得	无
256	Method for treatment of	US7504269	US11/378400	中芯上海	美国	发明	2006-03-16	2009-03-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	samples for auger electronic spectrometer (aes) in the manufacture of integrated circuits									
257	Planar bond pad design and method of making the same	US7381636	US11/378597	中芯上海	美国	发明	2006-03-17	2008-06-03	原始取得	无
258	Method and structure for sample preparation for scanning electron microscopes in integrated circuit manufacturing	US7989228	US11/378888	中芯上海	美国	发明	2006-03-16	2011-08-02	原始取得	无
259	Method and structure for aluminum chemical mechanical polishing	US7645703	US11/387248	中芯上海	美国	发明	2006-03-22	2010-01-12	原始取得	无
260	Etch back with aluminum cmp for lcos devices	US7557031	US11/388359	中芯上海	美国	发明	2006-03-23	2009-07-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
261	Method of improving adhesion strength of low dielectric constant layers	US8110502	US11/394529	中芯上海	美国	发明	2006-03-30	2012-02-07	原始取得	无
262	Clean room safety shoe article with removal steel toe housing and method for treating the shoe	US7451553	US11/394598	中芯上海	美国	发明	2006-03-31	2008-11-18	原始取得	无
263	Method for forming low dielectric constant fluorine-doped layers	US7579271	US11/418501	中芯上海	美国	发明	2006-05-03	2009-08-25	原始取得	无
264	Bond pad for low k dielectric materials and method for manufacture for semiconductor devices	US8049308	US11/449902	中芯上海	美国	发明	2006-06-09	2011-11-01	原始取得	无
265	Bga package holder device and method for testing of bga packages	US7541827	US11/450967	中芯上海	美国	发明	2006-06-09	2009-06-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
266	Integration scheme method and structure for transistors using strained silicon	US7547595	US11/471035	中芯上海	美国	发明	2006-06-19	2009-06-16	原始取得	无
267	Single mask scheme method and structure for integrating pmos and nmos transistors using strained silicon	US7820500	US11/471071	中芯上海	美国	发明	2006-06-19	2010-10-26	原始取得	无
268	Method for making an opening for electrical contact by etch back profile control	US7655561	US11/497552	中芯上海	美国	发明	2006-07-31	2010-02-02	原始取得	无
269	Using reverse arrangement for trend test in statistical process control for manufacture of semiconductor integrated	US7595205	US11/498970	中芯上海	美国	发明	2006-08-02	2009-09-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	circuits									
270	Method and structure of an one time programmable memory device in an embedded eeprom	US7736967	US11/502129	中芯上海	美国	发明	2006-08-09	2010-06-15	原始取得	无
271	Method and system for determining semiconductor characteristics	US7655558	US11/508591	中芯上海	美国	发明	2006-08-22	2010-02-02	原始取得	无
272	Method and apparatus to prevent contamination of optical element by resist processing	US7701549	US11/512662	中芯上海	美国	发明	2006-08-29	2010-04-20	原始取得	无
273	Method and structure for double lining for shallow trench isolation	US7682929	US11/536458	中芯上海	美国	发明	2006-09-28	2010-03-23	原始取得	无
274	Method for atomic layer	US7569487	US11/536472	中芯上海	美国	发明	2006-09-28	2009-08-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	deposition of materials using a pre-treatment for semiconductor devices									
275	Reconfigurable mask method and device using mems for manufacturing integrated circuits	US7932997	US11/537655	中芯上海	美国	发明	2006-10-01	2011-04-26	原始取得	无
276	Method with high gapfill capability for semiconductor devices	US7456067	US11/539612	中芯上海	美国	发明	2006-10-06	2008-11-25	原始取得	无
277	Dual damascence copper process using a selected mask	US7989341	US11/539614	中芯上海	美国	发明	2006-10-06	2011-08-02	原始取得	无
278	Polysilicon gate doping method and structure for strained silicon mos transistors	US7335566	US11/548280	中芯上海	美国	发明	2006-10-10	2008-02-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
279	Wide input common mode voltage comparator	US8044687	US11/548696	中芯上海	美国	发明	2006-10-11	2011-10-25	原始取得	无
280	Method of improving a shallow trench isolation gapfill process	US7989309	US11/549116	中芯上海	美国	发明	2006-10-13	2011-08-02	原始取得	无
281	Method and structure for fabricating capacitor devices for integrated circuits	US7670900	US11/549118	中芯上海	美国	发明	2006-10-13	2010-03-02	原始取得	无
282	System and method for i/o esd protection with polysilicon regions fabricated by processes for making core transistors	US7642602	US11/550529	中芯上海	美国	发明	2006-10-18	2010-01-05	原始取得	无
283	Method for fabricating isolation structures for flash memory semiconductor	US7427552	US11/556131	中芯上海	美国	发明	2006-11-02	2008-09-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	devices									
284	Device and method for voltage regulator with low standby current	US7353124	US11/565542	中芯上海	美国	发明	2006-11-30	2008-04-01	原始取得	无
285	Device and method for voltage regulator with stable and fast response and low standby current	US7352210	US11/567135	中芯上海	美国	发明	2006-12-05	2008-04-01	原始取得	无
286	Etching method and structure using a hard mask for strained silicon mos transistors	US7557000	US11/609748	中芯上海	美国	发明	2006-12-12	2009-07-07	原始取得	无
287	Method for fabricating landing polysilicon contact structures for semiconductor devices	US7615475	US11/609758	中芯上海	美国	发明	2006-12-12	2009-11-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
288	Dummy patterns and method of manufacture for mechanical strength of low k dielectric materials in copper interconnect structures for semiconductor devices	US7605470	US11/611332	中芯上海	美国	发明	2006-12-15	2009-10-20	原始取得	无
289	Contact etch stop film	US7629673	US11/611347	中芯上海	美国	发明	2006-12-15	2009-12-08	原始取得	无
290	Two-step self-aligned source etch with large process window	US7645667	US11/611363	中芯上海	美国	发明	2006-12-15	2010-01-12	原始取得	无
291	Seal ring structures with unlanded via stacks	US7479699	US11/611391	中芯上海	美国	发明	2006-12-15	2009-01-20	原始取得	无
292	Method for cleaning backside etch during manufacture of integrated circuits	US8420550	US11/611403	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2006-12-15	2013-04-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
293	Multi-lane elastic buffer cluster for clock tolerance compensation and de-skew among multiple receiving lanes	US7751517	US11/611412	中芯上海	美国	发明	2006-12-15	2010-07-06	原始取得	无
294	Method for fabricating mos devices with a salicided gate and source/drain combined with a non-silicide source drain regions	US7842578	US11/615967	中芯上海	美国	发明	2006-12-23	2010-11-30	原始取得	无
295	Semiconductor device with amorphous silicon monos memory cell structure and method for manufacturing thereof	US7625796	US11/615968	中芯上海	美国	发明	2006-12-23	2009-12-01	原始取得	无
296	Multipurpose decapsulation	US7772030	US11/615971	中芯上海	美国	发明	2006-12-23	2010-08-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	holder and method for a ball grid array package									
297	Method for controlling charge amount of ion beam and a wafer applied in the method	US7501643	US11/618236	中芯上海	美国	发明	2006-12-29	2009-03-10	原始取得	无
298	Method for decreasing pn junction leakage current of dynamic random access memory	US7473595	US11/618592	中芯上海	美国	发明	2006-12-29	2009-01-06	原始取得	无
299	Method for controlling charge amount of ion beam and a wafer applied in the method	US7491952	US11/618704	中芯上海	美国	发明	2006-12-29	2009-02-17	原始取得	无
300	Method of preparing a sample for transmission electron microscopy	US7649173	US11/618728	中芯上海	美国	发明	2006-12-29	2010-01-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
301	Method and structure for self aligned formation of a gate polysilicon layer	US7807532	US11/623048	中芯上海	美国	发明	2007-01-12	2010-10-05	原始取得	无
302	High performance sense amplifier and method thereof for memory system	US7787321	US11/623894	中芯上海	美国	发明	2007-01-17	2010-08-31	原始取得	无
303	System and method for power control for asic device	US7814344	US11/624691	中芯上海	美国	发明	2007-01-18	2010-10-12	原始取得	无
304	High bandwidth apparatus and method for generating differential signals	US7368989	US11/678467	中芯上海	美国	发明	2007-02-23	2008-05-06	原始取得	无
305	Method and resulting structure for fabricating test key structures in dram structures	US7468283	US11/686588	中芯上海	美国	发明	2007-03-15	2008-12-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
306	System and method for power control for asic device	US7996689	US11/692902	中芯上海	美国	发明	2007-03-28	2011-08-09	原始取得	无
307	Method for forming self aligned contacts for integrated circuit devices	US7928000	US11/697287	中芯上海	美国	发明	2007-04-05	2011-04-19	原始取得	无
308	Planar microshells for vacuum encapsulated devices and damascene method of manufacture	US7923790	US11/716070	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2011-04-12	继受取得	无
309	Method to form a mems structure having a suspended portion	US7816166	US11/716082	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2010-10-19	继受取得	无
310	Method for temperature compensation in mems resonators with isolated regions of distinct material	US7639104	US11/716115	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2009-12-29	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
311	Microshells for multi-level vacuum cavities	US7659150	US11/716156	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2010-02-09	继受取得	无
312	Mems coupler and method to form the same	US7858422	US11/716227	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2010-12-28	继受取得	无
313	Ic-compatible mems structure	US7514760	US11/716284	中芯上海	美国	发明	2007-03-09	2009-04-07	继受取得	无
314	Multi-purpose poly edge test structure	US7439538	US11/728050	中芯上海	美国	发明	2007-03-22	2008-10-21	原始取得	无
315	System and method for providing adaptive power supply to system on a chip	US7443051	US11/743134	中芯上海	美国	发明	2007-05-01	2008-10-28	原始取得	无
316	System and method for power-on control of input/output drivers	US7403047	US11/754957	中芯上海	美国	发明	2007-05-29	2008-07-22	原始取得	无
317	Mask-less method and structure for patterning	US8053178	US11/765399	中芯上海	美国	发明	2007-06-19	2011-11-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	photosensitive material using optical fibers									
318	System and method for providing live insertion	US7944239	US11/780419	中芯上海	美国	发明	2007-07-19	2011-05-17	原始取得	无
319	Method of making strained semiconductor transistors having lattice-mismatched semiconductor regions underlying source and drain regions	US7396714	US11/820303	中芯国际	美国	发明	2007-06-18	2008-07-08	继受取得	无
320	Metal-insulator-metal capacitor and fabrication method thereof	US7897454	US11/833236	中芯上海	美国	发明	2007-08-03	2011-03-01	原始取得	无
321	Method and resulting structure for dram cell and peripheral transistor	US7678644	US11/834008	中芯上海	美国	发明	2007-08-06	2010-03-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
322	Sonos flash memory and method for fabricating the same	US7648882	US11/840984	中芯上海	美国	发明	2007-08-19	2010-01-19	原始取得	无
323	Cmos driving circuit	US7554366	US11/851329	中芯上海	美国	发明	2007-09-06	2009-06-30	原始取得	无
324	Lcos display unit and method for forming the same	US7995165	US11/851331	中芯上海	美国	发明	2007-09-06	2011-08-09	原始取得	无
325	Method for planarization of wafer and method for formation of isolation structure in top metal layer	US8058175	US11/852918	中芯上海	美国	发明	2007-09-10	2011-11-15	原始取得	无
326	Peripheral component interconnect express interface and method for signal processing	US7949809	US11/852976	中芯上海	美国	发明	2007-09-10	2011-05-24	原始取得	无
327	Method and resulting	US7611945	US11/853347	中芯上海	美国	发明	2007-09-11	2009-11-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	structure for fabricating dram capacitor structure									
328	Method and system for yield similarity of semiconductor devices	US7831409	US11/853794	中芯上海	美国	发明	2007-09-11	2010-11-09	原始取得	无
329	Fluxless reflow process for bump formation	US7838411	US11/859163	中芯上海	美国	发明	2007-09-21	2010-11-23	原始取得	无
330	Method of fabricating mirrors for liquid crystal on silicon display device	US7938979	US11/862971	中芯上海	美国	发明	2007-09-27	2011-05-10	原始取得	无
331	Method for fabricating pixel cell of cmos image sensor	US7989252	US11/871121	中芯上海	美国	发明	2007-10-11	2011-08-02	原始取得	无
332	Method of decreasing program disturb in memory cells	US7668009	US11/874902	中芯上海	美国	发明	2007-10-18	2010-02-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
333	Method for decreasing program disturb in memory cells	US7649771	US11/875822	中芯上海	美国	发明	2007-10-19	2010-01-19	原始取得	无
334	Method for inspecting the electrical performance of a flash memory cell	US7940584	US11/927432	中芯上海	美国	发明	2007-10-29	2011-05-10	原始取得	无
335	System and method for switching between high voltage and low voltage	US7545201	US11/934681	中芯上海	美国	发明	2007-11-02	2009-06-09	原始取得	无
336	Multi-die semiconductor package structure and method for manufacturing the same	US7875505	US11/942174	中芯上海	美国	发明	2007-11-19	2011-01-25	原始取得	无
337	Method for building mos transistor model and method for verifying mos transistor model	US7885799	US11/945991	中芯上海	美国	发明	2007-11-27	2011-02-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
338	Device and method for voltage regulator with low standby current	US7664611	US11/950209	中芯上海	美国	发明	2007-12-04	2010-02-16	原始取得	无
339	System and method for manufacturing contact	US8828867	US11/950370	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2007-12-04	2014-09-09	原始取得	无
340	Isolation structure for mos transistor and method for forming the same	US7718506	US11/951072	中芯上海	美国	发明	2007-12-05	2010-05-18	原始取得	无
341	Failure alarm device and failure alarm method	US7751911	US11/951327	中芯上海	美国	发明	2007-12-05	2010-07-06	原始取得	无
342	Device and method for voltage regulator with stable and fast response and low standby current	US7589563	US11/951850	中芯上海	美国	发明	2007-12-06	2009-09-15	原始取得	无
343	Method and system for	US8749006	US11/952901	中芯上	美国	发明	2007-12-07	2014-06-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	image sensor and lens on a silicon back plane wafer			海、中芯北京						
344	Method and device for cmos image sensing with separate source formation	US7582522	US11/959350	中芯上海	美国	发明	2007-12-18	2009-09-01	原始取得	无
345	Method and system for device characterization with array and decoder	US7521955	US12/018699	中芯上海	美国	发明	2008-01-23	2009-04-21	原始取得	无
346	Method and a system for operating a physical vapor deposition process	US8123918	US12/026975	中芯上海	美国	发明	2008-02-06	2012-02-28	原始取得	无
347	High bandwidth apparatus and method for generating differential signals	US7656231	US12/033165	中芯上海	美国	发明	2008-02-19	2010-02-02	原始取得	无
348	Method and system for forming a controllable gate	US7851383	US12/052640	中芯上海	美国	发明	2008-03-20	2010-12-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	oxide									
349	Voltage shifter circuit	US7667490	US12/117476	中芯上海	美国	发明	2008-05-08	2010-02-23	原始取得	无
350	Encapsulated mems device and method to form the same	US8349635	US12/124043	中芯上海	美国	发明	2008-05-20	2013-01-08	继受取得	无
351	Method and computer code for statistical process control for censored production data	US8024139	US12/130716	中芯上海	美国	发明	2008-05-30	2011-09-20	原始取得	无
352	Multiple point gate oxide integrity test method and system for the manufacture of semiconductor integrated circuits	US7573285	US12/134791	中芯上海	美国	发明	2008-06-06	2009-08-11	原始取得	无
353	Method for eliminating loading effect using a via	US7655554	US12/135008	中芯上海	美国	发明	2008-06-06	2010-02-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	plug									
354	System and method for cmos image sensing	US7868367	US12/136568	中芯上海	美国	发明	2008-06-10	2011-01-11	原始取得	无
355	Atomic layer deposition method and semiconductor device formed by the same	US8158512	US12/141040	中芯上海	美国	发明	2008-06-17	2012-04-17	原始取得	无
356	Atomic layer deposition method and semiconductor device formed by the same	US7709386	US12/141045	中芯上海	美国	发明	2008-06-17	2010-05-04	原始取得	无
357	Method and structure using a pure silicon dioxide hardmask for gate patterning for strained silicon mos transistors	US8106423	US12/145268	中芯上海	美国	发明	2008-06-24	2012-01-31	原始取得	无
358	Method and structure for fabricating dark-periphery	US7939227	US12/163533	中芯上海	美国	发明	2008-06-27	2011-05-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	mask for the manufacture of semiconductor wafers									
359	Electrically programmable device with embedded eeprom and method for making thereof	US7759194	US12/180389	中芯上海	美国	发明	2008-07-25	2010-07-20	原始取得	无
360	Out-of plane mems resonator with static out-of-plane deflection	US7999635	US12/182082	中芯上海	美国	发明	2008-07-29	2011-08-16	继受取得	无
361	Method for fabricating semiconductor device capable of adjusting the thickness of gate oxide layer	US7759238	US12/187370	中芯上海	美国	发明	2008-08-06	2010-07-20	原始取得	无
362	Self-biased phase locked loop and phase locking method	US7719335	US12/189085	中芯上海	美国	发明	2008-08-08	2010-05-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
363	System and method for conducting accelerated soft error rate testing	US8106664	US12/197952	中芯上海	美国	发明	2008-08-25	2012-01-31	原始取得	无
364	Mems structure having a stress-inducer temperature-compensated resonator member	US7944124	US12/201819	中芯上海	美国	发明	2008-08-29	2011-05-17	继受取得	无
365	Multi-purpose poly edge test structure	US8164091	US12/211615	中芯上海	美国	发明	2008-09-16	2012-04-24	原始取得	无
366	Method and structure for low-k interlayer dielectric layer	US7807564	US12/218356	中芯上海	美国	发明	2008-07-11	2010-10-05	原始取得	无
367	Method and resulting structure using silver for lcos devices	US7863145	US12/234382	中芯上海	美国	发明	2008-09-19	2011-01-04	原始取得	无
368	Silicon germanium and	US8551831	US12/234393	中芯上	美国	发明	2008-09-19	2013-10-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	polysilicon gate structure for strained silicon transistors			海、中芯北京						
369	Method and resulting structure dram cell with selected inverse narrow width effect	US7880263	US12/238256	中芯上海	美国	发明	2008-09-25	2011-02-01	原始取得	无
370	Dram cell transistor device and method	US7989284	US12/238521	中芯上海	美国	发明	2008-09-26	2011-08-02	原始取得	无
371	Method for pmos device processing using a polysilicon footing characteristic to achieve low leakage	US7989230	US12/238689	中芯上海	美国	发明	2008-09-26	2011-08-02	原始取得	无
372	Ono spacer etch process to reduce dark current	US8133751	US12/238696	中芯上海	美国	发明	2008-09-26	2012-03-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
373	Method and system for derivation of breakdown voltage for mos integrated circuit devices	US7619435	US12/251387	中芯上海	美国	发明	2008-10-14	2009-11-17	原始取得	无
374	Self aligned mos structure with polysilicon contact	US8598004	US12/258371	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-24	2013-12-03	原始取得	无
375	Method and structure for a cmos image sensor using a triple gate process	US8048705	US12/258732	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-11-01	原始取得	无
376	Method and system for defect detection in manufacturing integrated circuits	US7991497	US12/258786	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-08-02	原始取得	无
377	Amorphous silicon monos or mas memory cell structure with otp function	US7892904	US12/258950	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-02-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
378	Method and system for forming conductive bumping with copper interconnection	US8053907	US12/258956	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-11-08	原始取得	无
379	Method for treatment of samples for transmission electron microscopes	US7923683	US12/258965	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-04-12	原始取得	无
380	Semiconductor device with amorphous silicon mas memory cell structure and manufacturing method thereof	US8105920	US12/259015	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2012-01-31	原始取得	无
381	Tft monos or sonos memory cell structures	US8101478	US12/259032	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2012-01-24	原始取得	无
382	Poly gate etch method and device for sonos-based flash memory	US8030165	US12/259053	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-10-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
383	Method for rapid thermal treatment using high energy electromagnetic radiation of a semiconductor substrate for formation of dielectric films	US7989363	US12/259095	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-08-02	原始取得	无
384	Atomic layer deposition epitaxial silicon growth for tft flash memory cell	US8415218	US12/259128	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-27	2013-04-09	原始取得	无
385	Method for defect reduction for memory cell capacitors	US8053310	US12/259138	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-11-08	原始取得	无
386	Tft sas memory cell structures	US8513079	US12/259144	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-27	2013-08-20	原始取得	无
387	Method and resulting capacitor structure for liquid crystal on silicon	US7936406	US12/259160	中芯上海	美国	发明	2008-10-27	2011-05-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	display devices									
388	Method of forming tft floating gate memory cell structures	US8420466	US12/259165	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-27	2013-04-16	原始取得	无
389	Method of forming low stress multi-layer metallurgical structures and high reliable lead free solder termination electrodes	US7816787	US12/273238	中芯上海	美国	发明	2008-11-18	2010-10-19	原始取得	无
390	Method with high gapfill capability for semiconductor devices	US8026151	US12/273323	中芯上海	美国	发明	2008-11-18	2011-09-27	原始取得	无
391	Method and resulting structure for fabricating test key structures in dram structures	US7847288	US12/331506	中芯上海	美国	发明	2008-12-10	2010-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
392	Methods for forming a gate and a shallow trench isolation region and for planarizating an etched surface of silicon substrate	US8039402	US12/333066	中芯上海	美国	发明	2008-12-11	2011-10-18	原始取得	无
393	Self-biased phase locked loop	US7719328	US12/336428	中芯上海	美国	发明	2008-12-16	2010-05-18	原始取得	无
394	Method for treatment of samples for auger electronic spectrometer (aes) in the manufacture of integrated circuits	US7927893	US12/364977	中芯上海	美国	发明	2009-02-03	2011-04-19	原始取得	无
395	Phase locked loop, lock detector and lock detection method	US7777540	US12/390324	中芯上海	美国	发明	2009-02-20	2010-08-17	原始取得	无
396	Low jitter cmos to cml converter	US7847591	US12/391100	中芯上海	美国	发明	2009-02-23	2010-12-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
397	Method and system for calibrating exposure system for manufacturing of integrated circuits	US8804100	US12/398143	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-03-04	2014-08-12	原始取得	无
398	Method and structure for fabricating smooth mirrors for liquid crystal on silicon devices	US9310643	US12/420706	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-04-08	2016-04-12	原始取得	无
399	Parallel to serial conversion circuit	US7821429	US12/430019	中芯上海	美国	发明	2009-04-24	2010-10-26	原始取得	无
400	Bga package holder device and method for testing of bga packages	US7932739	US12/437427	中芯上海	美国	发明	2009-05-07	2011-04-26	原始取得	无
401	Self-biased phase locked loop	US7986191	US12/464687	中芯上海	美国	发明	2009-05-12	2011-07-26	原始取得	无
402	Integrated electrostatic	US8053843	US12/483195	中芯上海	美国	发明	2009-06-11	2011-11-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	discharge (esd) device									
403	Sonos flash memory	US7977734	US12/502778	中芯上海	美国	发明	2009-07-14	2011-07-12	原始取得	无
404	Method for forming low dielectric constant fluorine-doped layers	US7910475	US12/505414	中芯上海	美国	发明	2009-07-17	2011-03-22	原始取得	无
405	Device with polymer layers and two-step self-aligned source etch with large process window	US7919810	US12/539575	中芯上海	美国	发明	2009-08-11	2011-04-05	原始取得	无
406	Charge pump circuit	US8120413	US12/542533	中芯北京	美国	发明	2009-08-17	2012-02-21	原始取得	无
407	Method for making split dual gate field effect transistor	US8093114	US12/549192	中芯上海	美国	发明	2009-08-27	2012-01-10	原始取得	无
408	Method for collecting optical proximity correction parameter	US7820346	US12/573753	中芯上海	美国	发明	2009-10-05	2010-10-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
409	Contact etch stop film	US7939915	US12/578374	中芯上海	美国	发明	2009-10-13	2011-05-10	原始取得	无
410	Method and system for analog-to-digital conversion	US7920085	US12/582691	中芯上海	美国	发明	2009-10-20	2011-04-05	原始取得	无
411	Method and system for determining semiconductor characteristics	US8679864	US12/637688	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-12-14	2014-03-25	原始取得	无
412	Method for eliminating loading effect using a via plug	US8089153	US12/637704	中芯上海	美国	发明	2009-12-14	2012-01-03	原始取得	无
413	Method for temperature compensation in mems resonators with isolated regions of distinct material	US8464418	US12/638919	中芯上海	美国	发明	2009-12-15	2013-06-18	继受取得	无
414	Method and structure for performing a chemical mechanical polishing	US8105897	US12/647359	中芯上海	美国	发明	2009-12-24	2012-01-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	process									
415	Method and structure for performing a chemical mechanical polishing process	US8105899	US12/647367	中芯上海	美国	发明	2009-12-24	2012-01-31	原始取得	无
416	Method and structure for performing a chemical mechanical polishing process	US8097508	US12/647369	中芯上海	美国	发明	2009-12-24	2012-01-17	原始取得	无
417	System and method for detecting one or more winding paths for patterns on a reticle for the manufacture of semiconductor integrated circuits	US8762902	US12/649278	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-12-29	2014-06-24	原始取得	无
418	Amplitude shift keyed (ask)	US8446983	US12/692603	中芯上	美国	发明	2010-01-23	2013-05-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	demodulation pattern and use in radio frequency identification (rfid)			海、中芯北京						
419	Method of making cmos image sensor-hybrid silicide	US7932127	US12/700700	中芯上海	美国	发明	2010-02-04	2011-04-26	原始取得	无
420	Method for manufacturing nano-crystalline silicon material for semiconductor integrated circuits	US8748260	US12/704495	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-02-11	2014-06-10	原始取得	无
421	Pad structure and test method	US8487641	US12/792533	中芯北京	美国	发明	2010-06-02	2013-07-16	原始取得	无
422	Application of millisecond heating source for surface treatment	US8148272	US12/842017	中芯上海	美国	发明	2010-07-22	2012-04-03	原始取得	无
423	Integration scheme for strained source/drain cmos	US8058120	US12/845676	中芯上海	美国	发明	2010-07-28	2011-11-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	using oxide hard mask									
424	Method and structure for self aligned contact for integrated circuits	US8507378	US12/848068	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-07-30	2013-08-13	原始取得	无
425	Method for forming contact hole structure	US8377821	US12/850349	中芯北京	美国	发明	2010-08-04	2013-02-19	原始取得	无
426	Resistive random access memory and the method of operating the same	US8451646	US12/854491	中芯北京	美国	发明	2010-08-11	2013-05-28	原始取得	无
427	Wireless memory card and method thereof	US8521956	US12/857513	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-08-16	2013-08-27	原始取得	无
428	Method for circuit layout and rapid thermal annealing method for semiconductor apparatus	US8392863	US12/877877	中芯北京	美国	发明	2010-09-08	2013-03-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
429	3-d electrically programmable and erasable single-transistor non-volatile semiconductor memory device	US8471323	US12/880039	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-10	2013-06-25	原始取得	无
430	Burn-in testing system	US7944223	US12/882051	中芯上海	美国	发明	2010-09-14	2011-05-17	原始取得	无
431	Method for manufacturing nano-crystalline silicon material from chloride chemistries for the semiconductor integrated circuits	US8685826	US12/884057	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-16	2014-04-01	原始取得	无
432	Non-volatile memory having nano crystalline silicon hillocks floating gate	US8815680	US12/886534	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-20	2014-08-26	原始取得	无
433	Surrounding stacked gate	US8513727	US12/892879	中芯上	美国	发明	2010-09-28	2013-08-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	multi-gate fet structure nonvolatile memory device			海、中芯北京						
434	System and method for integrated circuits with cylindrical gate structures	US8884363	US12/892881	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-28	2014-11-11	原始取得	无
435	Electroforming technique for mask formation	US8748313	US12/897618	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-10-04	2014-06-10	原始取得	无
436	Cmos image sensor with non-contact structure	US8513721	US12/902134	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-10-11	2013-08-20	原始取得	无
437	Method for fabricating an enlarged oxide-nitride-oxide structure for nand flash memory semiconductor devices	US8354704	US12/917419	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-11-01	2013-01-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
438	Mems coupler and method to form the same	US8716815	US12/927312	中芯上海	美国	发明	2010-11-10	2014-05-06	继受取得	无
439	Method for copper hillock reduction	US8815615	US12/938158	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-11-02	2014-08-26	原始取得	无
440	Method for temperature compensation in mems resonators with isolated regions of distinct material	US8669831	US12/950519	中芯上海	美国	发明	2010-11-19	2014-03-11	继受取得	无
441	System and method for cmos image sensing	US8026540	US12/953417	中芯上海	美国	发明	2010-11-23	2011-09-27	原始取得	无
442	System and method for eeprom architecture	US8470669	US12/959229	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-02	2013-06-25	原始取得	无
443	Method for manufacturing twin bit structure cell with	US8546224	US12/965808	中芯上海、中芯	美国	发明	2010-12-10	2013-10-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	aluminum oxide layer			北京						
444	Method for manufacturing twin bit structure cell with silicon nitride layer	US9064804	US12/968264	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-14	2015-06-23	原始取得	无
445	Low power high voltage regulator for non-volatile memory device	US8471537	US12/969571	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-15	2013-06-25	原始取得	无
446	Method for manufacturing twin bit structure cell with hafnium oxide and nano-crystalline silicon layer	US8598001	US12/978473	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-24	2013-12-03	原始取得	无
447	Method and structure for high q varactor	US8722475	US12/986123	中芯上海	美国	发明	2011-01-06	2014-05-13	原始取得	无
448	Hybrid integrated semiconductor tri-gate and	US9202762	US12/986130	中芯上海	美国	发明	2011-01-06	2015-12-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	split dual-gate finfet devices and method for manufacturing									
449	Method and resulting structure dram cell with selected inverse narrow width effect	US8338893	US12/987025	中芯上海	美国	发明	2011-01-07	2012-12-25	原始取得	无
450	Method and system of embedded microlens	US8319303	US12/987930	中芯上海	美国	发明	2011-01-10	2012-11-27	原始取得	无
451	Automatic identification of systematic repeating defects in semiconductor production	US8312395	US13/007556	中芯上海	美国	发明	2011-01-14	2012-11-13	原始取得	无
452	Amorphous silicon monos or mas memory cell structure with otp function	US8247864	US13/013229	中芯上海	美国	发明	2011-01-25	2012-08-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
453	Planar microshells for vacuum encapsulated devices and damascene method of manufacture	US8273594	US13/017767	中芯上海	美国	发明	2011-01-31	2012-09-25	继受取得	无
454	Microshells with integrated getter layer	US8288835	US13/017844	中芯上海	美国	发明	2011-01-31	2012-10-16	继受取得	无
455	Planar microshells for vacuum encapsulated devices and damascene method of manufacture	US8313970	US13/017892	中芯上海	美国	发明	2011-01-31	2012-11-20	继受取得	无
456	On-chip plasma charging sensor	US8796685	US13/035895	中芯上海	美国	发明	2011-02-25	2014-08-05	原始取得	无
457	System and method of selective optical pattern enhancement for semiconductor manufacturing	US8541147	US13/035900	中芯上海	美国	发明	2011-02-25	2013-09-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
458	System and method for test pattern for lithography process	US8501376	US13/046733	中芯上海	美国	发明	2011-03-12	2013-08-06	原始取得	无
459	Technique for forming a mems device	US8852984	US13/075800	中芯上海	美国	发明	2011-03-30	2014-10-07	继受取得	无
460	Technique for forming a mems device using island structures	US8877536	US13/075806	中芯上海	美国	发明	2011-03-30	2014-11-04	继受取得	无
461	Device and methods for electrostatic discharge protection	US8368186	US13/076269	中芯上海	美国	发明	2011-03-30	2013-02-05	原始取得	无
462	Method and device for a dram capacitor having low depletion ratio	US8426286	US13/078917	中芯上海	美国	发明	2011-04-01	2013-04-23	原始取得	无
463	Method and resulting capacitor structure for	US8681283	US13/081471	中芯上海	美国	发明	2011-04-06	2014-03-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	liquid crystal on silicon display devices									
464	Dual damascene copper process using a selected mask	US8685853	US13/093809	中芯上海	美国	发明	2011-04-25	2014-04-01	原始取得	无
465	Method and structure for fabricating dark-periphery mask for the manufacture of semiconductor wafers	US8404409	US13/100285	中芯上海	美国	发明	2011-05-03	2013-03-26	原始取得	无
466	Dram cell transistor device and method	US8324666	US13/108917	中芯上海	美国	发明	2011-05-16	2012-12-04	原始取得	无
467	Method for introducing channel stress and field effect transistor fabricated by the same	US8450155	US13/131602	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-01	2013-05-28	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
468	Method for fabricating a	US8288238	US13/133643	中芯上	美国	发明	2010-09-25	2012-10-16	北京大学：原始取	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	tunneling field-effect transistor			海、北京大学					得；中芯上海：继受取得	
469	Programming method for programming flash memory array structure	US8593848	US13/146005	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-21	2013-11-26	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
470	Lcos display unit and method for forming the same	US8379183	US13/155870	中芯上海	美国	发明	2011-06-08	2013-02-19	原始取得	无
471	Method for fabricating a phase change memory	US8409883	US13/157076	中芯北京	美国	发明	2011-06-09	2013-04-02	原始取得	无
472	Method for cleaning a polishing pad	US8721401	US13/163667	中芯上海	美国	发明	2011-06-17	2014-05-13	原始取得	无
473	Method for fabricating an nmos transistor	US8728894	US13/171426	中芯上海	美国	发明	2011-06-28	2014-05-20	原始取得	无
474	Method for processing a glass substrate	US8741747	US13/171749	中芯上海	美国	发明	2011-06-29	2014-06-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
475	Out-of-plane mems resonator with static out-of-plane deflection	US8258893	US13/173432	中芯上海	美国	发明	2011-06-30	2012-09-04	继受取得	无
476	Out-of-plane resonator	US8674775	US13/173449	中芯上海	美国	发明	2011-06-30	2014-03-18	继受取得	无
477	Switchable electrode for power handling	US8471641	US13/173815	中芯上海	美国	发明	2011-06-30	2013-06-25	继受取得	无
478	Phase change memory and method for fabricating the same	US8481348	US13/176632	中芯北京	美国	发明	2011-07-05	2013-07-09	原始取得	无
479	Polishing apparatus and exception handling method thereof	US8858817	US13/176674	中芯北京	美国	发明	2011-07-05	2014-10-14	原始取得	无
480	Method for forming metal gate and mos transistor	US8507336	US13/176678	中芯北京	美国	发明	2011-07-05	2013-08-13	原始取得	无
481	Method for forming a gate electrode	US8349675	US13/177517	中芯北京	美国	发明	2011-07-06	2013-01-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
482	Method for fabricating a high-k metal gate mos	US8313991	US13/178455	中芯上海	美国	发明	2011-07-07	2012-11-20	原始取得	无
483	Method for chip scale package and package structure thereof	US9059004	US13/179837	中芯北京	美国	发明	2011-07-11	2015-06-16	原始取得	无
484	Chemical mechanical polishing device and polishing element	US8851959	US13/184907	中芯上海	美国	发明	2011-07-18	2014-10-07	原始取得	无
485	Transistor and method for forming the same	US8420511	US13/196671	中芯北京	美国	发明	2011-08-02	2013-04-16	原始取得	无
486	Method for forming metal gate	US8673707	US13/198645	中芯上海	美国	发明	2011-08-04	2014-03-18	原始取得	无
487	Electrostatic discharge protection device and method for fabricating the same	US8476672	US13/201370	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-02	2013-07-02	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
488	Semiconductor device and method for fabricating the same	US8541847	US13/201618	中芯上海、北京大学	美国	发明	2010-09-25	2013-09-24	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
489	Transistor and method for forming the same	US8492213	US13/204319	中芯北京	美国	发明	2011-08-05	2013-07-23	原始取得	无
490	Method for forming an interconnect structure	US8354341	US13/208332	中芯上海	美国	发明	2011-08-11	2013-01-15	原始取得	无
491	Methods for forming a gate and a shallow trench isolation region and for planarizing an etched surface of silicon substrate	US8377827	US13/208885	中芯上海	美国	发明	2011-08-12	2013-02-19	原始取得	无
492	Methods for forming a gate and a shallow trench isolation region and for planarizing an etched surface of silicon substrate	US8367554	US13/208892	中芯上海	美国	发明	2011-08-12	2013-02-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
493	Cleaning device and a cleaning method of a fixed abrasives polishing pad	US8920572	US13/211306	中芯上海	美国	发明	2011-08-17	2014-12-30	原始取得	无
494	Bga package structure and method for fabricating the same	US8723319	US13/219371	中芯北京	美国	发明	2011-08-26	2014-05-13	原始取得	无
495	Semiconductor device having air gap and method for manufacturing the same	US8575024	US13/226374	中芯上海	美国	发明	2011-09-06	2013-11-05	原始取得	无
496	Method for fabricating a capacitor and capacitor structure thereof	US8679937	US13/235181	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2011-09-16	2014-03-25	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
497	Method of forming a gate pattern and a semiconductor device	US8741744	US13/240637	中芯上海	美国	发明	2011-09-22	2014-06-03	原始取得	无
498	Chemical mechanical	US8845398	US13/240733	中芯上海	美国	发明	2011-09-22	2014-09-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	polisher and polishing pad component thereof									
499	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8507379	US13/240820	中芯北京	美国	发明	2011-09-22	2013-08-13	原始取得	无
500	Semiconductor device and method for fabricating semiconductor device	US8841187	US13/243218	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2014-09-23	原始取得	无
501	Semiconductor device	US8872575	US13/243437	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2014-10-28	原始取得	无
502	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8951852	US13/243563	中芯北京	美国	发明	2011-09-23	2015-02-10	原始取得	无
503	Method of manufacturing a phase change semiconductor device and the phase change	US8846483	US13/243862	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2014-09-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor device									
504	Method of forming gate pattern and semiconductor device	US8759179	US13/243902	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2014-06-24	原始取得	无
505	Method of manufacturing semiconductor device and wafer	US9410233	US13/243944	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2016-08-09	原始取得	无
506	Method for manufacturing a transistor	US8435900	US13/243977	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2013-05-07	原始取得	无
507	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9099323	US13/244054	中芯北京	美国	发明	2011-09-23	2015-08-04	原始取得	无
508	Polishing method and method for forming a gate	US8541308	US13/244196	中芯上海	美国	发明	2011-09-23	2013-09-24	原始取得	无
509	Integrated electrostatic discharge (esd) device	US8891213	US13/244292	中芯上海	美国	发明	2011-09-24	2014-11-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
510	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US8735282	US13/250153	中芯北京	美国	发明	2011-09-30	2014-05-27	原始取得	无
511	Chemical mechanical polishing method	US8455362	US13/253947	中芯上海	美国	发明	2011-10-05	2013-06-04	原始取得	无
512	Resistive-switching memory and fabrication method thereof	US8513639	US13/254570	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-12	2013-08-20	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
513	Strained channel field effect transistor and the method for fabricating the same	US8673722	US13/255443	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-03-23	2014-03-18	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
514	Fabrication method for surrounding gate silicon nanowire transistor with air as spacers	US8513067	US13/266791	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-07-15	2013-08-20	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
515	Method and system for	US8293635	US13/269538	中芯上海	美国	发明	2011-10-07	2012-10-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	forming conductive bumping with copper interconnection									
516	Bond pad for low k dielectric materials and method for manufacture for semiconductor devices	US8395240	US13/274246	中芯上海	美国	发明	2011-10-14	2013-03-12	原始取得	无
517	Semiconductor device and method for manufacturing the same	US8389404	US13/283574	中芯上海	美国	发明	2011-10-27	2013-03-05	原始取得	无
518	Fixed abrasive pad and method for forming the same	US9004985	US13/286961	中芯上海	美国	发明	2011-11-01	2015-04-14	原始取得	无
519	Method of fabricating semiconductor devices including pmos devices having embedded sige	US9449834	US13/289983	中芯北京	美国	发明	2011-11-04	2016-09-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
520	Method for fabricating a semiconductor device	US8372722	US13/290007	中芯北京	美国	发明	2011-11-04	2013-02-12	原始取得	无
521	Mask-less method and structure for patterning photosensitive material using optical fibers	US8351748	US13/291079	中芯上海	美国	发明	2011-11-07	2013-01-08	原始取得	无
522	Integrated electrostatic discharge (esd) device	US8817435	US13/291093	中芯上海	美国	发明	2011-11-07	2014-08-26	原始取得	无
523	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US8476163	US13/291096	中芯上海	美国	发明	2011-11-08	2013-07-02	原始取得	无
524	Method of fabricating semiconductor devices	US9349862	US13/293001	中芯北京	美国	发明	2011-11-09	2016-05-24	原始取得	无
525	Method of fabricating semiconductor devices	US8450166	US13/293030	中芯北京	美国	发明	2011-11-09	2013-05-28	原始取得	无
526	Method of fabricating	US8450167	US13/293052	中芯北京	美国	发明	2011-11-09	2013-05-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor devices									
527	Method for forming pattern and mask pattern, and method for manufacturing semiconductor device	US8828871	US13/293979	中芯北京	美国	发明	2011-11-10	2014-09-09	原始取得	无
528	Post-etching treatment process for copper interconnecting wires	US8445376	US13/304266	中芯上海	美国	发明	2011-11-23	2013-05-21	原始取得	无
529	Method for forming through silicon via structure	US8563432	US13/304268	中芯上海	美国	发明	2011-11-23	2013-10-22	原始取得	无
530	Method for manufacturing semiconductor device having interlayer dielectric layers and a gate contact	US8673776	US13/305417	中芯上海	美国	发明	2011-11-28	2014-03-18	原始取得	无
531	Method for manufacturing transistor	US8377770	US13/305726	中芯上海	美国	发明	2011-11-28	2013-02-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
532	Method for forming semiconductor device	US8536001	US13/306834	中芯北京	美国	发明	2011-11-29	2013-09-17	原始取得	无
533	Method for manufacturing a semiconductor device	US8513075	US13/306969	中芯北京	美国	发明	2011-11-29	2013-08-20	原始取得	无
534	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8697575	US13/307766	中芯北京	美国	发明	2011-11-30	2014-04-15	原始取得	无
535	Method for removing polishing byproducts and polishing device	US8808063	US13/308526	中芯上海	美国	发明	2011-11-30	2014-08-19	原始取得	无
536	Method for manufacturing semiconductor device	US9881836	US13/310311	中芯北京	美国	发明	2011-12-02	2018-01-30	原始取得	无
537	Method of fabricating a semiconductor device	US8664122	US13/310365	中芯北京	美国	发明	2011-12-02	2014-03-04	原始取得	无
538	Method of fabricating a semiconductor device	US8580695	US13/310624	中芯北京	美国	发明	2011-12-02	2013-11-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
539	Post-etch treating method	US9064819	US13/313266	中芯北京	美国	发明	2011-12-07	2015-06-23	原始取得	无
540	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8587026	US13/313979	中芯北京	美国	发明	2011-12-07	2013-11-19	原始取得	无
541	Method for forming hard mask in semiconductor device fabrication	US8828868	US13/314000	中芯北京	美国	发明	2011-12-07	2014-09-09	原始取得	无
542	Electrostatic discharge protection circuit and electrostatic discharge protection method	US8767359	US13/314797	中芯北京	美国	发明	2011-12-08	2014-07-01	原始取得	无
543	Method of fabricating a semiconductor device	US8846535	US13/315143	中芯北京	美国	发明	2011-12-08	2014-09-30	原始取得	无
544	Semiconductor device and manufacturing method thereof for protecting	US9324662	US13/316165	中芯北京	美国	发明	2011-12-09	2016-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	metal-gate from oxidation									
545	Semiconductor device manufacturing method	US8642470	US13/316192	中芯北京	美国	发明	2011-12-09	2014-02-04	原始取得	无
546	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8610175	US13/316217	中芯北京	美国	发明	2011-12-09	2013-12-17	原始取得	无
547	Semiconductor device and manufacturing method for the same	US8664052	US13/316451	中芯北京	美国	发明	2011-12-09	2014-03-04	原始取得	无
548	Semiconductor device capable of reducing plasma induced damage and fabrication method thereof	US8722549	US13/316454	中芯北京	美国	发明	2011-12-09	2014-05-13	原始取得	无
549	Combined-source mos transistor with comb-shaped gate, and method for	US8507959	US13/318333	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-01	2013-08-13	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing the same									
550	Flash memory and fabrication method and operation method for the same	US8526242	US13/321120	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-03-07	2013-09-03	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
551	Method of manufacturing a semiconductor device	US8748279	US13/323489	中芯北京	美国	发明	2011-12-12	2014-06-10	原始取得	无
552	Method for manufacturing a semiconductor device	US8835325	US13/323728	中芯北京	美国	发明	2011-12-12	2014-09-16	原始取得	无
553	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8466065	US13/324885	中芯北京	美国	发明	2011-12-13	2013-06-18	原始取得	无
554	Double gate transistor and method of fabricating the same	US8502289	US13/324945	中芯北京	美国	发明	2011-12-13	2013-08-06	原始取得	无
555	Apparatus and method for	US8891732	US13/325017	中芯北京	美国	发明	2011-12-13	2014-11-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	detecting marks and semiconductor device processing system									
556	Electric-controlled operator	US8556318	US13/326011	中芯北京	美国	发明	2011-12-14	2013-10-15	原始取得	无
557	Semiconductor device and manufacturing method involving multilayer contact etch stop	US8877651	US13/326161	中芯北京	美国	发明	2011-12-14	2014-11-04	原始取得	无
558	Method of manufacturing semiconductor device including ashing of photoresist with deuterium or tritium gas	US8753930	US13/326275	中芯上海	美国	发明	2011-12-14	2014-06-17	原始取得	无
559	Semiconductor wafer and processing method therefor	US8692357	US13/326303	中芯北京	美国	发明	2011-12-14	2014-04-08	原始取得	无
560	Semiconductor device and	US8951871	US13/326322	中芯北京	美国	发明	2011-12-15	2015-02-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing method thereof									
561	Method of fabricating semiconductor devices	US8716151	US13/326323	中芯北京	美国	发明	2011-12-15	2014-05-06	原始取得	无
562	Polishing method and polishing device	US8758090	US13/328846	中芯上海	美国	发明	2011-12-16	2014-06-24	原始取得	无
563	Photolithography alignment mark, mask and semiconductor wafer containing the same mark	US9024456	US13/329152	中芯北京	美国	发明	2011-12-16	2015-05-05	原始取得	无
564	Tft monos or sonos memory cell structures	US8487366	US13/332259	中芯上海	美国	发明	2011-12-20	2013-07-16	原始取得	无
565	Semiconductor device with amorphous silicon mas memory cell structure and manufacturing method	US8569757	US13/333994	中芯上海	美国	发明	2011-12-21	2013-10-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
566	Magnetic tunnel junction device and its fabricating method	US8574927	US13/335882	中芯北京	美国	发明	2011-12-22	2013-11-05	原始取得	无
567	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8951883	US13/345409	中芯北京	美国	发明	2012-01-06	2015-02-10	原始取得	无
568	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9263566	US13/351139	中芯北京	美国	发明	2012-01-16	2016-02-16	原始取得	无
569	Reaction apparatus for processing wafer, electrostatic chuck and wafer temperature control method	US8952297	US13/351741	中芯北京	美国	发明	2012-01-17	2015-02-10	原始取得	无
570	Semiconductor device and	US8912568	US13/354060	中芯北京	美国	发明	2012-01-19	2014-12-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing method thereof									
571	Semiconductor device manufacturing method	US8586405	US13/369738	中芯北京	美国	发明	2012-02-09	2013-11-19	原始取得	无
572	Method for manufacturing semiconductor device with tensile stress	US9478654	US13/369782	中芯北京	美国	发明	2012-02-09	2016-10-25	原始取得	无
573	Method for fabricating semiconductor nano circular ring	US8722312	US13/379752	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-09-09	2014-05-13	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
574	High voltage-resistant lateral double-diffused transistor based on nanowire device	US8564031	US13/381633	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-04-01	2013-10-22	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
575	Method for fabricating surrounding-gate silicon	US8563370	US13/384215	中芯上海、北京	美国	发明	2011-07-04	2013-10-22	北京大学：原始取得；中芯上海：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	nanowire transistor with air sidewalls			大学					受取得	
576	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8722533	US13/398834	中芯上海	美国	发明	2012-02-16	2014-05-13	原始取得	无
577	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8975181	US13/398837	中芯北京	美国	发明	2012-02-16	2015-03-10	原始取得	无
578	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8835213	US13/401819	中芯北京	美国	发明	2012-02-21	2014-09-16	原始取得	无
579	Photolithographic method	US9581915	US13/405233	中芯北京	美国	发明	2012-02-25	2017-02-28	原始取得	无
580	Photolithographic apparatus	US8982314	US13/405238	中芯北京	美国	发明	2012-02-25	2015-03-17	原始取得	无
581	Mask, manufacturing method thereof and mask haze monitoring method	US8563201	US13/411474	中芯北京	美国	发明	2012-03-02	2013-10-22	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
582	Integrated semiconductor device and manufacturing method therefor	US9812442	US13/418339	中芯北京	美国	发明	2012-03-12	2017-11-07	原始取得	无
583	Magnetic tunnel junction device and its fabricating method	US8860155	US13/427116	中芯北京	美国	发明	2012-03-22	2014-10-14	原始取得	无
584	Semiconductor apparatus and manufacturing method thereof	US9111862	US13/431728	中芯上海	美国	发明	2012-03-27	2015-08-18	原始取得	无
585	Method, optical module and auto-focusing system for wafer edge exposure	US9081149	US13/441838	中芯北京	美国	发明	2012-04-06	2015-07-14	原始取得	无
586	Semiconductor trench structure having a silicon nitride layer overlaying an oxide layer	US9029978	US13/456079	中芯上海	美国	发明	2012-04-25	2015-05-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
587	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8877577	US13/458363	中芯上海	美国	发明	2012-04-27	2014-11-04	原始取得	无
588	Manufacturing method for semiconductor device having side by side different fins	US8679950	US13/481800	中芯北京	美国	发明	2012-05-26	2014-03-25	原始取得	无
589	Semiconductor device manufacturing method	US8716080	US13/481803	中芯北京	美国	发明	2012-05-26	2014-05-06	原始取得	无
590	Semiconductor device having metal alloy gate and method for manufacturing the same	US8815728	US13/486994	中芯上海	美国	发明	2012-06-01	2014-08-26	原始取得	无
591	I-shape floating gate for flash memory device and fabricating the same	US8536639	US13/498585	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-11-30	2013-09-17	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
592	Mos transistor having combined-source structure with low power consumption and method for fabricating the same	US8710557	US13/501241	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-10-14	2014-04-29	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
593	Fabrication method of vertical silicon nanowire field effect transistor	US8592276	US13/501711	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-11-18	2013-11-26	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
594	Cmos device for reducing radiation-induced charge collection and method for fabricating the same	US8877594	US13/509170	中芯上海、北京大学	美国	发明	2011-11-30	2014-11-04	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
595	Multilevel resistive memory having large storage capacity	US8633465	US13/513155	中芯上海、北京大学	美国	发明	2012-02-08	2014-01-21	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
596	Method for fabricating ultra-fine nanowire	US8372752	US13/543704	中芯上海、北京	美国	发明	2012-07-06	2013-02-12	北京大学：原始取得；中芯上海：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				大学					受取得	
597	Chip-to-wafer bonding method and three-dimensional integrated semiconductor device	US8697543	US13/551559	中芯北京	美国	发明	2012-07-17	2014-04-15	原始取得	无
598	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8518781	US13/552446	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-07-18	2013-08-27	原始取得	无
599	Ge-based nmos device and method for fabricating the same	US8865543	US13/580971	中芯上海、北京大学	美国	发明	2012-02-21	2014-10-21	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
600	Cmos device for reducing charge sharing effect and fabrication method thereof	US8652929	US13/582034	中芯上海、北京大学	美国	发明	2012-04-16	2014-02-18	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
601	Heat dissipation structure of	US8598636	US13/582624	中芯上	美国	发明	2011-08-17	2013-12-03	北京大学：原始取	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	soi field effect transistor			海、北京大学					得；中芯上海：继受取得	
602	Out-of plane mems resonator with static out-of-plane deflection	US8629739	US13/599240	中芯上海	美国	发明	2012-08-30	2014-01-14	继受取得	无
603	Semiconductor device and related manufacturing method	US8872243	US13/618004	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-09-14	2014-10-28	原始取得	无
604	Elastic retention wheels and wafer adapter containing the same wheels	US9111973	US13/622869	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-09-19	2015-08-18	原始取得	无
605	Semiconductor device and method for manufacturing a semiconductor device	US8728926	US13/623340	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-09-20	2014-05-20	原始取得	无
606	Complementary junction field effect transistor device	US8877575	US13/626634	中芯上海、中芯	美国	发明	2012-09-25	2014-11-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and its gate-last fabrication method			北京						
607	Method and system for forming conductive bumping with copper interconnection	US8581366	US13/645448	中芯上海	美国	发明	2012-10-04	2013-11-12	原始取得	无
608	Apparatus and method for holding a wafer	US8917489	US13/649576	中芯上海	美国	发明	2012-10-11	2014-12-23	原始取得	无
609	Apparatus and method for holding a wafer	US8929051	US13/649686	中芯上海	美国	发明	2012-10-11	2015-01-06	原始取得	无
610	Fin fet structure with dual-stress spacers and method for forming the same	US9099558	US13/653329	中芯上海	美国	发明	2012-10-16	2015-08-04	原始取得	无
611	Semiconductor magnetoresistive	US8765490	US13/654321	中芯上海、中芯	美国	发明	2012-10-17	2014-07-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	random-access memory (mram) device and manufacturing method thereof			北京						
612	Metal silicide layer, nmos transistor, and fabrication method	US8865593	US13/654518	中芯上海	美国	发明	2012-10-18	2014-10-21	原始取得	无
613	Phase change memory and manufacturing method therefor	US8916413	US13/656370	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-10-19	2014-12-23	原始取得	无
614	Via arrangement and semiconductor device with the via arrangement	US8890320	US13/659829	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-10-24	2014-11-18	原始取得	无
615	Method of fabricating miniaturized semiconductor or other device	US9443755	US13/660853	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-10-25	2016-09-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
616	High-k dielectric layer based semiconductor structures and fabrication process thereof	US9190282	US13/662535	中芯上海	美国	发明	2012-10-28	2015-11-17	原始取得	无
617	Electrically conductive device and manufacturing method thereof	US8932950	US13/664317	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-10-30	2015-01-13	原始取得	无
618	Semiconductor device and fabrication method	US8889516	US13/672696	中芯上海	美国	发明	2012-11-08	2014-11-18	原始取得	无
619	Cmos device and fabrication method	US8802523	US13/675216	中芯上海	美国	发明	2012-11-13	2014-08-12	原始取得	无
620	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8871583	US13/675759	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-11-13	2014-10-28	原始取得	无
621	Semiconductor memory device and manufacturing	US9023710	US13/675975	中芯上海、中芯	美国	发明	2012-11-13	2015-05-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof			北京						
622	Ic device including package structure and method of forming the same	US8816501	US13/684165	中芯上海	美国	发明	2012-11-22	2014-08-26	原始取得	无
623	Integrated semiconductor device and fabrication method	US8828814	US13/685729	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2014-09-09	原始取得	无
624	Method for inspecting a chip layout	US8560992	US13/685731	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2013-10-15	原始取得	无
625	Semiconductor device and manufacturing method	US8975167	US13/686019	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2015-03-10	原始取得	无
626	Mask pattern alignment method and system	US9348240	US13/686096	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2016-05-24	原始取得	无
627	Transistor device and fabrication method	US8975642	US13/686163	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2015-03-10	原始取得	无
628	Fin field-effect-transistor	US8748247	US13/686300	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2014-06-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	(fet) structure and manufacturing method									
629	Method for forming metal gate	US8679923	US13/686483	中芯上海	美国	发明	2012-11-27	2014-03-25	原始取得	无
630	Inductor device and fabrication method	US8866259	US13/690267	中芯上海	美国	发明	2012-11-30	2014-10-21	原始取得	无
631	Inductor device and fabrication method	US8884399	US13/690378	中芯上海	美国	发明	2012-11-30	2014-11-11	原始取得	无
632	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8912039	US13/691533	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-11-30	2014-12-16	原始取得	无
633	Interface treatment method for germanium-based device	US8632691	US13/702562	中芯上海、北京大学	美国	发明	2012-06-14	2014-01-21	北京大学：原始取得；中芯上海：继受取得	无
634	Hybrid integrated semiconductor tri-gate and	US9922878	US13/711586	中芯上海	美国	发明	2012-12-11	2018-03-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	split dual-gate finfet devices and method for manufacturing									
635	Cmos devices and fabrication method	US8901675	US13/714452	中芯上海	美国	发明	2012-12-14	2014-12-02	原始取得	无
636	Strained-induced mobility enhancement nano-device structure and integrated process architecture for cmos technologies	US9048300	US13/716533	中芯上海	美国	发明	2012-12-17	2015-06-02	原始取得	无
637	Method of fabricating a semiconductor device	US8822234	US13/722072	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2012-12-20	2014-09-02	原始取得	无
638	Semiconductor structure and fabrication method	US8753956	US13/724284	中芯上海	美国	发明	2012-12-21	2014-06-17	原始取得	无
639	Method and system for	US8673764	US13/726672	中芯上海	美国	发明	2012-12-26	2014-03-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	making and cleaning semiconductor device									
640	Lithography machine and scanning and exposing method thereof	US9134624	US13/730818	中芯上海	美国	发明	2012-12-28	2015-09-15	原始取得	无
641	Through silicon via packaging structures and fabrication method	US8853077	US13/730833	中芯上海	美国	发明	2012-12-29	2014-10-07	原始取得	无
642	Semiconductor structures and fabrication method	US8674450	US13/733461	中芯上海	美国	发明	2013-01-03	2014-03-18	原始取得	无
643	High-k layers, transistors, and fabrication method	US9029224	US13/736093	中芯上海	美国	发明	2013-01-08	2015-05-12	原始取得	无
644	Pmos transistors and fabrication method	US8980718	US13/737966	中芯上海	美国	发明	2013-01-10	2015-03-17	原始取得	无
645	Mos transistor, formation method thereof, and sram	US8975703	US13/739311	中芯上海	美国	发明	2013-01-11	2015-03-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	memory cell circuit									
646	Transistor device and fabrication method	US9112012	US13/740293	中芯上海	美国	发明	2013-01-14	2015-08-18	原始取得	无
647	Cmos device and fabrication method	US8884374	US13/744864	中芯上海	美国	发明	2013-01-18	2014-11-11	原始取得	无
648	Method and apparatus for monitoring electron beam condition of scanning electron microscope	US8829424	US13/756148	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-01-31	2014-09-09	原始取得	无
649	Standard wafer and its fabrication method	US9019152	US13/757063	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-02-01	2015-04-28	原始取得	无
650	Exposure device and exposure method	US9223229	US13/761436	中芯上海	美国	发明	2013-02-07	2015-12-29	原始取得	无
651	Semiconductor device and manufacturing method	US8871622	US13/762163	中芯上海、中芯	美国	发明	2013-02-07	2014-10-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof			北京						
652	Transistor and method for forming the same	US8741708	US13/770283	中芯上海	美国	发明	2013-02-19	2014-06-03	原始取得	无
653	Fin field effect transistor and fabrication method	US9129994	US13/777142	中芯上海	美国	发明	2013-02-26	2015-09-08	原始取得	无
654	Fin field effect transistor and fabrication method	US8865552	US13/777346	中芯上海	美国	发明	2013-02-26	2014-10-21	原始取得	无
655	Method for forming double patterned structure	US8853093	US13/787855	中芯上海	美国	发明	2013-03-07	2014-10-07	原始取得	无
656	Method of forming double pattern in a structure	US9070557	US13/787869	中芯上海	美国	发明	2013-03-07	2015-06-30	原始取得	无
657	Mos transistor, fabrication method thereof, and sram memory cell circuit	US9178062	US13/792251	中芯上海	美国	发明	2013-03-11	2015-11-03	原始取得	无
658	Silicon-on-insulator substrate and fabrication	US8980729	US13/795086	中芯上海	美国	发明	2013-03-12	2015-03-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method									
659	Method of epitaxially growing silicon by atomic layer deposition for tft flash memory cell	US8906785	US13/801077	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-03-13	2014-12-09	原始取得	无
660	System and method for test structure on a wafer	US9472476	US13/801251	中芯上海	美国	发明	2013-03-13	2016-10-18	原始取得	无
661	Small pitch patterns and fabrication method	US9312328	US13/831987	中芯上海	美国	发明	2013-03-15	2016-04-12	原始取得	无
662	Transistors and fabrication method thereof	US8859354	US13/831995	中芯上海	美国	发明	2013-03-15	2014-10-14	原始取得	无
663	Nanowires, nanowire fielde-effect transistors and fabrication method	US8912545	US13/832648	中芯上海	美国	发明	2013-03-15	2014-12-16	原始取得	无
664	Transistors and fabrication method	US9054021	US13/832933	中芯上海	美国	发明	2013-03-15	2015-06-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
665	Semiconductor device including contact holes and method for forming the same	US8748248	US13/833972	中芯上海	美国	发明	2013-03-15	2014-06-10	原始取得	无
666	Method for correcting layout pattern and mask thereof	US8788983	US13/845149	中芯上海	美国	发明	2013-03-18	2014-07-22	原始取得	无
667	System and method for integrated circuits with cylindrical gate structures	US9373694	US13/848707	中芯上海	美国	发明	2013-03-21	2016-06-21	原始取得	无
668	Tft floating gate memory cell structures	US8941170	US13/850868	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-03-26	2015-01-27	原始取得	无
669	Method and device for a dram capacitor having low depletion ratio	US8742542	US13/851466	中芯上海	美国	发明	2013-03-27	2014-06-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
670	Signal receiver and signal transmission apparatus	US8854105	US13/855466	中芯上海	美国	发明	2013-04-02	2014-10-07	原始取得	无
671	Fin field-effect transistors and fabrication method thereof	US9117906	US13/861584	中芯上海	美国	发明	2013-04-12	2015-08-25	原始取得	无
672	Method for fabricating mos transistors	US8846527	US13/887509	中芯上海	美国	发明	2013-05-06	2014-09-30	原始取得	无
673	Semiconductor sram structures	US9368503	US13/890278	中芯上海	美国	发明	2013-05-09	2016-06-14	原始取得	无
674	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US8829483	US13/895185	中芯北京	美国	发明	2013-05-15	2014-09-09	原始取得	无
675	Voltage regulator devices and voltage regulating method	US9343958	US13/896567	中芯上海	美国	发明	2013-05-17	2016-05-17	原始取得	无
676	Semiconductor device and	US8716764	US13/897171	中芯上海	美国	发明	2013-05-17	2014-05-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing method thereof									
677	Semiconductor device with contact hole and manufacturing method thereof	US9082641	US13/897836	中芯上海	美国	发明	2013-05-20	2015-07-14	原始取得	无
678	Method for temperature compensation in mems resonators with isolated regions of distinct material	US9422157	US13/901258	中芯上海	美国	发明	2013-05-23	2016-08-23	继受取得	无
679	Transistor device and fabrication method	US9147614	US13/904341	中芯上海	美国	发明	2013-05-29	2015-09-29	原始取得	无
680	Method for dual energy implantation for ultra-shallow junction formation of mos devices	US9024281	US13/906897	中芯上海	美国	发明	2013-05-31	2015-05-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
681	Phase change memory	US8933428	US13/910956	中芯北京	美国	发明	2013-06-05	2015-01-13	原始取得	无
682	Semiconductor device and manufacturing method thereof for protecting metal-gate from oxidation	US9318445	US13/911805	中芯北京	美国	发明	2013-06-06	2016-04-19	原始取得	无
683	Semiconductor device and fabrication method	US9147737	US13/914868	中芯上海	美国	发明	2013-06-11	2015-09-29	原始取得	无
684	Semiconductor device and method for fabricating semiconductor device	US9391188	US13/916890	中芯上海	美国	发明	2013-06-13	2016-07-12	原始取得	无
685	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US8895389	US13/919276	中芯上海	美国	发明	2013-06-17	2014-11-25	原始取得	无
686	Jlt (junction-less transistor) device and method for fabricating the same	US8928082	US13/921209	中芯上海	美国	发明	2013-06-19	2015-01-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
687	Cmos transistors, fin field-effect transistors and fabrication methods thereof	US8859358	US13/921386	中芯上海	美国	发明	2013-06-19	2014-10-14	原始取得	无
688	Semicondcutor device comprising transistor	US8569798	US13/923883	中芯北京	美国	发明	2013-06-21	2013-10-29	原始取得	无
689	Gate structure and manufacturing method thereof	US9035397	US13/923943	中芯上海	美国	发明	2013-06-21	2015-05-19	原始取得	无
690	Lithography system and lithography method	US10180631	US13/924325	中芯上海	美国	发明	2013-06-21	2019-01-15	原始取得	无
691	Semiconductor device and fabricating method thereof	US8999843	US13/927830	中芯上海	美国	发明	2013-06-26	2015-04-07	原始取得	无
692	Method and apparatus for repairing defective memory cells	US9111643	US13/928233	中芯上海	美国	发明	2013-06-26	2015-08-18	原始取得	无
693	Method of manufacturing a	US8962428	US13/935228	中芯上海	美国	发明	2013-07-03	2015-02-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor device									
694	Laser annealing device and method	US9257287	US13/935265	中芯上海	美国	发明	2013-07-03	2016-02-09	原始取得	无
695	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9293550	US13/940095	中芯上海	美国	发明	2013-07-11	2016-03-22	原始取得	无
696	Surrounding stacked gate multi-gate fet structure nonvolatile memory device	US8889510	US13/940256	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-07-12	2014-11-18	原始取得	无
697	System and method for test pattern for lithography process	US8921013	US13/940260	中芯上海	美国	发明	2013-07-12	2014-12-30	原始取得	无
698	Fin field-effect transistors and fabrication method thereof	US8809173	US13/940283	中芯上海	美国	发明	2013-07-12	2014-08-19	原始取得	无
699	Semiconductor device and	US9287397	US13/947911	中芯上海	美国	发明	2013-07-22	2016-03-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method of fabricating same									
700	Method for fabricating a semiconductor device	US8846475	US13/954976	中芯上海	美国	发明	2013-07-31	2014-09-30	原始取得	无
701	Semiconductor device	US8581311	US13/961907	中芯北京	美国	发明	2013-08-08	2013-11-12	原始取得	无
702	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9263321	US13/970333	中芯上海	美国	发明	2013-08-19	2016-02-16	原始取得	无
703	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9379206	US14/012900	中芯上海	美国	发明	2013-08-28	2016-06-28	原始取得	无
704	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9012289	US14/017163	中芯北京	美国	发明	2013-09-03	2015-04-21	原始取得	无
705	Method and apparatus for alarm monitoring	US9798320	US14/017297	中芯上海	美国	发明	2013-09-03	2017-10-24	原始取得	无
706	Semiconductor device having buried layer and	US9159785	US14/020790	中芯上海	美国	发明	2013-09-07	2015-10-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method for forming the same									
707	Interconnection structures and fabrication method thereof	US9190317	US14/020795	中芯上海	美国	发明	2013-09-07	2015-11-17	原始取得	无
708	Cylindrical reticle system, exposure apparatus and exposure method	US9298103	US14/020850	中芯上海	美国	发明	2013-09-08	2016-03-29	原始取得	无
709	Nano field-effect vacuum tube and fabrication method thereof	US9029211	US14/020965	中芯上海	美国	发明	2013-09-09	2015-05-12	原始取得	无
710	Semiconductor structure and fabrication method	US9177913	US14/022387	中芯上海	美国	发明	2013-09-10	2015-11-03	原始取得	无
711	Transistors and fabrication method thereof	US9147749	US14/022500	中芯上海	美国	发明	2013-09-10	2015-09-29	原始取得	无
712	Semiconductor device	US9209130	US14/028733	中芯上海	美国	发明	2013-09-17	2015-12-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	having ground shield structure and fabrication method thereof									
713	Method for detecting electron beam of scanning electron microscope and for detecting fine patterns	US8742345	US14/028917	中芯上海	美国	发明	2013-09-17	2014-06-03	原始取得	无
714	Self-aligned mos structure with local interconnects and self-aligned source/drain polysilicon contacts	US8816449	US14/029777	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2013-09-17	2014-08-26	原始取得	无
715	Cylindrical reticle system, exposure apparatus and exposure method	US9323163	US14/029939	中芯上海	美国	发明	2013-09-18	2016-04-26	原始取得	无
716	Metal gate transistors and fabrication method thereof	US8772148	US14/030026	中芯上海	美国	发明	2013-09-18	2014-07-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
717	Method for fabricating interconnect structure	US9449869	US14/035378	中芯上海	美国	发明	2013-09-24	2016-09-20	原始取得	无
718	Fabrication method for mim capacitor	US9236296	US14/037348	中芯上海	美国	发明	2013-09-25	2016-01-12	原始取得	无
719	Interconnect structure and fabrication method	US9136171	US14/038789	中芯上海	美国	发明	2013-09-27	2015-09-15	原始取得	无
720	Exposure apparatus and exposure method thereof	US9298099	US14/039332	中芯上海	美国	发明	2013-09-27	2016-03-29	原始取得	无
721	Method for forming shallow trench isolation	US9147596	US14/040605	中芯上海	美国	发明	2013-09-27	2015-09-29	原始取得	无
722	Exposure apparatus and exposure method thereof	US9411242	US14/040685	中芯上海	美国	发明	2013-09-29	2016-08-09	原始取得	无
723	Electrode manufacturing method, fuse device and manufacturing method therefor	US9589837	US14/054371	中芯上海	美国	发明	2013-10-15	2017-03-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
724	Shallow trench and fabrication method	US9087788	US14/055899	中芯上海	美国	发明	2013-10-17	2015-07-21	原始取得	无
725	Method for fabricating phase change memory	US9006022	US14/056253	中芯上海	美国	发明	2013-10-17	2015-04-14	原始取得	无
726	Electrostatic discharge protection structure and method for forming the same	US9117819	US14/057169	中芯上海	美国	发明	2013-10-18	2015-08-25	原始取得	无
727	Static random access memory structures	US8976576	US14/057294	中芯上海	美国	发明	2013-10-18	2015-03-10	原始取得	无
728	Fabrication method for semiconductor device with three or four-terminal-finfet	US9287182	US14/060881	中芯上海	美国	发明	2013-10-23	2016-03-15	原始取得	无
729	Interconnection structures and fabrication method thereof	US8883626	US14/060975	中芯上海	美国	发明	2013-10-23	2014-11-11	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
730	Lateral double diffusion metal-oxide-semiconductor (ldmos) transistors and fabrication method thereof	US9543411	US14/061179	中芯上海	美国	发明	2013-10-23	2017-01-10	原始取得	无
731	Cmos device with double-sided terminals and method of making the same	US9647085	US14/069290	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2013-10-31	2017-05-09	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
732	Semiconductor device and fabrication method	US9123812	US14/069693	中芯上海	美国	发明	2013-11-01	2015-09-01	原始取得	无
733	Metal gate transistor and method for forming the same	US9337043	US14/070536	中芯上海	美国	发明	2013-11-03	2016-05-10	原始取得	无
734	Semiconductor structure having common gate and fabrication method thereof	US9196725	US14/070538	中芯上海	美国	发明	2013-11-03	2015-11-24	原始取得	无
735	Mos transistors and	US9147746	US14/070645	中芯上海	美国	发明	2013-11-04	2015-09-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof									
736	Semiconductor device and fabrication method	US8956964	US14/077495	中芯上海	美国	发明	2013-11-12	2015-02-17	原始取得	无
737	Ground shield structure and semiconductor device	US8987839	US14/077608	中芯上海	美国	发明	2013-11-12	2015-03-24	原始取得	无
738	Fin field-effect transistors and fabrication method thereof	US8883585	US14/078655	中芯上海	美国	发明	2013-11-13	2014-11-11	原始取得	无
739	Methods for monitoring source symmetry of photolithography systems	US9316925	US14/078836	中芯上海	美国	发明	2013-11-13	2016-04-19	原始取得	无
740	Patterned ground shield structures and semiconductor devices	US9000561	US14/078946	中芯上海	美国	发明	2013-11-13	2015-04-07	原始取得	无
741	Semiconductor bullet lot dispatch systems and	US10325236	US14/079167	中芯上海	美国	发明	2013-11-13	2019-06-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	methods									
742	Double-side process silicon mos and passive devices for rf front-end modules	US9147598	US14/084597	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2013-11-19	2015-09-29	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
743	Ion source device and method for providing ion source	US9177750	US14/094815	中芯上海	美国	发明	2013-12-03	2015-11-03	原始取得	无
744	Mems capacitive pressure sensors and fabrication method thereof	US9206030	US14/095060	中芯上海	美国	发明	2013-12-03	2015-12-08	原始取得	无
745	Mems pressure sensors and fabrication method thereof	US9029212	US14/095155	中芯上海	美国	发明	2013-12-03	2015-05-12	原始取得	无
746	Mos transistors and fabrication method thereof	US8980705	US14/096286	中芯上海	美国	发明	2013-12-04	2015-03-17	原始取得	无
747	Interconnect structure and fabrication method	US9153480	US14/106961	中芯上海	美国	发明	2013-12-16	2015-10-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
748	Photolithographic masks and fabrication method thereof	US9348215	US14/140678	中芯上海	美国	发明	2013-12-26	2016-05-24	原始取得	无
749	Semiconductor structures and fabrication methods for improving undercut between porous film and hardmask film	US9330964	US14/140939	中芯上海	美国	发明	2013-12-26	2016-05-03	原始取得	无
750	Local interconnect structure and fabrication method	US9111942	US14/141035	中芯上海	美国	发明	2013-12-26	2015-08-18	原始取得	无
751	Transistor device and fabrication method	US9136183	US14/143623	中芯上海	美国	发明	2013-12-30	2015-09-15	原始取得	无
752	Three-dimensional quantum well transistor and fabrication method	US9029222	US14/144623	中芯上海	美国	发明	2013-12-31	2015-05-12	原始取得	无
753	Transistors and fabrication	US9018712	US14/144696	中芯上	美国	发明	2013-12-31	2015-04-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	methods thereof using a stacked protection layer			海、中芯北京						
754	Tsv interconnect structure and manufacturing method thereof	US10515892	US14/145572	中芯上海	美国	发明	2013-12-31	2019-12-24	原始取得	无
755	Method for electromigration and adhesion using two selective deposition	US9824918	US14/145665	中芯上海	美国	发明	2013-12-31	2017-11-21	原始取得	无
756	Capacitive pressure sensors and fabrication methods thereof	US9207138	US14/161740	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-01-23	2015-12-08	原始取得	无
757	Pmos transistors and fabrication methods thereof	US8936987	US14/161816	中芯上海	美国	发明	2014-01-23	2015-01-20	原始取得	无
758	System for making and cleaning semiconductor	US9640425	US14/166981	中芯上海	美国	发明	2014-01-29	2017-05-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	device									
759	Method for core and in/out-put device reliability improve at high-k last process	US9502403	US14/169146	中芯上海	美国	发明	2014-01-30	2016-11-22	原始取得	无
760	Edge bead removal apparatus and methods	US9548225	US14/177346	中芯上海	美国	发明	2014-02-11	2017-01-17	原始取得	无
761	Mos transistor and fabrication method	US9431516	US14/177403	中芯上海	美国	发明	2014-02-11	2016-08-30	原始取得	无
762	Semiconductor device containing mim capacitor and fabrication method	US9093419	US14/177570	中芯上海	美国	发明	2014-02-11	2015-07-28	原始取得	无
763	Semiconductor device including porous low-k dielectric layer and fabrication method	US9093268	US14/178494	中芯上海	美国	发明	2014-02-12	2015-07-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
764	Semiconductor device and fabrication method	US9607885	US14/178611	中芯上海	美国	发明	2014-02-12	2017-03-28	原始取得	无
765	Double patterning methods and structures	US8975186	US14/178913	中芯上海	美国	发明	2014-02-12	2015-03-10	原始取得	无
766	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9053944	US14/179847	中芯上海	美国	发明	2014-02-13	2015-06-09	原始取得	无
767	Method for processing structure in manufacturing semiconductor device	US9252010	US14/180227	中芯上海	美国	发明	2014-02-13	2016-02-02	原始取得	无
768	Tsv layout structure and tsv interconnect structure, and fabrication methods thereof	US10141244	US14/181862	中芯上海	美国	发明	2014-02-17	2018-11-27	原始取得	无
769	Semiconductor devices and fabrication methods thereof	US9142446	US14/182789	中芯上海	美国	发明	2014-02-18	2015-09-22	原始取得	无
770	Fabrication method of	US9117887	US14/183553	中芯上海	美国	发明	2014-02-19	2015-08-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor device									
771	Junction-less transistors and fabrication method thereof	US9064729	US14/188789	中芯上海	美国	发明	2014-02-25	2015-06-23	原始取得	无
772	Triple patterning method	US9034762	US14/188945	中芯上海	美国	发明	2014-02-25	2015-05-19	原始取得	无
773	Transistor device and fabrication method	US9209299	US14/189088	中芯上海	美国	发明	2014-02-25	2015-12-08	原始取得	无
774	Finfet device and method of forming fin in the same	US9184291	US14/189448	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-02-25	2015-11-10	原始取得	无
775	Flash memory and fabrication method thereof	US9012317	US14/192893	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-02-28	2015-04-21	原始取得	无
776	Nanoscale silicon schottky diode array for low power phase change memory application	US9202885	US14/201525	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-07	2015-12-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
777	Method of fabricating dual trench isolated selective epitaxial diode array	US9070620	US14/203500	中芯上海	美国	发明	2014-03-10	2015-06-30	原始取得	无
778	Multi-gate vdmos transistor and method for forming the same	US9112023	US14/205398	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-12	2015-08-18	原始取得	无
779	Semiconductor device including sti structure and fabrication method	US9305823	US14/207678	中芯上海	美国	发明	2014-03-13	2016-04-05	原始取得	无
780	Esd protection structure and esd protection circuit	US8981483	US14/227405	中芯上海	美国	发明	2014-03-27	2015-03-17	原始取得	无
781	Esd protection structure and esd protection circuit	US9105477	US14/227500	中芯上海	美国	发明	2014-03-27	2015-08-11	原始取得	无
782	Enhanced stress memorization technique for metal gate transistors	US9059210	US14/227986	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-27	2015-06-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
783	Magnetic tunnel junctions and fabrication method thereof	US8956883	US14/228410	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-28	2015-02-17	原始取得	无
784	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9111874	US14/228485	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-28	2015-08-18	原始取得	无
785	Cmos transistors and fabrication method thereof	US9190327	US14/228832	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-28	2015-11-17	原始取得	无
786	Method of measuring threshold voltage of mos transistor in sram array	US8971099	US14/229915	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-30	2015-03-03	原始取得	无
787	Semiconductor device and fabrication method	US9093317	US14/229916	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-03-30	2015-07-28	原始取得	无
788	Method and system for	US9362331	US14/242841	中芯上	美国	发明	2014-04-01	2016-06-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	image sensor and lens on a silicon back plane wafer			海、中芯北京						
789	Ldmos device and fabrication method	US9112025	US14/247496	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-04-08	2015-08-18	原始取得	无
790	Resistor memory bit-cell and circuitry and method of making the same	US9129831	US14/249315	中芯上海	美国	发明	2014-04-09	2015-09-08	原始取得	无
791	Method for finfet sram ratio tuning	US9184170	US14/250355	中芯上海	美国	发明	2014-04-10	2015-11-10	原始取得	无
792	Device having reduced pad peeling during tensile stress testing and a method of forming thereof	US9396993	US14/256241	中芯上海	美国	发明	2014-04-18	2016-07-19	原始取得	无
793	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9209289	US14/264529	中芯上海	美国	发明	2014-04-29	2015-12-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
794	Frequency generation device	US9270283	US14/266337	中芯上海	美国	发明	2014-04-30	2016-02-23	原始取得	无
795	Semiconductor structure and method for forming the same	US9515078	US14/266693	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-04-30	2016-12-06	原始取得	无
796	System and method for reducing contamination in extreme ultraviolet lithography light source	US9176400	US14/267193	中芯上海	美国	发明	2014-05-01	2015-11-03	原始取得	无
797	Self-biased phase lock loop	US9024667	US14/267763	中芯上海	美国	发明	2014-05-01	2015-05-05	原始取得	无
798	Method of forming a spacer patterning mask	US9023224	US14/278538	中芯上海	美国	发明	2014-05-15	2015-05-05	原始取得	无
799	Mos transistors and fabrication methods thereof	US9425311	US14/279469	中芯上海	美国	发明	2014-05-16	2016-08-23	原始取得	无
800	Finfet device and fabrication method thereof	US9853026	US14/280217	中芯上海	美国	发明	2014-05-16	2017-12-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
801	Method for manufacturing semiconductor device	US9136182	US14/280254	中芯上海	美国	发明	2014-05-16	2015-09-15	原始取得	无
802	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9269772	US14/281007	中芯上海	美国	发明	2014-05-19	2016-02-23	原始取得	无
803	Pixel structures of cmos imaging sensors and fabrication method thereof	US9059068	US14/283426	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-05-21	2015-06-16	原始取得	无
804	Method and system for obtaining optical proximity correction model calibration data	US9105079	US14/283581	中芯上海	美国	发明	2014-05-21	2015-08-11	原始取得	无
805	Semiconductor devices and fabrication method thereof	US9362402	US14/287500	中芯上海	美国	发明	2014-05-27	2016-06-07	原始取得	无
806	Photoresist coating apparatus and methods	US10105722	US14/287716	中芯上海	美国	发明	2014-05-27	2018-10-23	原始取得	无
807	Semiconductor structure	US9431355	US14/288494	中芯上海	美国	发明	2014-05-28	2016-08-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and method for forming the same									
808	Transistor and method for forming the same	US9484204	US14/288627	中芯上海	美国	发明	2014-05-28	2016-11-01	原始取得	无
809	Stripe structures and fabrication method thereof	US9312355	US14/295649	中芯上海	美国	发明	2014-06-04	2016-04-12	原始取得	无
810	Semiconductor magnetoresistive random-access memory (mram) device and manufacturing method thereof	US9048413	US14/301072	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-06-10	2015-06-02	原始取得	无
811	Method of forming high k metal gate	US9099338	US14/305969	中芯上海	美国	发明	2014-06-16	2015-08-04	原始取得	无
812	Mems device and fabrication method	US9371223	US14/314703	中芯上海	美国	发明	2014-06-25	2016-06-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
813	On-chip plasma charging sensor	US9299622	US14/323749	中芯上海	美国	发明	2014-07-03	2016-03-29	原始取得	无
814	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9305833	US14/324403	中芯上海	美国	发明	2014-07-07	2016-04-05	原始取得	无
815	Fin field-effect transistors	US9054193	US14/327299	中芯上海	美国	发明	2014-07-09	2015-06-09	原始取得	无
816	Polishing device for removing polishing byproducts	US9511475	US14/327363	中芯上海	美国	发明	2014-07-09	2016-12-06	原始取得	无
817	Silicon-controlled rectifier electrostatic discharge protection device and method for forming the same	US9520488	US14/332534	中芯上海	美国	发明	2014-07-16	2016-12-13	原始取得	无
818	Photomask pattern and method for forming the	US9588414	US14/332565	中芯上海	美国	发明	2014-07-16	2017-03-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	same									
819	Transistor and method for forming the same	US9166050	US14/333131	中芯上海	美国	发明	2014-07-16	2015-10-20	原始取得	无
820	Euvl light source system and method	US9049774	US14/333268	中芯上海	美国	发明	2014-07-16	2015-06-02	原始取得	无
821	Fin field effect transistor and method for forming the same	US9508609	US14/336050	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-07-21	2016-11-29	原始取得	无
822	Semiconductor device with an aluminum alloy gate	US9196697	US14/337683	中芯上海	美国	发明	2014-07-22	2015-11-24	原始取得	无
823	Semiconductor structure and method for forming the same	US9111871	US14/340015	中芯上海	美国	发明	2014-07-24	2015-08-18	原始取得	无
824	Silicon-on-insulator substrate and method of manufacturing thereof	US9607880	US14/341487	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2014-07-25	2017-03-28	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
825	Semiconductor device having a closed cavity structure and method of manufacturing the same	US9397116	US14/444045	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2014-07-28	2016-07-19	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
826	Method and device for examining quality of dummy pattern insertion program used in circuit layout design	US9189590	US14/445700	中芯上海	美国	发明	2014-07-29	2015-11-17	原始取得	无
827	Chemical mechanical planarization apparatus and methods	US9950405	US14/445867	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-07-29	2018-04-24	原始取得	无
828	Static random access memory and fabrication methods thereof	US9754947	US14/445948	中芯上海	美国	发明	2014-07-29	2017-09-05	原始取得	无
829	Semiconductor device and related manufacturing	US9343435	US14/459962	中芯上海、中芯	美国	发明	2014-08-14	2016-05-17	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method			宁波					受取得	
830	Bipolar transistor, band-gap reference circuit and virtual ground reference circuit	US9337324	US14/463583	中芯北京	美国	发明	2014-08-19	2016-05-10	原始取得	无
831	Fin field effect transistors and fabrication method thereof	US9142675	US14/463707	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-08-20	2015-09-22	原始取得	无
832	Transistor device and related manufacturing method	US9287375	US14/464107	中芯上海	美国	发明	2014-08-20	2016-03-15	原始取得	无
833	Cmos inverters and fabrication methods thereof	US9368391	US14/475956	中芯上海	美国	发明	2014-09-03	2016-06-14	原始取得	无
834	Method of fabricating a magnetic tunnel junction device	US8975091	US14/481614	中芯北京	美国	发明	2014-09-09	2015-03-10	原始取得	无
835	Tunneling field effect	US9153585	US14/490182	中芯上海	美国	发明	2014-09-18	2015-10-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	transistor device and related manufacturing method									
836	Method of detecting a scattering bar by simulation	US9256703	US14/491732	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-09-19	2016-02-09	原始取得	无
837	Methods for high-k metal gate cmos with sic and sige source/drain regions	US9595585	US14/491853	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-09-19	2017-03-14	原始取得	无
838	Phase change memory and fabrication method	US9209387	US14/494321	中芯上海、中国科学院上海微系统与信息技术研究所	美国	发明	2014-09-23	2015-12-08	原始取得	无
839	Flash memory device and related manufacturing method	US9245897	US14/494456	中芯上海	美国	发明	2014-09-23	2016-01-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
840	Technique for forming a mems device	US9260290	US14/494688	中芯上海	美国	发明	2014-09-24	2016-02-16	继受取得	无
841	Nanowire device and method of manufacturing the same	US9614038	US14/495639	中芯上海	美国	发明	2014-09-24	2017-04-04	原始取得	无
842	Rf soi switch with backside cavity and the method to form it	US9293472	US14/495884	中芯上海	美国	发明	2014-09-24	2016-03-22	原始取得	无
843	Segregated finfet structure and manufacturing method	US9425278	US14/502912	中芯上海	美国	发明	2014-09-30	2016-08-23	原始取得	无
844	Fin-type field effect transistor and manufacturing method thereof	US9257538	US14/503348	中芯上海	美国	发明	2014-09-30	2016-02-09	原始取得	无
845	Semiconductor device and manufacturing method	US9190330	US14/505096	中芯上海、中芯	美国	发明	2014-10-02	2015-11-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof			北京						
846	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9190331	US14/505102	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-10-02	2015-11-17	原始取得	无
847	Enhanced optical proximity correction (opc) method and system	US9117053	US14/508022	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-10-07	2015-08-25	原始取得	无
848	Memory device and method for forming the same	US10325916	US14/509334	中芯上海	美国	发明	2014-10-08	2019-06-18	原始取得	无
849	Memory device and method for forming the same	US9401368	US14/509429	中芯上海	美国	发明	2014-10-08	2016-07-26	原始取得	无
850	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9379240	US14/509842	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-10-08	2016-06-28	原始取得	无
851	System and method for integrated circuits with	US9224812	US14/510672	中芯上海	美国	发明	2014-10-09	2015-12-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	cylindrical gate structures									
852	Method for fabricating inductor device	US9018731	US14/512988	中芯上海	美国	发明	2014-10-13	2015-04-28	原始取得	无
853	Transistor having a heterojunction and manufacturing method thereof	US9543390	US14/513792	中芯上海	美国	发明	2014-10-14	2017-01-10	原始取得	无
854	Semiconductor device with reduced defects	US9087836	US14/514956	中芯上海	美国	发明	2014-10-15	2015-07-21	原始取得	无
855	Semiconductor structures	US9105632	US14/520286	中芯上海	美国	发明	2014-10-21	2015-08-11	原始取得	无
856	Method for fabricating semiconductor device	US9461172	US14/520299	中芯上海	美国	发明	2014-10-21	2016-10-04	原始取得	无
857	Semiconductor device and fabrication method	US9136164	US14/530856	中芯上海	美国	发明	2014-11-03	2015-09-15	原始取得	无
858	Semiconductor device, related manufacturing	US9824928	US14/532624	中芯上海	美国	发明	2014-11-04	2017-11-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method, and related electronic device									
859	Methods and structures for thin-film encapsulation and co-integration of same with microelectronic devices and microelectromechanical systems (mems)	US9428377	US14/532658	中芯上海	美国	发明	2014-11-04	2016-08-30	继受取得	无
860	Membrane transducer structures and methods of manufacturing same using thin-film encapsulation	US9637371	US14/532675	中芯上海	美国	发明	2014-11-04	2017-05-02	继受取得	无
861	Trapped sacrificial structures and methods of manufacturing same using thin-film encapsulation	US9422149	US14/532723	中芯上海	美国	发明	2014-11-04	2016-08-23	继受取得	无
862	Interconnect structures and	US9419090	US14/539285	中芯上	美国	发明	2014-11-12	2016-08-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof			海、中芯北京						
863	Inductor device and fabrication method	US9515133	US14/539896	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2014-11-12	2016-12-06	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
864	Method for semiconductor selective etching and bsi image sensor	US9362332	US14/542525	中芯上海	美国	发明	2014-11-14	2016-06-07	原始取得	无
865	High-voltage-tolerant pull-up resistor circuit	US9634662	US14/547319	中芯上海	美国	发明	2014-11-19	2017-04-25	原始取得	无
866	Device for cleaning fixed abrasives polishing pad	US9475170	US14/548673	中芯上海	美国	发明	2014-11-20	2016-10-25	原始取得	无
867	Finfet fabrication method using buffer layers between channel and semiconductor substrate	US9425101	US14/548736	中芯上海	美国	发明	2014-11-20	2016-08-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
868	Substrate, related device, and related manufacturing method	US9377582	US14/549718	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2014-11-21	2016-06-28	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
869	Method for fabricating a field effect transistor with local isolations on raised source/drain trench sidewalls	US9478656	US14/554168	中芯上海	美国	发明	2014-11-26	2016-10-25	原始取得	无
870	Transistors and fabrication methods thereof	US9190481	US14/554432	中芯上海	美国	发明	2014-11-26	2015-11-17	原始取得	无
871	Flash memory and fabrication method thereof	US9293469	US14/554651	中芯上海	美国	发明	2014-11-26	2016-03-22	原始取得	无
872	Semiconductor device and related manufacturing method	US9715987	US14/558050	中芯上海	美国	发明	2014-12-02	2017-07-25	原始取得	无
873	Sealing structure for a	US9653312	US14/559197	中芯上海	美国	发明	2014-12-03	2017-05-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	bonded wafer and method of forming the sealing structure									
874	Tunneling nanotube field effect transistor and manufacturing method thereof	US9530977	US14/559408	中芯上海	美国	发明	2014-12-03	2016-12-27	原始取得	无
875	Method for manufacturing cmos device with high-k dielectric layers and high-k cap layers formed in different steps	US9299619	US14/559553	中芯上海	美国	发明	2014-12-03	2016-03-29	原始取得	无
876	Electrically conductive device and manufacturing method thereof	US9087845	US14/560729	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-12-04	2015-07-21	原始取得	无
877	Exposure apparatus, photolithographical reticles	US9606451	US14/560803	中芯上海	美国	发明	2014-12-04	2017-03-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and exposure methods thereof									
878	Method for forming deep trench isolation for rf devices on soi	US9349748	US14/564081	中芯上海	美国	发明	2014-12-08	2016-05-24	原始取得	无
879	Method for setting a flash memory for htol testing	US9449718	US14/566060	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-12-10	2016-09-20	原始取得	无
880	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9449950	US14/566357	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2014-12-10	2016-09-20	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
881	Semiconductor testing structures and fabrication method thereof	US9557348	US14/567362	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-12-11	2017-01-31	原始取得	无
882	Patterning apparatus and	US9547236	US14/568317	中芯上海	美国	发明	2014-12-12	2017-01-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	patterning methods thereof									
883	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9419104	US14/568819	中芯上海	美国	发明	2014-12-12	2016-08-16	原始取得	无
884	Wearable intelligent systems and interaction methods thereof	US10007331	US14/569860	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-12-15	2018-06-26	原始取得	无
885	Method to form a cylindrical germanium nanowire device on bulk silicon substrate	US9905677	US14/571287	中芯上海	美国	发明	2014-12-16	2018-02-27	原始取得	无
886	Semiconductor device	US9087901	US14/571561	中芯上海	美国	发明	2014-12-16	2015-07-21	原始取得	无
887	Semiconductor devices and fabrication method thereof	US9548212	US14/571831	中芯上海	美国	发明	2014-12-16	2017-01-17	原始取得	无
888	Integrated circuit device with radio frequency (rf)	US9589884	US14/572462	中芯上海、中芯	美国	发明	2014-12-16	2017-03-07	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	switches and controller			宁波					受取得	
889	Fin field effect transistor and method for forming the same	US9362286	US14/574639	中芯上海	美国	发明	2014-12-18	2016-06-07	原始取得	无
890	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9450075	US14/575967	中芯上海	美国	发明	2014-12-18	2016-09-20	原始取得	无
891	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9419005	US14/578937	中芯上海	美国	发明	2014-12-22	2016-08-16	原始取得	无
892	Integrated circuit and related manufacturing method	US9324712	US14/581671	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2014-12-23	2016-04-26	原始取得	无
893	Semiconductor device and manufacturing method	US9368600	US14/582917	中芯上海	美国	发明	2014-12-24	2016-06-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
894	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10211289	US14/583493	中芯上海	美国	发明	2014-12-26	2019-02-19	原始取得	无
895	Interconnect structure and method for forming the same	US9892921	US14/583878	中芯上海	美国	发明	2014-12-29	2018-02-13	原始取得	无
896	Method for forming flash memory devices	US9431405	US14/588460	中芯上海	美国	发明	2015-01-01	2016-08-30	原始取得	无
897	Method of manufacturing a semiconductor device and adjusting threshold voltages in the same	US9331084	US14/591716	中芯上海	美国	发明	2015-01-07	2016-05-03	原始取得	无
898	Mems capping method	US9290378	US14/592873	中芯上海	美国	发明	2015-01-08	2016-03-22	原始取得	无
899	Semiconductor device and	US9416004	US14/595543	中芯上海	美国	发明	2015-01-13	2016-08-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method									
900	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9553097	US14/596782	中芯上海	美国	发明	2015-01-14	2017-01-24	原始取得	无
901	Method of manufacturing an embedded split-gate flash memory device	US9443946	US14/597104	中芯上海	美国	发明	2015-01-14	2016-09-13	原始取得	无
902	Integrated circuit and manufacturing method thereof	US9691667	US14/597126	中芯上海	美国	发明	2015-01-14	2017-06-27	原始取得	无
903	Wafer bonding structures and wafer processing methods	US9640451	US14/597569	中芯上海	美国	发明	2015-01-15	2017-05-02	原始取得	无
904	Semiconductor device	US9117907	US14/607613	中芯上海	美国	发明	2015-01-28	2015-08-25	原始取得	无
905	Transistor device	US9112020	US14/607741	中芯上海	美国	发明	2015-01-28	2015-08-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
906	Semiconductor device and method for forming the same	US9337107	US14/609520	中芯上海	美国	发明	2015-01-30	2016-05-10	原始取得	无
907	Method of manufacturing a semiconductor device	US9653283	US14/610581	中芯上海	美国	发明	2015-01-30	2017-05-16	原始取得	无
908	Method of finfet formation	US9660058	US14/612186	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-02-02	2017-05-23	原始取得	无
909	Phase-change device, related manufacturing method, and related electronic device	US9419054	US14/614099	中芯上海	美国	发明	2015-02-04	2016-08-16	原始取得	无
910	Fin-type field effect transistor and manufacturing method thereof	US9590031	US14/622609	中芯上海	美国	发明	2015-02-13	2017-03-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
911	Method for manufacturing semiconductor device	US9263273	US14/626649	中芯上海	美国	发明	2015-02-19	2016-02-16	原始取得	无
912	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9330921	US14/626794	中芯上海	美国	发明	2015-02-19	2016-05-03	原始取得	无
913	Metal gate stack structure and manufacturing method	US9525046	US14/631829	中芯上海	美国	发明	2015-02-25	2016-12-20	原始取得	无
914	Gpib bus to zigbee interconnection	US9727509	US14/631835	中芯上海	美国	发明	2015-02-25	2017-08-08	原始取得	无
915	Method for fabricating a semi-floating gate transistor	US9490260	US14/631838	中芯上海	美国	发明	2015-02-25	2016-11-08	原始取得	无
916	Mems device and formation method thereof	US9334157	US14/641657	中芯上海	美国	发明	2015-03-09	2016-05-10	原始取得	无
917	Phase change memories	US9136469	US14/642573	中芯上海	美国	发明	2015-03-09	2015-09-15	原始取得	无
918	Method for compensating local oscillator frequency	US9473148	US14/642694	中芯上海	美国	发明	2015-03-09	2016-10-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
919	Mems device and formation method thereof	US9598276	US14/645741	中芯上海	美国	发明	2015-03-12	2017-03-21	原始取得	无
920	In-chip static-current device failure detecting methods and apparatus	US9606173	US14/645860	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-03-12	2017-03-28	原始取得	无
921	Electrical interconnection structure and fabrication method thereof	US9490210	US14/657465	中芯上海	美国	发明	2015-03-13	2016-11-08	原始取得	无
922	Method and system for optical proximity correction (opc)	US9638994	US14/657612	中芯上海	美国	发明	2015-03-13	2017-05-02	原始取得	无
923	Photolithographic method for forming a coating layer	US9633834	US14/660183	中芯上海	美国	发明	2015-03-17	2017-04-25	原始取得	无
924	Metal pillar bump packaging strctures and fabrication methods thereof	US9324671	US14/660376	中芯上海	美国	发明	2015-03-17	2016-04-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
925	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9455318	US14/661944	中芯上海	美国	发明	2015-03-18	2016-09-27	原始取得	无
926	Preventing over-polishing of poly gate in metal-gate cmp	US9543212	US14/663389	中芯上海	美国	发明	2015-03-19	2017-01-10	原始取得	无
927	Electrostatic discharge protection circuit and configuration method	US9876003	US14/663569	中芯上海	美国	发明	2015-03-20	2018-01-23	原始取得	无
928	Method and apparatus for reducing crosstalk in cmos image sensor	US9530814	US14/663813	中芯上海	美国	发明	2015-03-20	2016-12-27	原始取得	无
929	Magnetoresistive sensor, related manufacturing method, and related electronic device	US9450178	US14/668720	中芯上海	美国	发明	2015-03-25	2016-09-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
930	Semiconductor memory device and manufacturing method thereof	US9373784	US14/669776	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-03-26	2016-06-21	原始取得	无
931	Memory array and operation method for memory device, including data inversion	US9620239	US14/670717	中芯上海	美国	发明	2015-03-27	2017-04-11	原始取得	无
932	Interconnect structures and fabrication method thereof	US9728504	US14/671358	中芯上海	美国	发明	2015-03-27	2017-08-08	原始取得	无
933	Semiconductor device and fabrication method	US9362276	US14/671460	中芯上海	美国	发明	2015-03-27	2016-06-07	原始取得	无
934	Method and system for automatically collecting semiconductor manufacturing parameters	US10031516	US14/671565	中芯上海	美国	发明	2015-03-27	2018-07-24	原始取得	无
935	Fin-type field effect	US9455255	US14/674873	中芯上海	美国	发明	2015-03-31	2016-09-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	transistor and manufacturing method thereof									
936	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9349729	US14/681201	中芯上海	美国	发明	2015-04-08	2016-05-24	原始取得	无
937	Chip packaging structures and treatment methods thereof	US9431215	US14/681234	中芯上海	美国	发明	2015-04-08	2016-08-30	原始取得	无
938	Semiconductor channel-stop layer and method of manufacturing the same	US10068966	US14/683518	中芯上海	美国	发明	2015-04-10	2018-09-04	原始取得	无
939	Three-dimensional quantum well transistor	US9093354	US14/683670	中芯上海	美国	发明	2015-04-10	2015-07-28	原始取得	无
940	Nano field-effect vacuum	US9093508	US14/684044	中芯上海	美国	发明	2015-04-10	2015-07-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	tube									
941	Mems capacitive pressure sensors	US9463975	US14/684832	中芯上海	美国	发明	2015-04-13	2016-10-11	原始取得	无
942	Pixel structures of cmos imaging sensors	US9123606	US14/685905	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-04-14	2015-09-01	原始取得	无
943	Method for cmp of high-k metal gate structures	US9646840	US14/686618	中芯上海	美国	发明	2015-04-14	2017-05-09	原始取得	无
944	Static memory cell and formation method thereof	US9287387	US14/687030	中芯上海	美国	发明	2015-04-15	2016-03-15	原始取得	无
945	Vertical inductor and method of manufacturing the same	US9984819	US14/687839	中芯上海	美国	发明	2015-04-15	2018-05-29	原始取得	无
946	Semiconductor device, related manufacturing method, and related	US9640439	US14/690044	中芯上海	美国	发明	2015-04-17	2017-05-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	electronic device									
947	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9646830	US14/690927	中芯上海	美国	发明	2015-04-20	2017-05-09	原始取得	无
948	Semiconductor devices and fabrication method thereof	US9406677	US14/691037	中芯上海	美国	发明	2015-04-20	2016-08-02	原始取得	无
949	Image sensor device and method of manufacturing the same	US9368538	US14/692439	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2015-04-21	2016-06-14	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
950	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9331079	US14/694355	中芯上海	美国	发明	2015-04-23	2016-05-03	原始取得	无
951	Esd clamp circuit	US9825022	US14/702356	中芯上海	美国	发明	2015-05-01	2017-11-21	原始取得	无
952	Method for forming isolation member in trench of semiconductor substrate	US9570338	US14/703181	中芯上海	美国	发明	2015-05-04	2017-02-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
953	Method for chemical mechanical polishing of high-k metal gate structures	US9337104	US14/709465	中芯上海	美国	发明	2015-05-11	2016-05-10	原始取得	无
954	Mems pressure sensor with thermal compensation	US9751750	US14/711766	中芯上海	美国	发明	2015-05-13	2017-09-05	原始取得	无
955	Fin field-effect transistor and fabrication method thereof	US9871120	US14/712533	中芯上海	美国	发明	2015-05-14	2018-01-16	原始取得	无
956	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9502645	US14/712735	中芯上海	美国	发明	2015-05-14	2016-11-22	原始取得	无
957	Mems pressure sensor and method of manufacturing the same	US9573805	US14/713946	中芯上海	美国	发明	2015-05-15	2017-02-21	原始取得	无
958	Junction-less transistors	US9412864	US14/715178	中芯上海	美国	发明	2015-05-18	2016-08-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
959	Oscillator circuit and configuration method thereof	US9306587	US14/716879	中芯上海	美国	发明	2015-05-20	2016-04-05	原始取得	无
960	Semiconductor devices and fabrication method thereof	US9614051	US14/716886	中芯上海	美国	发明	2015-05-20	2017-04-04	原始取得	无
961	Semiconductor chip and method of manufacturing the same	US9293430	US14/717606	中芯上海	美国	发明	2015-05-20	2016-03-22	原始取得	无
962	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9406555	US14/718335	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-05-21	2016-08-02	原始取得	无
963	Silicon via with amorphous silicon layer and fabrication method thereof	US9607895	US14/722153	中芯上海	美国	发明	2015-05-27	2017-03-28	原始取得	无
964	Metal interconnect structure and fabrication method	US9735011	US14/722155	中芯上海	美国	发明	2015-05-27	2017-08-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
965	Fin field-effect transistors and fabrication method thereof	US9368497	US14/722671	中芯上海	美国	发明	2015-05-27	2016-06-14	原始取得	无
966	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9524865	US14/722979	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-05-27	2016-12-20	原始取得	无
967	Method for manufacturing semiconductor device	US9368412	US14/723346	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-05-27	2016-06-14	原始取得	无
968	Electronic circuit, electronic apparatus, and method for eliminating metastability	US9614500	US14/733955	中芯上海	美国	发明	2015-06-08	2017-04-04	原始取得	无
969	Layout design method and system	US9489481	US14/735952	中芯上海	美国	发明	2015-06-10	2016-11-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
970	Lateral double-diffused mosfet and fabrication method thereof	US9536742	US14/737692	中芯上海	美国	发明	2015-06-12	2017-01-03	原始取得	无
971	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9425068	US14/738513	中芯上海	美国	发明	2015-06-12	2016-08-23	原始取得	无
972	Semiconductor device and electronic apparatus including the same	US9716089	US14/738542	中芯上海	美国	发明	2015-06-12	2017-07-25	原始取得	无
973	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9415999	US14/738582	中芯上海	美国	发明	2015-06-12	2016-08-16	原始取得	无
974	Mask and method for manufacturing semiconductor device	US9524880	US14/739876	中芯上海	美国	发明	2015-06-15	2016-12-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
975	Vertically integrated three-dimensional cmos image sensors (3d cis) bonded with control circuit substrate	US10269852	US14/751134	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2015-06-26	2019-04-23	原始取得	无
976	Method for forming fin fet structure with dual-stress spacers	US9312386	US14/752940	中芯上海	美国	发明	2015-06-28	2016-04-12	原始取得	无
977	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9337206	US14/754287	中芯上海	美国	发明	2015-06-29	2016-05-10	原始取得	无
978	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9590043	US14/788009	中芯上海	美国	发明	2015-06-30	2017-03-07	原始取得	无
979	Multi-gate vdmos transistor	US9299788	US14/795312	中芯上海、中芯	美国	发明	2015-07-09	2016-03-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
980	Transistor device	US9312378	US14/795820	中芯上海	美国	发明	2015-07-09	2016-04-12	原始取得	无
981	Integrated circuit device and repair method thereof	US9508717	US14/797126	中芯上海	美国	发明	2015-07-11	2016-11-29	原始取得	无
982	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9514881	US14/797128	中芯上海	美国	发明	2015-07-11	2016-12-06	原始取得	无
983	Patterned feature and multiple patterning method thereof	US9443742	US14/797130	中芯上海	美国	发明	2015-07-12	2016-09-13	原始取得	无
984	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9472668	US14/799879	中芯上海	美国	发明	2015-07-15	2016-10-18	原始取得	无
985	Device and method for improving rf performance	US9478463	US14/800650	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2015-07-15	2016-10-25	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
986	Semiconductor structures	US9598279	US14/800777	中芯上海	美国	发明	2015-07-16	2017-03-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and fabrication methods thereof									
987	Photolithographic mask and fabrication method thereof	US9829788	US14/800877	中芯上海	美国	发明	2015-07-16	2017-11-28	原始取得	无
988	Frequency divider and related electronic device	US9634670	US14/805000	中芯上海	美国	发明	2015-07-21	2017-04-25	原始取得	无
989	Multi-modulus frequency divider and electronic apparatus including the same	US9906226	US14/805178	中芯上海	美国	发明	2015-07-21	2018-02-27	原始取得	无
990	Heat reservoir chamber, and method for thermal treatment	US9576828	US14/805956	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-07-22	2017-02-21	原始取得	无
991	Ldmos transistor and fabrication method thereof	US9691604	US14/808026	中芯上海	美国	发明	2015-07-24	2017-06-27	原始取得	无
992	Memory device includes	US9659672	US14/809615	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2017-05-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	efuse, and methods for reading and operating the same									
993	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9352957	US14/809642	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2016-05-31	原始取得	无
994	Memory array, memory device, and methods for reading and operating the same	US9418763	US14/809724	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2016-08-16	原始取得	无
995	Semiconductor device	US9640657	US14/809896	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2017-05-02	原始取得	无
996	Semiconductor device manufacturing method and related semiconductor wafer	US9406527	US14/810111	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2016-08-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
997	Chemical mechanical polishing method for first interlayer dielectric layer	US9490175	US14/810468	中芯上海	美国	发明	2015-07-27	2016-11-08	原始取得	无
998	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US9607902	US14/813435	中芯上海	美国	发明	2015-07-30	2017-03-28	原始取得	无
999	Method for improving adhesion between porous low k dielectric and barrier layer	US9721892	US14/815813	中芯上海	美国	发明	2015-07-31	2017-08-01	原始取得	无
1000	Flash memory fabrication method	US10121669	US14/815867	中芯上海	美国	发明	2015-07-31	2018-11-06	原始取得	无
1001	Method of forming shallow trench isolations for a semiconductor device	US9559017	US14/819508	中芯上海	美国	发明	2015-08-06	2017-01-31	原始取得	无
1002	Method of preventing drain	US9673278	US14/820547	中芯上海	美国	发明	2015-08-06	2017-06-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and read disturbances in non-volatile memory device									
1003	Static random access memory	US9472267	US14/825072	中芯上海	美国	发明	2015-08-12	2016-10-18	原始取得	无
1004	Electromechanical nonvolatile memory	US9355712	US14/826176	中芯上海	美国	发明	2015-08-13	2016-05-31	原始取得	无
1005	Resistor memory bit-cell and circuitry and method of making the same	US9331069	US14/826184	中芯上海	美国	发明	2015-08-13	2016-05-03	原始取得	无
1006	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9741824	US14/828569	中芯上海	美国	发明	2015-08-18	2017-08-22	原始取得	无
1007	Vertical junctionless transistor device and manufacturing methods	US9673322	US14/830731	中芯上海	美国	发明	2015-08-19	2017-06-06	原始取得	无
1008	Semiconductor device having metal gate structure	US9728620	US14/831247	中芯上海	美国	发明	2015-08-20	2017-08-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and fabrication method thereof									
1009	Photoresist with top-coating photo-decomposable base for photolithography	US9645499	US14/833029	中芯上海	美国	发明	2015-08-21	2017-05-09	原始取得	无
1010	Fin field-effect transistors and fabrication methods thereof	US9613868	US14/837370	中芯上海	美国	发明	2015-08-27	2017-04-04	原始取得	无
1011	Signal receiver, related method, and related electronic device	US9419659	US14/837484	中芯上海	美国	发明	2015-08-27	2016-08-16	原始取得	无
1012	Interconnect structure	US9698095	US14/838604	中芯上海	美国	发明	2015-08-28	2017-07-04	原始取得	无
1013	Finfet structure and manufacture method	US9502569	US14/839915	中芯上海	美国	发明	2015-08-28	2016-11-22	原始取得	无
1014	Finfet ldmos device and manufacturing methods	US9570606	US14/839917	中芯上海	美国	发明	2015-08-28	2017-02-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1015	Dispatching method and system	US10101733	US14/840587	中芯上海	美国	发明	2015-08-31	2018-10-16	原始取得	无
1016	Finfet device having a material formed on reduced source/drain region and method of forming the same	US9673325	US14/842773	中芯上海	美国	发明	2015-09-01	2017-06-06	原始取得	无
1017	Tunneling field effect transistor device and related manufacturing method	US9508606	US14/845466	中芯上海	美国	发明	2015-09-04	2016-11-29	原始取得	无
1018	Resistive random access memory device and manufacturing methods	US9419057	US14/846634	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-09-04	2016-08-16	原始取得	无
1019	Method for forming control gate salicide	US9330924	US14/846646	中芯上海	美国	发明	2015-09-04	2016-05-03	原始取得	无
1020	Semiconductor structures and fabrication methods	US9524933	US14/848802	中芯上海	美国	发明	2015-09-09	2016-12-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
1021	Semiconductor structure and fabrication method	US9368409	US14/848908	中芯上海	美国	发明	2015-09-09	2016-06-14	原始取得	无
1022	Method of manufacturing a mems microphone	US10149079	US14/849582	中芯上海	美国	发明	2015-09-09	2018-12-04	原始取得	无
1023	Stack mom capacitor structure for cis	US10062687	US14/849589	中芯上海	美国	发明	2015-09-09	2018-08-28	原始取得	无
1024	Transistor device and fabrication method	US9741819	US14/849641	中芯上海	美国	发明	2015-09-10	2017-08-22	原始取得	无
1025	Mems device and fabrication method thereof	US9502300	US14/855852	中芯上海	美国	发明	2015-09-16	2016-11-22	原始取得	无
1026	Charge pump with suppressed feedthrough effect	US9502970	US14/856540	中芯上海	美国	发明	2015-09-16	2016-11-22	原始取得	无
1027	Semiconductor device structure and manufacturing	US9472422	US14/856545	中芯上海、中芯	美国	发明	2015-09-16	2016-10-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	methods			北京						
1028	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9754893	US14/861139	中芯上海	美国	发明	2015-09-22	2017-09-05	原始取得	无
1029	Method and system for optical measurements	US9645096	US14/861273	中芯上海	美国	发明	2015-09-22	2017-05-09	原始取得	无
1030	Photolithography alignment mark structures, semiconductor structures, and fabrication method thereof	US9620458	US14/861591	中芯上海	美国	发明	2015-09-22	2017-04-11	原始取得	无
1031	Methods for forming vertical semiconductor pillars	US9548359	US14/863400	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-09-23	2017-01-17	原始取得	无
1032	Method to improve cantilever process	US9630833	US14/864851	中芯上海	美国	发明	2015-09-24	2017-04-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	performance									
1033	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9704972	US14/865052	中芯上海	美国	发明	2015-09-25	2017-07-11	原始取得	无
1034	Method and device for testing semiconductor manufacturing equipment automation program	US9804953	US14/868977	中芯上海	美国	发明	2015-09-29	2017-10-31	原始取得	无
1035	Method for reducing contamination in extreme ultraviolet lithography light source	US9665017	US14/870068	中芯上海	美国	发明	2015-09-30	2017-05-30	原始取得	无
1036	Methods for forming semiconductor device	US9633858	US14/871708	中芯上海	美国	发明	2015-09-30	2017-04-25	原始取得	无
1037	Solution for tsv substrate leakage	US9984926	US14/873182	中芯上海	美国	发明	2015-10-01	2018-05-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1038	Method for forming contact holes in a semiconductor device	US9761490	US14/879066	中芯上海	美国	发明	2015-10-08	2017-09-12	原始取得	无
1039	Low-voltage to high-voltage level shifter circuit	US9543931	US14/881078	中芯上海	美国	发明	2015-10-12	2017-01-10	原始取得	无
1040	Eeprom backup method and device	US9659661	US14/881110	中芯上海	美国	发明	2015-10-12	2017-05-23	原始取得	无
1041	Device isolation structure and manufacture method	US9653344	US14/882452	中芯上海	美国	发明	2015-10-13	2017-05-16	原始取得	无
1042	Fabrication method of interconnect structure	US9754799	US14/882581	中芯上海	美国	发明	2015-10-14	2017-09-05	原始取得	无
1043	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9761716	US14/883675	中芯上海	美国	发明	2015-10-15	2017-09-12	原始取得	无
1044	Light source and photolithography apparatus	US9992857	US14/883801	中芯上海	美国	发明	2015-10-15	2018-06-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	containing the same, calibrating apparatus and method									
1045	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9793209	US14/884880	中芯上海	美国	发明	2015-10-16	2017-10-17	原始取得	无
1046	Euv light source and exposure apparatus	US9706632	US14/885267	中芯上海	美国	发明	2015-10-16	2017-07-11	原始取得	无
1047	Euv light source and exposure apparatus	US9332626	US14/885375	中芯上海	美国	发明	2015-10-16	2016-05-03	原始取得	无
1048	Frequency divider and phase-locked loop including the same	US9935639	US14/887101	中芯上海	美国	发明	2015-10-19	2018-04-03	原始取得	无
1049	Semiconductor structure having common gate	US10050036	US14/918467	中芯上海	美国	发明	2015-10-20	2018-08-14	原始取得	无
1050	Transistor and fabrication	US9627269	US14/920193	中芯上海	美国	发明	2015-10-22	2017-04-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof									
1051	Method for forming semiconductor nanowire transistors	US9520484	US14/921919	中芯上海	美国	发明	2015-10-23	2016-12-13	原始取得	无
1052	Finfet 6t sram cell structure	US9613682	US14/921963	中芯上海	美国	发明	2015-10-23	2017-04-04	原始取得	无
1053	Layout for ldmos	US9647110	US14/921999	中芯上海	美国	发明	2015-10-23	2017-05-09	原始取得	无
1054	Mems capacitive pressure sensors	US9738508	US14/930926	中芯上海	美国	发明	2015-11-03	2017-08-22	原始取得	无
1055	Capacitive pressure sensors	US9541463	US14/931043	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2015-11-03	2017-01-10	原始取得	无
1056	Transistor and fabrication method thereof	US9601620	US14/931189	中芯上海	美国	发明	2015-11-03	2017-03-21	原始取得	无
1057	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US10112823	US14/933099	中芯上海	美国	发明	2015-11-05	2018-10-30	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1058	Semiconductor device and an electronic apparatus	US9871031	US14/934949	中芯上海	美国	发明	2015-11-06	2018-01-16	原始取得	无
1059	Nldmos transistor and fabrication method thereof	US9607839	US14/940709	中芯上海	美国	发明	2015-11-13	2017-03-28	原始取得	无
1060	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9502348	US14/941702	中芯上海	美国	发明	2015-11-16	2016-11-22	原始取得	无
1061	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9640427	US14/941732	中芯上海	美国	发明	2015-11-16	2017-05-02	原始取得	无
1062	Memory device, related method, and related electronic device	US9570115	US14/943626	中芯上海	美国	发明	2015-11-17	2017-02-14	原始取得	无
1063	Laser annealing device including tunable mask and method of using the same	US9406515	US14/944047	中芯上海	美国	发明	2015-11-17	2016-08-02	原始取得	无
1064	Layouts and fabrication	US9679902	US14/947196	中芯上海	美国	发明	2015-11-20	2017-06-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	methods for static random access memory									
1065	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9640446	US14/947673	中芯上海	美国	发明	2015-11-20	2017-05-02	原始取得	无
1066	Accelerometer with little cross effect	US9823267	US14/951330	中芯上海	美国	发明	2015-11-24	2017-11-21	原始取得	无
1067	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9613880	US14/958047	中芯上海	美国	发明	2015-12-03	2017-04-04	原始取得	无
1068	Finfet semiconductor device and fabrication method	US9570589	US14/959008	中芯上海	美国	发明	2015-12-04	2017-02-14	原始取得	无
1069	Mim capacitor	US9525022	US14/959396	中芯上海	美国	发明	2015-12-04	2016-12-20	原始取得	无
1070	Interface device, related method, and related	US9698788	US14/960901	中芯上海	美国	发明	2015-12-07	2017-07-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	open-drain device									
1071	Semiconductor device manufacturing method including implementing elements of memory unit and logic unit	US10014307	US14/961525	中芯上海	美国	发明	2015-12-07	2018-07-03	原始取得	无
1072	Method and device for a finfet	US9768167	US14/962315	中芯上海	美国	发明	2015-12-08	2017-09-19	原始取得	无
1073	Transistor device, related method, and related electronic device	US9748944	US14/962523	中芯上海	美国	发明	2015-12-08	2017-08-29	原始取得	无
1074	Electrically programmable fuse structure and fabrication method thereof	US9637834	US14/965674	中芯上海	美国	发明	2015-12-10	2017-05-02	原始取得	无
1075	Semiconductor structure and fabrication method	US9735251	US14/970881	中芯上海	美国	发明	2015-12-16	2017-08-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
1076	Fin field effect transistors and fabrication method thereof	US9613960	US14/975917	中芯上海	美国	发明	2015-12-21	2017-04-04	原始取得	无
1077	Carbon nanotube neuron device and method for making the same	US9502674	US14/980531	中芯上海	美国	发明	2015-12-28	2016-11-22	原始取得	无
1078	Complementary high mobility nanowire neuron device	US9502583	US14/980623	中芯上海	美国	发明	2015-12-28	2016-11-22	原始取得	无
1079	Complementary carbon nanotube neuron device	US9490300	US14/981807	中芯上海	美国	发明	2015-12-28	2016-11-08	原始取得	无
1080	Semiconductor structure and fabrication method thereof, and static random access memory cell	US9607995	US14/986979	中芯上海	美国	发明	2016-01-04	2017-03-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1081	Finfet device and fabrication method thereof	US9514994	US14/987192	中芯上海	美国	发明	2016-01-04	2016-12-06	原始取得	无
1082	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9859372	US14/988507	中芯上海	美国	发明	2016-01-05	2018-01-02	原始取得	无
1083	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9799525	US14/988555	中芯上海	美国	发明	2016-01-05	2017-10-24	原始取得	无
1084	Simplified zener diode dc spice model	US10073935	US14/988610	中芯上海	美国	发明	2016-01-05	2018-09-11	原始取得	无
1085	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9812326	US14/989169	中芯上海	美国	发明	2016-01-06	2017-11-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1086	Finfet and method for forming the same	US9893182	US14/989215	中芯上海	美国	发明	2016-01-06	2018-02-13	原始取得	无
1087	Mask read-only memory device and fabrication method thereof	US9905566	US14/989494	中芯上海	美国	发明	2016-01-06	2018-02-27	原始取得	无
1088	Semiconductor device and formation method thereof	US9780087	US14/990149	中芯上海	美国	发明	2016-01-07	2017-10-03	原始取得	无
1089	Semiconductor die and die cutting method	US9613865	US14/990830	中芯上海	美国	发明	2016-01-08	2017-04-04	原始取得	无
1090	Technique of reducing shallow trench isolation loss during fin formation in finfets	US9646888	US14/991184	中芯上海	美国	发明	2016-01-08	2017-05-09	原始取得	无
1091	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9786508	US14/992448	中芯上海	美国	发明	2016-01-11	2017-10-10	原始取得	无
1092	Semiconductor device,	US9966379	US14/994516	中芯上海	美国	发明	2016-01-13	2018-05-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	related manufacturing method, and related electronic device									
1093	Method for manufacturing semiconductor device	US9520483	US14/994927	中芯上海	美国	发明	2016-01-13	2016-12-13	原始取得	无
1094	Method and system for cmos image sensing device	US9497361	US14/995168	中芯上海	美国	发明	2016-01-13	2016-11-15	原始取得	无
1095	Backside processed semiconductor device	US9953877	US14/996091	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-01-14	2018-04-24	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
1096	Non-volatile memory device and method for manufacturing the same	US10211102	US15/001004	中芯上海	美国	发明	2016-01-19	2019-02-19	原始取得	无
1097	Method and device for high k metal gate transistors	US9570611	US15/002020	中芯上海	美国	发明	2016-01-20	2017-02-14	原始取得	无
1098	Finfet structure and method	US9899380	US15/008313	中芯上海	美国	发明	2016-01-27	2018-02-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	of forming same									
1099	Semiconductor device and fabrication method thereof	US9437709	US15/012297	中芯上海	美国	发明	2016-02-01	2016-09-06	原始取得	无
1100	Semiconductor device and method of fabricating same	US9653600	US15/013443	中芯上海	美国	发明	2016-02-02	2017-05-16	原始取得	无
1101	Semiconductor device with three or four-terminal-finfet	US9570468	US15/013840	中芯上海	美国	发明	2016-02-02	2017-02-14	原始取得	无
1102	Static random access memory (sram) device with finfet transistors	US9437597	US15/013902	中芯上海	美国	发明	2016-02-02	2016-09-06	原始取得	无
1103	Method and apparatus for facilitating manufacturing of semiconductor device	US9690891	US15/014853	中芯上海	美国	发明	2016-02-03	2017-06-27	原始取得	无
1104	Method of design rule check for off-grid irregular layout with on-grid design	US9798851	US15/015030	中芯上海	美国	发明	2016-02-03	2017-10-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	rule check deck									
1105	Power semiconductor device and fabrication method thereof	US9711627	US15/016655	中芯上海	美国	发明	2016-02-05	2017-07-18	原始取得	无
1106	Powers semiconductor device	US10032865	US15/017825	中芯上海	美国	发明	2016-02-08	2018-07-24	原始取得	无
1107	Mems capping method	US9731960	US15/018740	中芯上海	美国	发明	2016-02-08	2017-08-15	原始取得	无
1108	Rf soi switch with backside cavity and the method to form it	US9466573	US15/018763	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-02-08	2016-10-11	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
1109	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9773778	US15/040573	中芯上海	美国	发明	2016-02-10	2017-09-26	原始取得	无
1110	Flash memory	US9570452	US15/040910	中芯上海	美国	发明	2016-02-10	2017-02-14	原始取得	无
1111	Dual-inverter memory	US9672899	US15/043165	中芯上	美国	发明	2016-02-12	2017-06-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	device and operating method thereof			海、中芯北京						
1112	Semiconductor device including sti structure	US9601568	US15/052957	中芯上海	美国	发明	2016-02-25	2017-03-21	原始取得	无
1113	Ldmos device and fabrication method thereof	US9721806	US15/053001	中芯上海	美国	发明	2016-02-25	2017-08-01	原始取得	无
1114	Semiconductor device including stripe structures	US10403732	US15/055661	中芯上海	美国	发明	2016-02-29	2019-09-03	原始取得	无
1115	Semiconductor device including small pitch patterns	US9633851	US15/057212	中芯上海	美国	发明	2016-03-01	2017-04-25	原始取得	无
1116	Mask read-only memory array, memory device, and fabrication method thereof	US9559104	US15/059352	中芯上海	美国	发明	2016-03-03	2017-01-31	原始取得	无
1117	Fin field-effect transistor and fabrication method	US9564512	US15/059434	中芯上海	美国	发明	2016-03-03	2017-02-07	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	thereof									
1118	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9978641	US15/059501	中芯上海	美国	发明	2016-03-03	2018-05-22	原始取得	无
1119	Semiconductor structure having contact holes between sidewall spacers and fabrication method there of	US9799564	US15/059635	中芯上海	美国	发明	2016-03-03	2017-10-24	原始取得	无
1120	Semiconductor device manufacturing method including heat treatment	US9947538	US15/066442	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-03-10	2018-04-17	原始取得	无
1121	Phase-locked loop device	US9680482	US15/066973	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-03-10	2017-06-13	原始取得	无
1122	Semiconductor device and	US9825133	US15/067741	中芯上海	美国	发明	2016-03-11	2017-11-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	related manufacturing method									
1123	Transistor and fabrication method thereof	US9748405	US15/073772	中芯上海	美国	发明	2016-03-18	2017-08-29	原始取得	无
1124	Bipolar transistor, band-gap reference circuit and virtual ground reference circuit and methods of fabricating thereof	US9577063	US15/088961	中芯北京	美国	发明	2016-04-01	2017-02-21	原始取得	无
1125	High voltage level shifter in ultra low power supply memory application	US9768778	US15/093716	中芯上海	美国	发明	2016-04-07	2017-09-19	原始取得	无
1126	Zener triggered silicon controlled rectifier with small silicon area	US9691753	US15/093725	中芯上海	美国	发明	2016-04-07	2017-06-27	原始取得	无
1127	N-type fin field-effect	US9929267	US15/097575	中芯上海	美国	发明	2016-04-13	2018-03-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	transistor and fabrication method thereof									
1128	Transistor and fabrication method thereof	US10043671	US15/097627	中芯上海	美国	发明	2016-04-13	2018-08-07	原始取得	无
1129	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9620427	US15/098855	中芯上海	美国	发明	2016-04-14	2017-04-11	原始取得	无
1130	Semiconductor device and related electronic device	US9647064	US15/098889	中芯上海	美国	发明	2016-04-14	2017-05-09	原始取得	无
1131	Apparatus and method for overlay measurement	US9835956	US15/131500	中芯上海	美国	发明	2016-04-18	2017-12-05	原始取得	无
1132	Apparatus and method for overlay measurement	US10042269	US15/136482	中芯上海	美国	发明	2016-04-22	2018-08-07	原始取得	无
1133	Semiconductor device and related manufacturing	US9793173	US15/138963	中芯上海	美国	发明	2016-04-26	2017-10-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method									
1134	3d nand device and fabrication method thereof	US9711529	US15/144901	中芯上海	美国	发明	2016-05-03	2017-07-18	原始取得	无
1135	Deep trench isolation for rf devices on soi	US10074650	US15/145776	中芯上海	美国	发明	2016-05-03	2018-09-11	原始取得	无
1136	Fin field effect transistor	US9853030	US15/147154	中芯上海	美国	发明	2016-05-05	2017-12-26	原始取得	无
1137	Sram memory cell and sram memory with conductive interconnect	US10411018	US15/153318	中芯上海	美国	发明	2016-05-12	2019-09-10	原始取得	无
1138	Methods for forming cmos inverters	US9524912	US15/155974	中芯上海	美国	发明	2016-05-16	2016-12-20	原始取得	无
1139	Seal ring structure to avoid delamination defect	US9735116	US15/157318	中芯上海	美国	发明	2016-05-17	2017-08-15	原始取得	无
1140	Electromechanical nonvolatile memory	US9502422	US15/157365	中芯上海	美国	发明	2016-05-17	2016-11-22	原始取得	无
1141	System and method for	US9673060	US15/157366	中芯上海	美国	发明	2016-05-17	2017-06-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	integrated circuits with cylindrical gate structures									
1142	Mems device and fabrication method	US9731962	US15/158056	中芯上海	美国	发明	2016-05-18	2017-08-15	原始取得	无
1143	Fin field-effct transistors	US9608061	US15/158231	中芯上海	美国	发明	2016-05-18	2017-03-28	原始取得	无
1144	Circuit and method for generating clock-signals	US9774326	US15/168335	中芯上海	美国	发明	2016-05-31	2017-09-26	原始取得	无
1145	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9852991	US15/168628	中芯上海	美国	发明	2016-05-31	2017-12-26	原始取得	无
1146	Semiconductor device, finfet transistor and fabrication method thereof	US9799676	US15/169818	中芯上海	美国	发明	2016-06-01	2017-10-24	原始取得	无
1147	Pmos transistor and fabrication method thereof	US9741820	US15/170700	中芯上海	美国	发明	2016-06-01	2017-08-22	原始取得	无
1148	Chemical mechanical	US10099339	US15/171672	中芯上海	美国	发明	2016-06-02	2018-10-16	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	polishing (cmp) apparatus and method									
1149	Low voltage triggered silicon controlled rectifier with high holding voltage and small silicon area	US9613946	US15/179321	中芯上海	美国	发明	2016-06-10	2017-04-04	原始取得	无
1150	Memory device structure and fabricating method thereof	US9640432	US15/180508	中芯上海	美国	发明	2016-06-13	2017-05-02	原始取得	无
1151	Memory device	US9570453	US15/186664	中芯上海	美国	发明	2016-06-20	2017-02-14	原始取得	无
1152	Transistor device and fabrication method	US10056465	US15/187070	中芯上海	美国	发明	2016-06-20	2018-08-21	原始取得	无
1153	Phase-change device, related manufacturing method, and related electronic device	US9691974	US15/187293	中芯上海	美国	发明	2016-06-20	2017-06-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1154	Transistor and fabrication method thereof	US10056301	US15/187578	中芯上海	美国	发明	2016-06-20	2018-08-21	原始取得	无
1155	Asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter circuit and method for configuring the same	US9685972	US15/187647	中芯上海	美国	发明	2016-06-20	2017-06-20	原始取得	无
1156	Semiconductor device and method of manufacturing the same	US9559180	US15/188063	中芯上海	美国	发明	2016-06-21	2017-01-31	原始取得	无
1157	Voltage-adjusting device and related voltage-adjusting method	US9740230	US15/190179	中芯上海	美国	发明	2016-06-23	2017-08-22	原始取得	无
1158	Measuring system and measuring method	US9915519	US15/190182	中芯上海	美国	发明	2016-06-23	2018-03-13	原始取得	无
1159	Extreme ultraviolet light	US9927601	US15/192006	中芯上海	美国	发明	2016-06-24	2018-03-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	source, exposure apparatus, and integrated rotary structure fabricating method									
1160	Semiconductor interconnect device	US9576897	US15/194176	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-06-27	2017-02-21	原始取得	无
1161	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9837323	US15/196666	中芯上海	美国	发明	2016-06-29	2017-12-05	原始取得	无
1162	Semiconductor devices	US9728536	US15/196972	中芯上海	美国	发明	2016-06-29	2017-08-08	原始取得	无
1163	Method for forming photolithographic pattern	US10317801	US15/199230	中芯上海	美国	发明	2016-06-30	2019-06-11	原始取得	无
1164	Selected gate driver circuit in memory circuits, and control device and control method thereof	US9583156	US15/200252	中芯上海	美国	发明	2016-07-01	2017-02-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1165	Fin field effect transistor and fabricating method thereof	US9716178	US15/200414	中芯上海	美国	发明	2016-07-01	2017-07-25	原始取得	无
1166	Interconnect structures and fabrication method thereof	US9978646	US15/207672	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-12	2018-05-22	原始取得	无
1167	Semiconductor device	US9875965	US15/210623	中芯上海	美国	发明	2016-07-14	2018-01-23	原始取得	无
1168	Fabricating method of fin-type semiconductor device	US9923065	US15/212984	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-18	2018-03-20	原始取得	无
1169	Wafer-level bonding packaging method and wafer structure	US9919918	US15/214108	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-19	2018-03-20	原始取得	无
1170	Mos transistor and fabrication method	US10361283	US15/217550	中芯上海	美国	发明	2016-07-22	2019-07-23	原始取得	无
1171	Finfet having buffer layer	US9608115	US15/218631	中芯上海	美国	发明	2016-07-25	2017-03-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	between channel and substrate									
1172	Semiconductor structure and method for forming the same	US9905465	US15/220679	中芯上海	美国	发明	2016-07-27	2018-02-27	原始取得	无
1173	Method for manufacturing a conductor to be used as interconnect member	US9852943	US15/221216	中芯上海	美国	发明	2016-07-27	2017-12-26	原始取得	无
1174	Chip packaging structures	US9698113	US15/221856	中芯上海	美国	发明	2016-07-28	2017-07-04	原始取得	无
1175	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9718682	US15/222006	中芯上海	美国	发明	2016-07-28	2017-08-01	原始取得	无
1176	Method for reducing loss of silicon cap layer over sige source/drain in a cmos device	US9685382	US15/222624	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-28	2017-06-20	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1177	Bonding pad structure, bonding ring structure, and mems device packaging method	US10134698	US15/223525	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-29	2018-11-20	原始取得	无
1178	Three-dimensional transistor and fabrication method thereof	US9799728	US15/224140	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-07-29	2017-10-24	原始取得	无
1179	Flash memory devices	US9799664	US15/224786	中芯上海	美国	发明	2016-08-01	2017-10-24	原始取得	无
1180	Semiconductor structure including patterned feature	US9716007	US15/233630	中芯上海	美国	发明	2016-08-10	2017-07-25	原始取得	无
1181	Method to thin down indium phosphide layer	US9831313	US15/236189	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-12	2017-11-28	原始取得	无
1182	Bjt structure design for 14nm finfet device	US10121860	US15/236329	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-12	2018-11-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1183	Method to improve gate dielectric quality for finfet	US9911832	US15/236331	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-12	2018-03-06	原始取得	无
1184	Method to enhance finfet device performance with channel stop layer depth control	US9882030	US15/236344	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-12	2018-01-30	原始取得	无
1185	Fin field-effect transistor and fabrication method thereof	US10490457	US15/238573	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-16	2019-11-26	原始取得	无
1186	Test structure, fabrication method, and test method	US10078108	US15/238616	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-16	2018-09-18	原始取得	无
1187	Finfet and fabrication method thereof	US9634087	US15/239186	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-17	2017-04-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1188	Wafer structure, fabrication method, and spray apparatus	US9935059	US15/242559	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-21	2018-04-03	原始取得	无
1189	Metal interconnect structure and fabrication method thereof	US10090246	US15/242560	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-21	2018-10-02	原始取得	无
1190	Semiconductor device and fabrication method for forming the same	US9847419	US15/242562	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-21	2017-12-19	原始取得	无
1191	Trapped sacrificial structures and methods of manufacturing same using thin-film encapsulation	US9988265	US15/243031	中芯上海	美国	发明	2016-08-22	2018-06-05	原始取得	无
1192	Fin-fet device and fabrication method thereof	US10002756	US15/243775	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-22	2018-06-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1193	Nand flash memory and fabrication methods thereof	US9911593	US15/244875	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-23	2018-03-06	原始取得	无
1194	Magnetoresistive sensor, related manufacturing method, and related electronic device	US9761794	US15/245556	中芯上海	美国	发明	2016-08-24	2017-09-12	原始取得	无
1195	Methods and structures for thin-film encapsulation and co-integration of same with microelectronic devices and microelectromechanical systems (mems)	US10173893	US15/246278	中芯上海	美国	发明	2016-08-24	2019-01-08	原始取得	无
1196	Shallow trench isolation structure and fabricating method thereof	US10134625	US15/249205	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-08-26	2018-11-20	原始取得	无
1197	Mems device and	US10357768	US15/249439	中芯上海	美国	发明	2016-08-28	2019-07-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof									
1198	Control method and control apparatus of memory decoding system	US9892769	US15/249580	中芯上海	美国	发明	2016-08-29	2018-02-13	原始取得	无
1199	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US9647068	US15/260863	中芯上海	美国	发明	2016-09-09	2017-05-09	原始取得	无
1200	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10433435	US15/261471	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-09-09	2019-10-01	原始取得	无
1201	Semiconductor device including electrostatic discharge (esd) protection circuit and manufacturing method thereof	US9679889	US15/261558	中芯上海	美国	发明	2016-09-09	2017-06-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1202	Polishing pad	US10155296	US15/262817	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-12	2018-12-18	原始取得	无
1203	Electrostatic discharge protection structure and fabrication method thereof	US10115717	US15/262930	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-12	2018-10-30	原始取得	无
1204	Method for repairing mask defects	US10073338	US15/263299	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-12	2018-09-11	原始取得	无
1205	Resistive random access memory and fabrication method thereof	US10347833	US15/263918	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-13	2019-07-09	原始取得	无
1206	Finfet structure	US9966470	US15/269946	中芯上海	美国	发明	2016-09-19	2018-05-08	原始取得	无
1207	Method and device for metal gate stacks	US10211309	US15/272197	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-21	2019-02-19	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1208	Power-on reset circuit	US10116299	US15/273472	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-22	2018-10-30	原始取得	无
1209	Fet with local isolation layers on s/d trench sidewalls	US10079279	US15/273951	中芯上海	美国	发明	2016-09-23	2018-09-18	原始取得	无
1210	Electrostatic discharge protection device and method for forming the same	US10504887	US15/275030	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-23	2019-12-10	原始取得	无
1211	Semiconductor structures and fabrication method thereof	US9984882	US15/275111	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-23	2018-05-29	原始取得	无
1212	Conductive plug structure and fabrication method thereof	US9837311	US15/277853	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-27	2017-12-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1213	Substrate having two semiconductor materials on insulator	US10262891	US15/279236	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-09-28	2019-04-16	原始取得	无
1214	Transistor and method for forming the same	US10199478	US15/280214	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-09-29	2019-02-05	原始取得	无
1215	Method and device for reducing finfet self-heating effect	US9922980	US15/280482	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-29	2018-03-20	原始取得	无
1216	Semiconductor testing structures and semiconductor testing apparatus	US9823271	US15/280777	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-29	2017-11-21	原始取得	无
1217	Structure for cmos metal gate stack	US10304745	US15/283113	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-30	2019-05-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1218	Well implantation process for finfet device	US9984939	US15/283239	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-09-30	2018-05-29	原始取得	无
1219	Ultra-capacity battery	US10153095	US15/283944	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-03	2018-12-11	原始取得	无
1220	Semiconductor structure and fabricating method thereof	US10224248	US15/284839	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-04	2019-03-05	原始取得	无
1221	Cmos image sensor and fabrication method thereof	US9947709	US15/285269	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-04	2018-04-17	原始取得	无
1222	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10032860	US15/286176	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-05	2018-07-24	原始取得	无
1223	Fin-fet device and	US10037924	US15/287302	中芯上	美国	发明	2016-10-06	2018-07-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof			海、中芯北京						
1224	Method to improve device performance for finfet	US9978749	US15/292086	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-12	2018-05-22	原始取得	无
1225	Interconnection structure	US9761528	US15/294358	中芯上海	美国	发明	2016-10-14	2017-09-12	原始取得	无
1226	Mems device	US9969609	US15/296821	中芯上海	美国	发明	2016-10-18	2018-05-15	原始取得	无
1227	Semiconductor device and related manufacturing method	US9978760	US15/298578	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-20	2018-05-22	原始取得	无
1228	Signal receiver, related method, and related electronic device	US10153755	US15/298811	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-20	2018-12-11	原始取得	无
1229	Reference voltage generator and related method	US9864388	US15/298821	中芯上海	美国	发明	2016-10-20	2018-01-09	原始取得	无
1230	Semiconductor device	US9985015	US15/299282	中芯上海	美国	发明	2016-10-20	2018-05-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	having improved core and input/output device reliability									
1231	Self-enabled bus conflict detection circuit	US9990310	US15/299453	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-20	2018-06-05	原始取得	无
1232	Flash memory having water vapor induced air gaps and fabricating method thereof	US10418370	US15/331467	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-21	2019-09-17	原始取得	无
1233	Physically unclonable product and fabrication method thereof	US9876498	US15/332866	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-24	2018-01-23	原始取得	无
1234	Contact via structure and fabricating method thereof	US9978677	US15/333319	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-25	2018-05-22	原始取得	无
1235	Efuse bit cell, and	US9830996	US15/333894	中芯上	美国	发明	2016-10-25	2017-11-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	read/write method thereof, and efuse array			海、中芯北京						
1236	High voltage esd device for finfet technology	US9978741	US15/334130	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-25	2018-05-22	原始取得	无
1237	Interconnection structure, fabricating method thereof, and exposure alignment system	US9646865	US15/335003	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-26	2017-05-09	原始取得	无
1238	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US9911833	US15/335248	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-26	2018-03-06	原始取得	无
1239	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10269927	US15/335595	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-27	2019-04-23	原始取得	无
1240	Semiconductor device and	US10297454	US15/335777	中芯上	美国	发明	2016-10-27	2019-05-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication method thereof			海、中芯北京						
1241	Method and device for compact efuse array	US9754680	US15/336365	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-10-27	2017-09-05	原始取得	无
1242	Method for fabricating semiconductor structure	US9640479	US15/339403	中芯上海	美国	发明	2016-10-31	2017-05-02	原始取得	无
1243	Method for reducing crosstalk in cmos image sensor	US9773834	US15/339598	中芯上海	美国	发明	2016-10-31	2017-09-26	原始取得	无
1244	Inductor device	US10026801	US15/340683	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-11-01	2018-07-17	原始取得	无
1245	Semiconductor nanowire device and fabrication method thereof	US10083879	US15/341943	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-02	2018-09-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1246	Semiconductor device and fabricating method of a gate with an epitaxial layer	US9985132	US15/343433	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-04	2018-05-29	原始取得	无
1247	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10003019	US15/344226	中芯上海	美国	发明	2016-11-04	2018-06-19	原始取得	无
1248	Double-side process silicon mos and passive devices for rf front-end modules	US9711502	US15/345135	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-11-07	2017-07-18	中芯上海：原始取得；中芯宁波：继受取得	无
1249	Method of high voltage device fabrication	US9966265	US15/346570	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-08	2018-05-08	原始取得	无
1250	Method to improve ge channel interfacial layer quality for cmos finfet	US10026828	US15/346586	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-08	2018-07-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1251	Method and system for predicting high-temperature operating life of sram devices	US10041994	US15/348669	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-10	2018-08-07	原始取得	无
1252	Method to improve hci performance for finfet	US9875944	US15/348705	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-10	2018-01-23	原始取得	无
1253	Method and system for uniform deposition of metal	US9966307	US15/348729	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-10	2018-05-08	原始取得	无
1254	Tunneling nanotube field effect transistor and manufacturing method thereof	US9735362	US15/350504	中芯上海	美国	发明	2016-11-14	2017-08-15	原始取得	无
1255	Finfet having a gate electrode with sidewall spacers having asymmetric	US9941387	US15/350726	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-14	2018-04-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	dielectric constants and method of manufacturing									
1256	Electromechanical device including connector formed of dielectric material	US10280078	US15/352795	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-16	2019-05-07	原始取得	无
1257	Method for manufacturing memory device	US10002783	US15/352823	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-16	2018-06-19	原始取得	无
1258	Nand flash memory and fabrication method thereof	US9741573	US15/356176	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-18	2017-08-22	原始取得	无
1259	Write-tracking circuit for memory	US9830978	US15/359587	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-22	2017-11-28	原始取得	无
1260	Memory control method and memory control	US10310772	US15/361295	中芯上海、中芯	美国	发明	2016-11-25	2019-06-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	apparatus			北京						
1261	Method of manufacturing an eeprom device	US10079241	US15/362551	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-28	2018-09-18	原始取得	无
1262	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US10446648	US15/365825	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-11-30	2019-10-15	原始取得	无
1263	Memory control method and apparatus for programming and erasing areas	US10176876	US15/366505	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-01	2019-01-08	原始取得	无
1264	Fin field-effect transistor	US9755080	US15/368812	中芯上海	美国	发明	2016-12-05	2017-09-05	原始取得	无
1265	Edge bead removal apparatus	US9753371	US15/369075	中芯上海	美国	发明	2016-12-05	2017-09-05	原始取得	无
1266	Semiconductor device having vertical	US9831308	US15/370721	中芯上海、中芯	美国	发明	2016-12-06	2017-11-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	semiconductor pillars			北京						
1267	Resonator and related manufacturing method	US10511284	US15/371968	中芯上海、中芯宁波	美国	发明	2016-12-07	2019-12-17	原始取得	无
1268	Patterning method	US10427185	US15/372091	中芯上海	美国	发明	2016-12-07	2019-10-01	原始取得	无
1269	Compact efuse array with different mos sizes according to physical location in a word line	US9747999	US15/374064	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-09	2017-08-29	原始取得	无
1270	Method and device to improve shallow trench isolation	US10418283	US15/376408	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-12	2019-09-17	原始取得	无
1271	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10325818	US15/376511	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-12	2019-06-18	原始取得	无
1272	Memory cell structures	US9825091	US15/380899	中芯上	美国	发明	2016-12-15	2017-11-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				海、中芯北京						
1273	Method and structure for finfet sram	US9985037	US15/384194	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-19	2018-05-29	原始取得	无
1274	Method for reducing n-type finfet source and drain resistance	US9865505	US15/390279	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-23	2018-01-09	原始取得	无
1275	Metal gate transistor and fabrication method thereof	US10037943	US15/392215	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2016-12-28	2018-07-31	原始取得	无
1276	Memory device, related method, and related electronic device	US9953689	US15/393023	中芯上海	美国	发明	2016-12-28	2018-04-24	原始取得	无
1277	Buried-channel mosfet and a surface-channel mosfet of	US10062704	US15/394592	中芯上海、中芯	美国	发明	2016-12-29	2018-08-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	a same type and fabrication method thereof			北京						
1278	Cmos image sensor and fabrication method thereof	US10038027	US15/396878	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-03	2018-07-31	原始取得	无
1279	Pmos transistor and fabrication method thereof	US10497807	US15/397081	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-03	2019-12-03	原始取得	无
1280	Esd protection device and method	US10153271	US15/397376	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-03	2018-12-11	原始取得	无
1281	Method for fabricating finfet structure	US10084092	US15/397584	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-03	2018-09-25	原始取得	无
1282	Mark structure and fabrication method thereof	US9773739	US15/397788	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-01-04	2017-09-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1283	D flip-flop and signal driving method	US10200018	US15/397822	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-04	2019-02-05	原始取得	无
1284	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10147816	US15/397949	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-04	2018-12-04	原始取得	无
1285	Fin field-effect transistor and fabrication method thereof	US10121880	US15/398786	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-05	2018-11-06	原始取得	无
1286	Method of fabricating a semiconductor structure by asymmetric oxidation of fin material formed under gate stack	US10050130	US15/398817	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-05	2018-08-14	原始取得	无
1287	Low core power leakage	US9831879	US15/399462	中芯上	美国	发明	2017-01-05	2017-11-28	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	structure in io receiver during io power down			海、中芯北京						
1288	Finfet varactor	US9985144	US15/400201	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-06	2018-05-29	原始取得	无
1289	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9917030	US15/401134	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-09	2018-03-13	原始取得	无
1290	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US9978763	US15/401286	中芯上海	美国	发明	2017-01-09	2018-05-22	原始取得	无
1291	Method for thermal treatment using heat reservoir chamber	US10204809	US15/404672	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-12	2019-02-12	原始取得	无
1292	Semiconductor device and	US10056302	US15/405150	中芯上	美国	发明	2017-01-12	2018-08-21	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	related manufacturing method			海、中芯北京						
1293	Memory cell and fabrication method thereof	US10062767	US15/407308	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-17	2018-08-28	原始取得	无
1294	Asar adc circuit and conversion method thereof	US9755659	US15/407334	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-17	2017-09-05	原始取得	无
1295	Static random access memory and fabrication method thereof	US10332892	US15/407387	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-01-17	2019-06-25	原始取得	无
1296	Semiconductor structures	US9911742	US15/427942	中芯上海	美国	发明	2017-02-08	2018-03-06	原始取得	无
1297	Charge pump voltage regulator	US10014768	US15/435519	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-02-17	2018-07-03	原始取得	无
1298	Transistor and fabrication	US10347493	US15/435557	中芯上	美国	发明	2017-02-17	2019-07-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof			海、中芯北京						
1299	Crystal oscillator circuit	US10425085	US15/436892	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-02-20	2019-09-24	原始取得	无
1300	Ldmos transistor and fabrication method thereof	US10002960	US15/436905	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-02-20	2018-06-19	原始取得	无
1301	Input-output receiver	US10243564	US15/436911	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-02-20	2019-03-26	原始取得	无
1302	Method for manufacturing a device isolation structure	US9824914	US15/438204	中芯上海	美国	发明	2017-02-21	2017-11-21	原始取得	无
1303	Nanowire device and method of manufacturing the same	US9876079	US15/439181	中芯上海	美国	发明	2017-02-22	2018-01-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1304	Photolithography alignment mark structures and semiconductor structures	US10163806	US15/445076	中芯上海	美国	发明	2017-02-28	2018-12-25	原始取得	无
1305	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US9929182	US15/452788	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-08	2018-03-27	原始取得	无
1306	Flash memory structure and fabrication method thereof	US9923100	US15/452836	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-08	2018-03-20	原始取得	无
1307	Semiconductor memory device and fabrication method thereof	US9922985	US15/452869	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-08	2018-03-20	原始取得	无
1308	Eeprom backup method and device	US9786373	US15/466503	中芯上海	美国	发明	2017-03-22	2017-10-10	原始取得	无
1309	Membrane transducer structures and methods of	US10118820	US15/469393	中芯上海	美国	发明	2017-03-24	2018-11-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing same using thin-film encapsulation									
1310	Ldmos transistor, esd device, and fabrication method thereof	US10395931	US15/471612	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-28	2019-08-27	原始取得	无
1311	Ldmos design for a finfet device	US10043804	US15/471983	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-28	2018-08-07	原始取得	无
1312	Method and device for compound semiconductor fin structure	US10374065	US15/473164	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-29	2019-08-06	原始取得	无
1313	Ldmos finfet device	US10340274	US15/473183	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-29	2019-07-02	原始取得	无
1314	Word line voltage generator for multiple-time	US9990963	US15/473226	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-03-29	2018-06-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	programmable memory			北京						
1315	Increasing thickness of functional layer according to increasing recess area	US10388655	US15/473318	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-29	2019-08-20	原始取得	无
1316	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10319839	US15/473703	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-30	2019-06-11	原始取得	无
1317	Fin-fet devices and fabrication methods thereof	US10297595	US15/473726	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-30	2019-05-21	原始取得	无
1318	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10062572	US15/476249	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-03-31	2018-08-28	原始取得	无
1319	Wafer cassette and placement method thereof	US10147626	US15/477139	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2018-12-04	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1320	Semiconductor fabrication method including non-uniform cover layer	US10090170	US15/477153	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2018-10-02	原始取得	无
1321	Memory and reference circuit calibration method thereof	US10008246	US15/477215	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2018-06-26	原始取得	无
1322	Method for forming semiconductor structure having stress layers	US10090156	US15/477250	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2018-10-02	原始取得	无
1323	Field-effect-transistors and fabrication methods thereof	US10211203	US15/477394	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2019-02-19	原始取得	无
1324	Method and device for finfet with graphene nanoribbon	US10361196	US15/477815	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-03	2019-07-23	原始取得	无
1325	Method for capping cu	US9929096	US15/477829	中芯上	美国	发明	2017-04-03	2018-03-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	layer using graphene in semiconductor			海、中芯北京						
1326	Sealing structure for a bonded wafer and method of forming the sealing structure	US9837287	US15/482346	中芯上海	美国	发明	2017-04-07	2017-12-05	原始取得	无
1327	Chemical mechanical polishing simulation methods and simulation devices thereof	US10496785	US15/482880	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-10	2019-12-03	原始取得	无
1328	Method to optimize standard cells manufacturability	US10262097	US15/483516	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-10	2019-04-16	原始取得	无
1329	Method for forming finfet device	US10008495	US15/483554	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-10	2018-06-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1330	Frequency divider circuit and a frequency synthesizer circuit	US10374620	US15/488202	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-14	2019-08-06	原始取得	无
1331	Mos-varactor design to improve tuning efficiency	US10186593	US15/489768	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-18	2019-01-22	原始取得	无
1332	Fin-fet devices and fabrication methods thereof	US10090306	US15/491501	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-19	2018-10-02	原始取得	无
1333	Methods for reading and operating memory device including efuse	US9991002	US15/492491	中芯上海	美国	发明	2017-04-20	2018-06-05	原始取得	无
1334	Methods for reading and operating memory device including efuse	US9991003	US15/492531	中芯上海	美国	发明	2017-04-20	2018-06-05	原始取得	无
1335	Semiconductor device with	US10431501	US15/494607	中芯上	美国	发明	2017-04-24	2019-10-01	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	high-k gate dielectric layer and fabrication method thereof			海、中芯北京						
1336	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10002869	US15/494691	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-04-24	2018-06-19	原始取得	无
1337	Finfet devices having a material formed on reduced source/drain region	US10290724	US15/498272	中芯上海	美国	发明	2017-04-26	2019-05-14	原始取得	无
1338	Fan-out package structure, and manufacturing method thereof	US10056350	US15/571581	中芯长电	美国	发明	2016-03-14	2018-08-21	原始取得	无
1339	Vertical junctionless transistor devices	US10103268	US15/582288	中芯上海	美国	发明	2017-04-28	2018-10-16	原始取得	无
1340	Alignment method and alignment system thereof	US10048603	US15/587544	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-05-05	2018-08-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1341	Ldmos transistor	US9870916	US15/597319	中芯上海	美国	发明	2017-05-17	2018-01-16	原始取得	无
1342	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10483263	US15/603754	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-05-24	2019-11-19	原始取得	无
1343	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10026841	US15/603768	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-05-24	2018-07-17	原始取得	无
1344	Epi integrality on source/drain region of finfet	US10332980	US15/612805	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-06-02	2019-06-25	原始取得	无
1345	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10103082	US15/613717	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-06-05	2018-10-16	原始取得	无
1346	Semiconductor device including a recessed	US10411115	US15/613813	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-06-05	2019-09-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	insulation region and fabrication method thereof			北京						
1347	Packaging structure including interconnecs and packaging method thereof	US10236273	US15/614056	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-06-05	2019-03-19	原始取得	无
1348	Power semiconductor device with semiconductor pillars	US10090403	US15/623952	中芯上海	美国	发明	2017-06-15	2018-10-02	原始取得	无
1349	Contact structure and associated method for flash memory	US10242910	US15/624846	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-06-16	2019-03-26	原始取得	无
1350	Structure and method for memory cell array	US9923027	US15/624865	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-06-16	2018-03-20	原始取得	无
1351	Semiconductor interconnect structure and manufacturing	US10290539	US15/627961	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-06-20	2019-05-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof			北京						
1352	Ldmos device	US9875908	US15/630533	中芯上海	美国	发明	2017-06-22	2018-01-23	原始取得	无
1353	Semiconductor device and related manufacturing method	US9991082	US15/631113	中芯上海	美国	发明	2017-06-23	2018-06-05	原始取得	无
1354	Non-volatile memories and data reading methods thereof	US10410727	US15/641781	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-05	2019-09-10	原始取得	无
1355	Metal interconnect structure	US10373826	US15/644089	中芯上海	美国	发明	2017-07-07	2019-08-06	原始取得	无
1356	Semiconductor structure	US10002944	US15/645013	中芯上海	美国	发明	2017-07-10	2018-06-19	原始取得	无
1357	Method and device for temperature measurement of finfet devices	US9970981	US15/648408	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-12	2018-05-15	原始取得	无
1358	Method for manufacturing a seal ring structure to avoid delamination defect	US10249574	US15/650687	中芯上海	美国	发明	2017-07-14	2019-04-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1359	Semiconductor device and manufacture thereof	US10115628	US15/651918	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-17	2018-10-30	原始取得	无
1360	Transistor and fabrication method thereof	US10026850	US15/655322	中芯上海	美国	发明	2017-07-20	2018-07-17	原始取得	无
1361	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10347747	US15/658623	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-25	2019-07-09	原始取得	无
1362	Top-down method for fabricating nanowire device	US10304926	US15/662242	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-27	2019-05-28	原始取得	无
1363	Electrostatic discharge protection structure and fabricating method thereof	US10186507	US15/662849	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-07-28	2019-01-22	原始取得	无
1364	Cmos image sensor	US10163958	US15/663501	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-07-28	2018-12-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1365	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10096518	US15/665651	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-01	2018-10-09	原始取得	无
1366	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10157771	US15/665695	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-01	2018-12-18	原始取得	无
1367	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10177246	US15/666838	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-02	2019-01-08	原始取得	无
1368	Method for correcting target patterns and mask having corrected target patterns	US10423062	US15/667956	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-03	2019-09-24	原始取得	无
1369	Laterally diffused metal-oxide-semiconductor	US10199494	US15/669322	中芯上海、中芯	美国	发明	2017-08-04	2019-02-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	devices and fabrication methods thereof			北京						
1370	Gate structures and fabrication methods thereof	US10211108	US15/673547	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-10	2019-02-19	原始取得	无
1371	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10347578	US15/673628	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-10	2019-07-09	原始取得	无
1372	Device for a finfet	US10157919	US15/676354	中芯上海	美国	发明	2017-08-14	2018-12-18	原始取得	无
1373	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10340271	US15/679362	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-17	2019-07-02	原始取得	无
1374	Memory array, and method for reading, programming and erasing memory array	US10204688	US15/679412	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-17	2019-02-12	原始取得	无
1375	Method for reducing cracks	US10177027	US15/679914	中芯上	美国	发明	2017-08-17	2019-01-08	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	in a step-shaped cavity			海、中芯北京						
1376	Method for preventing excessive etching of edges of an insulator layer	US10249508	US15/679937	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-17	2019-04-02	原始取得	无
1377	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10312329	US15/683029	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-22	2019-06-04	原始取得	无
1378	Method for forming a semiconductor device comprising a selectively grown graphene layer	US10121872	US15/683106	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-22	2018-11-06	原始取得	无
1379	Semiconductor device and manufacturing method thereof	US10134849	US15/683237	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-08-22	2018-11-20	原始取得	无
1380	Method to improve finfet	US10340385	US15/688524	中芯上	美国	发明	2017-08-28	2019-07-02	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	device performance			海、中芯北京						
1381	Semiconductor device	US10446402	US15/697905	中芯上海	美国	发明	2017-09-07	2019-10-15	原始取得	无
1382	Semiconductor structures	US10396032	US15/704568	中芯上海	美国	发明	2017-09-14	2019-08-27	原始取得	无
1383	Semiconductor device and related manufacturing method	US10373880	US15/704623	中芯上海	美国	发明	2017-09-14	2019-08-06	原始取得	无
1384	Manufacturing method of semiconductor device	US10504728	US15/706069	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-09-15	2019-12-10	原始取得	无
1385	Defect inspection method and apparatus using micro lens matrix	US10416091	US15/706409	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-09-15	2019-09-17	原始取得	无
1386	Semiconductor device and finfet transistor	US10134761	US15/707250	中芯上海	美国	发明	2017-09-18	2018-11-20	原始取得	无
1387	Three-dimensional	US10522619	US15/707359	中芯上	美国	发明	2017-09-18	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	transistor			海、中芯北京						
1388	Semiconductor structure having contact holes between sidewall spacers	US10134639	US15/707543	中芯上海	美国	发明	2017-09-18	2018-11-20	原始取得	无
1389	Method for testing inter-layer connections	US10267840	US15/709267	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-09-19	2019-04-23	原始取得	无
1390	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10128117	US15/711479	中芯上海	美国	发明	2017-09-21	2018-11-13	原始取得	无
1391	Bandgap with system sleep mode	US10522196	US15/714935	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-09-25	2019-12-31	原始取得	无
1392	Method for fabricating	US10504883	US15/720734	中芯上	美国	发明	2017-09-29	2019-12-10	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	damascene structure using fluorocarbon film			海、中芯北京						
1393	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10177145	US15/721295	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-09-29	2019-01-08	原始取得	无
1394	Method for manufacturing a semiconductor device having a fin located on a substrate	US10236216	US15/723723	中芯上海、中芯新技术、IMEC International	美国	发明	2017-10-03	2019-03-19	原始取得	无
1395	Electrostatic discharge protection structure and fabricating method thereof	US10354993	US15/725854	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-05	2019-07-16	原始取得	无
1396	Fin-fet devices and fabrication methods thereof	US10269972	US15/726183	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-05	2019-04-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1397	Semiconductor structure with improved punch-through and fabrication method thereof	US10177146	US15/726644	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-06	2019-01-08	原始取得	无
1398	Channel stop imp for the finfet device	US10367058	US15/728184	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-09	2019-07-30	原始取得	无
1399	Fin cut process and fin structure	US10325813	US15/728204	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-09	2019-06-18	原始取得	无
1400	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10192744	US15/728395	中芯上海	美国	发明	2017-10-09	2019-01-29	原始取得	无
1401	Wafer level chip packaging method	US10290515	US15/752180	中芯长电	美国	发明	2016-05-20	2019-05-14	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1402	Fin-fet devices and fabrication methods thereof	US10388573	US15/783854	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-13	2019-08-20	原始取得	无
1403	Finfet device and fabrication method thereof	US10312155	US15/784357	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-16	2019-06-04	原始取得	无
1404	Fin-fet device and fabrication method thereof	US10297511	US15/785071	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-16	2019-05-21	原始取得	无
1405	Semiconductor apparatus and manufacturing method	US10256153	US15/786250	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-17	2019-04-09	原始取得	无
1406	Balun structure	US10374571	US15/792291	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-24	2019-08-06	原始取得	无
1407	Fin field-effect transistor	US10269645	US15/792439	中芯上	美国	发明	2017-10-24	2019-04-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and fabrication method thereof			海、中芯北京						
1408	Photolithographic mask	US9946155	US15/793579	中芯上海	美国	发明	2017-10-25	2018-04-17	原始取得	无
1409	Integrated semiconductor device and manufacturing method therefor	US10128231	US15/794876	中芯北京	美国	发明	2017-10-26	2018-11-13	原始取得	无
1410	Flash memory device and manufacture thereof	US10297609	US15/797884	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-30	2019-05-21	原始取得	无
1411	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10269659	US15/799706	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-31	2019-04-23	原始取得	无
1412	Magnetic random access memory and manufacture thereof	US10388697	US15/799915	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-10-31	2019-08-20	原始取得	无
1413	Dynamic random access	US10475798	US15/804846	中芯上	美国	发明	2017-11-06	2019-11-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	memory and fabrication method thereof			海、中芯北京						
1414	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10211106	US15/806191	中芯上海	美国	发明	2017-11-07	2019-02-19	原始取得	无
1415	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10199383	US15/808781	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-09	2019-02-05	原始取得	无
1416	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10121700	US15/809120	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-10	2018-11-06	原始取得	无
1417	Retention voltage generation circuit and electronic apparatus	US10283192	US15/809387	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-10	2019-05-07	原始取得	无
1418	Semiconductor structure	US10347496	US15/813420	中芯上	美国	发明	2017-11-15	2019-07-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and fabrication method thereof			海、中芯北京						
1419	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10461188	US15/814154	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-15	2019-10-29	原始取得	无
1420	Chemical mechanical polishing device and chemical mechanical polishing method	US10453702	US15/814224	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-15	2019-10-22	原始取得	无
1421	Nonvolatile memories and reading methods thereof	US10121548	US15/815339	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-16	2018-11-06	原始取得	无
1422	Photomask manufacturing method	US10373841	US15/816673	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-17	2019-08-06	原始取得	无
1423	Method of forming	US10347530	US15/816973	中芯上	美国	发明	2017-11-17	2019-07-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	interconnect structure with partial copper plating			海、中芯宁波						
1424	Current source and digital to analog converter	US10312934	US15/817830	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-20	2019-06-04	原始取得	无
1425	Mask cooling apparatus and mask cooling method	US10345719	US15/820045	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-21	2019-07-09	原始取得	无
1426	Semiconductor device having a surface insulator layer and manufacturing method therefor	US10312093	US15/820561	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-22	2019-06-04	原始取得	无
1427	Low dropout regulator (ldo) circuit	US10261533	US15/821295	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-22	2019-04-16	原始取得	无
1428	Semiconductor device and	US10490674	US15/821349	中芯上	美国	发明	2017-11-22	2019-11-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacturing method thereof			海、中芯北京						
1429	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10199382	US15/821422	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-22	2019-02-05	原始取得	无
1430	Interconnection structures and fabrication methods thereof	US10453797	US15/821581	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-22	2019-10-22	原始取得	无
1431	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10522651	US15/823029	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-27	2019-12-31	原始取得	无
1432	Semiconductor structure, static random access memory, and fabrication method thereof	US10256243	US15/824830	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-28	2019-04-09	原始取得	无
1433	Wafer bonding structure	US10121762	US15/825872	中芯上	美国	发明	2017-11-29	2018-11-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and wafer bonding method			海、中芯北京						
1434	Sram devices and fabrication methods thereof	US10192790	US15/826043	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-29	2019-01-29	原始取得	无
1435	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10199297	US15/828190	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-11-30	2019-02-05	原始取得	无
1436	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10439042	US15/829453	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-12-01	2019-10-08	原始取得	无
1437	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10453690	US15/834843	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-12-07	2019-10-22	原始取得	无
1438	Fin field-effct transistor	US10431671	US15/835081	中芯上海	美国	发明	2017-12-07	2019-10-01	原始取得	无
1439	Semiconductor structure	US10418286	US15/843316	中芯上	美国	发明	2017-12-15	2019-09-17	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and fabrication method thereof			海、中芯北京						
1440	Capacitor, image sensor circuit and fabrication methods thereof	US10424610	US15/849265	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-12-20	2019-09-24	原始取得	无
1441	Packaging structure and fabrication method thereof	US10446474	US15/851007	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-12-21	2019-10-15	原始取得	无
1442	Semiconductor devices and fabrication methods thereof	US10332895	US15/856323	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2017-12-28	2019-06-25	原始取得	无
1443	Memory decoding system	US10176854	US15/860268	中芯上海	美国	发明	2018-01-02	2019-01-08	原始取得	无
1444	Semiconductor device having interconnect structure	US10090155	US15/861376	中芯上海	美国	发明	2018-01-03	2018-10-02	原始取得	无
1445	Memory and fabrication	US10325810	US15/862100	中芯上	美国	发明	2018-01-04	2019-06-18	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof			海、中芯北京						
1446	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10186598	US15/862569	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-04	2019-01-22	原始取得	无
1447	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10424662	US15/863480	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-05	2019-09-24	原始取得	无
1448	Deposition method	US10329667	US15/863700	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-05	2019-06-25	原始取得	无
1449	Semiconductor device and manufacture thereof	US10340342	US15/863733	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-05	2019-07-02	原始取得	无
1450	Lateral diffusion metal oxide semiconductor	US10403750	US15/867379	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-01-10	2019-09-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	(ldmos) device including plurality of second regions and manufacture thereof			北京						
1451	Mask read-only memory device	US10062702	US15/868098	中芯上海	美国	发明	2018-01-11	2018-08-28	原始取得	无
1452	Semiconductor structure and method for forming the same	US10504781	US15/868343	中芯上海	美国	发明	2018-01-11	2019-12-10	原始取得	无
1453	Cylindrical germanium nanowire device	US10468505	US15/870253	中芯上海	美国	发明	2018-01-12	2019-11-05	原始取得	无
1454	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10211062	US15/872167	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-16	2019-02-19	原始取得	无
1455	Level-shifter circuits and methods of using the same	US10469086	US15/872230	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-16	2019-11-05	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1456	Manufacturing method for dual work-function metal gates	US10403553	US15/872306	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-16	2019-09-03	原始取得	无
1457	Mask pattern correction method	US10423063	US15/874064	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-18	2019-09-24	原始取得	无
1458	Insulated gate bipolar transistor and fabrication method thereof	US10319845	US15/874125	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-18	2019-06-11	原始取得	无
1459	Detection circuits, detection method, and electronic systems for i/o output status	US10502781	US15/874371	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-18	2019-12-10	原始取得	无
1460	Insulated gate bipolar transistors and fabrication methods thereof	US10505012	US15/882354	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-01-29	2019-12-10	原始取得	无
1461	Flash memory structure	US10084097	US15/889940	中芯上	美国	发明	2018-02-06	2018-09-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				海、中芯北京						
1462	Semiconductor memory device	US10177162	US15/890062	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-06	2019-01-08	原始取得	无
1463	Copper pillar bump structure and manufacturing method therefor	US10312208	US15/891745	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-08	2019-06-04	原始取得	无
1464	Fin-type semiconductor device	US10312333	US15/893319	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-09	2019-06-04	原始取得	无
1465	Method and structure for improving dielectric reliability of cmos device	US10418287	US15/894755	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-12	2019-09-17	原始取得	无
1466	Semiconductor structure	US10424599	US15/895430	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-02-13	2019-09-24	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1467	N-type fin field-effect transistor	US10490663	US15/895594	中芯上海	美国	发明	2018-02-13	2019-11-26	原始取得	无
1468	Device, system, and method for reducing program disturb in multiple-time programmable cell array	US10410729	US15/902957	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-22	2019-09-10	原始取得	无
1469	Power amplifier circuit with adjustable bias voltage	US10439566	US15/902969	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-22	2019-10-08	原始取得	无
1470	Method to improve hkmg contact resistance	US10510858	US15/904175	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-02-23	2019-12-17	原始取得	无
1471	Method for manufacturing finfets by implanting counter-doped regions in	US10361288	US15/909285	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-01	2019-07-23	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	lightly-doped s/d extensions away from the channel									
1472	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10446666	US15/912145	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-05	2019-10-15	原始取得	无
1473	Fin field effect transistor and fabrication method thereof	US10460996	US15/912218	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-05	2019-10-29	原始取得	无
1474	Comparator and successive approximation analog-to-digital converter thereof	US10079611	US15/916517	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-09	2018-09-18	原始取得	无
1475	Self-heating test structure	US10418362	US15/918644	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-12	2019-09-17	原始取得	无
1476	Sti-diode structure	US10396174	US15/918674	中芯上	美国	发明	2018-03-12	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				海、中芯北京						
1477	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10490651	US15/918784	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-12	2019-11-26	原始取得	无
1478	3-d flash memory device and manufacture thereof	US10388761	US15/919375	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-13	2019-08-20	原始取得	无
1479	Semiconductor device and operation thereof	US10192868	US15/919380	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-13	2019-01-29	原始取得	无
1480	Phase change memory and fabrication method thereof	US10497869	US15/919537	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-13	2019-12-03	原始取得	无
1481	Wafer bonding methods and wafer-bonded structures	US10446519	US15/919940	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-03-13	2019-10-15	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1482	Method and apparatus for backside illumination sensor	US10340303	US15/922514	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-15	2019-07-02	原始取得	无
1483	Double-sided plastic fan-out package structure having antenna and manufacturing method thereof	US10325786	US15/923337	中芯长电	美国	发明	2018-03-16	2019-06-18	原始取得	无
1484	Semiconductor device and manufacture thereof	US10351421	US15/923648	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-16	2019-07-16	原始取得	无
1485	Switched-capacitor circuit, a radio frequency device, and a switched-capacitor circuit manufacturing method	US10348287	US15/923676	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-16	2019-07-09	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1486	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10411061	US15/924061	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-16	2019-09-10	原始取得	无
1487	Method to form hybrid sige fin	US10403546	US15/925326	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-19	2019-09-03	原始取得	无
1488	Channel stop imp for finfet device	US10403741	US15/925390	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-19	2019-09-03	原始取得	无
1489	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10483371	US15/925974	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-20	2019-11-19	原始取得	无
1490	Flash memory device and manufacturing method thereof	US10229926	US15/926791	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-20	2019-03-12	原始取得	无
1491	Image sensors, and	US10461113	US15/927594	中芯上	美国	发明	2018-03-21	2019-10-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabrication and operation methods thereof			海、中芯北京						
1492	Method and device having low contact resistance	US10446684	US15/935888	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-26	2019-10-15	原始取得	无
1493	Semiconductor structure of interconnect and fabrication method thereof	US10483162	US15/936766	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-27	2019-11-19	原始取得	无
1494	Apparatus for uniform metal deposition	US10217663	US15/938899	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-28	2019-02-26	原始取得	无
1495	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10361305	US15/941225	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-03-30	2019-07-23	原始取得	无
1496	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10373911	US15/945883	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-04-05	2019-08-06	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1497	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10446652	US15/945915	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-04-05	2019-10-15	原始取得	无
1498	Semiconductor device, related manufacturing method, and related electronic device	US10431588	US15/947525	中芯上海	美国	发明	2018-04-06	2019-10-01	原始取得	无
1499	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10410920	US15/958555	中芯上海	美国	发明	2018-04-20	2019-09-10	原始取得	无
1500	Method of manufacturing a vertical inductor	US10319518	US15/963033	中芯上海	美国	发明	2018-04-25	2019-06-11	原始取得	无
1501	Method and device to reduce finfet sram contact resistance	US10332891	US15/967471	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-04-30	2019-06-25	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1502	Calibrating apparatus and method	US10187964	US15/967852	中芯上海	美国	发明	2018-05-01	2019-01-22	原始取得	无
1503	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10411118	US15/970565	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-03	2019-09-10	原始取得	无
1504	Semiconductor devices and fabrication methods thereof	US10431498	US15/971002	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-04	2019-10-01	原始取得	无
1505	Finfet device and fabrication method thereof	US10453962	US15/971144	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-04	2019-10-22	原始取得	无
1506	Semiconductor device and manufacturing method therefor	US10418454	US15/973711	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-08	2019-09-17	原始取得	无
1507	Method for manufacturing semiconductor device	US10381464	US15/973978	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-05-08	2019-08-13	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京						
1508	Manufacturing method of a resistance device having a fin	US10522613	US15/974136	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-08	2019-12-31	原始取得	无
1509	Vertical tunneling field effect transistor device and fabrication method thereof	US10446660	US15/974426	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-08	2019-10-15	原始取得	无
1510	Dc-dc conversion circuit system and forming method thereof	US10211738	US15/976090	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-10	2019-02-19	原始取得	无
1511	Semiconductor device and manufacture thereof	US10410986	US15/980033	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-15	2019-09-10	原始取得	无
1512	Electro-static discharge transistor array apparatus	US10396066	US15/980081	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-15	2019-08-27	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1513	Power supply circuit, power supply circuit generation method, and power supply circuit control method	US10429873	US15/980107	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-15	2019-10-01	原始取得	无
1514	Static random-access memory (sram) and manufacture thereof	US10490561	US15/981505	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-16	2019-11-26	原始取得	无
1515	Fan-out structure and manufacture thereof	US10446511	US15/981522	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-16	2019-10-15	原始取得	无
1516	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10475928	US15/985191	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-21	2019-11-12	原始取得	无
1517	Semiconductor chip, and fabrication and packaging methods thereof	US10522479	US15/985272	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-21	2019-12-31	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1518	Semiconductor devices and fabrication methods thereof	US10388575	US15/985278	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-21	2019-08-20	原始取得	无
1519	Finfet device	US10347629	US15/991332	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-29	2019-07-09	原始取得	无
1520	Semiconductor devices and fabrication methods thereof	US10403549	US15/993974	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-31	2019-09-03	原始取得	无
1521	Semiconductor device and manufacture thereof	US10453968	US15/994520	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-05-31	2019-10-22	原始取得	无
1522	Semiconductor device providing improved read and write margin, and manufacturing method for the same	US10490652	US15/995265	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-01	2019-11-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1523	Method of improving surface smoothness of dummy gate	US10312163	US15/995283	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-01	2019-06-04	原始取得	无
1524	Semiconductor device and fabrication method thereof	US10297509	US16/005307	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-11	2019-05-21	原始取得	无
1525	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10497614	US16/006053	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-12	2019-12-03	原始取得	无
1526	Method for fabricating power semiconductor device	US10490629	US16/019090	中芯上海	美国	发明	2018-06-26	2019-11-26	原始取得	无
1527	Cmos image sensor	US10340304	US16/019281	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-26	2019-07-02	原始取得	无
1528	Metal gate transistor	US10192828	US16/019888	中芯上	美国	发明	2018-06-27	2019-01-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				海、中芯北京						
1529	Power supply circuit and a method of controlling the same	US10386881	US16/021746	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-28	2019-08-20	原始取得	无
1530	Method for manufacturing semiconductor device	US10395927	US16/023200	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-06-29	2019-08-27	原始取得	无
1531	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10522632	US16/025724	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-02	2019-12-31	原始取得	无
1532	Static random access memory and fabrication method thereof	US10297603	US16/032838	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-11	2019-05-21	原始取得	无
1533	Tunnel field-effect transistor and fabrication	US10475884	US16/036693	中芯上海、中芯	美国	发明	2018-07-16	2019-11-12	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	method thereof			北京						
1534	Semiconductor structure, manufacturing method therefor, and high-k metal gate fin field-effect transistor	US10522684	US16/039085	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-18	2019-12-31	原始取得	无
1535	High voltage level shifting (hvls) circuit and related semiconductor devices	US10382040	US16/041640	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-20	2019-08-13	原始取得	无
1536	Semiconductor structure and fabrication method thereof	US10453921	US16/043040	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-23	2019-10-22	原始取得	无
1537	Method for manufacturing semiconductor apparatus	US10381398	US16/050580	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-07-31	2019-08-13	原始取得	无
1538	Memory cell, memory cell	US10460803	US16/057316	中芯上	美国	发明	2018-08-07	2019-10-29	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	array, memory device and operation method of memory cell array			海、中芯北京						
1539	Eeprom device	US10483269	US16/103725	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-08-14	2019-11-19	原始取得	无
1540	Semiconductor device and method for manufacturing the same	US10522685	US16/106625	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-08-21	2019-12-31	原始取得	无
1541	Semiconductor structures and fabrication methods thereof	US10446463	US16/115151	中芯上海、中芯新技术	美国	发明	2018-08-28	2019-10-15	原始取得	无
1542	Electrostatic discharge protection structure and fabrication method thereof	US10446538	US16/136671	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-09-20	2019-10-15	原始取得	无
1543	Method for manufacturing	US10490361	US16/179456	中芯上	美国	发明	2018-11-02	2019-11-26	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	ultra-capacity battery			海、中芯北京						
1544	Semiconductor structure with barrier layers	US10418461	US16/218748	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-12-13	2019-09-17	原始取得	无
1545	Static random-access memory (sram) devices	US10446450	US16/225346	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-12-19	2019-10-15	原始取得	无
1546	Semiconductor structure	US10411023	US16/236787	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2018-12-31	2019-09-10	原始取得	无
1547	Flash memory device and manufacture thereof	US10483283	US16/379422	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2019-04-09	2019-11-19	原始取得	无
1548	Semiconductor device having a surface insulating	US10497791	US16/392107	中芯上海、中芯	美国	发明	2019-04-23	2019-12-03	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	layter and manufacturing method therefor			北京						
1549	Semiconductor structure	US10510548	US16/422006	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2019-05-24	2019-12-17	原始取得	无
1550	Semiconductor structure	US10522463	US16/422655	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2019-05-24	2019-12-31	原始取得	无
1551	Method for processing a photomask for semiconductor devices	US8268086	US10/927821	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2004-08-27	2012-09-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1552	Method and system for metal barrier and seed integration	US8309456	US11/249141	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2005-10-11	2012-11-13	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1553	System and method for i/o esd protection with floating	US8686507	US11/517546	中芯上海、中芯	美国	发明	2006-09-06	2014-04-01	中芯上海：原始取得；中芯北京：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	and/or biased polysilicon regions			北京					受取得	
1554	Method and structure for electrostatic discharge protection of photomasks	US7612980	US11/552142	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2006-10-23	2009-11-03	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1555	Cmos image sensor	US8304821	US11/615969	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2006-12-23	2012-11-06	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1556	System and method for direct etching	US7534711	US11/615972	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2006-12-23	2009-05-19	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1557	Reliability test structure for multilevel interconnect	US8323990	US11/728184	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2007-03-22	2012-12-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1558	Method and structure for copper gap fill plating of	US8242017	US12/044254	中芯上海、中芯	美国	发明	2008-03-07	2012-08-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	interconnect structures for semiconductor integrated circuits			北京					受取得	
1559	Atomic layer deposition method and semiconductor device formed by the same	US8273639	US12/132459	中芯北京	美国	发明	2008-06-03	2012-09-25	继受取得	无
1560	Method of eliminating micro-trenches during spacer etch	US8187950	US12/258366	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-24	2012-05-29	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1561	Method for forming p-type lightly doped drain region using germanium pre-amorphous treatment	US8318571	US12/258375	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-24	2012-11-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1562	Word line booster for flash memory device	US8259507	US12/259040	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-27	2012-09-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1563	Method of interconnect for image sensor	US8247258	US12/259172	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2008-10-27	2012-08-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1564	Semiconductor device with amorphous silicon monos memory cell structure and method for manufacturing thereof	US8143666	US12/576231	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-10-08	2012-03-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1565	Device under bonding pad using single metallization	US8373272	US12/582690	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-10-20	2013-02-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1566	System and method for test structure on a wafer	US8415663	US12/616749	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-11-11	2013-04-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1567	System and method for i/o esd protection with polysilicon regions	US8283726	US12/623363	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-11-20	2012-10-09	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	fabricated by processes for making core transistors									
1568	Method and structure for performing a chemical mechanical polishing process	US8105898	US12/647362	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-12-24	2012-01-31	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1569	System and method for metal-oxide-semiconductor field effect transistor	US8217471	US12/650494	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2009-12-30	2012-07-10	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1570	Method for manufacturing twin bit structure cell with al2o3/nano-crystalline si layer	US8114732	US12/704502	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-02-11	2012-02-14	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1571	Method and system for continuous line-type landing polysilicon contact (lpc) structures	US8318556	US12/704511	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-02-11	2012-11-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1572	Rapid thermal annealing method for a semiconductor device	US8249737	US12/708469	中芯北京	美国	发明	2010-02-18	2012-08-21	继受取得	无
1573	System and method for quality assurance for reticles used in manufacturing of integrated circuits	US8319959	US12/724276	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-03-15	2012-11-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1574	Method of flash memory design with differential cell for better endurance	US8320193	US12/794697	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-06-04	2012-11-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1575	Method of programming flash memory of the differential cell structures for better endurance	US8295096	US12/794698	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-06-04	2012-10-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1576	Method for dual energy implantation for	US8466050	US12/830241	中芯上海、中芯	美国	发明	2010-07-02	2013-06-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	ultra-shallow junction formation of mos devices			北京					受取得	
1577	Electrically programmable device with embedded eeprom and method for making thereof	US8354707	US12/833939	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-07-09	2013-01-15	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1578	Multilayer oxide on nitride on oxide structure and method for the manufacture of semiconductor devices	US8269311	US12/845651	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-07-28	2012-09-18	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1579	Method and system for cmos image sensing device	US9269625	US12/848229	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-08-02	2016-02-23	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1580	Green transistor for resistive random access memory and method of operating the same	US8208286	US12/861622	中芯北京	美国	发明	2010-08-23	2012-06-26	继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
1581	Method of rapid thermal treatment using high energy electromagnetic radiation of a semiconductor substrate for formation of epitaxial materials	US8309472	US12/869620	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-08-26	2012-11-13	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1582	Green transistor for nano-si ferro-electric ram and method of operating the same	US8264863	US12/869941	中芯北京	美国	发明	2010-08-27	2012-09-11	继受取得	无
1583	Via contact structures and methods for integrated circuits	US8329529	US12/885248	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-17	2012-12-11	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1584	Scalable flash eeprom memory cell with floating gate spacer wrapped by control gate and method of	US8119479	US12/887496	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-21	2012-02-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	manufacture									
1585	Apparatus and method for calibrating lithography process	US9293354	US12/891738	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-09-27	2016-03-22	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1586	Method and structure for top metal formation of liquid crystal on silicon devices	US8339553	US12/897617	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-10-04	2012-12-25	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1587	Method and system for manufacturing copper-based capacitor	US8395200	US12/950973	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-11-19	2013-03-12	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1588	Method for determining color using cmos image sensor	US8383444	US12/953410	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-11-23	2013-02-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1589	Method for forming a cmos image sensing pixel	US8404510	US12/953414	中芯上海、中芯	美国	发明	2010-11-23	2013-03-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
				北京					受取得	
1590	Integrated inductor	US8324692	US12/953426	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-11-23	2012-12-04	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1591	Array architecture for embedded flash memory devices	US8536637	US12/959279	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-02	2013-09-17	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1592	Method and resulting structure for deep trench polysilicon hard mask removal	US8247305	US12/960357	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-03	2012-08-21	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1593	Method and device for cmos image sensing with multiple gate oxide thicknesses	US8383445	US12/979258	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-27	2013-02-26	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无
1594	Anti-fuse based	US8350356	US12/979265	中芯上	美国	发明	2010-12-27	2013-01-08	中芯上海：原始取	无

序号	专利名称	专利号	申请号	专利权人	申请国家/地区	专利类型	申请日	公告日	取得方式[2]	他项权利
	programmable serial number generator			海、中芯北京					得；中芯北京：继受取得	
1595	System and method for input pin esd protection with floating and/or biased polysilicon regions	US8319286	US12/979306	中芯上海、中芯北京	美国	发明	2010-12-27	2012-11-27	中芯上海：原始取得；中芯北京：继受取得	无

附表二：主要商标权[1]

（一） 主要境内商标权

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	SMIC	中芯上海	9436366	9	2012-05-28 至 2022-05-27	原始取得	无
2	SMIC	中芯上海	9436365	40	2012-06-21 至 2022-06-20	原始取得	无
3	中芯	中芯上海	3933285	9	2009-06-28 至 2029-06-27	原始取得	无

[1] 本附表二系截至报告期末登记在发行人及其子公司名下的与其生产经营相关的主要商标权。

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
4	中芯	中芯上海	3933286	40	2006-10-14 至 2026-10-13	原始取得	无
5	中芯	中芯上海	8147343	9	2012-03-28 至 2022-03-27	原始取得	无
6	中芯	中芯上海	8249306	40	2011-08-07 至 2021-08-06	原始取得	无
7	中芯	中芯上海	8686359	41	2011-10-07 至 2021-10-06	原始取得	无
8	中芯国际	中芯上海	8147397	9	2012-03-28 至 2022-03-27	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
9	中芯国际	中芯上海	8157402	40	2011-05-07 至 2021-05-06	原始取得	无
10	中芯国际产学研联合实验室	中芯上海	8147409	9	2012-03-28 至 2022-03-27	原始取得	无
11	中芯国际产学研联合实验室	中芯上海	8249305	40	2011-08-07 至 2021-08-06	原始取得	无
12	SMIC	中芯上海	1797385	9	2002-06-28 至 2022-06-27	原始取得	无
13	SMIC	中芯上海	8157404	40	2011-05-07 至 2021-05-06	原始取得	无
14	SMIC United Labs	中芯上海	8157420	9	2011-04-07 至 2021-04-06	原始取得	无
15	SMIC United Labs	中芯上海	8249304	40	2011-08-07 至 2021-08-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
16	DDF Double Density Flash	中芯上海	5619861	9	2009-12-21 至 2029-12-20	原始取得	无
17	DDF Double Density Flash	中芯上海	5619863	42	2010-05-07 至 2030-05-06	原始取得	无
18	SMIC	中芯上海	8157421	9	2011-04-07 至 2021-04-06	原始取得	无
19	SMIC	中芯上海	3933287	9	2006-03-28 至 2026-03-27	原始取得	无
20	SMIC	中芯上海	3933288	40	2006-10-14 至 2026-10-13	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
21		中芯上海	14450375	9	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无
22		中芯上海	14450388	16	2015-06-14 至 2025-06-13	原始取得	无
23		中芯上海	14450408	35	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
24		中芯上海	14450431	38	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无
25		中芯上海	14450448	41	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无
26		中芯上海	14450494	42	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
27		中芯上海	14450508	45	2015-06-07 至 2025-06-06	原始取得	无
28		中芯上海	16643993	42	2016-06-14 至 2026-06-13	原始取得	无
29		中芯上海	16643657	16	2016-05-28 至 2026-05-27	原始取得	无
30		中芯上海	16643712	35	2016-06-14 至 2026-06-13	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
31	SPOCOLL	中芯上海	16643834	38	2016-06-21 至 2026-06-20	原始取得	无
32	SPOCOLL	中芯上海	16643920	41	2016-06-14 至 2026-06-13	原始取得	无
33	SPOCOLL	中芯上海	16645130	40	2016-07-14 至 2026-07-13	原始取得	无
34	SPOCOLL	中芯上海	18854067	9	2017-02-21 至 2027-02-20	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
35	SILTECH	中芯上海	10598491	9	2015-04-07 至 2025-04-06	原始取得	无
36		中芯长电	19039153	40	2017-12-21 至 2027-12-20	原始取得	无
37	SJSEMI	中芯长电	19039155	9	2017-06-14 至 2027-06-13	原始取得	无
38	SJSEMI	中芯长电	18942476	35	2017-02-28 至 2027-02-27	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
39	SJSEMI	中芯长电	18942891	16	2017-02-28 至 2027-02-27	原始取得	无
40	SuBuless	中芯长电	19058388	16	2017-03-21 至 2027-03-20	原始取得	无
41	SuBuless	中芯长电	19096773	9	2017-03-21 至 2027-03-20	原始取得	无
42	FoRCLeve	中芯长电	19058934	42	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
43	FoRCLeve	中芯长电	19058726	41	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
44	FoRCLeve	中芯长电	19058602	35	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
45	FoRCLeve	中芯长电	19058325	16	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
46	FoRCLeve	中芯长电	19096774	9	2017-03-21 至 2027-03-20	原始取得	无
47	SJSEMI	中芯长电	19039152	40	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
48	FinFO	中芯长电	25283607	40	2018-07-07 至 2028-07-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
49	SmartPoser	中芯长电	29859077	9	2019-01-28 至 2029-01-27	原始取得	无
50	SmartPoser	中芯长电	29848450	40	2019-01-28 至 2029-01-27	原始取得	无
51	SmartAiP	中芯长电	33315457A	9	2019-07-14 至 2029-07-13	原始取得	无
52	SuBuless	中芯长电	19096771	40	2017-03-21 至 2027-03-20	原始取得	无
53	SJSEMI	中芯长电	18942655	41	2017-02-28 至 2027-02-27	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
54	SJSEMI	中芯长电	18942730	42	2017-02-28 至 2027-02-27	原始取得	无
55	SuBuless	中芯长电	19058958	42	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
56	SuBuless	中芯长电	19058795	41	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无
57	FoRCLeve	中芯长电	19096772	40	2017-03-21 至 2027-03-20	原始取得	无
58	SuBuless	中芯长电	19058595	35	2017-03-07 至 2027-03-06	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
59	SJSEMI	中芯长电	18058124	9	2017-11-21 至 2027-11-20	原始取得	无

（二） 主要境外商标权

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	注册地区	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	SMIC	中芯上海	301867177	中国香港	9、40、42	2011-03-23 至 2021-03-22	原始取得	无
2	中芯	中芯上海	300167634	中国香港	9、40	2004-03-01 至 2024-02-28	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	注册地区	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
3	A. 中芯 B. 中芯 C. 中芯 D. 中芯	中芯上海	301431666	中国香港	42	2009-09-18 至 2029-09-17	原始取得	无
4	A. 中芯國際 B. 中芯国际	中芯上海	301431648	中国香港	9、40、42	2009-09-18 至 2029-09-17	原始取得	无
5	SMIC	中芯上海	301431675	中国香港	9、40、42	2009-09-18 至 2029-09-17	原始取得	无
6	SMIC	中芯上海	00172938	中国台湾	40	2002-11-16 至 2022-11-15	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	注册地区	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
	SMIC SMIC							
7	SMIC	中芯上海	4232214	美国	9、40、42	2012-10-30 至 2022-10-29	原始取得	无
8	SMIC	中芯上海	016008625	欧洲	9、39、40、42	2016-11-07 至 2026-11-07	原始取得	无
9	SMIC	中芯上海	302016000125950	意大利	9、40、42	2016-12-13 至 2026-12-13	原始取得	无

序号	注册商标图案	商标权人	注册号	注册地区	类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
10	SMIC	中芯上海	016008674	欧洲	9、39、40、42	2016-11-07 至 2026-11-07	原始取得	无
11	SMIC	中芯上海	302016000125969	意大利	9、40、42	2016-12-13 至 2026-12-13	原始取得	无

附表三：集成电路布图设计专有权

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
1	PLVDSTX_28_4_LVTTL_OV3	BS.145502759	中芯上海	2014-12-31	2015-03-27	原始取得	无
2	USB11	BS.145503054	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
3	DUP	BS.145503062	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
4	5VTOL	BS.145503070	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
5	Clamp	BS.145503089	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
6	OSCIO	BS.145503097	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
7	RFIO	BS.145503100	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
8	mipiUSBIO	BS.145503119	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
9	CARDIO	BS.145503127	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
10	STDIO	BS.145503135	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
11	S40NLLUHSSP_XDEC	BS.145503143	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
12	S40NLLUHSSP-YMUX4SA	BS.145503151	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
13	S40NLLUHSSP-YMUX8SA	BS.14550316X	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
14	S013EEHSROMP-YMUX32SA	BS.145503178	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
15	SCC40NLL_HDC40_STD	BS.145503186	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
16	SCC40NLL_HDC40_ECO	BS.145503194	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
17	SCC40NLL_HDC40_PMK1	BS.145503208	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
18	SCC40NLL_HDC40_PMK2	BS.145503216	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
19	SCC40NLL_HSC40_STD	BS.145503224	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
20	SCC40NLL_VHSC40_STD	BS.145503232	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
21	S40NLLEFUSE_PIPO256B	BS.145502740	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
22	S40NLLEFUSE_PIPO8KB	BS.145503011	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
23	S55NLLEFUSE1Kqual_F2	BS.14550302X	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
24	S40NLLAD2G_8MUX	BS.145503038	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
25	S40NLLEFUSE_PIPO256B_NSU&Clampcell	BS.145503046	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
26	S40NLL_POR11C	BS.145503003	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
27	S40NLL_POR33C	BS.145502996	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
28	S40NLL_VR3311_100mA_Capless_V0p1	BS.145502988	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
29	S40NLLDLL_ALD125	BS.14550297X	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
30	S40NLLDA3310BCDP_54_H	BS.145502961	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
31	S55NLLEFUSE_PIPO128B	BS.145502953	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无
32	S55NLLEFUSE_PIPO4K_R	BS.145502945	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
33	S55NLLEFUSE_PIPO4K4M	BS.145502937	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
34	S55NLLDA10B_200	BS.145502910	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
35	S55NLLEFUSE_PIPO4K_R_split	BS.145502929	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
36	S55NLLEFUSE_SISO96B5M	BS.145502902	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
37	S65NLLDA3310BCDP_54_H	BS.145502899	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
38	S65NLLDA3310B4C_300_H	BS.145502880	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
39	SP65NLLD2P_POR12C_3P3V_M7_MTT	BS.145502872	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
40	S013LXAD2J	BS.145502783	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
41	S013LXPLLGS_T500	BS.145502791	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
42	S013PLLGD_600M2	BS.145502805	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
43	S013EE_LDO5015_30mA_Capless	BS.145502813	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
44	S013EP_POR15C	BS.145502775	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
45	S153EFUSE_SISO256B_F2	BS.145502767	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
46	S40NLLPLLGS_ZP1500	BS.145502821	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
47	S011EFUSE_IP_QUAL	BS.14550283X	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
48	SP013D3RP_VR3325_EFUSE_E	BS.145502848	中芯上海	2014-12-31	2015-03-23	原始取得	无
49	S65NLLEFUSE_SISO96B5M	BS.145502856	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
50	S65NLLDA10B4CSC_200S	BS.145502864	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
51	S018EE16KB_LPI	BS.145502732	中芯上海	2014-12-31	2015-03-24	原始取得	无
52	S013EE16KB	BS.145502716	中芯上海	2014-12-31	2015-03-25	原始取得	无

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
53	S013EE10KX36_DV1215	BS.145502724	中芯上海	2014-12-31	2015-03-20	原始取得	无
54	STDIO	BS.155012576	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
55	PowerCut	BS.155012630	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
56	Schmitt-trigger	BS.155012681	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
57	ESDdiode	BS.155012509	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
58	SP40NLLD2P_MIPI	BS.155012436	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
59	28PLL	BS.155012495	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
60	SPC28NHKD18RNP_XTAL	BS.155012487	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
61	FCPAD	BS.155012479	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
62	ESDDiode	BS.155012525	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
63	SPC55NLLD2P_SUBLVDS_RX	BS.155012584	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
64	S95ULPHDSP_XDEC	BS.155012592	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
65	S95ULPHDSP_YMUX8SA	BS.155012606	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
66	SCC95HV_HS_STD cell template	BS.155012614	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
67	SCC95HV_UHD_STD cell template	BS.155012622	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
68	SCC95ULP_HS33_STD cell template	BS.15501255X	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
69	S011EFUSE_IP_QUAL	BS.155012673	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
70	S013CISEFUSE	BS.155012444	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
71	S013EFROSC_200M	BS.155012754	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
72	S018BCDEFUSE_IP_QUAL_S3	BS.155012770	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
73	S28NPSEFUSE_PIPO4KB	BS.155012789	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
74	S28NPSEFUSE_PIPO512B	BS.15501272X	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
75	S55NLLDA3310B_200	BS.155012711	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
76	S55NLLEFUSE_PIPO4KB_F2	BS.155012703	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
77	S65NLLEFUSE_PIPO4KB_F2	BS.155012746	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
78	S65NLLEFUSE_PIPO512B_F2	BS.155012541	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
79	S013EE4KBS	BS.155012762	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
80	S013EE12KX36_DV1215_V1P0_ECOB	BS.15501269X	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
81	S013EE20KX36_DV1215	BS.155012665	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
82	S013EE32KBS_PM	BS.155012533	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
83	S013EE64KB	BS.155012568	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
84	S018EE1KB_LPI_CTM	BS.155012517	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
85	S018EE6KB_LPI	BS.155012657	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
86	S018EE9KB_LPI	BS.155012460	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
87	S018EE20KX32S_V1P4_ECOC	BS.155012649	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无
88	S018EE64KB_SC	BS.155012452	中芯上海	2015-12-31	2016-03-24	原始取得	无

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日	取得方式	他项权利
89	S018EE512B_DV1833	BS.165520876	中芯上海	2016-12-26	2017-03-16	原始取得	无
90	S55NEF64KX32_L3	BS.165520884	中芯上海	2016-12-27	2017-03-13	原始取得	无
91	55NEF428KB	BS.165520892	中芯上海	2016-12-27	2017-03-16	原始取得	无
92	S55NEF512KX32_S0	BS.165520906	中芯上海	2016-12-27	2017-03-13	原始取得	无
93	S95HVMTP2KB	BS.165520914	中芯上海	2016-12-27	2017-03-16	原始取得	无
94	SCC013URS_VHS_RVT	BS.165520922	中芯上海	2016-12-27	2017-03-13	原始取得	无

附表四：发行人的其他子公司及参股公司

（一） 发行人的其他子公司

1、 中芯控股

截至报告期末，中芯控股持有上海市工商行政管理局于 2017 年 6 月 1 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯国际控股有限公司
注册资本	5,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	913100003221774669
法定代表人	赵海军
住所	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 1059 号 1 幢
成立日期	2015 年 07 月 28 日
经营期限	2015 年 07 月 28 日至 2065 年 07 月 27 日
经营范围	1.在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2.受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所提供企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；3.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；4.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；5.承接其母公司和关联公司的服务外包业务；6.集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；7、自有物业出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯控股的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	5,000.00	100.00
合计		**5,000.00**	**100.00**

2、 中芯集电

截至报告期末，中芯集电持有上海市工商行政管理局于 2018 年 6 月 15 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯集电投资（上海）有限公司
注册资本	46,580.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91310115754792112E
法定代表人	周子学
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号
成立日期	2003 年 09 月 30 日
经营期限	2003 年 09 月 30 日至 2023 年 09 月 29 日
经营范围	1.在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2.集成电路相关电子产品的研发、生产（由分支机构经营）；3.受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；4.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；5.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；6.承接其母公司和关联公司的服务外包业务；7.集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、

	许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯集电的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	46,580.00	100.00
合计		**46,580.00**	**100.00**

3、 中芯新技术

截至报告期末，中芯新技术现持有上海市市场监督管理局于 2019 年 11 月 11 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司
注册资本	40,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外商合资）
统一社会信用代码	9131000031057582XG
法定代表人	高永岗
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 3 号楼 6 楼
成立日期	2014 年 10 月 28 日
经营期限	2014 年 10 月 28 日至 2044 年 10 月 27 日
经营范围	集成电路的制造、技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让、销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯新技术的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯控股	30,100.00	75.25
2	中芯集电	9,900.00	24.75
合计		**40,000.00**	**100.00**

4、 成都开发

截至报告期末，成都开发持有成都高新技术产业开发区市场监督管理局于 2019 年 11 月 26 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯国际开发管理（成都）有限公司
注册资本	500.00 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	915101007801211363
法定代表人	姜镭
住所	四川省成都高新区桂溪工业园
成立日期	2005 年 12 月 29 日
经营期限	2005 年 12 月 29 日至 2055 年 12 月 28 日
经营范围	中芯国际配套项目设施（宿舍、学校、超市等）的建设、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，成都开发的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	500.00	100.00
合计		**500.00**	**100.00**

5、 芯电上海

截至报告期末，芯电上海持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2017 年 6 月 29 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	芯电半导体（上海）有限公司
注册资本	1,200.00 万美元
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
统一社会信用代码	913101156840682323
法定代表人	ZHAO HAIJUN（赵海军）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼－1

成立日期	2009 年 03 月 03 日
经营期限	2009 年 03 月 03 日至 2059 年 03 月 02 日
经营范围	半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，芯电上海的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	SilTech HK	1,200.00	100.00
合计		**1,200.00**	**100.00**

6、 中芯晶圆

截至报告期末，中芯晶圆持有上海市工商行政管理局于 2018 年 11 月 26 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯晶圆股权投资（上海）有限公司
注册资本	145,800.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91310000087838761E
法定代表人	高永岗
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢 2 层 227 室
成立日期	2014 年 02 月 27 日
经营期限	2014 年 02 月 27 日至 2029 年 02 月 26 日
经营范围	股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯晶圆的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
1	中芯上海	145,800.00	100.00
合计		**145,800.00**	**100.00**

7、 中芯晶圆宁波

截至报告期末，中芯晶圆宁波持有宁波市北仑区市场监督管理局于 2019 年 1 月 2 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司
注册资本	120,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91330206MA2AHAE84E
法定代表人	高永岗
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0652
成立日期	2018 年 02 月 28 日
经营期限	2018 年 02 月 28 日至 2033 年 02 月 27 日
经营范围	股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯晶圆宁波的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
1	中芯晶圆	120,000.00	100.00
合计		**120,000.00**	**100.00**

8、 中芯长电

截至报告期末，中芯长电持有江阴市市场监督管理局于 2015 年 11 月 12 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯长电半导体（江阴）有限公司
注册资本	39,950.00 万美元
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
统一社会信用代码	91320281321666575D
法定代表人	崔东

住所	江阴市长山大道 78 号
成立日期	2014 年 11 月 25 日
经营期限	2014 年 11 月 25 日至 2034 年 11 月 24 日
经营范围	集成电路设计，线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS 和化合物半导体集成电路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，中芯长电的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例(%)
1	SJ HK	39,950.00	100.00
合计		**39,950.00**	**100.00**

9、 上海合芯

截至报告期末，上海合芯持有上海市虹口区市场监督管理局于 2018 年 7 月 27 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海合芯投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310109312231932K
执行事务合伙人	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（委派代表：孙玉望）
住所	上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号（集中登记地）
成立日期	2014 年 08 月 01 日
经营期限	2014 年 08 月 01 日至 2064 年 07 月 31 日
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，上海合芯的出资情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	中芯晶圆宁波	4,950.00	99.00
2	中芯聚源	50.00	1.00

合计	**5,000.00**	**100.00**

10、 北京创新

截至报告期末，北京创新持有北京市工商行政管理局经济技术开发区分局于2019 年 12 月 24 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司
注册资本	15,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91110302MA017TPY2A
法定代表人	张昕
住所	北京市北京经济技术开发区文昌大道 18 号 9 幢一层
成立日期	2017 年 09 月 25 日
经营期限	2019 年 12 月 24 日至 2039 年 12 月 23 日
经营范围	与集成电路、半导体技术有关的开发、设计服务、技术服务、技术转让、技术咨询；半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；销售自产产品。（该企业 2019 年 12 月 24 日前为内资企业，于 2019 年 12 月 24 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，北京创新的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
1	中芯控股	9,900.00	66.00
2	北京亦庄国际投资发展有限公司	5,000.00	33.33
3	中芯北方	100.00	0.67
合计		**15,000.00**	**100.00**

11、 宁波设计

截至报告期末，宁波设计持有宁波市鄞州区市场监督管理局于 2019 年 7 月 1 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯国际创新设计服务中心（宁波）有限公司[1]
注册资本	2,000.00 万元人民币
公司类型	一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91330212MA2AETTY8P
法定代表人	高永岗
住所	浙江省宁波市鄞州区学士路 642 弄 2 号卓悦大厦 3、4、5 楼
成立日期	2017 年 10 月 13 日
经营期限	2017 年 10 月 13 日至 2067 年 10 月 12 日
经营范围	集成电路及微电子系统相关软、硬件的技术研发、设计、测试、技术咨询、技术转让、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，宁波设计的股权结构如下表所示：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**股权比例(%)**
1	中芯上海	2,000.00	100.00
合计		**2,000.00**	**100.00**

12、 SMIC Japan

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC Japan 的基本情况如下：

公司名称	SMIC Japan Company limited
注册地	日本
注册号	0100-01-136671
法定股本	10,000,000.00 日元
成立日期	2002 年 10 月 08 日
住所	东京都港区港南二丁目 16 番 4 号

[1] 2020 年 3 月，中芯上海将其所持宁波设计全部股权转让给芯创智（北京）微电子有限公司，宁波设计名称变更为“芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司”。

根据 Shinohara Legal/Immigration Service 出具的法律意见书，截至报告期末，SMIC Japan 的股权结构如下：

序号	股东名称	法定股本（日元）	股权比例(%)
1	中芯国际	10,000,000.00	100.00
合计		**10,000,000.00**	**100.00**

13、 SMIC Americas

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC Americas 的基本信息如下：

公司名称	SMIC, Americas
注册地	美国
注册号	C2246481
法定股本	500,000.00 美元
成立日期	2001 年 06 月 22 日
住所	1732 N 1st Street, Suite 200, San Jose, CA 95112

根据 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 出具的报告，截至报告期末，SMIC Americas 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	500,000.00	100.00
合计		**500,000.00**	**100.00**

14、 Better Way

根据发行人提供的资料，截至报告期末，Better Way 的基本情况如下：

公司名称	Better Way Enterprises Limited
注册地	萨摩亚
注册号	6481
法定股本	1,000,000.00 美元
成立日期	2000 年 04 月 05 日
住所	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Matafele, Apia, Samoa (P.O. Box 217, Apia, Samoa)

根据 Clarke EY Koria Lawyers 出具的法律意见书，截至报告期末，Better Way 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	1,000,000.00	100.00
合计		**1,000,000.00**	**100.00**

15、 Magnificent

根据发行人提供的资料，截至报告期末，Magnificent 基本信息如下：

公司名称	Magnificent Tower Limited
注册地	BVI
注册号	1003599
法定股本	50,000.00 美元
成立日期	2006 年 01 月 05 日
住所	Conyers Trust Company (BVI) Limited, Commerce House, Wickhams CAY 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

根据 Conyers Dill & Pearman 出具的法律意见书，截至报告期末，Magnificent 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	Better Way	50,000.00	**100.00**
合计		**50,000.00**	**100.00**

16、 SMIC Europe

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC Europe 的基本情况如下：

公司名称	SMIC Europe S.r.l
注册地	意大利
注册号	Milano 2112053
法定股本	100,000.00 欧元
成立日期	2003 年 07 月 03 日
住所	MILANO(MI) VIALE FRANCESCO RESTELLI 3 CAP 20124

根据 Allen & Overy – Studio Legale Associato 出具的报告，截至报告期末，SMIC Europe 的股权结构如下：

序号	股东名称	法定股本（欧元）	股权比例(%)
1	中芯国际	100,000.00	100.00
合计		**100,000.00**	**100.00**

17、 Solar Cell

根据发行人提供的资料，截至报告期末，Solar Cell 基本信息如下：

公司名称	Semiconductor Manufacturing International (Solar Cell) Corporation
注册地	Cayman
注册号	151181
法定股本	11,000.00 美元
成立日期	2005 年 06 月 30 日
住所	PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

根据发行人提供的资料，截至报告期末，Solar Cell 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	11,000.00	100.00
合计		**11,000.00**	**100.00**

18、 Solar Cell HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末， Solar Cell HK 基本信息如下：

公司名称	SMIC Solar Cell (HK) Company Limited（中芯国际太阳能光伏〔香港〕有限公司）[1]
注册地	香港
注册号	1177680
法定股本	10,000.00 港元
成立日期	2007 年 10 月 23 日
住所	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong

根据发行人提供的资料，截至报告期末，Solar Cell HK 股权结构如下表所示：

[1] 该公司已于 2020 年 1 月 17 日注销。

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	Solar Cell	10,000.00	100.00
合计		**10,000.00**	**100.00**

19、 SH Cayman

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SH Cayman 基本信息如下：

公司名称	SMIC Shanghai (Cayman) Corporation
注册地	开曼群岛
注册号	198722
法定股本	50,000.00 美元
成立日期	2007 年 11 月 08 日
住所	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

根据 Conyers Dill & Pearman 出具的法律意见书，截至报告期末，SH Cayman 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	50,000.00	100.00
合计		**50,000.00**	**100.00**

20、 BJ Cayman

根据发行人提供的资料，截至报告期末，BJ Cayman 基本信息如下：

公司名称	SMIC Beijing (Cayman) Corporation
注册地	开曼群岛
注册号	198720
法定股本	50,000.00 美元
成立日期	2007 年 11 月 08 日
住所	PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

根据发行人提供的资料，截至报告期末，BJ Cayman 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	50,000.00	100.00

合计	**50,000.00**	**100.00**

21、 BJ HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末，BJ HK 基本信息如下：

公司名称	SMIC Beijing (HK) Company Limited（中芯国际北京〔香港〕有限公司）[1]
注册地	香港
注册号	1181320
法定股本	1,000.00 港元
成立日期	2007 年 11 月 02 日
住所	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong

根据发行人提供的资料，截至报告期末，BJ HK 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	BJ Cayman	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

22、 TJ Cayman

根据发行人提供的资料，截至报告期末，TJ Cayman 基本信息如下：

公司名称	SMIC Tianjin (Cayman) Corporation
注册地	开曼群岛
注册号	198710
法定股本	50,000.00 美元
成立日期	2007 年 11 月 08 日
住所	PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

根据发行人提供的资料，截至报告期末，TJ Cayman 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	50,000.00	100.00
合计		**50,000.00**	**100.00**

[1] 该公司已于 2020 年 1 月 17 日注销。

23、 TJ HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末，TJ HK 基本信息如下：

公司名称	SMIC Tianjin (HK) Company Limited（中芯国际天津〔香港〕有限公司）[1]
注册地	香港
注册号	1181334
法定股本	1,000.00 港元
成立日期	2007 年 11 月 02 日
住所	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong

经本所律师查验，截至报告期末，TJ HK 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	TJ Cayman	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

24、 SMIC BVI

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC BVI 的基本情况如下：

公司名称	Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation
注册地	BVI
注册号	1400826
法定股本	10.00 美元
成立日期	2007 年 04 月 26 日
住所	Conyers Trust Company (BVI) Limited, Commerce House, Wickhams CAY 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

根据 Conyers Dill & Pearman 出具的法律意见书，截至报告期末，SMIC BVI 的股权结构如下：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	10.00	100.00
合计		**10.00**	**100.00**

[1] 该公司已于 2020 年 1 月 17 日注销。

25、 SZ Cayman

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SZ Cayman 的基本信息如下：

公司名称	SMIC Shenzhen (Cayman) Corporation
注册地	开曼群岛
注册号	203473
法定股本	50,000.00 美元
设立日期	2008 年 01 月 21 日
注册经营地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SZ Cayman 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	50,000.00	100.00
合计		**50,000.00**	**100.00**

26、 SZ HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC SZ(HK)的基本信息如下：

公司名称	SMIC Shenzhen (HK) Company Limited（中芯国际深圳〔香港〕有限公司）[1]
注册地	香港
注册号	1207964
法定股本	1,000.00 港元
设立日期	2008 年 01 月 29 日
注册经营地址	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SMIC SZ(HK)股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	SZ Cayman	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

27、 SilTech Cayman

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SilTech Cayman 的基本信息如下：

[1] 该公司已于 2020 年 1 月 17 日注销。

公司名称	SilTech Semiconductor Corporation
注册地	开曼群岛
注册号	204815
法定股本	10,000.00 美元
设立日期	2008 年 02 月 13 日
注册经营地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SilTech Cayman 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	中芯国际	10,000.00	100.00
合计		**10,000.00**	**100.00**

28、 SilTech HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SilTech HK 的基本信息如下：

公司名称	SilTech Semiconductor (Hong Kong) Corporation Limited（芯电半导体〔香港〕有限公司）
注册地	香港
注册号	1219618
法定股本	1,000.00 港元
设立日期	2008 年 03 月 20 日
注册经营地址	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SilTech HK 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	SilTech Cayman	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

29、 SJ CA

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SJ CA 基本信息如下：

公司名称	SJ Semiconductor Corporation
注册地	开曼群岛

注册号	290967
法定股本	15,000.00 美元
设立日期	2014 年 08 月 19 日
注册经营地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

根据 Conyers Dill & Pearman 出具的法律意见书，截至报告期末，SJ CA 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股权类型	持股数
1	中芯国际	普通股	1
		优先 A 股	51,000,000
		优先 B 股	266,666,666
2	Xun Xin (Shanghai) Investment Co. Ltd.	优先 B 股	166,666,666
3	Changjiang Electronics International (Hong Kong) Trading & Investing Limited	优先 A 股	49,000,000
4	Qualcomm Global Trading Pte.Ltd.	优先 B 股	33,333,332
5	Jeff Foo Seek Yann	普通股	137,500
合计			**566,804,165**

根据发行人的确认，截至报告期末，因 SJ CA 对其员工进行股权激励，发行人实际持有 SJ CA 55.97%股份权益。

30、 SJ HK

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SJ HK 基本信息如下：

公司名称	SJ Semiconductor (HK) Limited（中芯长电半导体〔香港〕有限公司）
注册地	香港
注册号	2140216
法定股本	1,000.00 港元
设立日期	2014 年 09 月 02 日
注册经营地址	Suite 3003 30/F 9 Queen's Road Central, HK

根据 Slaughter and May 出具的法律意见书，截至报告期末，SJ HK 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（港元）	股权比例(%)
1	SJ CA	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

31、 SJ USA

根据发行人提供的资料，截至报告期末，SJ USA 基本信息如下：

公司名称	SJ Semiconductor (USA) Co.
注册地	美国
注册号	C3892839
法定股本	2,000,000.00 美元
设立日期	2016 年 04 月 04 日
注册经营地址	1732 N. FIRST STREET, SUITE 200, SAN JOSE, CA 95112

根据发行人于香港联交所的公告文件，截至报告期末，SJ US 股权结构如下表所示：

序号	股东名称	法定股本（美元）	股权比例(%)
1	SJ CA	2,000,000.00	100.00
合计		**2,000,000.00**	**100.00**

（二） 发行人参股公司

1、 长电科技

截至报告期末，长电科技持有无锡市行政审批局于 2019 年 9 月 25 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	江苏长电科技股份有限公司
注册资本	160,287.4555 万元人民币
公司类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91320200142248781B
法定代表人	郑力

住所	江阴市澄江镇长山路 78 号
成立日期	1998 年 11 月 06 日
经营期限	1998 年 11 月 06 日至--
经营范围	研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	芯电上海持股 14.28%

2、 中芯宁波

截至报告期末，中芯宁波持有宁波市北仑区市场监督管理局于 2019 年 5 月 21 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯集成电路（宁波）有限公司
注册资本	182,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91330206MA282QRM1W
法定代表人	黄河
住所	浙江省宁波市北仑区小港街道安居路 335 号 3 幢、4 幢、5 幢
成立日期	2016 年 10 月 14 日
经营期限	2016 年 10 月 14 日至 2046 年 10 月 13 日
经营范围	半导体集成电路芯片、集成电路相关产品、光掩膜的开发、设计、测试、技术服务、销售及制造；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯控股持股 38.57%

3、 中芯绍兴

截至报告期末，中芯绍兴持有绍兴市越城区市场监督管理局于 2019 年 11 月 15 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
注册资本	588,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91330600MA2BDY6H13
法定代表人	赵奇
住所	浙江省绍兴市越城区皋埠镇临江路 518 号
成立日期	2018 年 03 月 09 日
经营期限	2018 年 03 月 09 日至 2068 年 03 月 15 日
经营范围	半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯控股持股 23.47%

4、 芯鑫租赁

截至报告期末，芯鑫租赁持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 6 月 6 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	芯鑫融资租赁有限责任公司
注册资本	1,064,994 万元人民币
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	9131011535067083X5
法定代表人	杜洋
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室
成立日期	2015 年 08 月 27 日
经营期限	2015 年 08 月 27 日至 2045 年 08 月 26 日
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

持股情况	中芯国际持股 7.44%

5、 凸版彩晶

截至报告期末，凸版彩晶持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2019 年 10 月 25 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司
注册资本	6,400 万美元
公司类型	有限责任公司（外商合资）
统一社会信用代码	913101157683915471
法定代表人	植木哲朗
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼
成立日期	2004 年 11 月 24 日
经营期限	2004 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日
经营范围	成像传感器的设计；设计、生产、加工晶圆彩膜 / 微型镜头及其相关产品，加工晶圆片，组装模件，销售公司自产产品；上述同类产品的批发和进出口，并提供相关技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯国际持股 30.00%

6、 华芯创投

截至报告期末，华芯创投持有上海市市场监督管理局于 2019 年 4 月 24 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	上海华芯创业投资企业
公司类型	中外合作企业
统一社会信用代码	91310000570811198E
法定代表人	LIP-BU TAN
住所	上海市杨浦区国定支路 28 号 3003 室
成立日期	2011 年 03 月 31 日
经营期限	2011 年 03 月 31 日至 2020 年 03 月 20 日[1]

[1] 经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，经营期限于 2020 年 4 月 7 日变更为“2011 年 3 月 31 日至

经营范围	以自有资金依法从事创业投资；提供创业投资咨询；向被投资企业提供创业管理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营。）
持股情况	中芯国际持股 1.27%

7、 灿芯半导体

截至报告期末，灿芯半导体持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2019 年 12 月 30 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	灿芯半导体（上海）有限公司
注册资本	536.4390 万美元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91310115677813273L
法定代表人	ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 6 楼
成立日期	2008 年 07 月 17 日
经营期限	2008 年 07 月 17 日至 2028 年 07 月 16 日
经营范围	集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发佣金代理（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯控股持股 34.75%

8、 盛吉盛

截至报告期末，盛吉盛持有宁波市鄞州区市场监督管理局于 2019 年 10 月 9 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司
注册资本	2,200.00 万美元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91330200MA2AHN2244
法定代表人	项习飞

2020 年 3 月 30 日”。

住所	浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村
成立日期	2018 年 03 月 22 日
经营期限	2018 年 03 月 22 日至 2068 年 03 月 21 日
经营范围	二手半导体设备及配件的翻新、改造、安装、维护、销售；半导体设备的研发、生产、销售；半导体生产及研发设备的技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；半导体相关的功能材料、器件、配件及相关产品的技术开发、生产、销售和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯控股持股 27.27%

9、 上海创新

截至报告期末，上海创新持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 5 月 10 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	上海集成电路制造创新中心有限公司
注册资本	15,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91310115MA1K40GC95
法定代表人	桂永浩
住所	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 401-23 室
成立日期	2018 年 01 月 16 日
经营期限	2018 年 01 月 16 日至不约定期限
经营范围	集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路的设计、研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯上海持股 33.33%

10、 中芯协成

截至报告期末，中芯协成持有北京市工商行政管理局密云分局于 2017 年 3 月 29 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯协成投资（北京）有限责任公司
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110228592355189F
法定代表人	单小海
住所	北京市密云区溪翁庄镇环湖路 66 号镇政府 1 号楼 110 室-383
成立日期	2012 年 01 月 09 日
经营期限	2012 年 01 月 09 日至 2042 年 01 月 08 日
经营范围	投资管理、资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况	中芯上海持股 49.00%

11、 上海新储

截至报告期末，上海新储持有上海市工商行政管理局于 2016 年 11 月 1 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	上海新储集成电路有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91310000682206013P
法定代表人	封松林
住所	上海市金山区亭卫公路 6505 号 2 幢 8 号
成立日期	2008 年 12 月 04 日
经营期限	2008 年 12 月 04 日至 2028 年 12 月 03 日
经营范围	相变存储器的技术研发，相变存储器及相关产品的生产加工（委托加工），销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

持股情况	中芯上海持股 19.00%

12、 中芯聚源

截至报告期末，中芯聚源持有上海市工商行政管理局于 2018 年 12 月 20 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

公司名称	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司
注册资本	3,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000087837486P
法定代表人	高永岗
住所	上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 337 室
成立日期	2014 年 02 月 27 日
经营期限	2014 年 02 月 27 日至 2044 年 02 月 26 日
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯上海持股 19.51%

13、 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）

截至报告期末，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）持有上海市工商行政管理局于 2017 年 5 月 12 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FL2G39Y
执行事务合伙人	上海肇芯投资管理中心（有限合伙）（委派代表：孙玉望）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 17 幢 101 室 201 号
成立日期	2016 年 06 月 27 日
经营期限	2016 年 06 月 27 日至 2024 年 06 月 26 日
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆持有 31.63%财产份额

14、 北京吾金创业投资中心（有限合伙）

截至报告期末，北京吾金创业投资中心持有北京市工商行政管理局昌平分局于 2018 年 8 月 13 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	北京吾金创业投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110114318103480R
执行事务合伙人	北京金吾兴业投资管理有限公司（委派何浩为代表）
住所	北京市昌平区生命园路 29 号 A 座 301-1
成立日期	2014 年 10 月 27 日
经营期限	2014 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日
经营范围	投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆宁波持有 32.61%财产份额

15、 上海聚源载兴投资中心（有限合伙）

截至报告期末，上海聚源载兴投资中心（有限合伙）持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2019 年 8 月 19 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310115350747163X
执行事务合伙人	宁波聚源立诚投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙玉望）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期	2015 年 08 月 25 日
经营期限	2015 年 08 月 25 日至 2022 年 08 月 24 日
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆宁波持有 66.23%财产份额

16、 上海诚芯投资中心（有限合伙）

截至报告期末，上海诚芯投资中心(有限合伙)持有中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 9 月 7 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海诚芯投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310115312208652M
执行事务合伙人	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（委派代表：孙玉望）
住所	中国（上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期	2014 年 08 月 05 日
经营期限	2014 年 08 月 05 日至 2021 年 08 月 04 日
经营范围	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除经纪)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆宁波持有 31.50%财产份额

17、 上海信芯投资中心（有限合伙）

截至报告期末，上海信芯投资中心（有限合伙）持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 6 月 20 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海信芯投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913101153122377606
执行事务合伙人	中芯聚源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙玉望）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期	2014 年 08 月 05 日
经营期限	2014 年 08 月 05 日至 2044 年 08 月 04 日
经营范围	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆宁波持有 49.00%财产份额

18、 上海聚源启泰投资中心（有限合伙）

截至报告期末，上海聚源启泰投资中心（有限合伙）持有中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2018 年 9 月 21 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海聚源启泰投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	9131011532470977XK
执行事务合伙人	中芯聚源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙玉望）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期	2015 年 02 月 05 日
经营期限	2015 年 02 月 05 日至 2022 年 02 月 04 日
经营范围	实业投资；投资管理；资产管理；投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股情况	中芯晶圆宁波持有 33.00%财产份额

19、 苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）

截至报告期末，苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）持有苏州市吴江区市场监督管理局于 2019 年 6 月 12 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320500346175158R
执行事务合伙人	苏州聚源利泽投资中心（有限合伙）（委派代表：孙玉望）
住所	苏州市吴江区松陵镇开发区云梨路北侧
成立日期	2015 年 07 月 07 日
经营期限	2015 年 07 月 07 日至 2022 年 07 月 06 日
经营范围	对外投资以及相关的投资管理、投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯晶圆宁波持有 44.83%财产份额

20、 盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有深圳市市场监督管理局于 2019 年 11 月 18 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5F47LD0P
执行事务合伙人	尧芯（深圳）商务信息咨询有限公司（委派代表：刘廷儒）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期	2018 年 05 月 07 日
经营期限	2018 年 05 月 07 日至 2025 年 01 月 01 日
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
持股情况	中芯晶圆宁波持有 10.21%财产份额

21、 中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）

截至报告期末，中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）持有天津市西青区市场和质量监督管理局于 2018 年 3 月 27 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91120111MA06AUN56D
执行事务合伙人	天津熠芯投资管理中心（有限合伙）（委派代表：张小刚）
住所	天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 F1 座 512 室
成立日期	2018 年 03 月 27 日
经营期限	2018 年 03 月 27 日至 2027 年 03 月 26 日
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

	展经营活动）
持股情况	中芯晶圆宁波持有 9.05%财产份额

22、 无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）

截至报告期末，无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）持有无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局于 2018 年 6 月 15 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320214MA1WCXRQ83
执行事务合伙人	上海市临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
住所	无锡市新吴区震泽路 18-3 号无锡软件园二期射手座 2283 室
成立日期	2018 年 04 月 16 日
经营期限	2018 年 04 月 16 日至 2023 年 04 月 15 日
经营范围	实业投资、股权投资、创业投资，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯晶圆宁波持有 16.53%财产份额

23、 上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有上海市嘉定区市场监督管理局于 2018 年 9 月 25 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310114MA1GT59D9N
执行事务合伙人	上海上创新微投资管理有限公司（委派代表：秦曦）
住所	上海市嘉定区沪宜公路 3638 号 2 幢 J173 室
成立日期	2016 年 01 月 14 日
经营期限	2016 年 01 月 14 日至 2024 年 01 月 13 日
经营范围	创业投资，资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

持股情况	中芯晶圆宁波持有 3.61%财产份额

24、 青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）

截至报告期末，青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）持有青岛市黄岛区行政审批服务局于 2019 年 9 月 16 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370211MA3CD1P303
执行事务合伙人	青岛华芯博原创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：Hing Wong）
住所	山东省青岛市黄岛区井冈山路 658 号 2004 室
成立日期	2016 年 06 月 30 日
经营期限	2016 年 06 月 30 日至 2024 年 06 月 27 日
经营范围	以自有资金依法从事创业投资、提供创业投资咨询（以上经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；向被投资企业提供创业管理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	中芯晶圆持有 3.00%财产份额

25、 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）

截至报告期末，北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）持有北京市工商行政管理局海淀分局于 2016 年 11 月 15 日核发的《营业执照》，根据发行人提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，其基本信息如下：

名称	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	9111010831792288XB
执行事务合伙人	北京清芯华创投资管理有限公司（委派刘越为代表）
住所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1502 室
成立日期	2014 年 09 月 25 日
经营期限	2014 年 09 月 25 日至 2022 年 09 月 24 日

经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况	中芯晶圆持有 8.92%财产份额[1]

26、 CFT Nordic

根据发行人提供的资料，截至报告期末，CFT Nordic 的基本信息如下：

公司名称	CFT Nordic Investment Center Limited
注册地	香港
注册号	2436478
法定股本	204.00 万欧元
设立日期	2016 年 10 月 07 日
注册经营地址	2202,22/F Chinachem Tower 34-37 Connaught RD Central HK
发行人持股情况	TJ Cayman 持股 49.00%

[1] 根据发行人提供的《北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（2019 年签署），持股情况变更为中芯晶圆宁波持有 8.92%的财产份额，截至报告期末，尚未办理工商登记变更手续。2020 年 1 月 22 日，该次变更办理完毕工商登记手续。